

康迈微旗下斯普瑞斯品牌在 2022 年 1 月发布 265 款现货薄膜滤波器的基础上新增 122 款，现达到 387 款，涵盖带通、高通、低通，全现货供应。查找现货请登陆 [www.dianzibuy.com](http://www.dianzibuy.com) 查看，明码标价，诚信经营。更多产品登陆官网 [www.com-mw.com](http://www.com-mw.com) 查看。

## 目录

带通滤波器	STBP2R5-0R6-F620 (2.2-2.8GHz)	.....	(1)	点击查看规格书
带通滤波器	STBP2R5-0R4-D516 (2.3-2.65GHz)	.....	(2)	点击查看规格书
带通滤波器	STBP2R9-0R5-G448 (2.6-3.1GHz)	.....	(3)	点击查看规格书
带通滤波器	STBP4R7-4R2-H474 (2.6-6.8GHz)	.....	(4)	点击查看规格书
带通滤波器	STBP3R6-1R8-F475 (2.7-4.5GHz)	.....	(5)	点击查看规格书
带通滤波器	STBP4R4-3R3-F483 (2.7-6.0GHz)	.....	(6)	点击查看规格书
带通滤波器	STBP3R6-1R4-F621 (2.9-4.3GHz)	.....	(7)	点击查看规格书
带通滤波器	STBP3R9-2R0-F580 (2.9-4.9GHz)	.....	(8)	点击查看规格书
带通滤波器	STBP3R0-0R1-D633 (2.92-3.02GHz)	.....	(9)	点击查看规格书
带通滤波器	STBP3R4-0R8-A446 (3.0-3.8GHz)	.....	(10)	点击查看规格书
带通滤波器	STBP3R9-1R8-D637 (3.0-4.8GHz)	.....	(11)	点击查看规格书
带通滤波器	STBP3R5-0R8-D643 (3.1-3.9GHz)	.....	(12)	点击查看规格书
带通滤波器	STBP3R1-0R0-G270 (3.1GHz)	.....	(13)	点击查看规格书
带通滤波器	STBP3R7-0R9-F560 (3.2-4.1GHz)	.....	(14)	点击查看规格书
带通滤波器	STBP3R5-0R4-G449 (3.3-3.7GHz)	.....	(15)	点击查看规格书
带通滤波器	STBP3R5-0R1-D632 (3.4-3.5GHz)	.....	(16)	点击查看规格书
带通滤波器	STBP3R6-0R0-G271 (3.6GHz)	.....	(17)	点击查看规格书
带通滤波器	STBP4R4-1R3-G405 (3.7-5.0GHz)	.....	(18)	点击查看规格书
带通滤波器	STBP4R4-1R0-F561 (3.9-4.9GHz)	.....	(19)	点击查看规格书
带通滤波器	STBP5R7-3R7-D428 (3.9-7.6GHz)	.....	(20)	点击查看规格书
带通滤波器	STBP4R0-0R1-D634 (3.91-4.01GHz)	.....	(21)	点击查看规格书
带通滤波器	STBP4R2-0R5-G450 (3.95-4.45GHz)	.....	(22)	点击查看规格书
带通滤波器	STBP4R5-1R0-D644 (4.0-5.0GHz)	.....	(23)	点击查看规格书
带通滤波器	STBP5R0-2R0-A447 (4.0-6.0GHz)	.....	(24)	点击查看规格书
带通滤波器	STBP4R1-0R0-G272 (4.1GHz)	.....	(25)	点击查看规格书



带通滤波器	STBP5R4-2R4-D631 (4.2-6.6GHz)	.....	(26)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP4R7-0R6-B265 (4.4-5.0GHz)	.....	(27)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP4R5-0R1-D635 (4.42-4.52GHz)	.....	(28)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP5R0-1R0-D502 (4.5-5.5GHz)	.....	(29)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP5R2-1R2-D669 (4.55-5.75GHz)	.....	(30)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP4R9-0R1-D636 (4.88-4.98GHz)	.....	(31)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP6R2-2R6-G252 (4.9-7.5GHz)	.....	(32)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP5R5-1R0-D645 (4.95-5.95GHz)	.....	(33)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP6R1-2R2-G289 (5.0-7.1GHz)	.....	(34)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP5R7-1R0-D406 (5.15-6.15GHz)	.....	(35)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP5R4-0R0-G274 (5.4GHz)	.....	(36)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP6R2-1R0-D582 (5.7-6.7GHz)	.....	(37)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP8R8-5R8-A661 (5.9-11.7GHz)	.....	(38)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP6R3-0R8-D549 (5.9-6.7GHz)	.....	(39)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP6R1-0R3-D463 (5.95-6.25GHz)	.....	(40)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP6R6-1R1-D646 (6.0-7.1GHz)	.....	(41)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP7R5-3R0-D444 (6.0-8.9GHz)	.....	(42)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP8R5-6R0-A430 (6.0-11.0GHz)	.....	(43)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP105-9R0-H058 (6.0-15.0GHz)	.....	(44)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP7R1-1R9-D668 (6.1-8.0GHz)	.....	(45)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP7R6-3R0-D557 (6.1-9.1GHz)	.....	(46)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R6-7R0-H640 (6.1-13.1GHz)	.....	(47)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP7R1-1R3-D670 (6.4-7.7GHz)	.....	(48)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP130-132-G267 (6.4-19.6GHz)	.....	(49)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP7R4-1R8-A271 (6.45-8.25GHz)	.....	(50)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP6R6-0R2-D464 (6.5-6.7GHz)	.....	(51)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP8R3-3R6-D630 (6.5-10.1GHz)	.....	(52)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP7R8-2R4-G253 (6.6-9.0GHz)	.....	(53)	点此查看规格书



带通滤波器	STBP7R9-2R3-D500 (6.7-9.0GHz)	.....	(54)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP7R0-0R2-A548 (6.85-7.05GHz)	.....	(55)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP8R0-2R2-D296 (6.9-9.1GHz)	.....	(56)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP8R2-2R6-G290 (6.9-9.3GHz)	.....	(57)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP125-110-H059 (7.0-18.0GHz)	.....	(58)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP7R2-0R2-A247 (7.1-7.3GHz)	.....	(59)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP8R5-2R8-D667 (7.1-9.9GHz)	.....	(60)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP7R8-1R1-D647 (7.2-8.3GHz)	.....	(61)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP7R7-0R8-D555 (7.3-8.1GHz)	.....	(62)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP7R6-0R2-D550 (7.45-7.65GHz)	.....	(63)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP8R0-1R0-D436 (7.45-8.45GHz)	.....	(64)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP100-5R0-A330 (7.5-12.5GHz)	.....	(65)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP8R3-1R3-G349 (7.6-8.9GHz)	.....	(66)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R2-3R2-A373 (7.6-10.8GHz)	.....	(67)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R8-4R2-A348 (7.7-11.9GHz)	.....	(68)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP8R0-0R3-G441 (7.85-8.15GHz)	.....	(69)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP8R0-0R2-A248 (7.9-8.1GHz)	.....	(70)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP8R0-0R2-D429 (7.9-8.16GHz)	.....	(71)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP8R3-0R7-G340 (7.9-8.6GHz)	.....	(72)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP8R8-1R7-G350 (7.9-9.6GHz)	.....	(73)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP107-5R5-D577 (7.9-13.4GHz)	.....	(74)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP8R0-4R0-D442 (8.0-10.0GHz)	.....	(75)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R5-3R0-D458 (8.0-11.0GHz)	.....	(76)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R9-3R8-D485 (8.0-11.8GHz)	.....	(77)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP106-5R2-A641 (8.0-13.2GHz)	.....	(78)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP145-130-H060 (8.0-21.0GHz)	.....	(79)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R5-2R7-G254 (8.1-10.8GHz)	.....	(80)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP103-4R4-A671 (8.1-12.5GHz)	.....	(81)	点此查看规格书



带通滤波器	STBP8R9-1R2-D648 (8.3-9.5GHz)	.....	(82)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R1-1R6-A403 (8.3-9.9GHz)	.....	(83)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R2-1R8-G351 (8.3-10.1GHz)	.....	(84)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP8R7-0R8-G341 (8.4-9.1GHz)	.....	(85)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP110-5R0-A511 (8.5-13.5GHz)	.....	(86)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP8R8-0R2-A249 (8.72-8.92GHz)	.....	(87)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R2-0R7-G342 (8.85-9.55GHz)	.....	(88)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R7-1R5-G352 (8.9-10.4GHz)	.....	(89)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP117-5R6-A431 (8.9-14.50GHz)	.....	(90)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP106-3R1-D297 (9.0-12.1GHz)	.....	(91)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP110-3R8-D559 (9.1-12.9GHz)	.....	(92)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP158-132-H061 (9.2-22.4GHz)	.....	(93)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP101-1R6-G353 (9.3-10.9GHz)	.....	(94)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP107-2R5-G291 (9.3-12.0GHz)	.....	(95)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R8-0R7-G343 (9.4-10.1GHz)	.....	(96)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP100-1R2-G256 (9.4-10.6GHz)	.....	(97)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP101-1R3-D505 (9.4-10.7GHz)	.....	(98)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R5-0R2-D497 (9.4-9.6GHz)	.....	(99)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R6-0R2-A250 (9.5-9.7GHz)	.....	(100)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP100-1R0-D649 (9.5-10.5GHz)	.....	(101)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP106-1R6-G354 (9.8-11.4GHz)	.....	(102)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP107-1R8-A254 (9.8-11.6GHz)	.....	(103)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP103-0R7-G345 (9.9-10.6GHz)	.....	(104)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP116-3R2-D491 (10.0-13.2GHz)	.....	(105)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP126-5R1-G371 (10.0-15.1GHz)	.....	(106)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP140-8R0-A443 (10.0-18.0GHz)	.....	(107)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP174-148-H062 (10.0-24.8GHz)	.....	(108)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP112-2R2-A553 (10.1-12.3GHz)	.....	(109)	点此查看规格书



带通滤波器	STBP115-2R8-G255 (10.1-12.9GHz)	.....	(110)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP118-3R4-D501 (10.1-13.5GHz)	.....	(111)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP107-1R0-D487 (10.2-11.2GHz)	.....	(112)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP108-0R7-G346 (10.3-11.2GHz)	.....	(113)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP112-1R7-G355 (10.3-12.0GHz)	.....	(114)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP112-1R6-D613 (10.4-12.0GHz)	.....	(115)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP112-1R6-D672 (10.5-11.9GHz)	.....	(116)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP115-2R0-D650 (10.5-12.5GHz)	.....	(117)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP123-3R4-A432 (10.6-14.0GHz)	.....	(118)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP113-0R7-G347 (10.9-11.6GHz)	.....	(119)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP117-1R6-G257 (10.9-12.5GHz)	.....	(120)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP119-1R7-G356 (10.9-12.7GHz)	.....	(121)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP119-2R0-A576 (10.9-12.9GHz)	.....	(122)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP195-170-H063 (11.0-28.0GHz)	.....	(123)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP126-2R7-D492 (11.2-13.9GHz)	.....	(124)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP148-7R1-A332 (11.2-18.3GHz)	.....	(125)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP135-4R3-A710 (11.3-15.6GHz)	.....	(126)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP119-0R9-G348 (11.4-12.3GHz)	.....	(127)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP122-1R6-D673 (11.4-13.0GHz)	.....	(128)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP127-2R4-A253 (11.5-13.9GHz)	.....	(129)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP136-4R0-A331 (11.6-15.6GHz)	.....	(130)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP137-4R2-D652 (11.6-15.8GHz)	.....	(131)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP142-5R0-A349 (11.7-16.7GHz)	.....	(132)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP122-0R8-D402 (11.75-12.45GHz)	.....	(133)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP142-4R7-A424 (11.8-16.5GHz)	.....	(134)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP120-0R0-E706 (12.0GHz)	.....	(135)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP135-3R0-D298 (12.0-15.0GHz)	.....	(136)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP150-6R02-A575 (12.0-18.0GHz)	.....	(137)	点此查看规格书



带通滤波器	STBP152-6R4-D662 (12.0-18.4GHz)	.....	(138)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP200-160-H064 (12.0-28.0GHz)	.....	(139)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP127-1R1-D488 (12.2-13.3GHz)	.....	(140)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP137-2R8-A554 (12.3-15.1GHz)	.....	(141)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP132-1R5-D651 (12.4-13.9GHz)	.....	(142)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP132-1R6-D614 (12.4-14.0GHz)	.....	(143)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP125-0R0-E707 (12.5GHz)	.....	(144)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP143-3R1-D504 (12.5-16.1GHz)	.....	(145)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP155-6R0-D512 (12.5-18.5GHz)	.....	(146)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP140-2R4-D440 (12.8-15.2GHz)	.....	(147)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP130-0R0-E708 (13.0GHz)	.....	(148)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP141-2R2-D558 (13.0-15.2GHz)	.....	(149)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP138-1R4-G258 (13.1-14.5GHz)	.....	(150)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP141-1R4-D674 (13.4-14.8GHz)	.....	(151)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP135-0R0-E709 (13.5GHz)	.....	(152)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP149-2R8-A370 (13.5-16.3GHz)	.....	(153)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP159-4R8-A351 (13.5-18.3GHz)	.....	(154)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP177-8R4-A479 (13.5-21.9GHz)	.....	(155)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP156-4R0-A433 (13.6-17.6GHz)	.....	(156)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP144-1R3-A405 (13.7-15.0GHz)	.....	(157)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP148-2R1-A255 (13.7-15.8GHz)	.....	(158)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP150-2R4-D653 (13.8-16.2GHz)	.....	(159)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP140-0R0-E711 (14.0GHz)	.....	(160)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP147-1R3-D404 (14.0-15.3GHz)	.....	(161)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP150-2R0-D571 (14.0-16.0GHz)	.....	(162)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP167-5R4-A353 (14.0-19.4GHz)	.....	(163)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP185-9R0-A334 (14.0-23.0GHz)	.....	(164)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP162-4R2-A352 (14.1-18.3GHz)	.....	(165)	点此查看规格书



带通滤波器	STBP157-3R0-D494 (14.2-17.2GHz)	.....	(166)	<a href="#">点此查看规格书</a>
带通滤波器	STBP166-4R4-A372 (14.4-18.8GHz)	.....	(167)	<a href="#">点此查看规格书</a>
带通滤波器	STBP145-0R0-E712 (14.5GHz)	.....	(168)	<a href="#">点此查看规格书</a>
带通滤波器	STBP169-4R4-A434 (14.7-19.1GHz)	.....	(169)	<a href="#">点此查看规格书</a>
带通滤波器	STBP165-3R2-D318 (14.9-18.1GHz)	.....	(170)	<a href="#">点此查看规格书</a>
带通滤波器	STBP167-3R6-D503 (14.9-18.5GHz)	.....	(171)	<a href="#">点此查看规格书</a>
带通滤波器	STBP176-5R4-A585 (14.9-20.3GHz)	.....	(172)	<a href="#">点此查看规格书</a>
带通滤波器	STBP177-5R6-A541 (14.9-20.5GHz)	.....	(173)	<a href="#">点此查看规格书</a>
带通滤波器	STBP150-0R0-E713 (15.0GHz)	.....	(174)	<a href="#">点此查看规格书</a>
带通滤波器	STBP160-2R0-D572 (15.0-17.0GHz)	.....	(175)	<a href="#">点此查看规格书</a>
带通滤波器	STBP160-2R0-D441 (15.0-17.0GHz)	.....	(176)	<a href="#">点此查看规格书</a>
带通滤波器	STBP158-1R2-G259 (15.2-16.4GHz)	.....	(177)	<a href="#">点此查看规格书</a>
带通滤波器	STBP165-2R6-D454 (15.2-17.8GHz)	.....	(178)	<a href="#">点此查看规格书</a>
带通滤波器	STBP165-2R4-A603 (15.3-17.7GHz)	.....	(179)	<a href="#">点此查看规格书</a>
带通滤波器	STBP170-3R2-A371 (15.4-18.6GHz)	.....	(180)	<a href="#">点此查看规格书</a>
带通滤波器	STBP162-1R4-D508 (15.5-16.9GHz)	.....	(181)	<a href="#">点此查看规格书</a>
带通滤波器	STBP165-2R0-A552 (15.5-17.5GHz)	.....	(182)	<a href="#">点此查看规格书</a>
带通滤波器	STBP186-6R0-A355 (15.6-21.6GHz)	.....	(183)	<a href="#">点此查看规格书</a>
带通滤波器	STBP187-6R0-G312 (15.7-21.7GHz)	.....	(184)	<a href="#">点此查看规格书</a>
带通滤波器	STBP169-2R1-A256 (15.8-17.9GHz)	.....	(185)	<a href="#">点此查看规格书</a>
带通滤波器	STBP169-2R1-D462 (15.8-18.0GHz)	.....	(186)	<a href="#">点此查看规格书</a>
带通滤波器	STBP171-2R3-D654 (15.9-18.2GHz)	.....	(187)	<a href="#">点此查看规格书</a>
带通滤波器	STBP160-0R0-E714 (16.0GHz)	.....	(188)	<a href="#">点此查看规格书</a>
带通滤波器	STBP192-6R4-G442 (16.0-22.4GHz)	.....	(189)	<a href="#">点此查看规格书</a>
带通滤波器	STBP170-1R8-D579 (16.1-17.9GHz)	.....	(190)	<a href="#">点此查看规格书</a>
带通滤波器	STBP169-1R3-A274 (16.2-17.5GHz)	.....	(191)	<a href="#">点此查看规格书</a>
带通滤波器	STBP177-2R8-D495 (16.3-19.1GHz)	.....	(192)	<a href="#">点此查看规格书</a>
带通滤波器	STBP219-104-A383 (16.7-27.1GHz)	.....	(193)	<a href="#">点此查看规格书</a>



带通滤波器	STBP184-2R9-A354 (16.9-19.8GHz)	.....	(194)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP185-3R2-D375 (16.9-20.1GHz)	.....	(195)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP197-5R6-A590 (16.9-22.5GHz)	.....	(196)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP201-6R2-A409 (17.0-23.2GHz)	.....	(197)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP218-9R6-A421 (17.0-26.6GHz)	.....	(198)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP194-4R8-A391 (17.1-21.9GHz)	.....	(199)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP199-5R4-A417 (17.2-22.6GHz)	.....	(200)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP211-7R8-A359 (17.2-25.0GHz)	.....	(201)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP181-1R6-C288 (17.3-18.9GHz)	.....	(202)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP220-9R4-A336 (17.3-26.7GHz)	.....	(203)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP195-4R2-D484 (17.4-21.6GHz)	.....	(204)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP221-9R4-G369 (17.4-26.8GHz)	.....	(205)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP207-6R3-A357 (17.5-23.8GHz)	.....	(206)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP220-8R9-A513 (17.6-26.4GHz)	.....	(207)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP179-0R5-C438 (17.8-18.1GHz)	.....	(208)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP191-2R3-C276 (17.9-20.2GHz)	.....	(209)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP192-2R6-A551 (17.9-20.5GHz)	.....	(210)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP204-5R0-D569 (17.9-22.9GHz)	.....	(211)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP190-2R0-D437 (18.0-20.0GHz)	.....	(212)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP197-3R3-D386 (18.0-21.3GHz)	.....	(213)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP221-8R0-A358 (18.1-26.1GHz)	.....	(214)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP198-3R0-D496 (18.3-21.3GHz)	.....	(215)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP187-0R3-D507 (18.56-18.8GHz)	.....	(216)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP187-0R1-D507 (18.6-18.7GHz)	.....	(217)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP206-4R0-A356 (18.6-22.6GHz)	.....	(218)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP249-114-A408 (19.2-30.6GHz)	.....	(219)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP193-0R0-E715 (19.3GHz)	.....	(220)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP203-2R0-D563 (19.3-21.3GHz)	.....	(221)	点此查看规格书



带通滤波器	STBP223-5R4-A591 (19.6-25.0GHz)	.....	(222)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP199-0R3-C439 (19.8-20.1GHz)	.....	(223)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP230-6R0-A629 (19.9-26.1GHz)	.....	(224)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP207-1R4-D489 (20.0-21.4GHz)	.....	(225)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP230-6R0-A586 (20.0-26.0GHz)	.....	(226)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP249-9R8-A361 (20.0-29.8GHz)	.....	(227)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP211-2R0-D435 (20.1-22.1GHz)	.....	(228)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP217-3R0-D456 (20.2-23.2GHz)	.....	(229)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP221-3R8-C279 (20.2-24.0GHz)	.....	(230)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP230-5R1-A392 (20.4-25.5GHz)	.....	(231)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP210-0R6-E523 (20.7-21.3GHz)	.....	(232)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP235-5R6-A418 (20.7-26.3GHz)	.....	(233)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP213-1R0-E521 (20.8-21.8GHz)	.....	(234)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP215-1R0-C360 (20.9-22.0GHz)	.....	(235)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP218-1R2-G432 (21.2-22.4GHz)	.....	(236)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP220-0R9-E658 (21.5-22.4GHz)	.....	(237)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP224-1R6-E470 (21.6-23.2GHz)	.....	(238)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP237-4R2-C311 (21.6-25.8GHz)	.....	(239)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP227-2R0-A206 (21.7-23.7GHz)	.....	(240)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP243-5R0-G260 (21.8-26.8GHz)	.....	(241)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP250-6R4-C534 (21.8-28.2GHz)	.....	(242)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP235-3R0-D387 (22.0-25.0GHz)	.....	(243)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP228-1R4-D460 (22.1-23.5GHz)	.....	(244)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP225-0R6-E469 (22.15-22.8GHz)	.....	(245)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP249-5R4-A592 (22.2-27.6GHz)	.....	(246)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP227-0R5-D459 (22.5-23.0GHz)	.....	(247)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP275-8R6-A362 (23.2-31.8GHz)	.....	(248)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP280-9R2-A337 (23.4-32.6GHz)	.....	(249)	点此查看规格书



带通滤波器	STBP240-1R0-E663 (23.5-24.5GHz)	.....	(250)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP281-9R2-A656 (23.5-32.7GHz)	.....	(251)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP244-1R2-C312 (23.8-25.0GHz)	.....	(252)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP261-4R2-C280 (24.0-28.2GHz)	.....	(253)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP262-4R4-C320 (24.0-28.4GHz)	.....	(254)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP267-5R0-A393 (24.2-29.2GHz)	.....	(255)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP288-8R4-C363 (24.6-33.0GHz)	.....	(256)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP276-5R6-A419 (24.8-30.4GHz)	.....	(257)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP263-2R5-C244 (25.0-27.5GHz)	.....	(258)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP275-5R0-A593 (25.0-30.0GHz)	.....	(259)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP289-7R5-C364 (25.1-32.6GHz)	.....	(260)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP293-8R4-C384 (25.1-33.5GHz)	.....	(261)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP256-1R0-C313 (25.2-26.0GHz)	.....	(262)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP288-7R0-A627 (25.3-32.3GHz)	.....	(263)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP330-140-C607 (26.0-40.0GHz)	.....	(264)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP267-0R9-C314 (26.2-27.1GHz)	.....	(265)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP313-9R8-A410 (26.3-36.1GHz)	.....	(266)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP321-112-C535 (26.5-37.7GHz)	.....	(267)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP286-4R0-C605 (26.6-30.6GHz)	.....	(268)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP289-4R6-C542 (26.6-31.2GHz)	.....	(269)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP312-8R3-C416 (27.0-35.3GHz)	.....	(270)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP335-130-C339 (27.0-40.0GHz)	.....	(271)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP278-0R6-C315 (27.5-28.1GHz)	.....	(272)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP299-4R8-G451 (27.5-32.3GHz)	.....	(273)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP339-128-C365 (27.5-40.3GHz)	.....	(274)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP316-7R8-C426 (27.7-35.5GHz)	.....	(275)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP303-5R0-C321 (27.8-32.8GHz)	.....	(276)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP311-6R6-C278 (27.8-34.4GHz)	.....	(277)	点此查看规格书



带通滤波器	STBP288-1R6-C287 (28.0-29.6GHz)	.....	(278)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP303-4R3-G452 (28.1-32.4GHz)	.....	(279)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP307-4R7-A394 (28.3-33.0GHz)	.....	(280)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP298-2R0-C716 (28.8-30.8GHz)	.....	(281)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP301-2R6-C388 (28.8-31.4GHz)	.....	(282)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP317-5R4-A420 (29.0-34.4GHz)	.....	(283)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP343-9R8-G334 (29.4-39.2GHz)	.....	(284)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP307-2R3-C717 (29.5-31.8GHz)	.....	(285)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP325-5R4-C587 (29.8-35.2GHz)	.....	(286)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP304-1R0-C573 (29.9-30.9GHz)	.....	(287)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP306-1R3-C286 (29.9-31.2GHz)	.....	(288)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP321-3R8-C606 (30.2-34.0GHz)	.....	(289)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP333-5R2-G409 (30.7-35.9GHz)	.....	(290)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP356-9R6-C385 (30.8-40.4GHz)	.....	(291)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP339-5R6-C381 (31.1-36.7GHz)	.....	(292)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP351-7R4-C376 (31.4-38.8GHz)	.....	(293)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP361-8R8-C628 (31.7-40.5GHz)	.....	(294)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP361-8R6-C341 (31.8-40.4GHz)	.....	(295)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP329-2R0-C389 (31.9-33.9GHz)	.....	(296)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP343-4R8-C322 (31.9-36.7GHz)	.....	(297)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP340-4R0-C422 (32.0-36.0GHz)	.....	(298)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP361-8R2-C659 (32.0-40.2GHz)	.....	(299)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP363-8R5-C367 (32.0-40.5GHz)	.....	(300)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP365-9R0-C366 (32.0-41.0GHz)	.....	(301)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP376-112-C368 (32.0-43.2GHz)	.....	(302)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP349-5R6-C642 (32.1-37.7GHz)	.....	(303)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP347-4R6-C395 (32.4-37.0GHz)	.....	(304)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP344-3R2-G411 (32.8-36.0GHz)	.....	(305)	点此查看规格书



带通滤波器	STBP350-4R0-C588 (32.8-37.0GHz)	.....	(306)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP353-5R0-G456 (32.8-37.8GHz)	.....	(307)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP361-6R2-A533 (33.0-39.2GHz)	.....	(308)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP374-8R8-C411 (33.0-41.8GHz)	.....	(309)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP355-4R4-C596 (33.3-37.7GHz)	.....	(310)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP360-4R9-C423 (33.5-38.4GHz)	.....	(311)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP369-6R6-C281 (33.6-40.2GHz)	.....	(312)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP347-1R9-C609 (33.7-35.6GHz)	.....	(313)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP350-1R8-G379 (34.1-35.9GHz)	.....	(314)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP364-3R3-G412 (34.7-38.0GHz)	.....	(315)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP373-5R0-C589 (34.8-39.8GHz)	.....	(316)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP374-5R4-G410 (34.9-40.1GHz)	.....	(317)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP381-5R8-C382 (35.2-41.0GHz)	.....	(318)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP370-3R5-G453 (35.3-38.8GHz)	.....	(319)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP380-4R8-C396 (35.6-40.4GHz)	.....	(320)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP381-4R6-C597 (35.8-40.4GHz)	.....	(321)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP394-7R1-G173 (35.8-42.9GHz)	.....	(322)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP383-3R4-C611 (36.6-40.0GHz)	.....	(323)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP411-7R8-C342 (37.2-45.0GHz)	.....	(324)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP391-2R0-C612 (38.1-40.1GHz)	.....	(325)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP422-7R6-C412 (38.4-46.0GHz)	.....	(326)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP443-115-C345 (38.5-50.0GHz)	.....	(327)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP445-110-C343 (39.0-50.0GHz)	.....	(328)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP420-4R4-C324 (39.8-44.2GHz)	.....	(329)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP453-9R4-C626 (40.6-50.0GHz)	.....	(330)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP448-2R8-C564 (43.4-46.2GHz)	.....	(331)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP475-5R0-G522 (45.0-50.0GHz)	.....	(332)	点此查看规格书
带通滤波器	STBP477-4R6-C543 (45.4-50.0GHz)	.....	(333)	点此查看规格书



高通滤波器	STHP2R7-H474 (2.7-6.5GHz)	.....	(334)	<a href="#">点此查看规格书</a>
高通滤波器	STHP6R0-H640 (6.0-13.0GHz)	.....	(335)	<a href="#">点此查看规格书</a>
高通滤波器	STHP6R0-H058 (6.0-14.0GHz)	.....	(336)	<a href="#">点此查看规格书</a>
高通滤波器	STHP6R4-G267 (6.4-19.6GHz)	.....	(337)	<a href="#">点此查看规格书</a>
高通滤波器	STHP7R0-H059 (7.0-17.5GHz)	.....	(338)	<a href="#">点此查看规格书</a>
高通滤波器	STHP8R0-H060 (8.0-20.0GHz)	.....	(339)	<a href="#">点此查看规格书</a>
高通滤波器	STHP9R2-H061 (9.2-22.0GHz)	.....	(340)	<a href="#">点此查看规格书</a>
高通滤波器	STHP100-H062 (10.0-23.0GHz)	.....	(341)	<a href="#">点此查看规格书</a>
高通滤波器	STHP110-H583 (11.0-24.0GHz)	.....	(342)	<a href="#">点此查看规格书</a>
高通滤波器	STHP110-H063 (11.0-27.0GHz)	.....	(343)	<a href="#">点此查看规格书</a>
高通滤波器	STHP120-H064 (12.0-28.0GHz)	.....	(344)	<a href="#">点此查看规格书</a>
高通滤波器	STHP130-H065 (13.0-28.0GHz)	.....	(345)	<a href="#">点此查看规格书</a>
高通滤波器	STHP140-H066 (14.0-30.0GHz)	.....	(346)	<a href="#">点此查看规格书</a>
高通滤波器	STHP150-H067 (15.0-32.0GHz)	.....	(347)	<a href="#">点此查看规格书</a>
高通滤波器	STHP160-H068 (16.0-38.0GHz)	.....	(348)	<a href="#">点此查看规格书</a>
高通滤波器	STHP165-H070 (16.5-40.0GHz)	.....	(349)	<a href="#">点此查看规格书</a>
高通滤波器	STHP170-H069 (17.0-38.0GHz)	.....	(350)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP4R4-L472 (DC-4.4GHz)	.....	(351)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP5R0-L020 (DC-5.0GHz)	.....	(352)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP6R0-L021 (DC-6.0GHz)	.....	(353)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP7R0-L022 (DC-7.0GHz)	.....	(354)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP8R0-L023 (DC-8.0GHz)	.....	(355)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP8R0-L622 (DC-8.0GHz)	.....	(356)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP8R6-L024 (DC-8.6GHz)	.....	(357)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP9R8-L025 (DC-9.8GHz)	.....	(358)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP110-L026 (DC-11.0GHz)	.....	(359)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP115-L222 (DC-11.5GHz)	.....	(360)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP120-L027 (DC-12.0GHz)	.....	(361)	<a href="#">点此查看规格书</a>



低通滤波器	STLP130-L028 (DC-13.0GHz)	.....	(362)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP138-L029 (DC-13.8GHz)	.....	(363)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP146-L030 (DC-14.6GHz)	.....	(364)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP158-L031 (DC-15.8GHz)	.....	(365)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP170-L032 (DC-17.0GHz)	.....	(366)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP175-G337 (DC-17.5GHz)	.....	(367)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP176-L033 (DC-17.6GHz)	.....	(368)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP178-L623 (DC-17.8GHz)	.....	(369)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP180-L040 (DC-18.0GHz)	.....	(370)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP190-L034 (DC-19.0GHz)	.....	(371)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP200-L035 (DC-20.0GHz)	.....	(372)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP214-G183 (DC-21.4GHz)	.....	(373)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP220-L690 (DC-22.0GHz)	.....	(374)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP240-G184 (DC-24.0GHz)	.....	(375)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP245-L691 (DC-24.5GHz)	.....	(376)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP248-L427 (DC-24.8GHz)	.....	(377)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP260-G185 (DC-26.0GHz)	.....	(378)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP260-L686 (DC-26.0GHz)	.....	(379)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP280-G186 (DC-28.0GHz)	.....	(380)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP300-G187 (DC-30.0GHz)	.....	(381)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP315-G188 (DC-31.5GHz)	.....	(382)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP320-L624 (DC-32.0GHz)	.....	(383)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP340-G192 (DC-34.0GHz)	.....	(384)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP360-G193 (DC-36.0GHz)	.....	(385)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP378-G194 (DC-37.8GHz)	.....	(386)	<a href="#">点此查看规格书</a>
低通滤波器	STLP396-G195 (DC-39.6GHz)	.....	(387)	<a href="#">点此查看规格书</a>



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

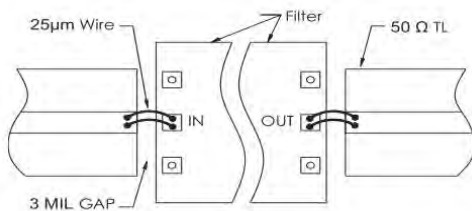
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		2.5		GHz
工作频率	2.2		2.8	GHz
中心损耗		2.0	2.5	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-1.3GHz	45	50	dBc
	@4.1-9.0GHz	45	50	dBc

### 环境要求

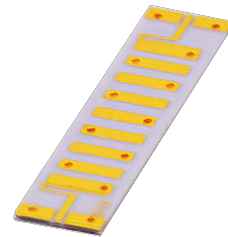
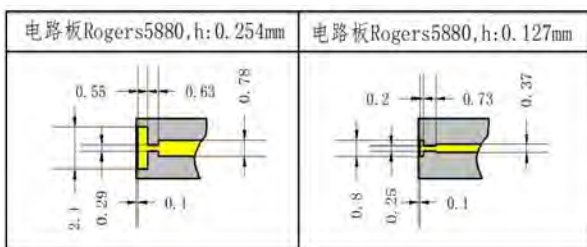
最大输入功率	30	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

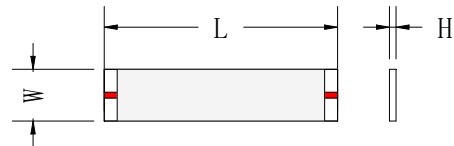


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

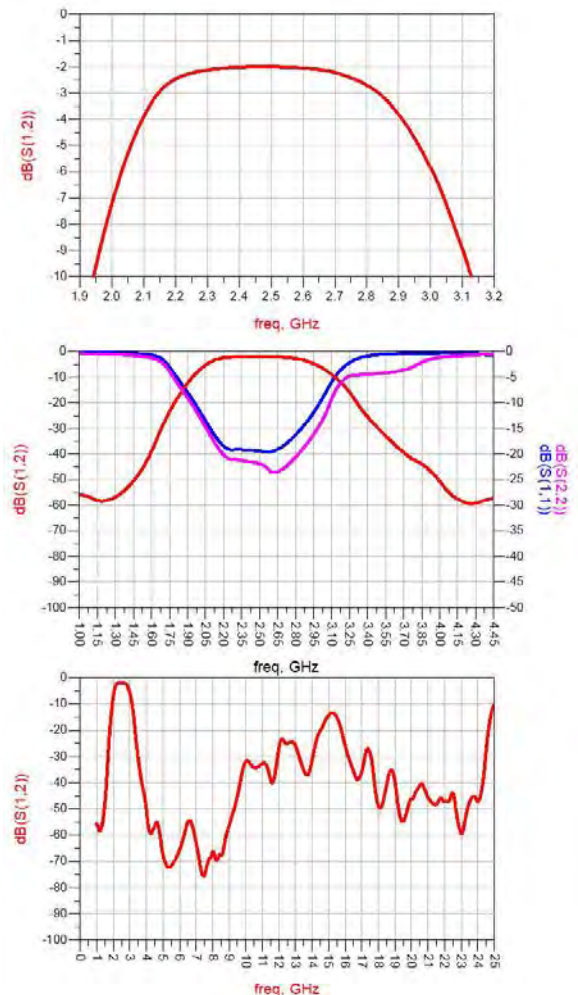


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	12.0	5.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

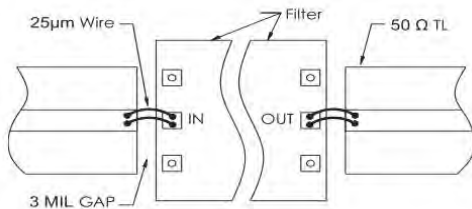
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		2.475		GHz
工作频率	2.3		2.65	GHz
中心损耗		2.2	2.7	dB
带内波动		0.8	1.2	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-1.7GHz	45	50	dBc
	@3.4-4.0GHz	50	45	dBc

环境要求

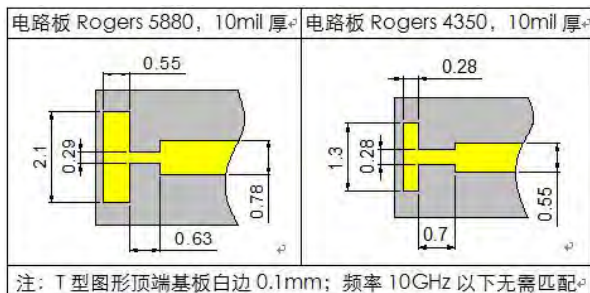
最大输入功率	30	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

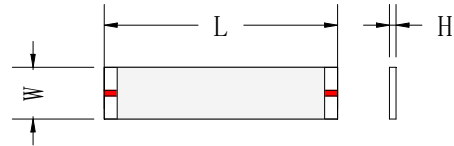
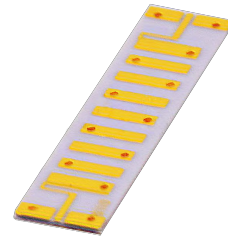


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

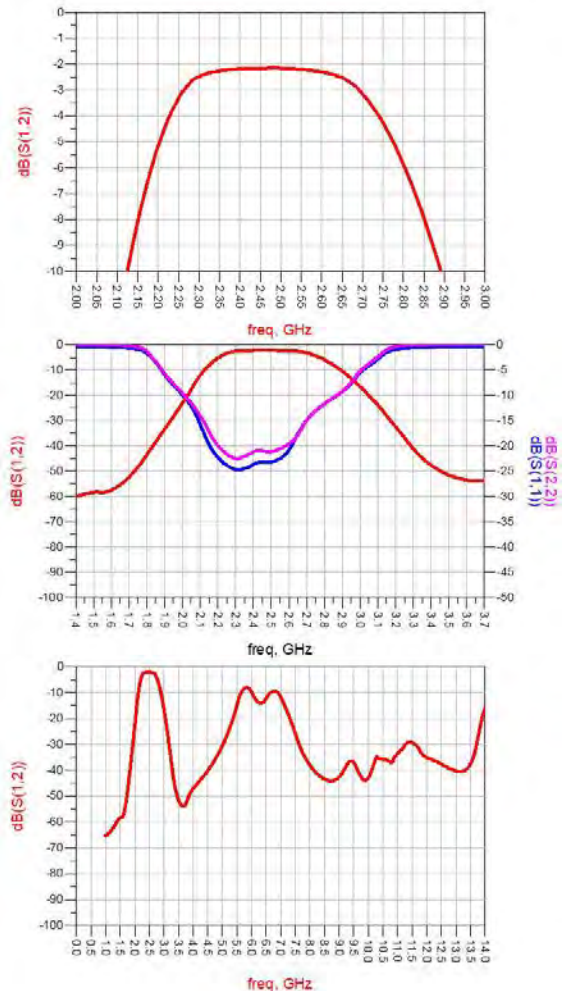


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	8.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



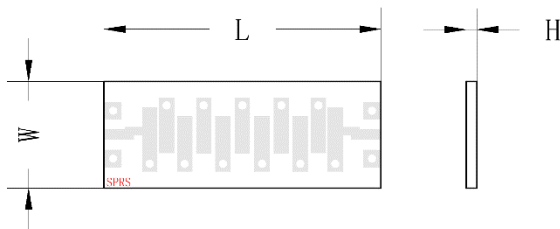
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

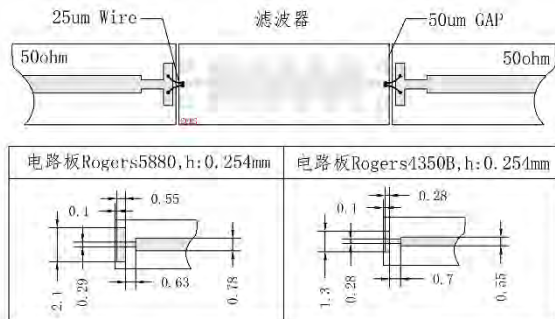
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		2.85		GHz
工作频率	2.6		3.1	GHz
中心损耗		2.9	3.4	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-1.8GHz	40	45		dBc
带外抑制@4.0-6.5GHz	40	45		dBc
承受功率			27	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.0, W: 10.0, H: 0.254, 端口居中



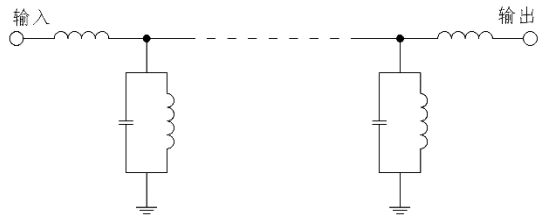
推荐装配图:



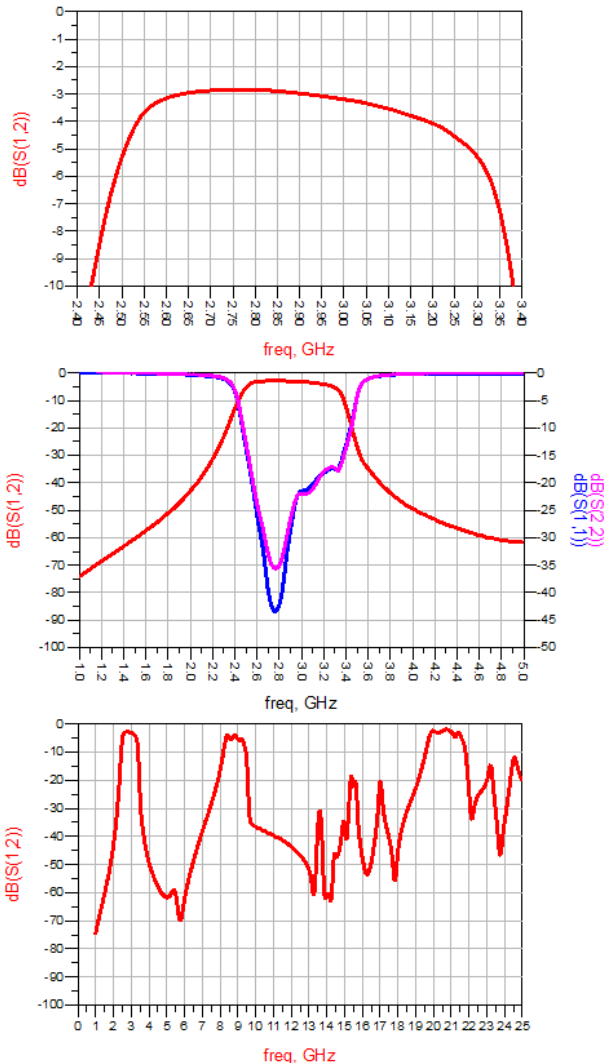
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

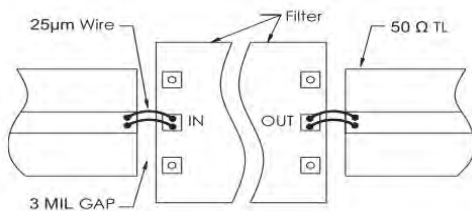
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		4.7		GHz
工作频率	2.6		6.8	GHz
中心损耗		0.6	0.9	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@DC-1.7GHz	38	43	dBc
	@8.5-11.6GHz	24	29	dBc

### 环境要求

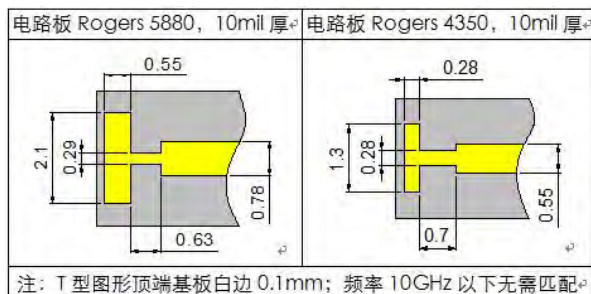
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

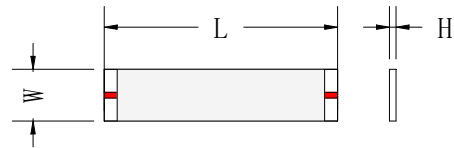
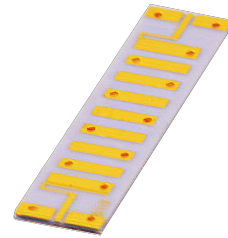


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

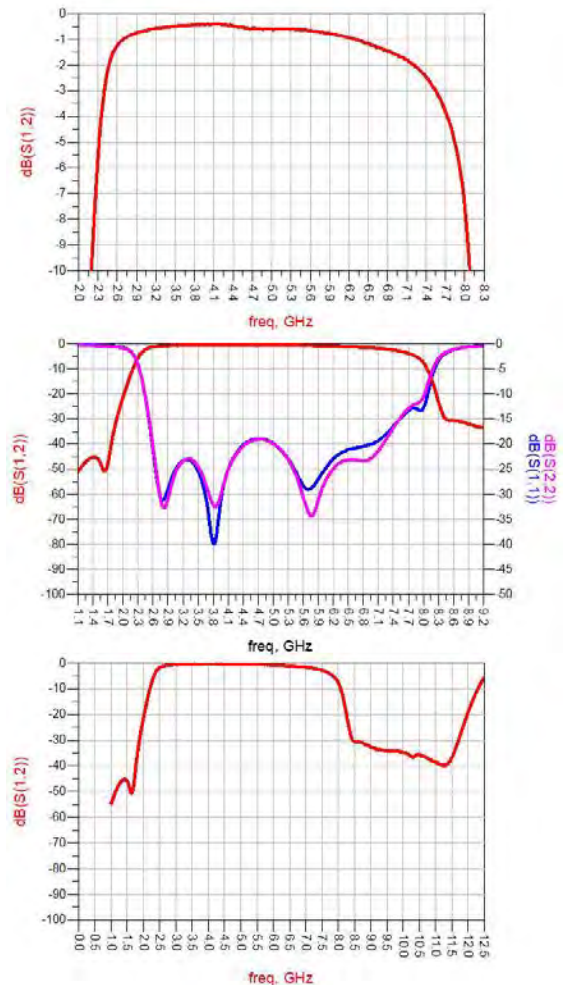


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	5.5	5.0	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

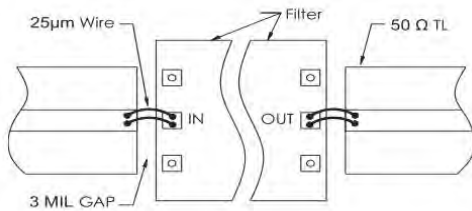
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		3.6		GHz
工作频率	2.7		4.5	GHz
中心损耗		3.6	4.1	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-1.2GHz	45	50	dBc
	@6.0-11.0GHz	45	50	dBc

环境要求

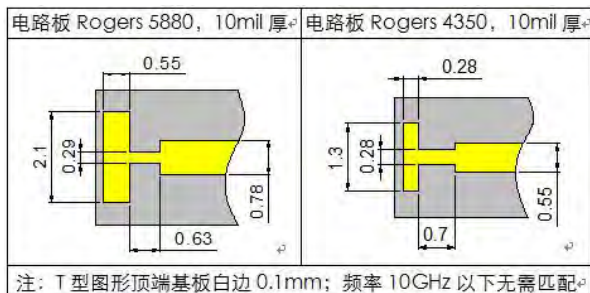
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

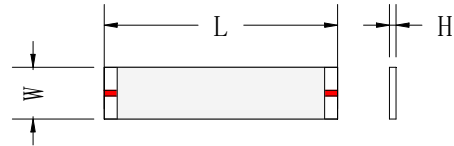
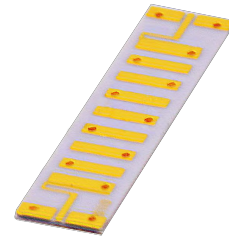


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

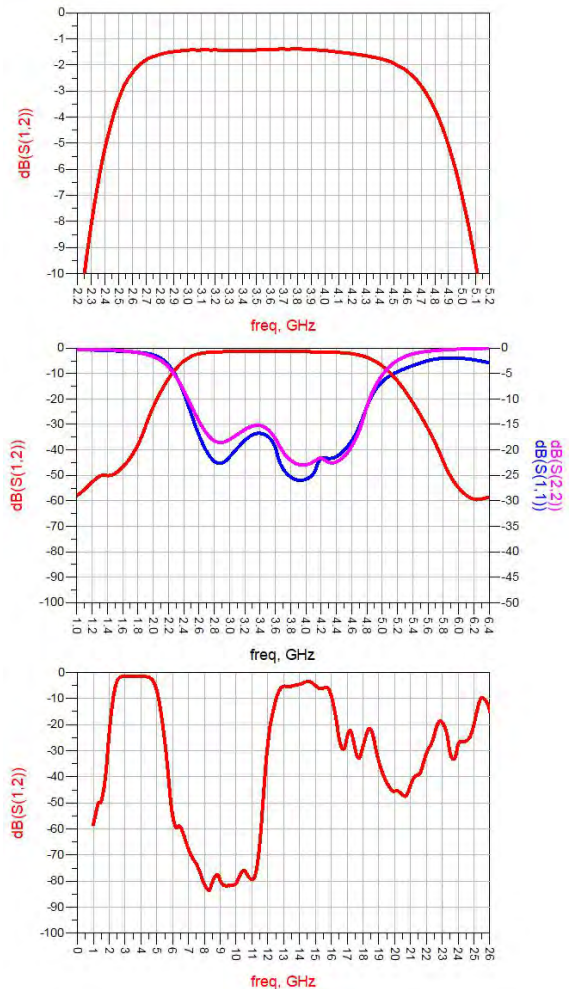


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	12.0	5.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

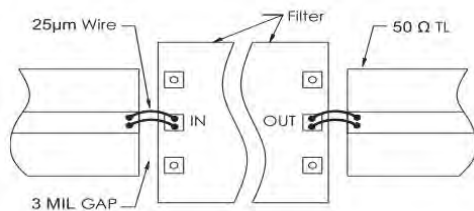
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		4.35		GHz
工作频率	2.7		6.0	GHz
中心损耗		1.4	1.9	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-1.3GHz	42	47	dBc
	@7.9-13.5GHz	42	47	dBc

### 环境要求

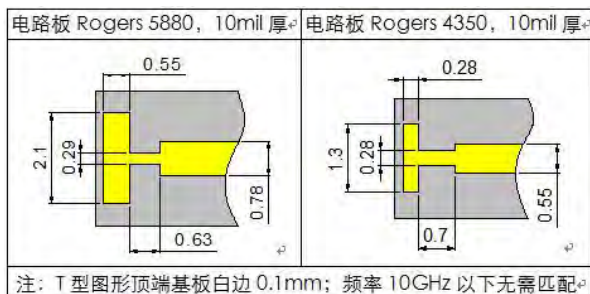
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

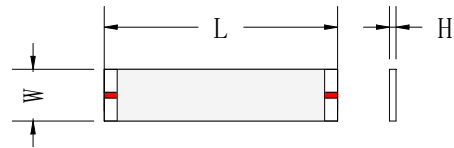
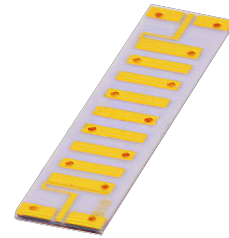


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

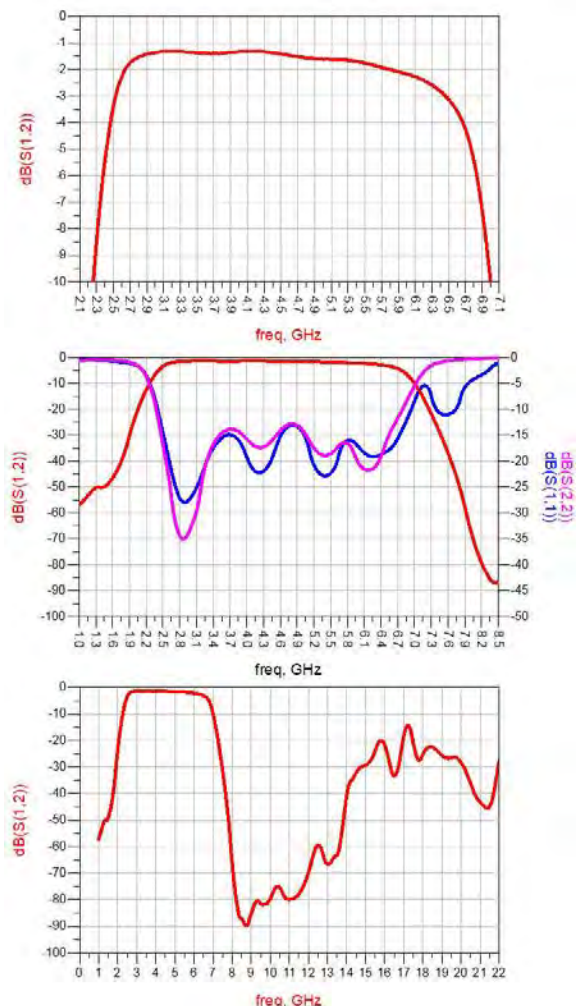


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	12.0	5.0	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

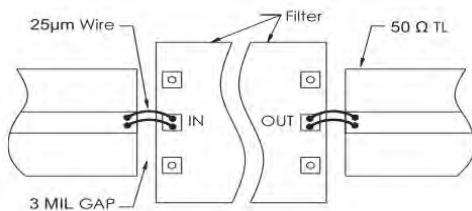
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		3.6		GHz
工作频率	2.9		4.3	GHz
中心损耗		1.3	1.7	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-2.0GHz	42	47	dBc
	@5.4-9.5GHz	42	47	dBc

### 环境要求

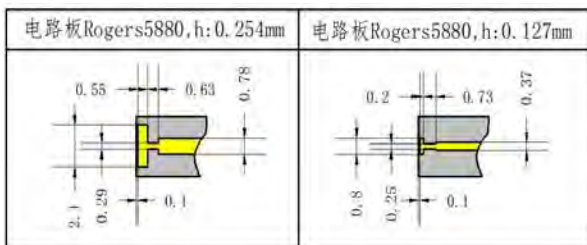
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

### 推荐装配图

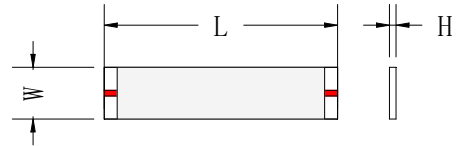
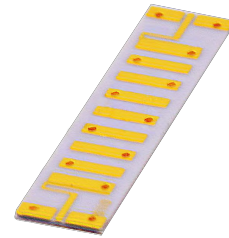


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

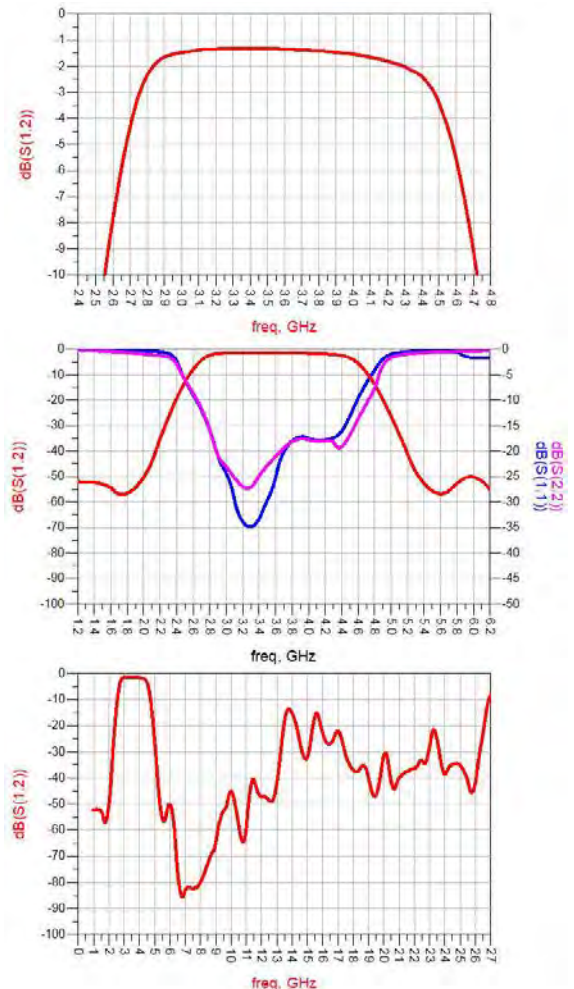


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	10.0	5.5	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

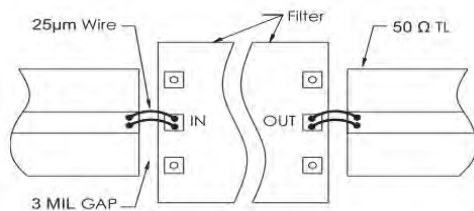
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		3.9		GHz
工作频率	2.9		4.9	GHz
中心损耗		1.7	2.2	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-1.7GHz	45	50	dBc
	@6.1-9.5GHz	45	50	dBc

### 环境要求

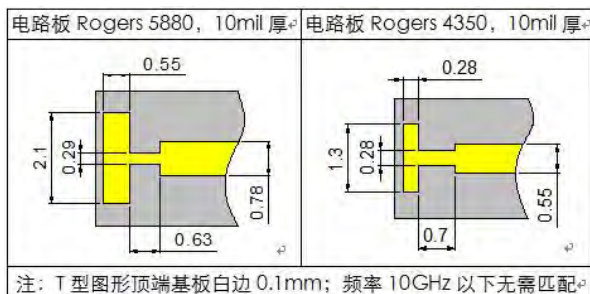
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

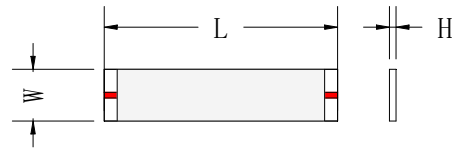
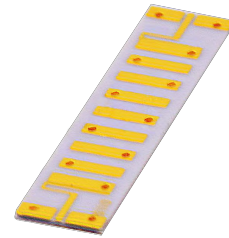


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

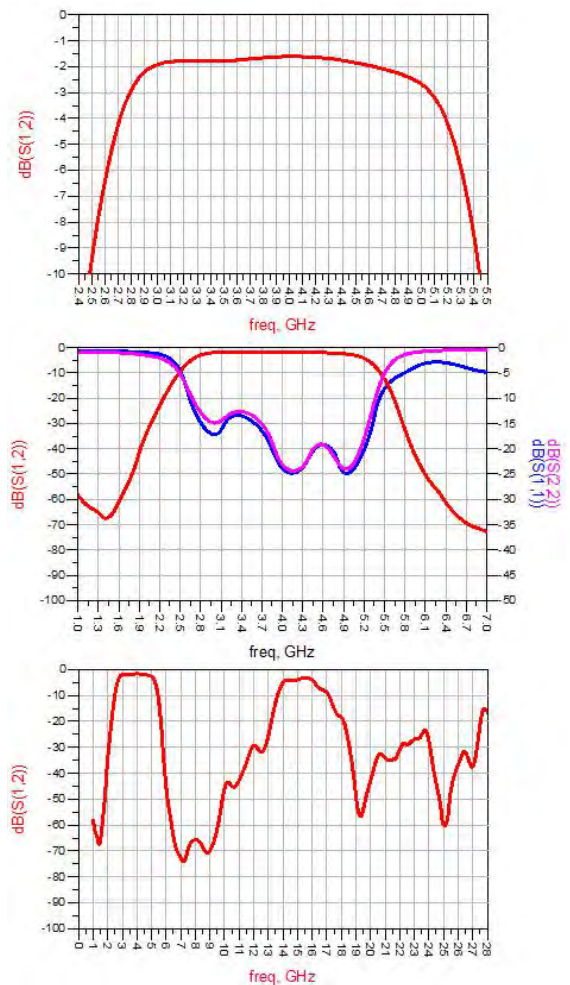


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	12.0	5.0	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

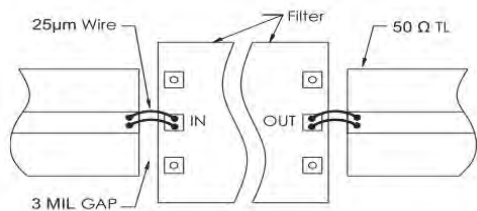
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		2.97		GHz
工作频率	2.92		3.02	GHz
中心损耗		4.1	4.7	dB
带内波动		0.3	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-2.5GHz	43	48	dBc
	@3.5-8.0GHz	43	48	dBc

环境要求

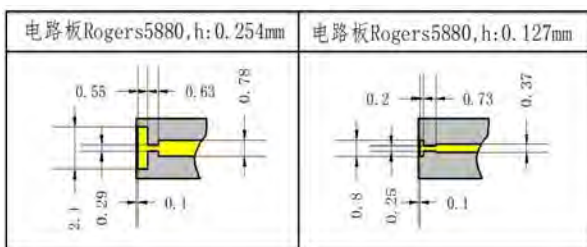
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

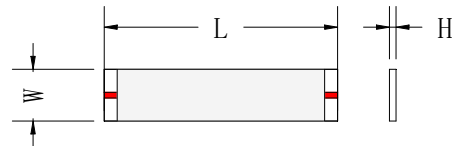
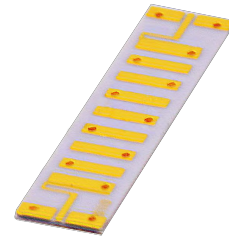


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.62mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

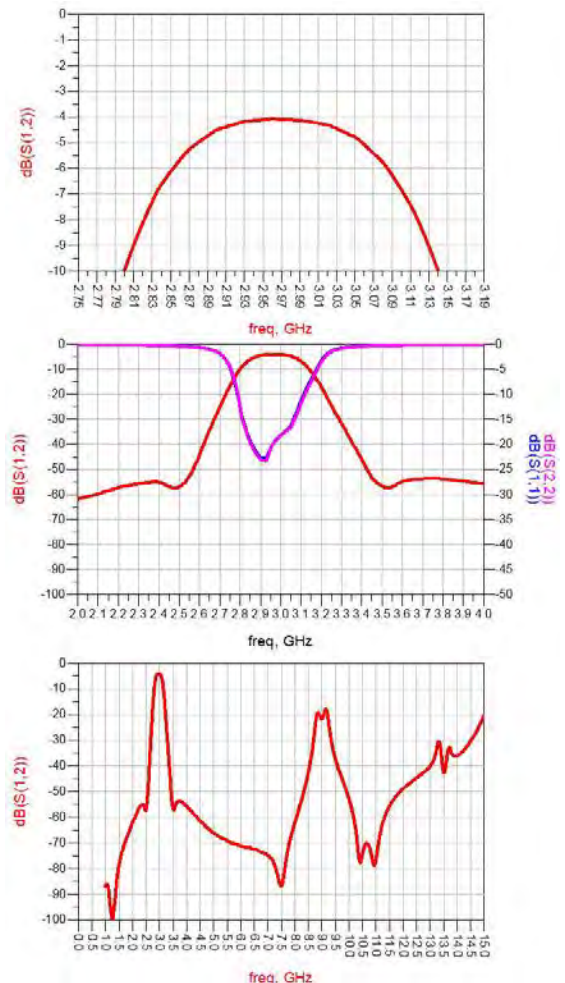


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	6.0	0.381	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



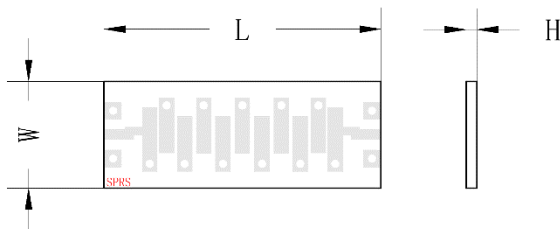
### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

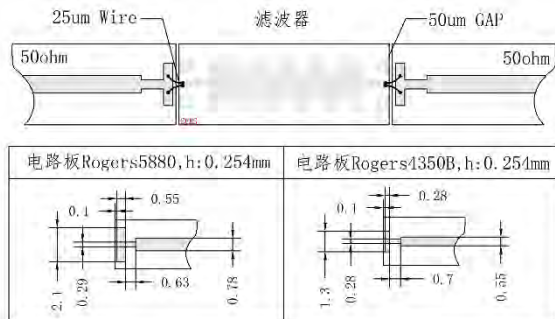
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		3.4		GHz
工作频率	3.0		3.8	GHz
中心损耗		2.5	3.0	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-1.3GHz	45	50		dBc
带外抑制@5.5-7.5GHz	45	50		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 6.5, W: 8.5, H: 0.254, 端口居中



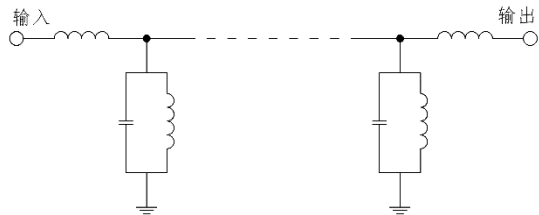
### 推荐装配图:



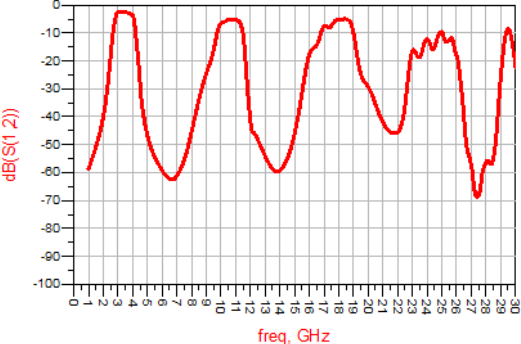
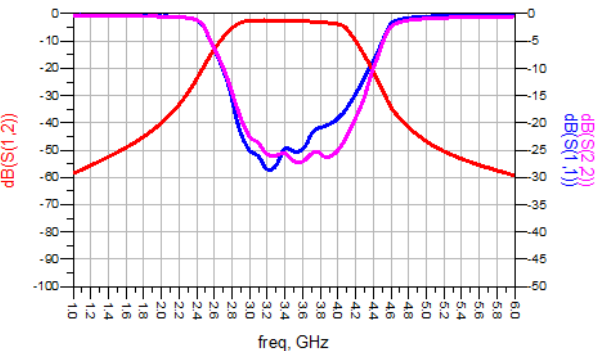
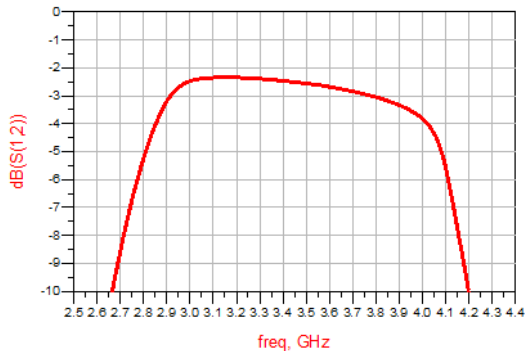
### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

### 原理图



### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

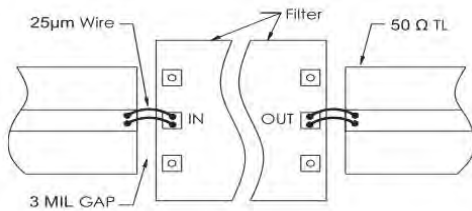
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		3.9		GHz
工作频率	3.0		4.8	GHz
中心损耗		2.2	2.6	dB
带内波动		1.1	1.5	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-2.6GHz	35	40	dBc
	@5.5-10.0GHz	32	37	dBc

环境要求

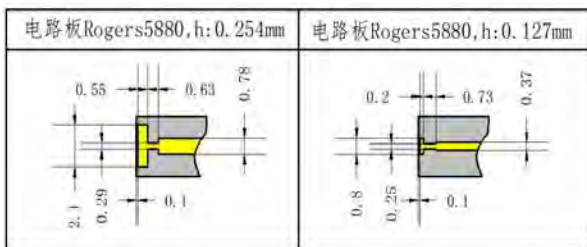
最大输入功率	30	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

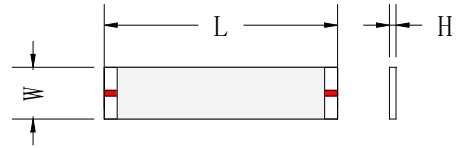
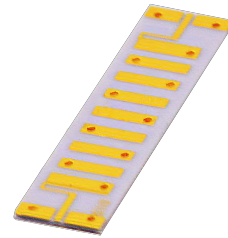


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.62mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

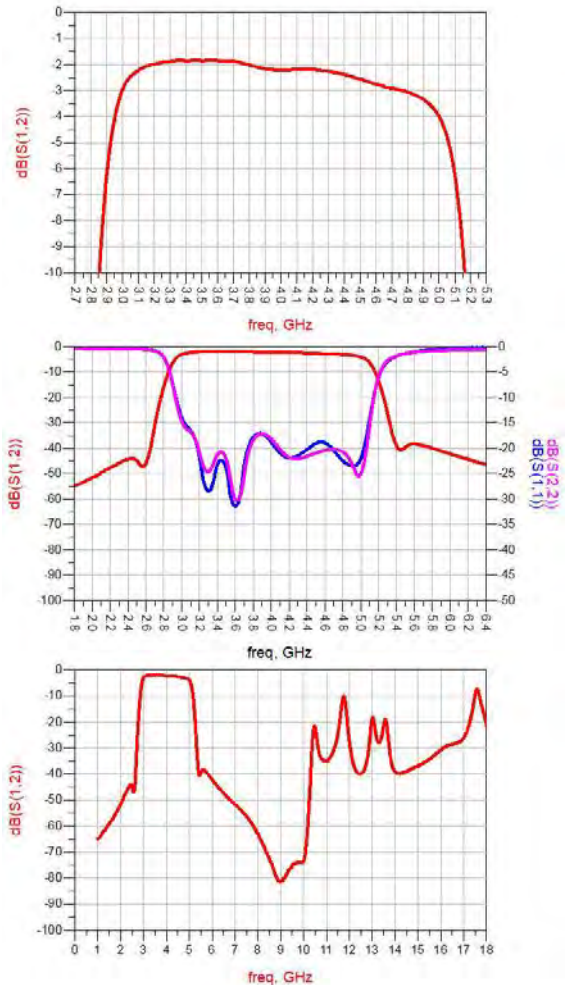


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	7.5	0.381	mm

典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

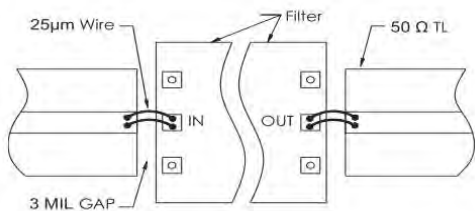
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		3.5		GHz
工作频率	3.1		3.9	GHz
中心损耗		2.3	2.8	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-2.3GHz	40	45	dBc
	@4.7-8.2GHz	35	40	dBc

环境要求

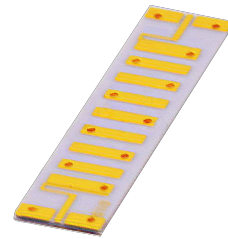
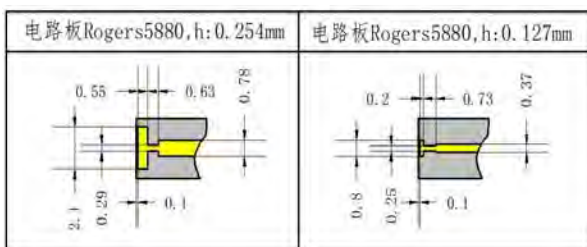
最大输入功率	30	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

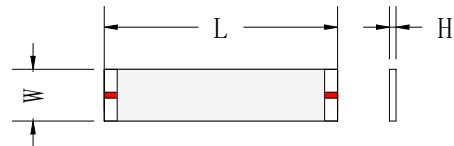


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

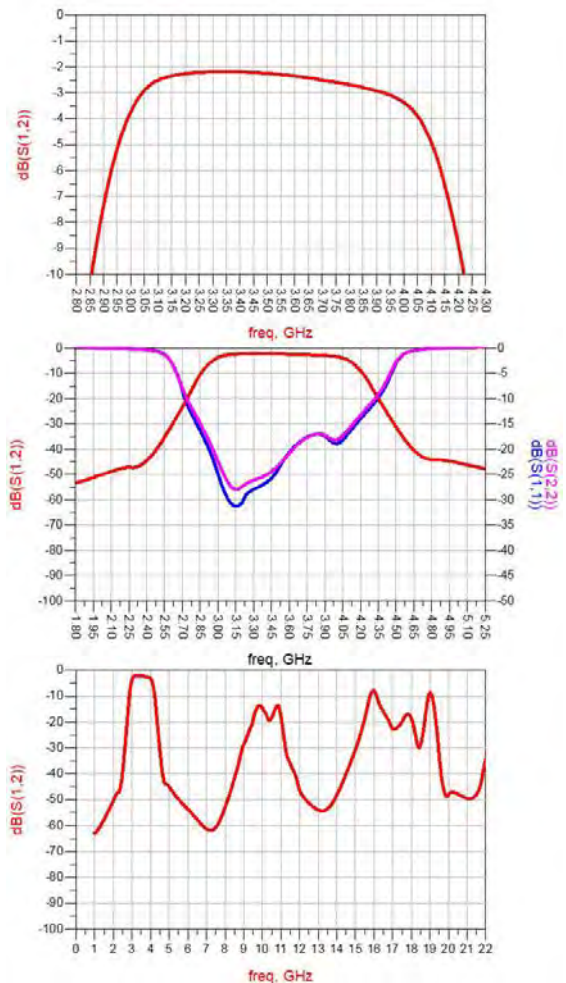


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	8.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



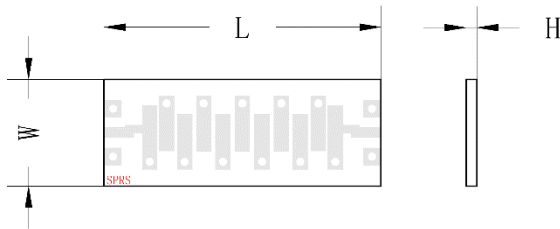
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

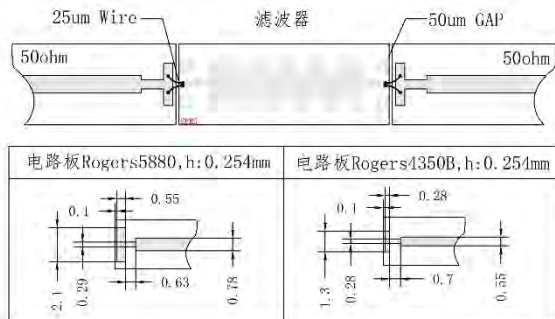
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		3.1		GHz
工作频率		/		GHz
中心损耗		4.5	5.0	dB
带内波动		/		dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-2.65GHz	43	48		dBc
带外抑制@3.65-8.5GHz	43	48		dBc
承受功率			24	dBm
工作温度	-55		+85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^{\circ}\text{C}$

外形图: L: 6.5, W: 6.0, H: 0.381, 端口居中



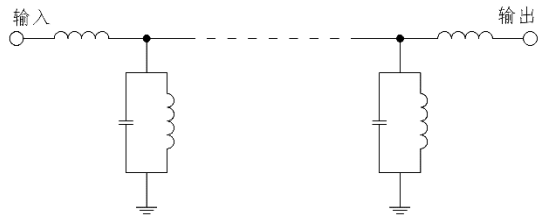
推荐装配图:



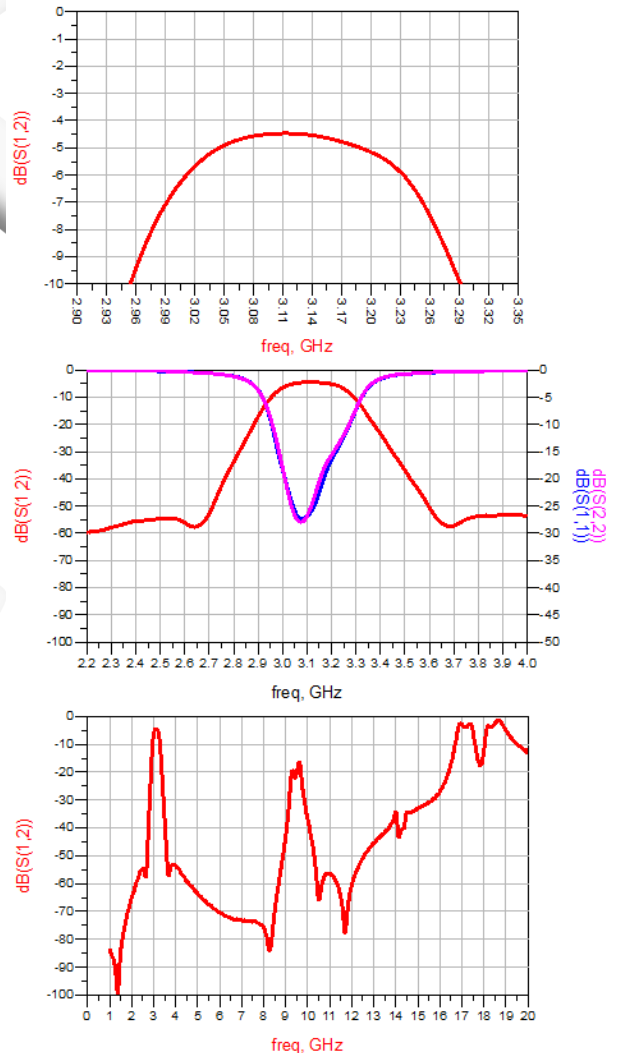
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.62mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^{\circ}\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

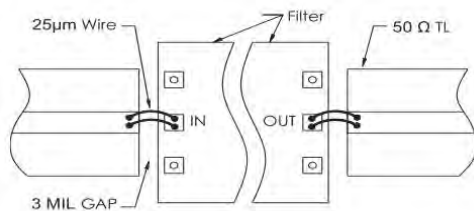
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		3.65		GHz
工作频率	3.2		4.1	GHz
中心损耗		3.1	3.6	dB
带内波动		1.0	1.4	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-2.6GHz	45	50	dBc
	@4.8-7.8GHz	45	50	dBc

环境要求

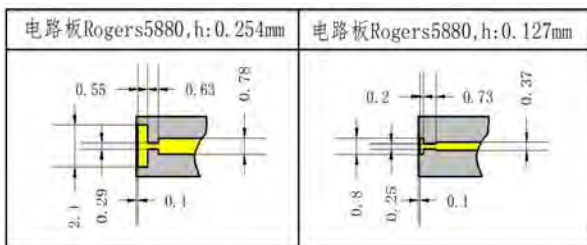
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

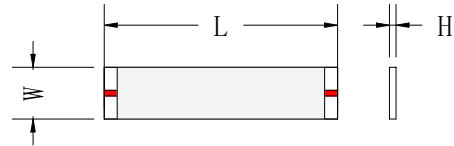
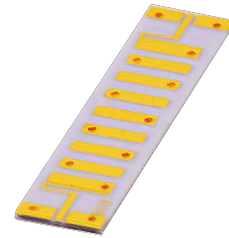


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

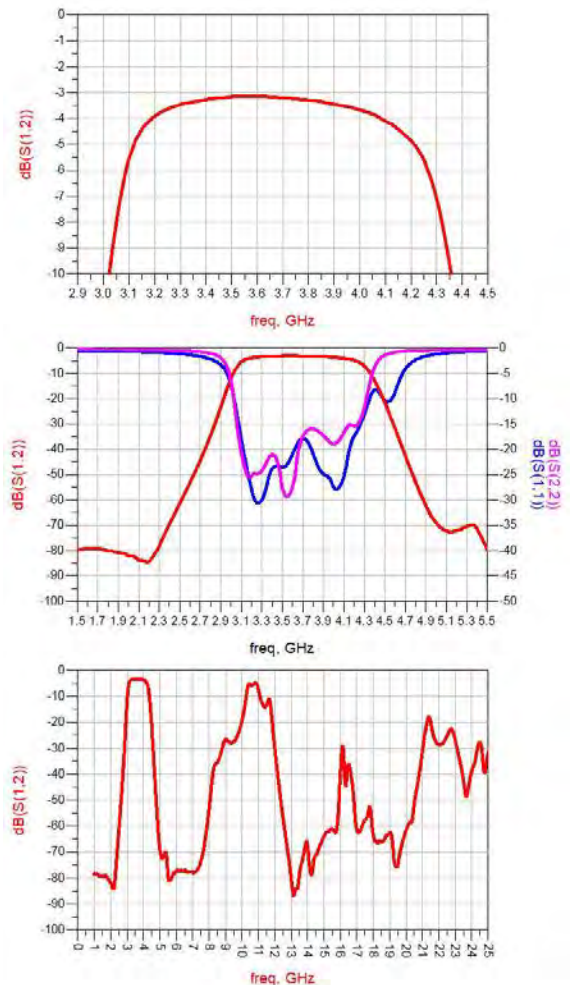


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	10.0	5.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



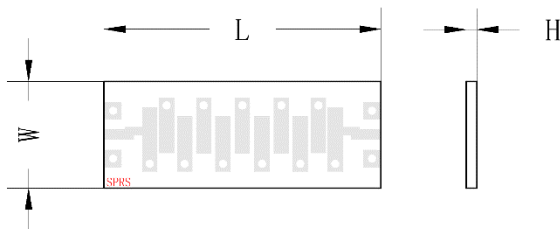
### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

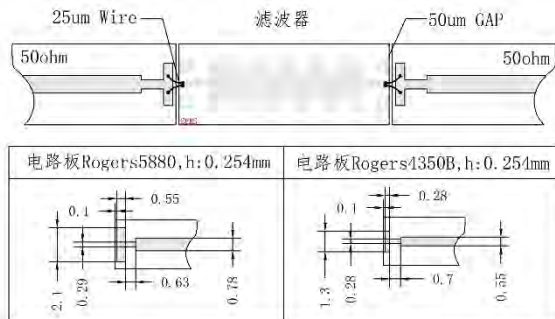
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		3.5		GHz
工作频率	3.3		3.7	GHz
中心损耗		4.6	5.1	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-2.7GHz	35	40		dBc
带外抑制@4.4-8.5GHz	35	40		dBc
承受功率			24	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.0, W: 8.5, H: 0.254, 端口居中



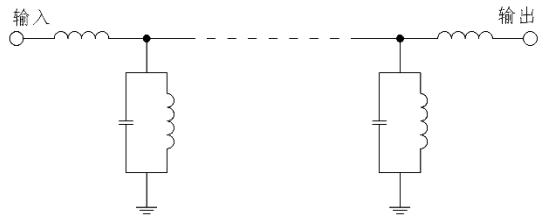
### 推荐装配图:



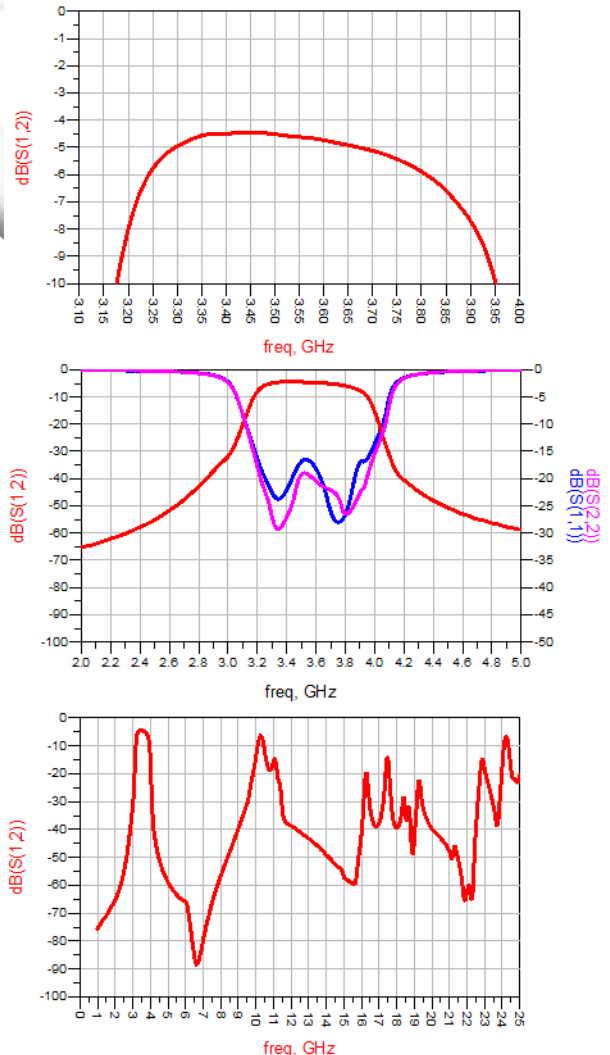
### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

### 原理图



### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

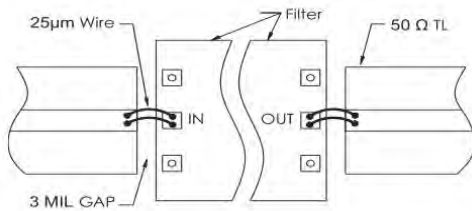
### 技术要求, $T_A = 25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		3.45		GHz
工作频率	3.4		3.5	GHz
中心损耗		3.9	4.5	dB
带内波动		0.3	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-3.0GHz	45	50	dBc
	@4.0-8.0GHz	45	50	dBc

### 环境要求

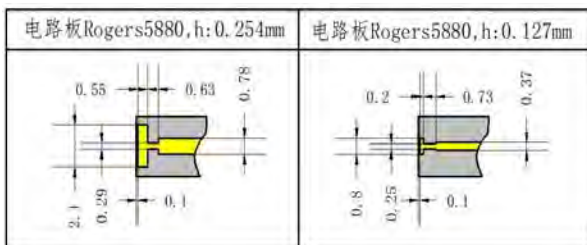
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

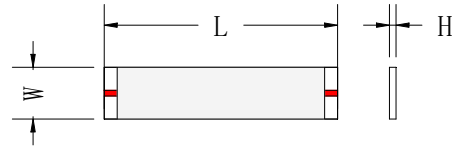
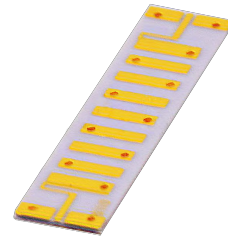


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.62mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

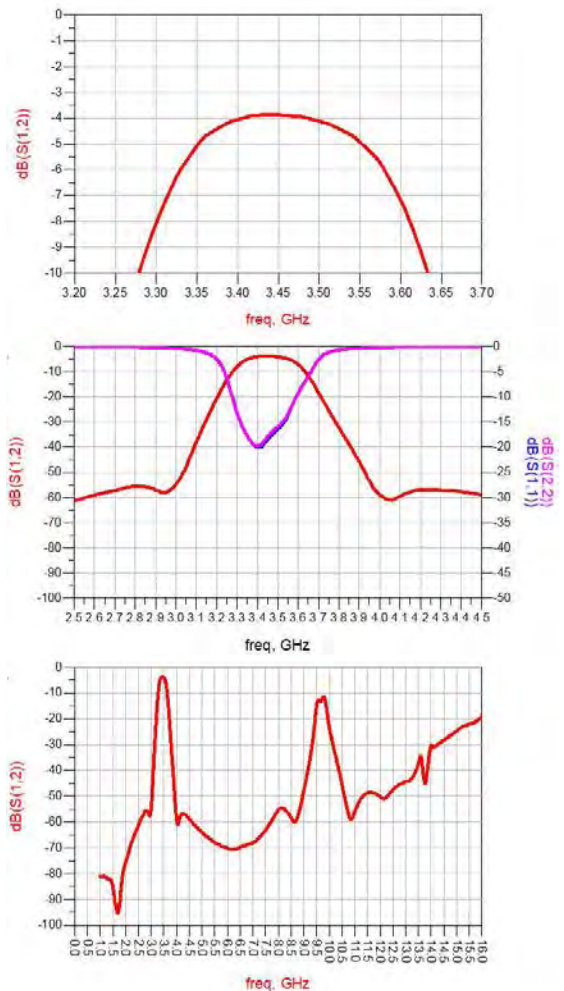


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	6.0	0.381	mm

### 典型曲线, $T_A = 25^\circ\text{C}$



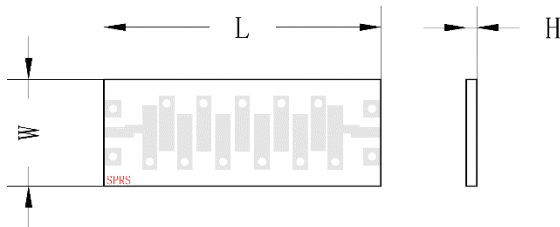
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

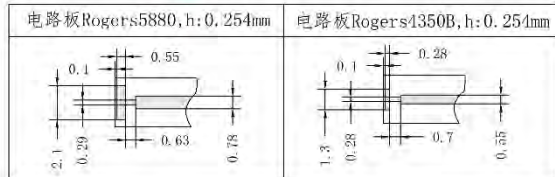
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		3.6		GHz
工作频率		/		GHz
中心损耗		4.5	5.0	dB
带内波动		/		dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-3.15GHz	43	48		dBc
带外抑制@4.15-9.0GHz	43	48		dBc
承受功率			24	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 6.5, W: 6.0, H: 0.381, 端口居中



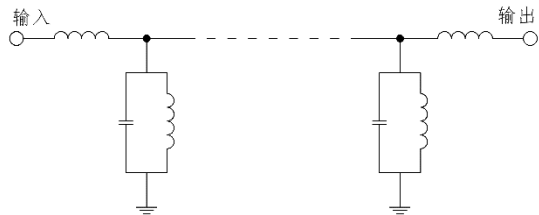
推荐装配图:



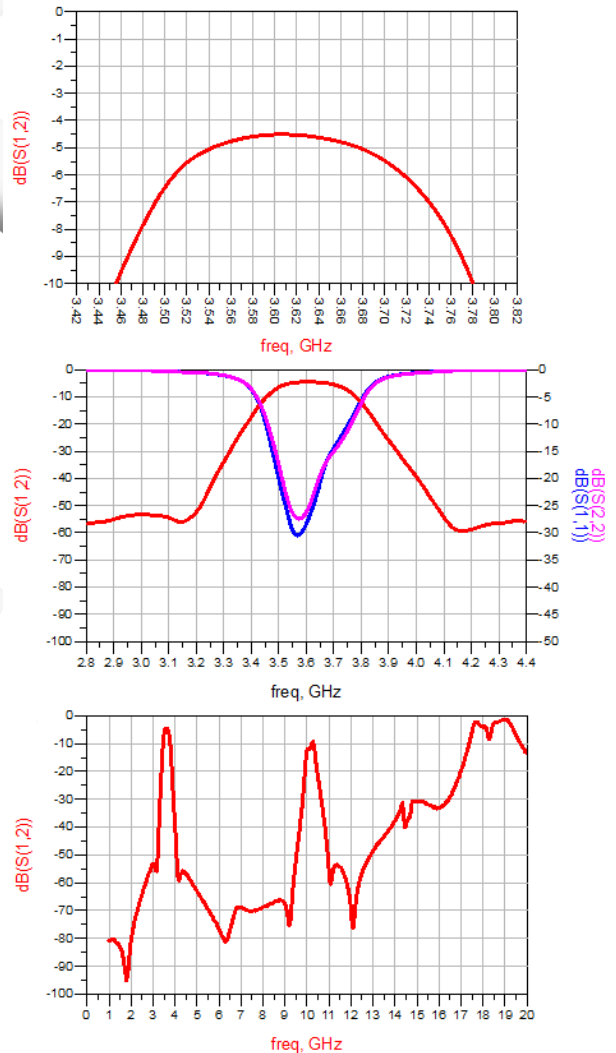
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.62mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



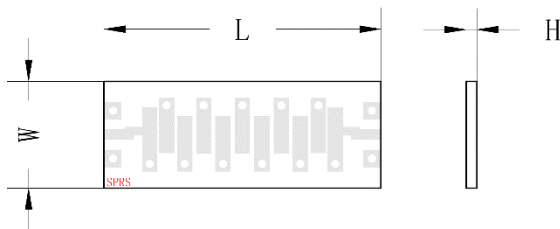
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

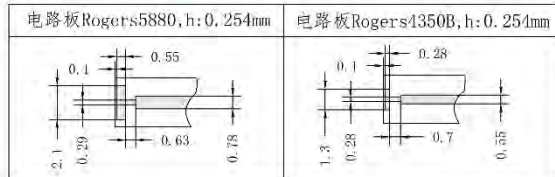
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		4.35		GHz
工作频率	3.7		5.0	GHz
中心损耗		1.9	2.4	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-2.9GHz	40	45		dBc
带外抑制@5.0-10.5GHz	35	40		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 6.5, W: 7.5, H: 0.254, 端口居中



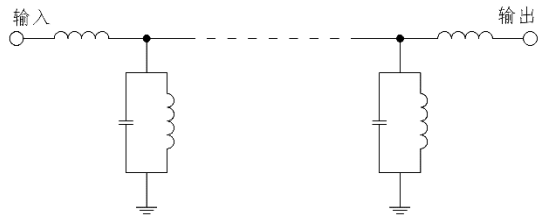
推荐装配图:



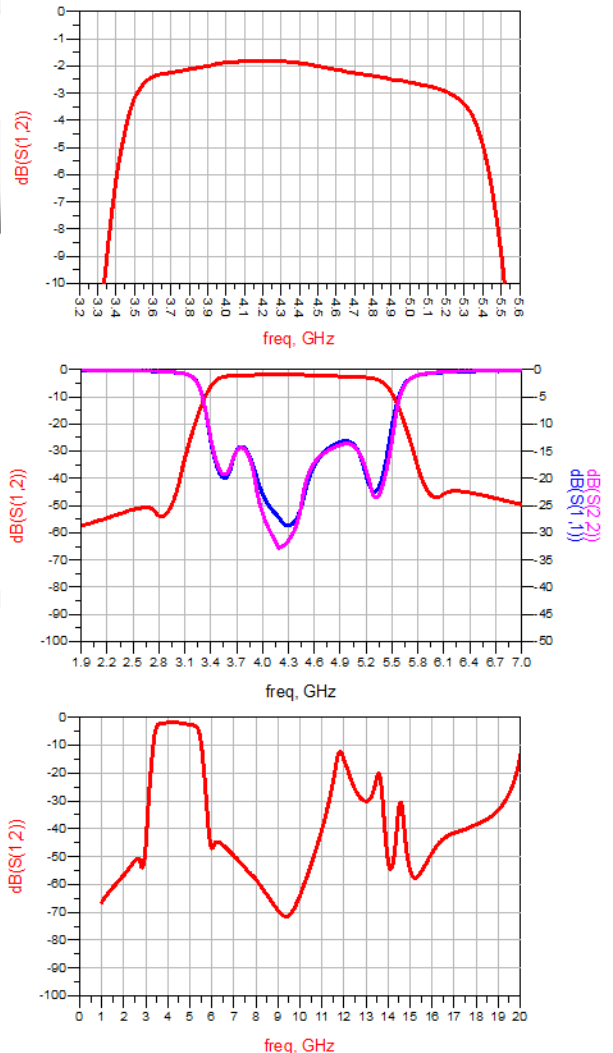
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钎铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

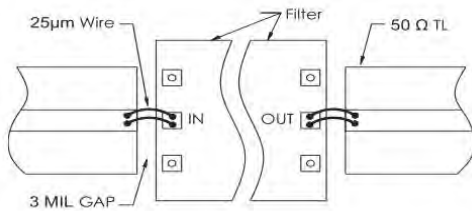
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		4.4		GHz
工作频率	3.9		4.9	GHz
中心损耗		2.6	3.1	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-3.0GHz	45	50	dBc
	@5.8-12.0GHz	35	40	dBc

环境要求

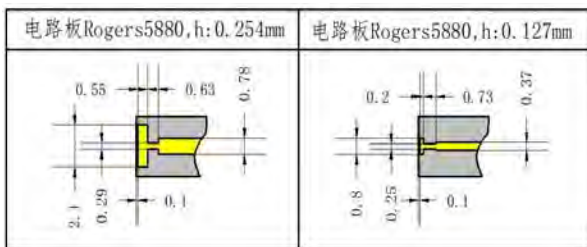
最大输入功率	30	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

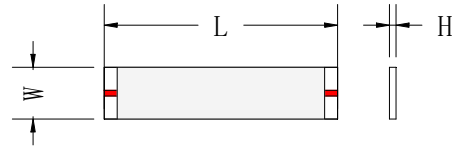
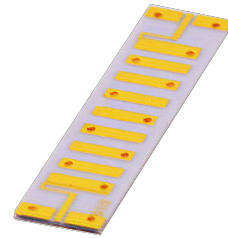


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

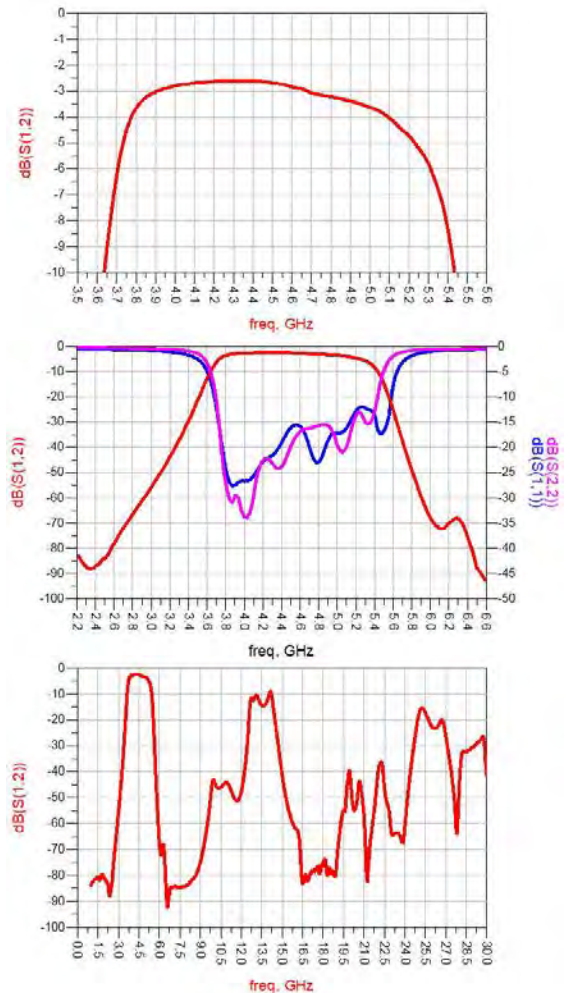


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	10.0	4.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

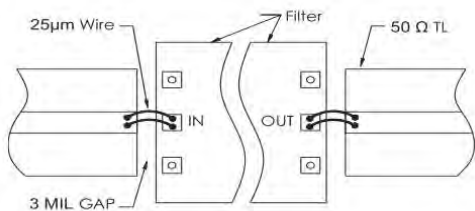
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		5.75		GHz
工作频率	3.9		7.6	GHz
中心损耗		2.4	2.8	dB
带内波动		1.6	2.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-2.0GHz	33	38	dBc
	@9.0-14.5GHz	25	30	dBc

### 环境要求

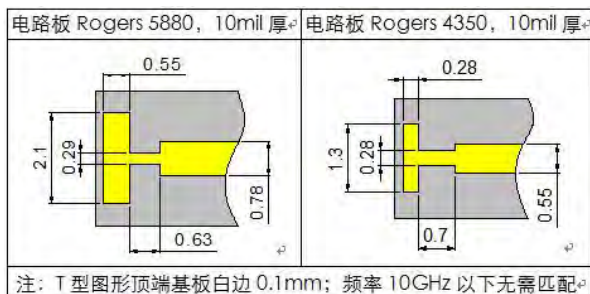
最大输入功率	25	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

### 推荐装配图

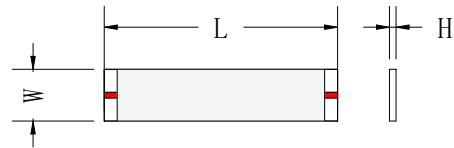
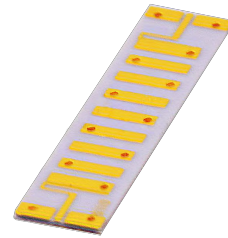


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

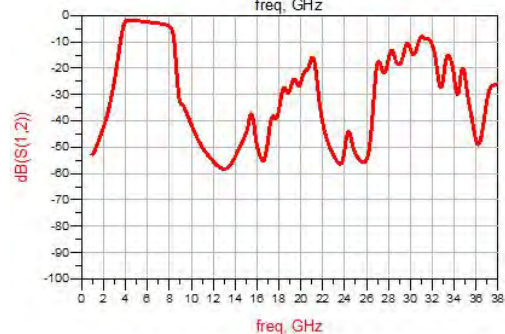
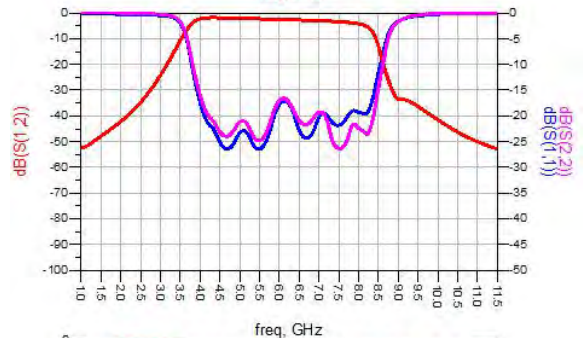


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	5.0	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

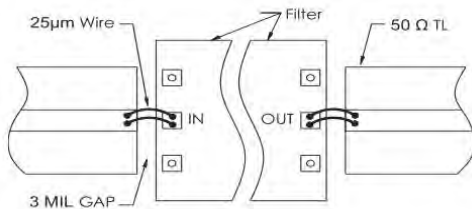
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		3.96		GHz
工作频率	3.91		4.01	GHz
中心损耗		4.6	5.2	dB
带内波动		0.3	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-3.5GHz	40	45	dBc
	@4.5-10.0GHz	45	50	dBc

### 环境要求

最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

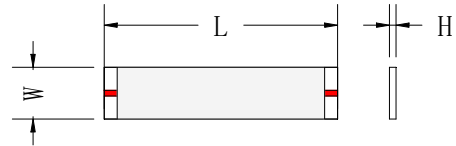
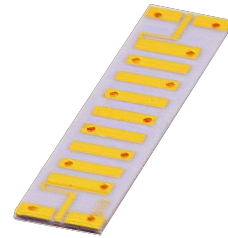


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.62mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

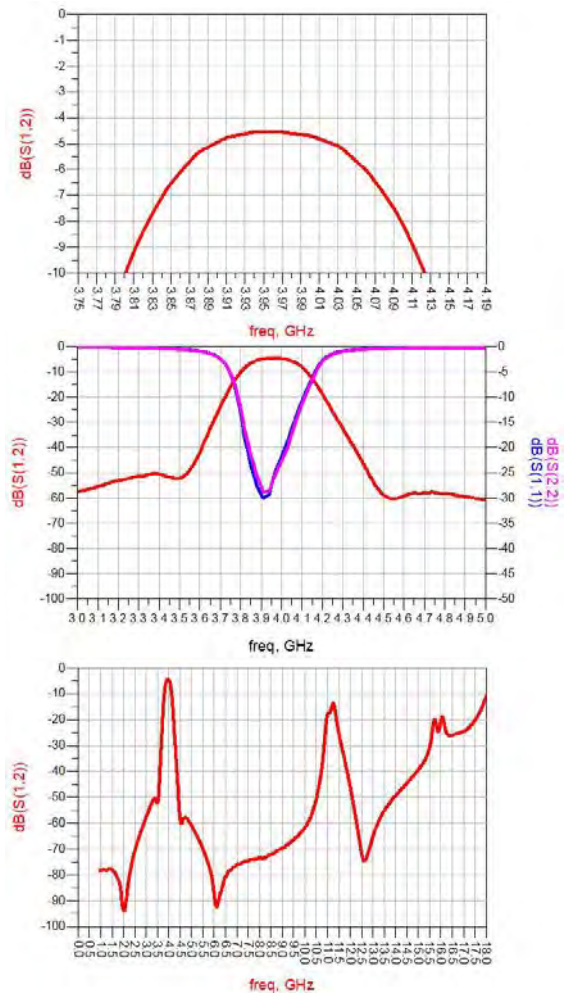
电路板Rogers5880, h: 0.254mm	电路板Rogers5880, h: 0.127mm

### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	5.5	0.381	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



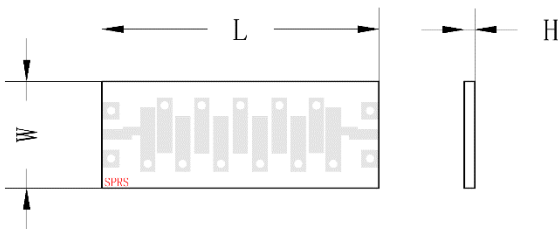
### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

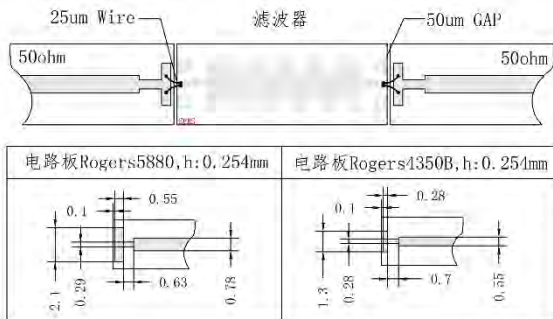
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		4.2		GHz
工作频率	3.95		4.45	GHz
中心损耗		4.0	4.5	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-3.3GHz	35	40		dBc
带外抑制@5.3-10.5GHz	35	40		dBc
承受功率			27	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.0, W: 7.0, H: 0.254, 端口居中



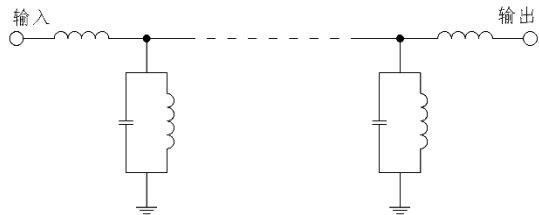
### 推荐装配图:



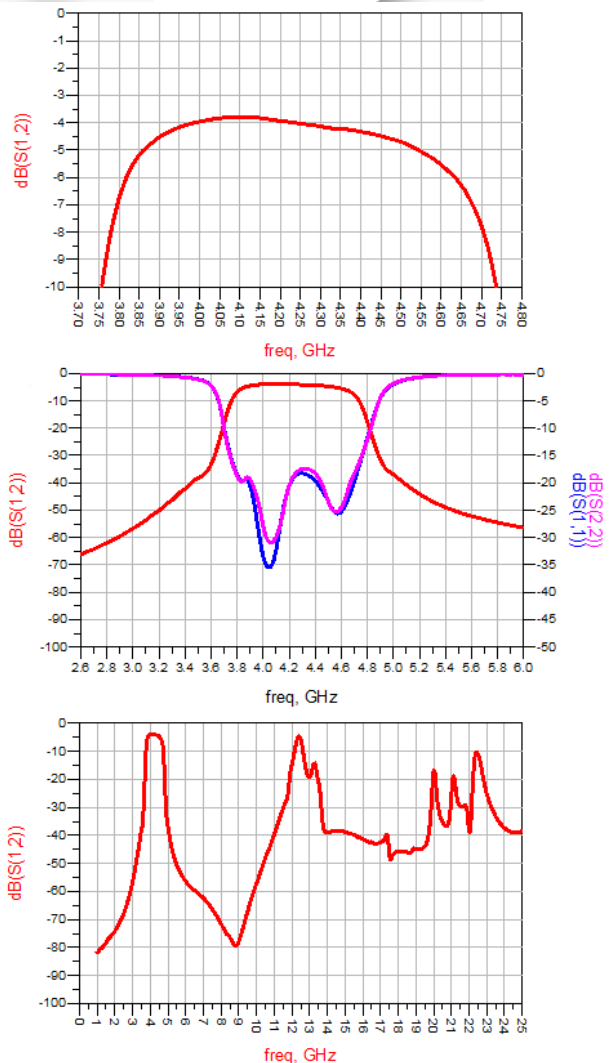
### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

### 原理图



### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

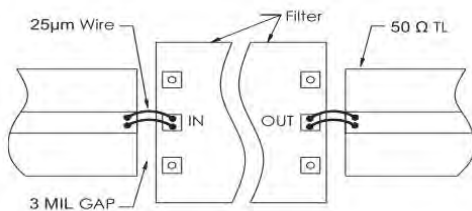
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		4.5		GHz
工作频率	4.0		5.0	GHz
中心损耗		2.3	2.8	dB
带内波动		0.8	1.2	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-3.3GHz	40	45	dBc
	@5.8-10.2GHz	40	45	dBc

环境要求

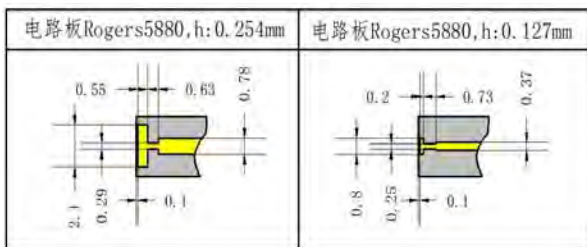
最大输入功率	30	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

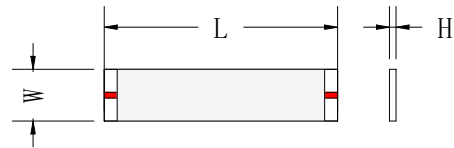
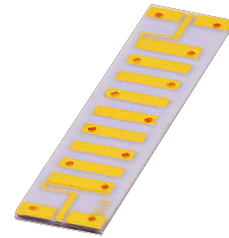


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

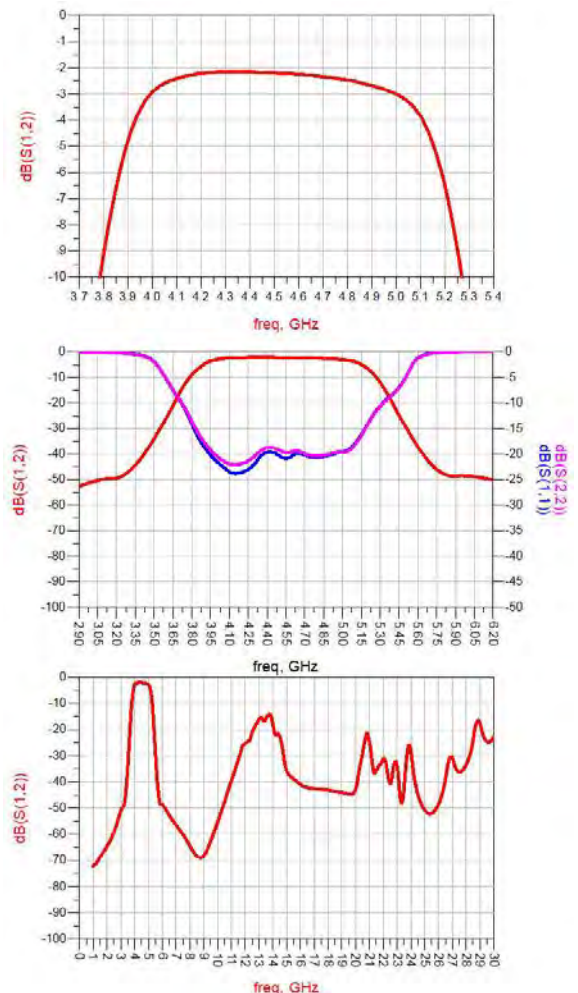


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	7.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



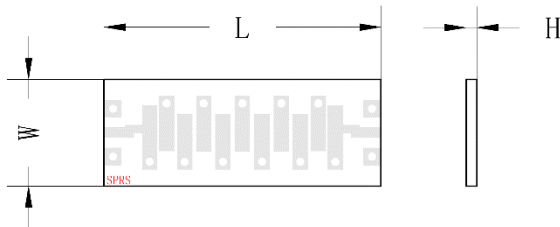
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

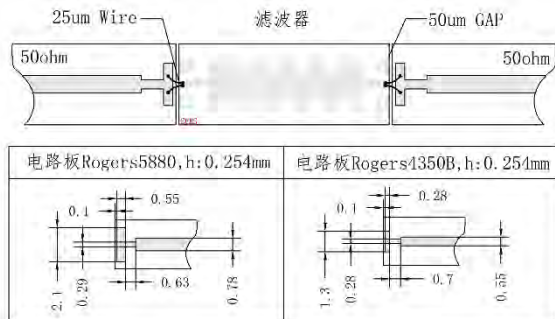
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		5.0		GHz
工作频率	4.0		6.0	GHz
中心损耗		1.4	1.8	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-2.7GHz	25	30		dBc
带外抑制@7.1-12.5GHz	25	30		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 5.5, W: 6.0, H: 0.254, 端口居中



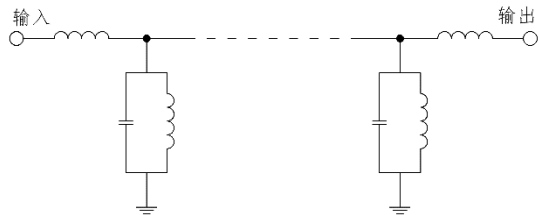
推荐装配图:



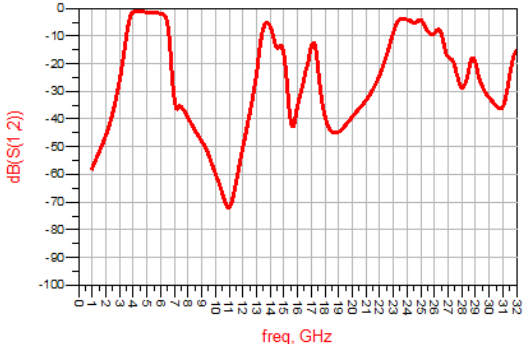
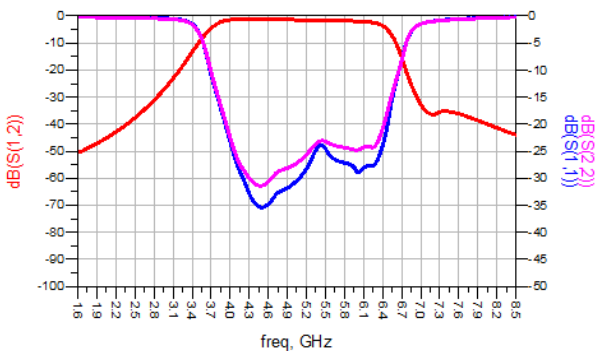
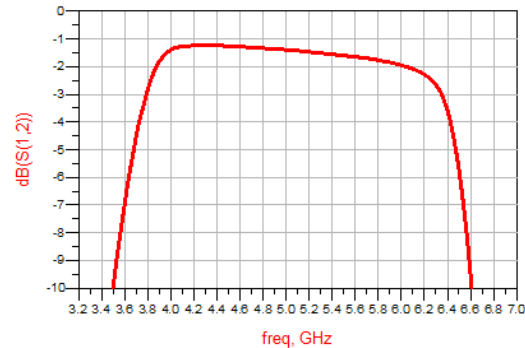
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



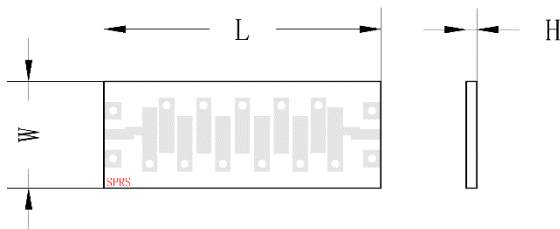
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

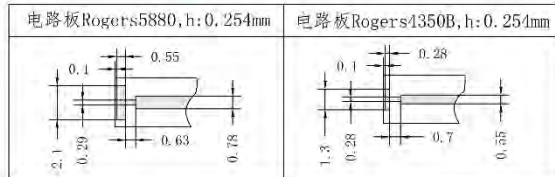
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		4.1		GHz
工作频率		/		GHz
中心损耗		4.5	5.0	dB
带内波动		/		dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-3.65GHz	38	43		dBc
带外抑制@4.65-10.5GHz	43	48		dBc
承受功率			20	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 6.5, W: 5.0, H: 0.381, 端口居中



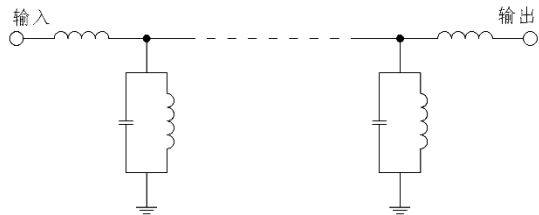
推荐装配图:



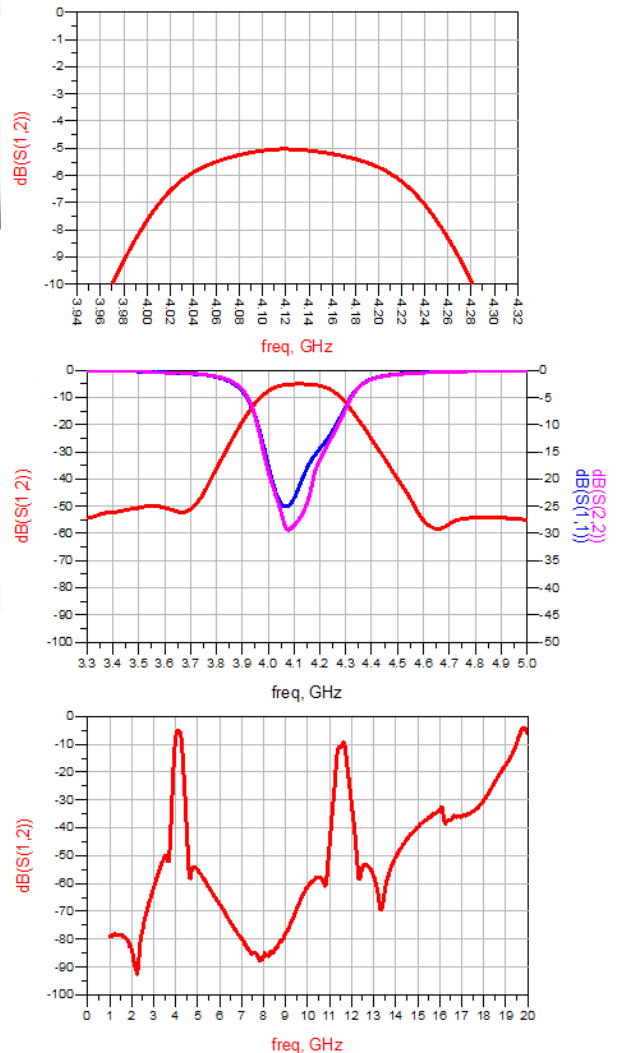
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.62mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

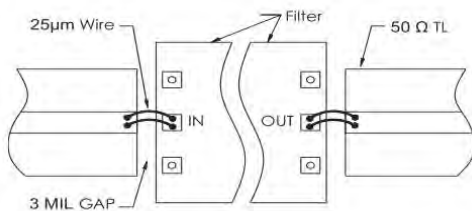
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		5.4		GHz
工作频率	4.2		6.6	GHz
中心损耗		1.6	2.0	dB
带内波动		1.1	1.5	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-3.6GHz	38	43	dBc
	@7.6-14.0GHz	38	43	dBc

环境要求

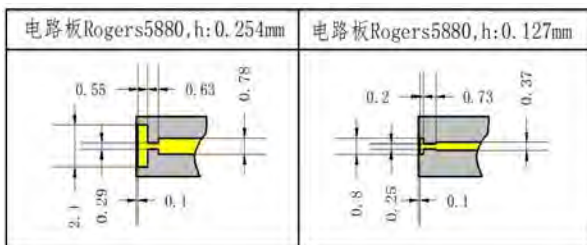
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

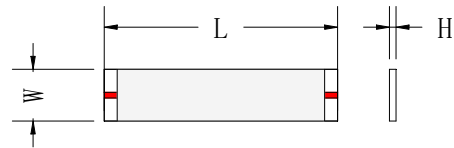
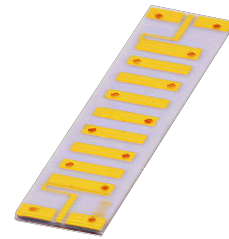


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

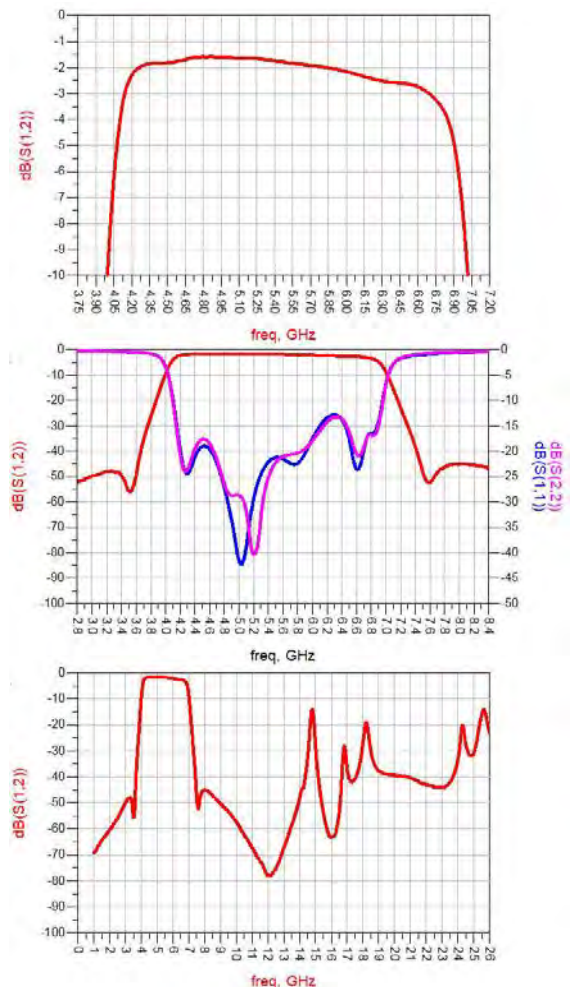


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	5.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

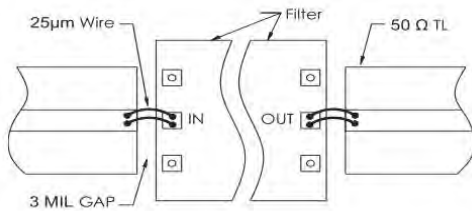
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		4.7		GHz
工作频率	4.4		5.0	GHz
中心损耗		4.0	4.5	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@DC-3.85GHz	40	45	dBc
	@5.8-8.0GHz	40	45	dBc

环境要求

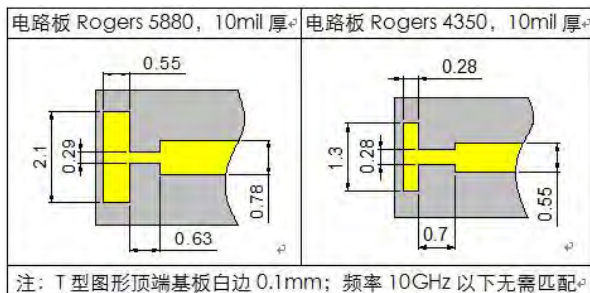
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

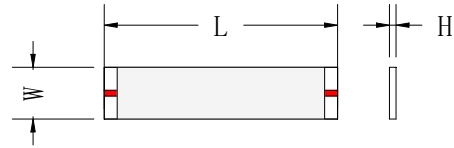
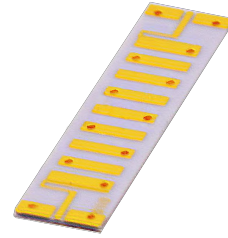


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

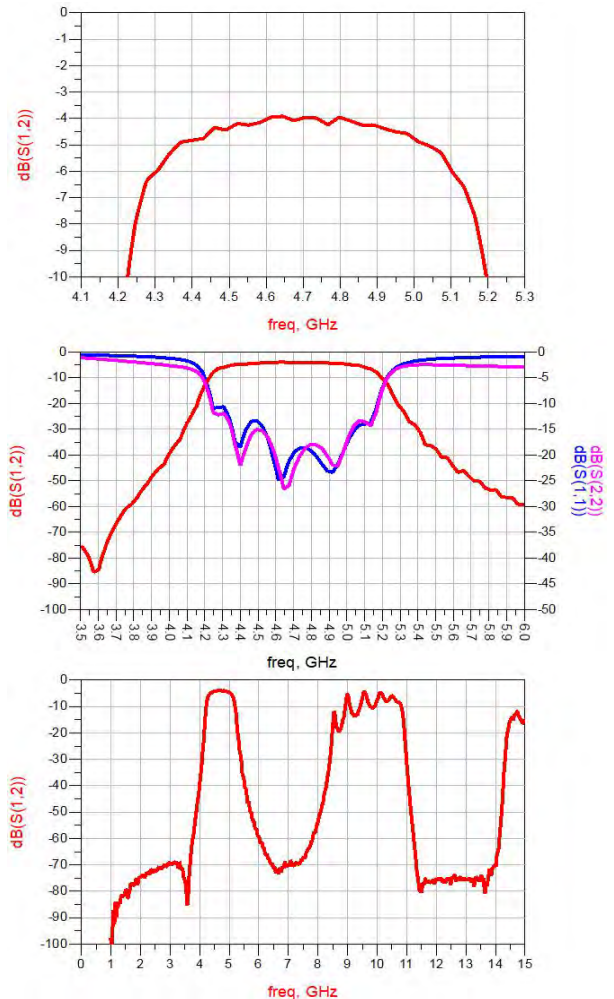


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	6.3	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

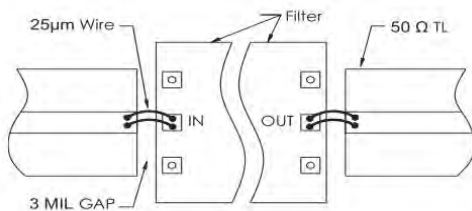
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		4.47		GHz
工作频率	4.42		4.52	GHz
中心损耗		4.7	5.3	dB
带内波动		0.3	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-4.0GHz	38	43	dBc
	@5.0-12.0GHz	45	50	dBc

### 环境要求

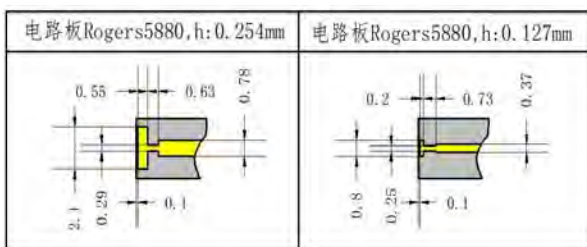
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

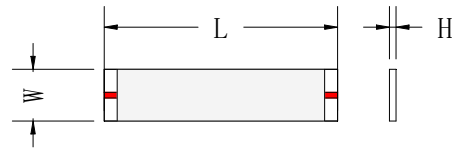
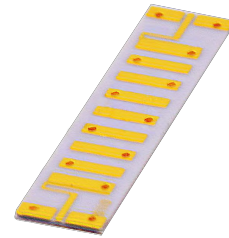


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.62mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

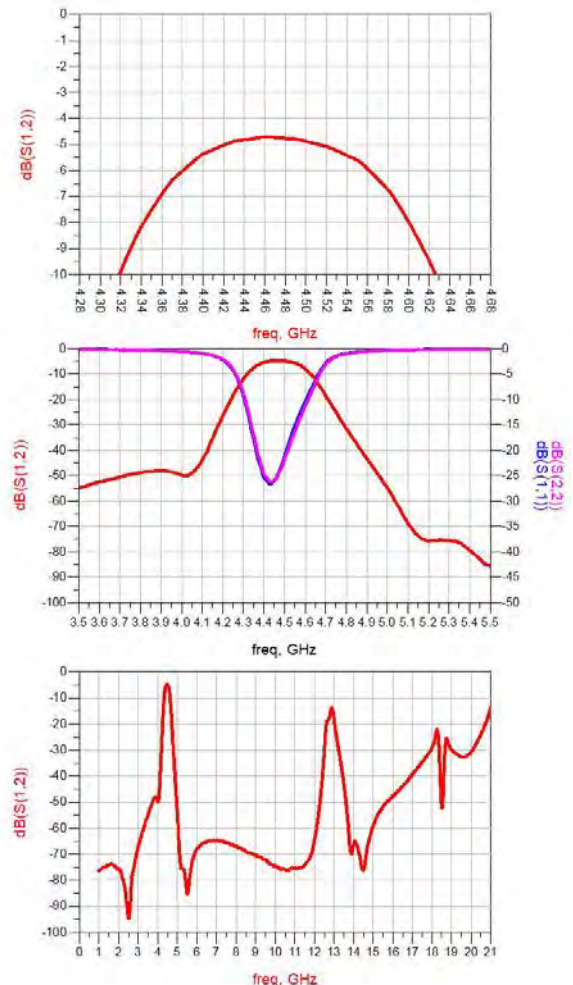


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	5.5	0.381	mm

### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

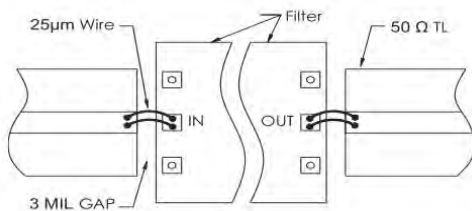
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		5.0		GHz
工作频率	4.5		5.5	GHz
中心损耗		2.6	3.1	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-3.7GHz	40	45	dBc
	@6.4-11.5GHz	40	45	dBc

### 环境要求

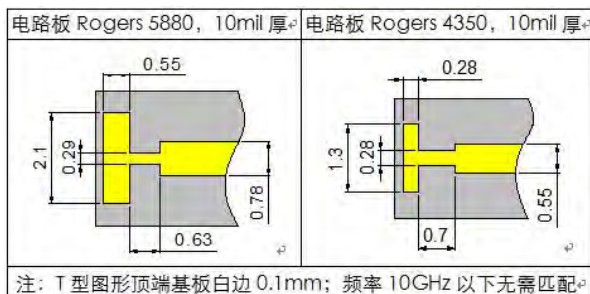
最大输入功率	30	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

### 推荐装配图

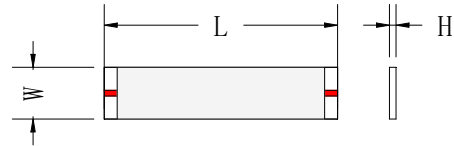
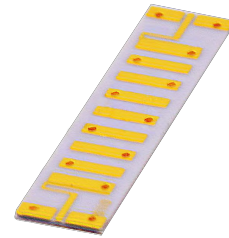


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

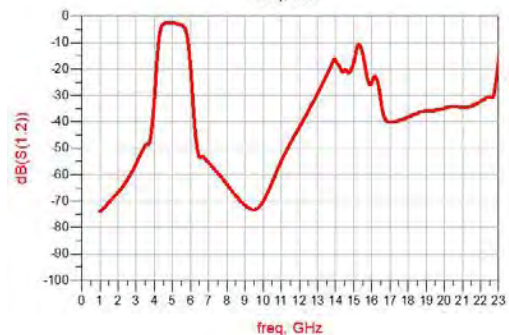
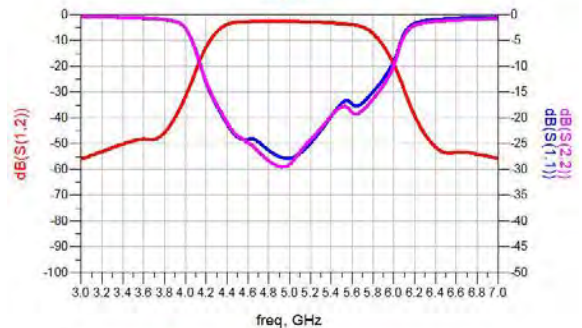


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	6.5	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



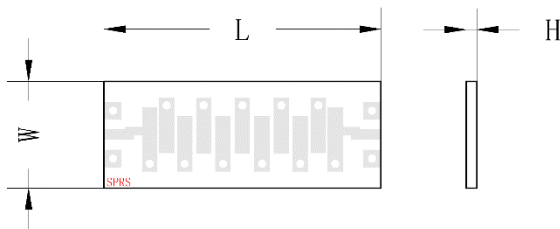
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

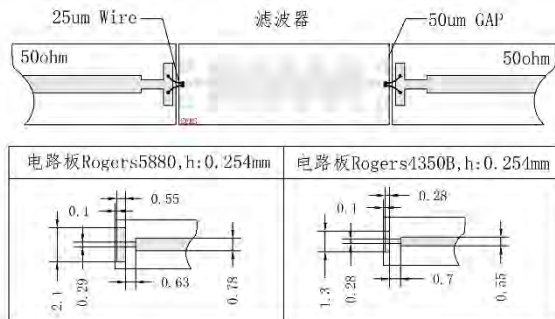
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		5.15		GHz
工作频率	4.55		5.75	GHz
中心损耗		2.1	2.6	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-3.7GHz	40	45		dBc
带外抑制@6.8-12.0GHz	40	45		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 6.5, W: 6.5, H: 0.254, 端口居中



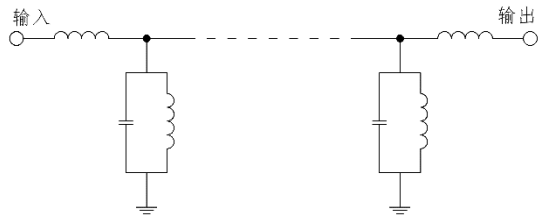
推荐装配图:



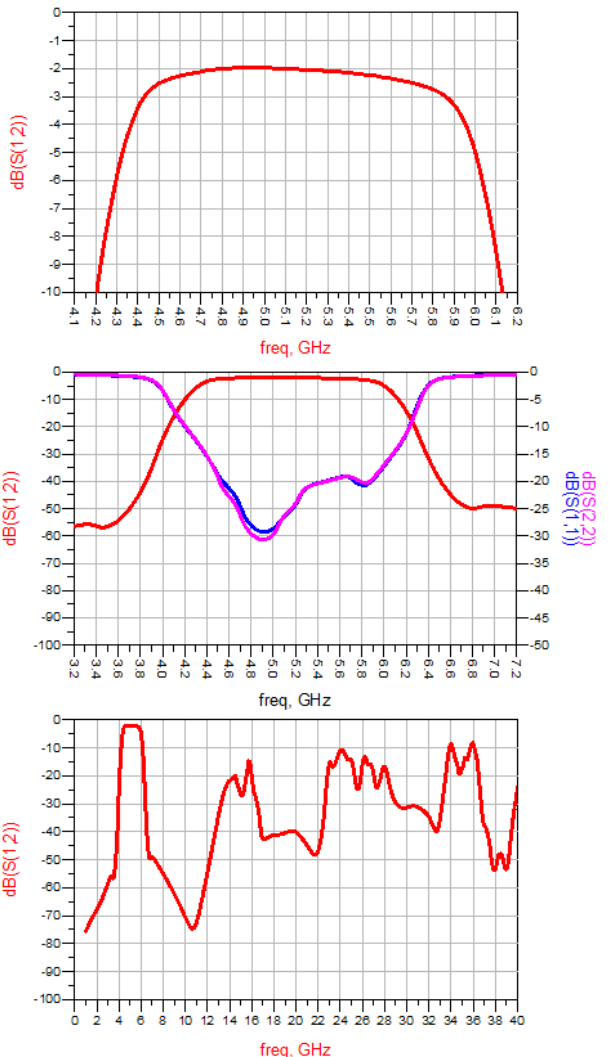
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

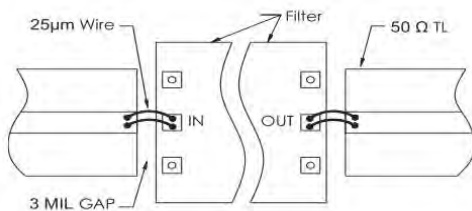
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		4.93		GHz
工作频率	4.88		4.98	GHz
中心损耗		4.7	5.3	dB
带内波动		0.3	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-4.5GHz	36	41	dBc
	@5.4-12.0GHz	45	50	dBc

环境要求

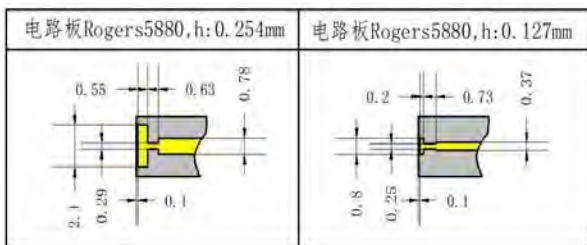
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

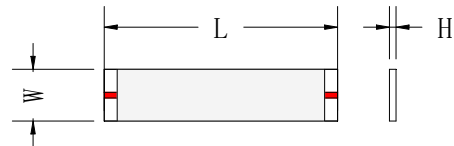
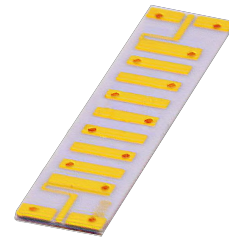


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.62mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

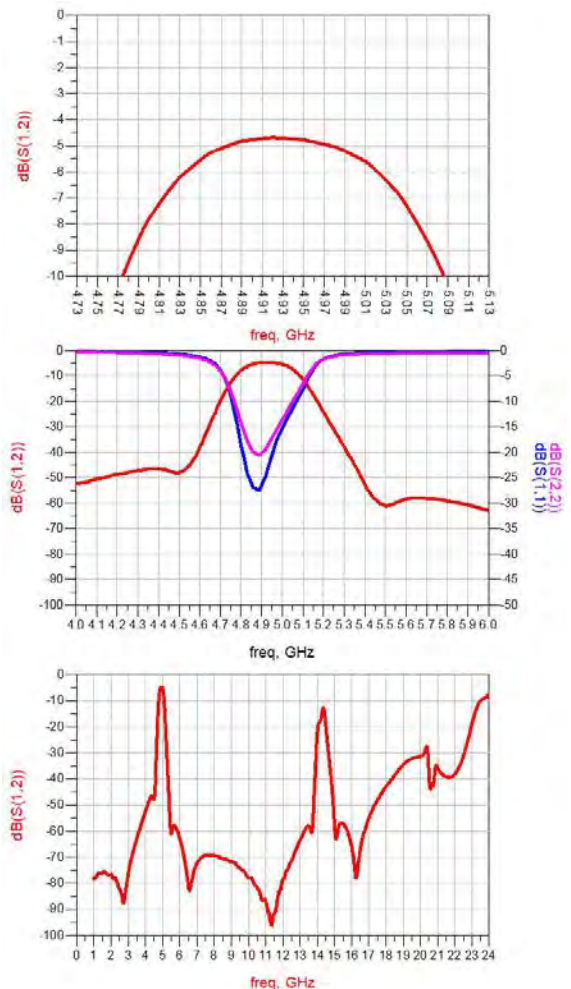


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	5.0	0.381	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



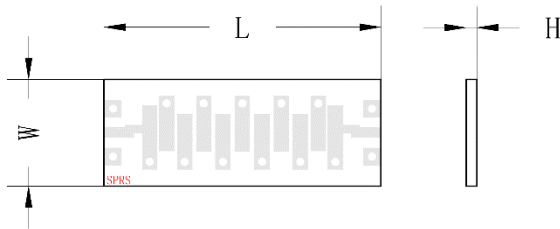
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

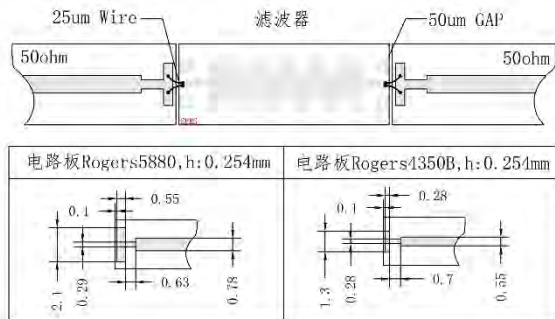
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		6.2		GHz
工作频率	4.9		7.5	GHz
中心损耗		1.6	2.1	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-3.6GHz	50	55		dBc
带外抑制@9.1-15.0GHz	50	55		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.0, W: 5.0, H: 0.254, 端口居中



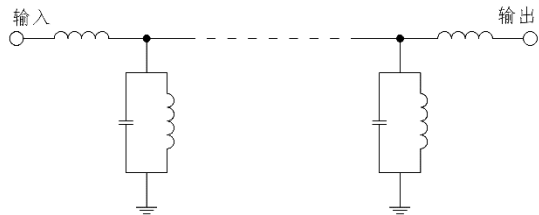
推荐装配图:



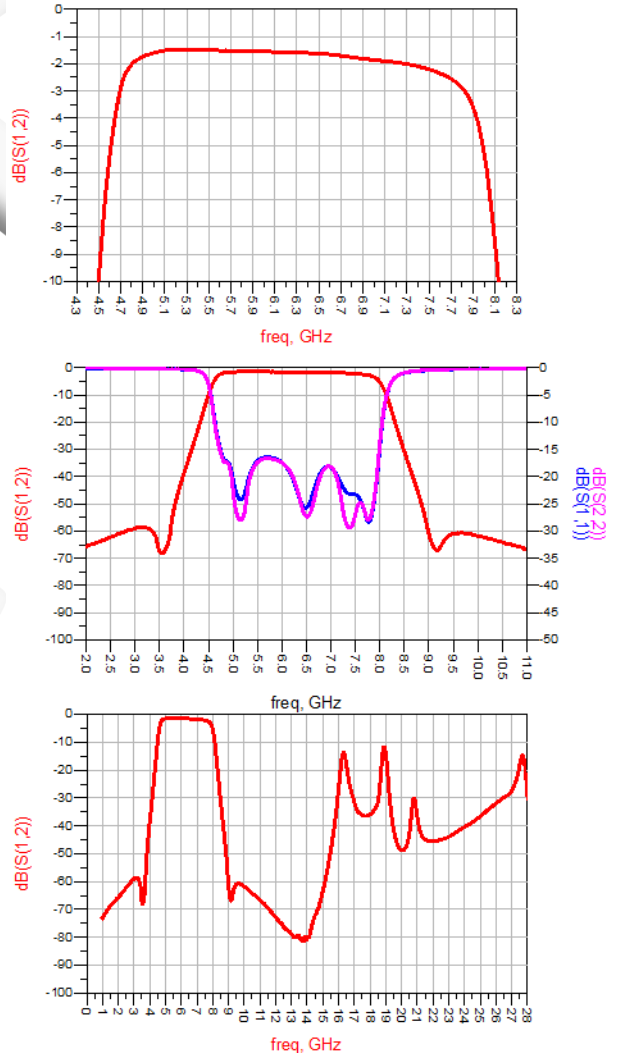
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

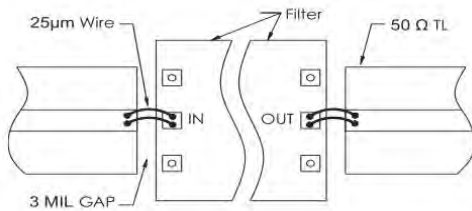
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		5.45		GHz
工作频率	4.95		5.95	GHz
中心损耗		2.1	2.6	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-4.2GHz	40	45	dBc
	@6.8-13.0GHz	35	40	dBc

环境要求

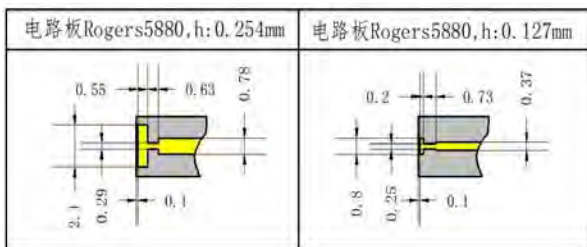
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

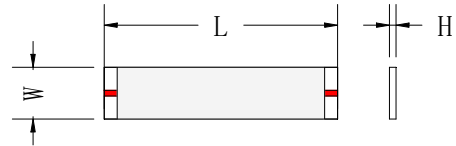
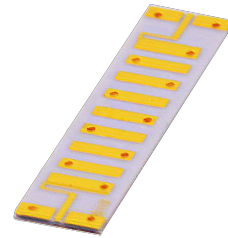


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

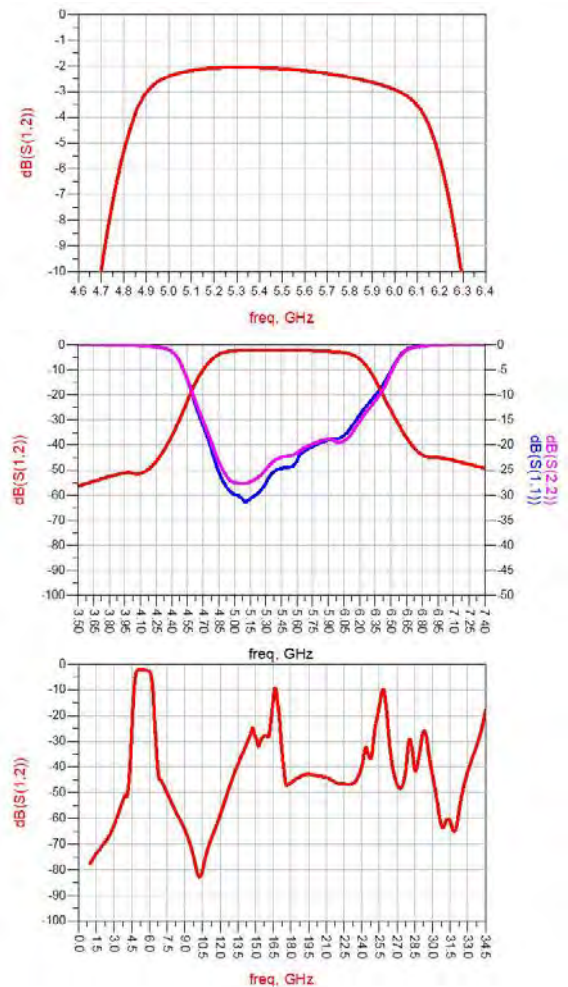


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	6.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



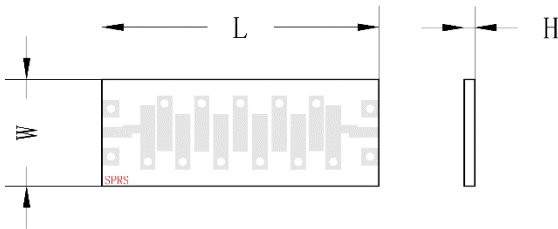
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

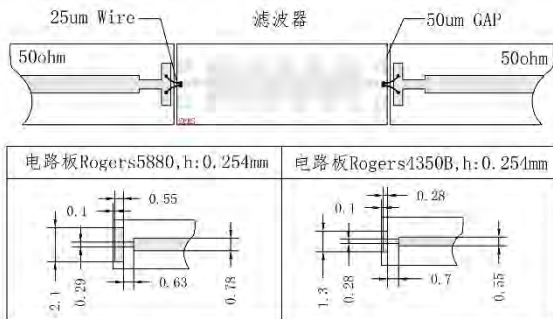
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		6.05		GHz
工作频率	5.0		7.1	GHz
中心损耗		1.7	2.2	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-4.1GHz	38	43		dBc
带外抑制@8.6-21.5GHz	45	50		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 6.5, W: 5.5, H: 0.254, 端口居中



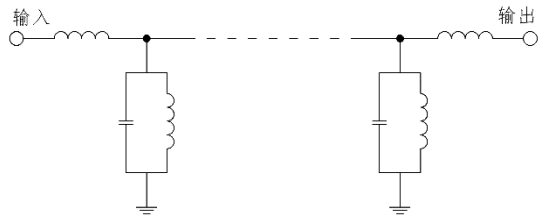
推荐装配图:



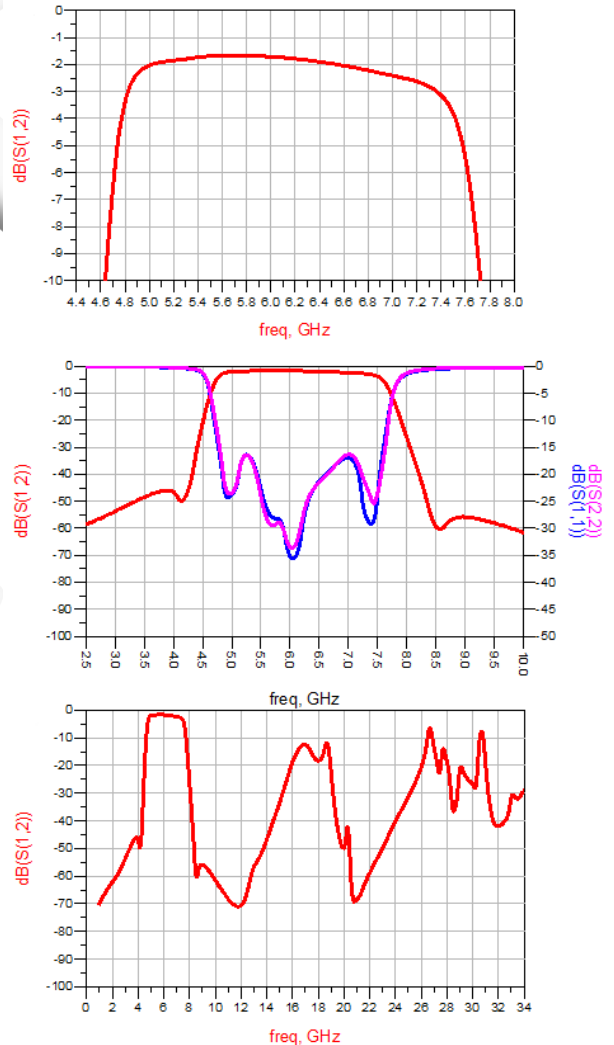
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

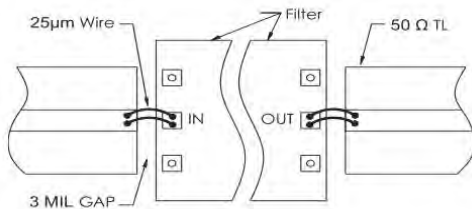
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		5.65		GHz
工作频率	5.15		6.15	GHz
中心损耗		2.2	2.7	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@DC-4.5GHz	40	45	dBc
	@6.9-13.0GHz	40	45	dBc

### 环境要求

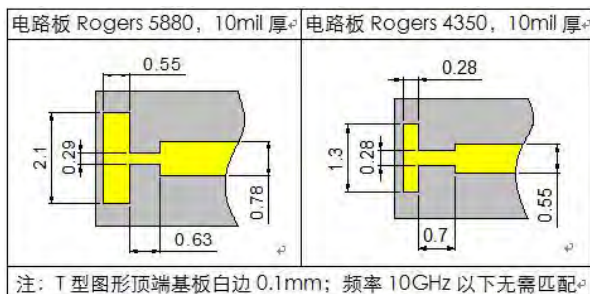
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

### 推荐装配图

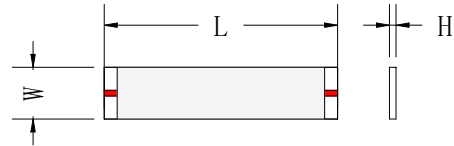
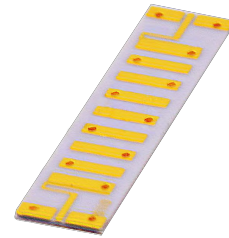


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

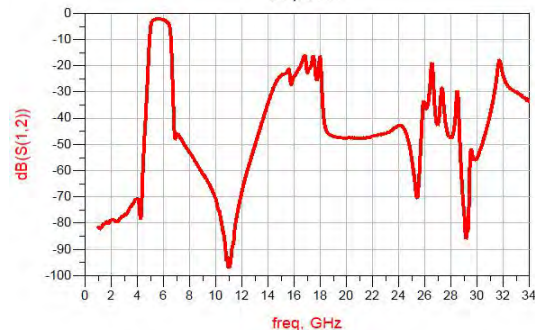
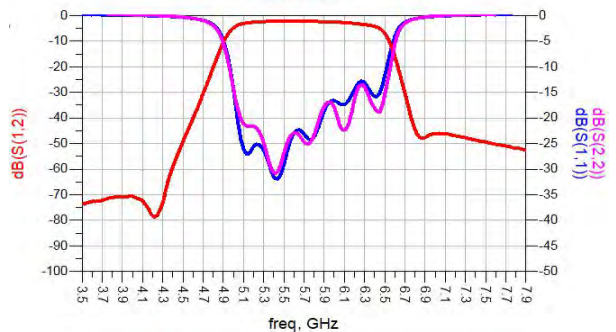


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	5.5	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



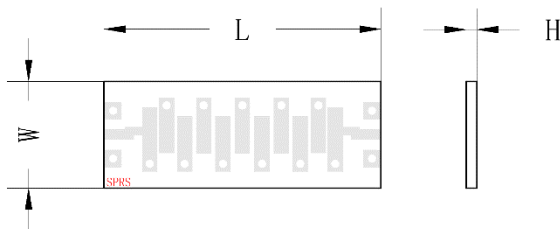
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

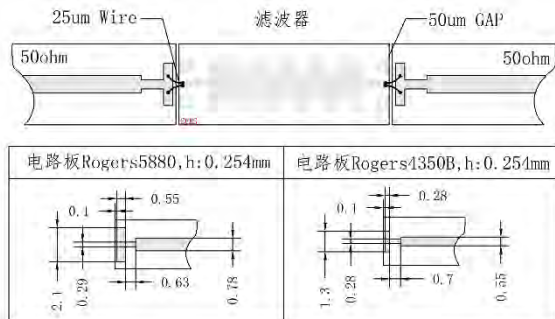
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		5.4		GHz
工作频率		/		GHz
中心损耗		5.5	6.0	dB
带内波动		/		dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-4.95GHz	35	40		dBc
带外抑制@5.95-10.5GHz	45	50		dBc
承受功率			25	dBm
工作温度	-55		+85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^{\circ}\text{C}$

外形图: L: 6.5, W: 4.0, H: 0.381, 端口居中



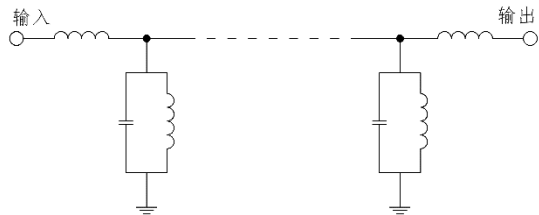
推荐装配图:



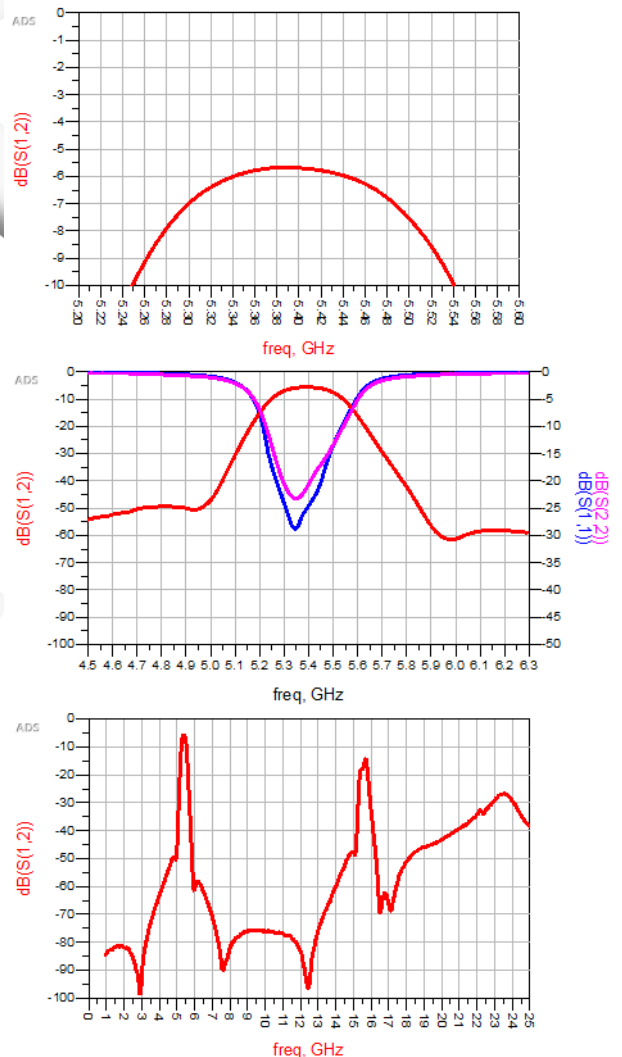
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.62mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^{\circ}\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

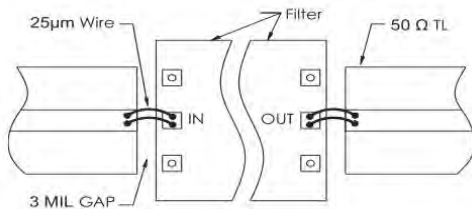
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		6.2		GHz
工作频率	5.7		6.7	GHz
中心损耗		2.8	3.3	dB
带内波动		1.2	1.5	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-5.0GHz	55	60	dBc
	@7.2-14.0GHz	37	42	dBc

### 环境要求

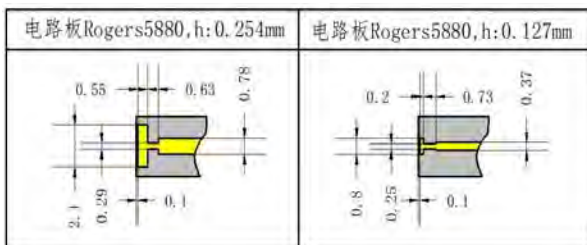
最大输入功率	30	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

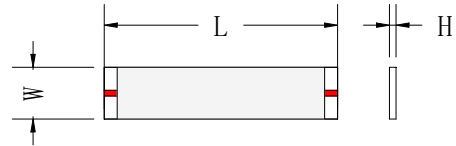
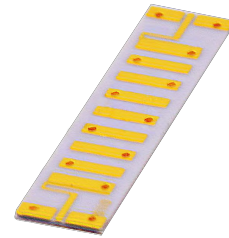


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

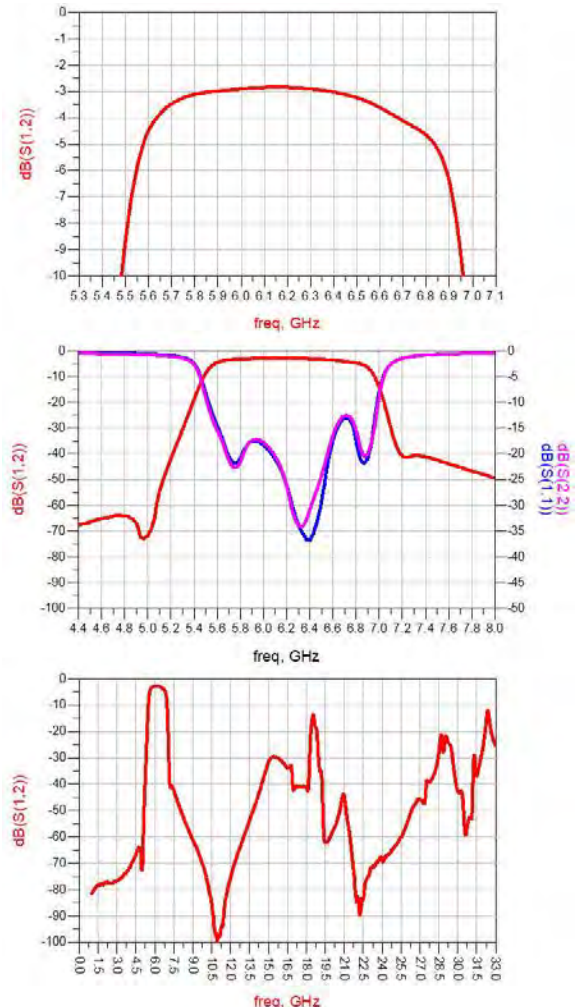


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	5.5	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



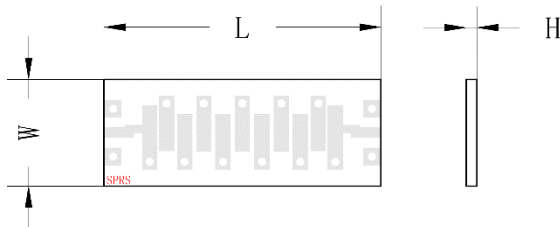
### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

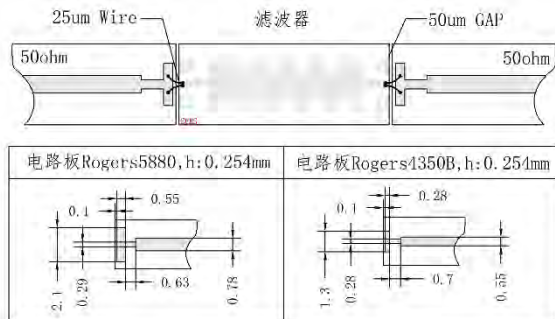
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		8.8		GHz
工作频率	5.9		11.7	GHz
中心损耗		1.4	2.0	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-2.0GHz	35	40		dBc
带外抑制@16.2-18.0GHz	30	35		dBc
承受功率			25	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 4.0, W: 4.0, H: 0.254, 端口居中



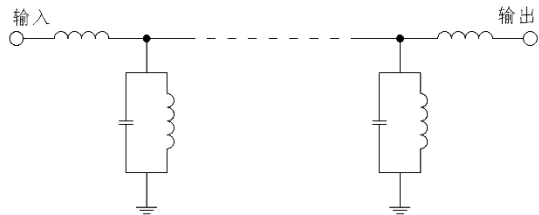
### 推荐装配图:



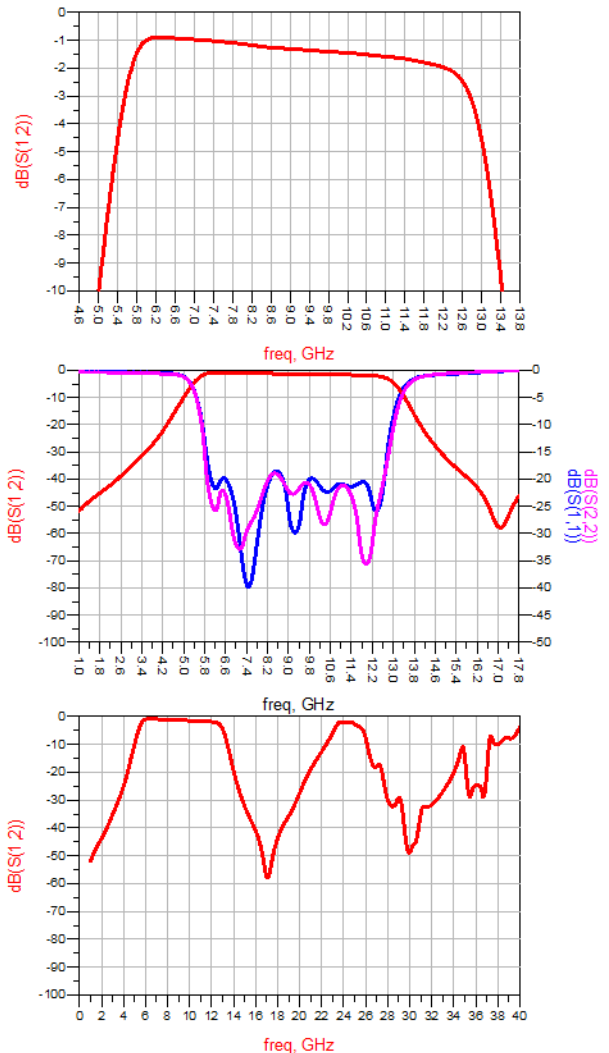
### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**1.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

### 原理图



### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



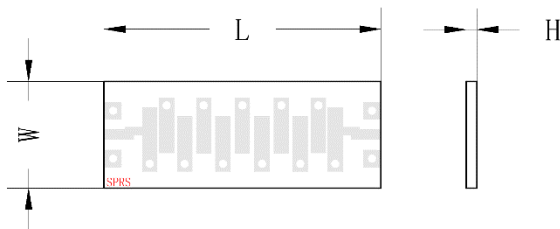
### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

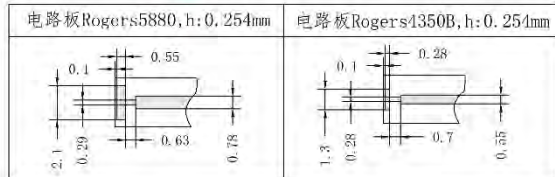
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		6.3		GHz
工作频率	5.9		6.7	GHz
中心损耗		2.7	3.2	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-5.1GHz	45	50		dBc
带外抑制@7.5-14.5GHz	31	36		dBc
承受功率			25	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.0, W: 5.5, H: 0.254, 端口居中



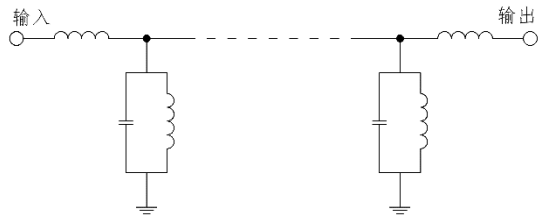
### 推荐装配图:



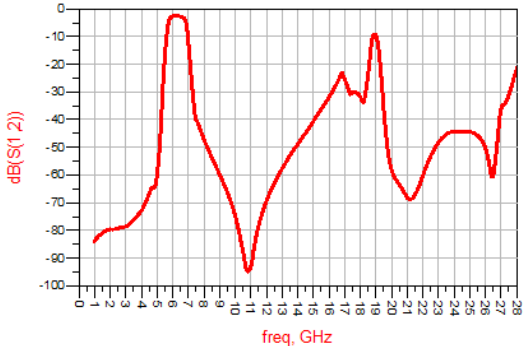
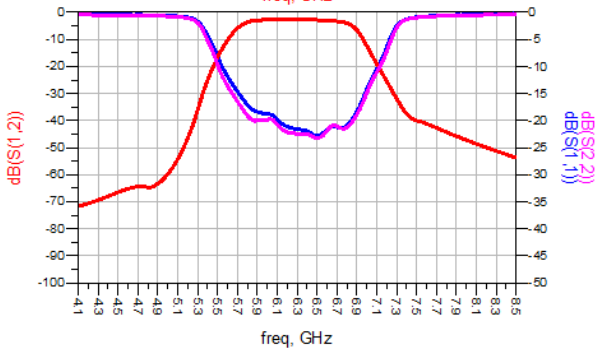
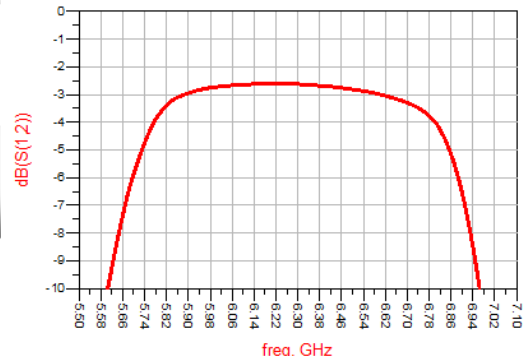
### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**1.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

### 原理图



### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



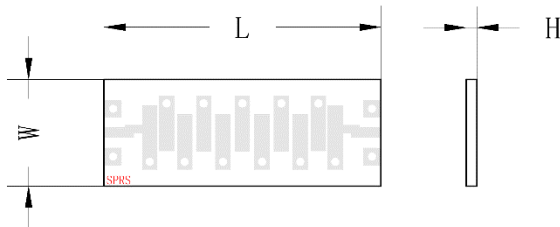
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

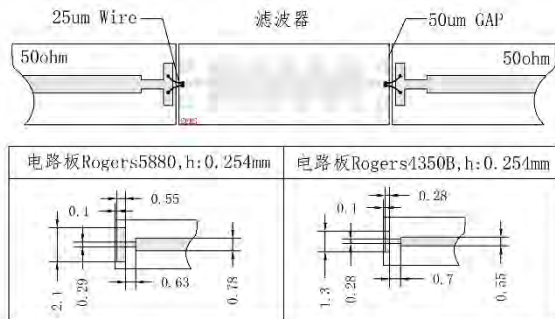
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		6.1		GHz
工作频率	5.95		6.25	GHz
中心损耗		4.5	5.0	dB
带内波动		0.5	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-5.4GHz	40	43		dBc
带外抑制@6.8-14.0GHz	40	43		dBc
承受功率			20	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 8.0, W: 5.5, H: 0.254, 端口居中



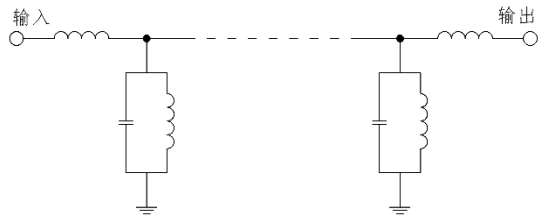
推荐装配图:



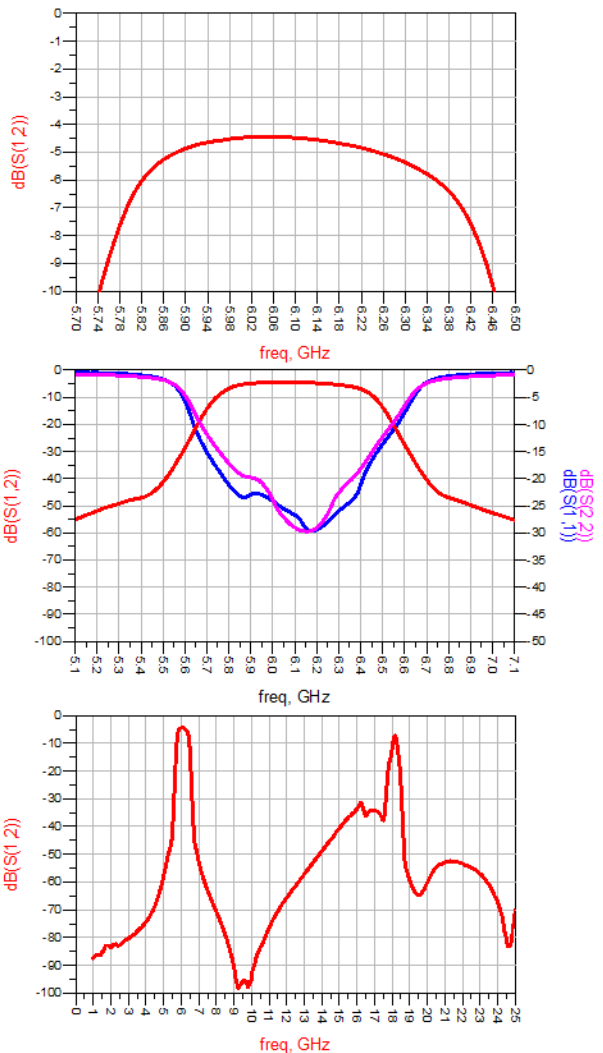
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

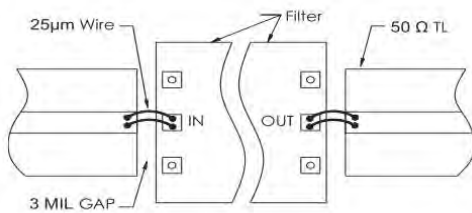
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		6.55		GHz
工作频率	6.0		7.1	GHz
中心损耗		2.3	2.8	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-4.2GHz	35	40	dBc
	@8.2-15.0GHz	45	50	dBc

环境要求

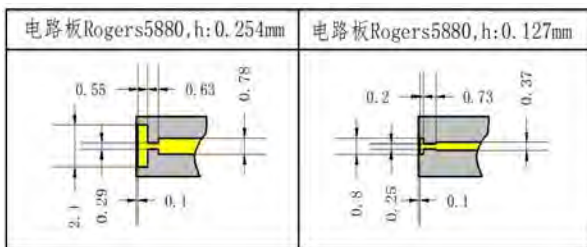
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

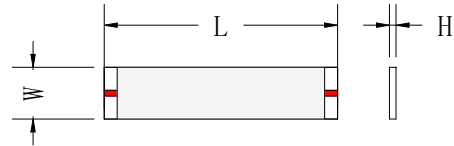
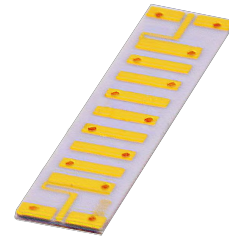


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

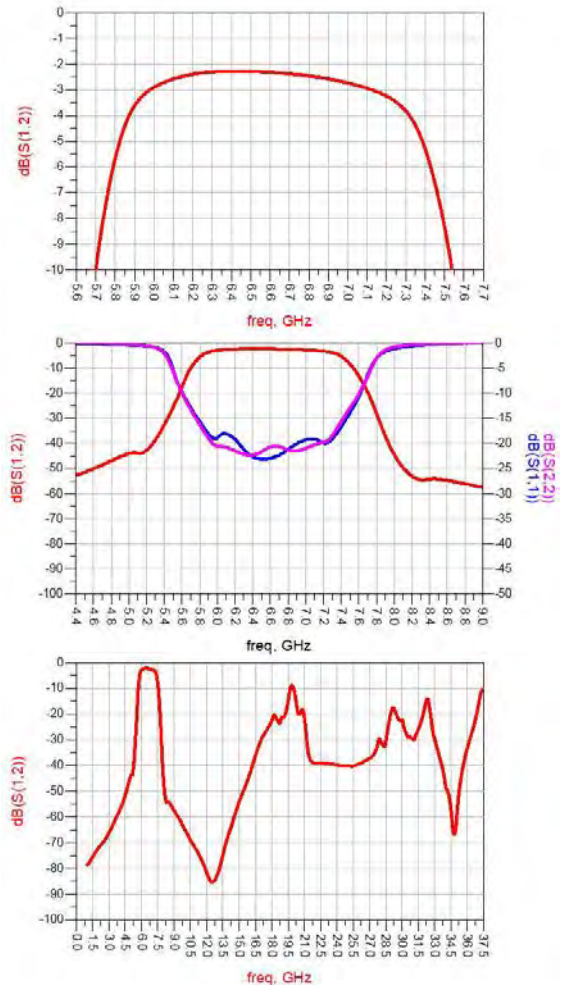


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	5.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

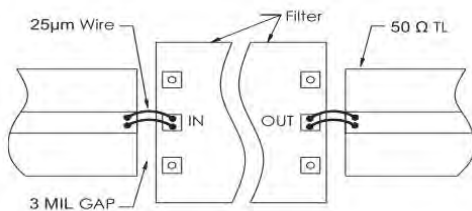
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		7.450		GHz
工作频率	6.0		8.9	GHz
中心损耗		1.6	2.0	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@DC-5.0GHz	40	45	dBc
	@10.4-18.0GHz	40	45	dBc

### 环境要求

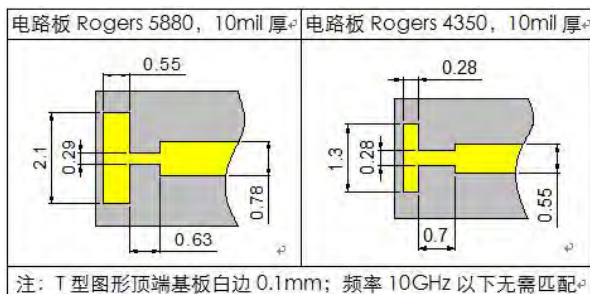
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^\circ\text{C}\sim+85^\circ\text{C}$	
储存温度	$-55^\circ\text{C}\sim+125^\circ\text{C}$	

### 推荐装配图

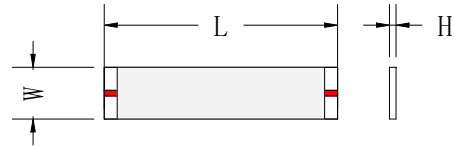
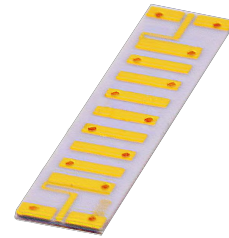


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配，T型尺寸如下：

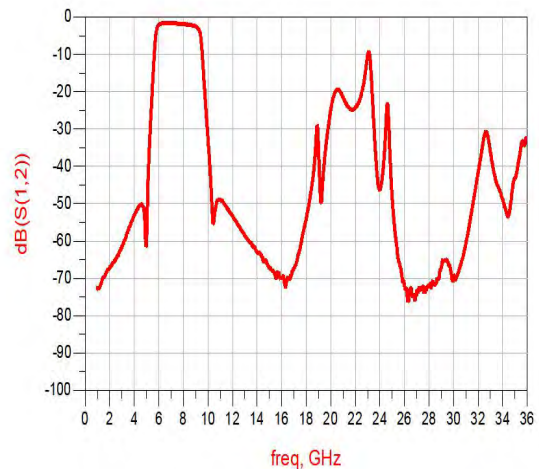
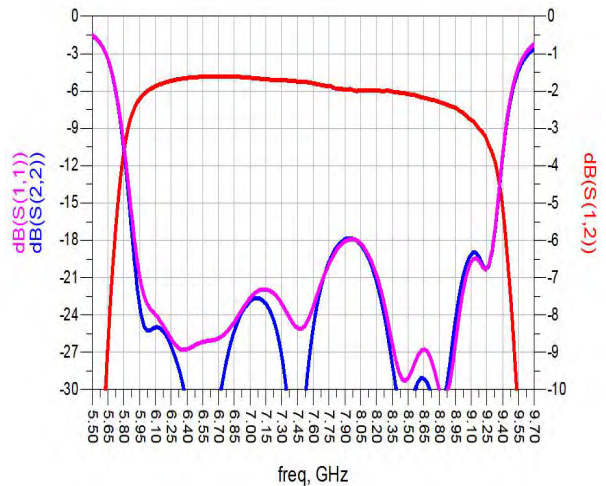


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	4.5	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

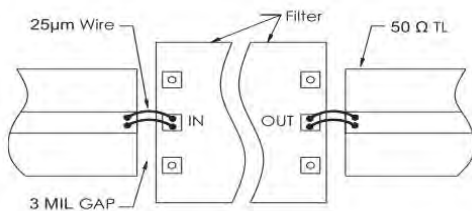
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		8.5		GHz
工作频率	6.0		11.0	GHz
中心损耗		2.0	2.4	dB
带内波动		1.5	2.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-3.2GHz	40	45	dBc
	@12.7-19.0GHz	40	45	dBc

### 环境要求

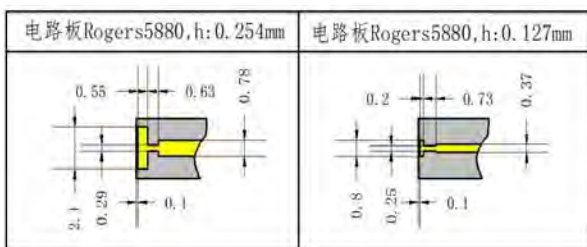
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

### 推荐装配图

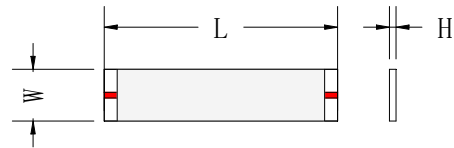
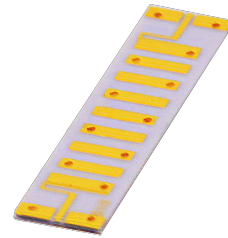


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

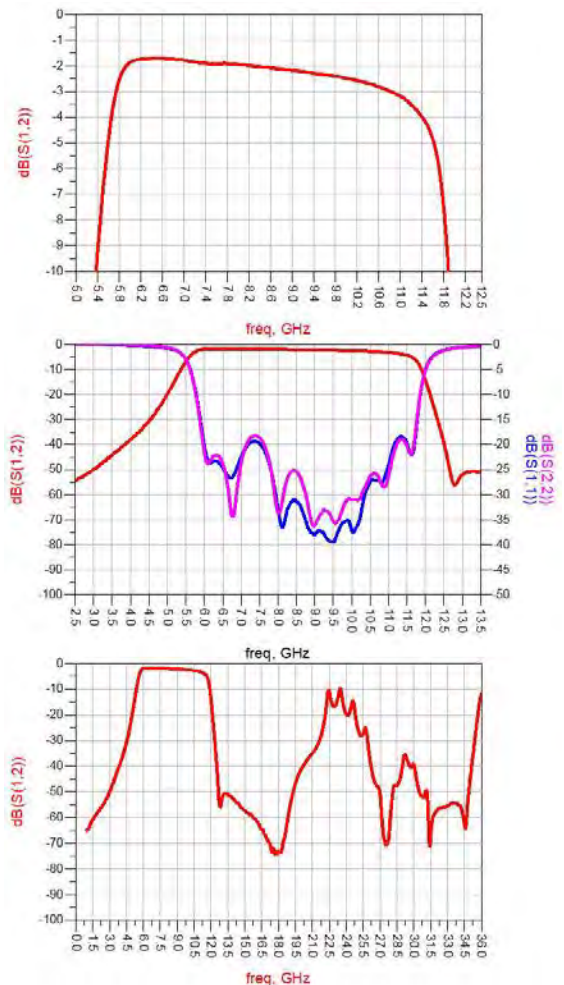


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	4.0	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

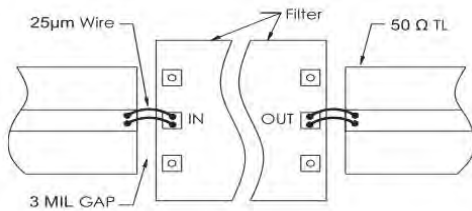
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		10.5		GHz
工作频率	6.0		15.0	GHz
中心损耗		0.7	1.0	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@DC-4.0GHz	38	43	dBc
	@17.2-25.0GHz	10	15	dBc

环境要求

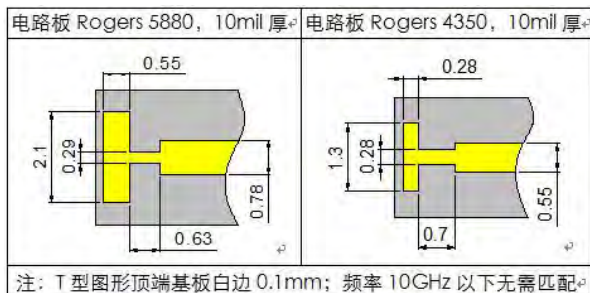
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

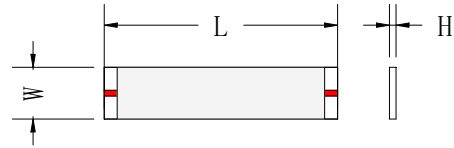
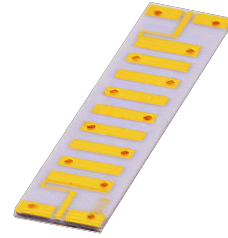


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

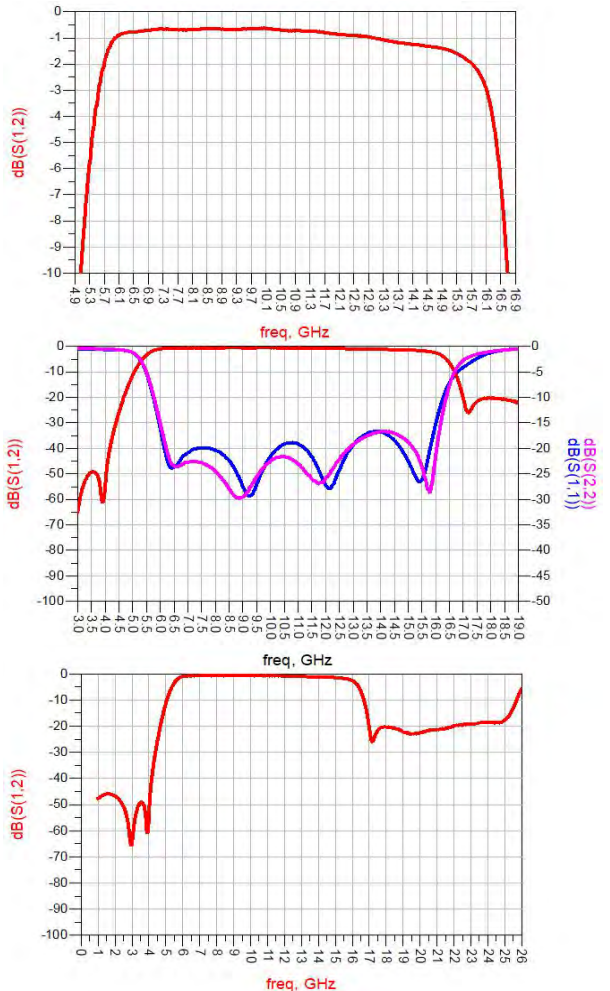


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	4.5	3.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



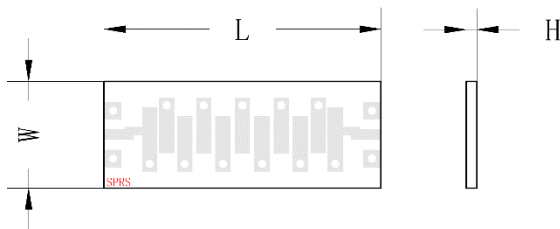
### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

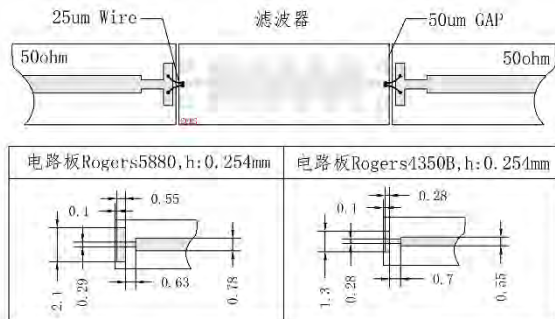
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		7.05		GHz
工作频率	6.1		8.0	GHz
中心损耗		1.3	1.8	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-5.0GHz	40	45		dBc
带外抑制@9.2-16.0GHz	42	45		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 6.5, W: 4.5, H: 0.254, 端口居中



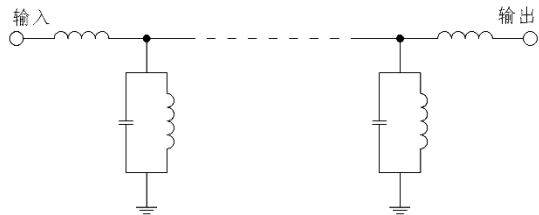
推荐装配图:



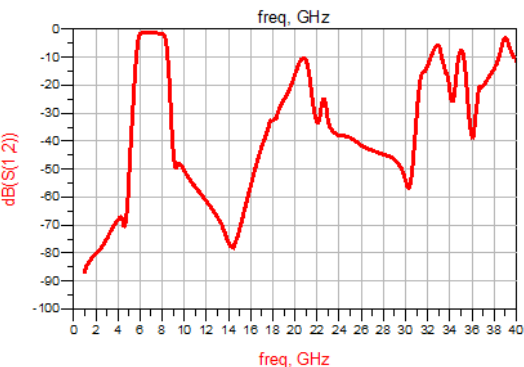
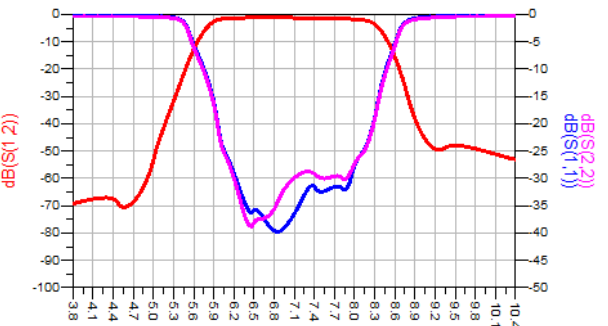
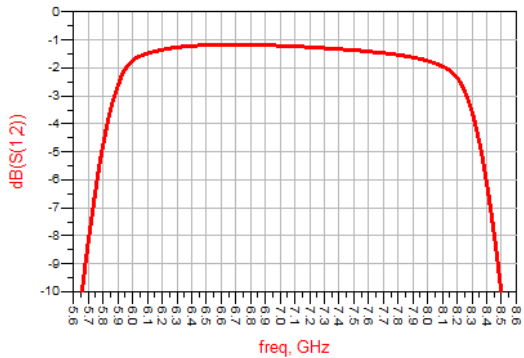
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**1.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

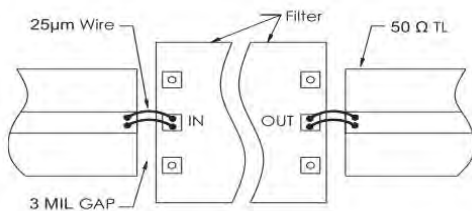
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		7.6		GHz
工作频率	6.1		9.1	GHz
中心损耗		1.5	2.0	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-4.7GHz	52	57	dBc
	@11.2-16GHz	55	60	dBc

环境要求

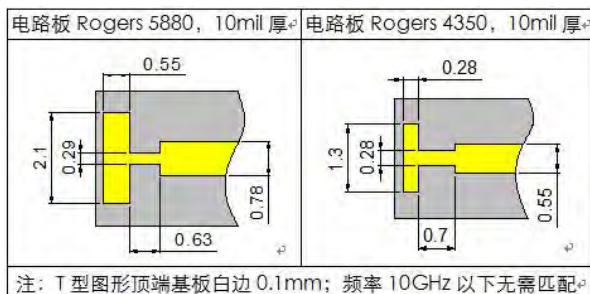
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

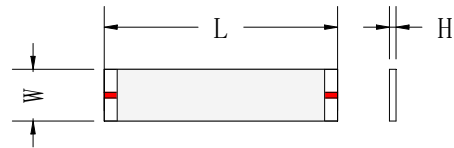
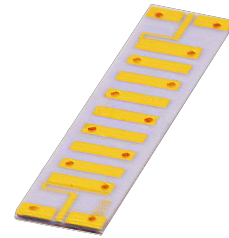


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

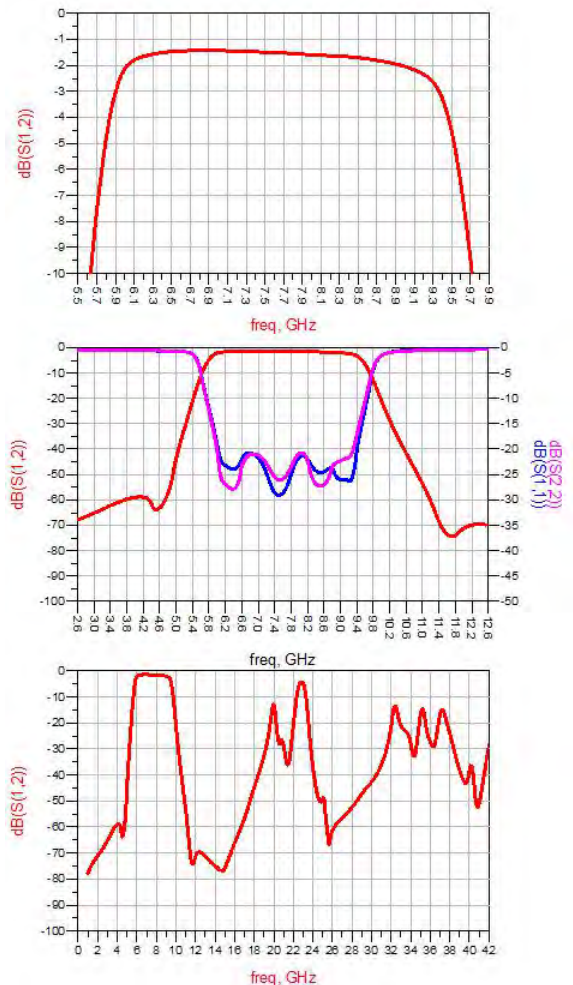


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	4.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

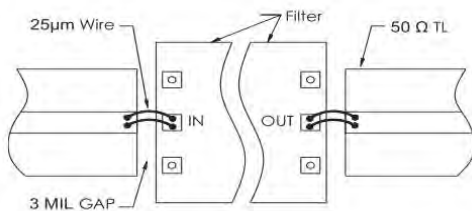
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		9.6		GHz
工作频率	6.1		13.1	GHz
中心损耗		0.8	1.2	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-5.0GHz	43	48	dBc
	@17.5-23.0GHz	43	48	dBc

### 环境要求

最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

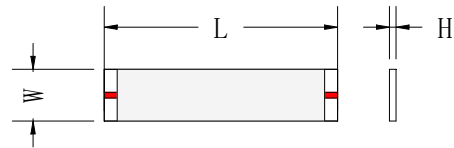
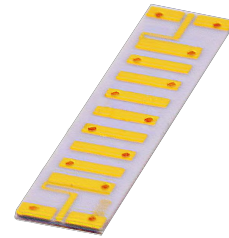


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

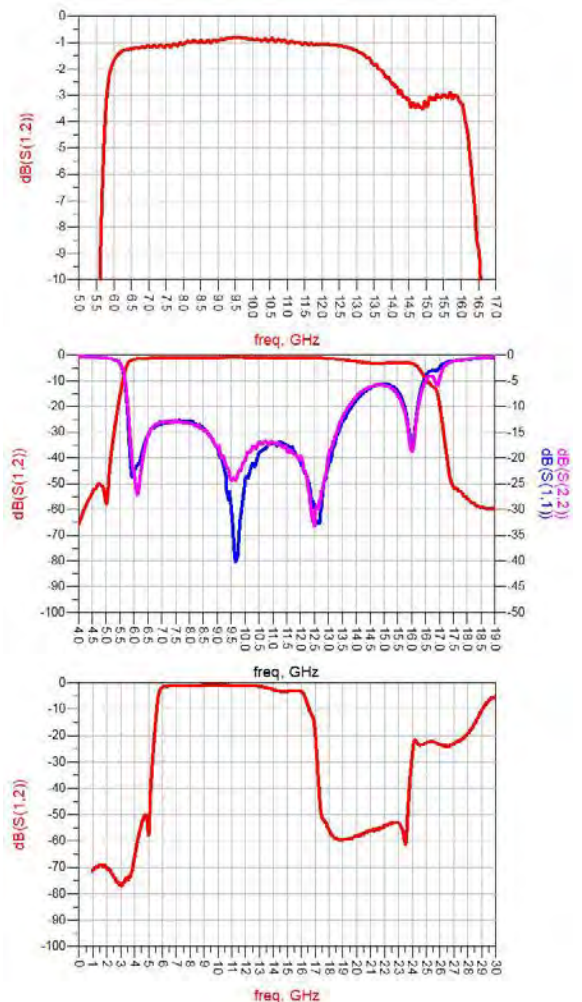
电路板Rogers5880, h: 0.254mm	电路板Rogers5880, h: 0.127mm

### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	2.8	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



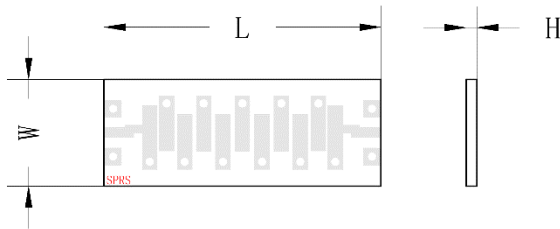
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

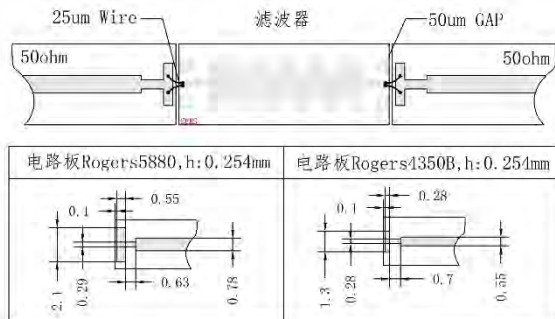
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		7.05		GHz
工作频率	6.4		7.7	GHz
中心损耗		2.0	2.5	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-5.3GHz	50	55		dBc
带外抑制@8.9-15.0GHz	50	55		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.5, W: 5.0, H: 0.254, 端口居中



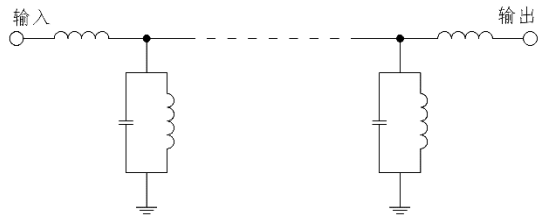
推荐装配图:



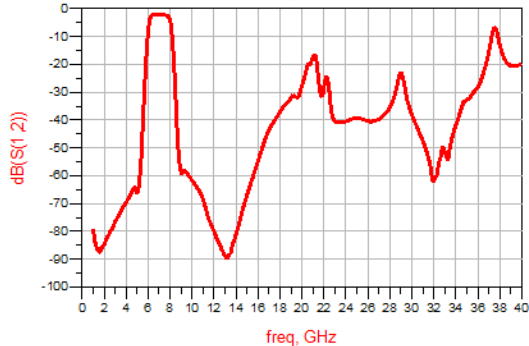
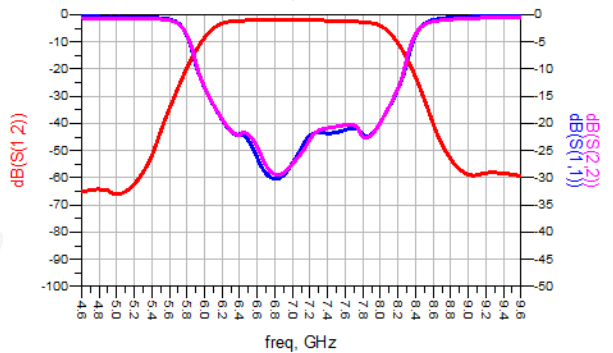
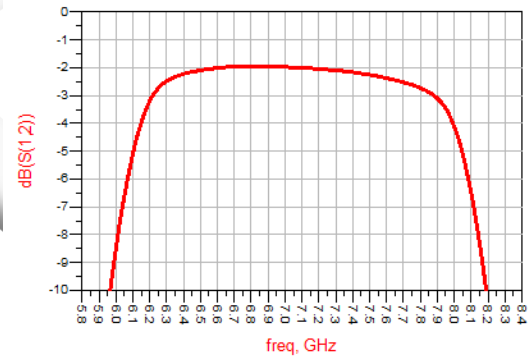
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



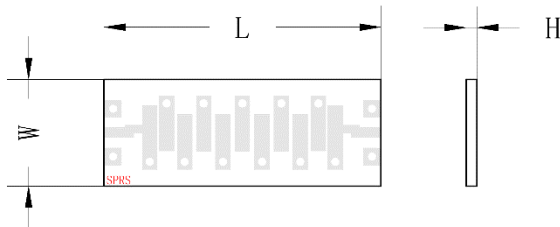
### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

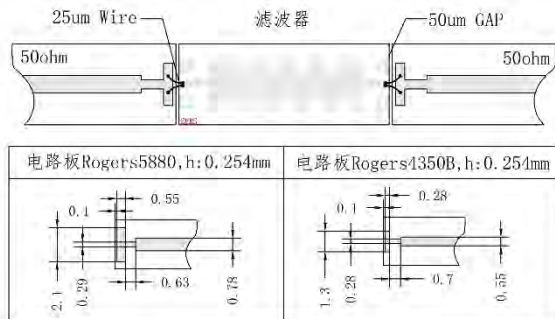
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		13.0		GHz
工作频率	6.4		19.6	GHz
中心损耗		0.7	1.3	dB
带内波动		0.9	1.0	dB
回波损耗	10	12		dB
带外抑制@DC-4.7GHz	50	55		dBc
带外抑制@23.6-25.0GHz	45	50		dBc
承受功率			20	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 8.5, W: 5.0, H: 0.254, 端口居中



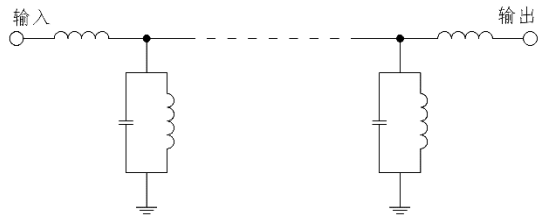
### 推荐装配图:



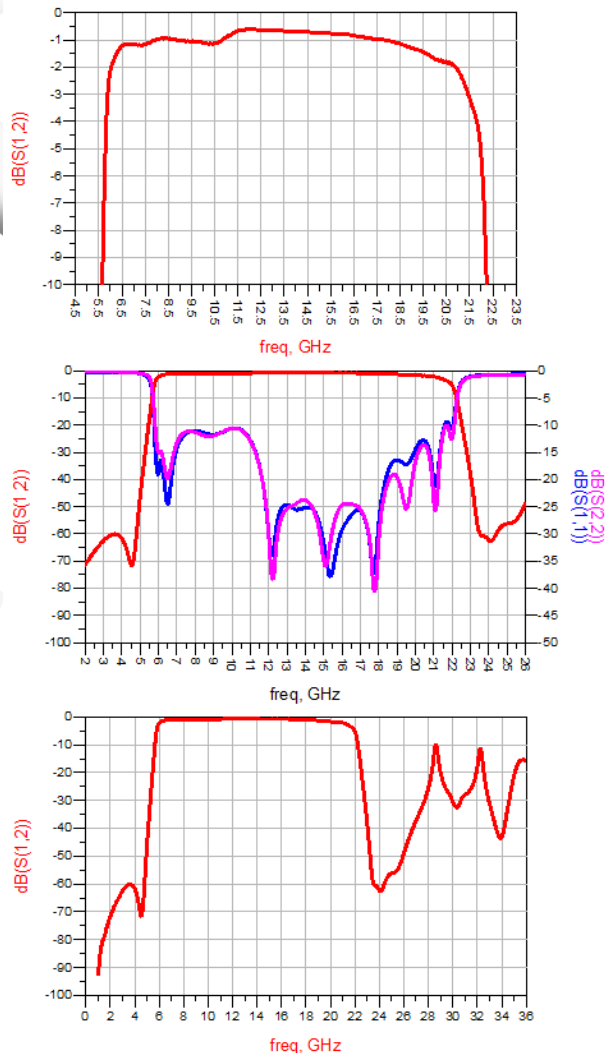
### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**1.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钎铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

### 原理图



### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

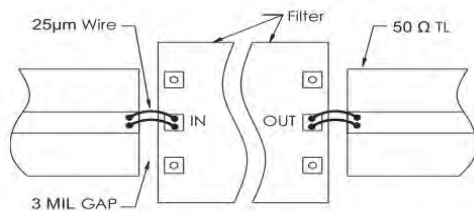
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		7.35		GHz
工作频率	6.45		8.25	GHz
中心损耗		2.5	3.0	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	15	18		
带外抑制	@4.8-5.5GHz	40	45	dBc
	@9.2-9.5GHz	40	45	dBc
	@DC-4.8GHz	60	65	dBc
	@9.5-15.5GHz	60	65	dBc

环境要求

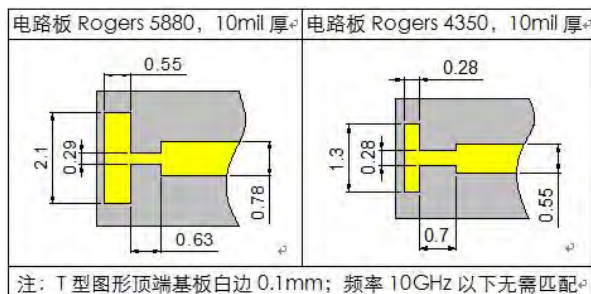
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

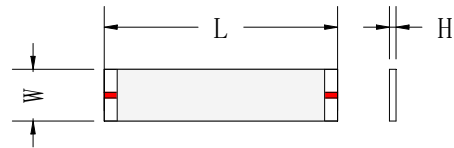
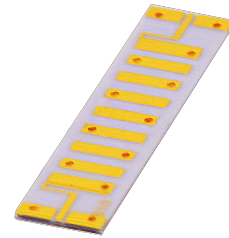


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

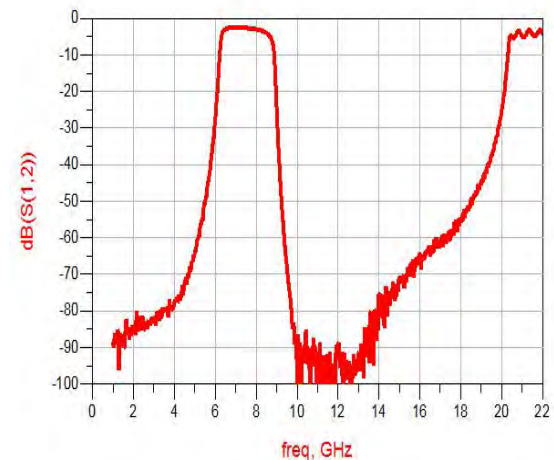
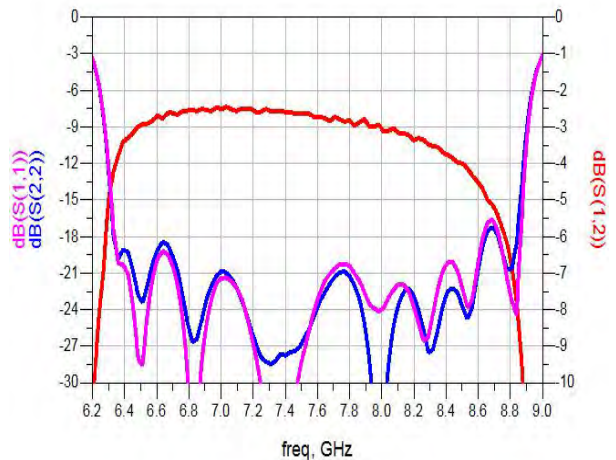


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	12.0	5.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



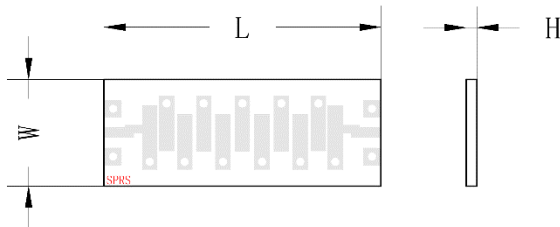
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

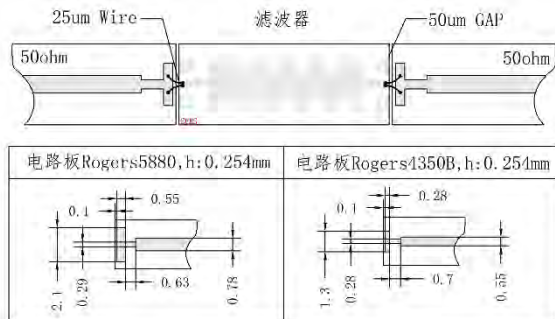
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		6.6		GHz
工作频率	6.5		6.7	GHz
中心损耗		4.6	5.1	dB
带内波动		0.4	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-5.9GHz	37	40		dBc
带外抑制@7.3-15.5GHz	37	40		dBc
承受功率			20	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 8.0, W: 5.5, H: 0.254, 端口居中



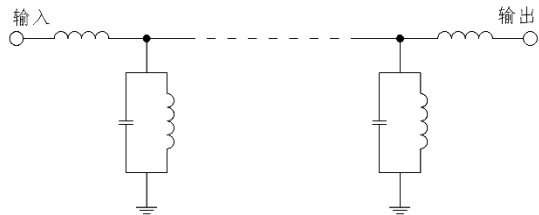
推荐装配图:



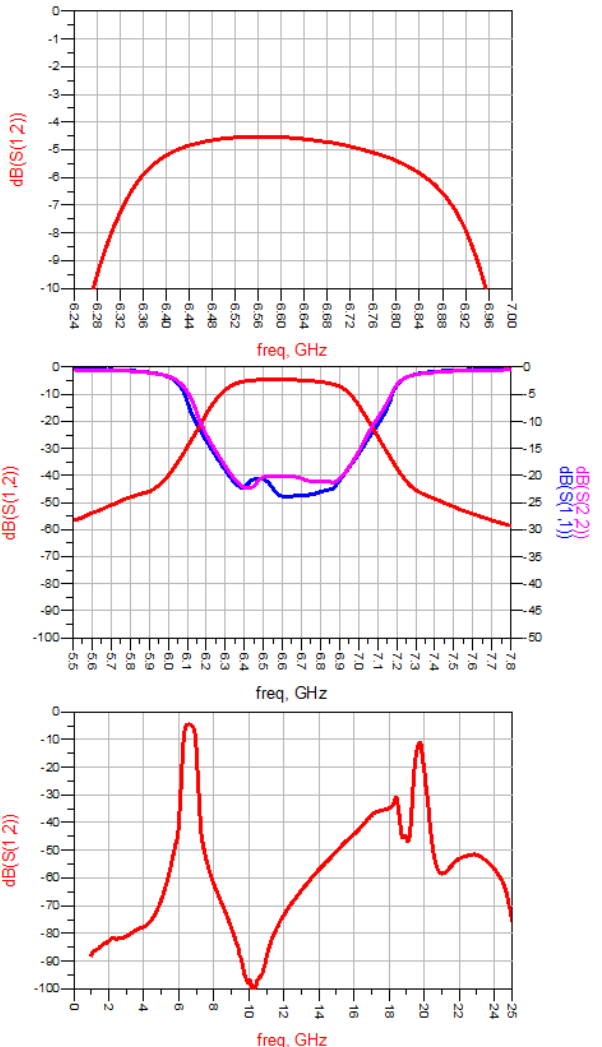
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

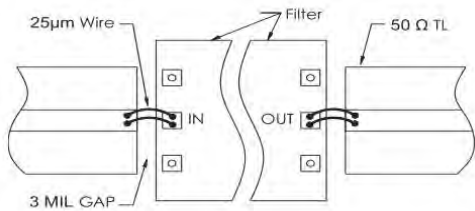
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		8.3		GHz
工作频率	6.5		10.1	GHz
中心损耗		1.3	1.6	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-5.3GHz	40	45	dBc
	@11.7-20.0GHz	40	45	dBc

环境要求

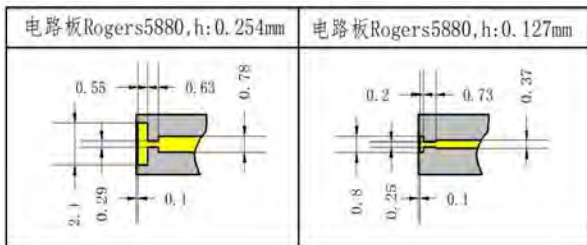
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

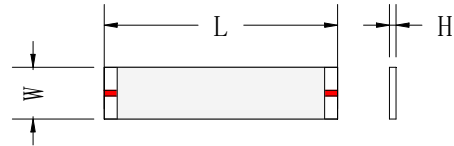
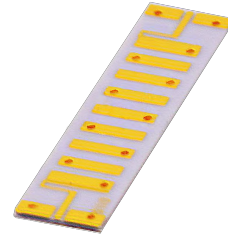


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

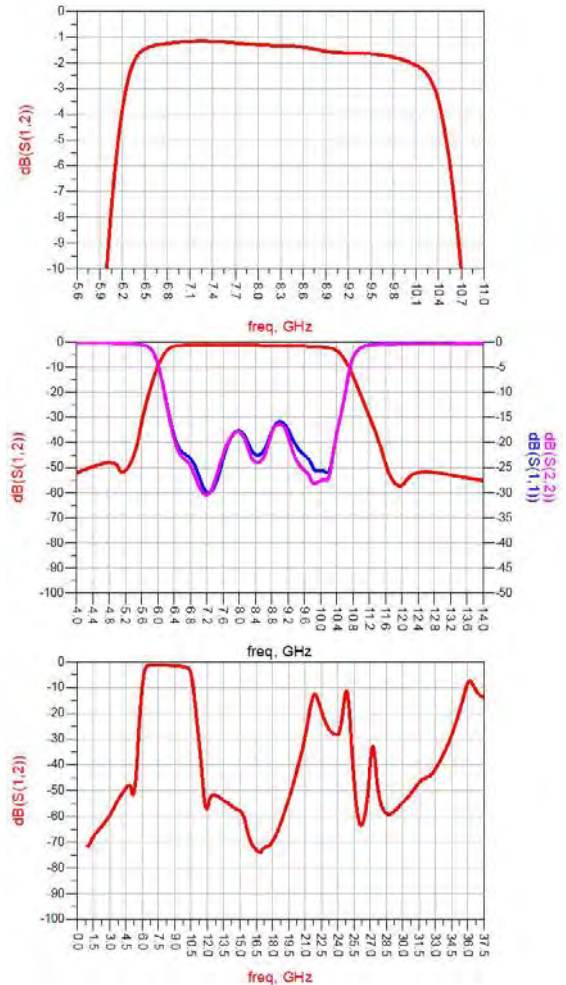


外形图



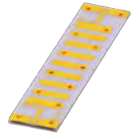
外形尺寸	L	W	H	单位
	5.5	4.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

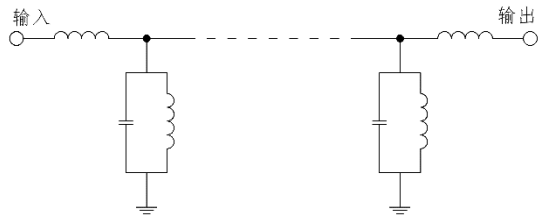
- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块



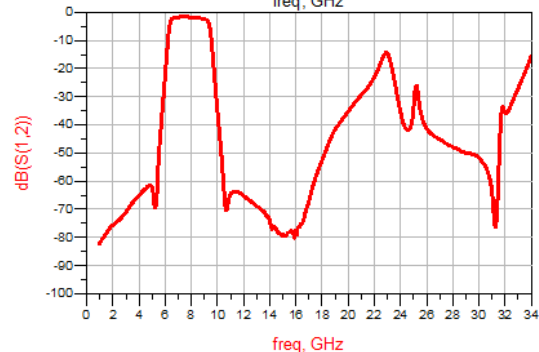
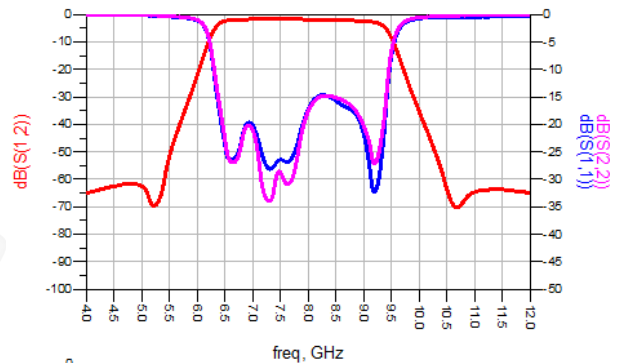
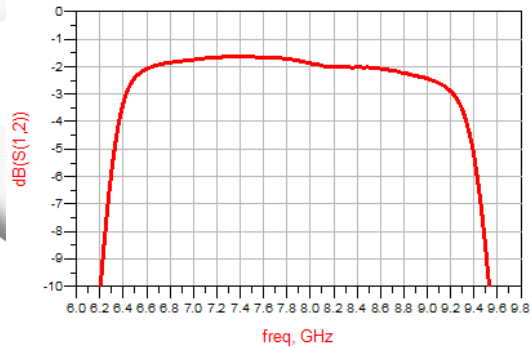
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		7.8		GHz
工作频率	6.6		9.0	GHz
中心损耗		1.8	2.3	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-5.2GHz	50	55		dBc
带外抑制@10.7-17.0GHz	50	55		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	°C
储存温度	-55		+125	°C

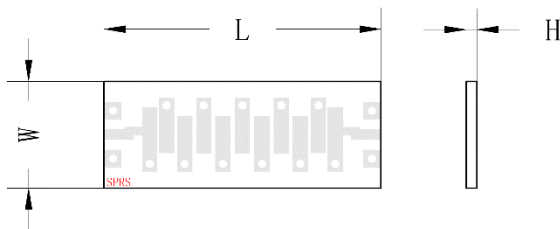
原理图



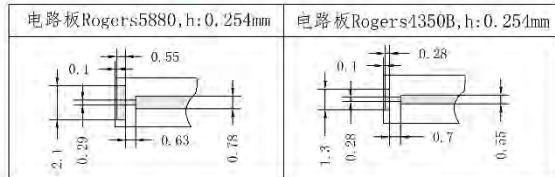
典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



外形图: L: 7.0, W: 4.5, H: 0.254, 端口居中



推荐装配图:



注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

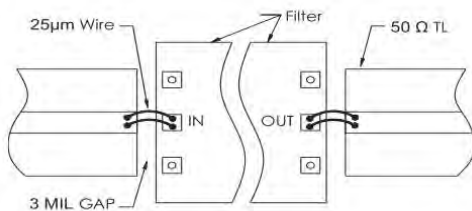
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		7.85		GHz
工作频率	6.7		9.0	GHz
中心损耗		1.6	2.0	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-5.8GHz	40	45	dBc
	@10.1-19.0GHz	40	45	dBc

### 环境要求

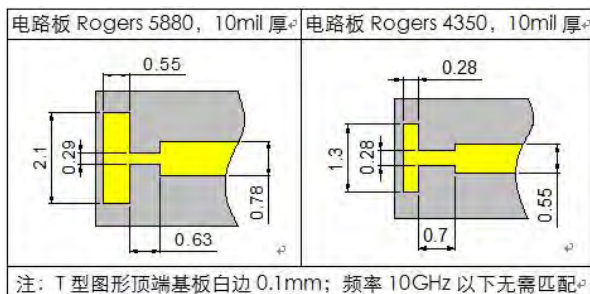
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

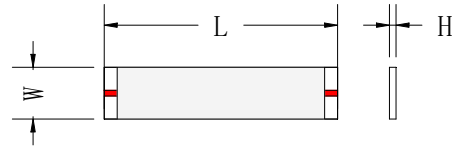
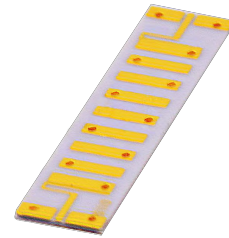


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

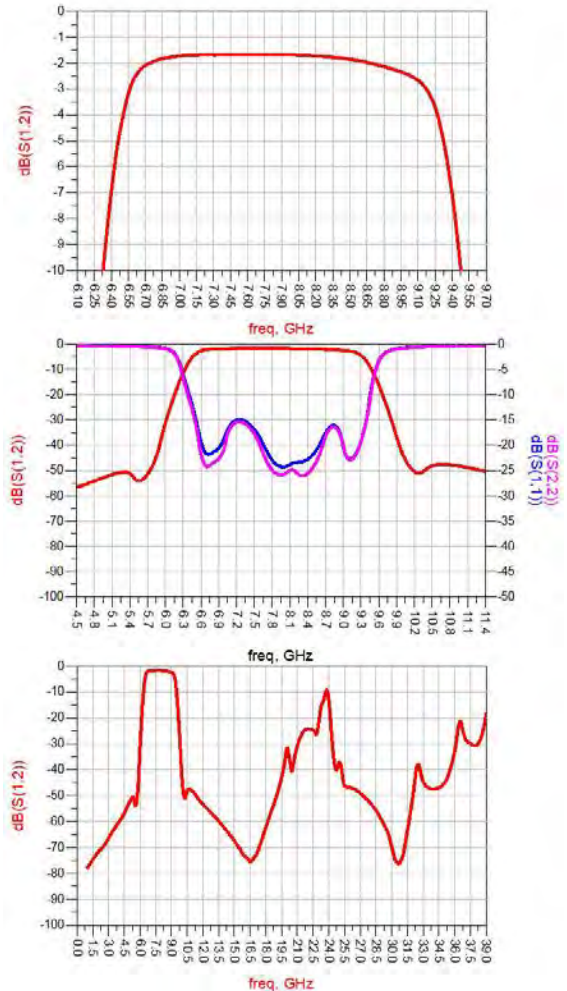


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	4.5	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

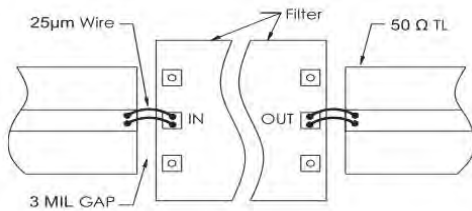
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		6.95		GHz
工作频率	6.85		7.05	GHz
中心损耗		3.5	4.0	dB
带内波动		0.3	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-5.6GHz	45	50	dBc
	@7.9-14.5GHz	45	50	dBc

环境要求

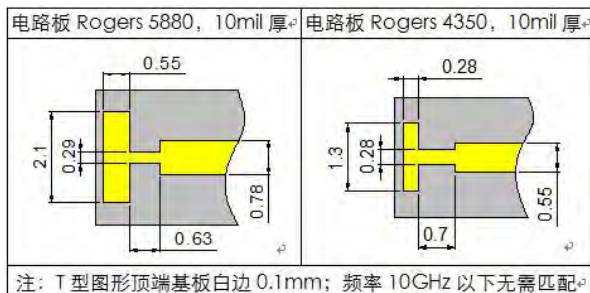
最大输入功率	30	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

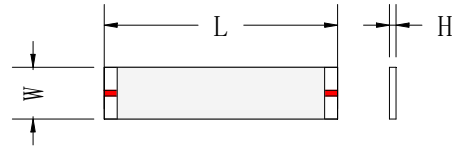
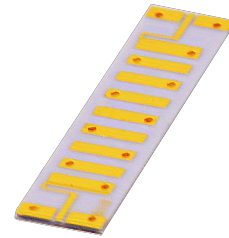


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

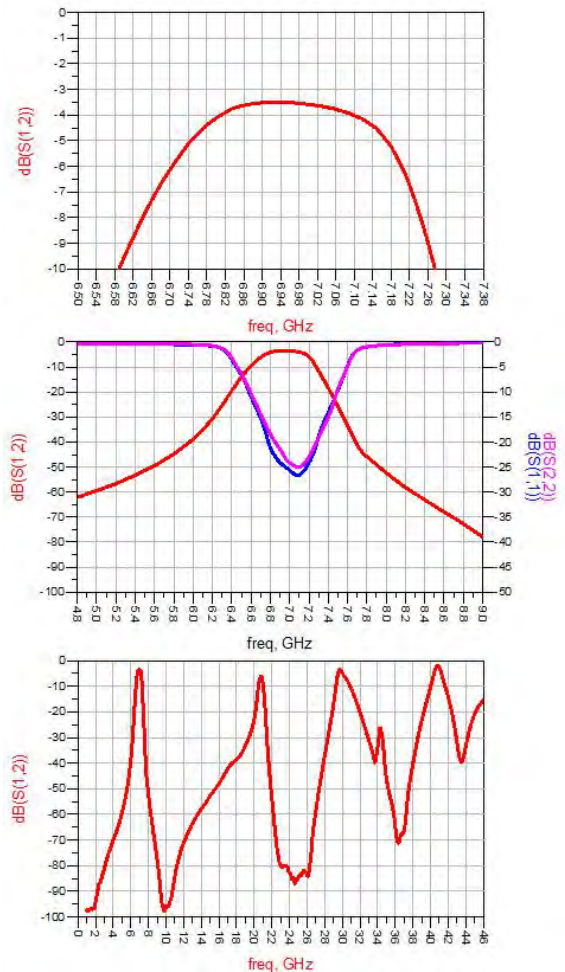


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	5.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

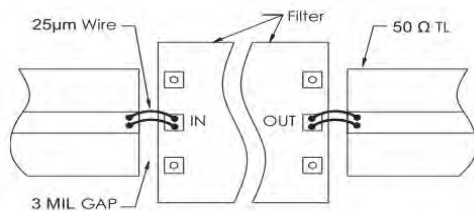
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		8.0		GHz
工作频率	6.9		9.1	GHz
中心损耗		1.6	2.1	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	14		
带外抑制	@DC-6.0GHz	43	46	dBc
	@10.4-19GHz	45	50	dBc

### 环境要求

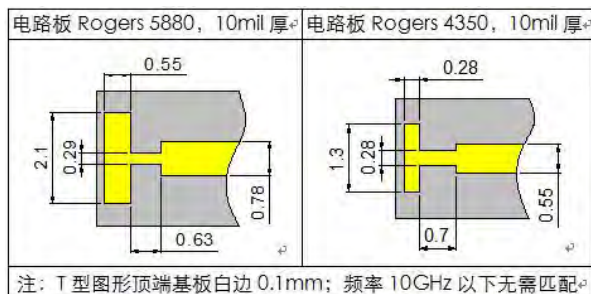
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

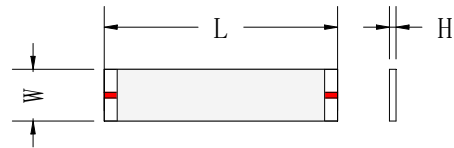
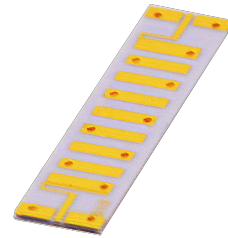


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

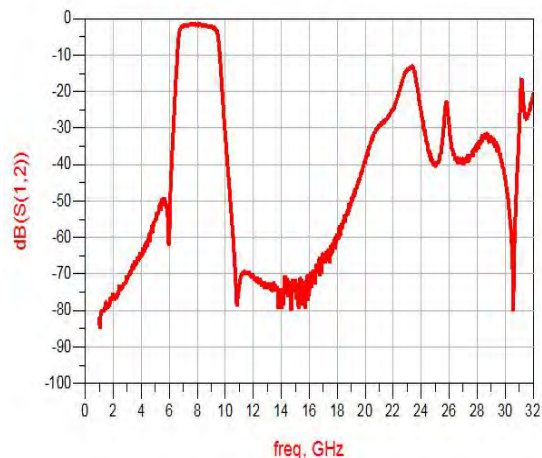
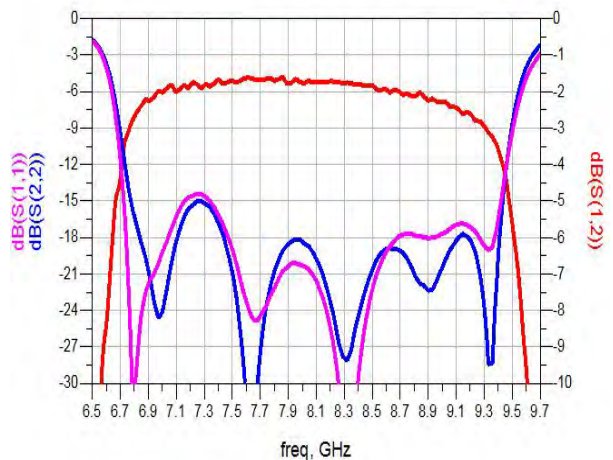


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	4.5	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



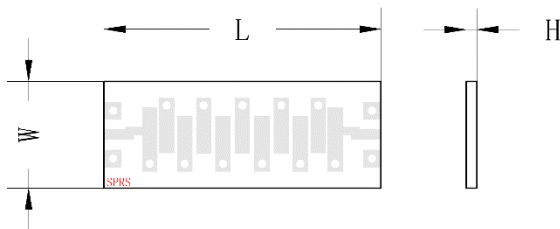
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

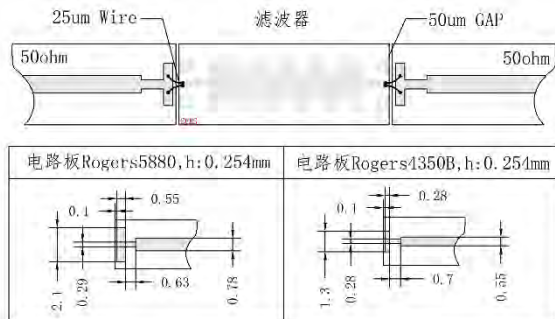
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		8.1		GHz
工作频率	6.9		9.3	GHz
中心损耗		2.0	2.5	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-5.9GHz	50	55		dBc
带外抑制@10.9-18.0GHz	55	60		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^{\circ}\text{C}$

外形图: L: 8.0, W: 4.5, H: 0.254, 端口居中



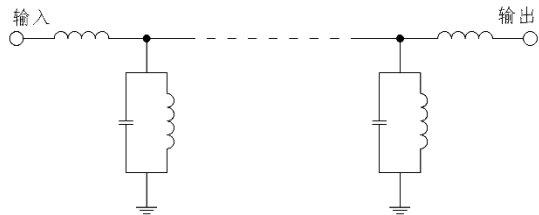
推荐装配图:



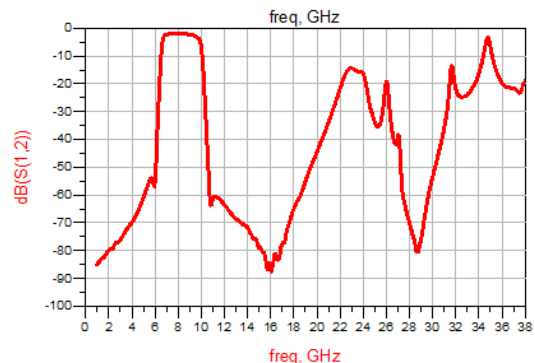
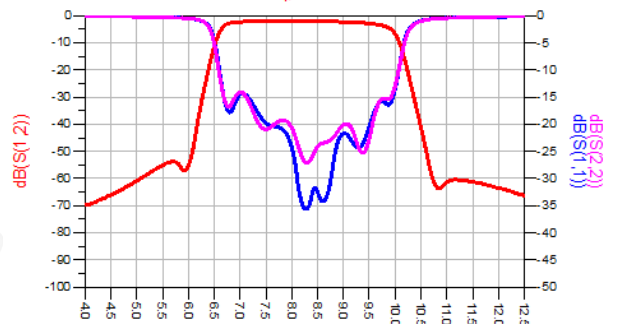
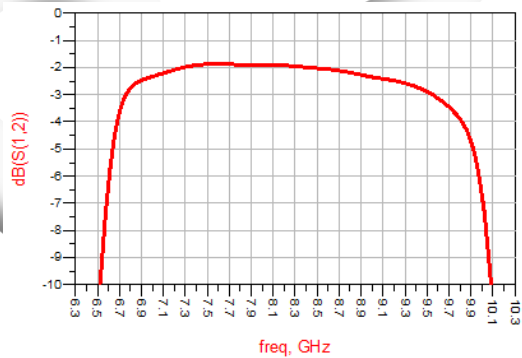
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^{\circ}\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

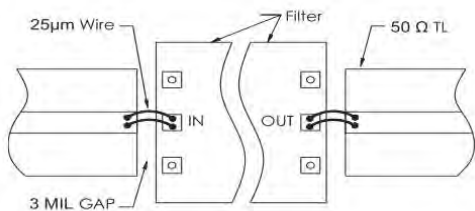
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		12.5		GHz
工作频率	7.0		18.0	GHz
中心损耗		0.4	0.7	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@DC-4.7GHz	45	48	dBc
	@20.5-30.0GHz	20	25	dBc

### 环境要求

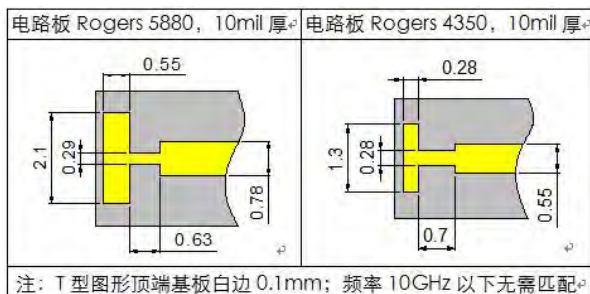
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

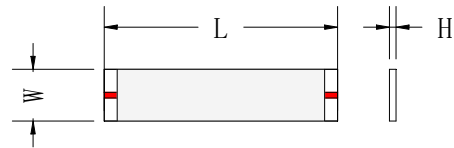
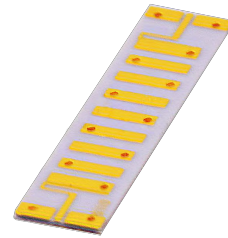


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

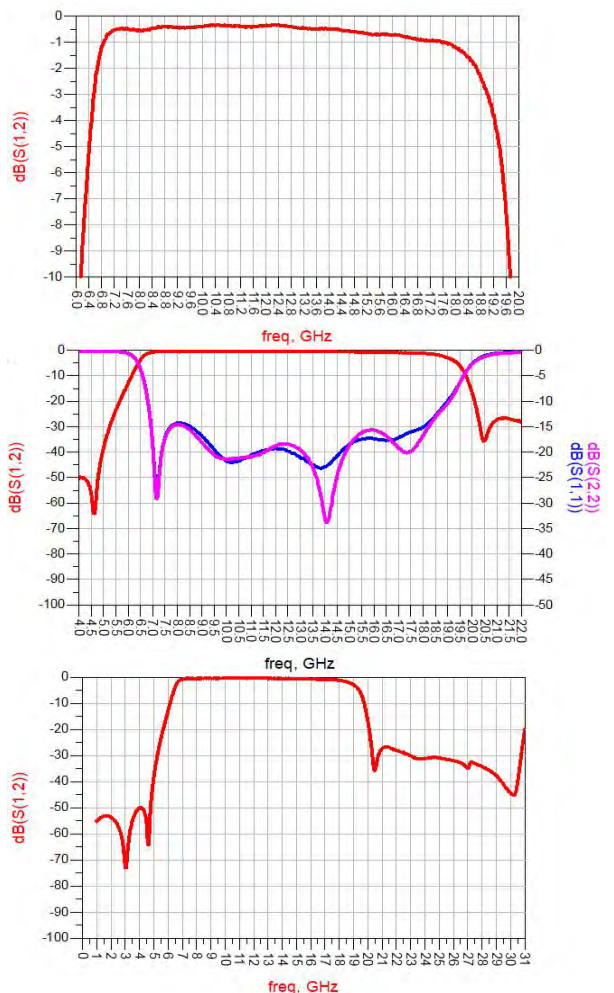


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	4.5	3.5	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

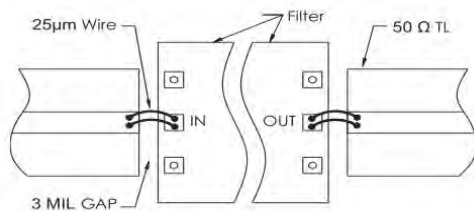
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		7.2		GHz
工作频率	7.1		7.3	GHz
中心损耗		4.6	5.2	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@DC-6.3GHz	40	45	dBc
	@7.8-19GHz	40	45	dBc

### 环境要求

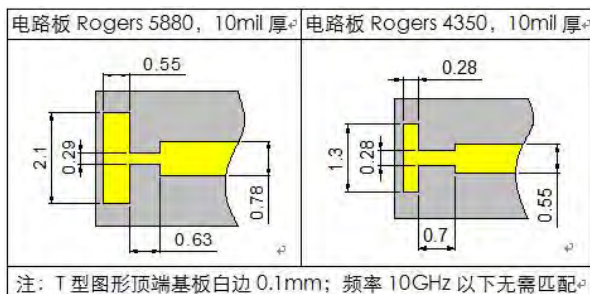
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

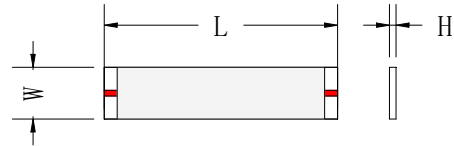
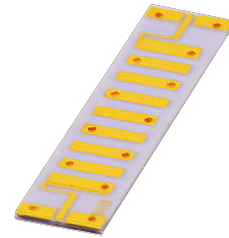


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

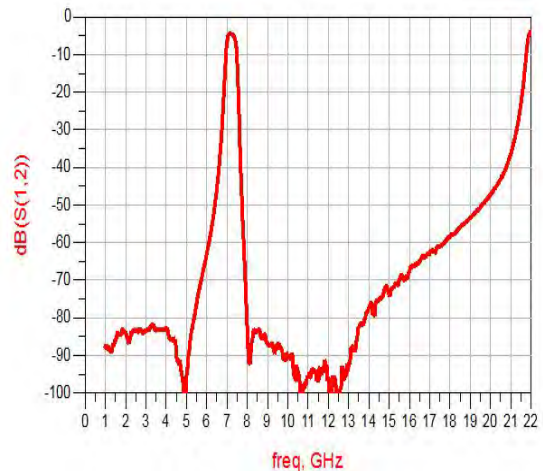
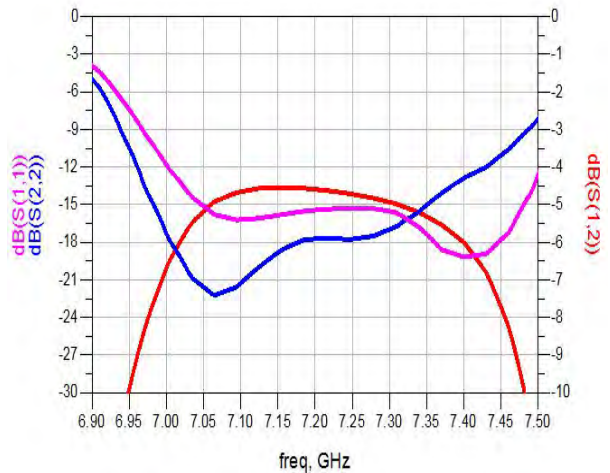


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	9.0	5.0	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



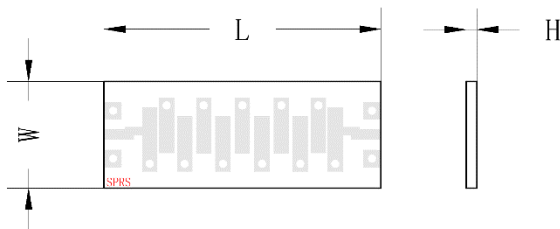
### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

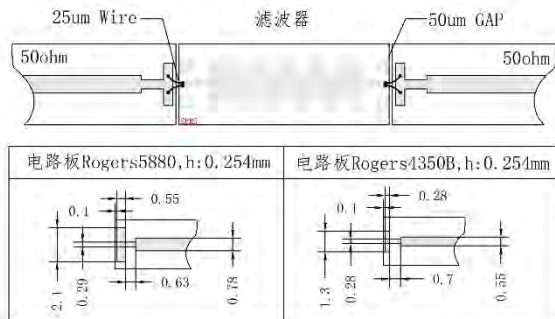
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		8.5		GHz
工作频率	7.1		9.9	GHz
中心损耗		1.2	1.7	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-5.8GHz	40	45		dBc
带外抑制@11.4-20.5GHz	42	45		dBc
承受功率			35	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 6.0, W: 4.0, H: 0.254, 端口居中



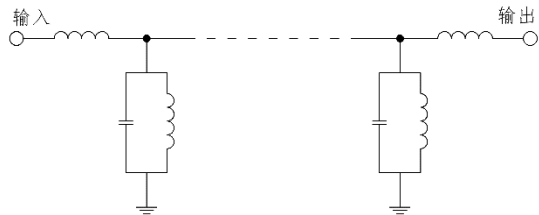
### 推荐装配图:



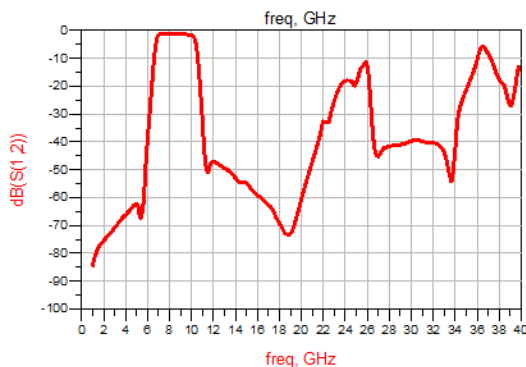
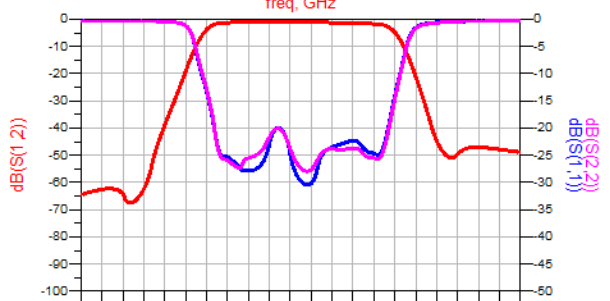
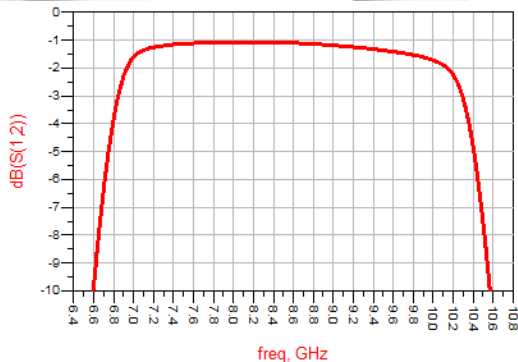
### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**1.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

### 原理图



### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块

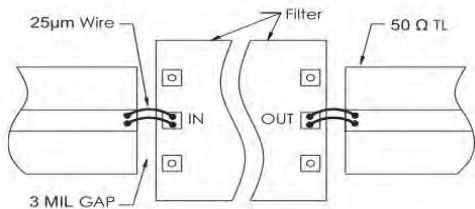
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		7.75		GHz
工作频率	7.2		8.3	GHz
中心损耗		2.0	2.5	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-6.3GHz	40	45	dBc
	@9.2-18.0GHz	40	45	dBc

环境要求

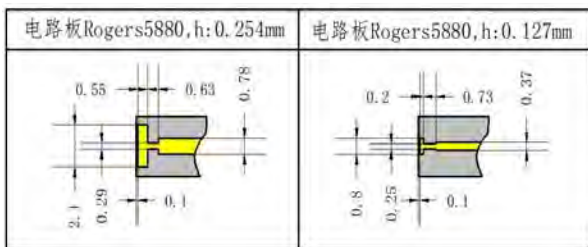
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^\circ\text{C}\sim+85^\circ\text{C}$	
储存温度	$-55^\circ\text{C}\sim+125^\circ\text{C}$	

推荐装配图

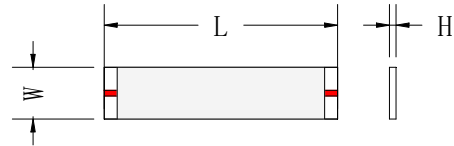
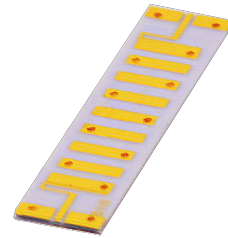


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁**0.1mm**,表面距上盖**2.75mm**,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配,T型尺寸如下:

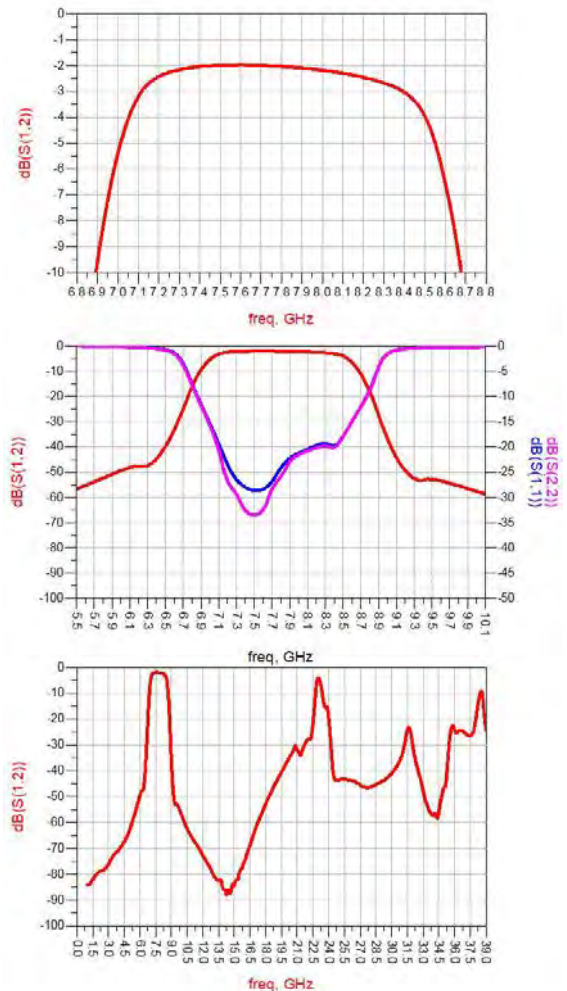


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	4.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

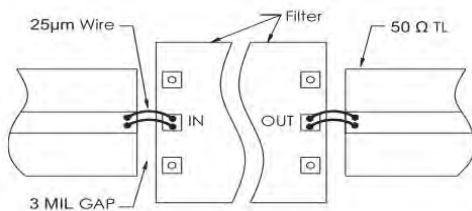
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		7.7		GHz
工作频率	7.3		8.1	GHz
中心损耗		2.8	3.3	dB
带内波动		0.8	1.2	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-6.4GHz	43	48	dBc
	@8.9-17.0GHz	45	50	dBc

环境要求

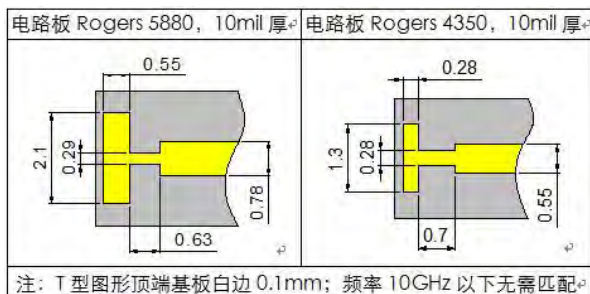
最大输入功率	30	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

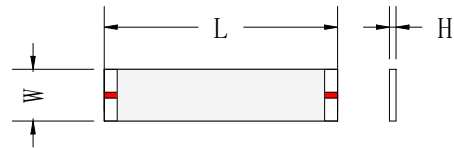
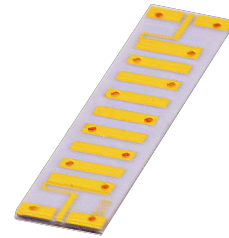


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

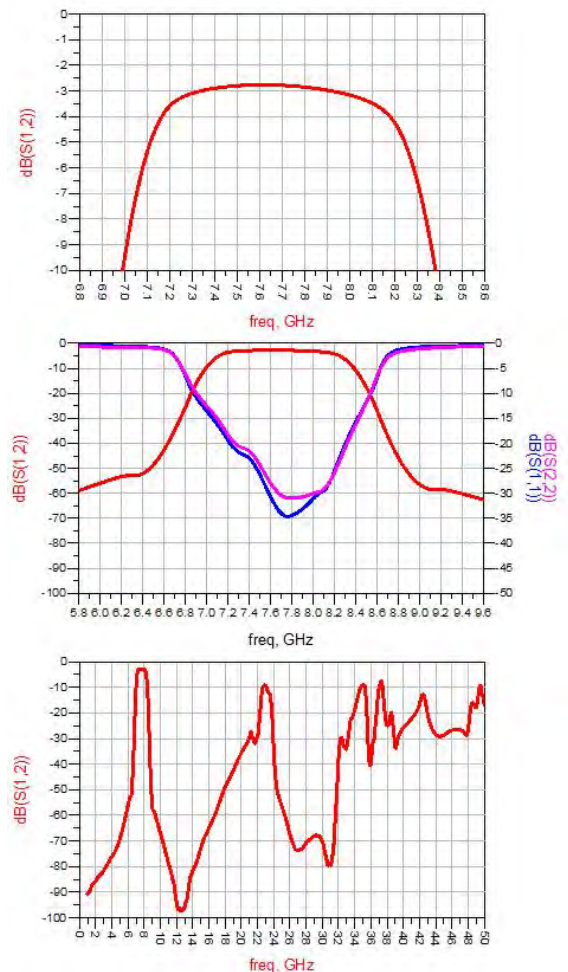


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.5	4.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

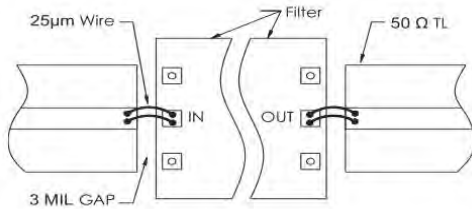
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		7.55		GHz
工作频率	7.45		7.65	GHz
中心损耗		3.9	4.4	dB
带内波动		0.4	1.2	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-6.75GHz	40	45	dBc
	@8.9-14GHz	40	45	dBc

环境要求

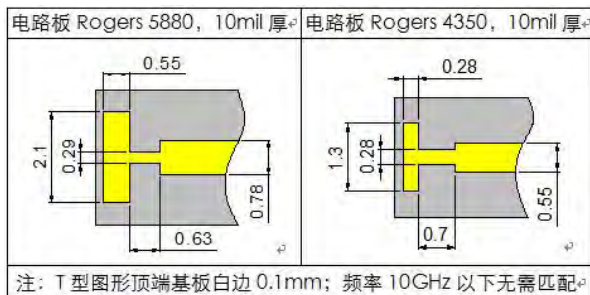
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

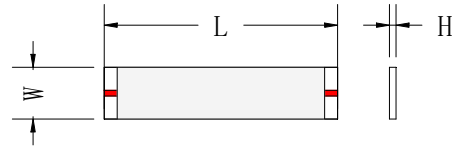
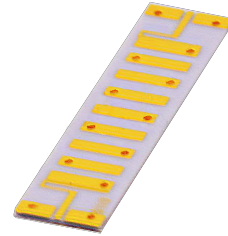


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

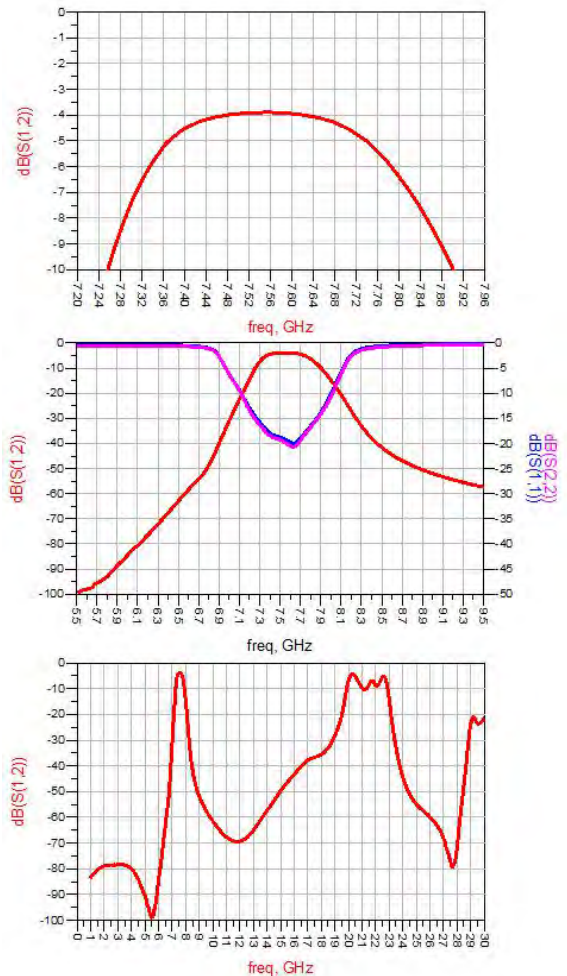


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	5.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

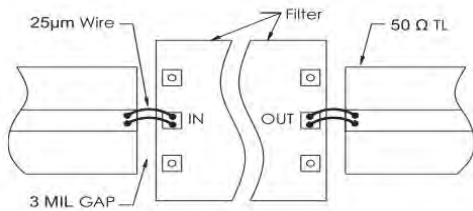
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		7.95		GHz
工作频率	7.45		8.45	GHz
中心损耗		2.4	2.9	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@DC-7.0GHz	30	35	dBc
	@9.1-19GHz	30	35	dBc

### 环境要求

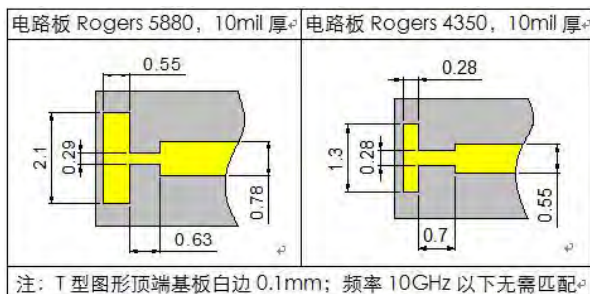
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

### 推荐装配图

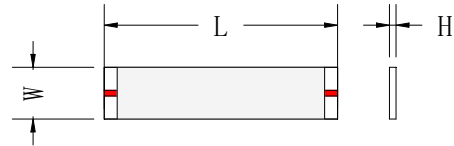
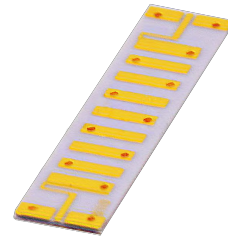


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

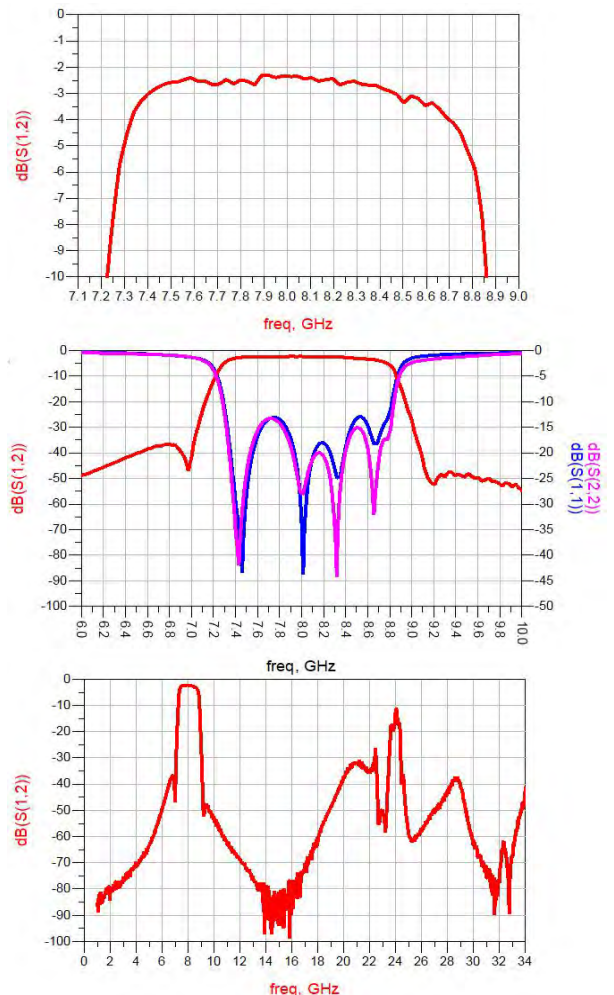


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	4.5	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

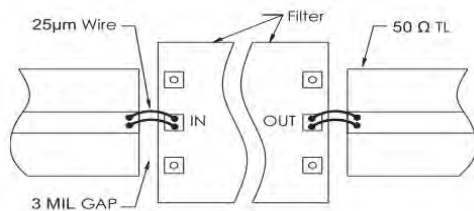
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		10.0		GHz
工作频率	7.5		12.5	GHz
中心损耗		1.6	2.1	dB
带内波动		1.0	1.2	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-4.5GHz	40	45	dBc
	@14.2-22.5GHz	40	45	dBc

### 环境要求

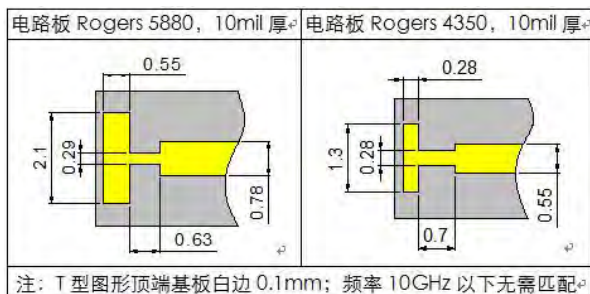
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^\circ\text{C}\sim+85^\circ\text{C}$	
储存温度	$-55^\circ\text{C}\sim+125^\circ\text{C}$	

### 推荐装配图

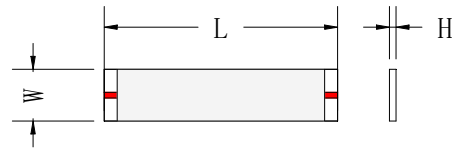
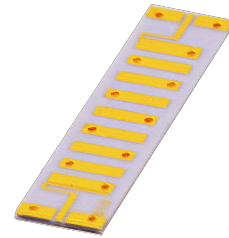


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

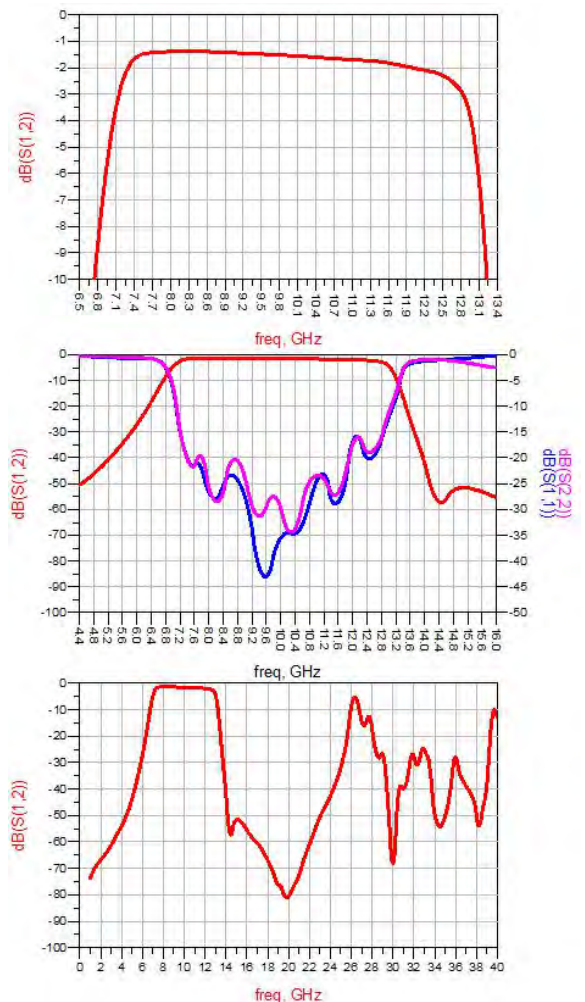


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	4.0	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



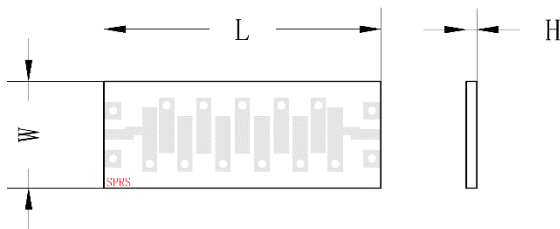
### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

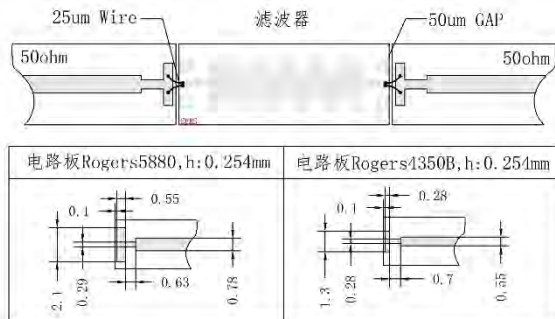
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		8.25		GHz
工作频率	7.6		8.9	GHz
中心损耗		2.4	2.9	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-6.7GHz	37	42		dBc
带外抑制@9.9-20.0GHz	34	39		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.5, W: 4.5, H: 0.254, 端口居中



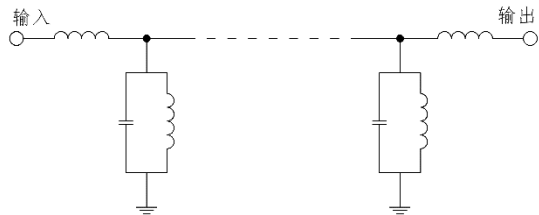
### 推荐装配图:



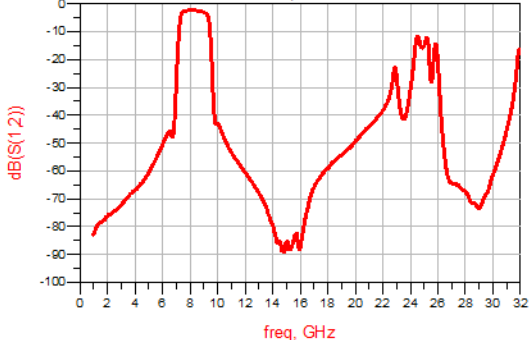
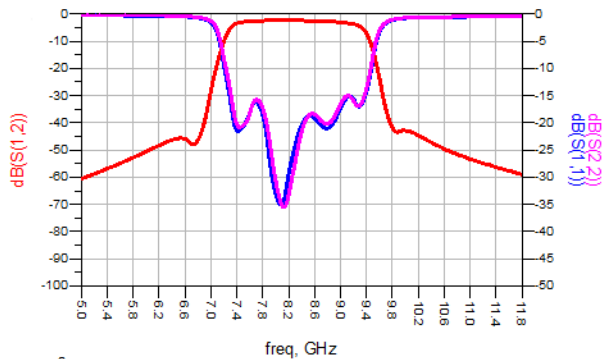
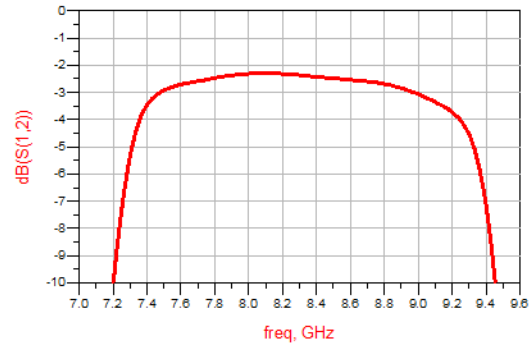
### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

### 原理图



### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

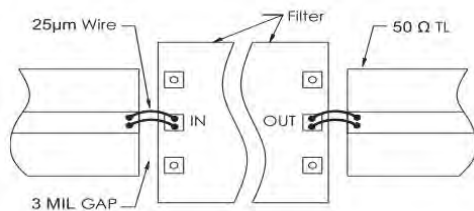
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		9.2		GHz
工作频率	7.6		10.8	GHz
中心损耗		1.8	2.3	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@3.6-5.5GHz	40	45	dBc
	@13-17GHz	40	45	dBc
	@DC-3.6GHz	60	63	dBc
	@17-22.5GHz	60	65	dBc

环境要求

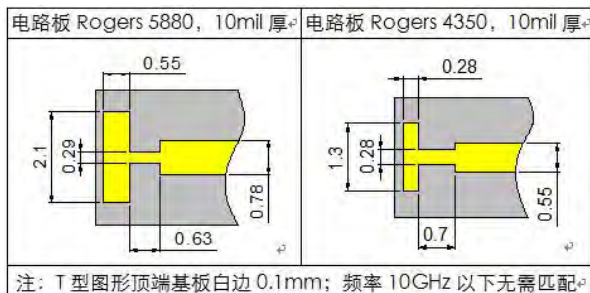
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

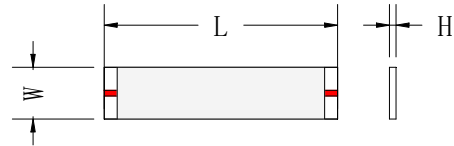
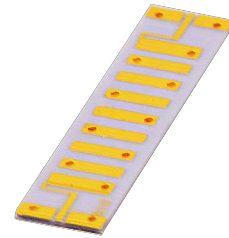


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

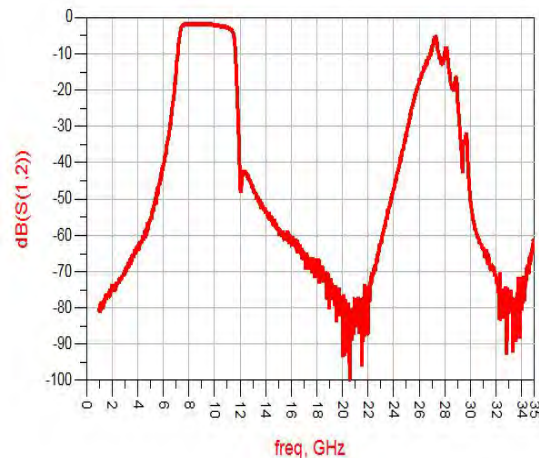
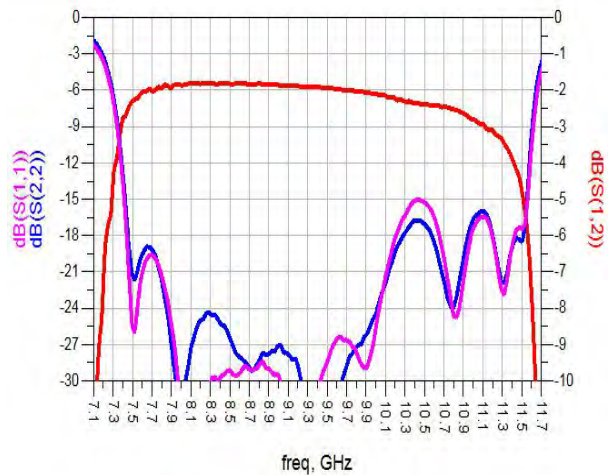


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	4.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

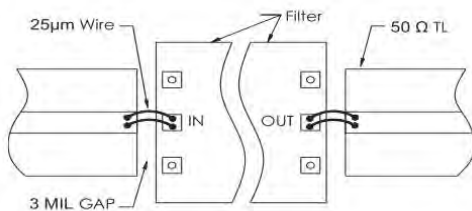
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		9.8		GHz
工作频率	7.7		11.9	GHz
中心损耗		2.5	3.0	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@DC-5.5GHz	40	45	dBc
	@13.8-24GHz	40	45	dBc

### 环境要求

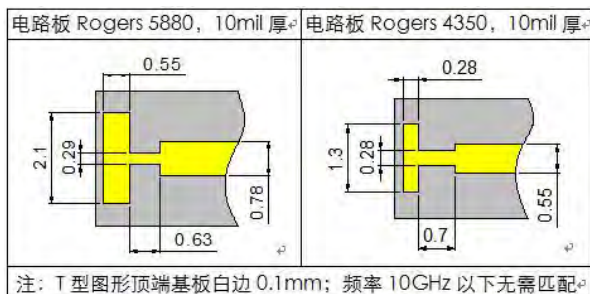
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

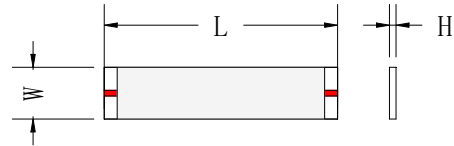
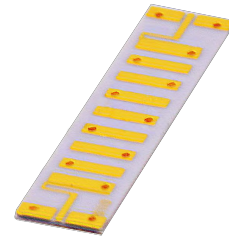


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2175mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

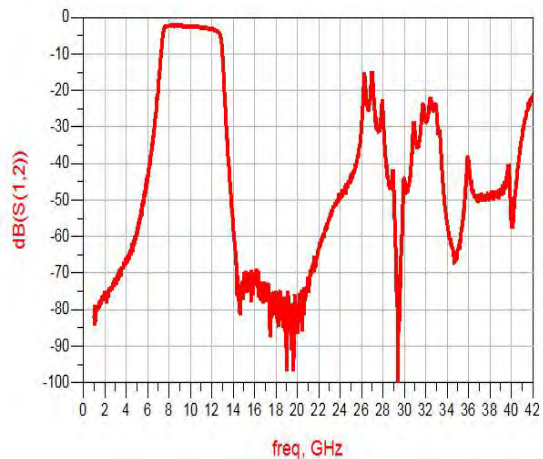
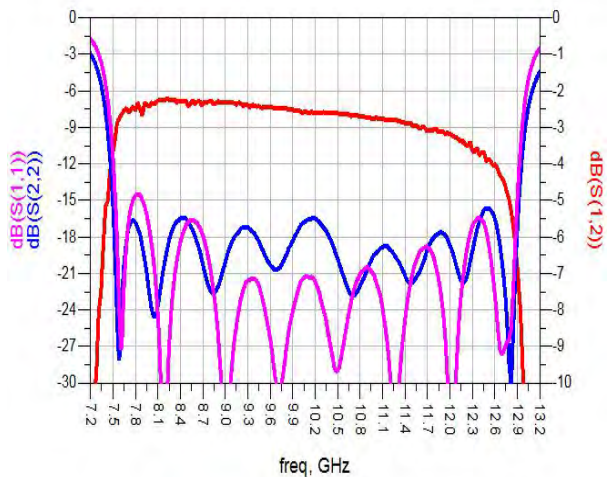


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.5	3.8	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



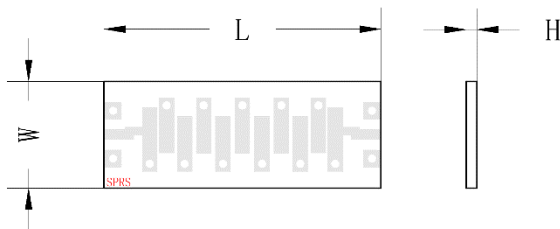
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

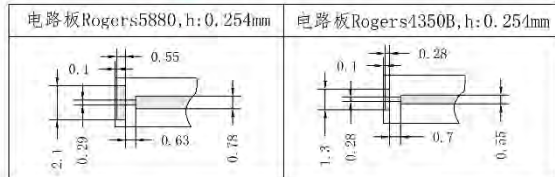
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		8.0		GHz
工作频率	7.85		8.15	GHz
中心损耗		3.8	4.3	dB
带内波动		0.5	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-7.2GHz	37	42		dBc
带外抑制@9.0-19.0GHz	37	42		dBc
承受功率			25	dBm
工作温度	-55		+85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^{\circ}\text{C}$

外形图: L: 6.5, W: 5.0, H: 0.254, 端口居中



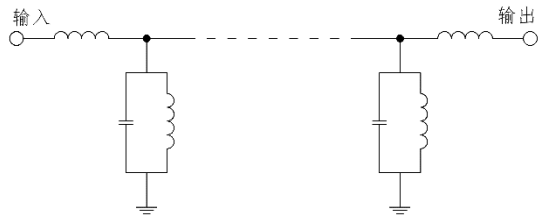
推荐装配图:



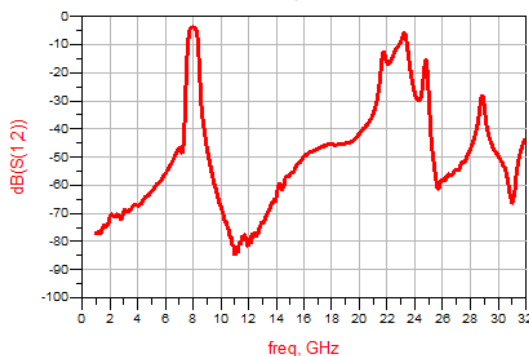
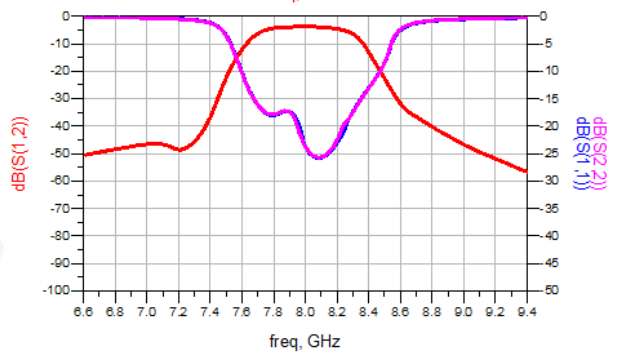
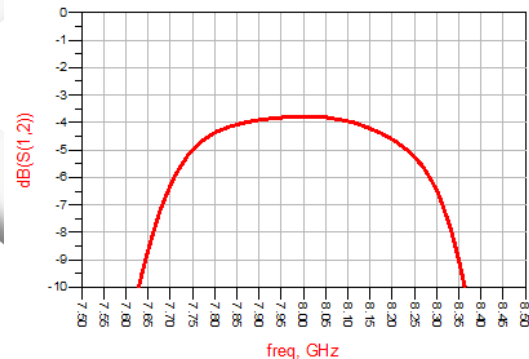
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^{\circ}\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

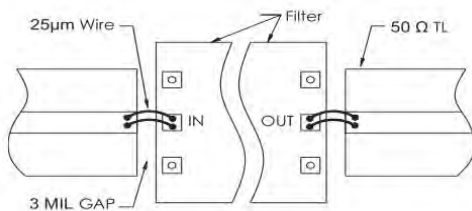
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		8.0		GHz
工作频率	7.9		8.1	GHz
中心损耗		5.0	5.5	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	14	18		
带外抑制	@DC-7.15GHz	40	45	dBc
	@8.65-22GHz	40	45	dBc

### 环境要求

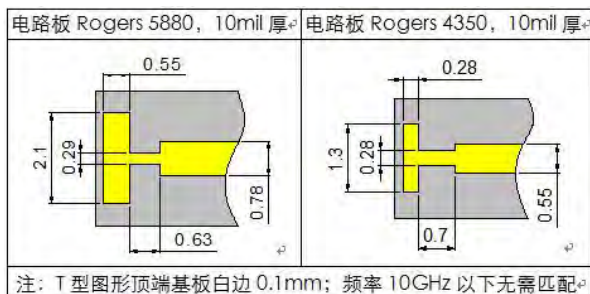
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

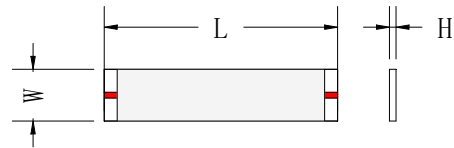
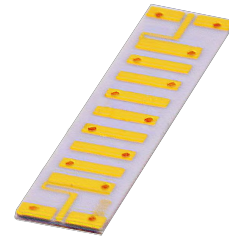


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

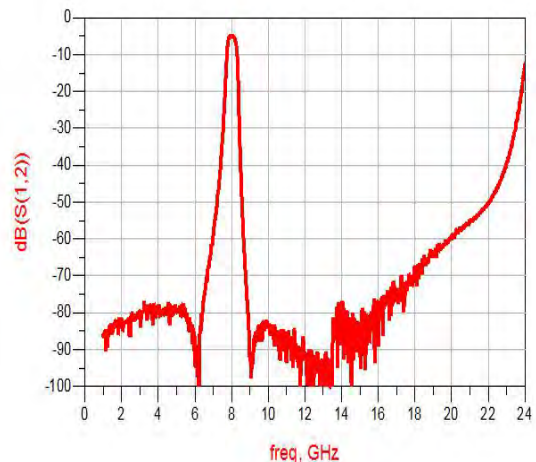
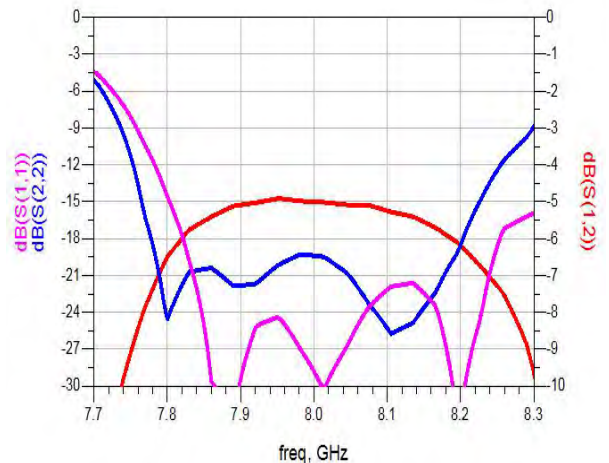


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	9.0	4.5	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

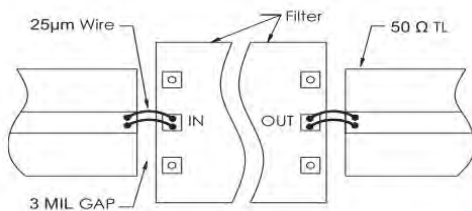
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		8.02		GHz
工作频率	7.94		8.1	GHz
中心损耗		5.5	6.0	dB
带内波动		1.0	1.5	dB
回波损耗		12	16	dB
带外抑制	@DC-6.6GHz	50	55	dBc
	@9.6-17GHz	50	55	dBc

### 环境要求

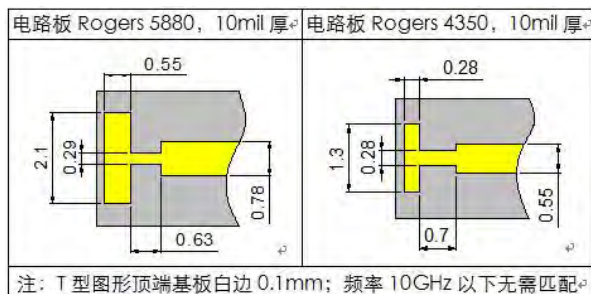
最大输入功率	25	dBm
工作温度	$-55^\circ\text{C}\sim+85^\circ\text{C}$	
储存温度	$-55^\circ\text{C}\sim+125^\circ\text{C}$	

### 推荐装配图

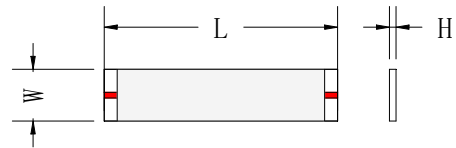
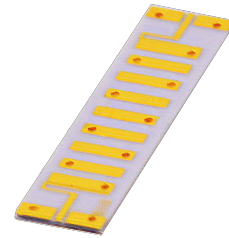


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

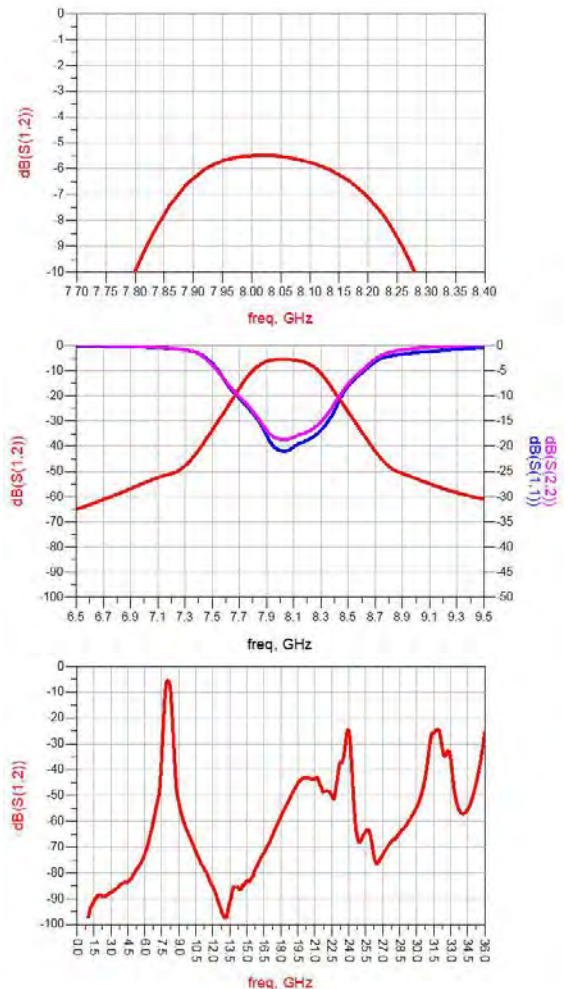


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	4.5	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



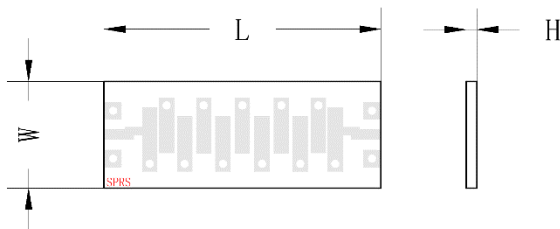
### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

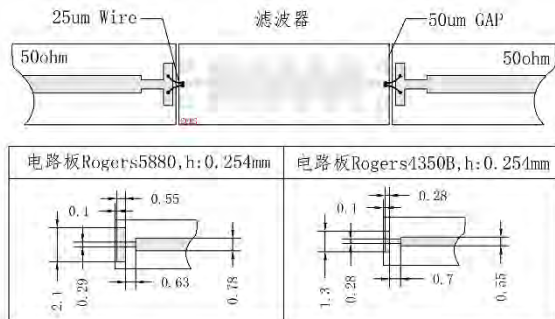
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		8.25		GHz
工作频率	7.9		8.6	GHz
中心损耗		2.4	2.9	dB
带内波动		0.5	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-7.2GHz	45	50		dBc
带外抑制@9.8-15.8GHz	36	41		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.5, W: 4.5, H: 0.254, 端口居中



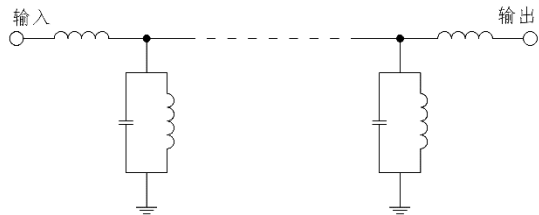
推荐装配图:



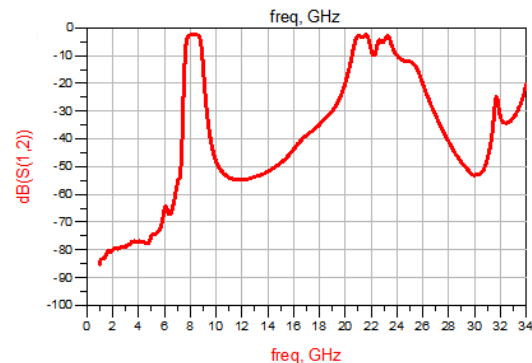
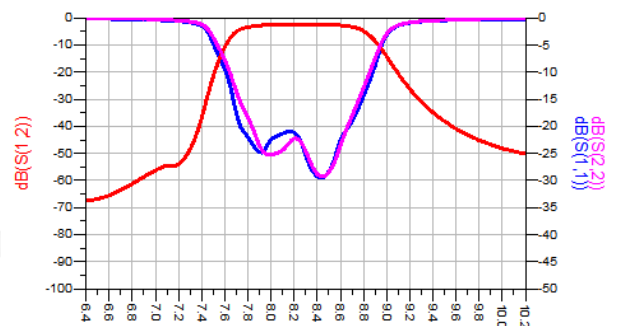
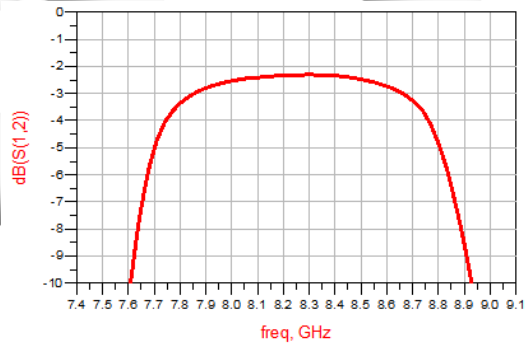
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



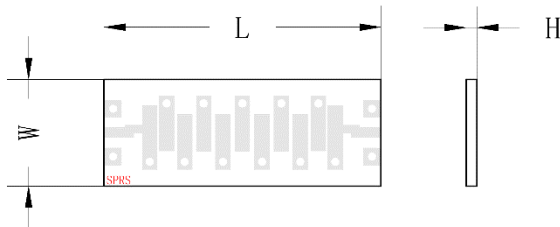
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

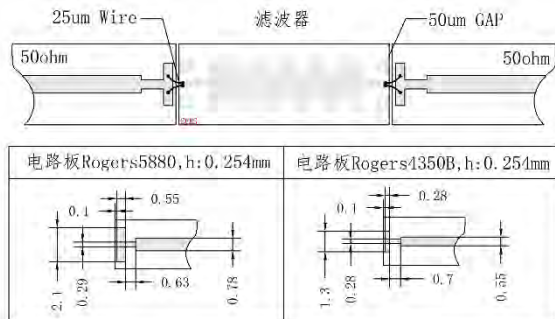
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		8.75		GHz
工作频率	7.9		9.6	GHz
中心损耗		1.9	2.4	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-7.0GHz	38	43		dBc
带外抑制@10.7-19.0GHz	45	50		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.5, W: 4.5, H: 0.254, 端口居中



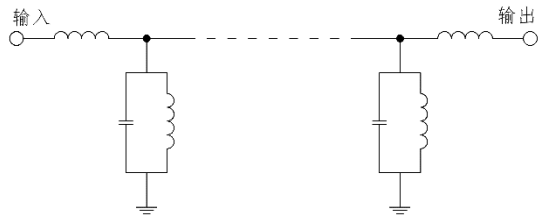
推荐装配图:



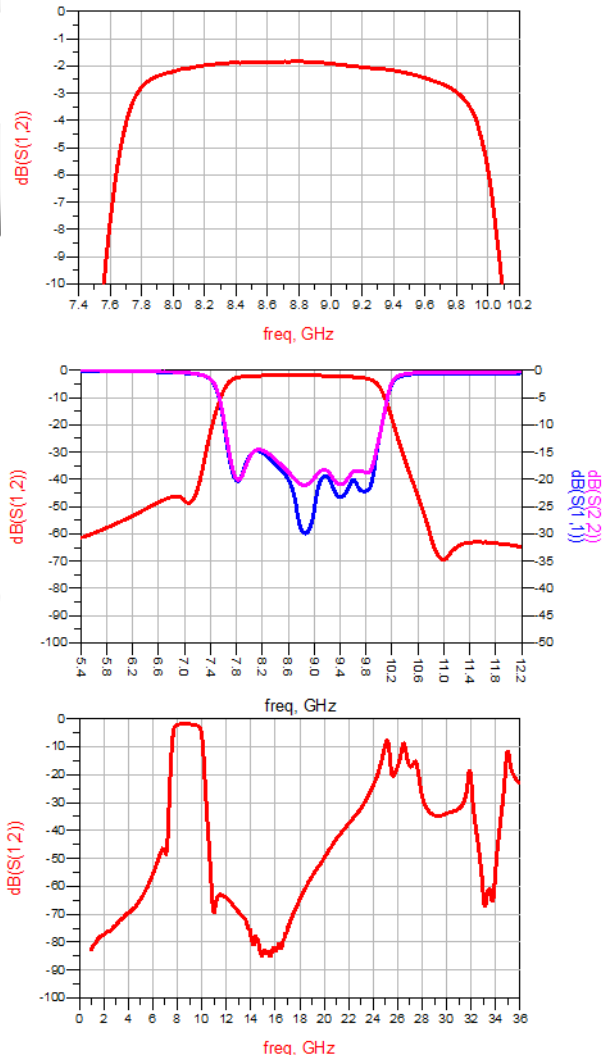
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

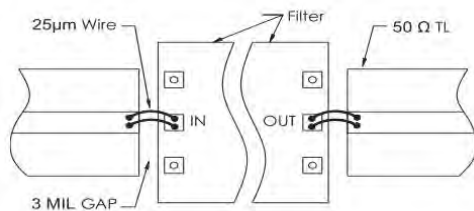
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		10.65		GHz
工作频率	7.9		13.4	GHz
中心损耗		2.0	2.5	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-5.8GHz	55	60	dBc
	@16.4-23.0GHz	55	60	dBc

环境要求

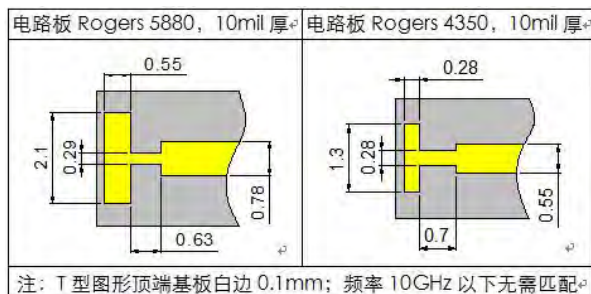
最大输入功率	30	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

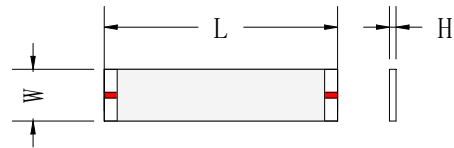
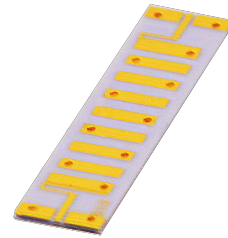


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm / °C),载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

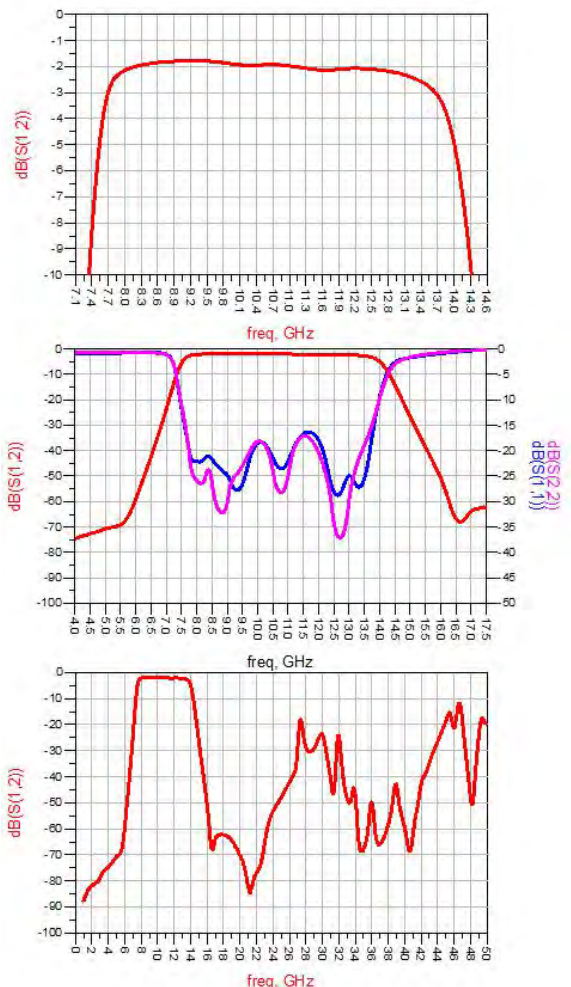


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	3.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

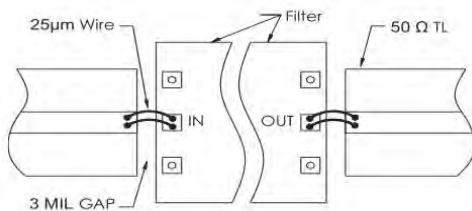
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		8.0		GHz
工作频率	6.0		10.0	GHz
中心损耗		1.2	1.7	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	16		dB
带外抑制	@DC-4.8GHz	40	45	dBc
	@11.8-19.0GHz	40	45	dBc

### 环境要求

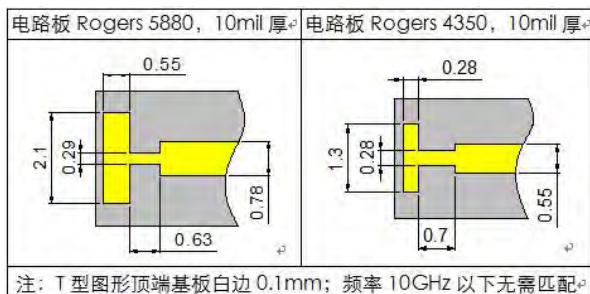
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

### 推荐装配图

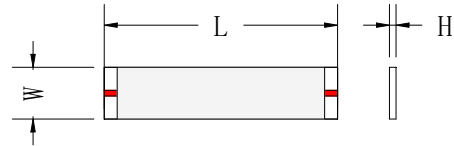
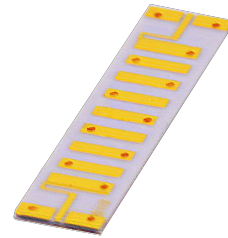


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

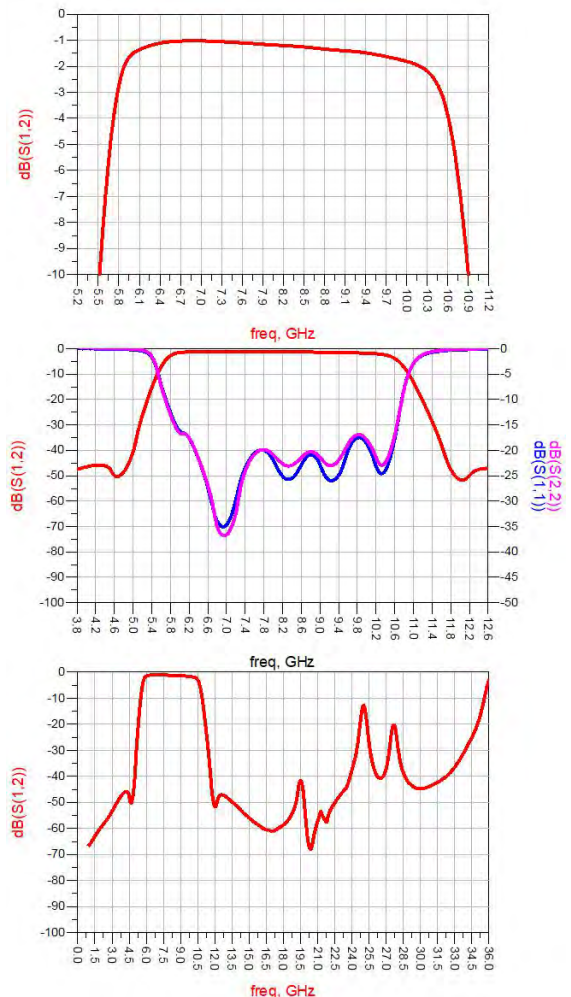


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	5.5	4.0	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

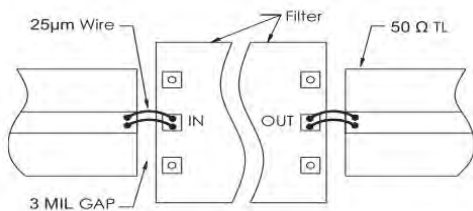
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		9.5		GHz
工作频率	8.0		11.0	GHz
中心损耗		1.7	2.3	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@DC-6.9GHz	40	45	dBc
	@12.3GHz	40	45	dBc

### 环境要求

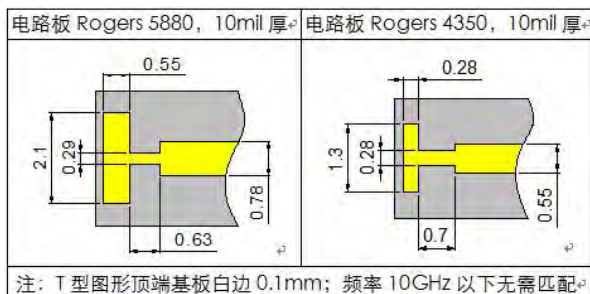
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^\circ\text{C}\sim+85^\circ\text{C}$	
储存温度	$-55^\circ\text{C}\sim+125^\circ\text{C}$	

### 推荐装配图

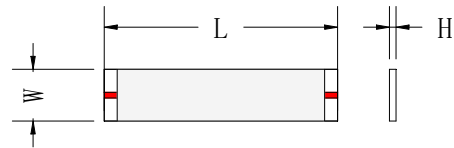
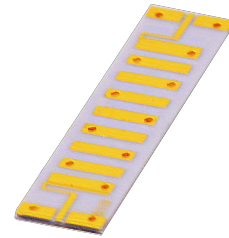


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

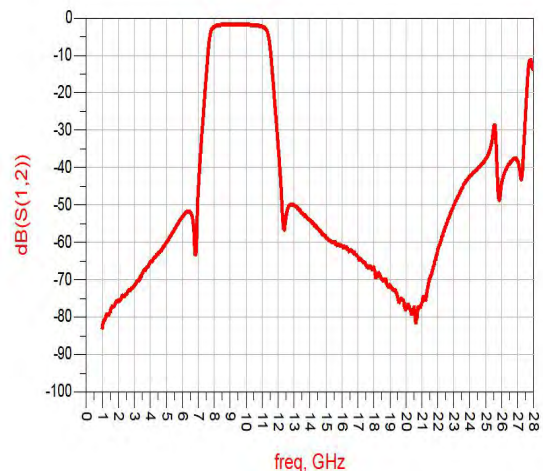
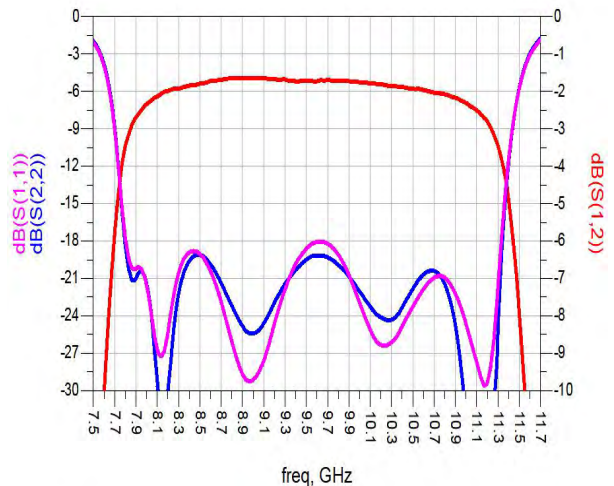


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	4.0	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

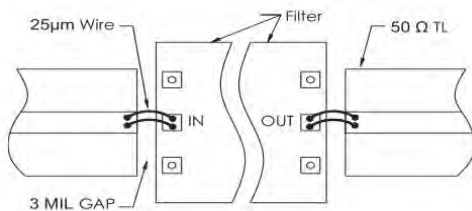
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		9.9		GHz
工作频率	8.0		11.8	GHz
中心损耗		1.4	1.9	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	16		dB
带外抑制	@DC-6.3GHz	42	47	dBc
	@13.9-23GHz	42	47	dBc

### 环境要求

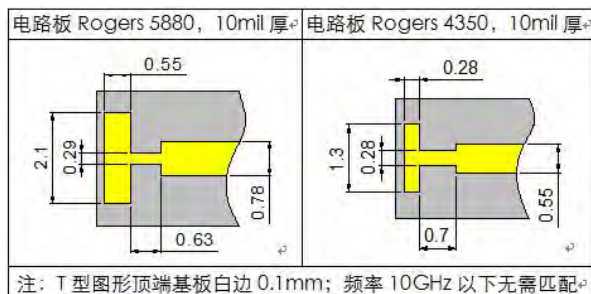
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

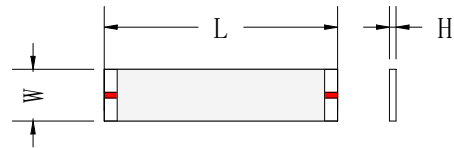
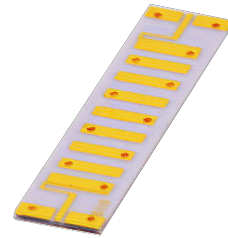


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

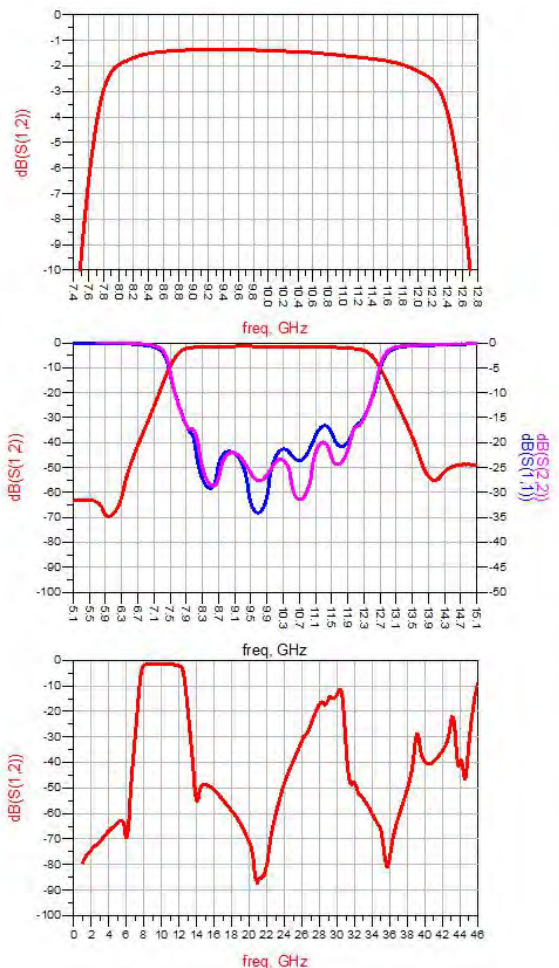


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	3.5	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块

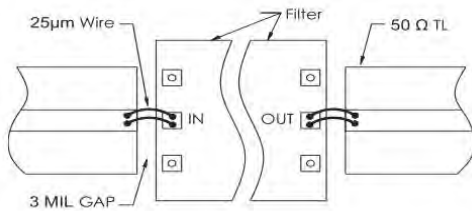
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		10.6		GHz
工作频率	8.0		13.2	GHz
中心损耗		1.2	1.6	dB
带内波动		1.2	1.5	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-4.8GHz	50	55	dBc
	@15.2-26.0GHz	50	55	dBc

环境要求

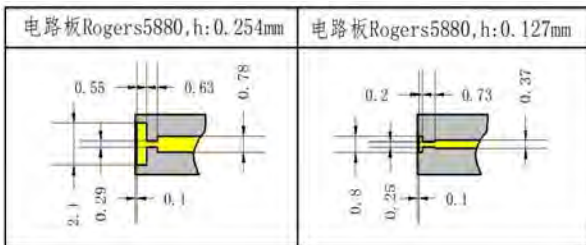
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

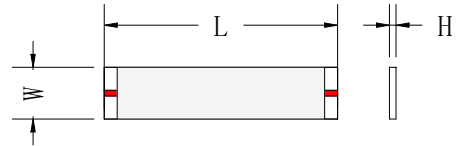
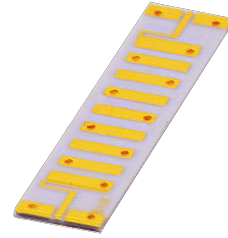


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁**0.1mm**,表面距上盖**2.75mm**,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配,T型尺寸如下:

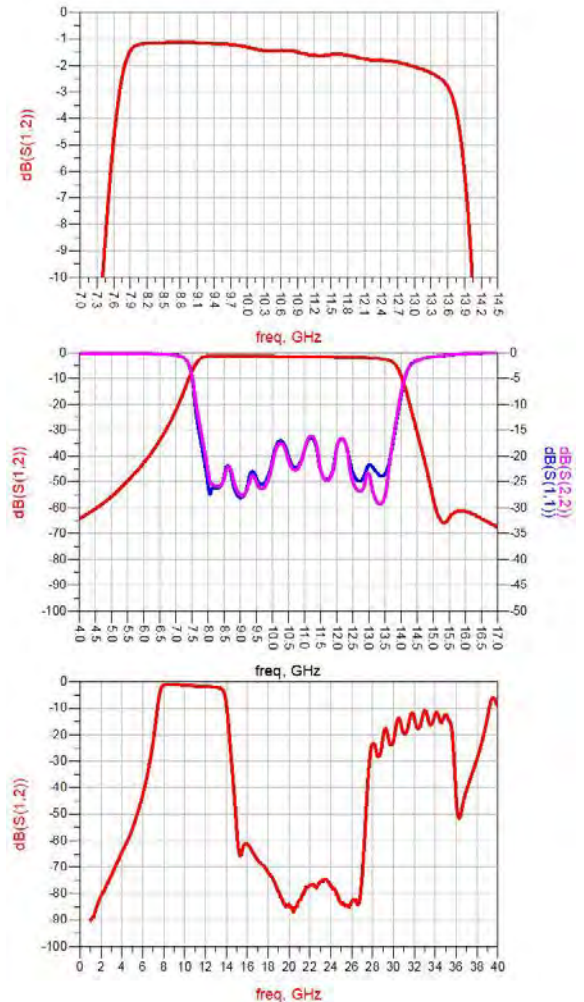


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.0	3.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

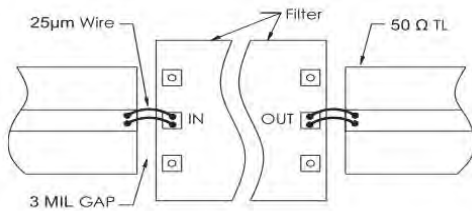
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		14.5		GHz
工作频率	8.0		21.0	GHz
中心损耗		0.4	0.7	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@DC-5.6GHz	41	46	dBc
	@23.8-34.5GHz	17	22	dBc

环境要求

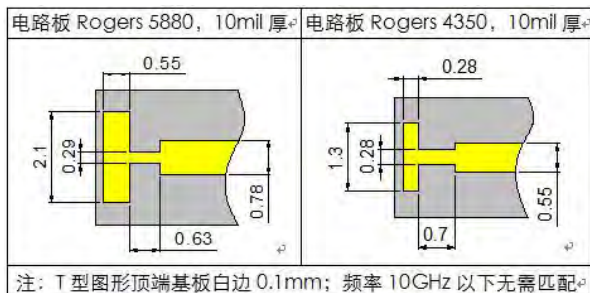
最大输入功率	25	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

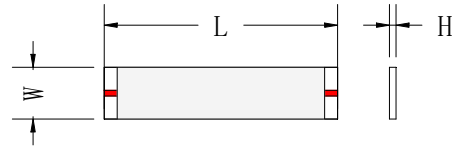
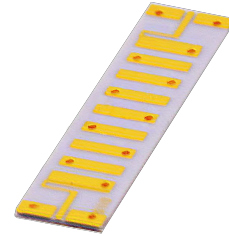


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配，T型尺寸如下:

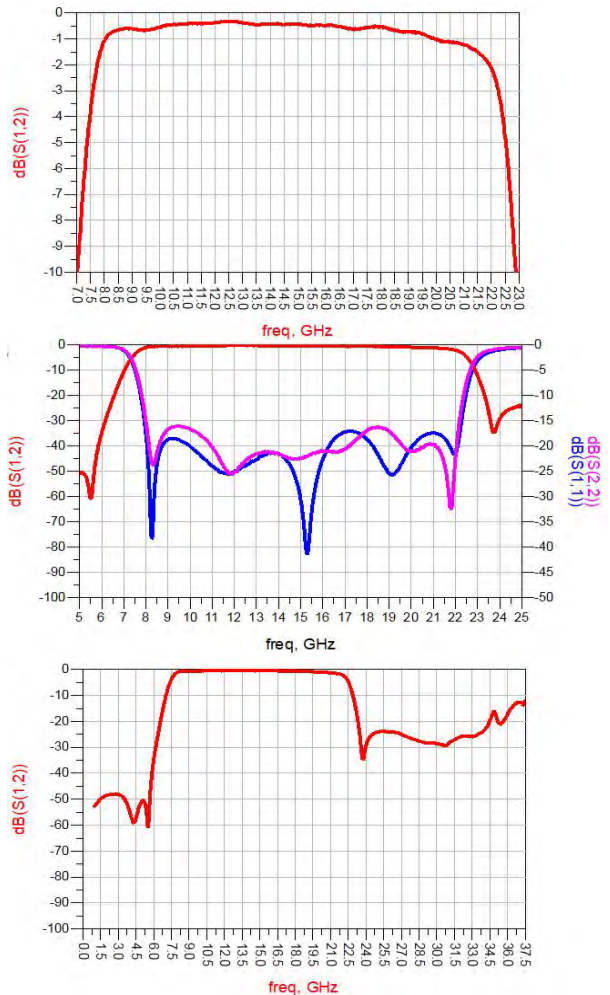


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	4.5	3.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



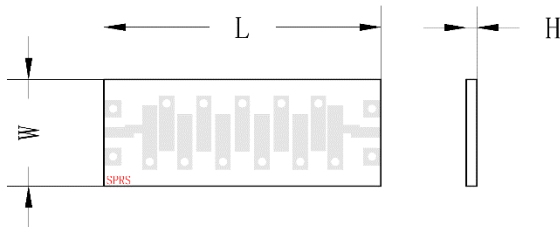
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

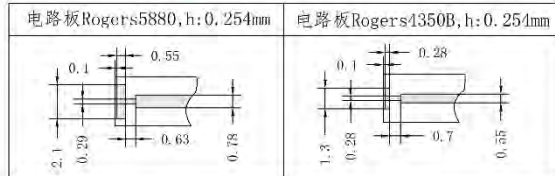
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		9.45		GHz
工作频率	8.1		10.8	GHz
中心损耗		1.8	2.3	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-7.0GHz	50	55		dBc
带外抑制@12.4-21.5GHz	55	60		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 8.0, W: 3.5, H: 0.254, 端口居中



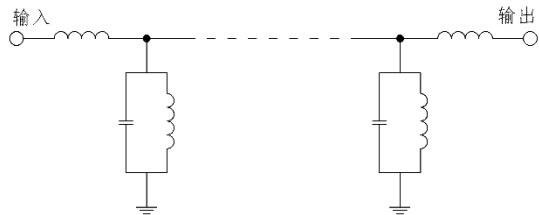
推荐装配图:



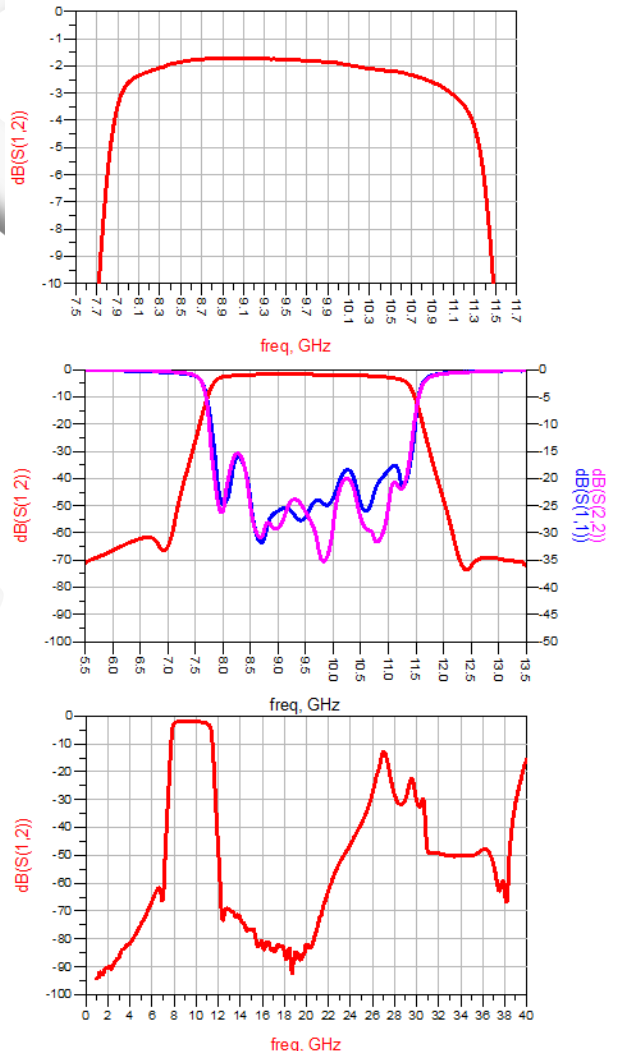
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁0.1mm，表面距上盖2.75mm，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图

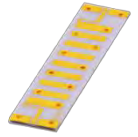


典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

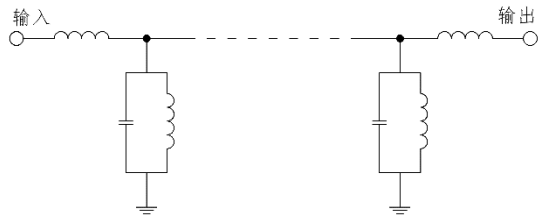
- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块



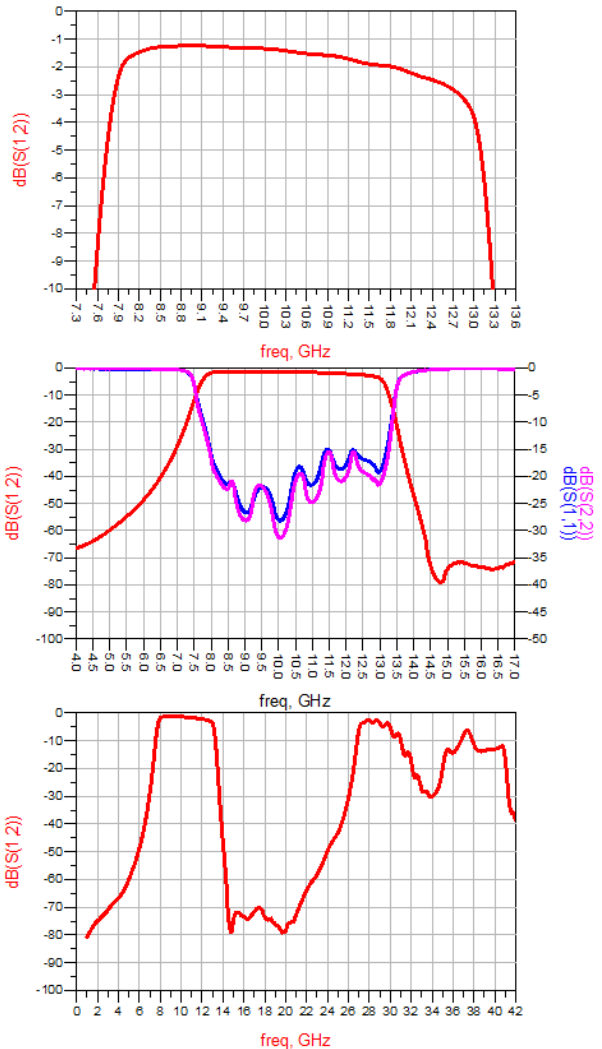
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		10.3		GHz
工作频率	8.1		12.5	GHz
中心损耗		1.5	2.0	dB
带内波动		1.1	1.5	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-4.5GHz	55	60		dBc
带外抑制@14.4-22.0GHz	55	60		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	°C
储存温度	-55		+125	°C

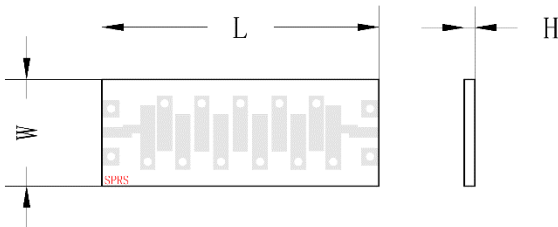
原理图



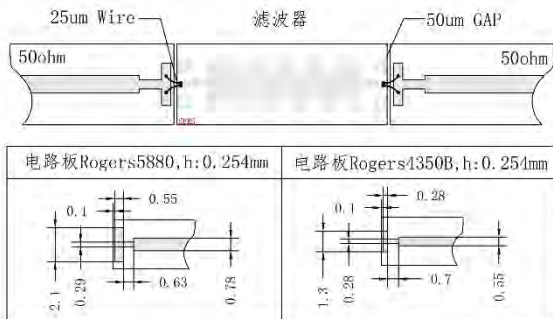
典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



外形图: L: 7.5, W: 4.0, H: 0.254, 端口居中



推荐装配图:



注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 ≥ 0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

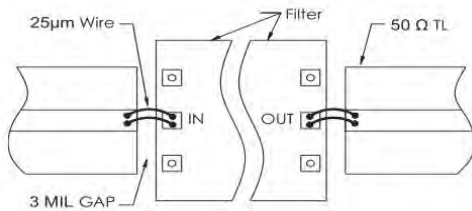
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		8.9		GHz
工作频率	8.3		9.5	GHz
中心损耗		1.8	2.3	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-7.5GHz	35	40	dBc
	@10.5-21.0GHz	37	42	dBc

环境要求

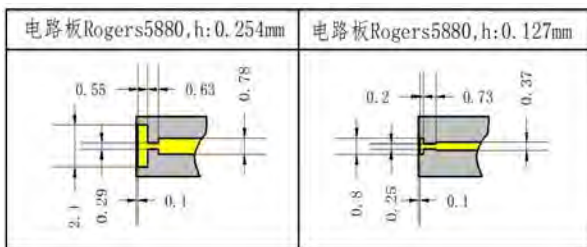
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

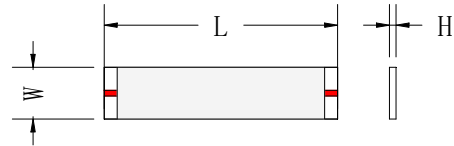
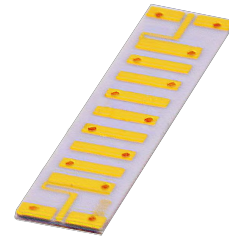


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

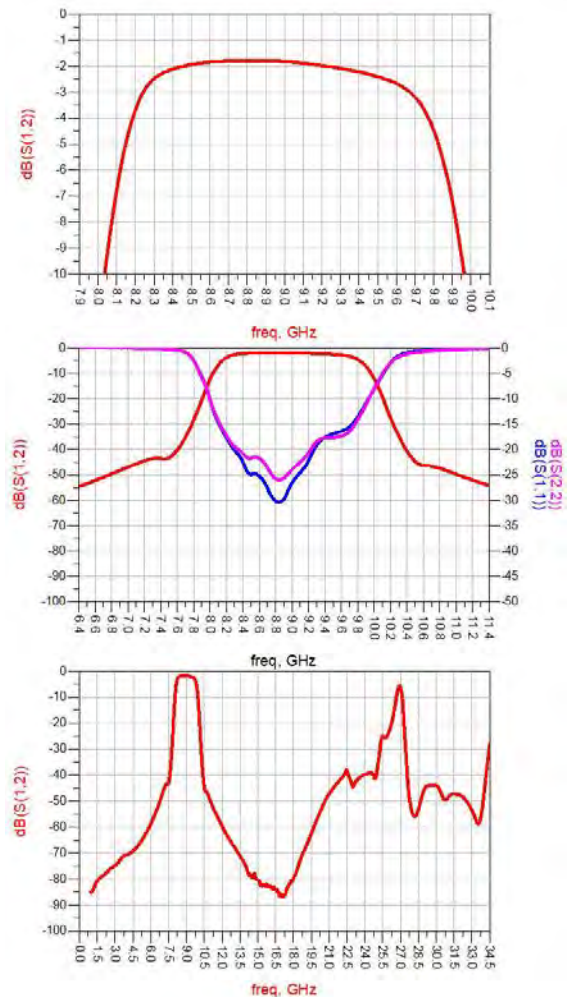


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	4.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

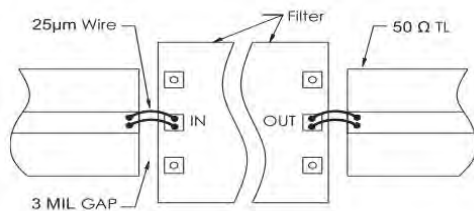
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		9.1		GHz
工作频率	8.3		9.9	GHz
中心损耗		2.0	2.5	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	14		
带外抑制	@DC-7.4GHz	40	45	dBc
	@11-25GHz	40	45	dBc

环境要求

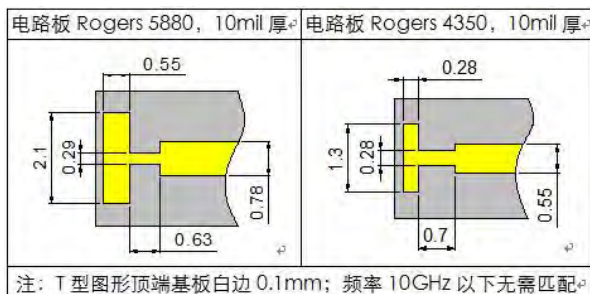
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

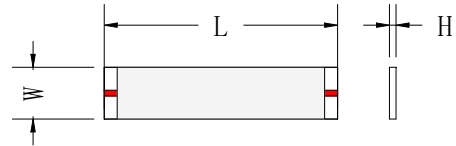
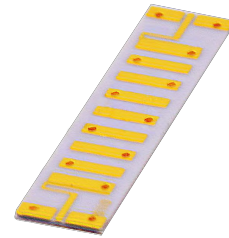


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

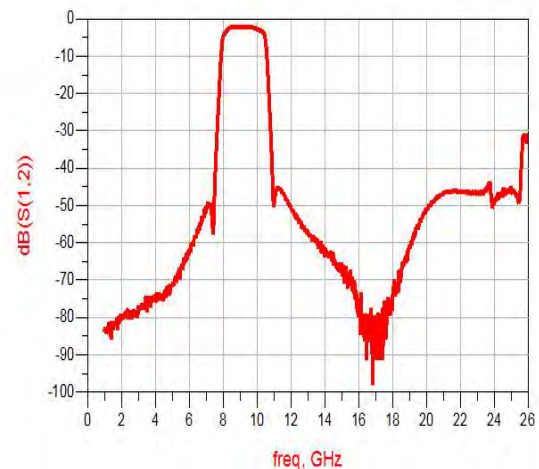
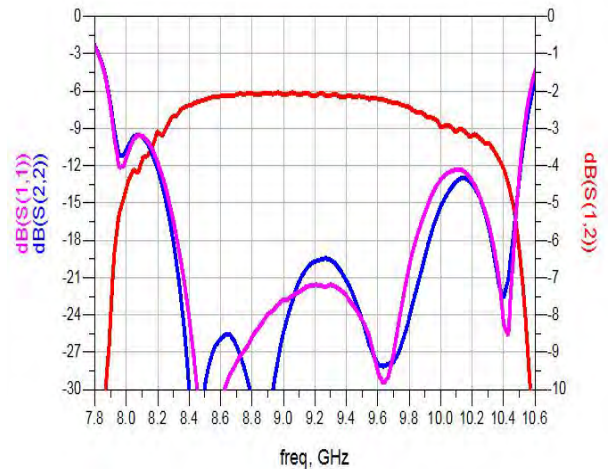


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	4.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



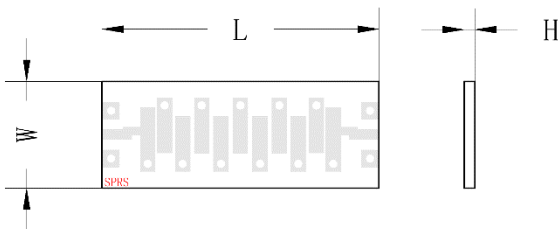
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

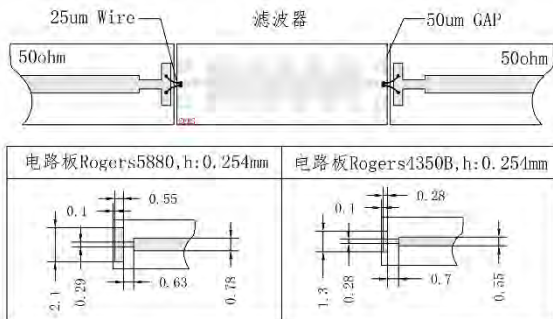
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		9.2		GHz
工作频率	8.3		10.1	GHz
中心损耗		1.9	2.4	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-7.5GHz	31	36		dBc
带外抑制@11.4-20.0GHz	45	50		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^{\circ}\text{C}$

外形图: L: 7.5, W: 4.5, H: 0.254, 端口居中



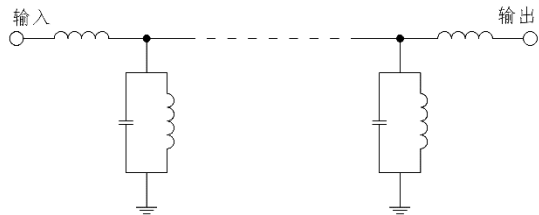
推荐装配图:



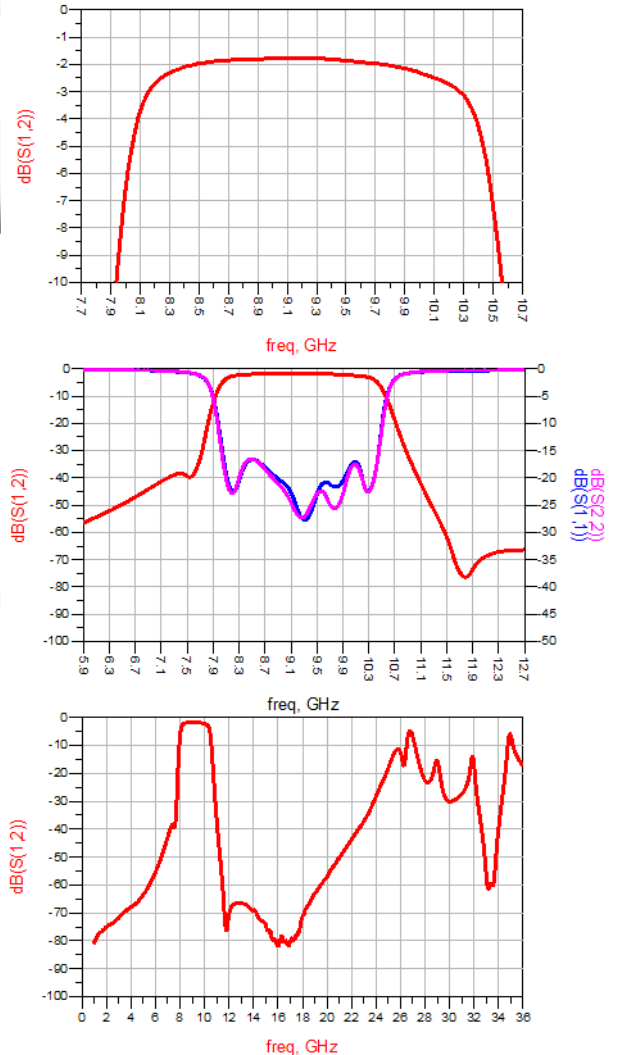
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^{\circ}\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



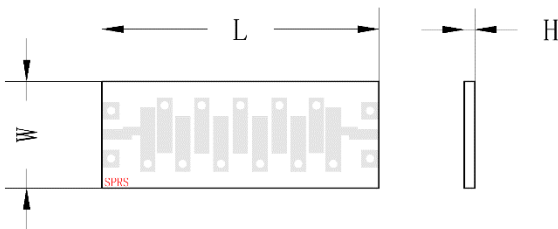
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

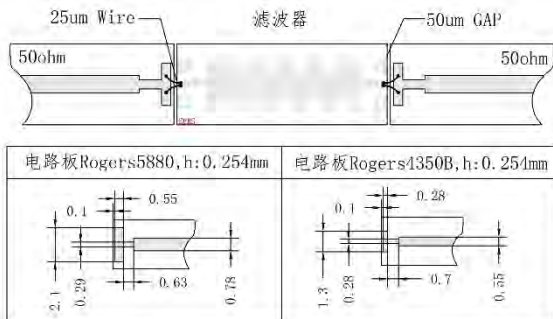
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		8.75		GHz
工作频率	8.4		9.1	GHz
中心损耗		2.3	2.8	dB
带内波动		0.5	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-7.6GHz	35	40		dBc
带外抑制@10.2-16.0GHz	35	40		dBc
承受功率			35	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.5, W: 4.5, H: 0.254, 端口居中



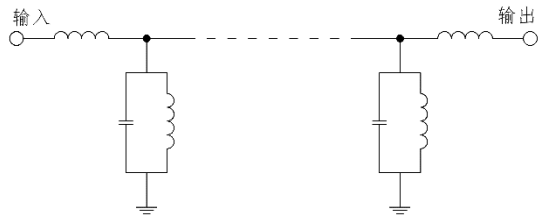
推荐装配图:



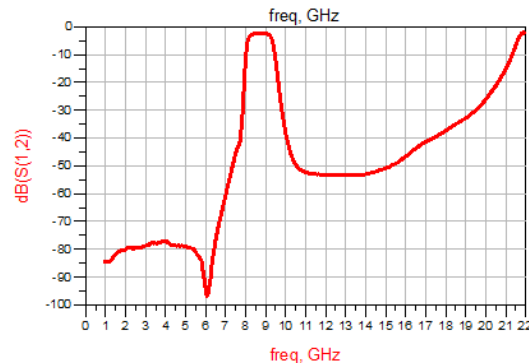
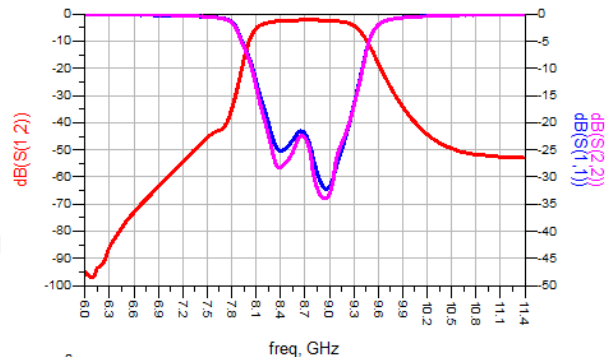
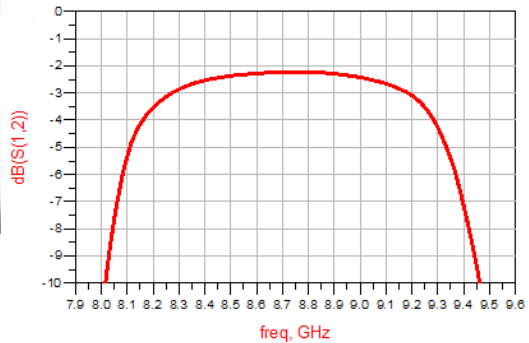
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

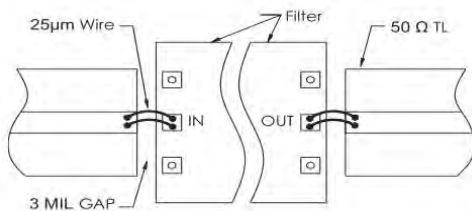
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		11.0		GHz
工作频率	8.5		13.5	GHz
中心损耗		1.1	1.6	dB
带内波动		1.0	1.2	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-6.0GHz	35	40	dBc
	@15.0-28.0GHz	35	40	dBc

环境要求

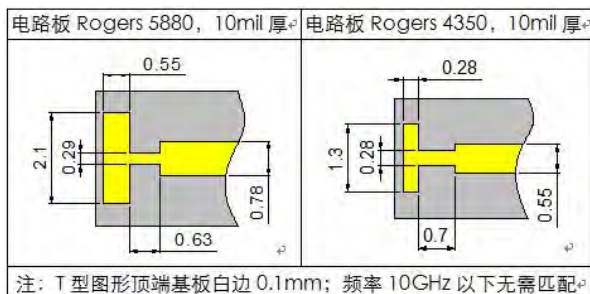
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

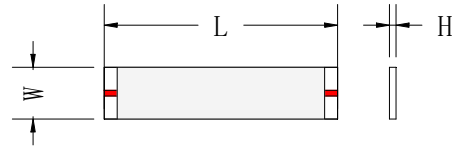
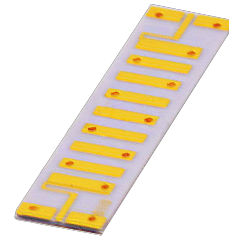


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm / °C), 载体厚度 ≥ 0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

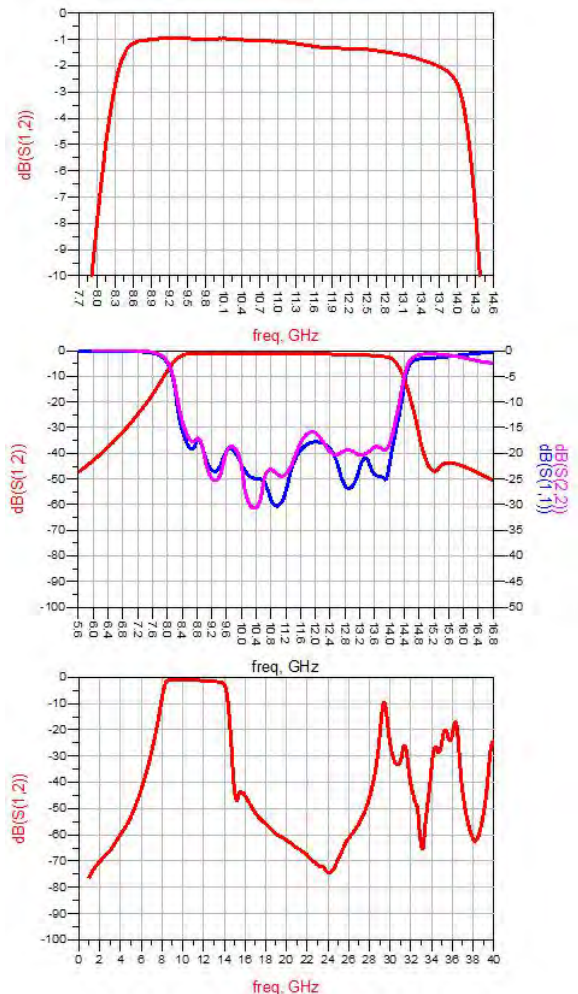


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.0	3.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

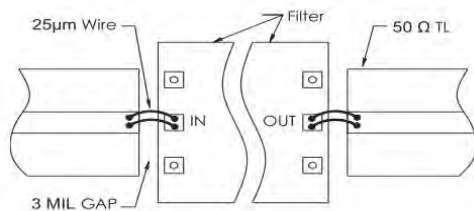
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		8.82		GHz
工作频率	8.72		8.92	GHz
中心损耗		4.9	5.5	dB
带内波动		0.5	1.0	dB
回波损耗	14	18		
带外抑制	@DC-7.9GHz	40	45	dBc
	@9.4-23GHz	40	45	dBc

### 环境要求

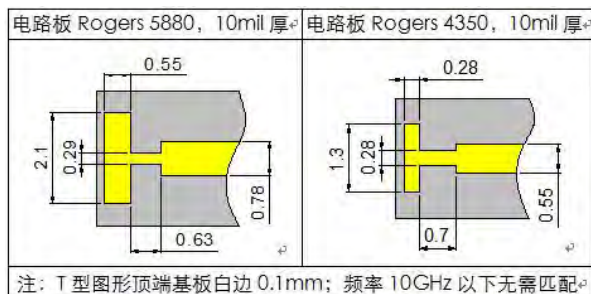
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

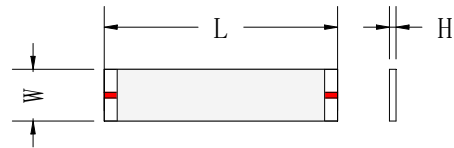
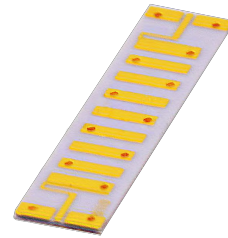


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

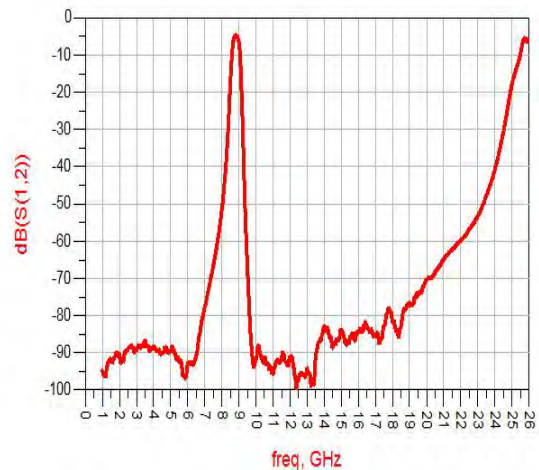
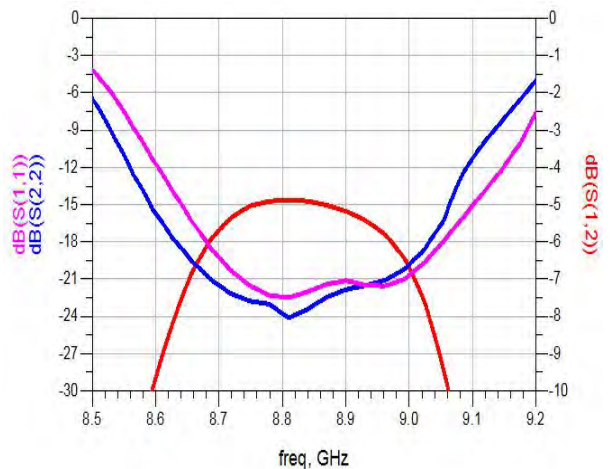


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	9.0	4.5	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



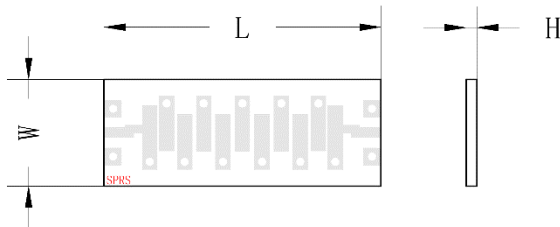
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

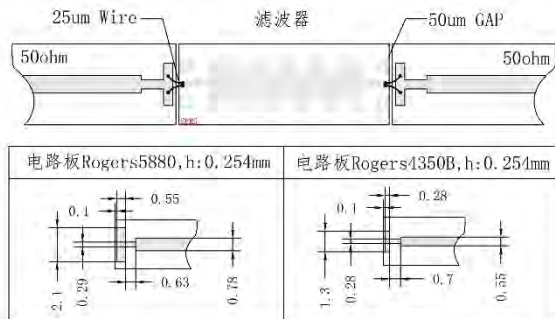
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		9.2		GHz
工作频率	8.85		9.55	GHz
中心损耗		2.3	2.8	dB
带内波动		0.5	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-8.1GHz	35	40		dBc
带外抑制@10.7-16.5GHz	35	40		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.5, W: 4.5, H: 0.254, 端口居中



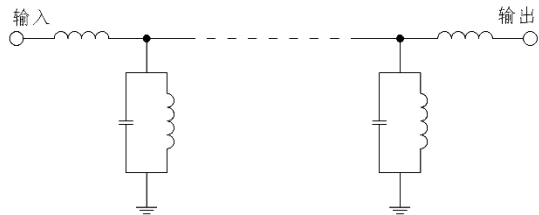
推荐装配图:



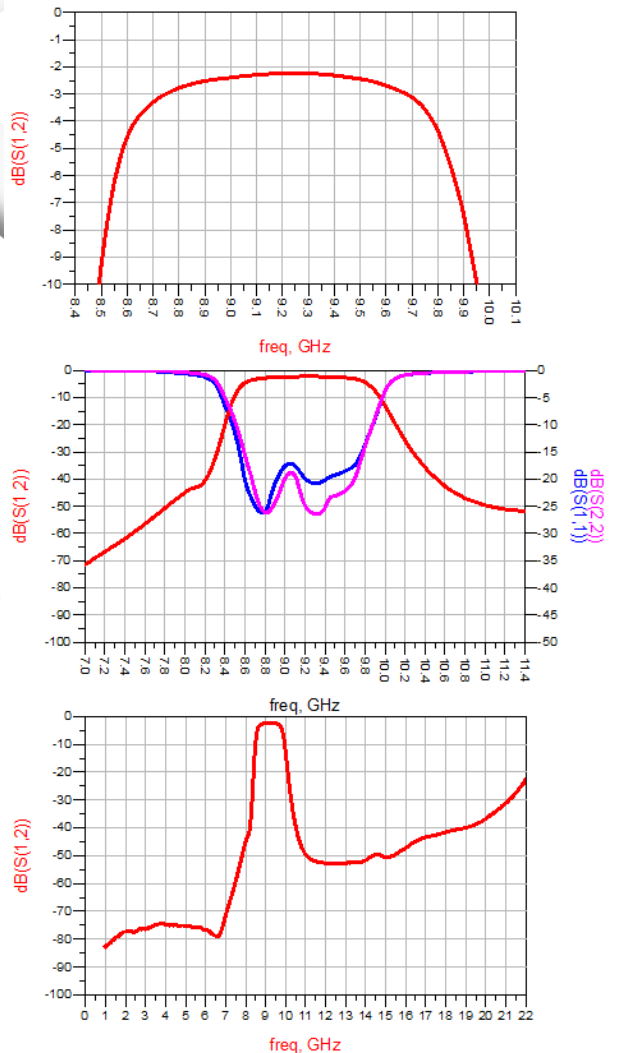
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



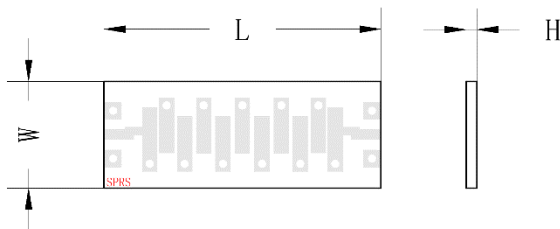
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

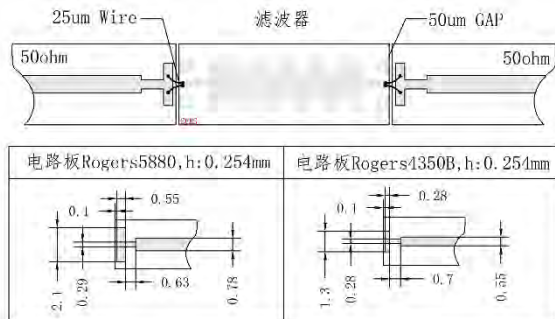
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		9.65		GHz
工作频率	8.9		10.4	GHz
中心损耗		1.9	2.4	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-8.0GHz	31	36		dBc
带外抑制@11.7-21.0GHz	45	50		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.5, W: 4.5, H: 0.254, 端口居中



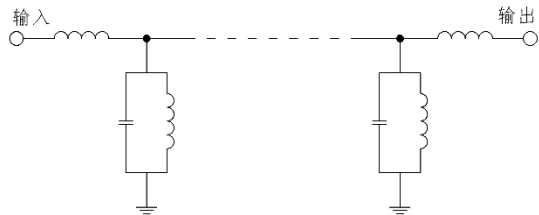
推荐装配图:



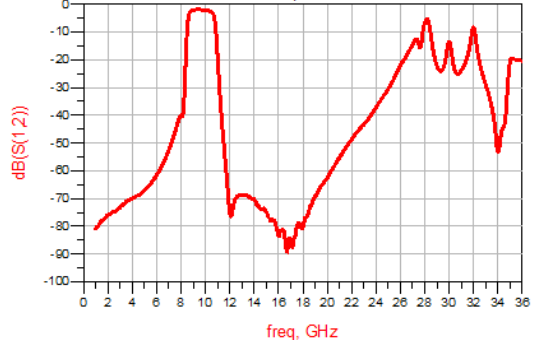
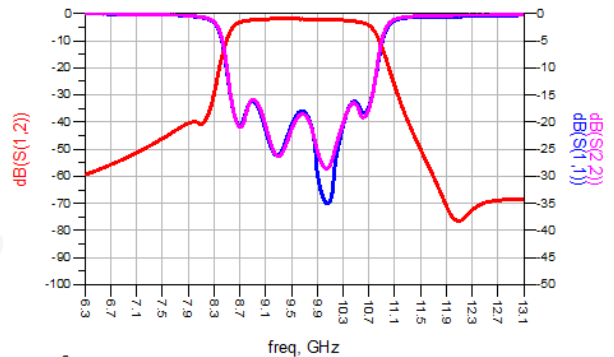
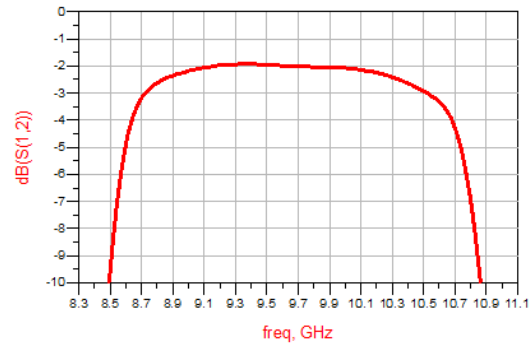
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

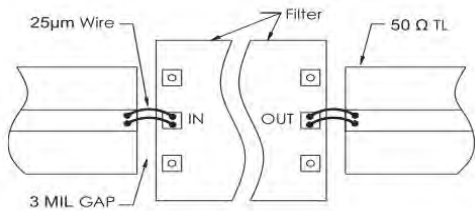
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		11.7		GHz
工作频率	8.9		14.5	GHz
中心损耗		1.1	1.6	dB
带内波动		0.9	1.2	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-4.5GHz	50	55	dBc
	@16.8-31.0GHz	50	55	dBc

环境要求

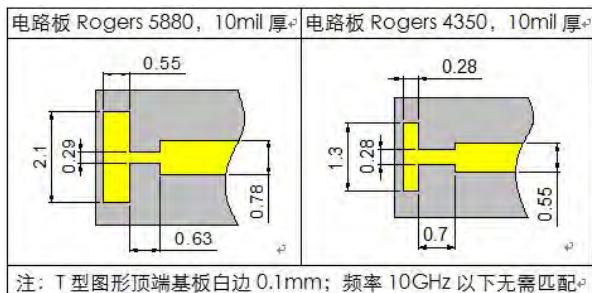
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^\circ\text{C}\sim+85^\circ\text{C}$	
储存温度	$-55^\circ\text{C}\sim+125^\circ\text{C}$	

推荐装配图

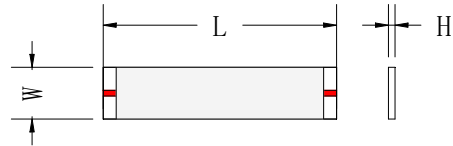
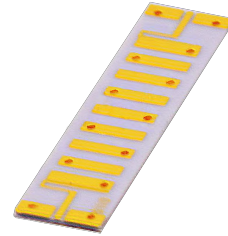


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

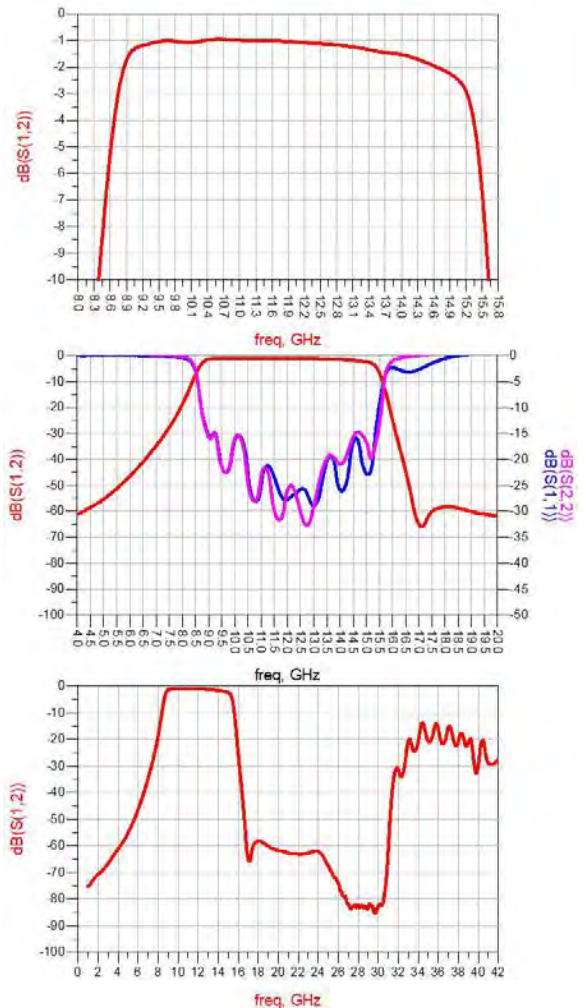


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	3.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

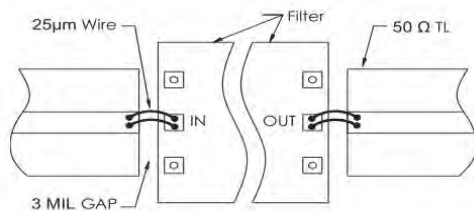
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		10.55		GHz
工作频率	9.0		12.1	GHz
中心损耗		1.8	2.3	dB
带内波动		0.85	1.0	dB
回波损耗	12	13.5		
带外抑制	@5.9-7.8GHz	40	45	dBc
	@13.7-14GHz	40	45	dBc
	@DC-5.9GHz	50	55	dBc
	@14-26GHz	50	55	dBc

### 环境要求

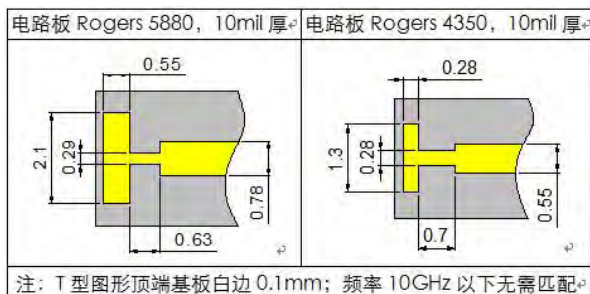
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

### 推荐装配图

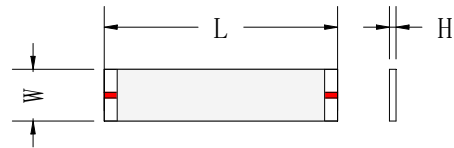
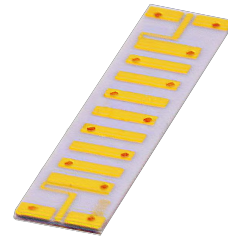


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

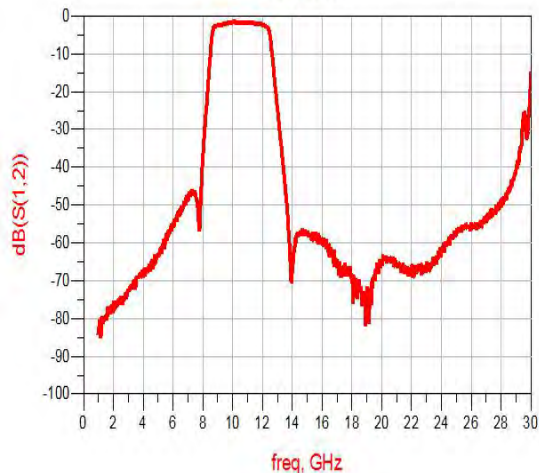
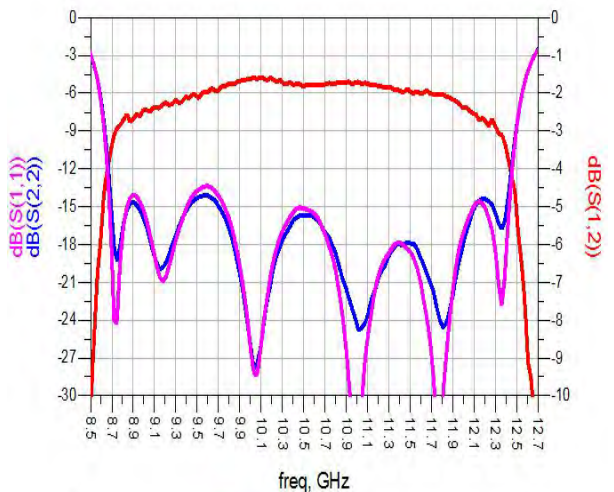


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	3.5	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

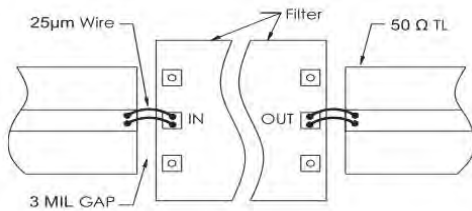
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		11.0		GHz
工作频率	9.1		12.9	GHz
中心损耗		1.5	2.0	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-5.8GHz	55	60	dBc
	@14.6-24.0GHz	55	60	dBc

环境要求

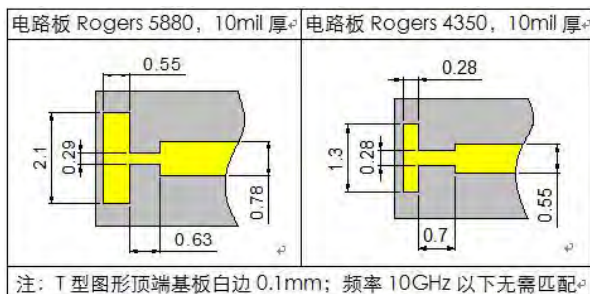
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

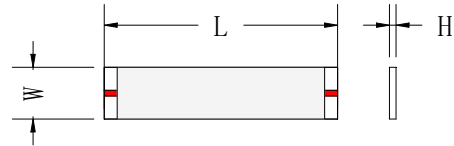
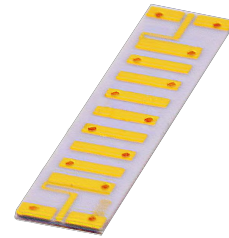


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

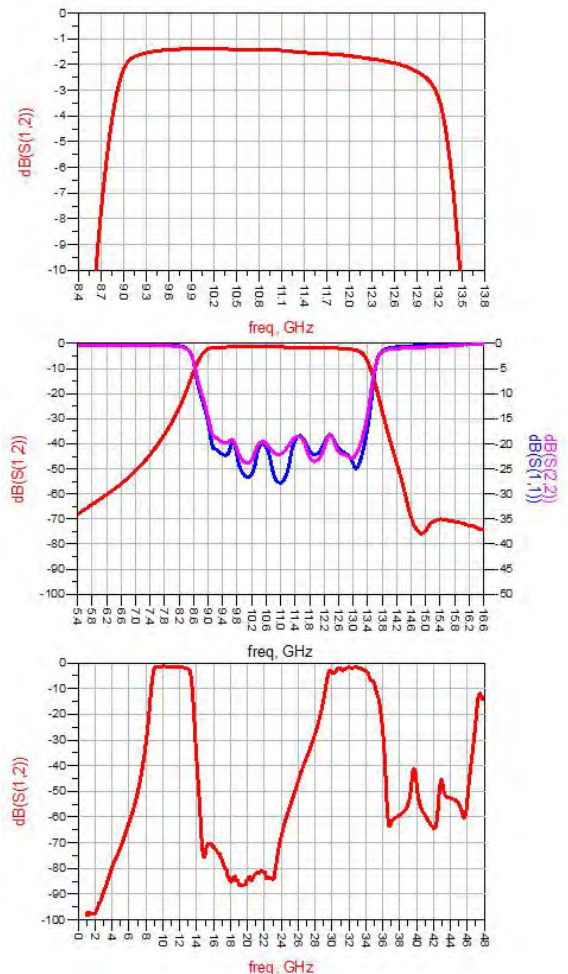


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	3.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

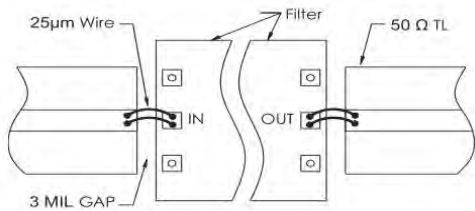
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		15.8		GHz
工作频率	9.2		22.4	GHz
中心损耗		0.5	0.8	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@DC-6.7GHz	40	45	dBc
	@25.5-35.0GHz	13	18	dBc

环境要求

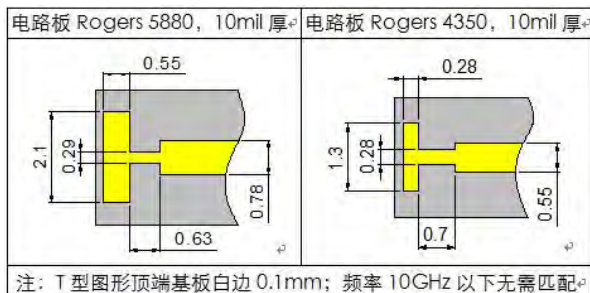
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

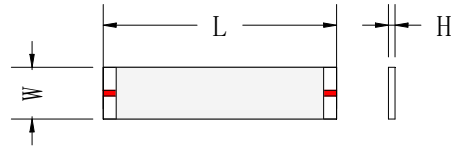
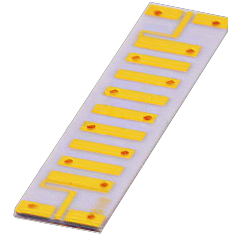


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

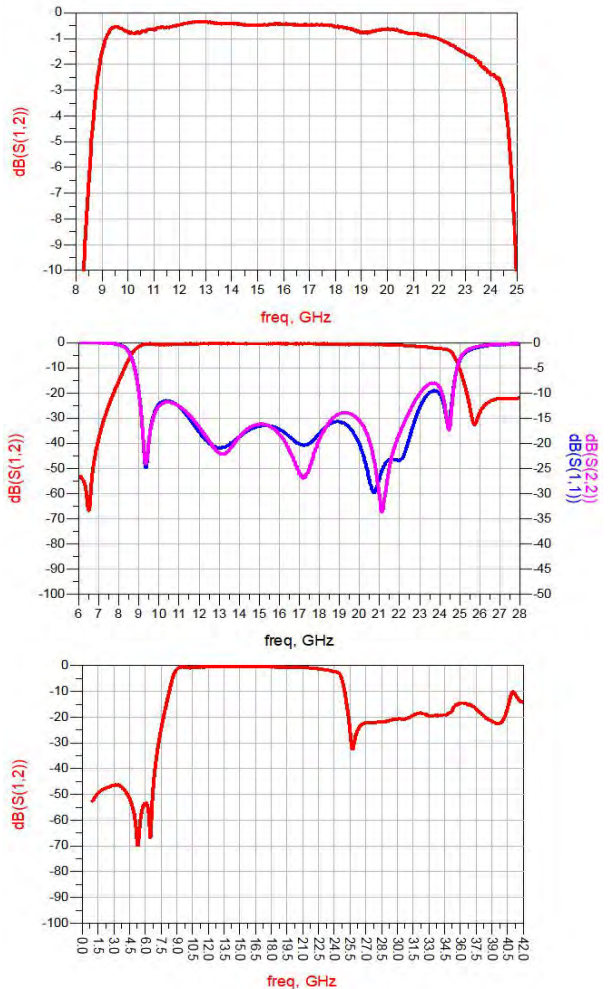


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	3.2	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



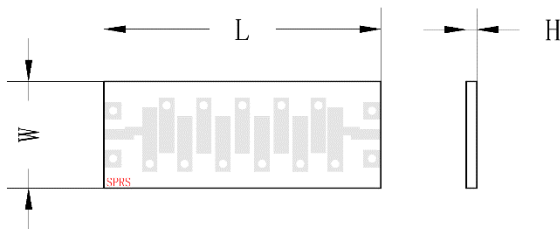
### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

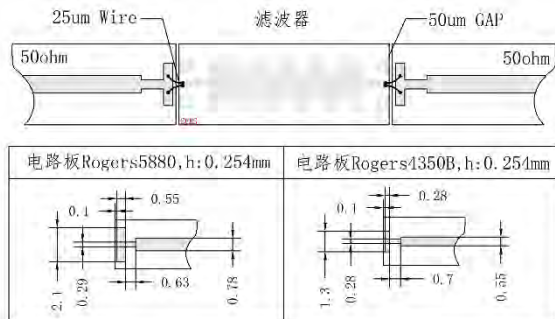
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		10.1		GHz
工作频率	9.3		10.9	GHz
中心损耗		1.9	2.4	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-8.5GHz	31	36		dBc
带外抑制@12.2-21.0GHz	45	50		dBc
承受功率			35	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.5, W: 4.5, H: 0.254, 端口居中



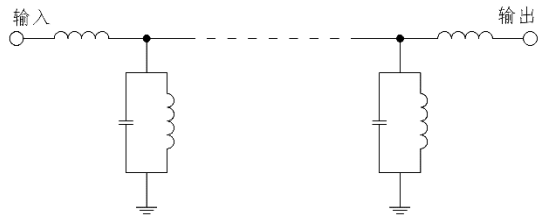
### 推荐装配图:



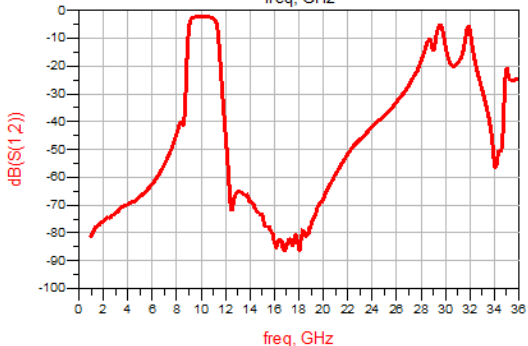
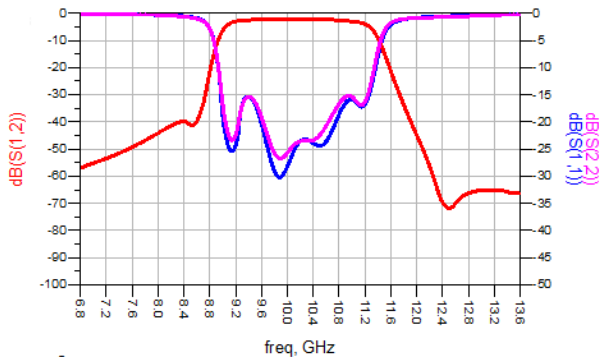
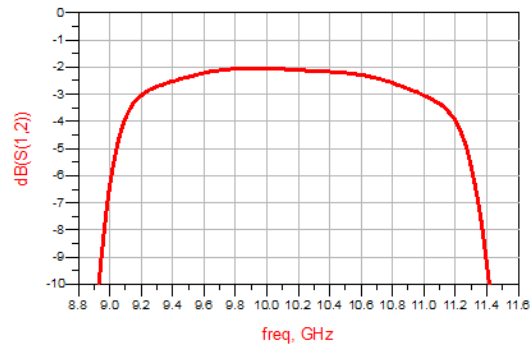
### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

### 原理图



### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



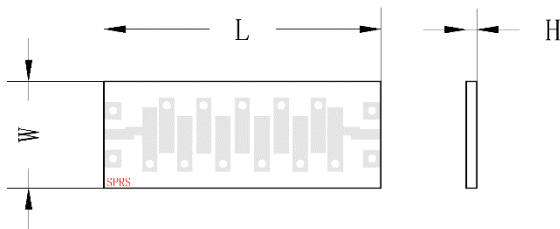
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

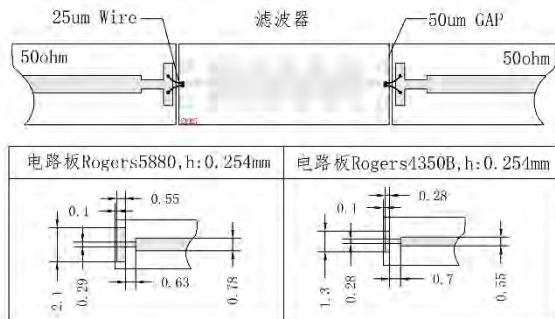
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		10.65		GHz
工作频率	9.3		12.0	GHz
中心损耗		2.0	2.5	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-8.2GHz	50	55		dBc
带外抑制@13.4-22.0GHz	55	60		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 8.0, W: 3.5, H: 0.254, 端口居中



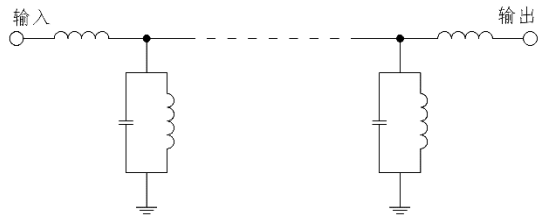
推荐装配图:



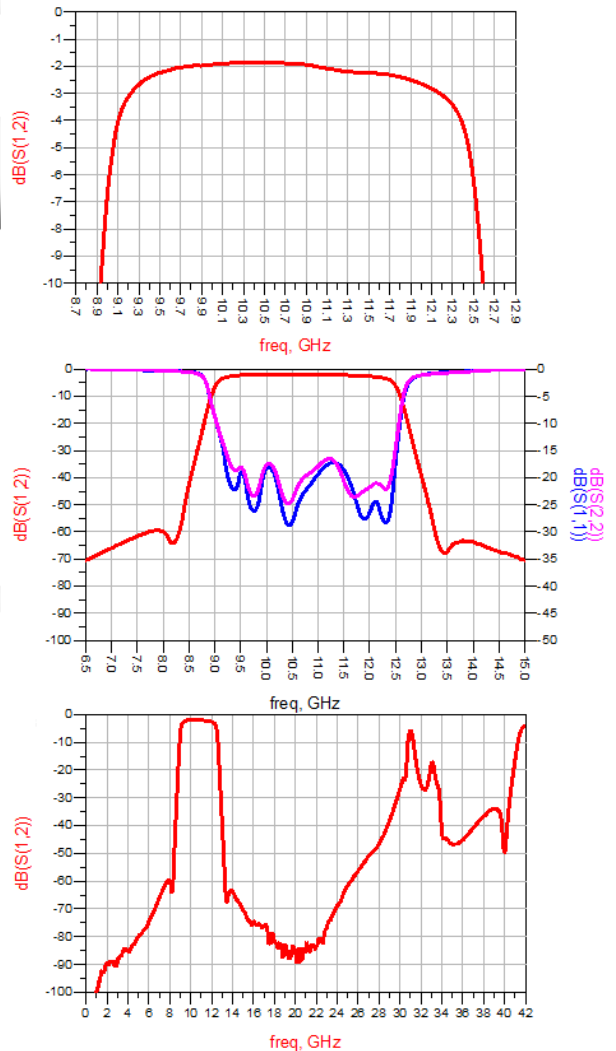
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁0.1mm，表面距上盖2.75mm，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



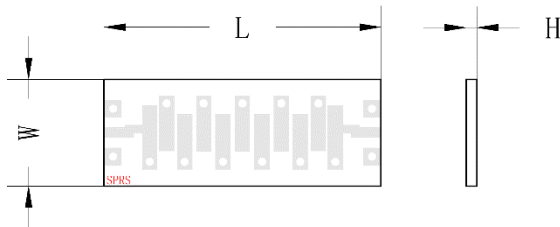
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

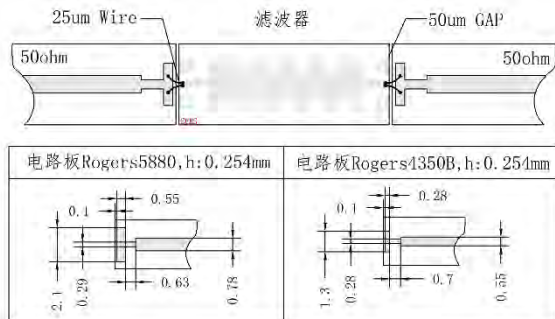
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		9.75		GHz
工作频率	9.4		10.1	GHz
中心损耗		2.6	3.1	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-8.6GHz	33	38		dBc
带外抑制@11.4-18.0GHz	35	40		dBc
承受功率			27	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.5, W: 4.5, H: 0.254, 端口居中



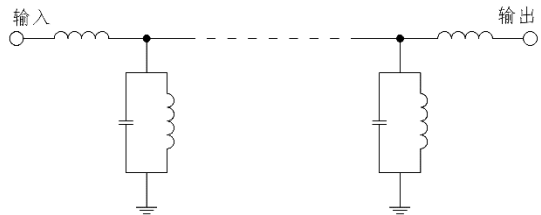
推荐装配图:



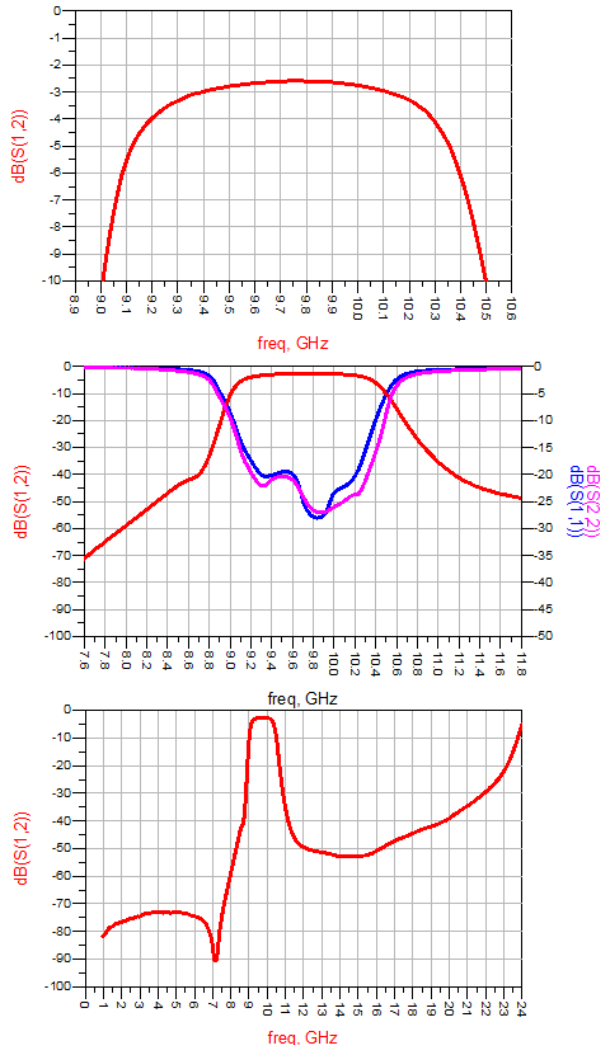
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



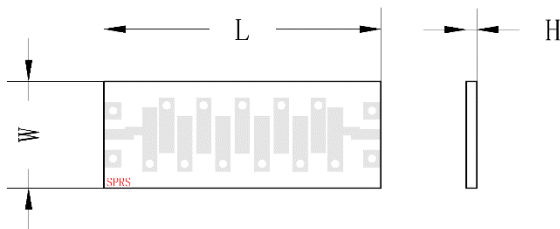
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

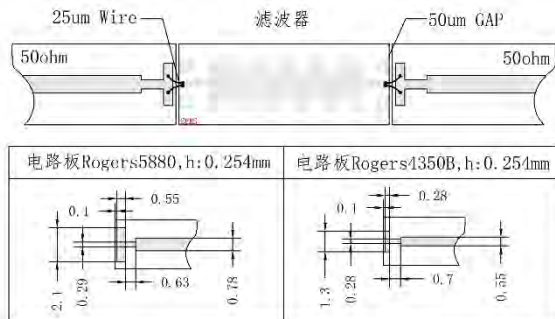
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		10.0		GHz
工作频率	9.4		10.6	GHz
中心损耗		2.7	3.2	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-8.3GHz	53	58		dBc
带外抑制@11.8-22.0GHz	53	58		dBc
承受功率			27	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 8.5, W: 4.0, H: 0.254, 端口居中



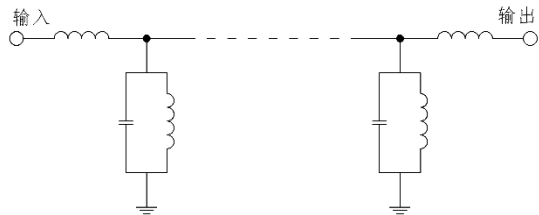
推荐装配图:



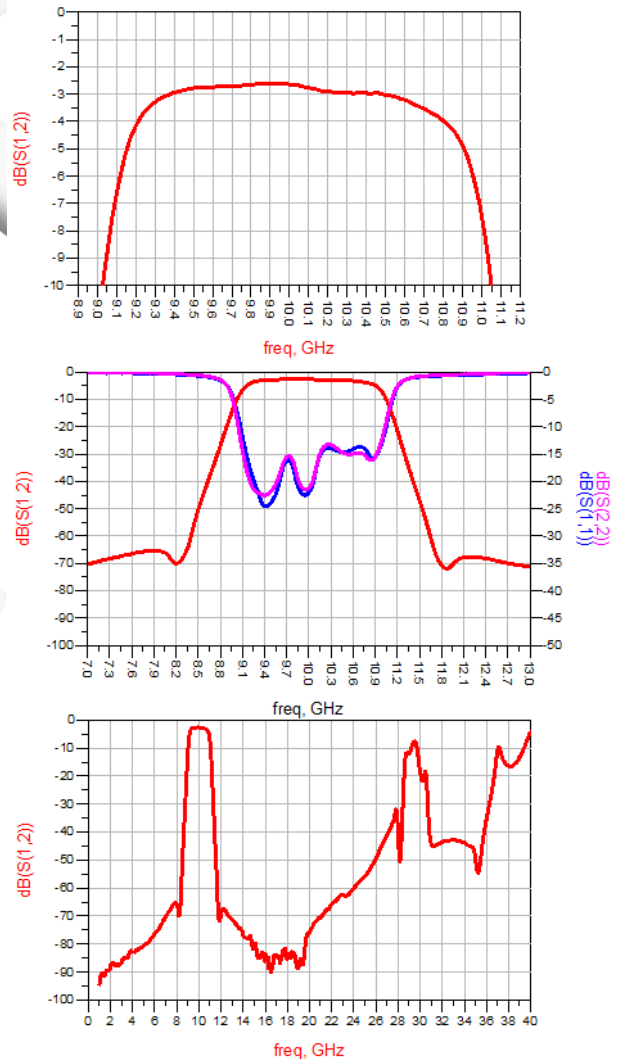
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

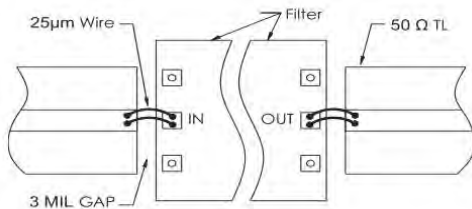
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		10.05		GHz
工作频率	9.4		10.7	GHz
中心损耗		2.1	2.6	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-8.5GHz	38	43	dBc
	@11.7-23.0GHz	45	50	dBc

环境要求

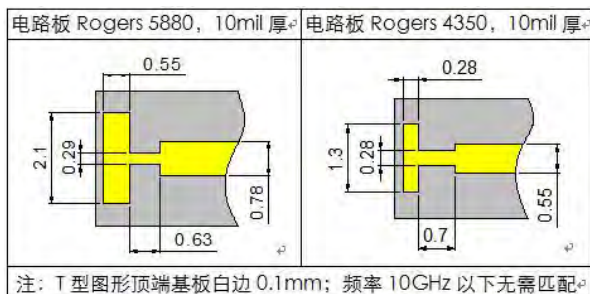
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

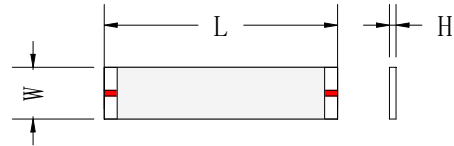
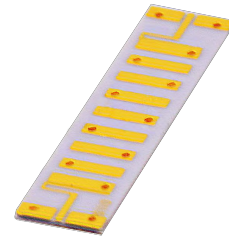


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

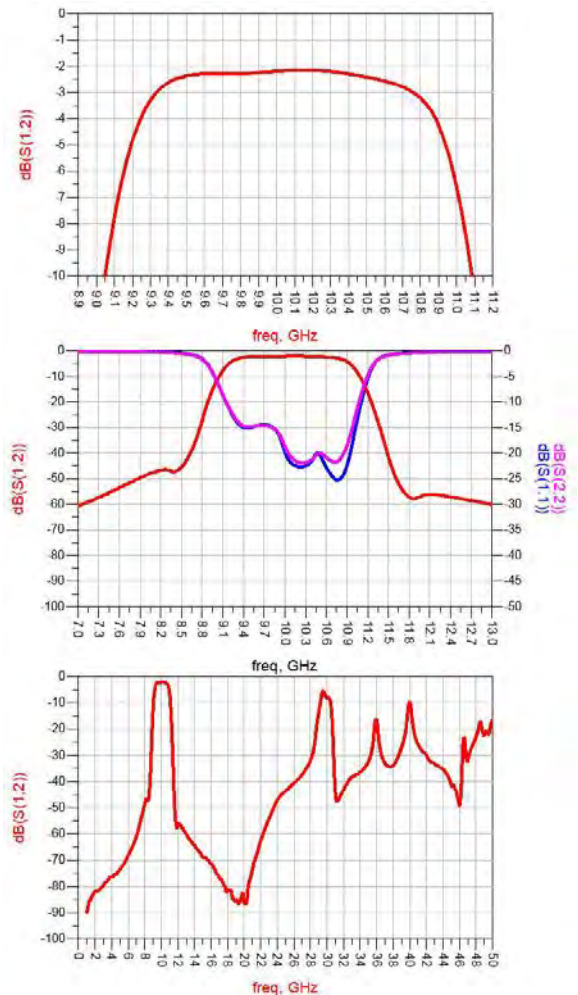


外形图



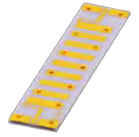
外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	4.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

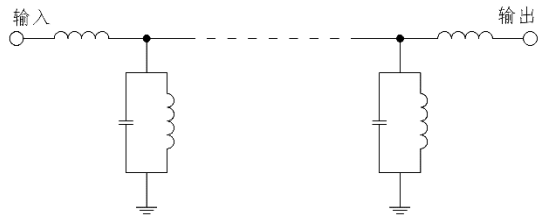
- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块



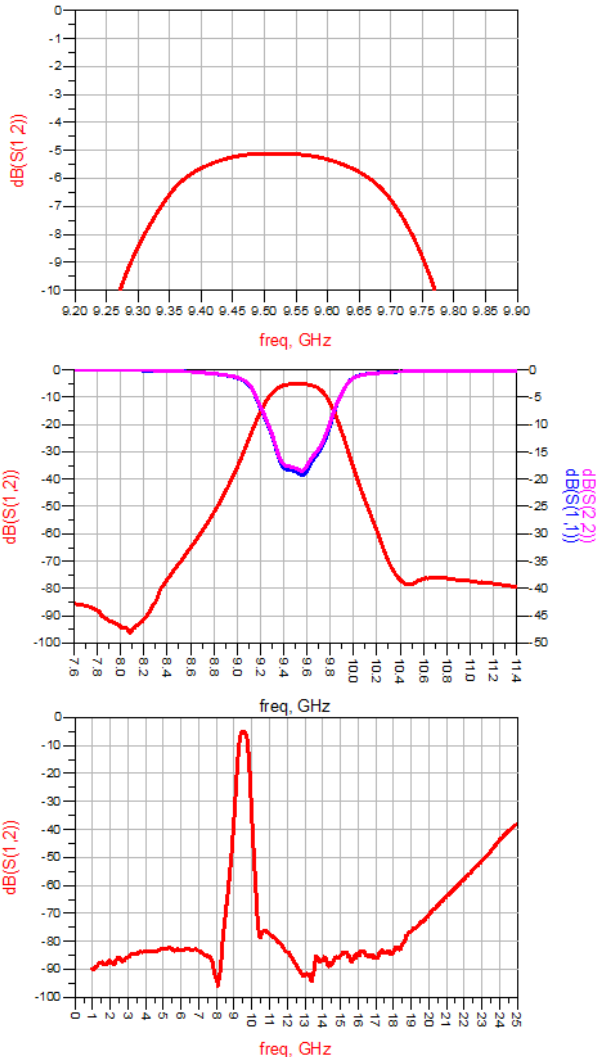
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		9.5		GHz
工作频率	9.4		9.6	GHz
中心损耗		5.2	5.7	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-8.7GHz	45	50		dBc
带外抑制@10.2-21.5GHz	45	50		dBc
承受功率			20	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

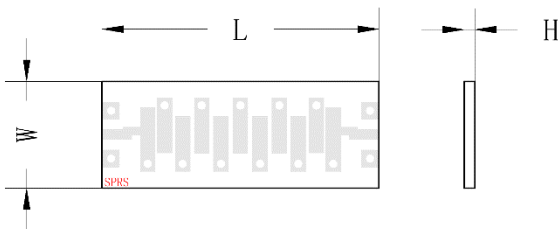
### 原理图



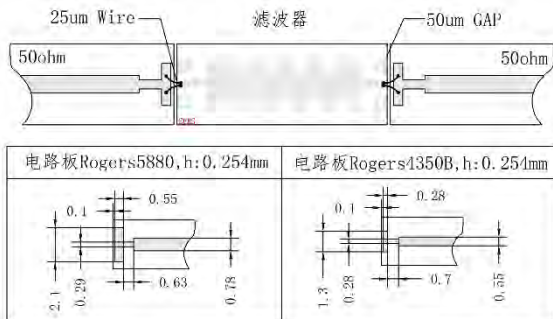
### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



外形图: L: 7.5, W: 4.0, H: 0.254, 端口居中



### 推荐装配图:



### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

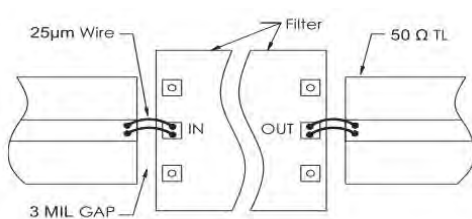
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		9.6		GHz
工作频率	9.5		9.7	GHz
中心损耗		5.2	5.8	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@DC-8.8GHz	40	45	dBc
	@10.2-25GHz	40	45	dBc

环境要求

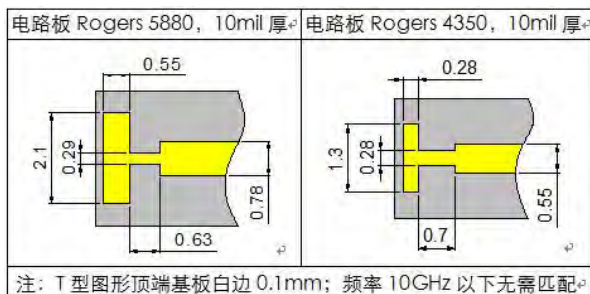
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

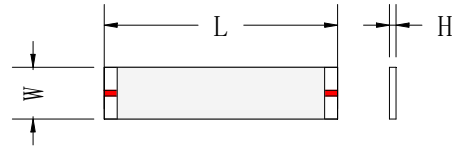
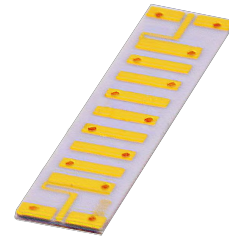


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

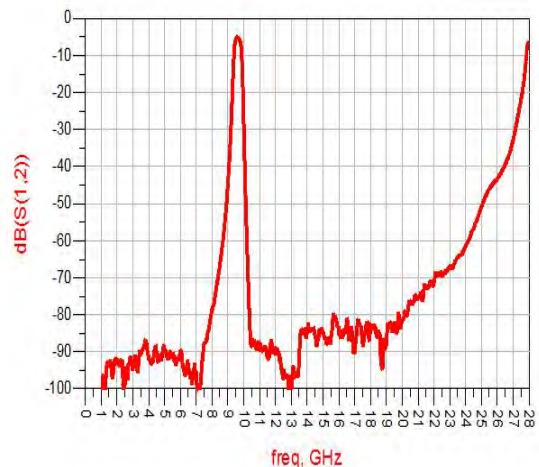
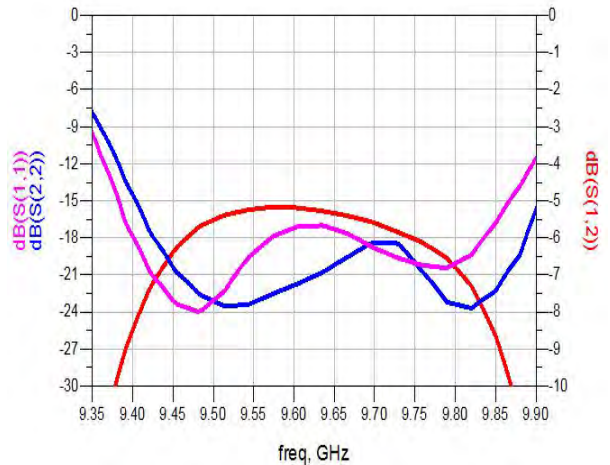


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	9.0	4.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

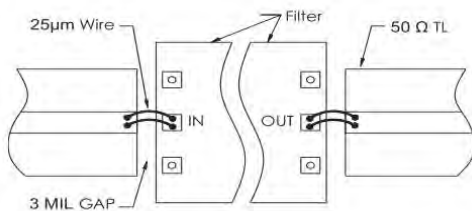
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		10.0		GHz
工作频率	9.5		10.5	GHz
中心损耗		2.5	3.0	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-8.7GHz	40	45	dBc
	@11.4-26.0GHz	40	45	dBc

### 环境要求

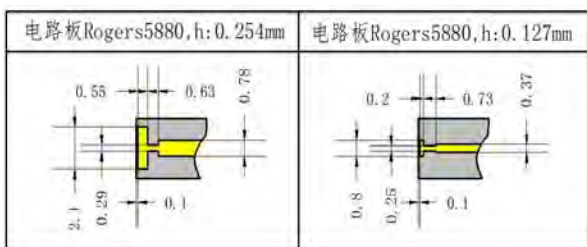
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

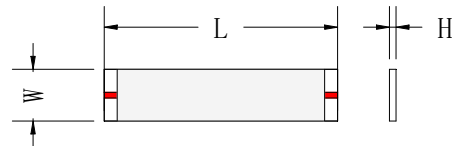
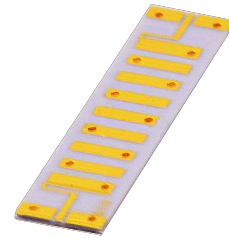


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

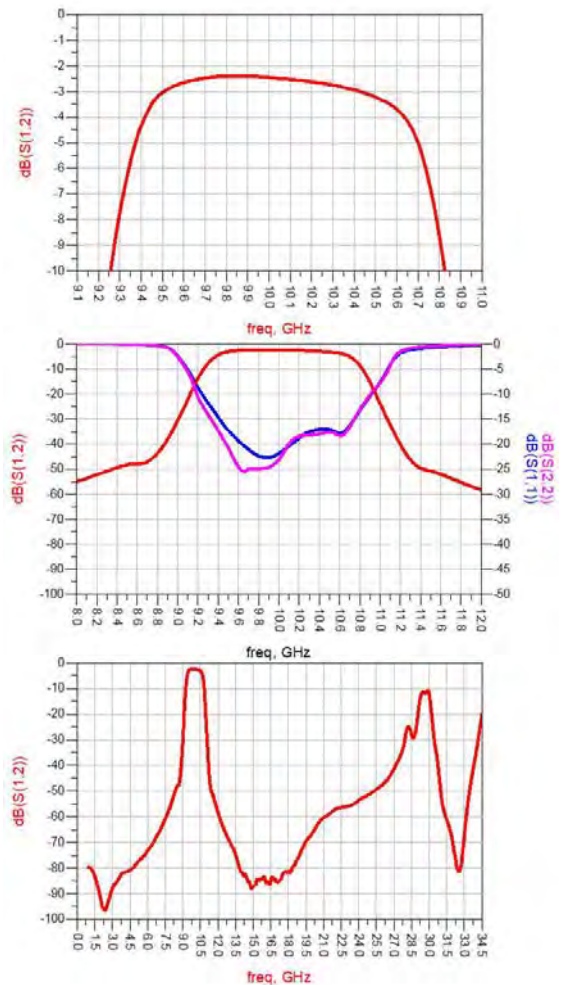


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	4.0	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



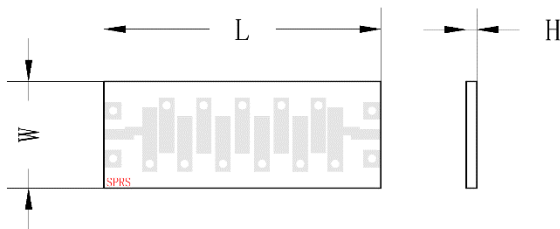
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

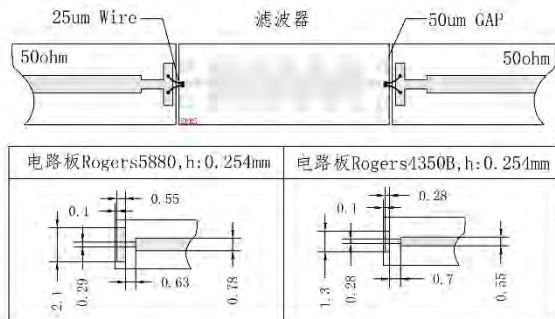
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		10.6		GHz
工作频率	9.8		11.4	GHz
中心损耗		1.9	2.4	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-9.0GHz	30	35		dBc
带外抑制@12.6-22.0GHz	45	50		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.5, W: 4.5, H: 0.254, 端口居中



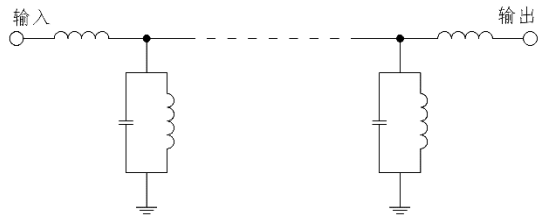
推荐装配图:



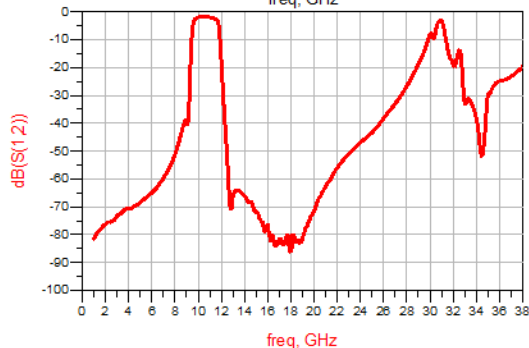
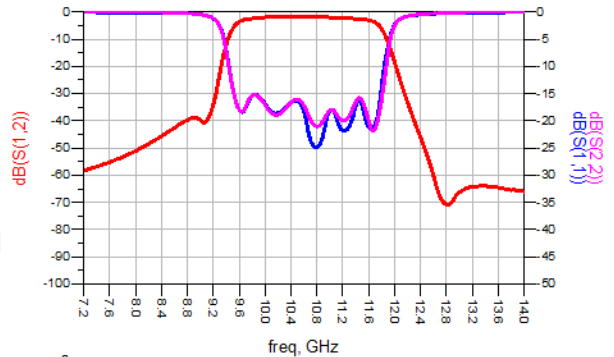
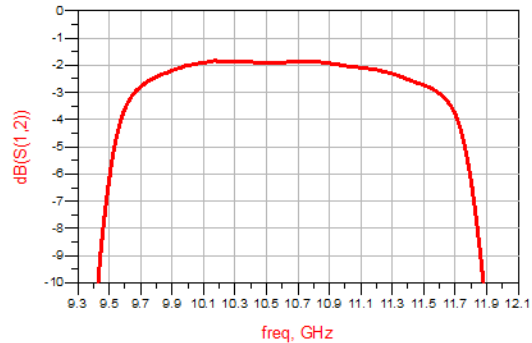
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

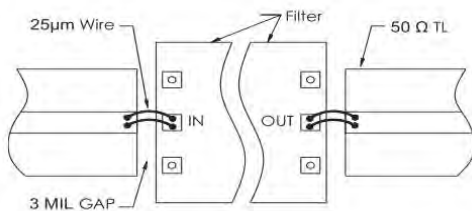
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		10.7		GHz
工作频率	9.8		11.6	GHz
中心损耗		1.8	2.3	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	14	16		
带外抑制	@7.9-8.6GHz	40	45	dBc
	@12.6-13GHz	40	45	dBc
	@DC-7.9GHz	60	65	dBc
	@13-25GHz	60	65	dBc

### 环境要求

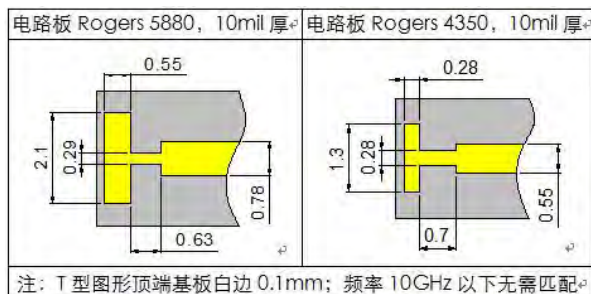
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

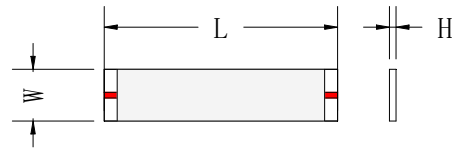
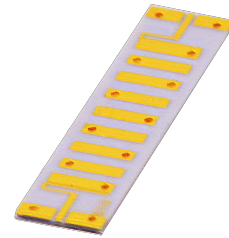


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**3.0mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

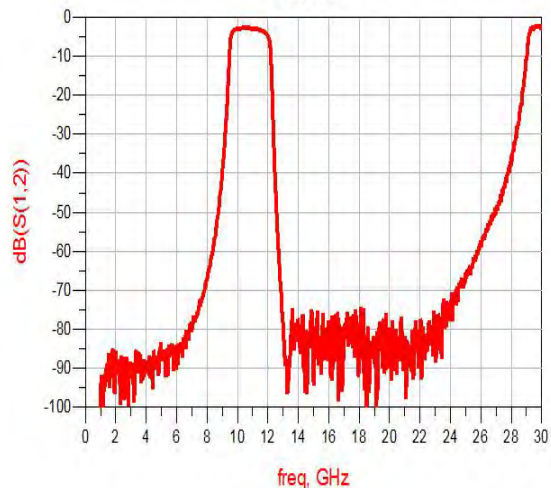
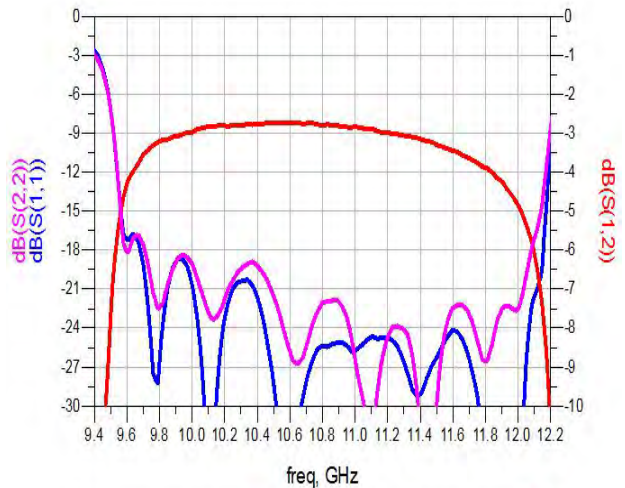


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	10.0	4.0	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



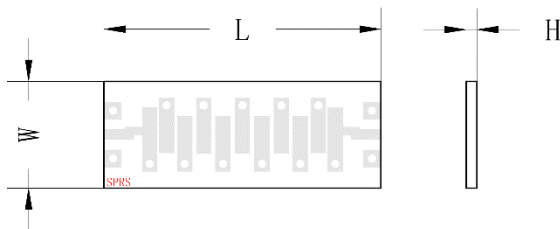
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

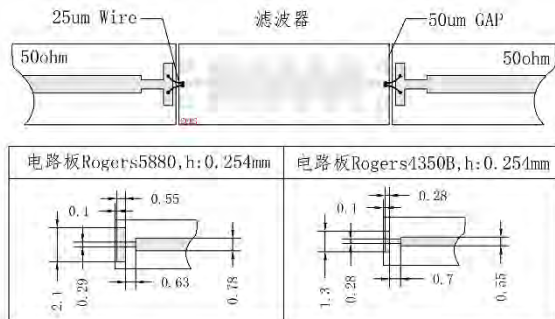
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		10.25		GHz
工作频率	9.9		10.6	GHz
中心损耗		2.5	3.1	dB
带内波动		0.5	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-9.2GHz	35	40		dBc
带外抑制@11.8-20.0GHz	35	40		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^{\circ}\text{C}$

外形图: L: 7.5, W: 4.5, H: 0.254, 端口居中



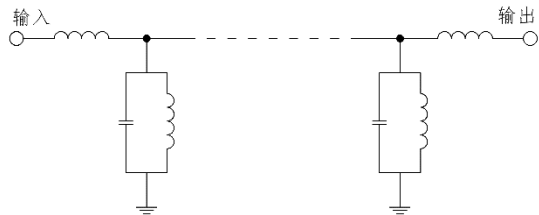
推荐装配图:



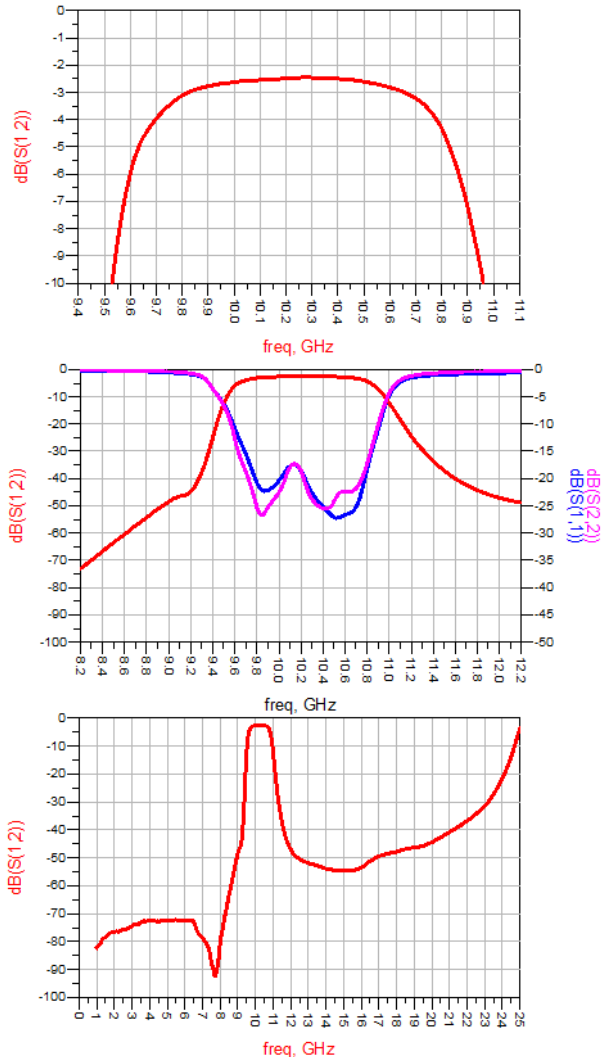
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^{\circ}\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块

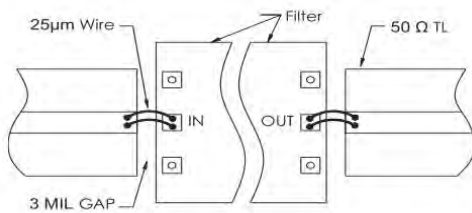
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		11.6		GHz
工作频率	10.0		13.2	GHz
中心损耗		1.7	2.2	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-8.8GHz	40	45	dBc
	@14.3-29.0GHz	40	45	dBc

环境要求

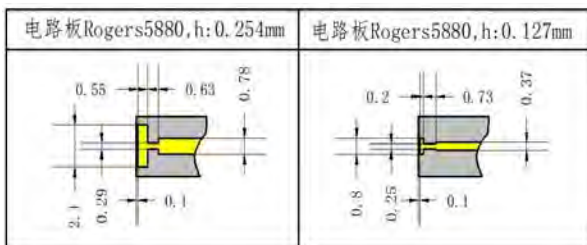
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

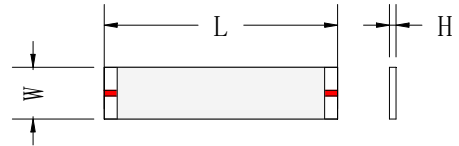
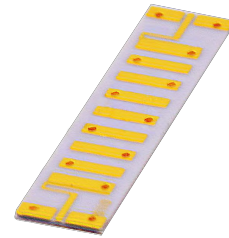


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁**0.1mm**,表面距上盖**2.75mm**,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配,T型尺寸如下:

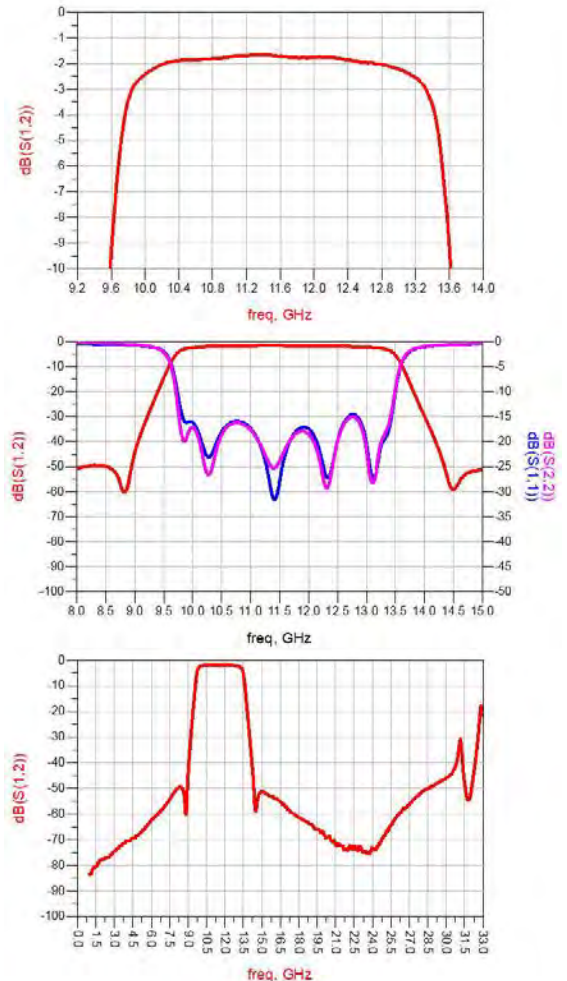


外形图



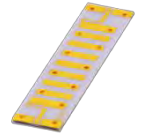
外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	3.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

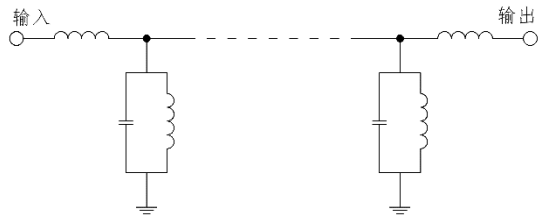
- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块



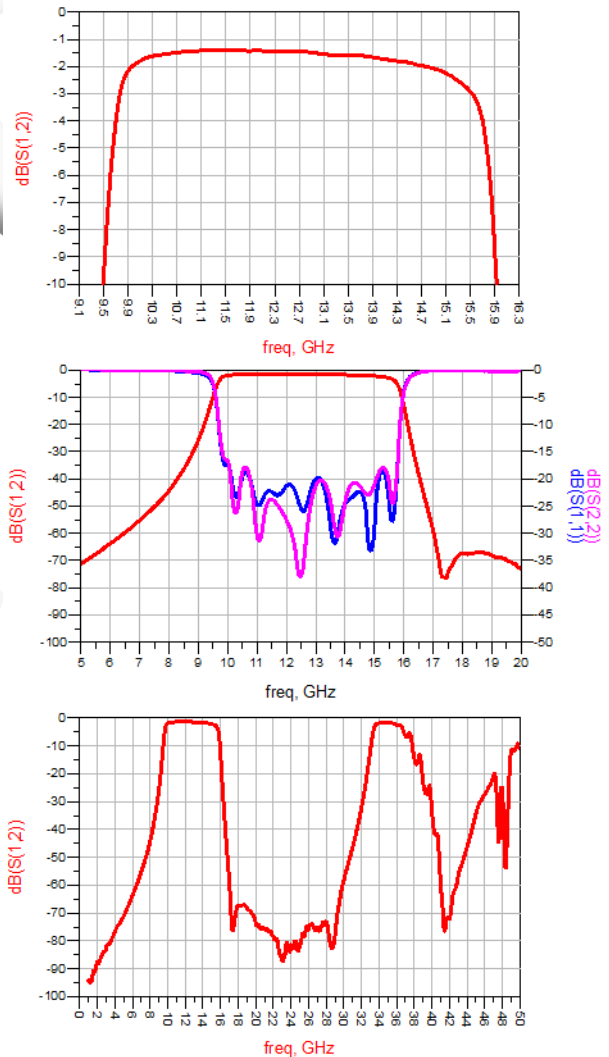
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		12.55		GHz
工作频率	10.0		15.1	GHz
中心损耗		1.5	2.0	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-6.0GHz	55	60		dBc
带外抑制@17.4-29.0GHz	55	60		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

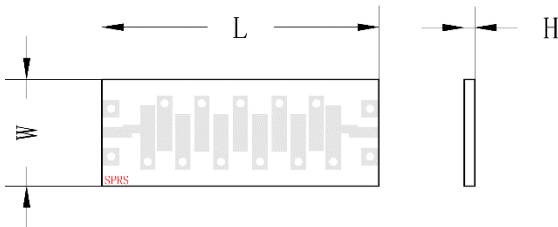
原理图



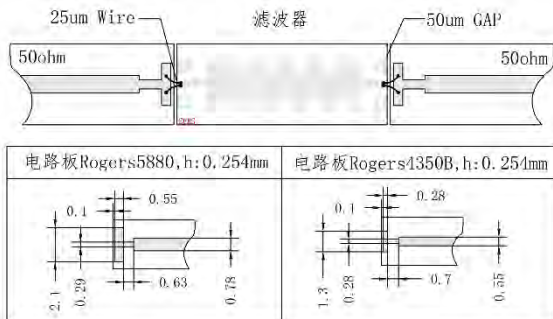
典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



外形图: L: 6.5, W: 3.0, H: 0.254, 端口居中



推荐装配图:



注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

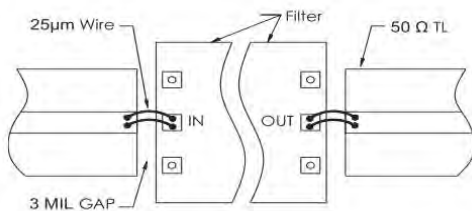
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		14.0		GHz
工作频率	10.0		18.0	GHz
中心损耗		1.2	1.7	dB
带内波动		0.5	0.8	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-7.0GHz	34	39	dBc
	@20.0-34.0GHz	34	39	dBc

环境要求

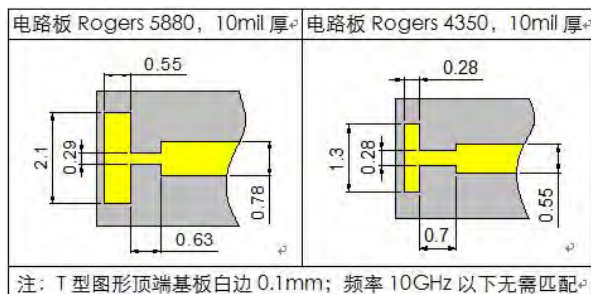
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

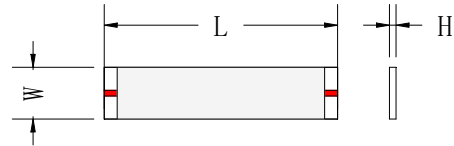
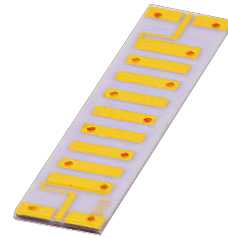


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

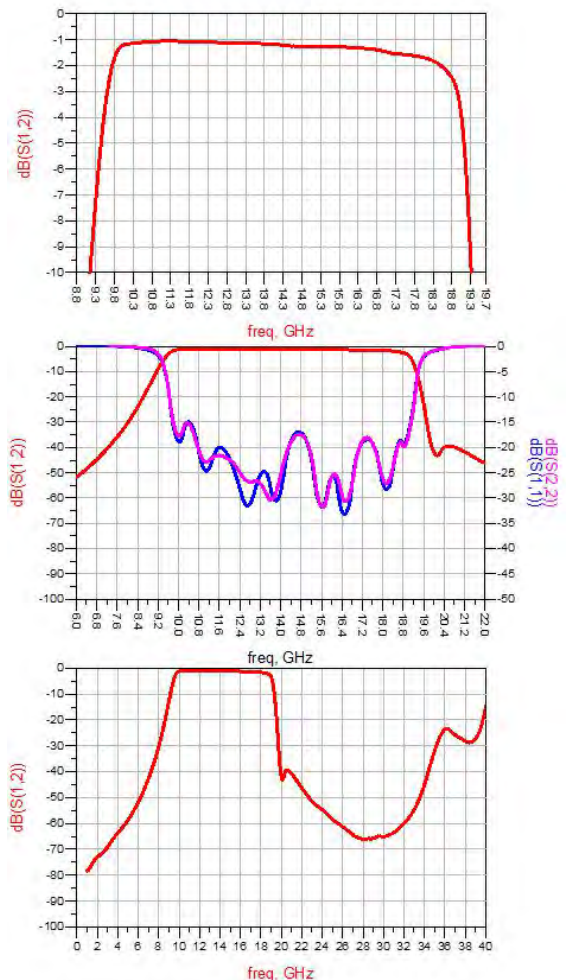


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.0	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

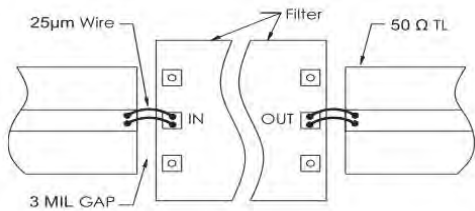
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		17.4		GHz
工作频率	10.0		24.8	GHz
中心损耗		0.5	0.8	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@DC-7.7GHz	30	35	dBc
	@27.0-36.0GHz	8	12	dBc

环境要求

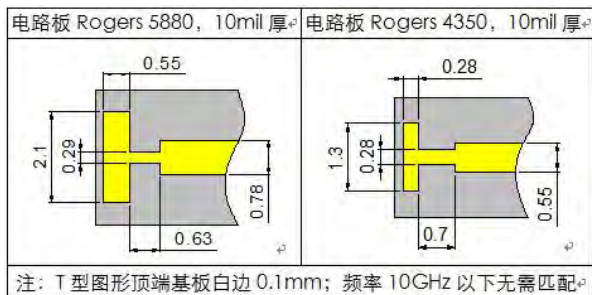
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

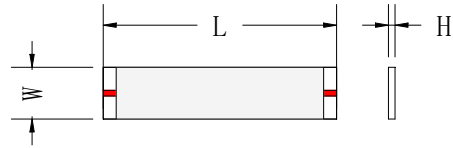
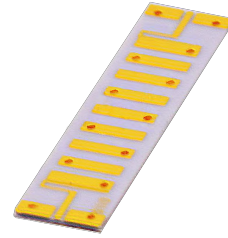


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

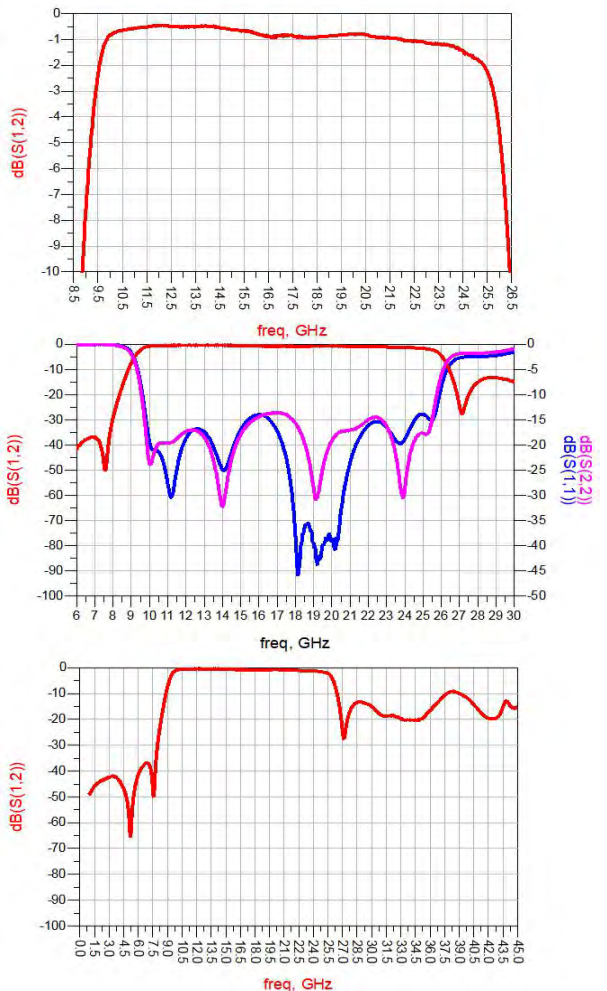


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	3.2	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

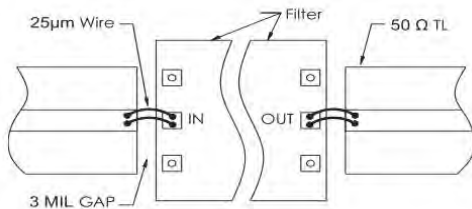
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		11.2		GHz
工作频率	10.1		12.3	GHz
中心损耗		2.2	2.6	dB
带内波动		1.0	1.4	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-8.4GHz	55	60	dBc
	@13.3-26.5GHz	55	60	dBc

环境要求

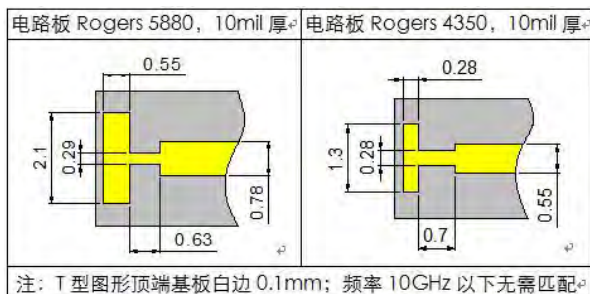
最大输入功率	30	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

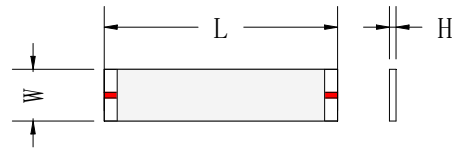
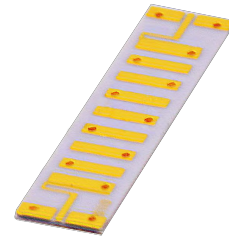


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

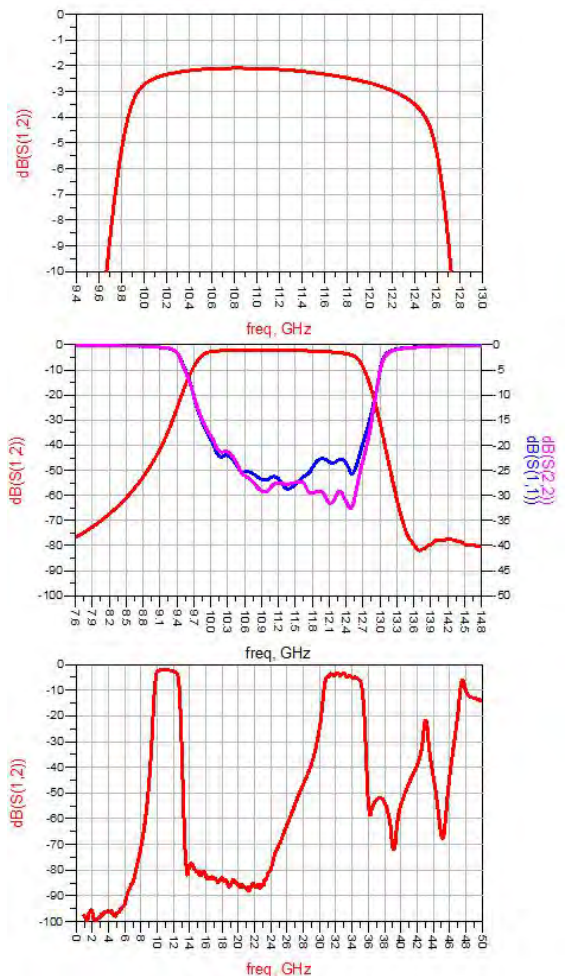


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	9.0	3.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



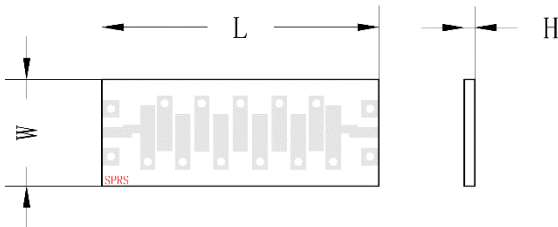
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

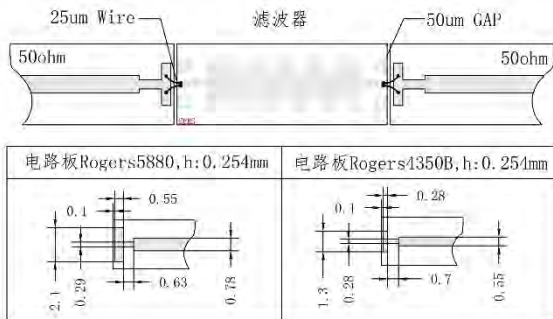
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		11.5		GHz
工作频率	10.1		12.9	GHz
中心损耗		1.8	2.3	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-8.8GHz	55	60		dBc
带外抑制@14.5-26.0GHz	55	60		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 8.5, W: 3.5, H: 0.254, 端口居中



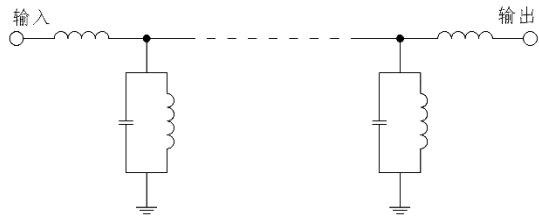
推荐装配图:



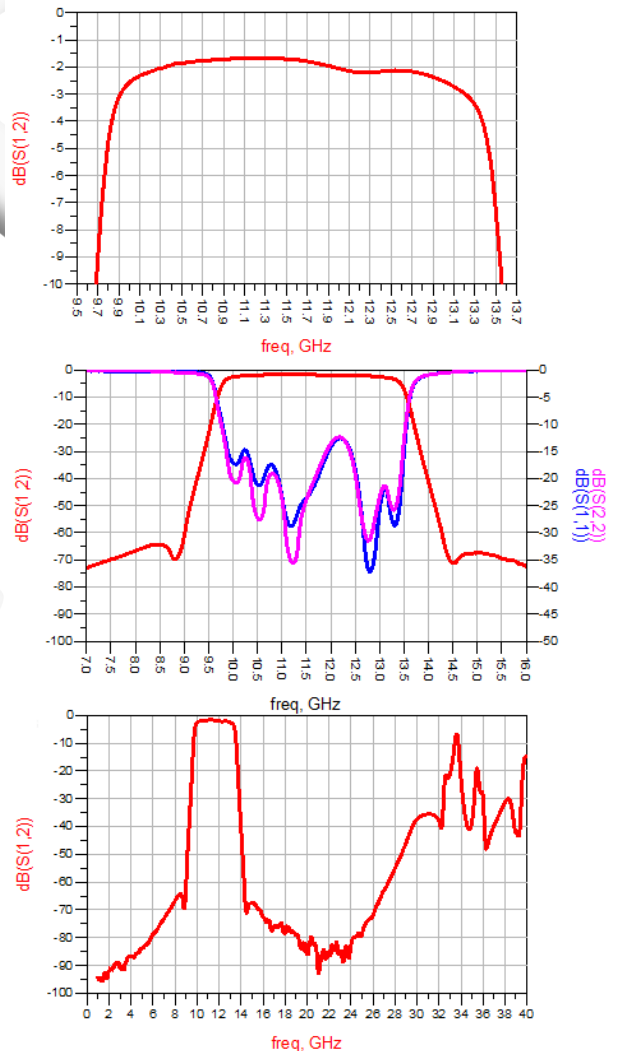
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

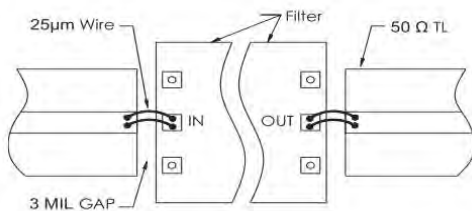
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		11.8		GHz
工作频率	10.1		13.5	GHz
中心损耗		1.2	1.6	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-8.9GHz	43	48	dBc
	@15.2-29.0GHz	43	48	dBc

### 环境要求

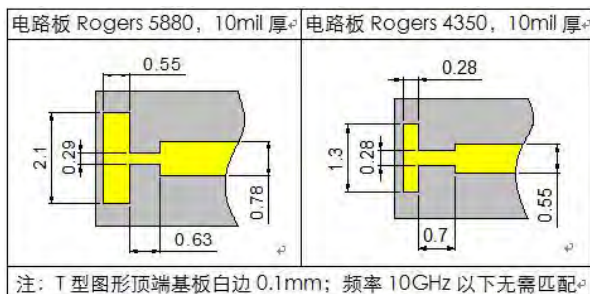
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

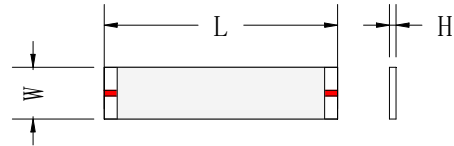
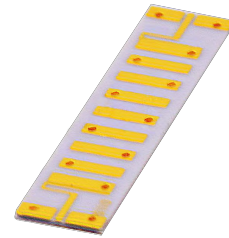


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

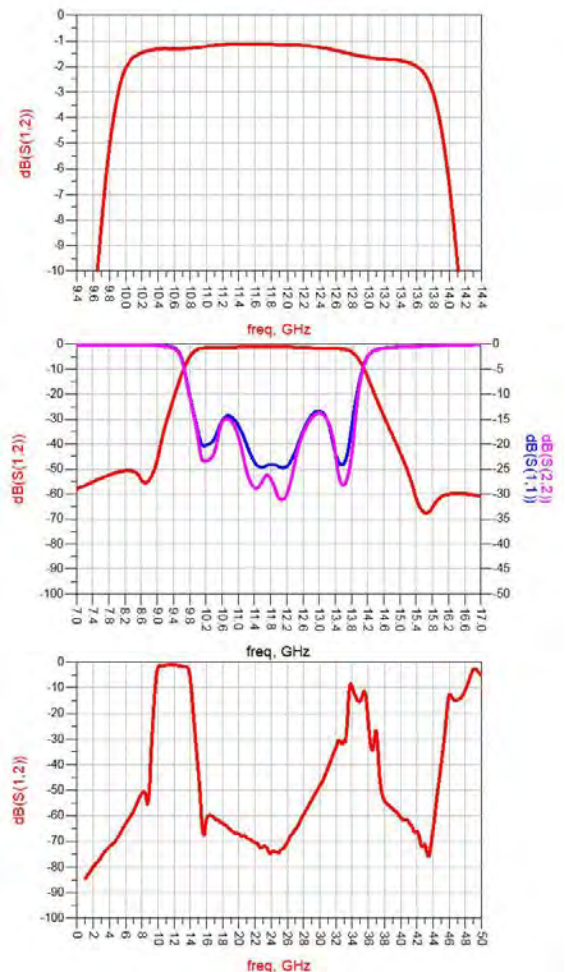


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	3.0	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

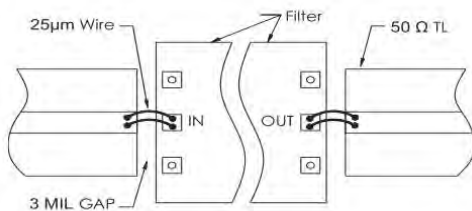
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		10.7		GHz
工作频率	10.2		11.2	GHz
中心损耗		2	2.5	dB
带内波动		0.6	0.8	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-8.7GHz	50	55	dBc
	@12.5-25GHz	50	55	dBc

环境要求

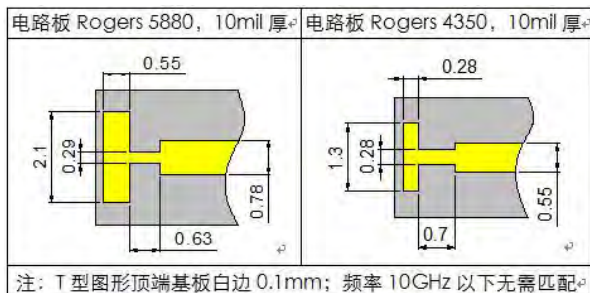
最大输入功率	30	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

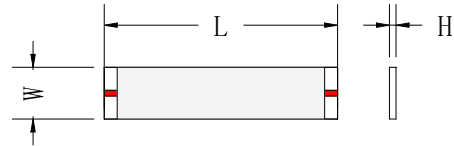
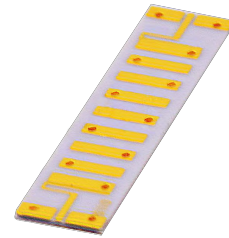


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

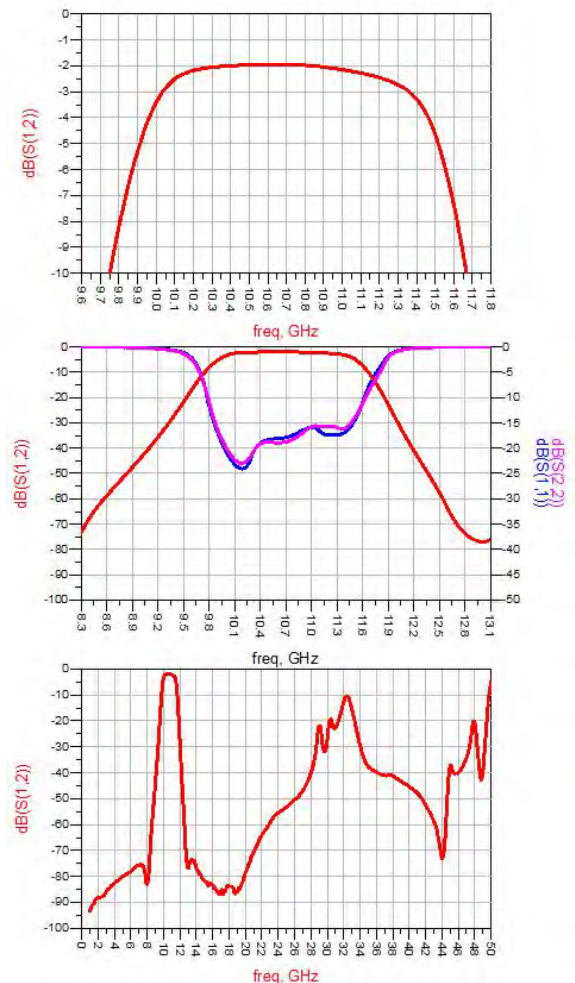


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



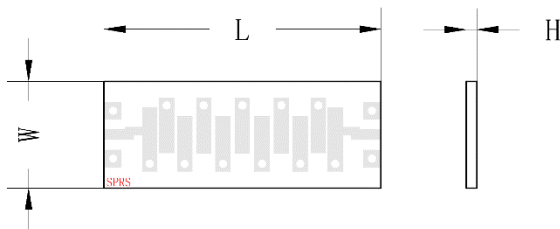
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

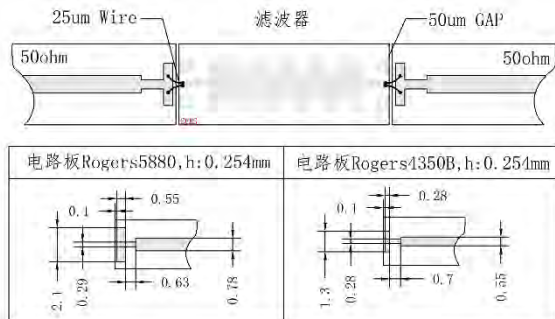
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		10.75		GHz
工作频率	10.3		11.2	GHz
中心损耗		2.4	2.9	dB
带内波动		0.5	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-9.7GHz	33	38		dBc
带外抑制@12.4-21.0GHz	35	40		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.5, W: 4.5, H: 0.254, 端口居中



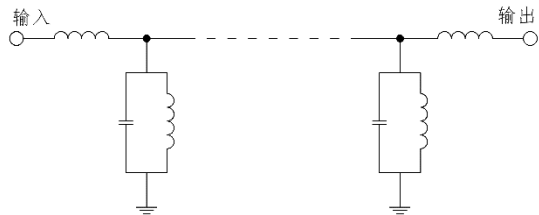
推荐装配图:



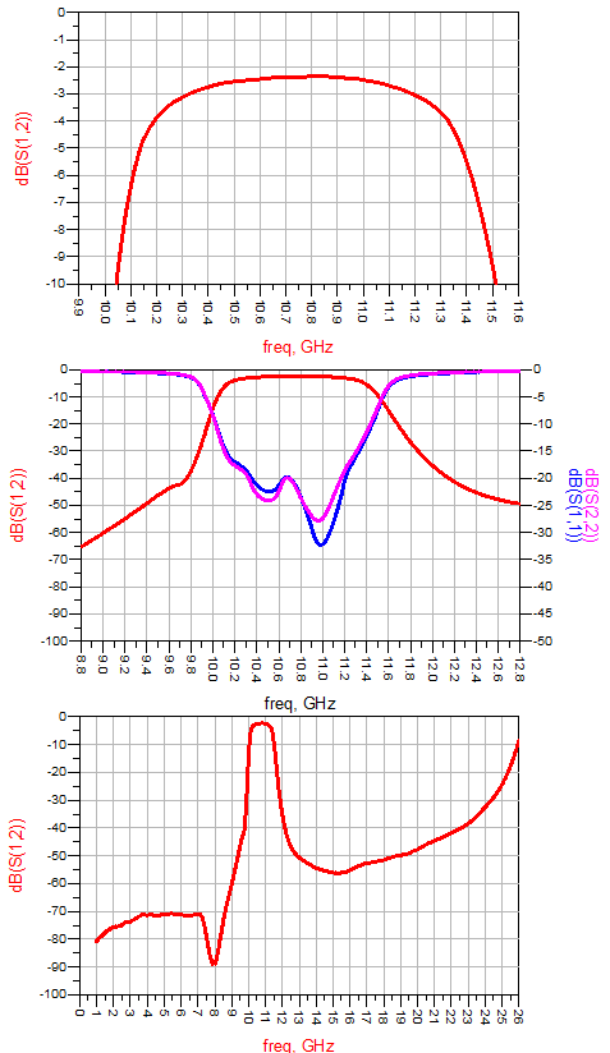
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



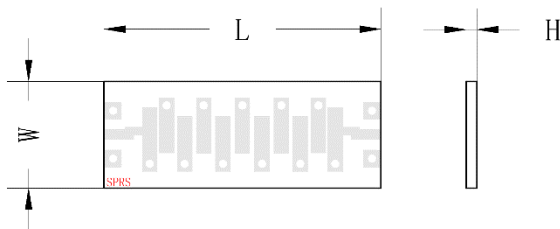
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

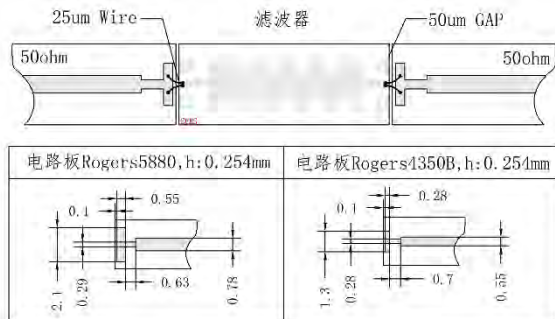
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		11.15		GHz
工作频率	10.3		12.0	GHz
中心损耗		1.9	2.4	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-9.5GHz	32	37		dBc
带外抑制@13.3-24.0GHz	45	50		dBc
承受功率			35	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.5, W: 4.5, H: 0.254, 端口居中



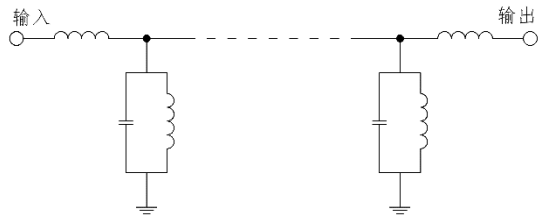
推荐装配图:



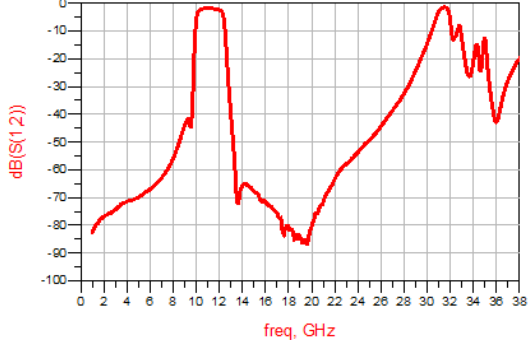
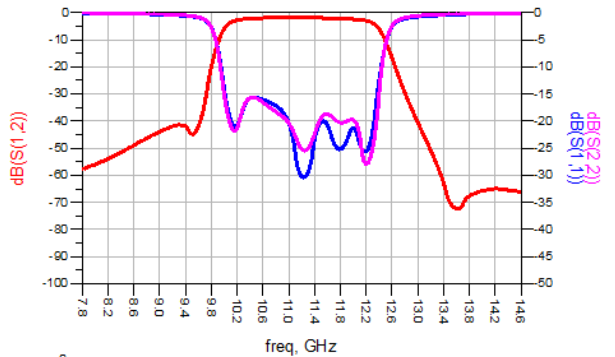
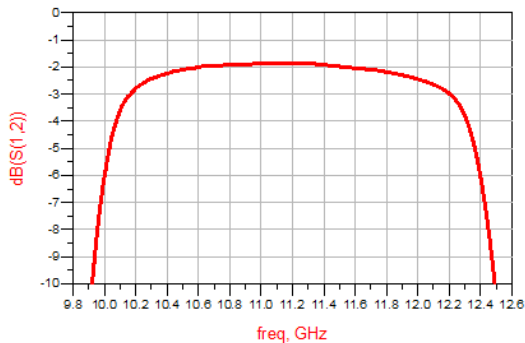
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

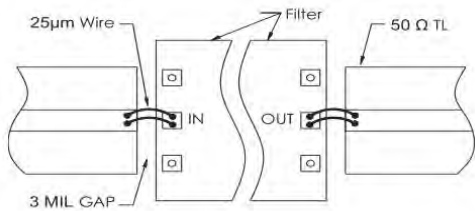
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		11.2		GHz
工作频率	10.4		12.0	GHz
中心损耗		2.2	2.5	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-9.6GHz	55	60	dBc
	@13.0-26.0GHz	55	60	dBc

环境要求

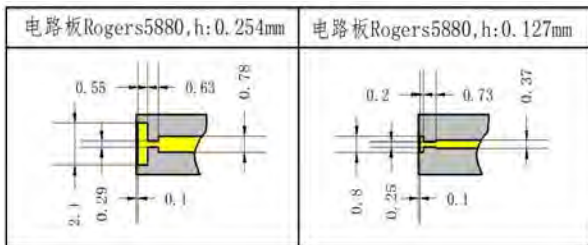
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

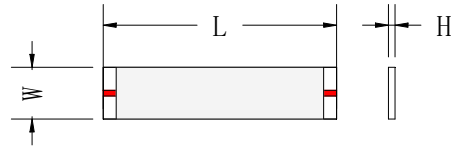
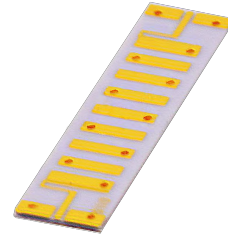


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

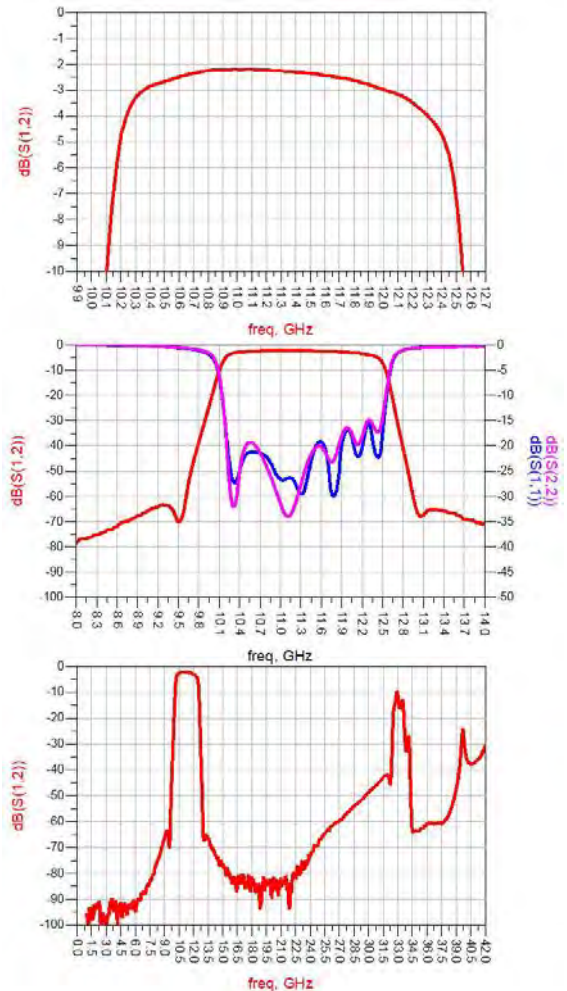


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	9.0	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



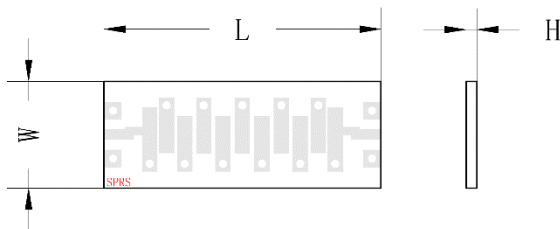
### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

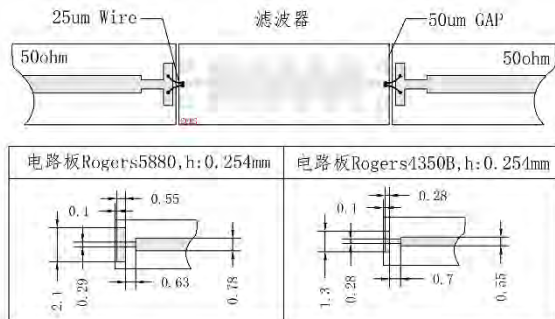
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		11.2		GHz
工作频率	10.5		11.9	GHz
中心损耗		1.6	2.1	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-9.2GHz	43	48		dBc
带外抑制@13.2-24.5GHz	43	48		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 6.5, W: 3.0, H: 0.254, 端口居中



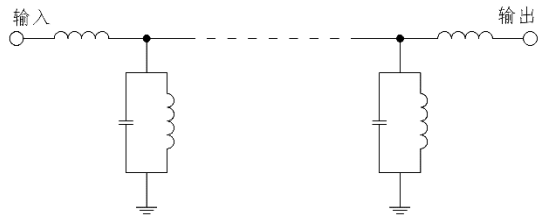
### 推荐装配图:



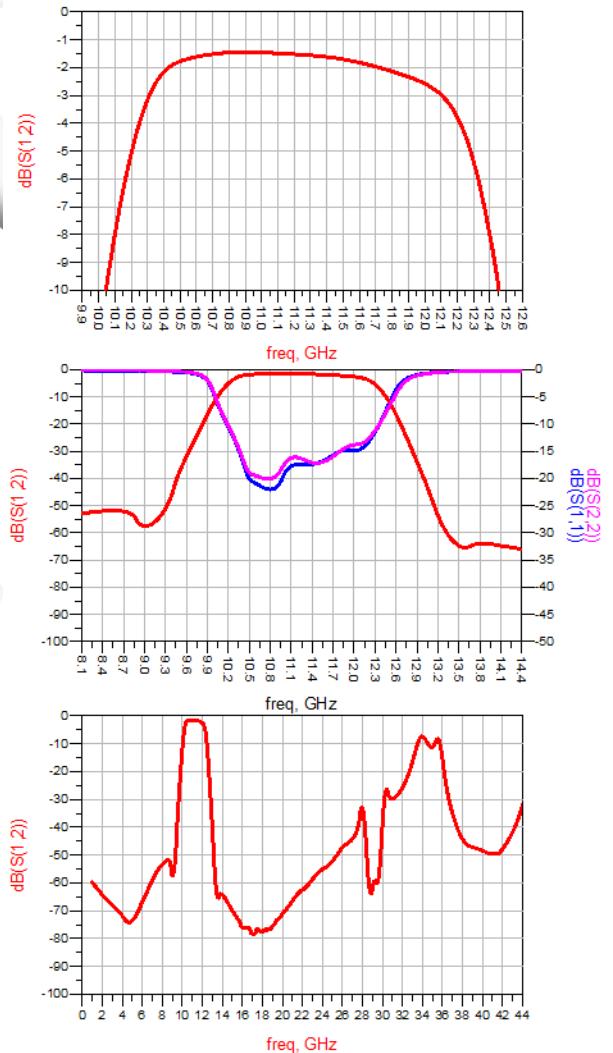
### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

### 原理图



### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

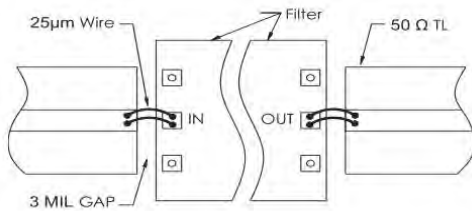
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		11.5		GHz
工作频率	10.5		12.5	GHz
中心损耗		1.6	2.1	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-9.5GHz	45	50	dBc
	@13.7-32.0GHz	45	50	dBc

环境要求

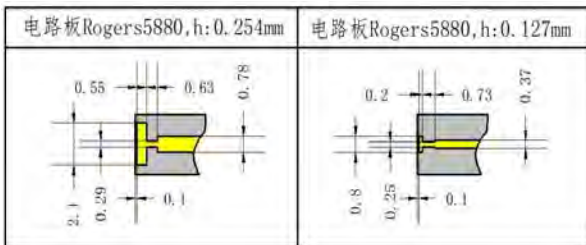
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

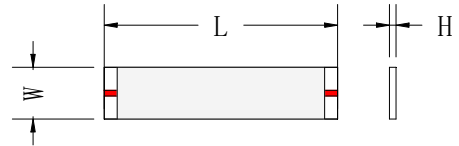
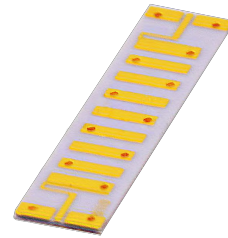


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

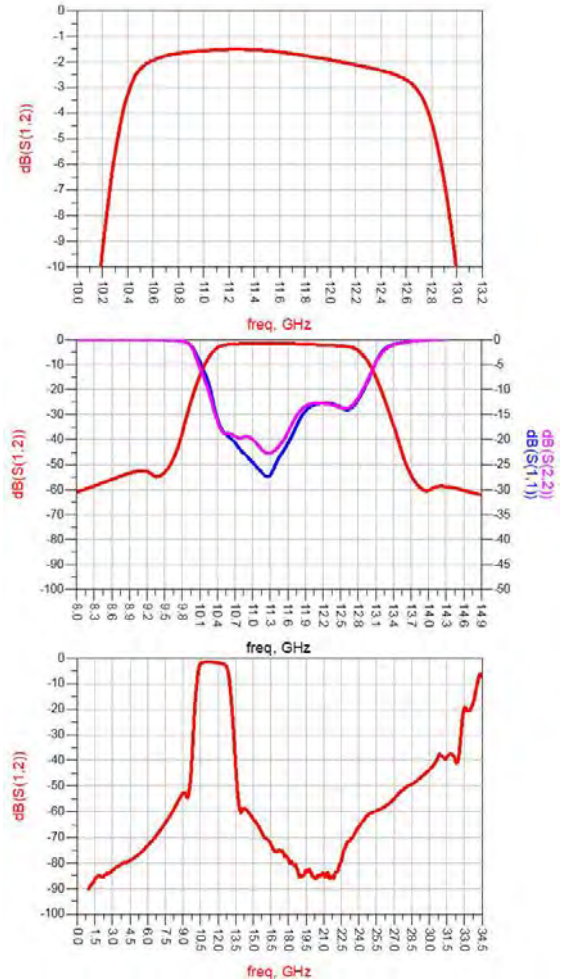


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	3.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

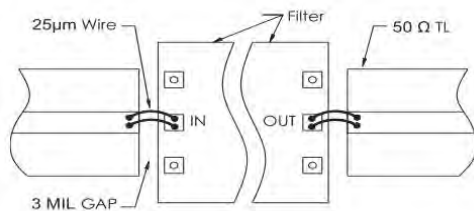
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		12.3		GHz
工作频率	10.6		14.0	GHz
中心损耗		1.1	1.6	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@DC-8.3GHz	40	45	dBc
	@15.3-31GHz	40	45	dBc

环境要求

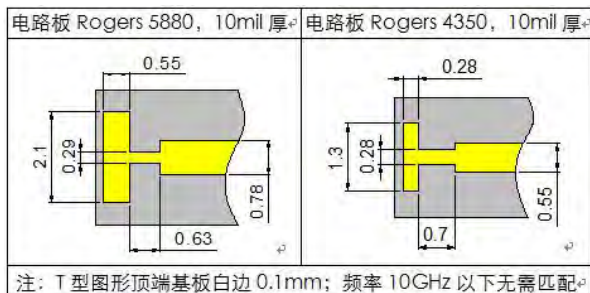
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

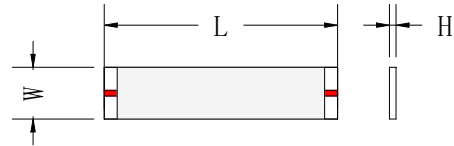
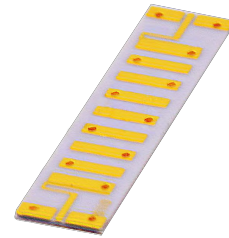


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

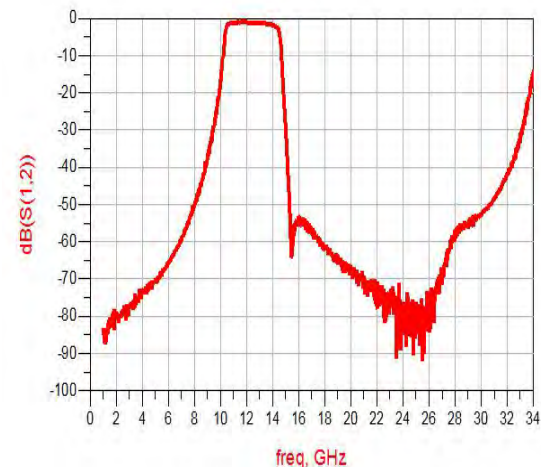
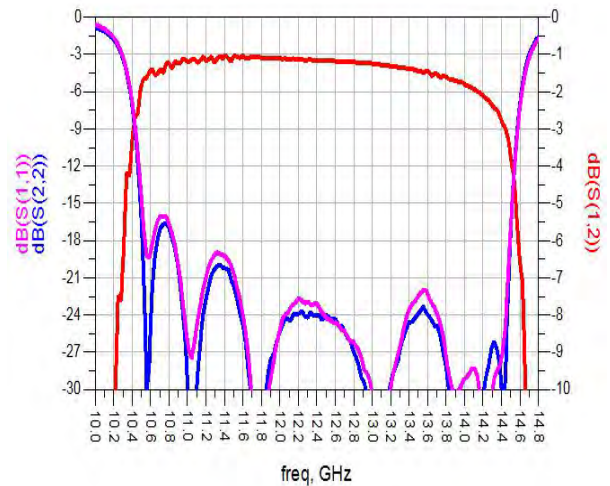


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	3.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



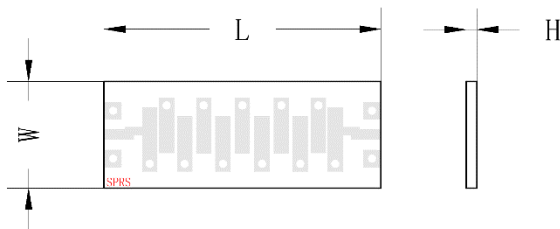
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

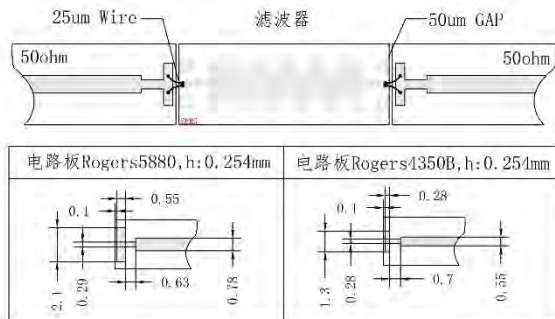
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		11.25		GHz
工作频率	10.9		11.6	GHz
中心损耗		2.5	3.0	dB
带内波动		0.5	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-10.2GHz	32	36		dBc
带外抑制@13.0-21.0GHz	35	40		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^{\circ}\text{C}$

外形图: L: 7.5, W: 4.5, H: 0.254, 端口居中

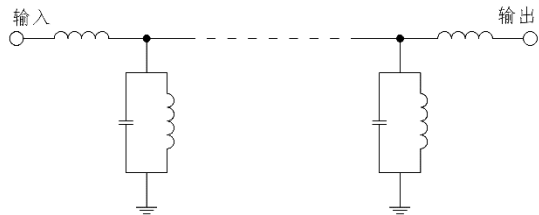


推荐装配图:

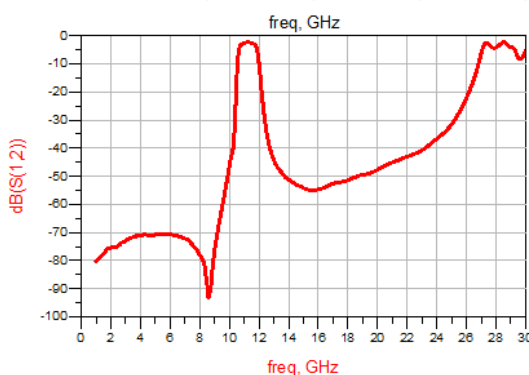
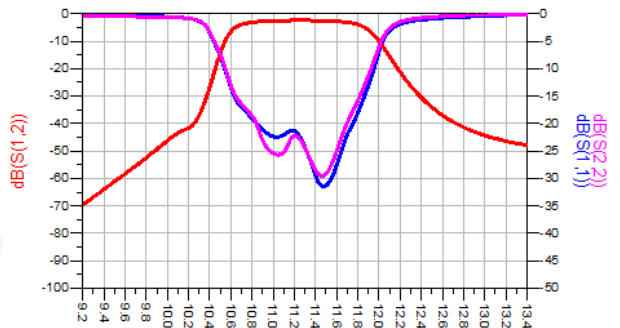
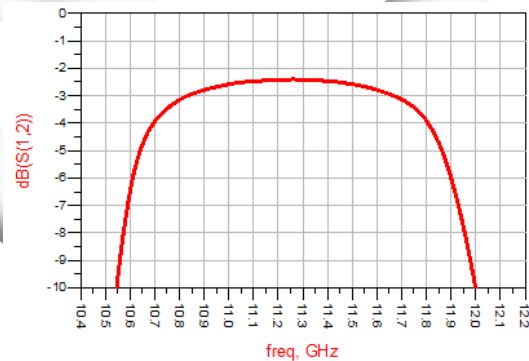


- 注意事项:
1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
  2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
  3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^{\circ}\text{C}$ ), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
  4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



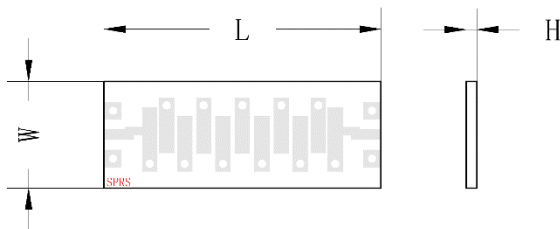
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

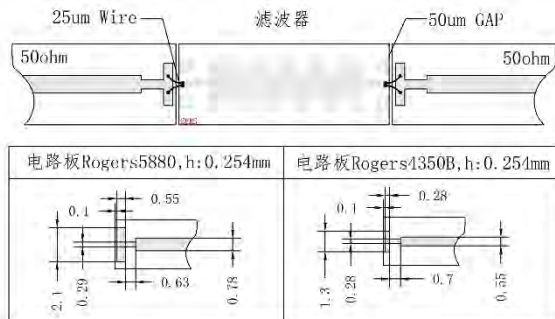
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		11.7		GHz
工作频率	10.9		12.5	GHz
中心损耗		2.5	3.0	dB
带内波动		0.9	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-9.6GHz	55	60		dBc
带外抑制@13.8-26.0GHz	53	60		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 8.0, W: 3.5, H: 0.254, 端口居中



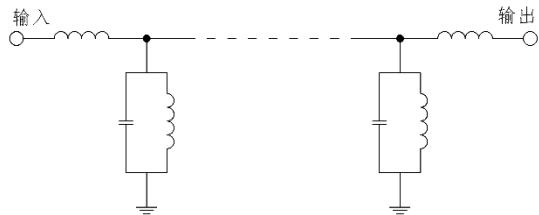
推荐装配图:



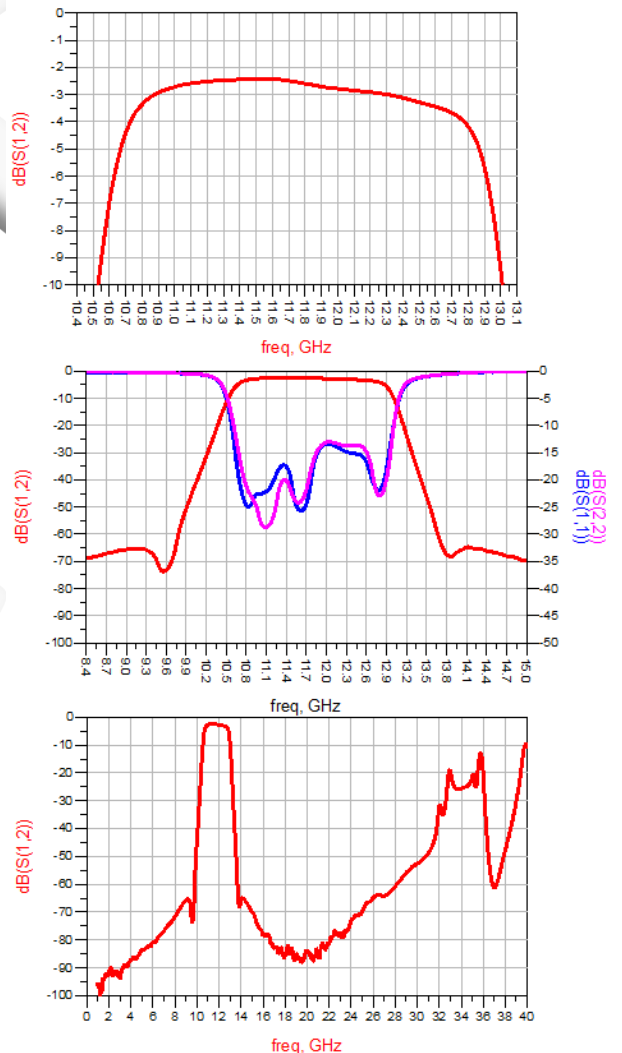
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



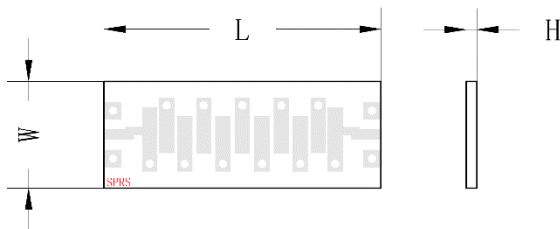
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

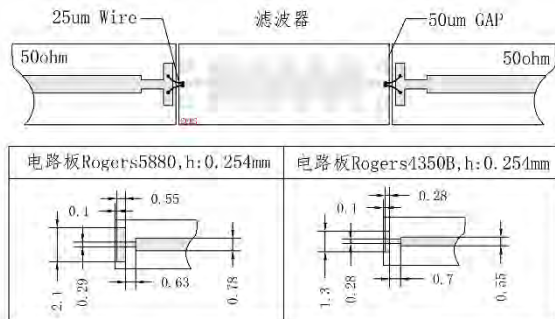
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		11.85		GHz
工作频率	10.9		12.7	GHz
中心损耗		1.9	2.4	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-10.1GHz	32	37		dBc
带外抑制@14.1-25.0GHz	45	50		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.5, W: 4.5, H: 0.254, 端口居中



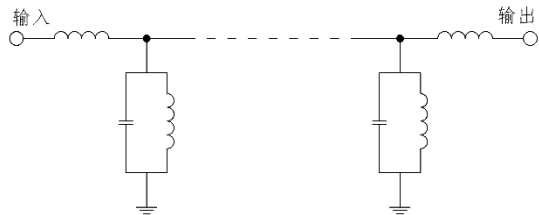
推荐装配图:



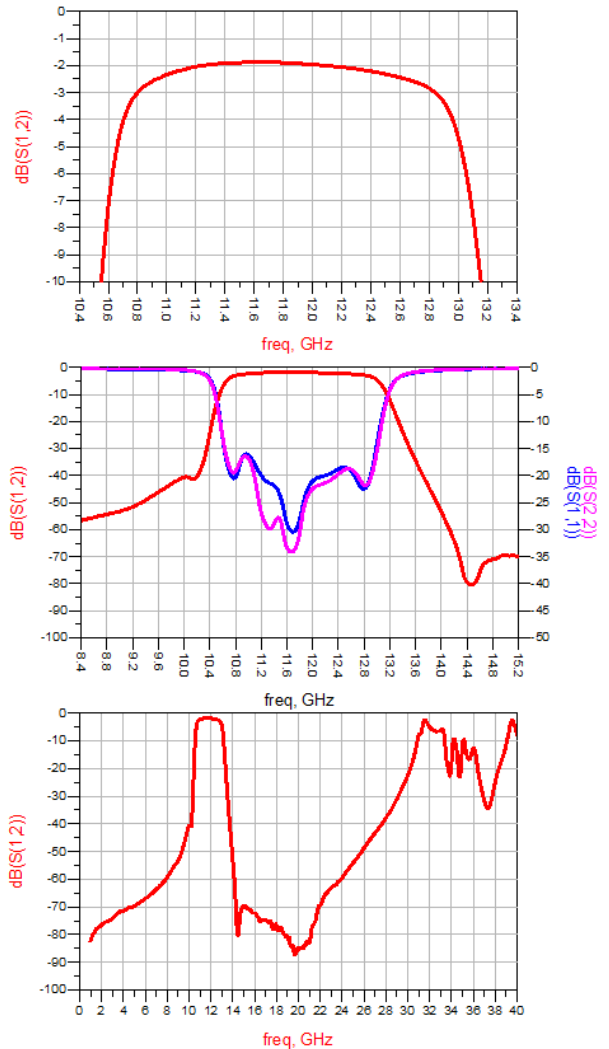
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

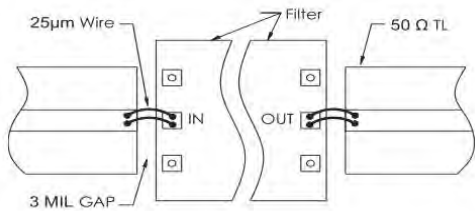
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		11.9		GHz
工作频率	10.9		12.9	GHz
中心损耗		1.8	2.3	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-9.6GHz	35	40	dBc
	@14.0-29.0GHz	35	40	dBc

环境要求

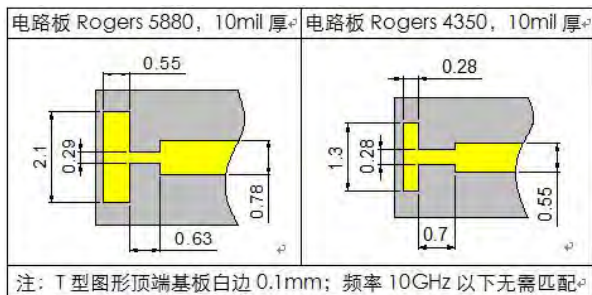
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

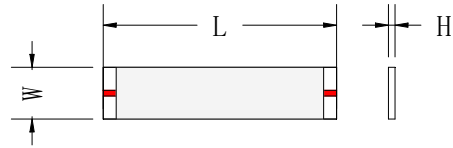
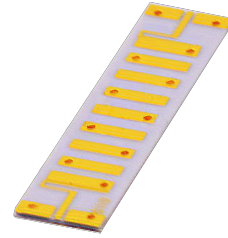


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖1.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

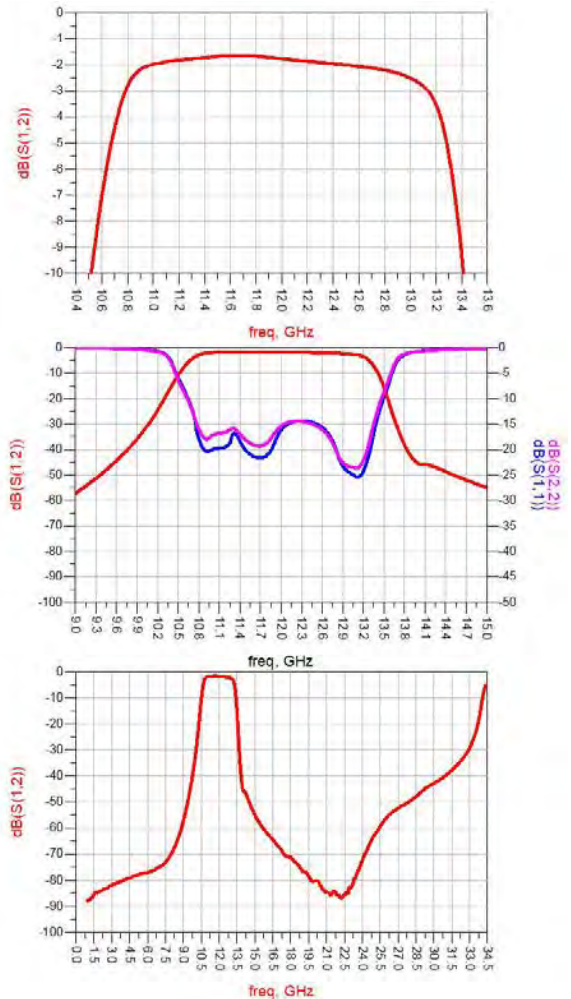


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	3.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

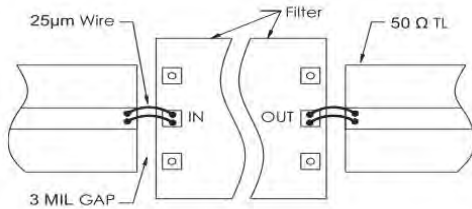
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		19.5		GHz
工作频率	11.0		28.0	GHz
中心损耗		0.5	0.8	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-8.5GHz	30	35	dBc
	@31.2-40.0GHz	13	18	dBc

环境要求

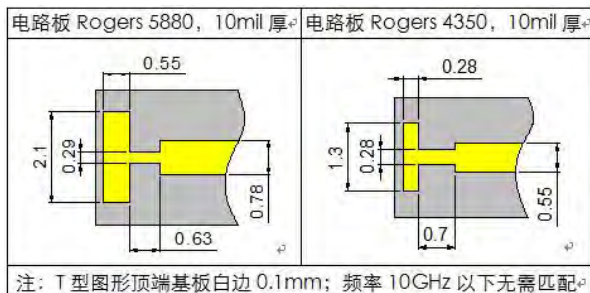
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

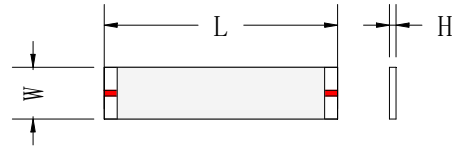
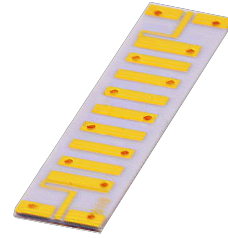


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁0.1mm，表面距上盖2.75mm，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配，T型尺寸如下:

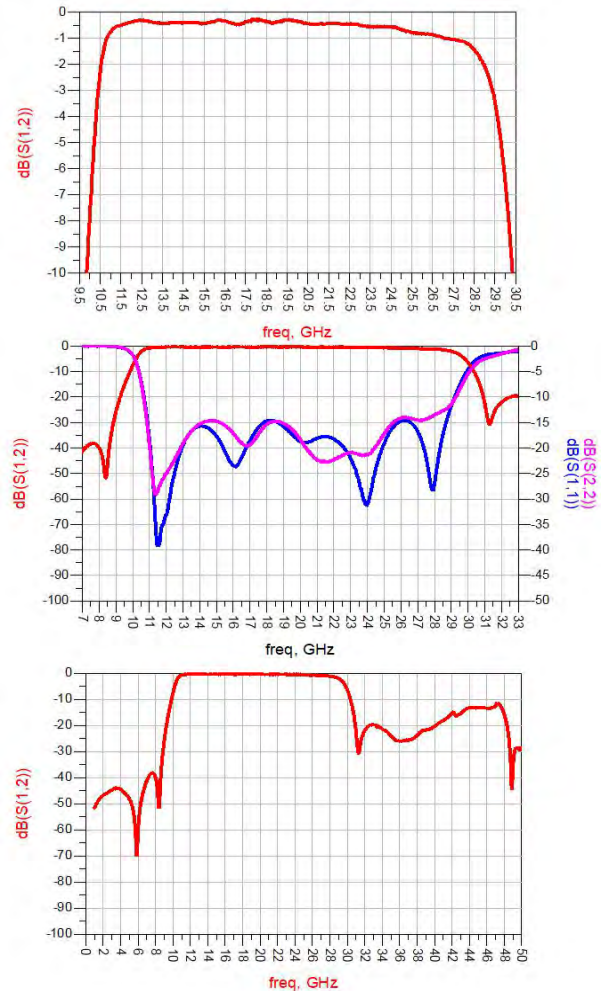


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	3.2	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



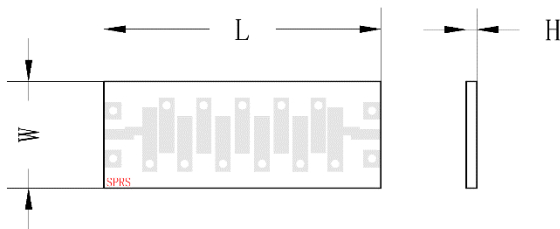
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

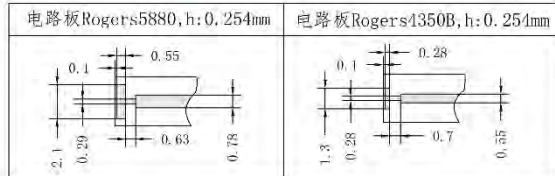
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		12.55		GHz
工作频率	11.2		13.9	GHz
中心损耗		1.7	2.2	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-9.7GHz	43	48		dBc
带外抑制@15.3-30.0GHz	43	48		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.0, W: 3.5, H: 0.254, 端口居中



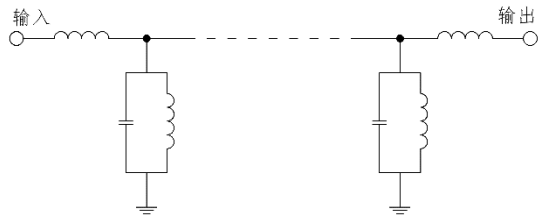
推荐装配图:



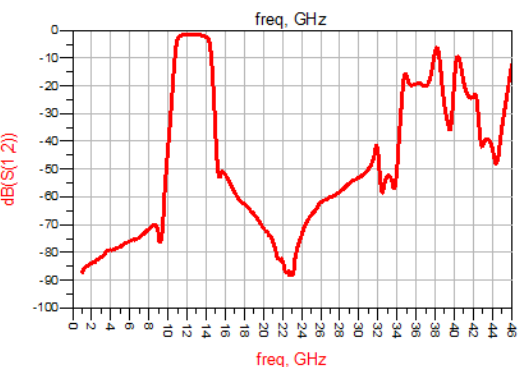
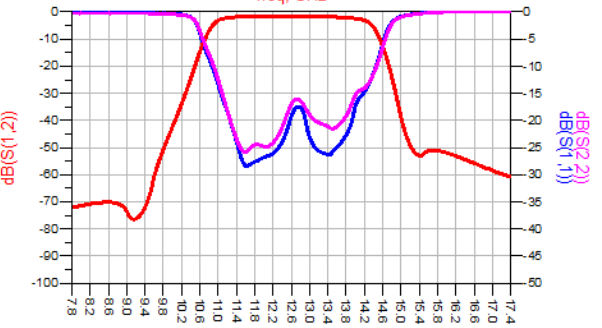
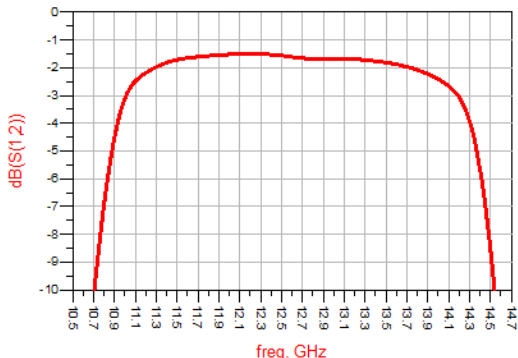
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

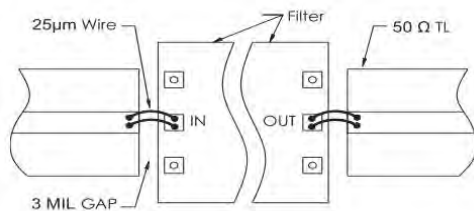
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		14.75		GHz
工作频率	11.2		18.3	GHz
中心损耗		2.3	2.8	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	14		
带外抑制	@5.0-7.8GHz	40	45	dBc
	@20.9-27.8GHz	40	45	dBc
	@DC-5.0GHz	60	65	dBc
	@27.8-35.8GHz	60	65	dBc

环境要求

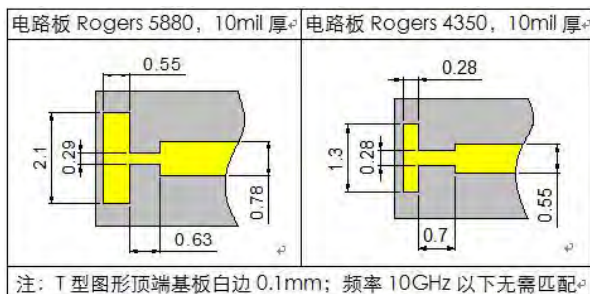
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

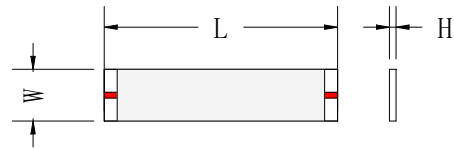
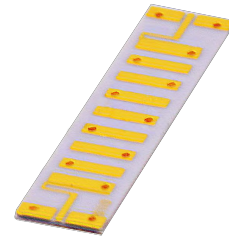


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

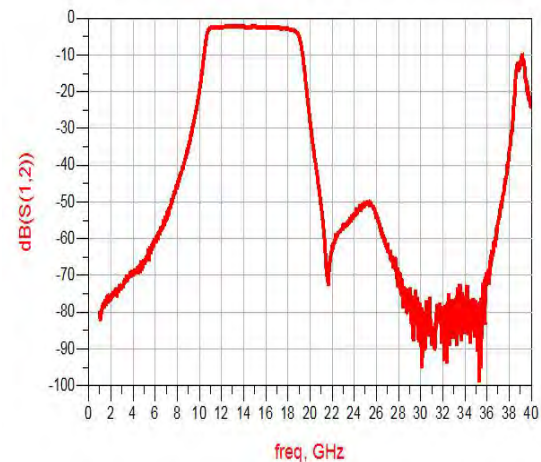
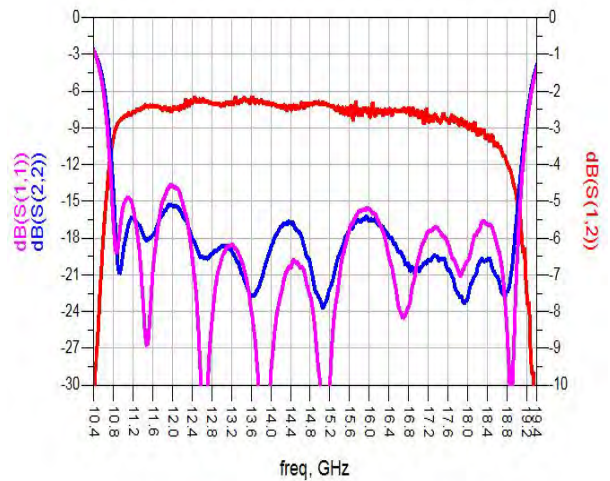


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



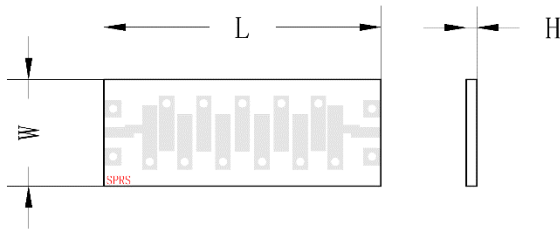
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

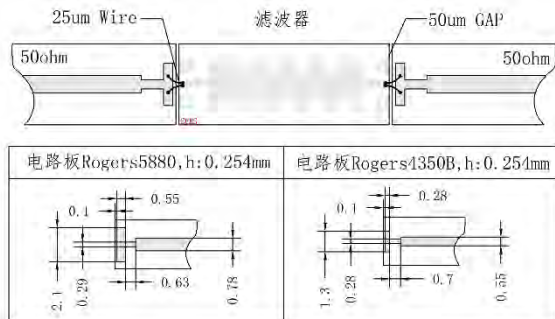
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		13.45		GHz
工作频率	11.3		15.6	GHz
中心损耗		1.0	1.5	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-8.3GHz	42	47		dBc
带外抑制@16.9-32.0GHz	40	45		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 6.5, W: 3.0, H: 0.254, 端口居中



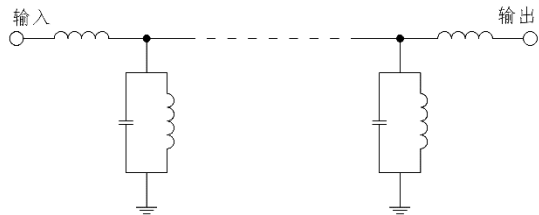
推荐装配图:



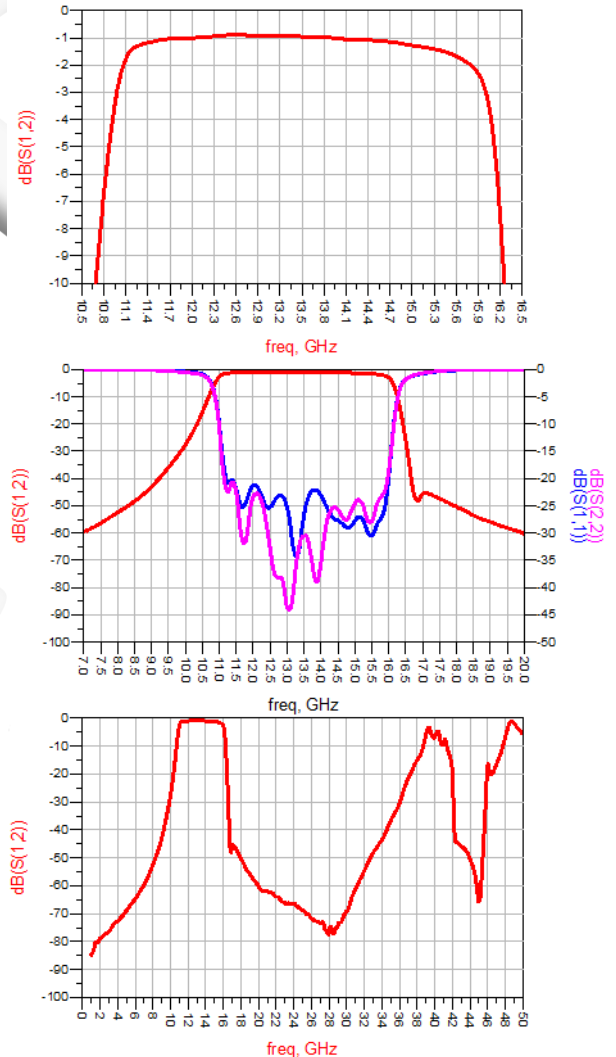
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



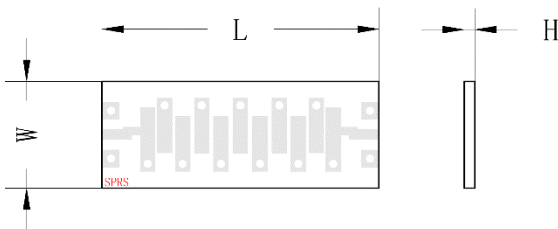
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

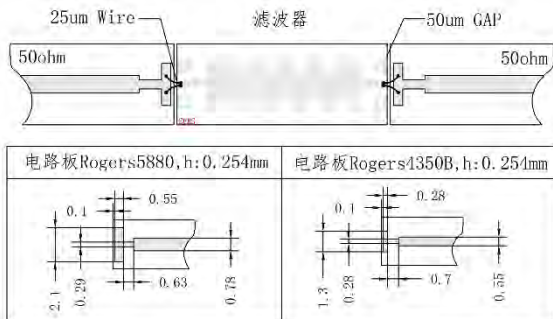
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		11.85		GHz
工作频率	11.4		12.3	GHz
中心损耗		2.2	2.7	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-10.6GHz	32	36		dBc
带外抑制@13.9-22.0GHz	35	40		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.5, W: 4.5, H: 0.254, 端口居中



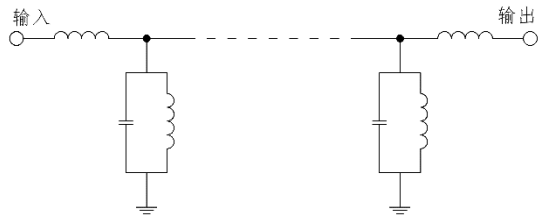
推荐装配图:



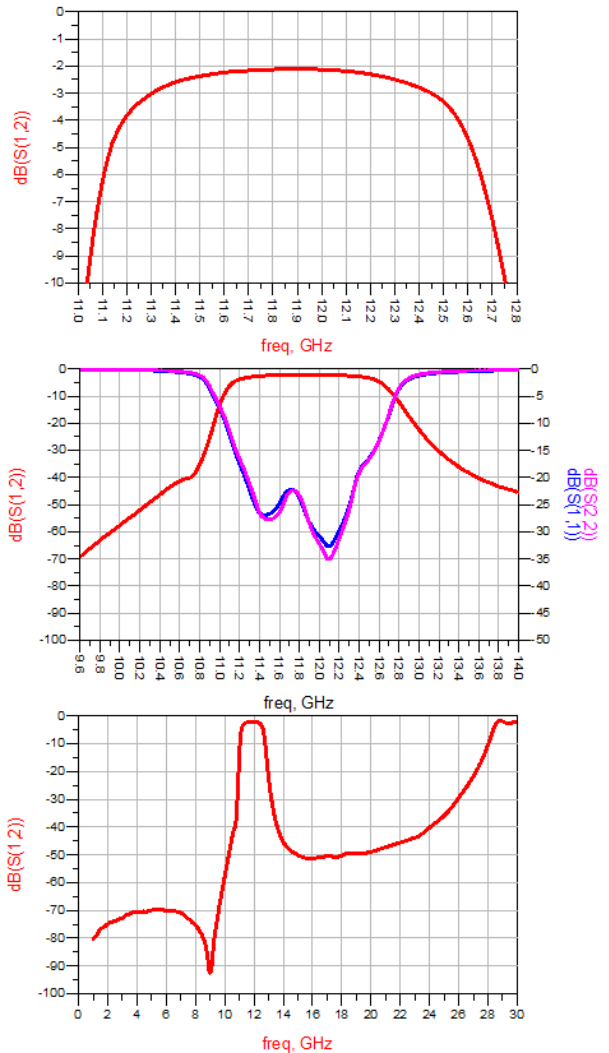
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



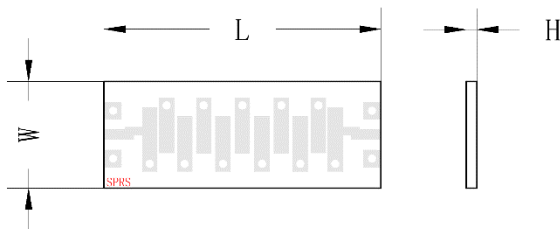
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

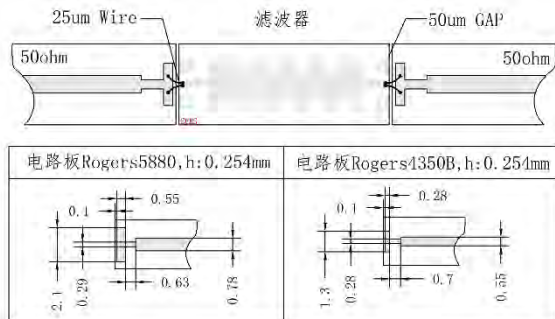
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		12.2		GHz
工作频率	11.4		13.0	GHz
中心损耗		1.8	2.3	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-10.3GHz	45	50		dBc
带外抑制@14.1-28.5GHz	45	50		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.0, W: 3.5, H: 0.254, 端口居中



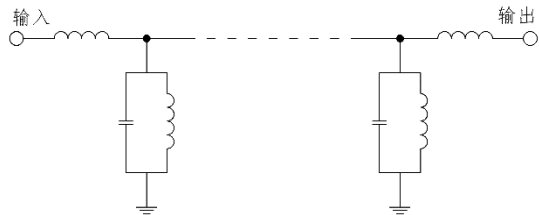
推荐装配图:



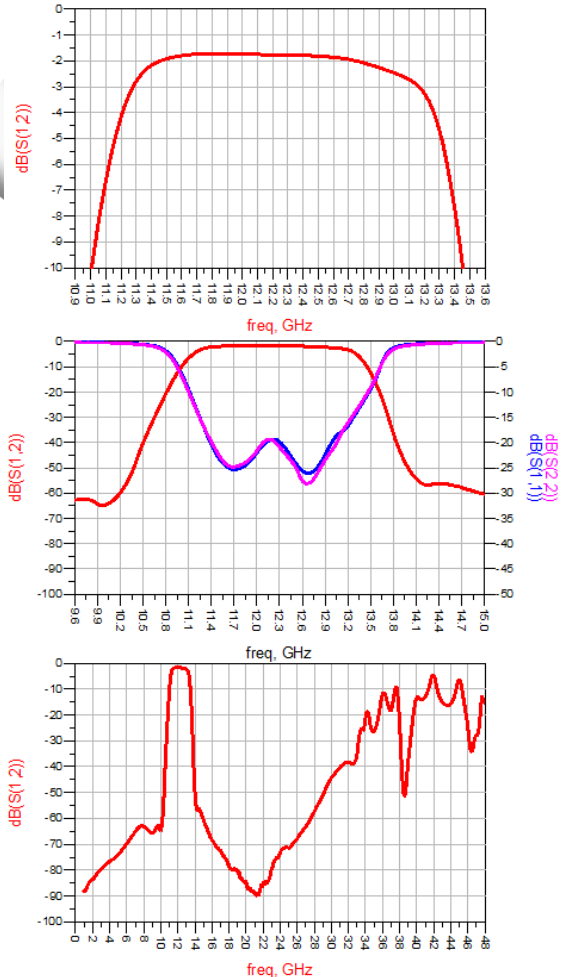
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

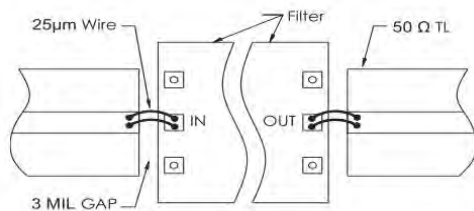
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		12.7		GHz
工作频率	11.5		13.9	GHz
中心损耗		2.8	3.3	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	14		
带外抑制	@9.5-10.4GHz	40	45	dBc
	@15.0-15.4GHz	40	45	dBc
	@DC-9.5GHz	60	65	dBc
	@15.4-29GHz	60	65	dBc

环境要求

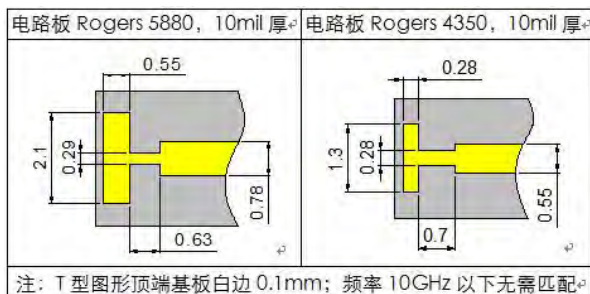
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

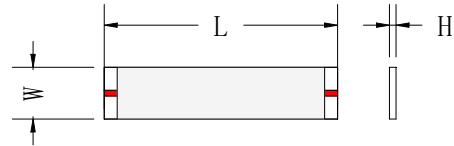
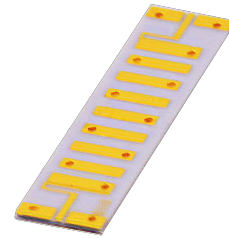


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

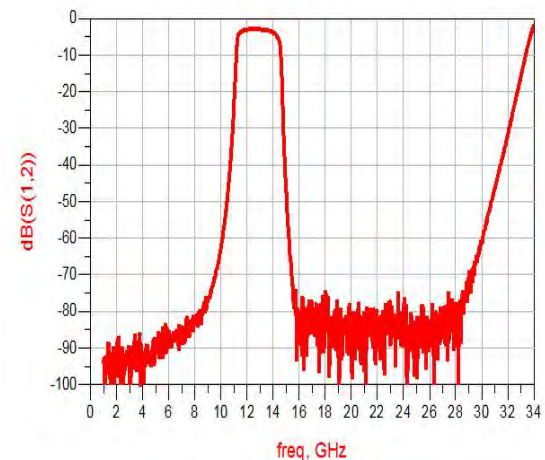
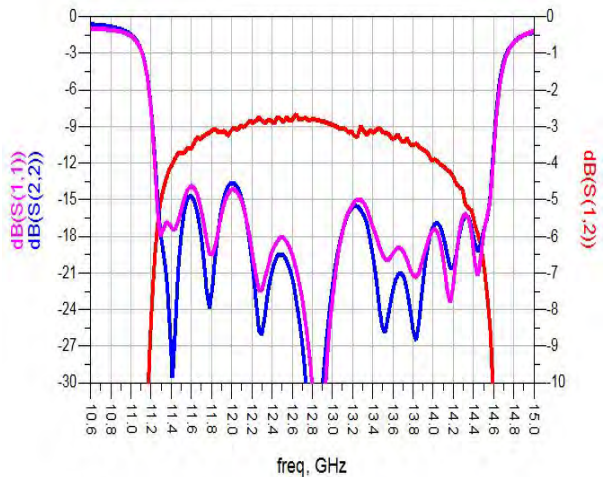


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	10.0	3.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



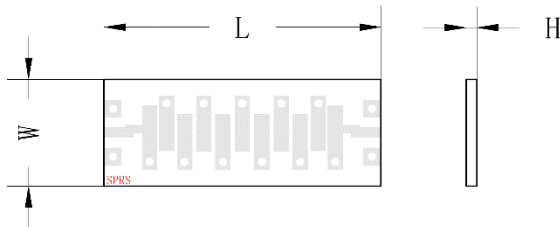
### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

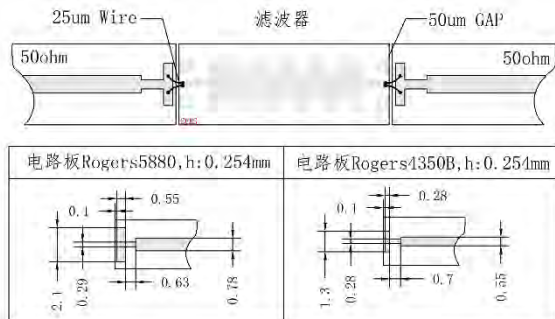
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		13.6		GHz
工作频率	11.6		15.6	GHz
中心损耗		3.7	4.2	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-9.4GHz	40	45		dBc
带外抑制@18.0-35.5GHz	40	45		dBc
承受功率			25	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 9.5, W: 3.0, H: 0.254, 端口居中



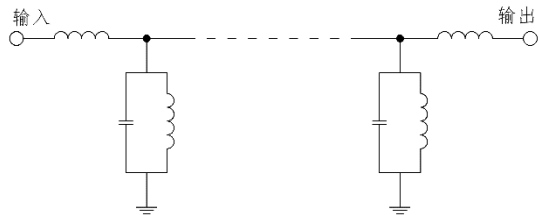
### 推荐装配图:



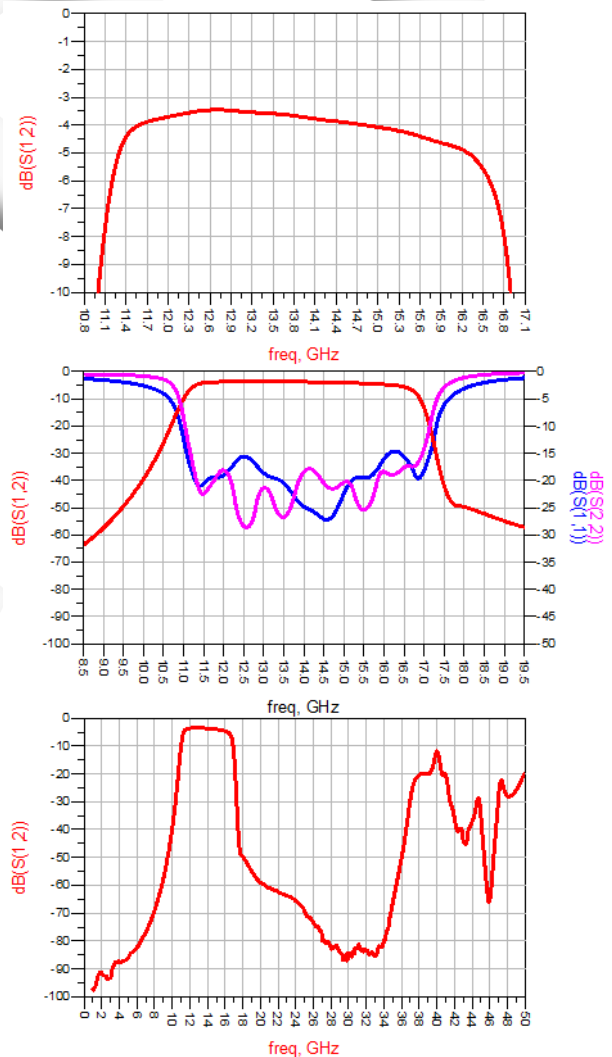
### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**1.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

### 原理图



### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

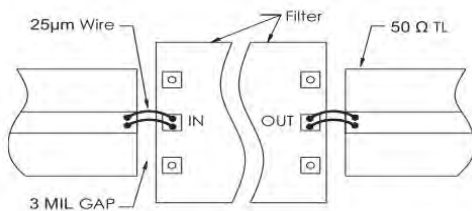
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		13.7		GHz
工作频率	11.6		15.8	GHz
中心损耗		0.9	1.2	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-8.5GHz	45	50	dBc
	@17.3-32.5GHz	45	50	dBc

### 环境要求

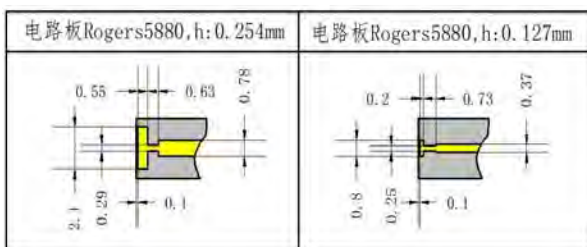
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

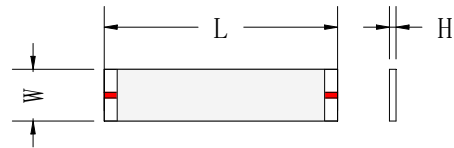
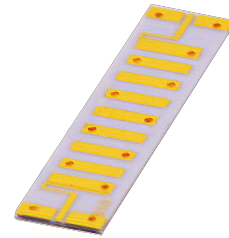


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

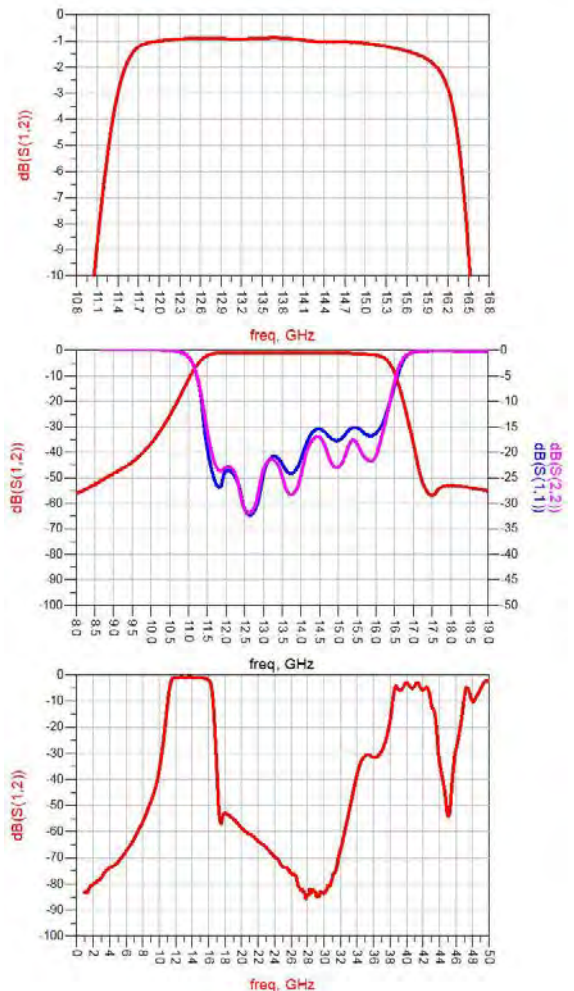


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.0	3.0	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



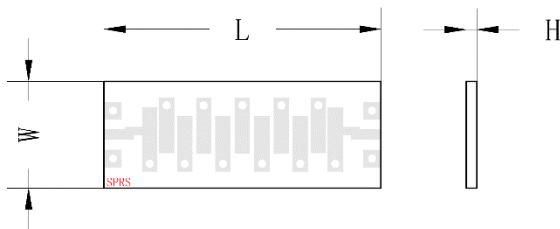
### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

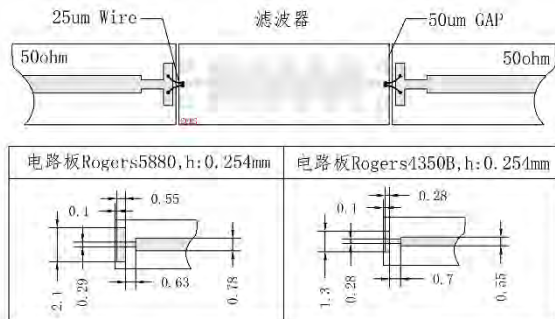
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		14.2		GHz
工作频率	11.7		16.7	GHz
中心损耗		1.2	1.7	dB
带内波动		0.9	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-9.4GHz	35	40		dBc
带外抑制@18.0-36.0GHz	35	40		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.0, W: 3.0, H: 0.254, 端口居中



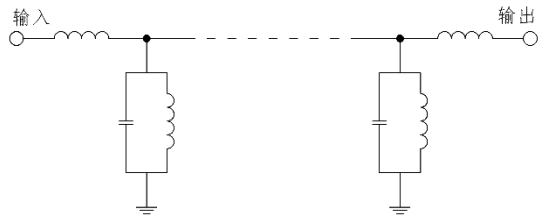
### 推荐装配图:



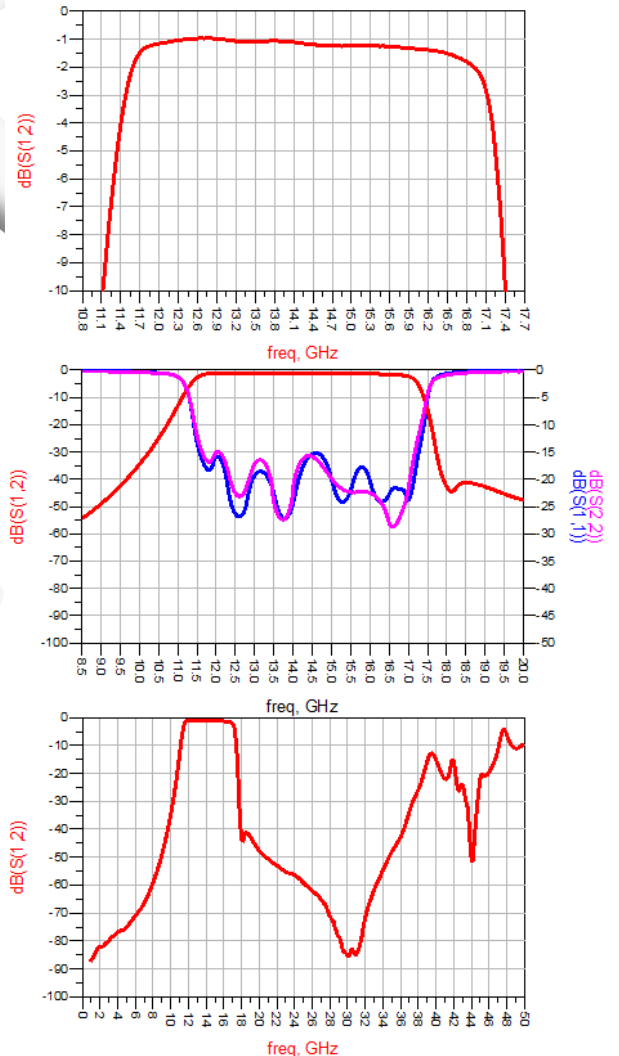
### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

### 原理图



### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

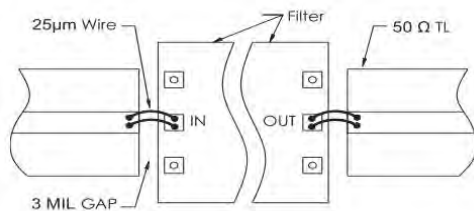
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		12.15		GHz
工作频率	11.75		12.45	GHz
中心损耗		3.0	3.5	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@DC-10.6GHz	40	45	dBc
	@13.3-33.0GHz	40	45	dBc

### 环境要求

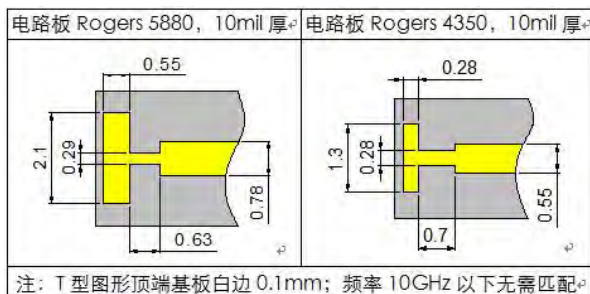
最大输入功率	30	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

### 推荐装配图

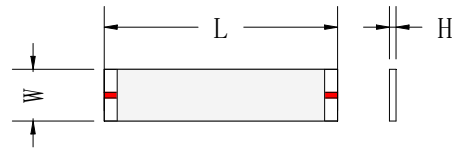
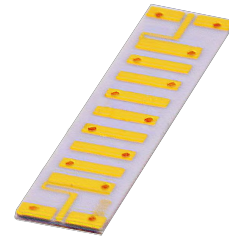


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

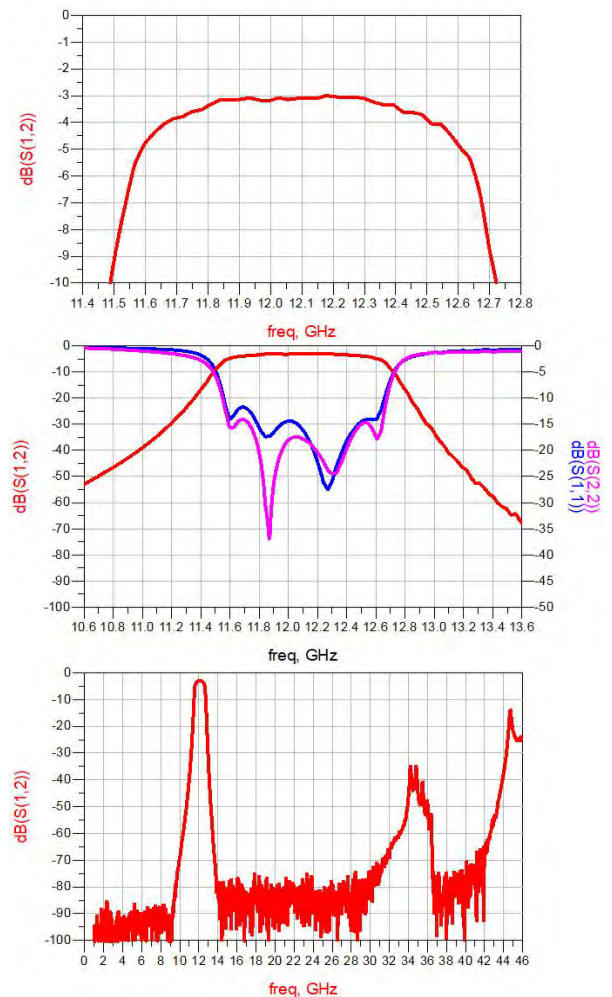


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	9.0	3.0	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块

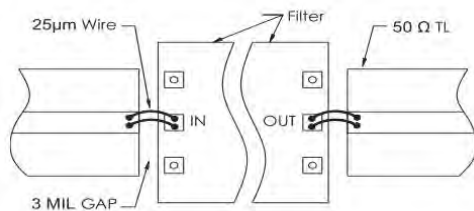
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		14.15		GHz
工作频率	11.8		16.5	GHz
中心损耗		1.2	1.7	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	14		
带外抑制	@DC-9.5GHz	40	45	dBc
	@19.1-36GHz	40	45	dBc

环境要求

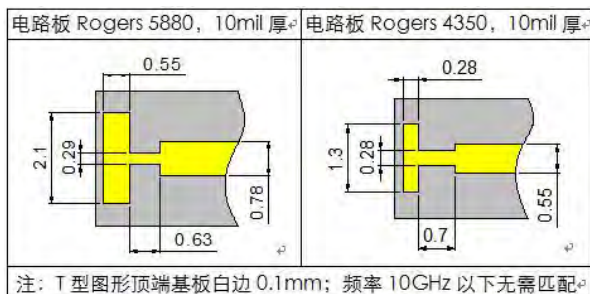
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

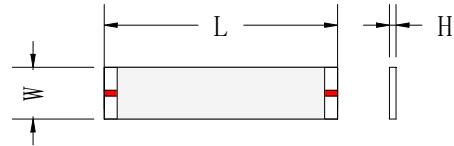
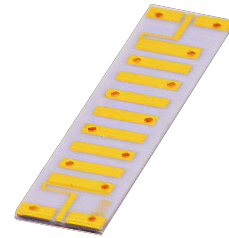


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁**0.1mm**,表面距上盖**1.75mm**,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配,T型尺寸如下:

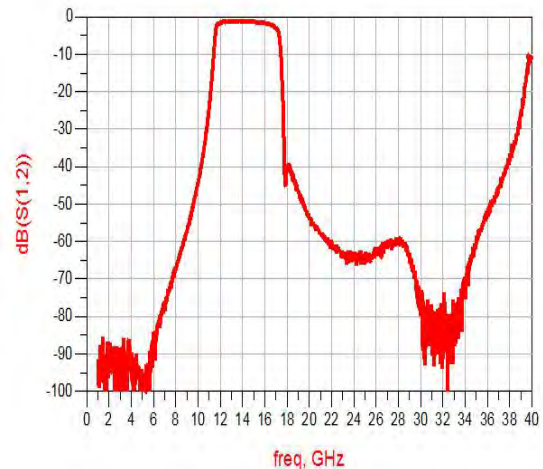
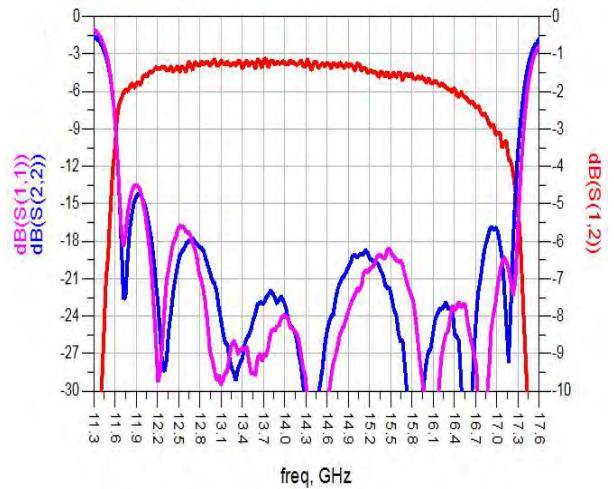


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



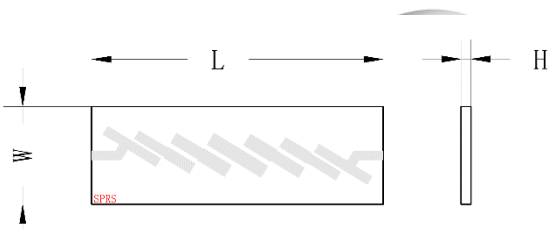
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

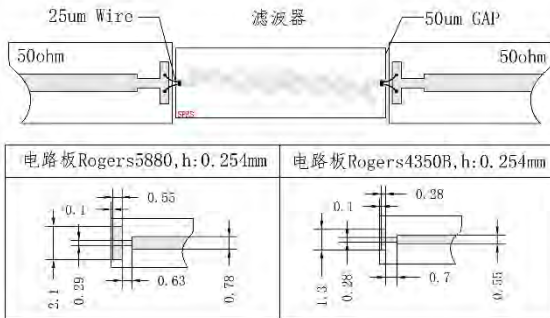
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		12.0		GHz
工作频率		/		GHz
中心损耗		6.5	7.0	dB
带内波动		/		dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-11.4GHz	38	43		dBc
带外抑制@12.6-21.0GHz	38	43		dBc
承受功率			20	dBm
工作温度	-55		+85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^{\circ}\text{C}$

外形图: L: 6.0, W: 4.0, H: 0.254, 端口居中



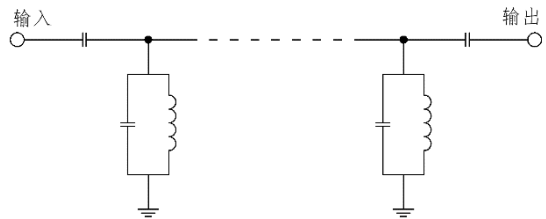
推荐装配图:



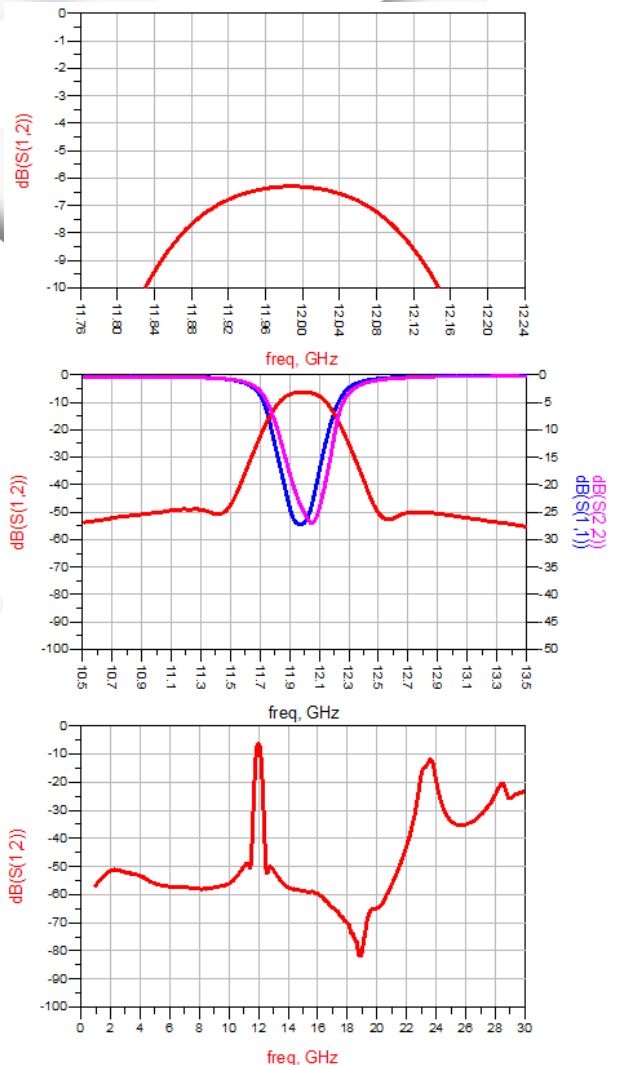
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^{\circ}\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块

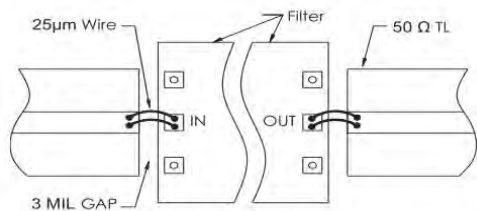
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		13.5		GHz
工作频率	12.0		15.0	GHz
中心损耗		1.4	1.9	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	14		
带外抑制	@DC-10.8GHz	43	46	dBc
	@16.6-33GHz	45	50	dBc

环境要求

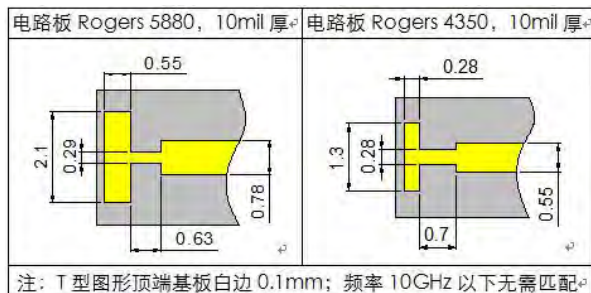
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

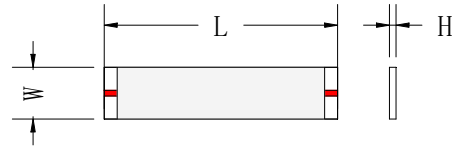
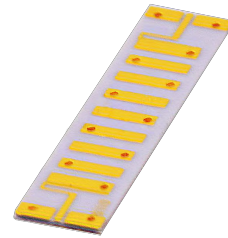


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁**0.1mm**,表面距上盖**2.75mm**,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配,T型尺寸如下:

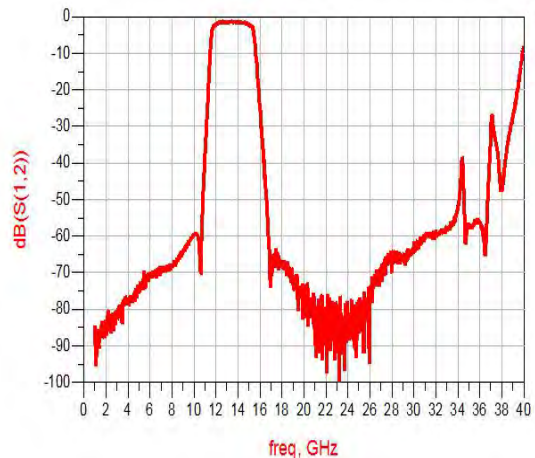
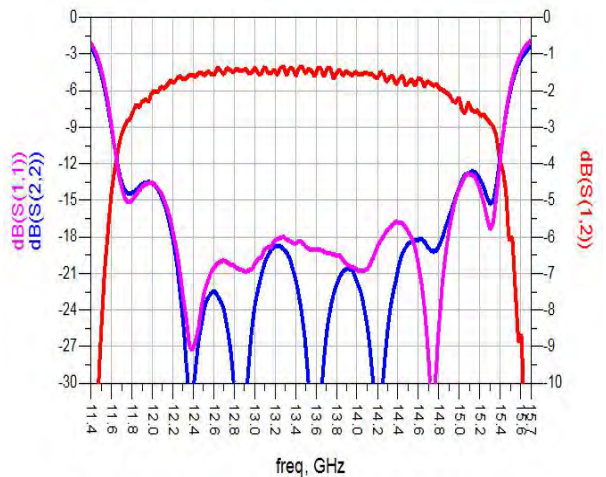


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

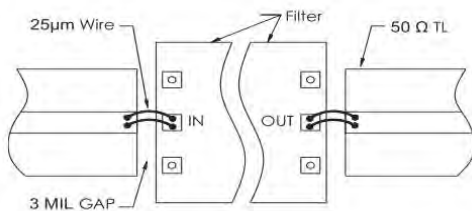
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		15.0		GHz
工作频率	12.0		18.0	GHz
中心损耗		1.6	2.1	dB
带内波动		1.1	1.4	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-9.4GHz	45	50	dBc
	@19.6-35.5GHz	45	50	dBc

环境要求

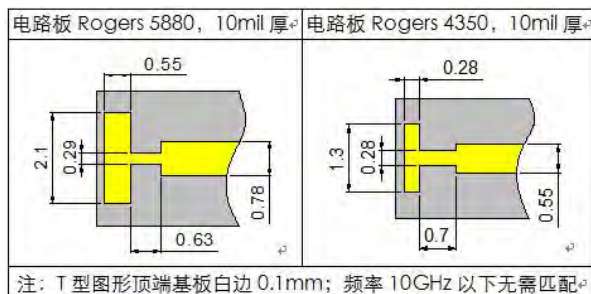
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

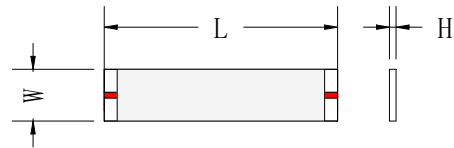
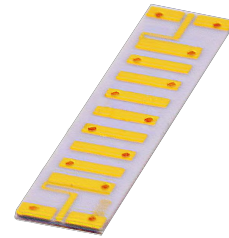


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm / °C),载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

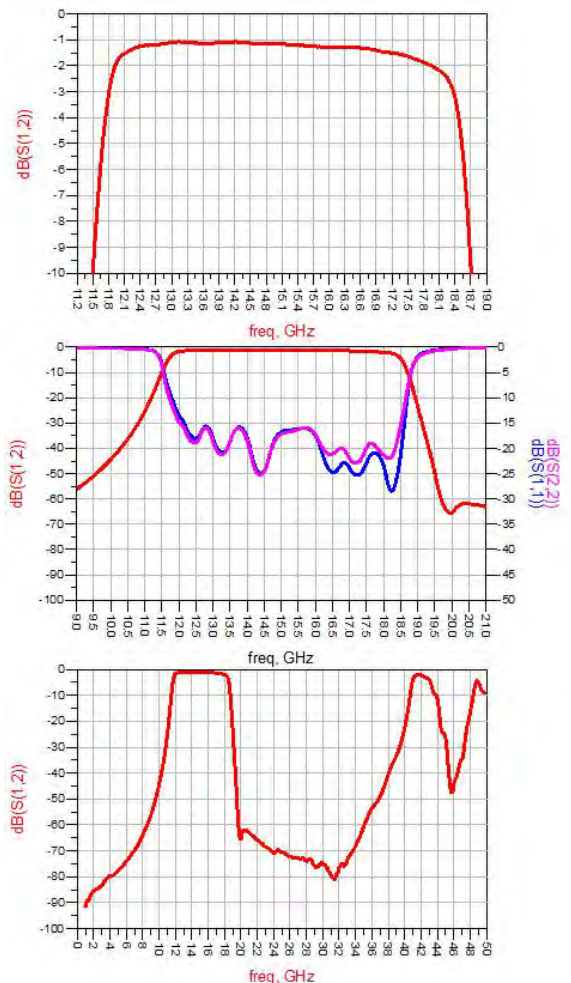


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

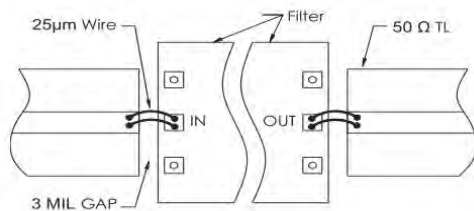
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		15.2		GHz
工作频率	12.0		18.4	GHz
中心损耗		0.9	1.4	dB
带内波动		0.6	0.9	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-10.7GHz	35	40	dBc
	@20.4-39.4GHz	35	40	dBc

环境要求

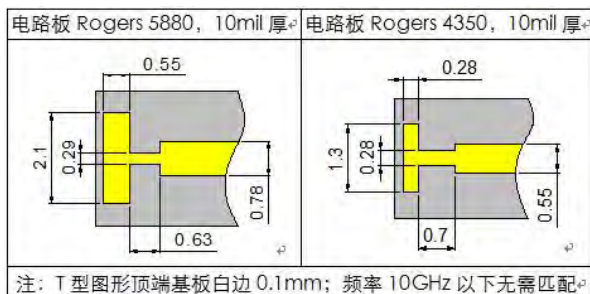
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

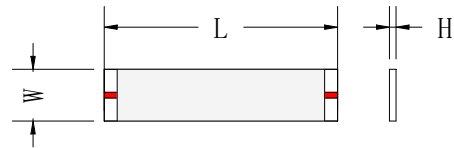
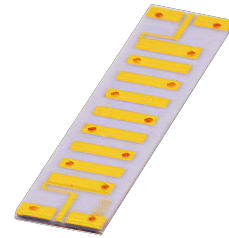


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

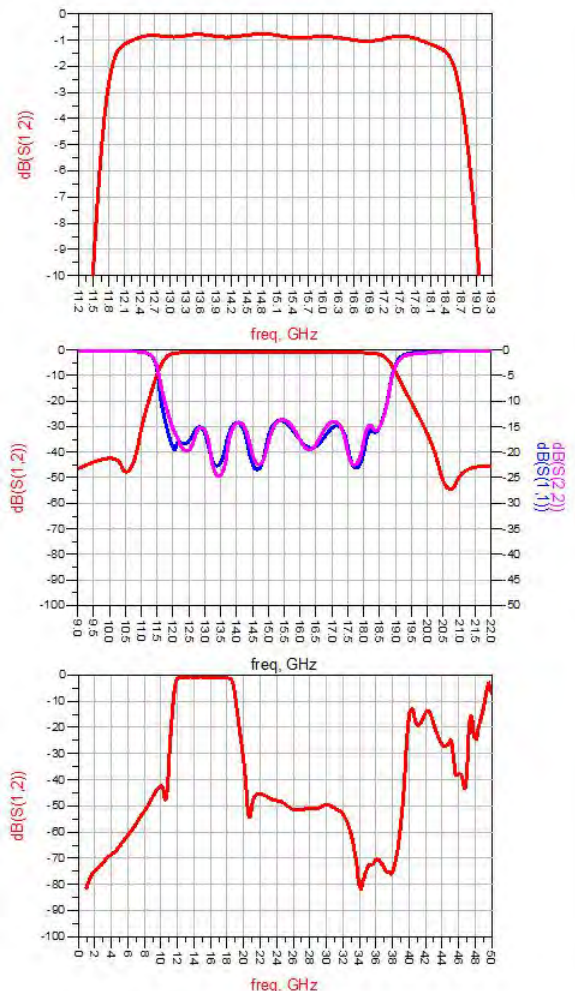


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.0	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

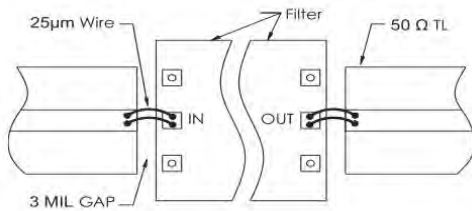
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		20.0		GHz
工作频率	12.0		28.0	GHz
中心损耗		0.5	0.8	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-9.3GHz	28	33	dBc
	@32.8-40.0GHz	12	16	dBc

环境要求

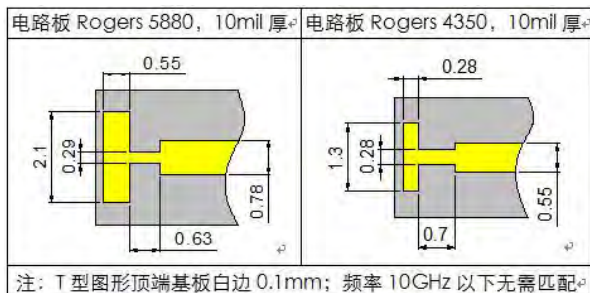
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

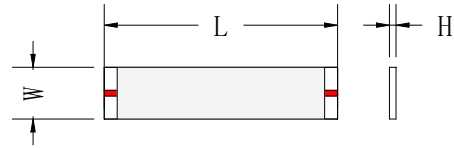
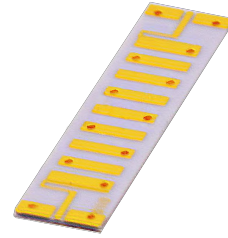


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

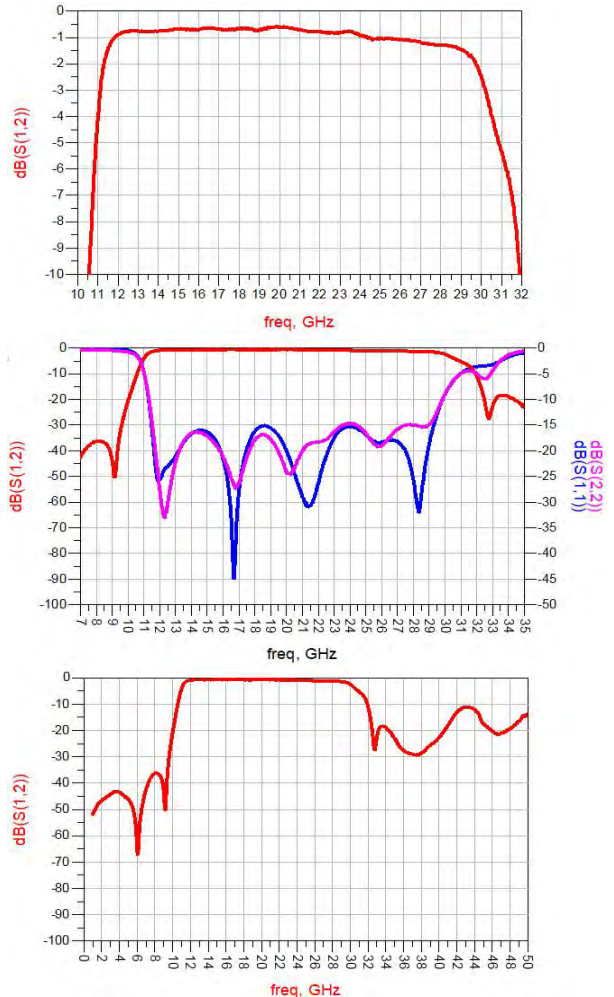


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	3.2	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

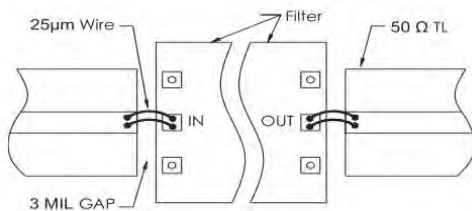
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		12.75		GHz
工作频率	12.2		13.3	GHz
中心损耗		2.8	3.3	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-10.6GHz	45	50	dBc
	@14.3-33GHz	45	50	dBc

环境要求

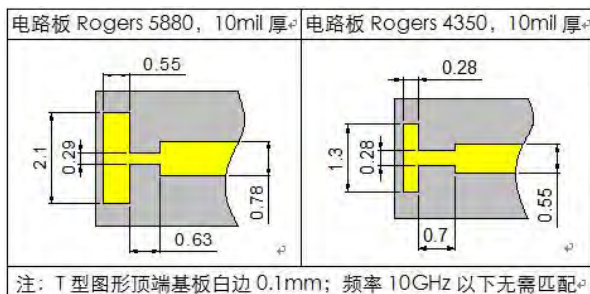
最大输入功率	30	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

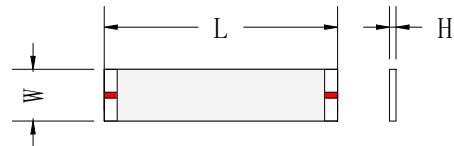
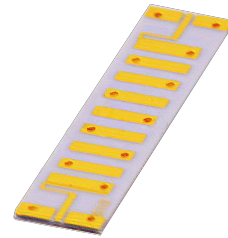


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

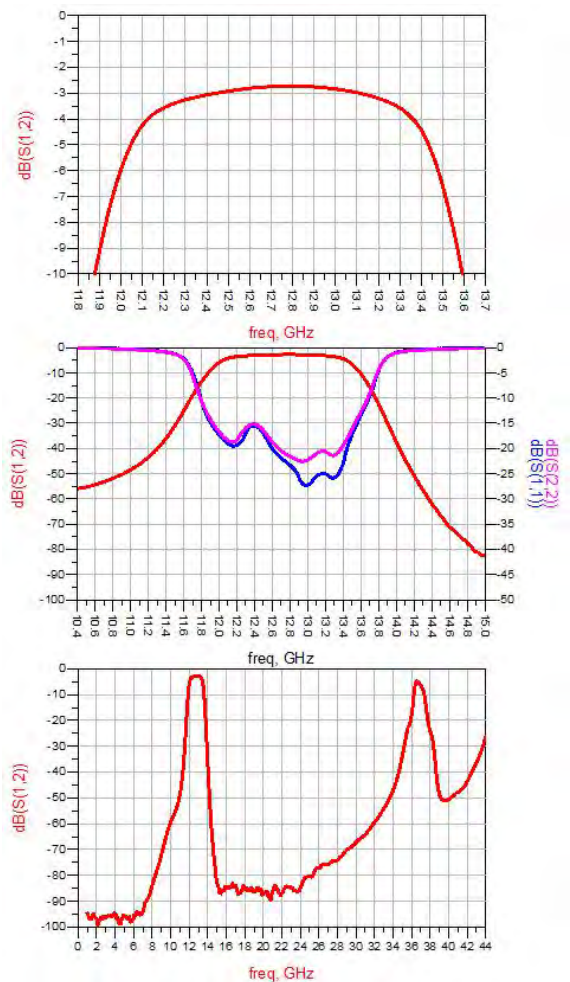


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	9.0	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

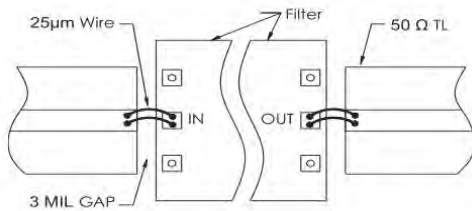
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		13.7		GHz
工作频率	12.3		15.1	GHz
中心损耗		2.0	2.5	dB
带内波动		1.1	1.4	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-10.5GHz	55	60	dBc
	@16.2-29.0GHz	55	60	dBc

环境要求

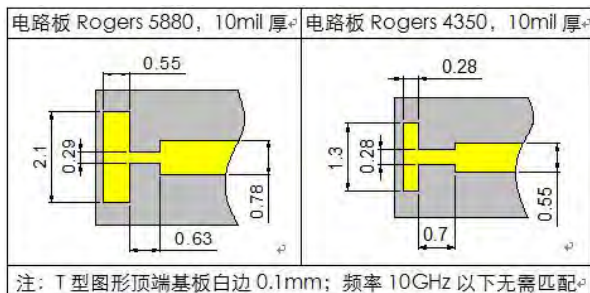
最大输入功率	30	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

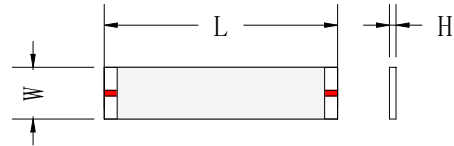
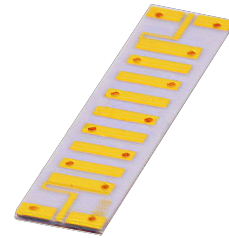


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm / °C),载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

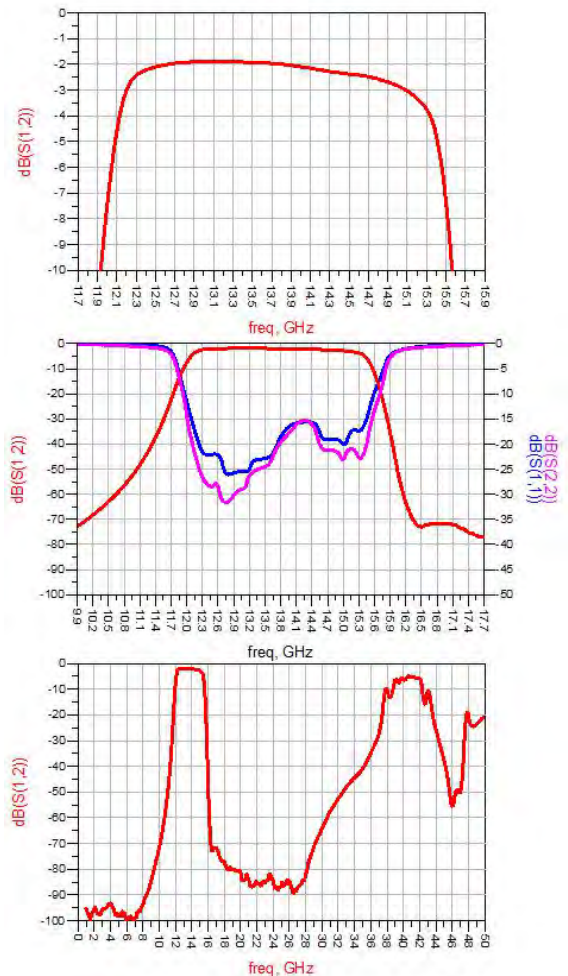


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	9.0	3.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

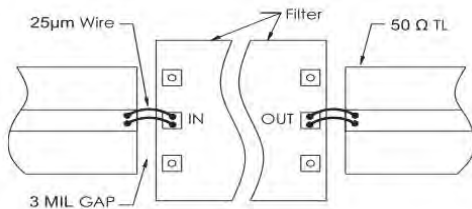
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		13.15		GHz
工作频率	12.4		13.9	GHz
中心损耗		2.2	2.7	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-11.3GHz	53	58	dBc
	@15.0-32.5GHz	53	58	dBc

环境要求

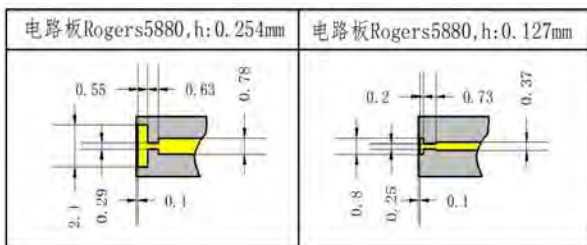
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

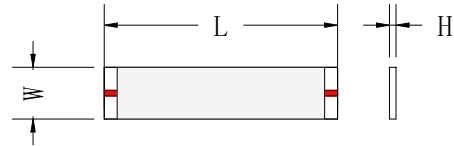
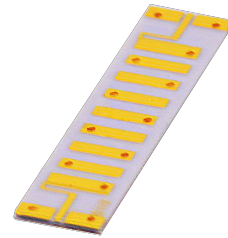


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

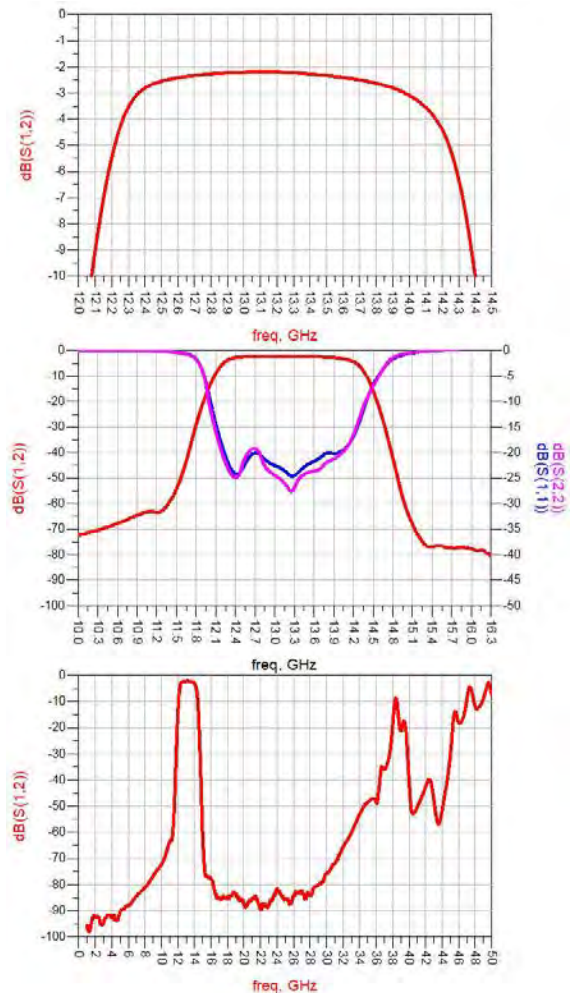


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	9.0	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

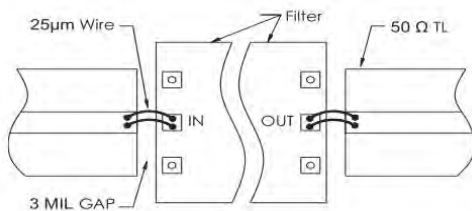
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		13.2		GHz
工作频率	12.4		14.0	GHz
中心损耗		2.5	3.0	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-11.5GHz	55	60	dBc
	@15.0-35.0GHz	55	60	dBc

环境要求

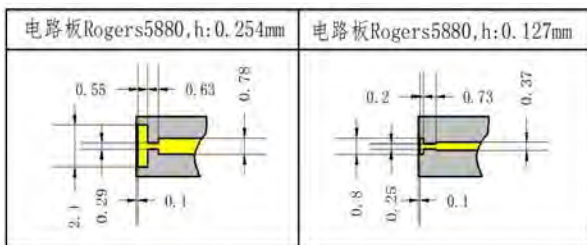
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

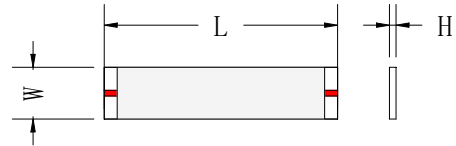
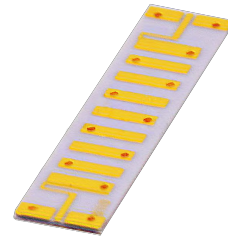


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

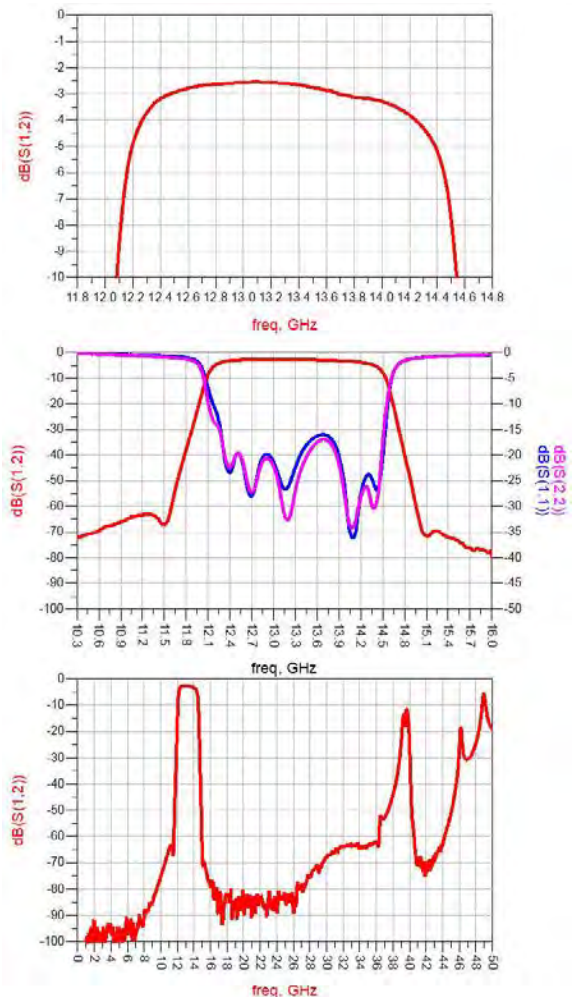


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	9.0	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



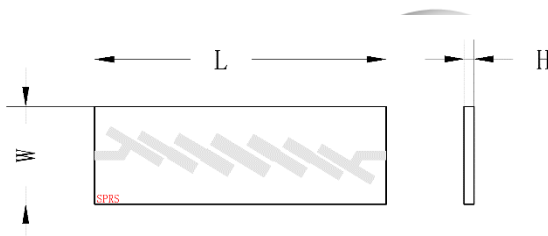
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

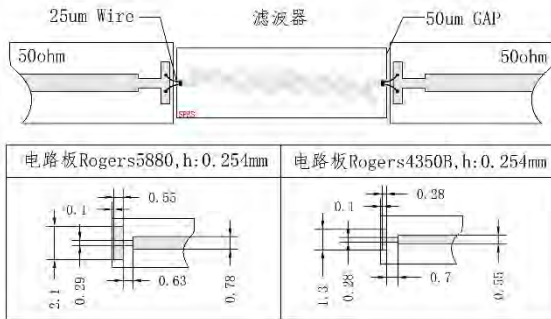
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		12.5		GHz
工作频率		/		GHz
中心损耗		6.8	7.3	dB
带内波动		/		dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-11.9GHz	38	43		dBc
带外抑制@13.1-21.0GHz	38	43		dBc
承受功率			20	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 6.0, W: 4.0, H: 0.254, 端口居中



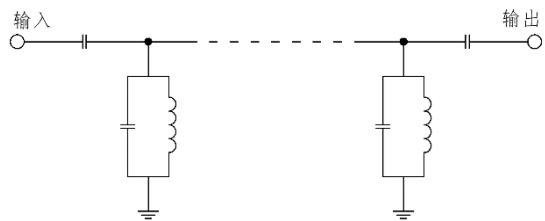
推荐装配图:



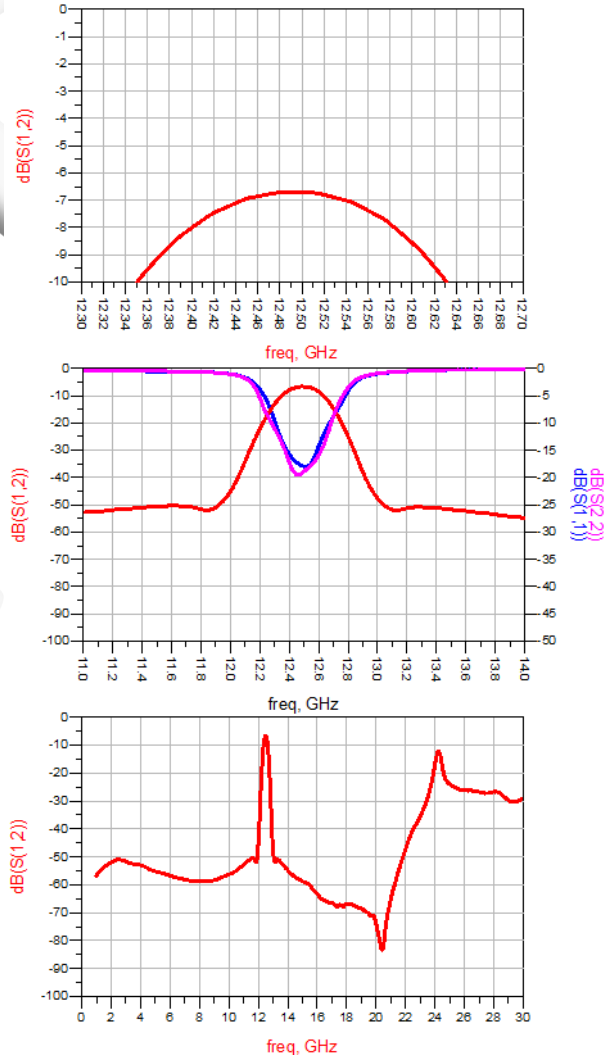
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

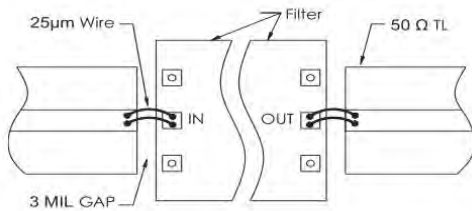
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		14.3		GHz
工作频率	12.5		16.1	GHz
中心损耗		1.2	1.6	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-8.8GHz	40	45	dBc
	@14.3-29.0GHz	40	45	dBc

环境要求

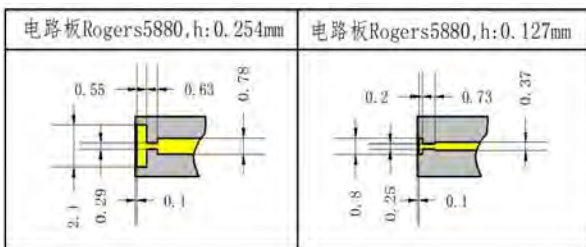
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

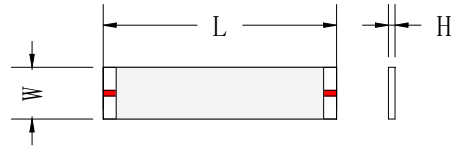
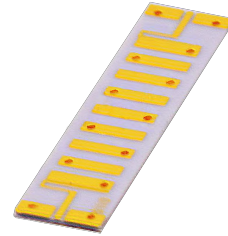


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

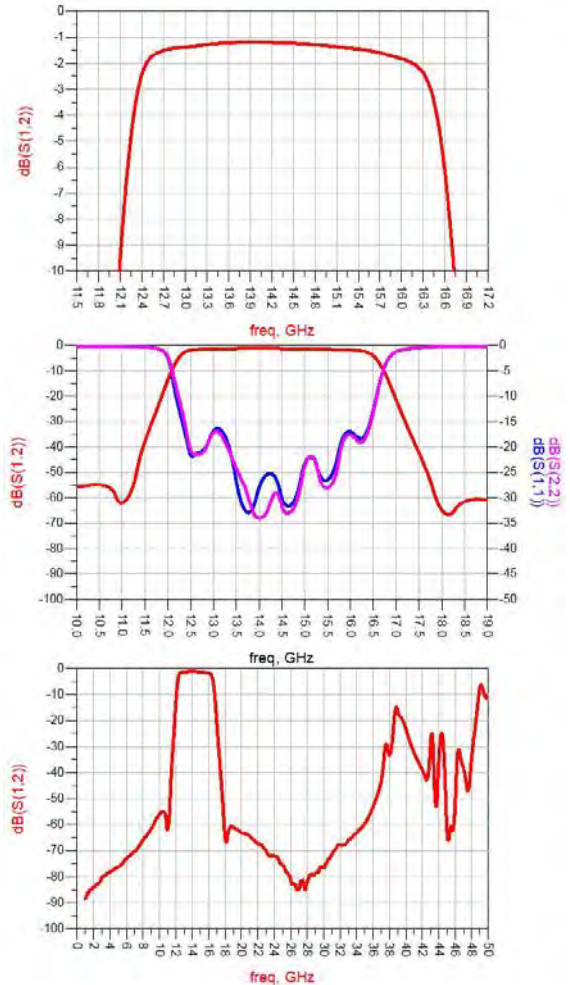


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

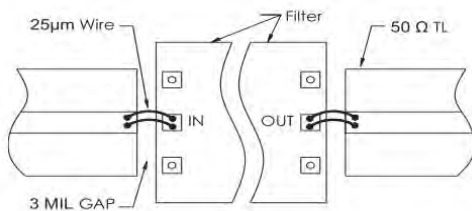
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		15.5		GHz
工作频率	12.5		18.5	GHz
中心损耗		0.8	1.0	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-11.2GHz	35	40	dBc
	@20.1-39GHz	35	40	dBc

环境要求

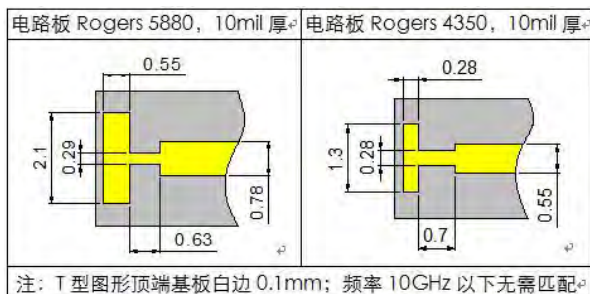
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

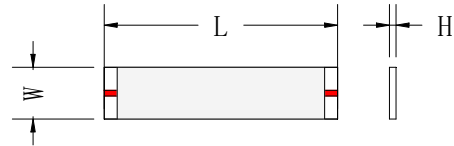
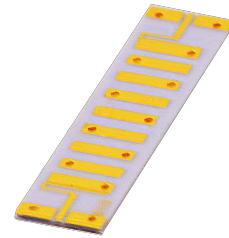


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

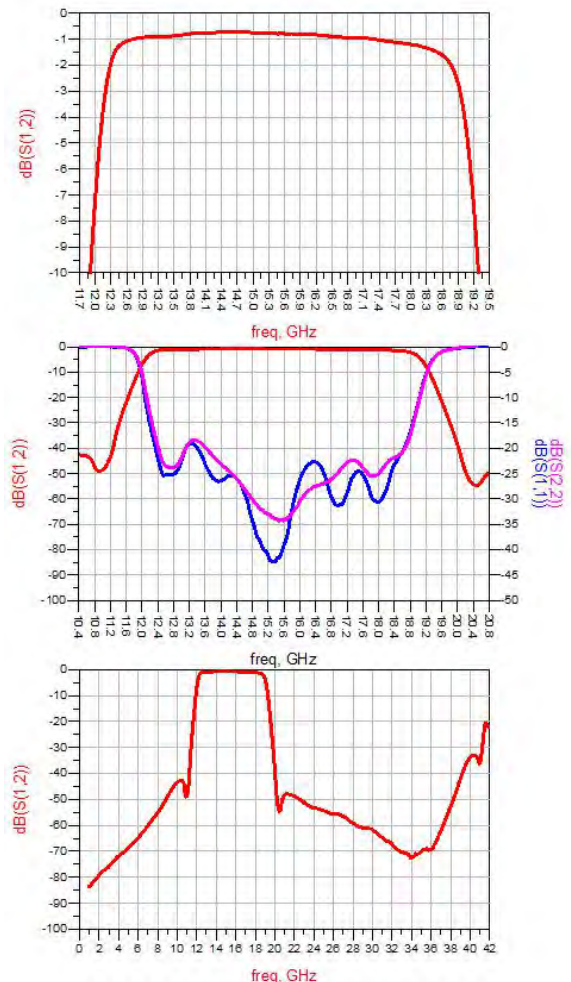


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.0	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

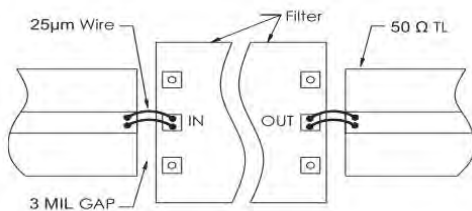
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		14.0		GHz
工作频率	12.8		15.2	GHz
中心损耗		1.8	2.3	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-11.5GHz	50	55	dBc
	@16.5-33.0GHz	50	55	dBc

### 环境要求

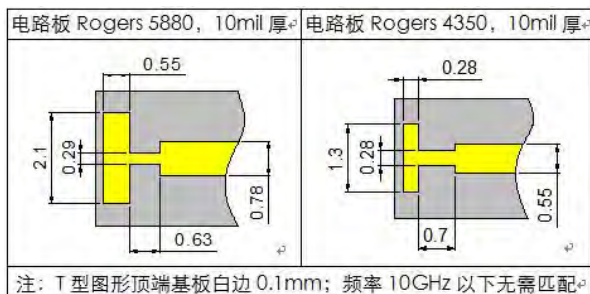
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

### 推荐装配图

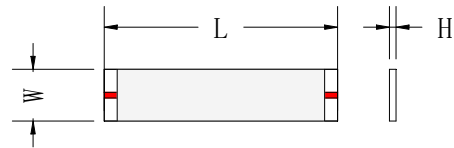
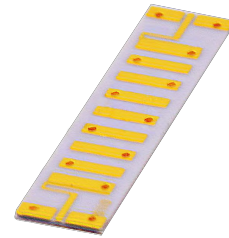


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**1.75mm**，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3. 芯片应安装在可伐（推荐）或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配，T型尺寸如下：

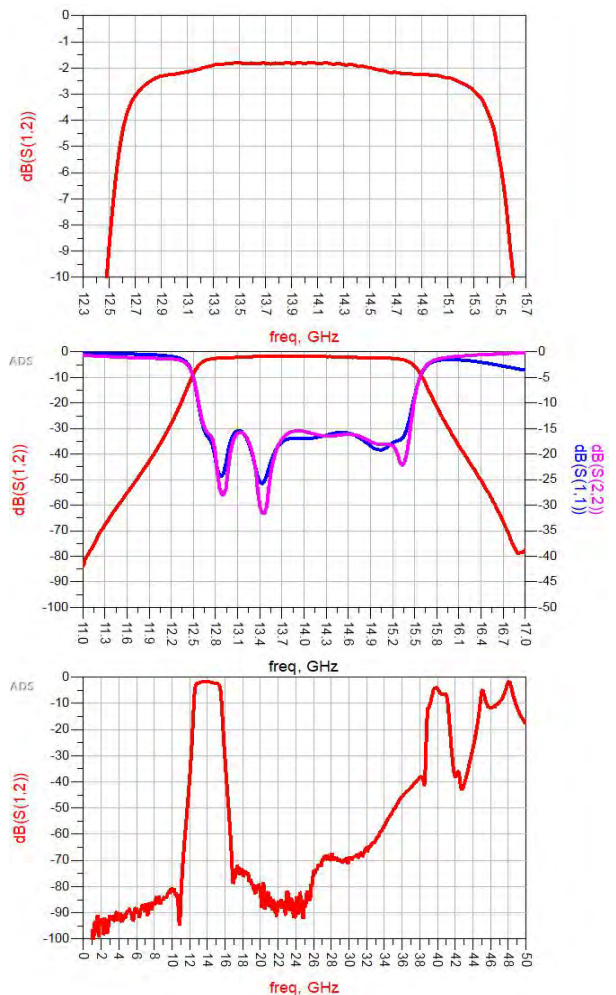


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	3.0	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



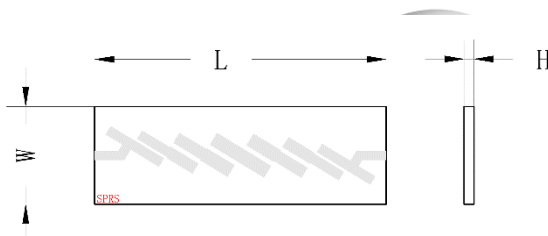
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

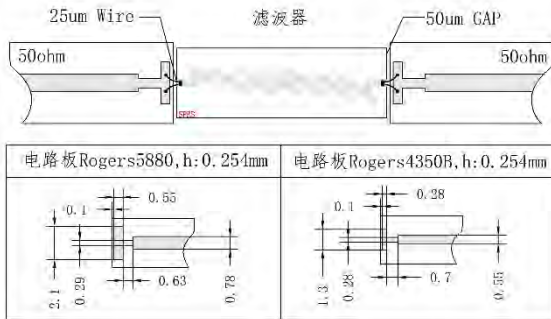
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		13.0		GHz
工作频率		/		GHz
中心损耗		6.4	6.9	dB
带内波动		/		dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-12.4GHz	37	42		dBc
带外抑制@13.6-22.0GHz	38	43		dBc
承受功率			20	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 6.0, W: 4.0, H: 0.254, 端口居中



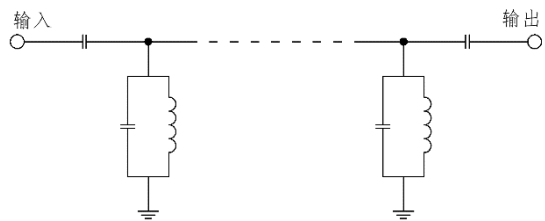
推荐装配图:



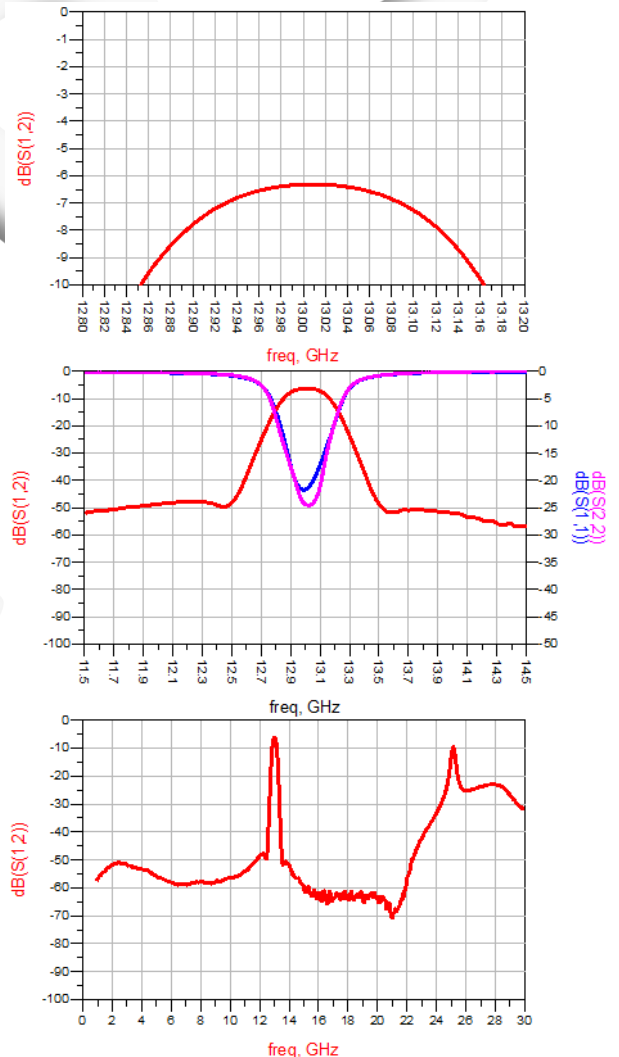
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

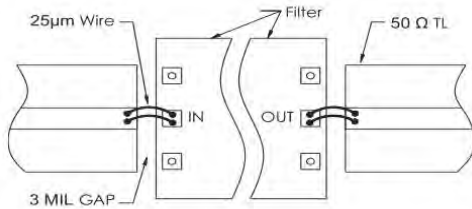
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		14.1		GHz
工作频率	13.0		15.2	GHz
中心损耗		1.5	2.0	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-11.5GHz	53	58	dBc
	@16.9-30.5GHz	53	58	dBc

环境要求

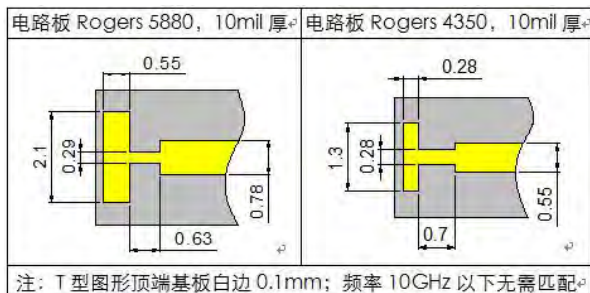
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

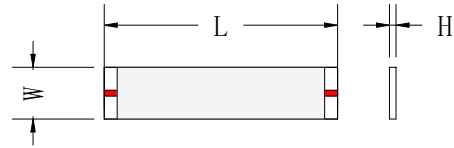
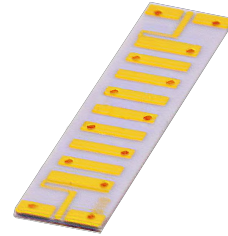


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

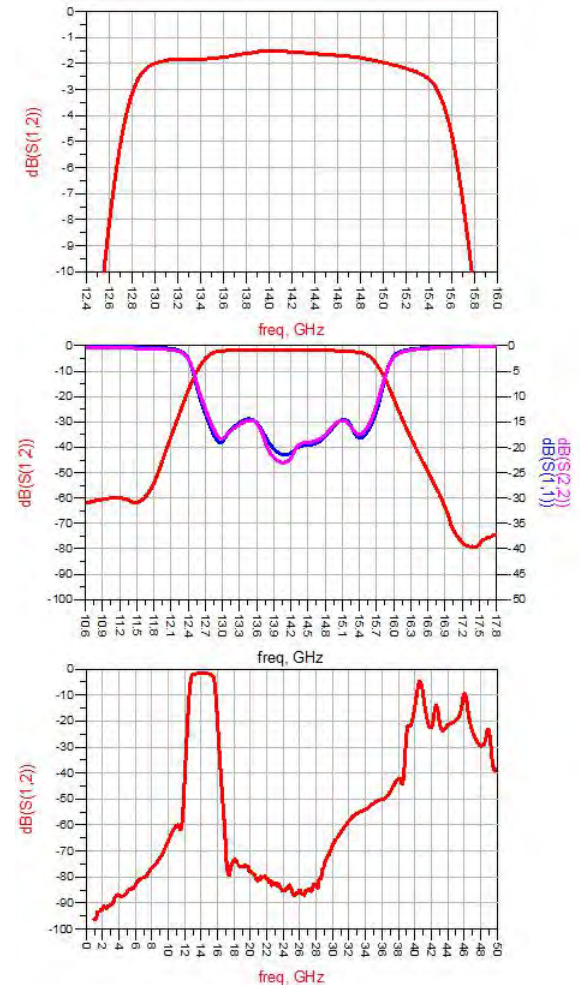


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



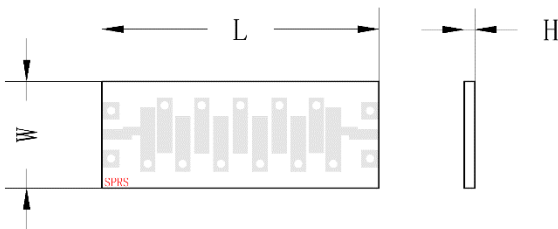
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

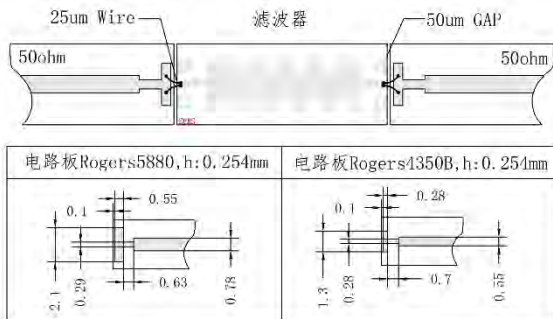
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		13.8		GHz
工作频率	13.1		14.5	GHz
中心损耗		2.6	3.1	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-12.0GHz	55	60		dBc
带外抑制@16.0-30.0GHz	65	70		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 10.0, W: 3.5, H: 0.254, 端口居中



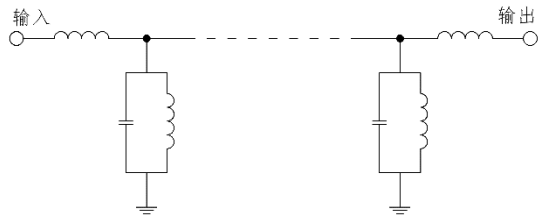
推荐装配图:



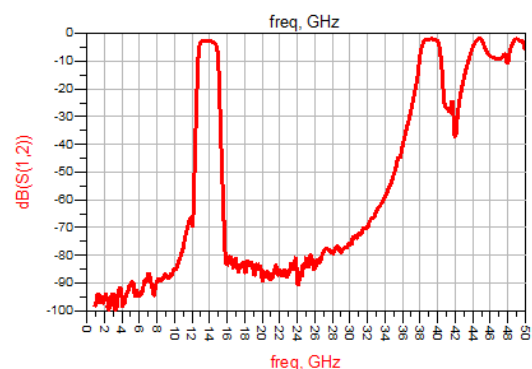
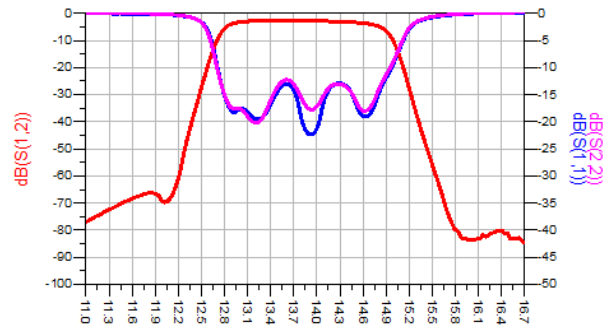
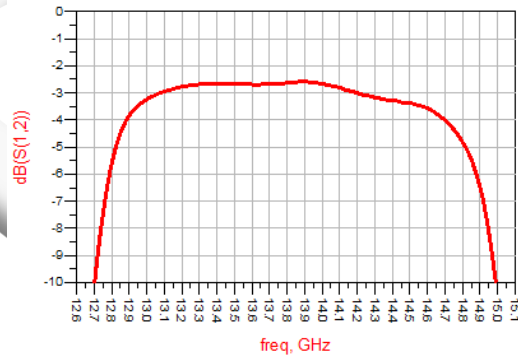
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



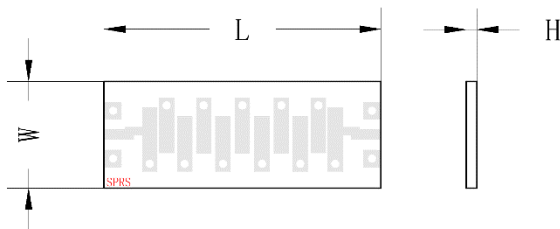
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

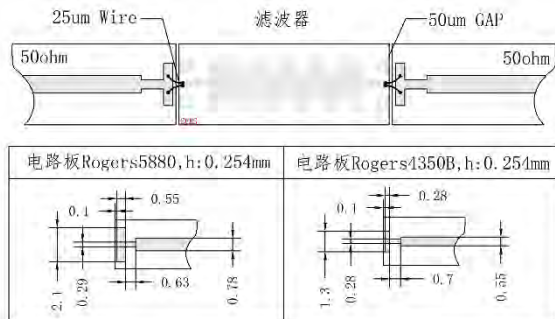
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		14.1		GHz
工作频率	13.4		14.8	GHz
中心损耗		2.0	2.5	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-12.1GHz	55	60		dBc
带外抑制@16.0-35.0GHz	55	60		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 8.0, W: 3.0, H: 0.254, 端口居中



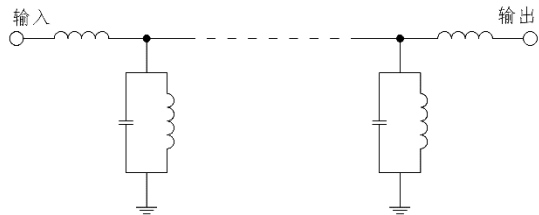
推荐装配图:



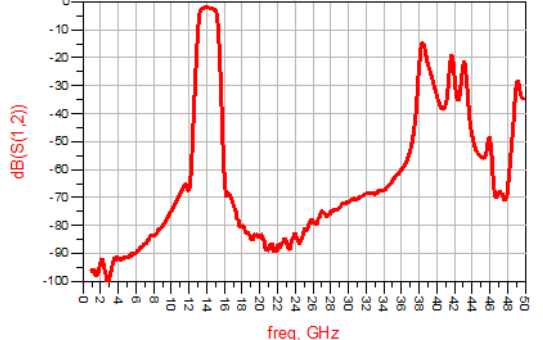
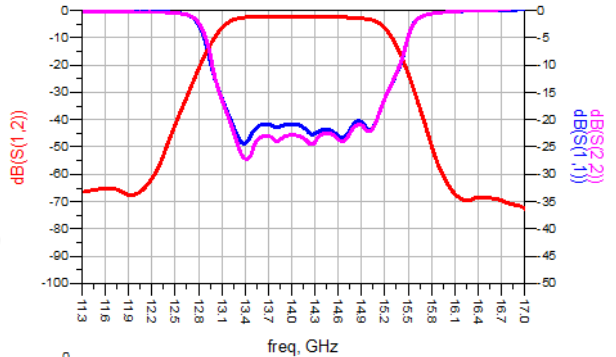
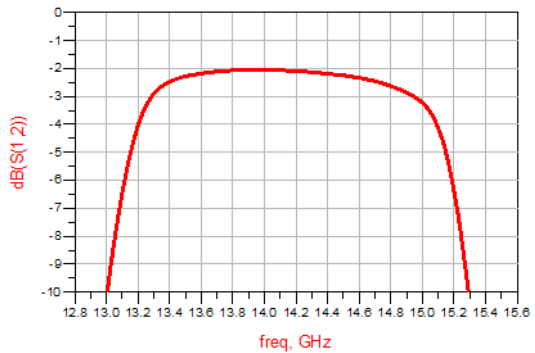
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



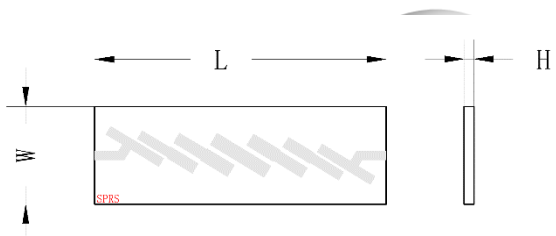
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

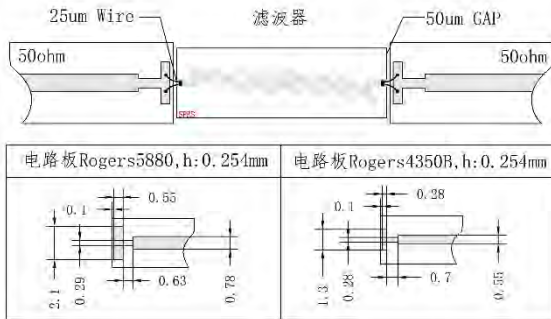
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		13.5		GHz
工作频率		/		GHz
中心损耗		6.5	7.0	dB
带内波动		/		dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-12.9GHz	38	43		dBc
带外抑制@14.1-23.0GHz	38	43		dBc
承受功率			20	dBm
工作温度	-55		+85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^{\circ}\text{C}$

外形图: L: 6.0, W: 4.0, H: 0.254, 端口居中



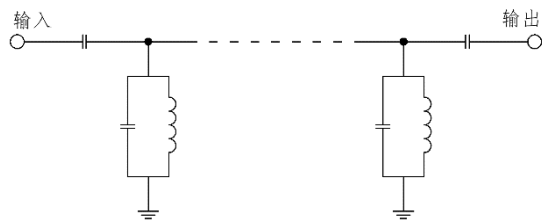
推荐装配图:



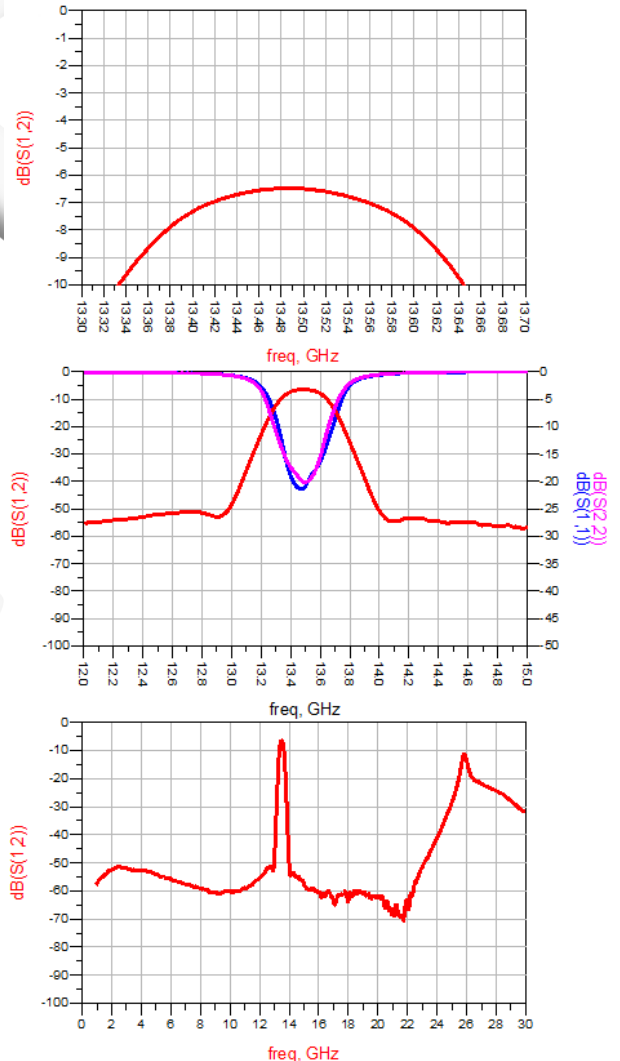
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^{\circ}\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

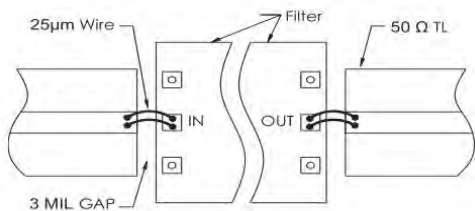
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		14.9		GHz
工作频率	13.5		16.3	GHz
中心损耗		1.6	2.1	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	14		
带外抑制	@6.6-10.6GHz	40	45	dBc
	@18.2-18.7GHz	40	45	dBc
	@DC-6.6GHz	60	65	dBc
	@18.7-36GHz	60	65	dBc

环境要求

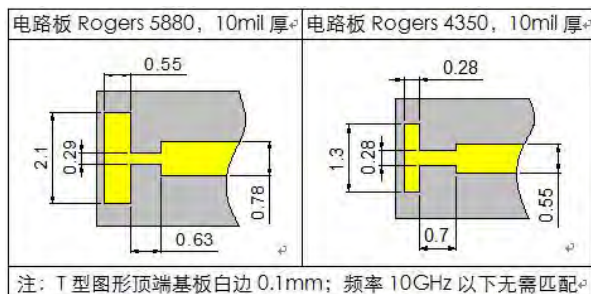
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

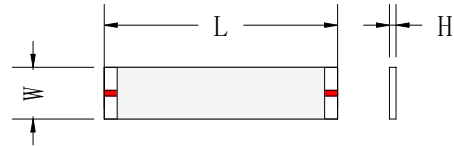
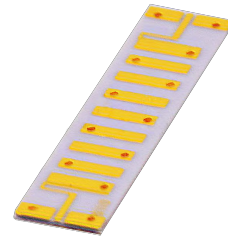


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

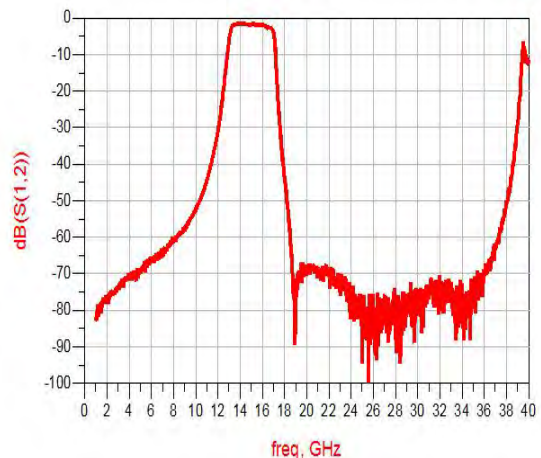
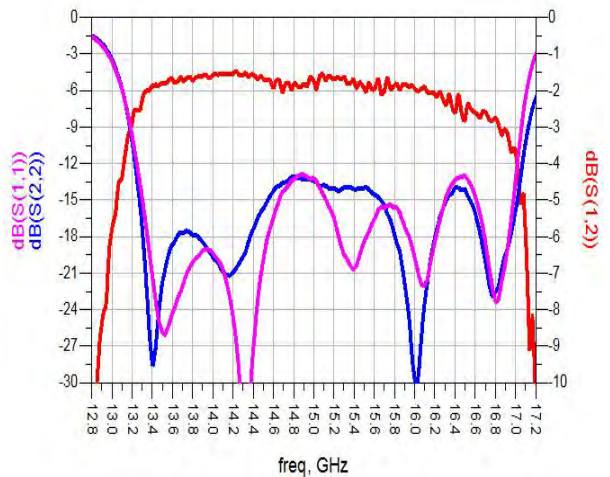


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	3.2	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

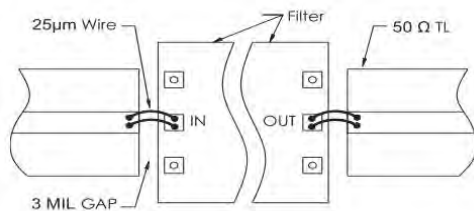
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		15.9		GHz
工作频率	13.5		18.3	GHz
中心损耗		1.0	1.5	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@DC-11.2GHz	40	45	dBc
	@20-39GHz	40	45	dBc

### 环境要求

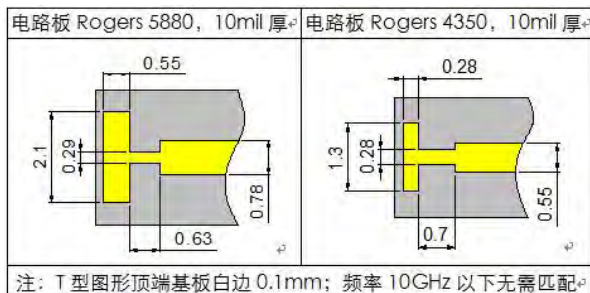
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^\circ\text{C}\sim+85^\circ\text{C}$	
储存温度	$-55^\circ\text{C}\sim+125^\circ\text{C}$	

### 推荐装配图

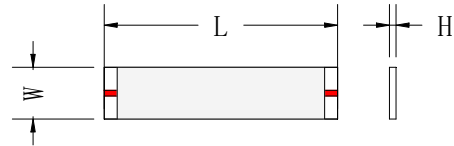
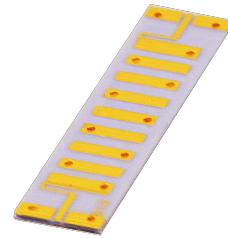


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

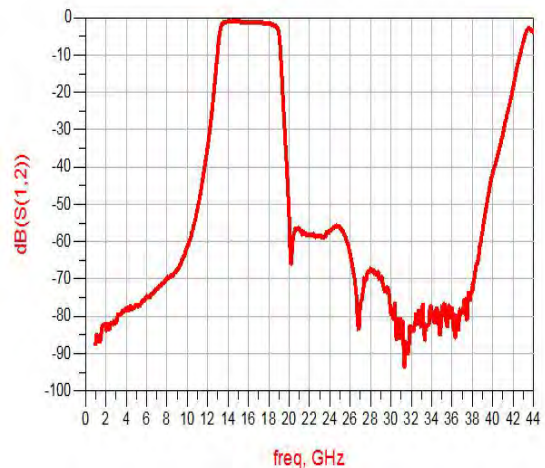
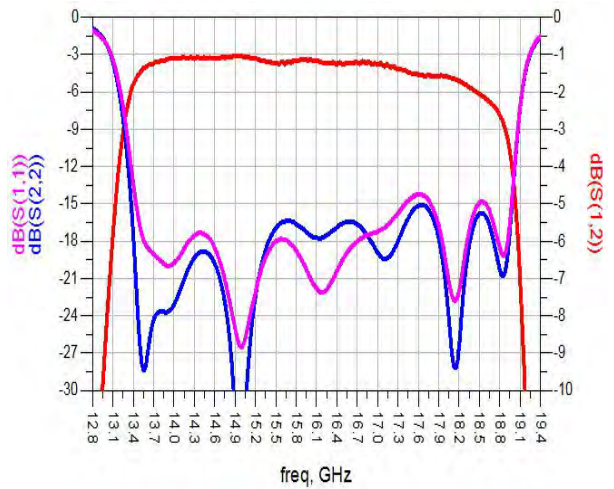


### 外形图



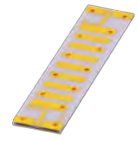
外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	3.0	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

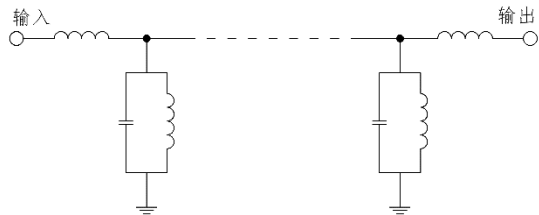
- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块



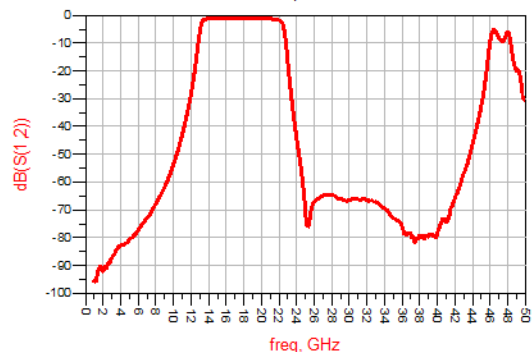
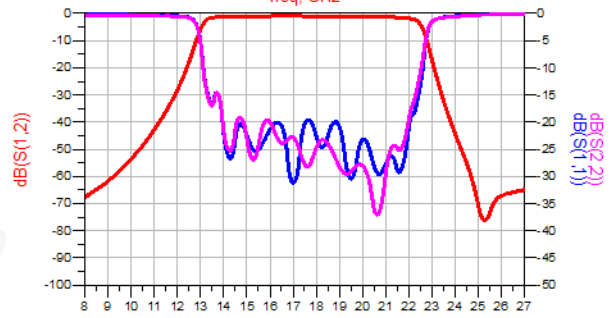
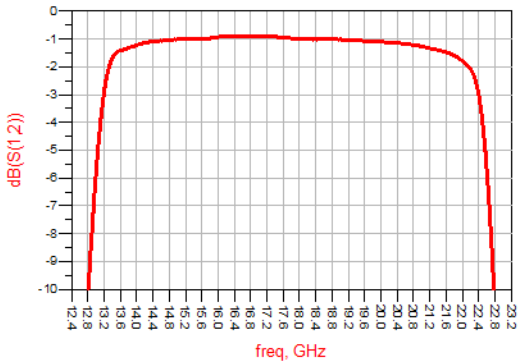
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		17.7		GHz
工作频率	13.5		21.9	GHz
中心损耗		1.0	1.5	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-8.7GHz	55	60		dBc
带外抑制@24.8-42.0GHz	55	60		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

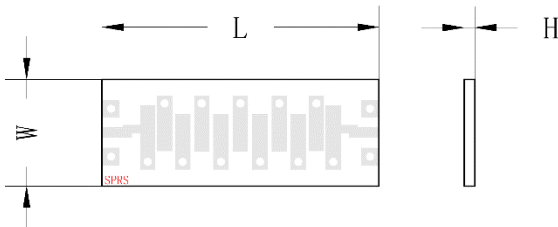
原理图



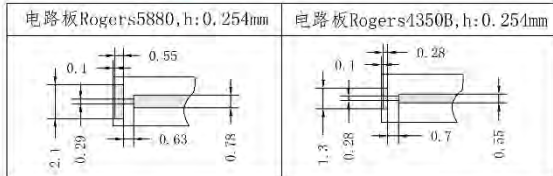
典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



外形图: L: 7.5, W: 2.5, H: 0.254, 端口居中



推荐装配图:



注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

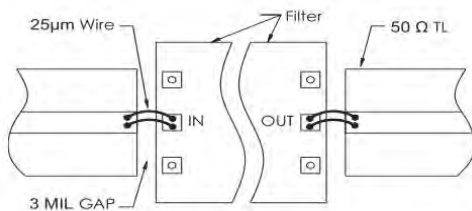
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		15.6		GHz
工作频率	13.6		17.6	GHz
中心损耗		1.3	1.8	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-11.5GHz	40	45	dBc
	@19.4-39.0GHz	40	45	dBc

环境要求

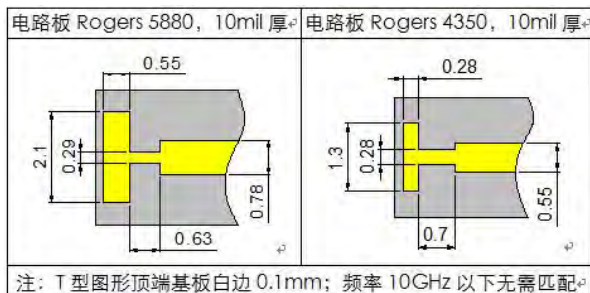
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

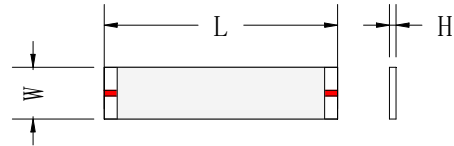
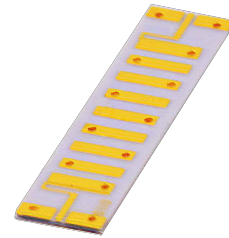


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

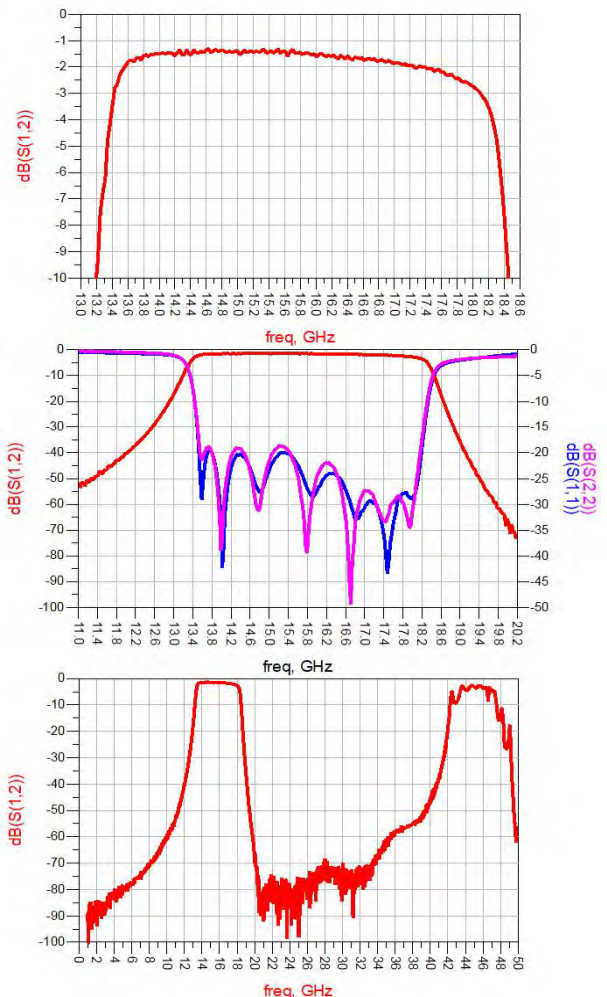


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.5	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

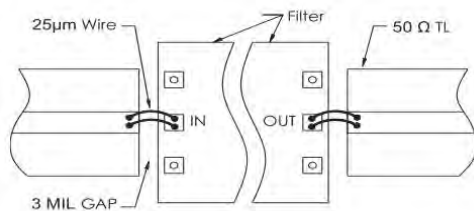
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		14.35		GHz
工作频率	13.7		15.0	GHz
中心损耗		2.5	3.0	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@DC-12.6GHz	40	45	dBc
	@16.0-38GHz	40	45	dBc

环境要求

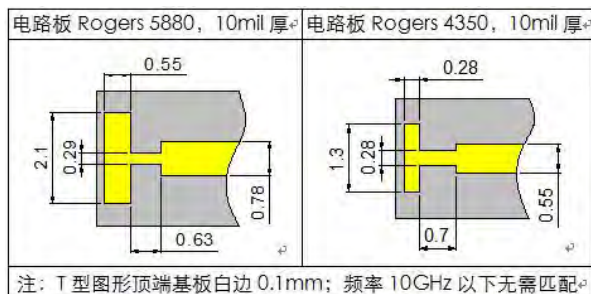
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

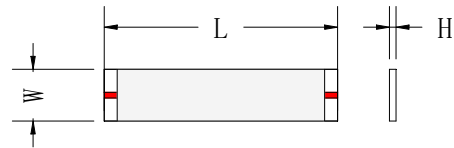
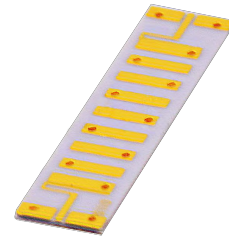


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

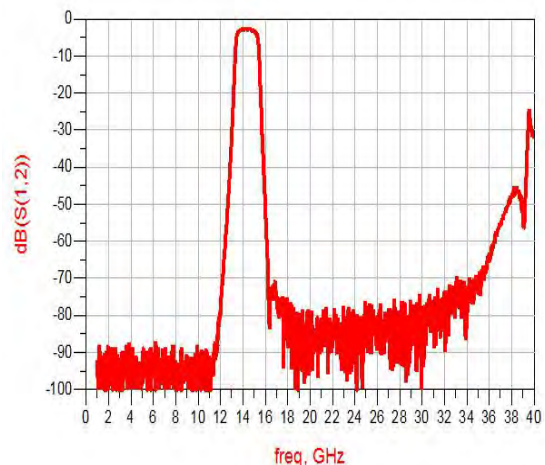
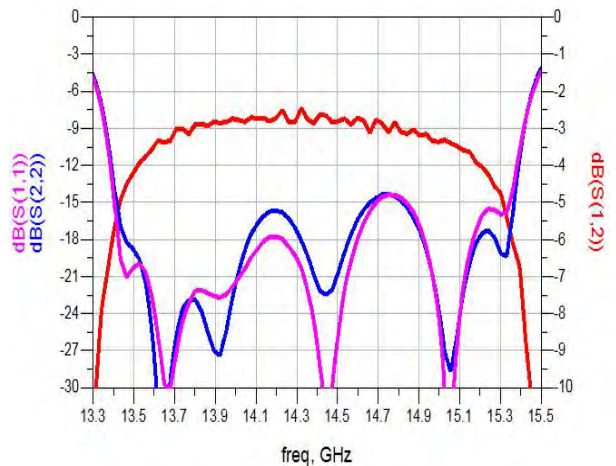


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	9.0	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

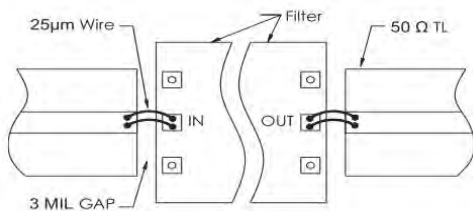
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		14.75		GHz
工作频率	13.7		15.8	GHz
中心损耗		2.2	2.7	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	10	12		
带外抑制	@12.4-12.7GHz	40	45	dBc
	@16.8-17GHz	40	45	dBc
	@DC-12.4GHz	60	65	dBc
	@17-40GHz	60	65	dBc

环境要求

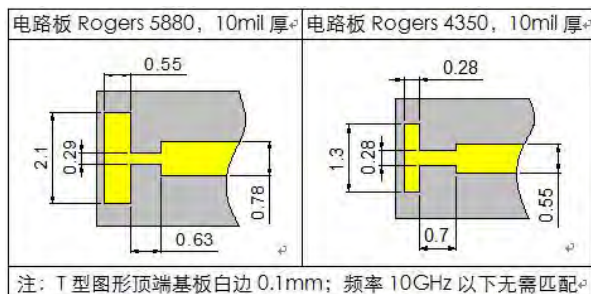
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

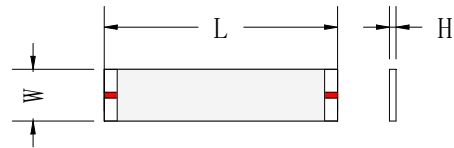
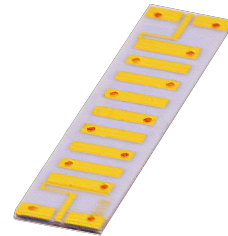


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

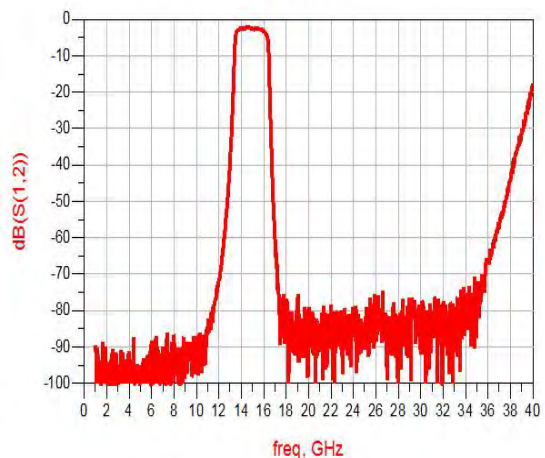
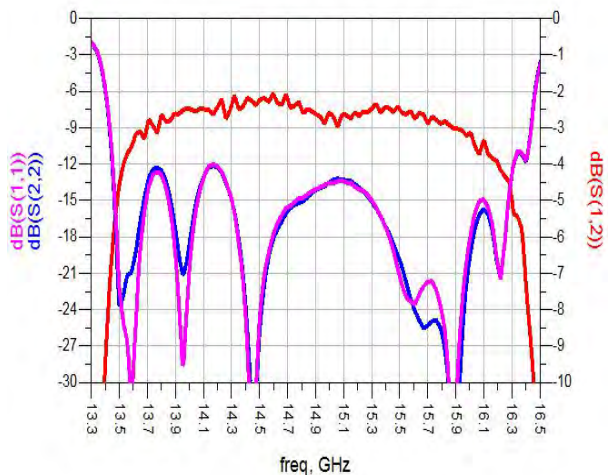


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	10.0	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块

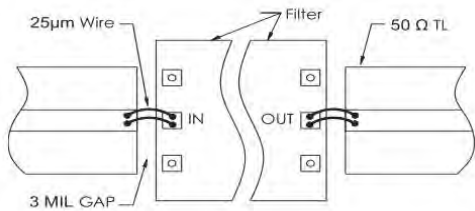
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		15.0		GHz
工作频率	13.8		16.2	GHz
中心损耗		2.0	2.5	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-12.5GHz	55	60	dBc
	@17.7-35.5GHz	55	60	dBc

环境要求

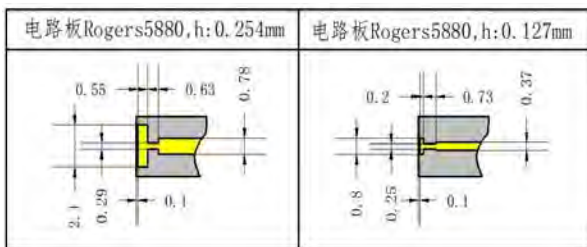
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^\circ\text{C}\sim+85^\circ\text{C}$	
储存温度	$-55^\circ\text{C}\sim+125^\circ\text{C}$	

推荐装配图

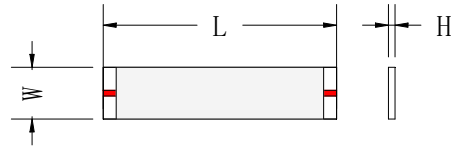
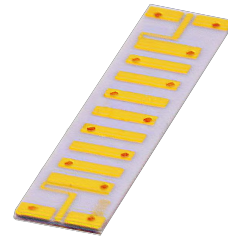


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁**0.1mm**,表面距上盖**2.75mm**,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配,T型尺寸如下:

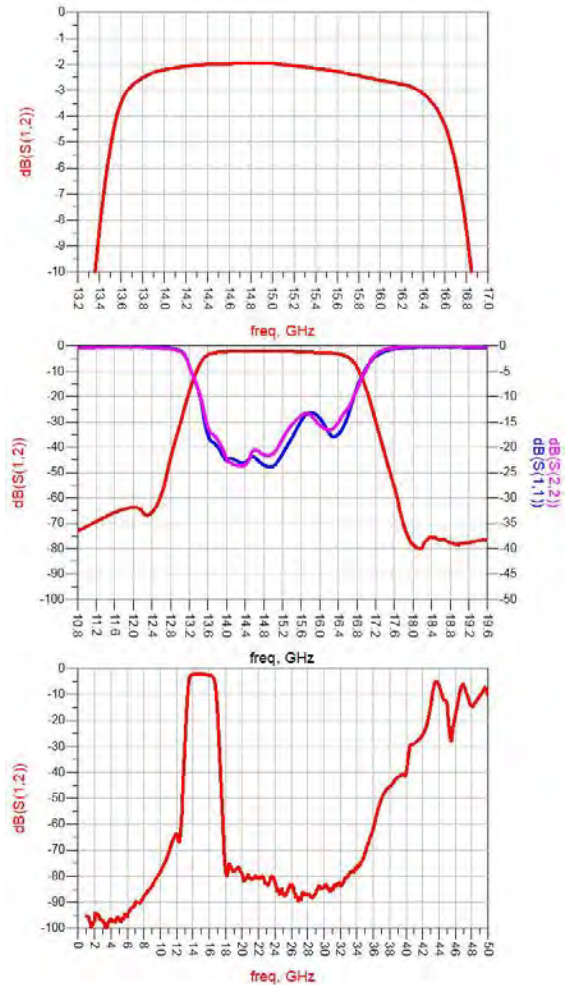


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	9.0	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



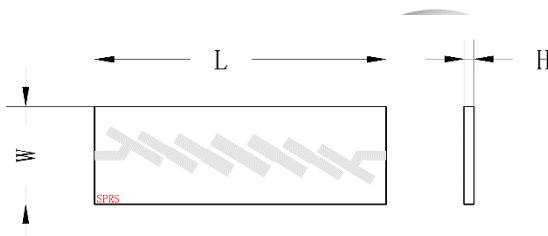
### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

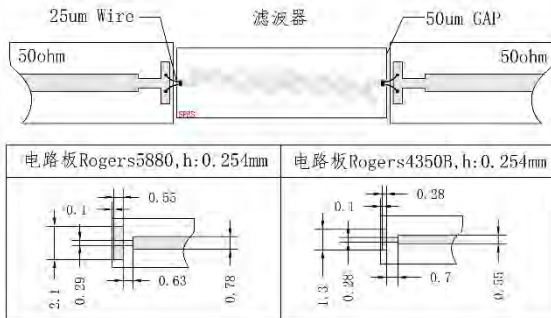
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		14.0		GHz
工作频率		/		GHz
中心损耗		6.5	7.0	dB
带内波动		/		dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-13.4GHz	38	43		dBc
带外抑制@14.6-23.0GHz	38	43		dBc
承受功率			20	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 6.0, W: 4.0, H: 0.254, 端口居中



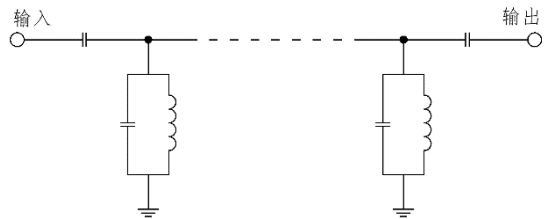
### 推荐装配图:



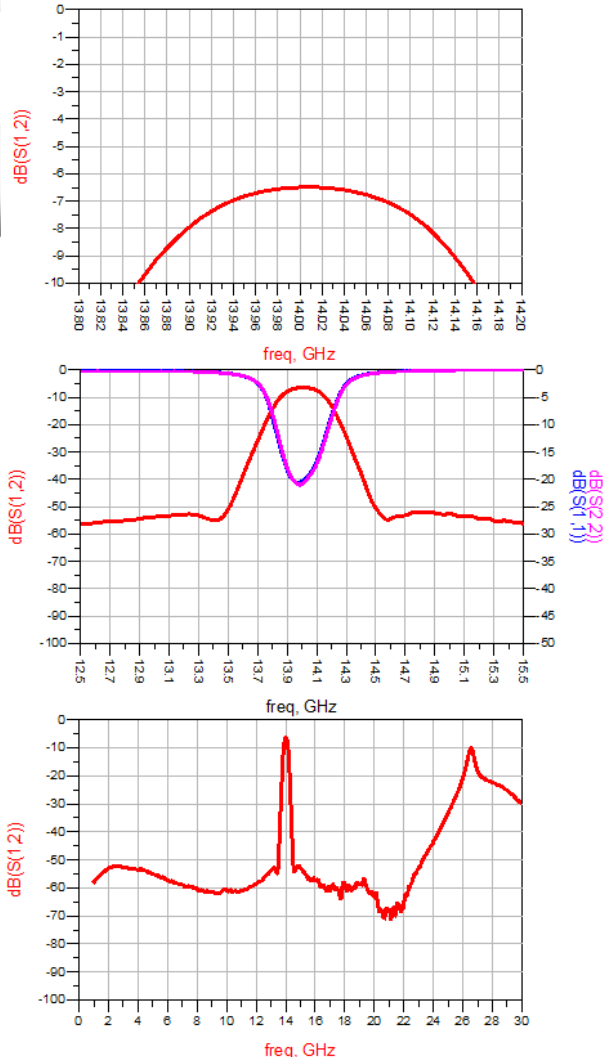
### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钎铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

### 原理图



### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

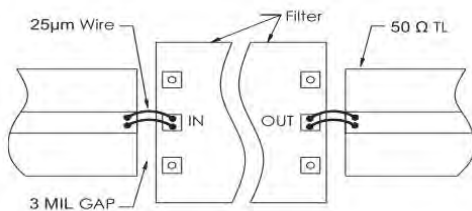
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		14.65		GHz
工作频率	14.0		15.3	GHz
中心损耗		2.5	3.0	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@DC-13.15GHz	40	45	dBc
	@16.25-39.5GHz	40	45	dBc

环境要求

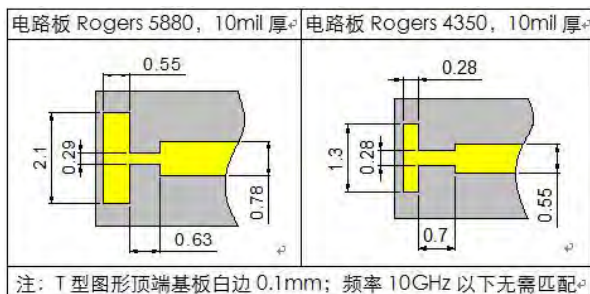
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

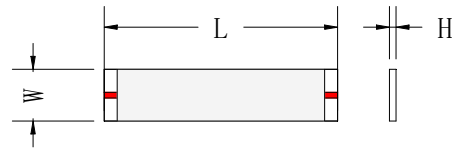
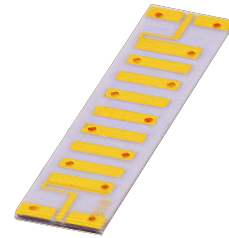


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

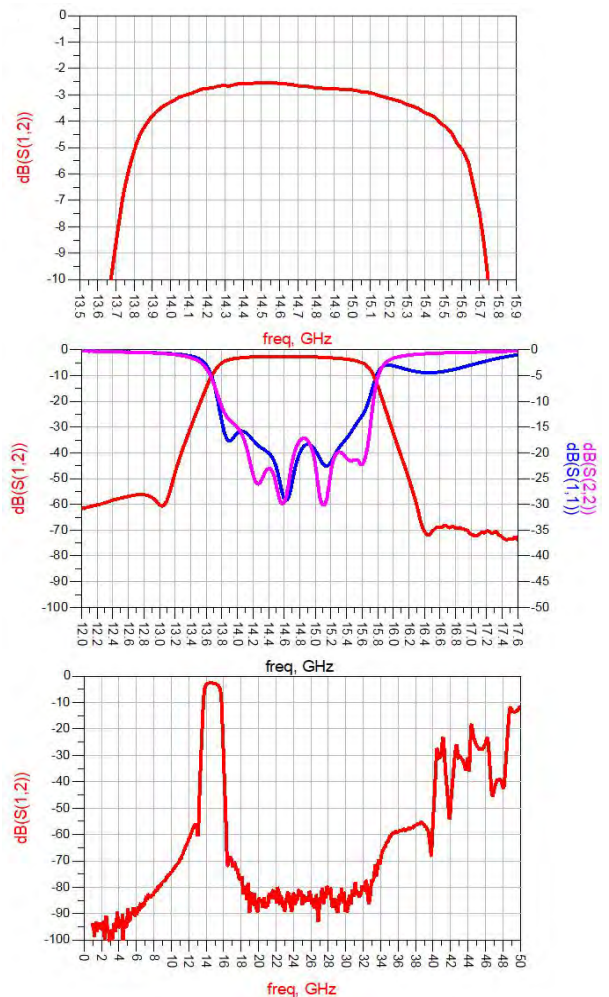


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	9.0	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

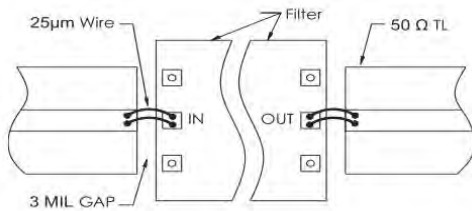
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		15.0		GHz
工作频率	14.0		16.0	GHz
中心损耗		2.2	2.7	dB
带内波动		0.9	1.1	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-13.1GHz	45	50	dBc
	@17.0-38GHz	45	50	dBc

环境要求

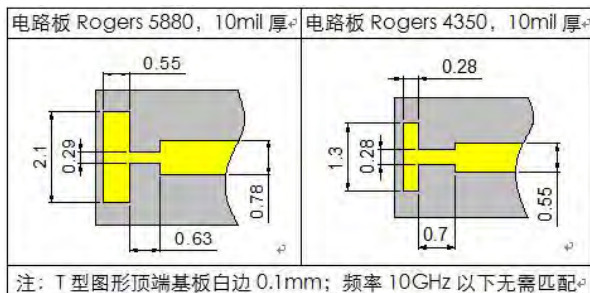
最大输入功率	30	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

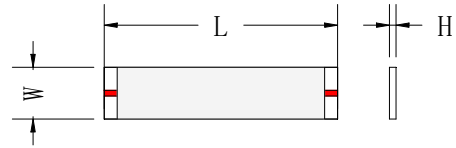
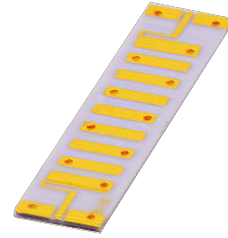


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

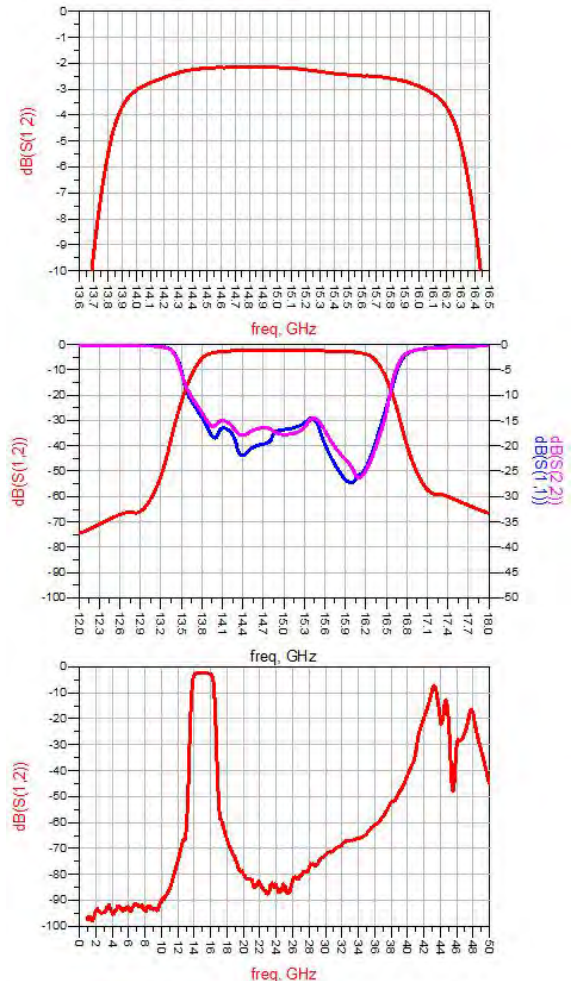


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.5	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

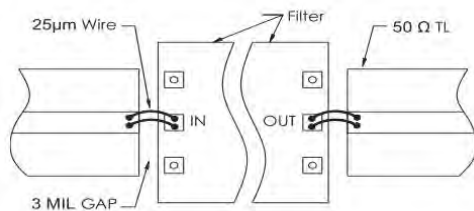
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		16.7		GHz
工作频率	14.0		19.4	GHz
中心损耗		0.9	1.4	dB
带内波动		0.6	0.8	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-10.8GHz	45	50	dBc
	@22.0-38.5GHz	45	50	dBc

环境要求

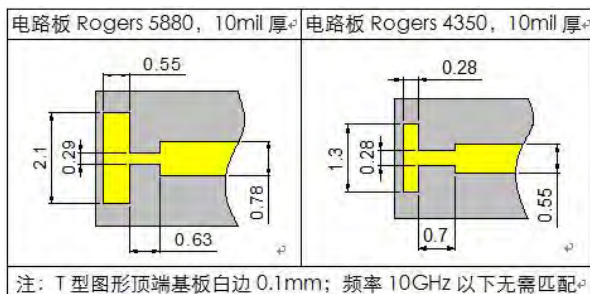
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

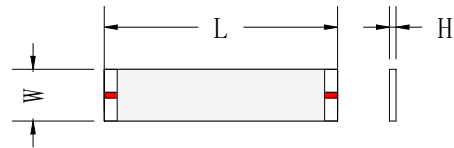
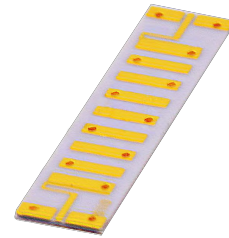


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

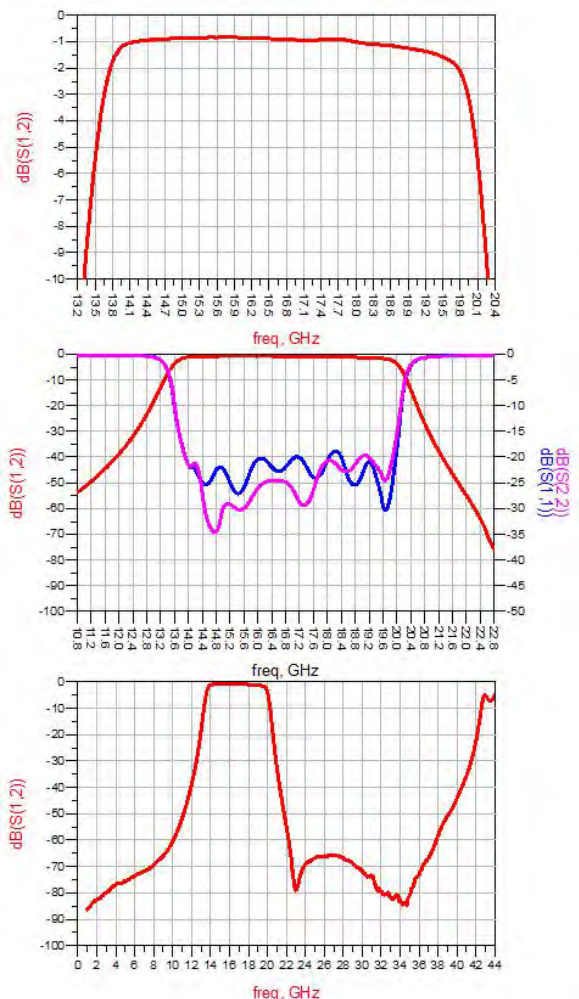


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.0	2.7	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

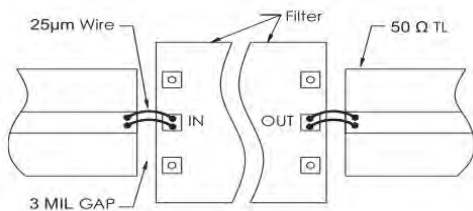
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		18.5		GHz
工作频率	14		23	GHz
中心损耗		1.9	2.4	dB
带内波动		0.9	1.0	dB
回波损耗	10	12		
带外抑制	@DC-10.7GHz	40	45	dBc
	@27.2-46GHz	40	45	dBc

### 环境要求

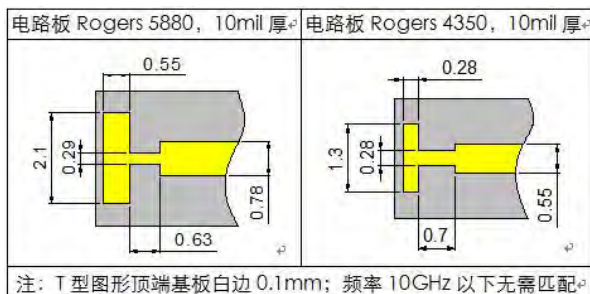
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

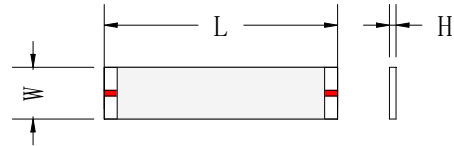
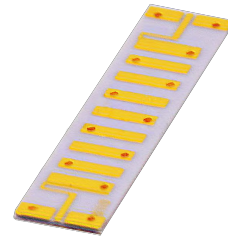


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

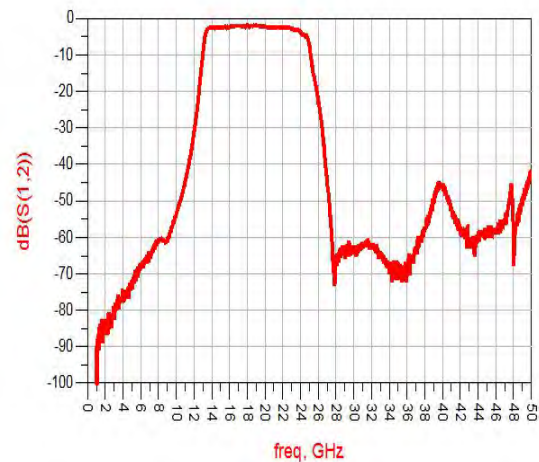


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	9.0	2.5	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

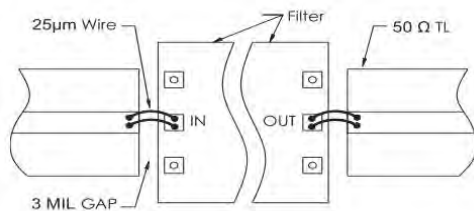
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		16.2		GHz
工作频率	14.1		18.3	GHz
中心损耗		0.8	1.3	dB
带内波动		0.6	0.8	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-10.0GHz	45	50	dBc
	@21.3-46.4GHz	45	50	dBc

环境要求

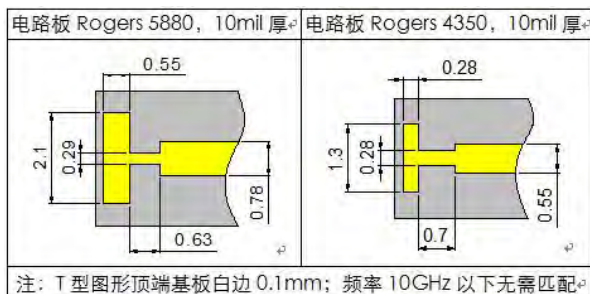
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

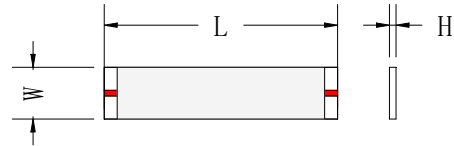
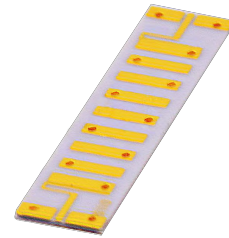


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖1.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

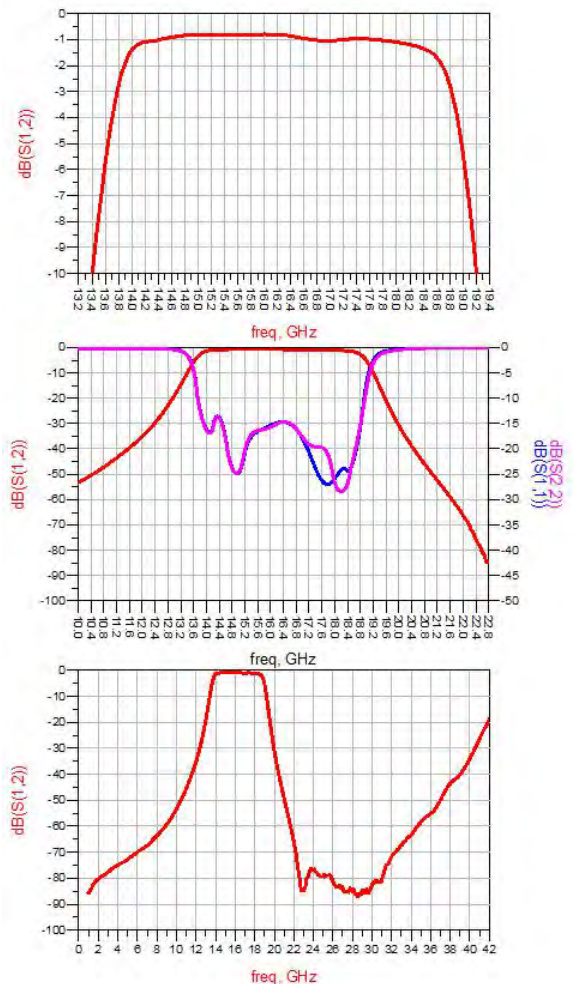


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.0	2.3	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



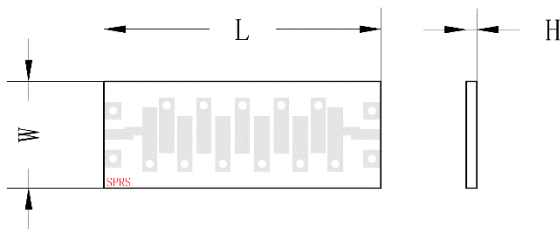
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

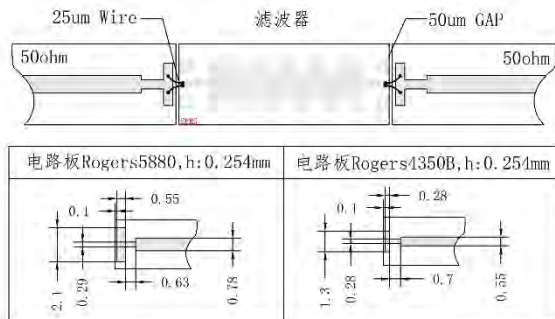
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		15.7		GHz
工作频率	14.2		17.2	GHz
中心损耗		1.8	2.3	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-12.5GHz	45	50		dBc
带外抑制@18.6-38.5GHz	45	50		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.0, W: 3.0, H: 0.254, 端口居中



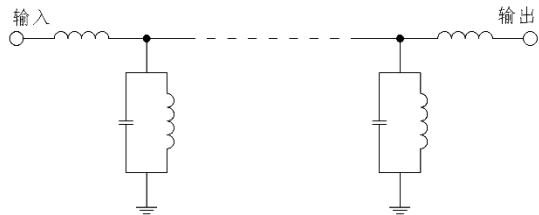
推荐装配图:



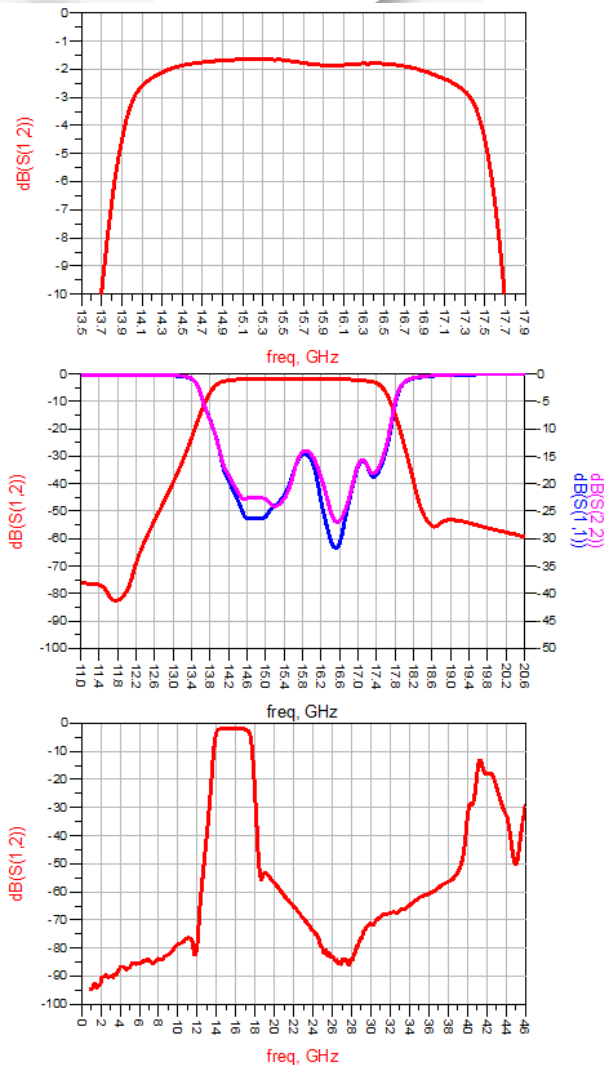
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

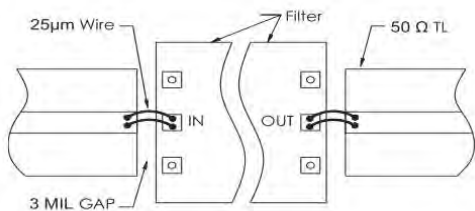
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		16.6		GHz
工作频率	14.4		18.8	GHz
中心损耗		1.5	2.0	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	10	12		
带外抑制	@8.2-11.2GHz	40	45	dBc
	@20.5-21GHz	40	45	dBc
	@DC-8.2GHz	60	65	dBc
	@21-40GHz	60	63	dBc

环境要求

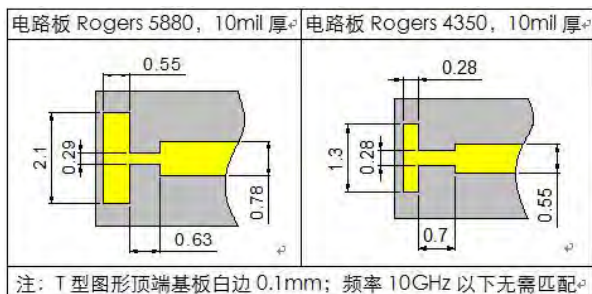
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

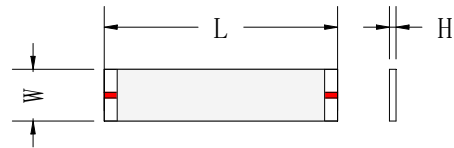
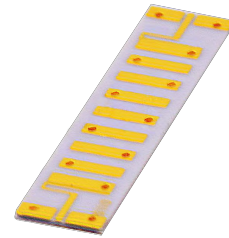


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

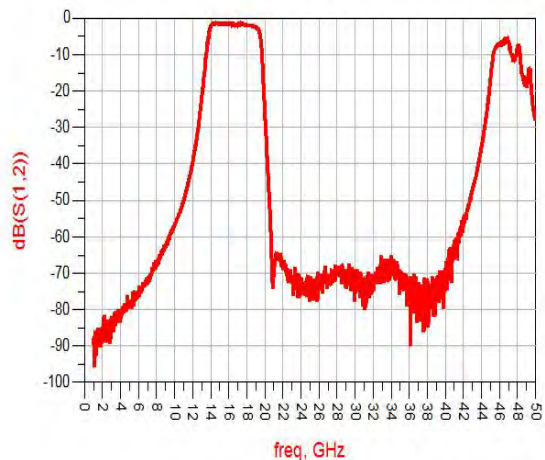
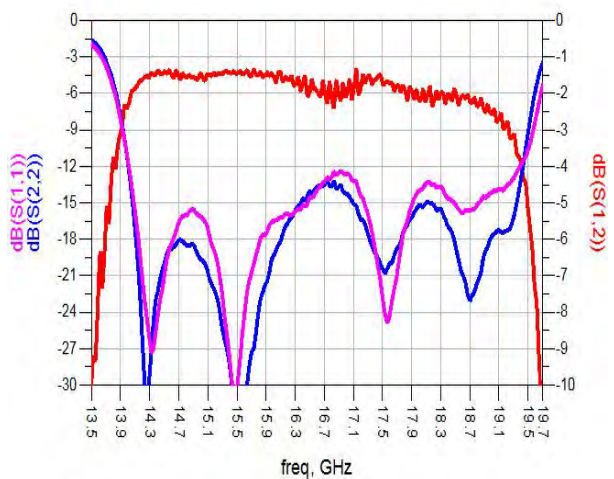


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.0	2.1	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



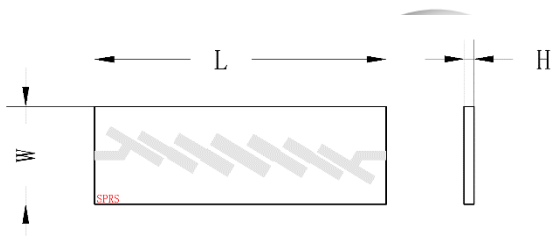
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

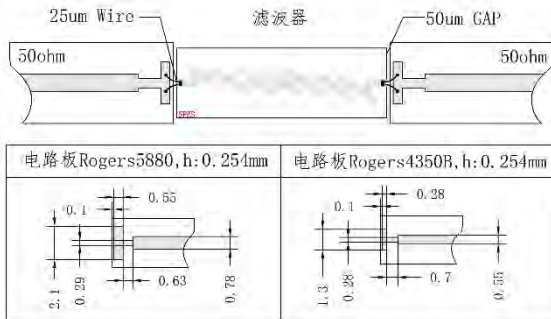
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		14.5		GHz
工作频率		/		GHz
中心损耗		6.5	7.0	dB
带内波动		/		dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-13.9GHz	38	44		dBc
带外抑制@15.1-23.5GHz	38	44		dBc
承受功率			20	dBm
工作温度	-55		+85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^{\circ}\text{C}$

外形图: L: 6.0, W: 4.0, H: 0.254, 端口居中



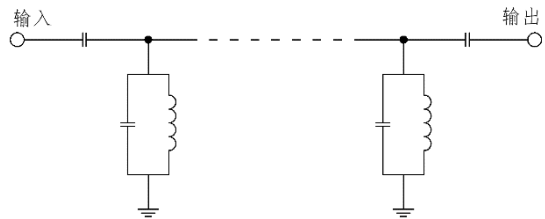
推荐装配图:



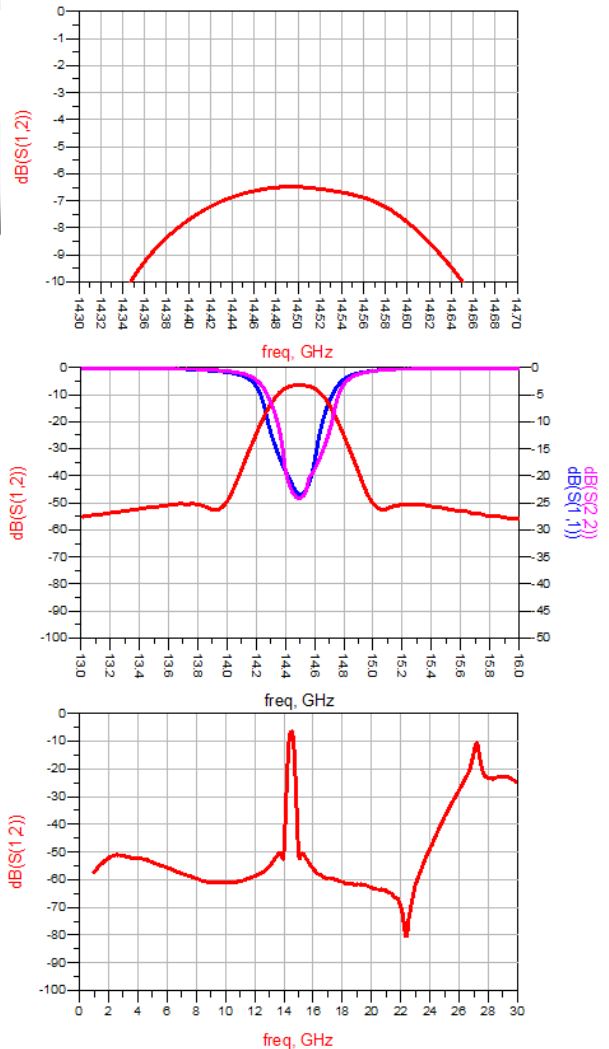
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^{\circ}\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

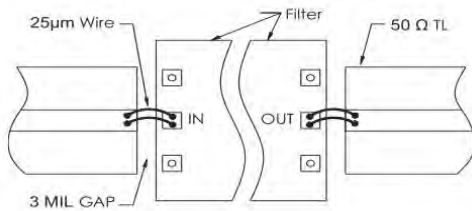
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		16.9		GHz
工作频率	14.7		19.1	GHz
中心损耗		1.3	1.8	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-12.2GHz	40	45	dBc
	@20.8-40.0GHz	40	45	dBc

环境要求

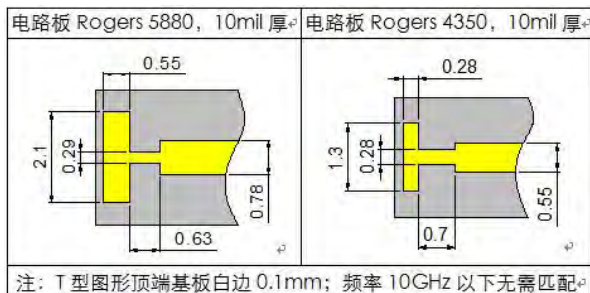
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

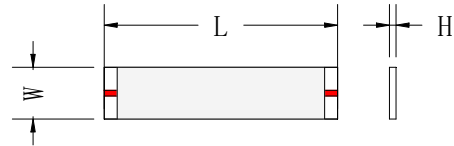
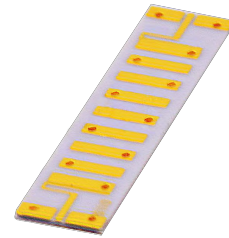


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

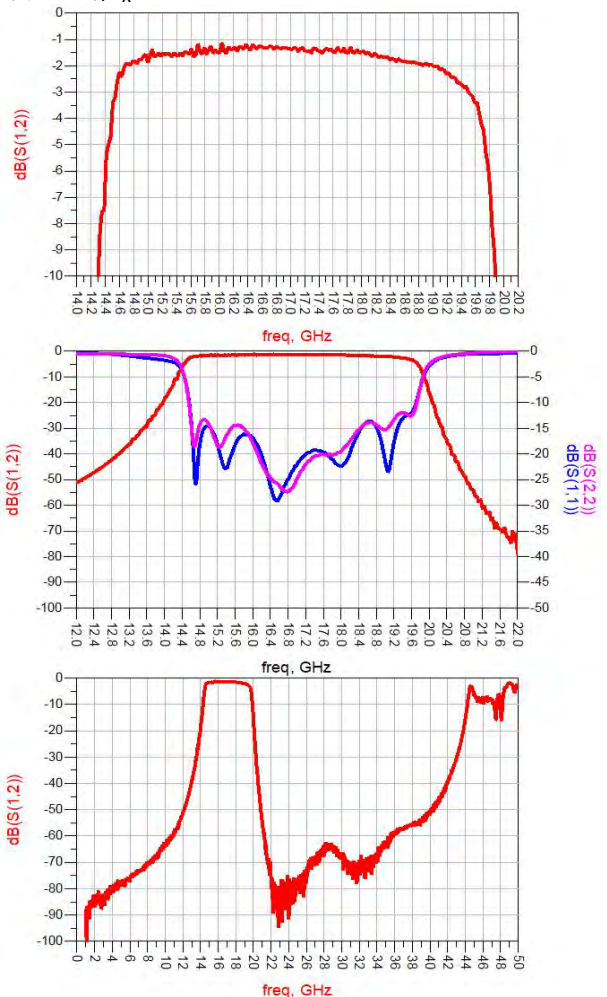


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

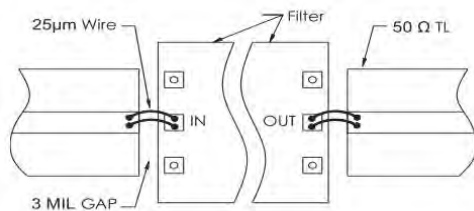
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		16.5		GHz
工作频率	14.9		18.1	GHz
中心损耗		2.0	2.5	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	14		
带外抑制	@DC-10GHz	60	65	dBc
	@10-13.2GHz	50	54	dBc
	@19.8-36GHz	52	56	dBc
	@36-40GHz	35	40	dBc

环境要求

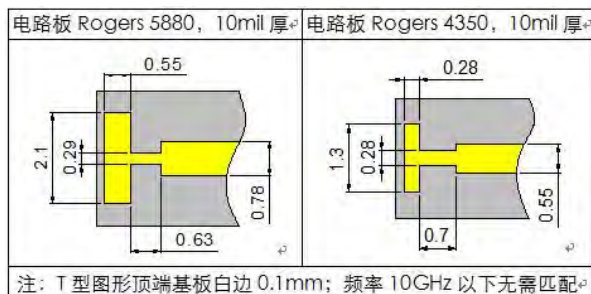
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

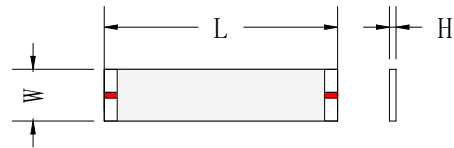
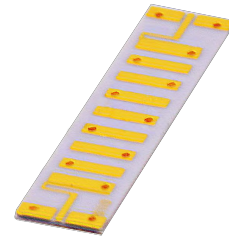


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

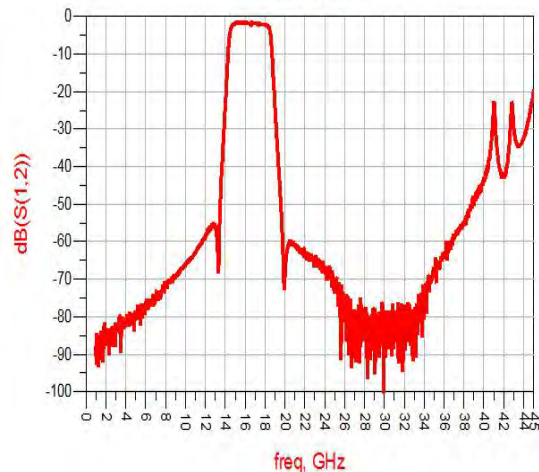
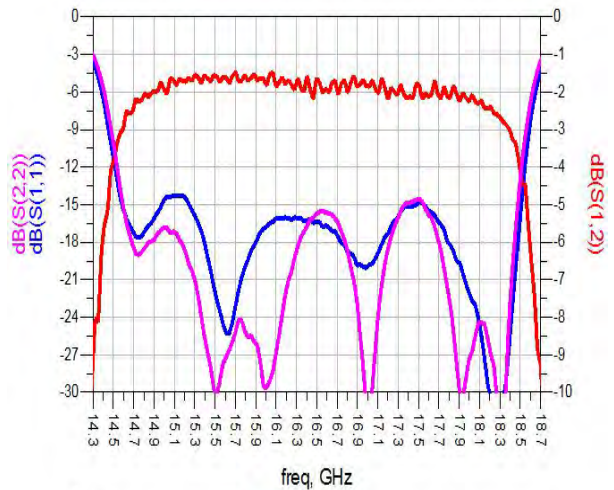


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

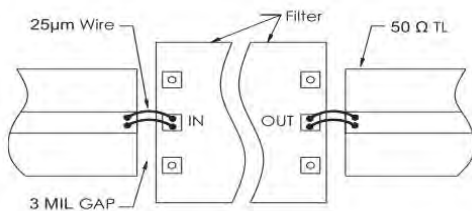
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		16.7		GHz
工作频率	14.9		18.5	GHz
中心损耗		1.4	1.8	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-13.6GHz	45	50	dBc
	@20.1-39.0GHz	45	50	dBc

### 环境要求

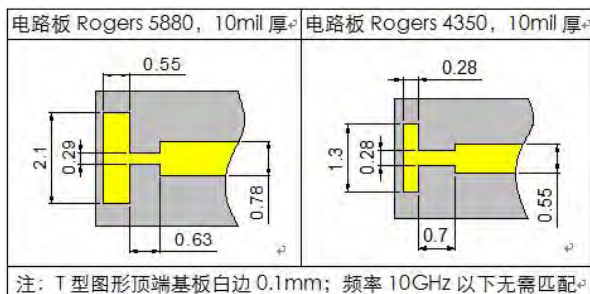
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

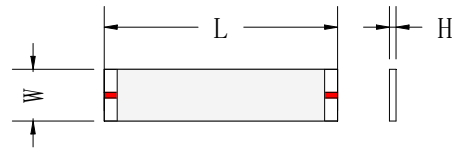
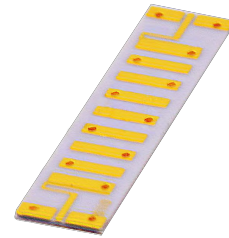


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

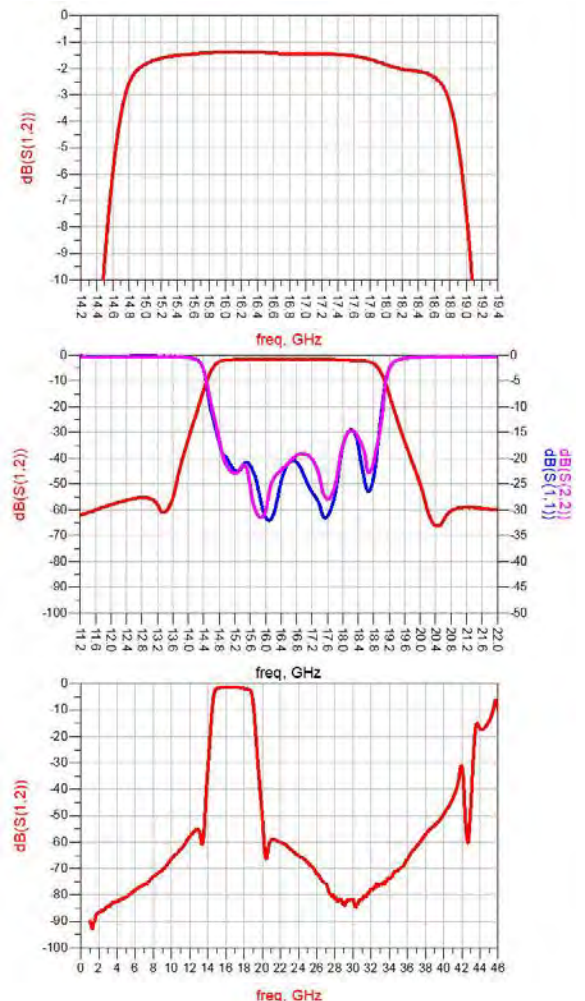


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	3.0	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

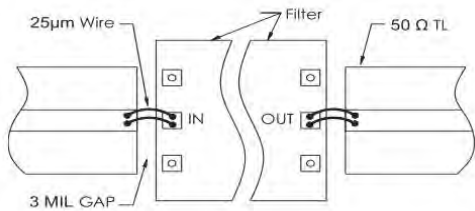
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		17.6		GHz
工作频率	14.9		20.3	GHz
中心损耗		1.4	1.9	dB
带内波动		0.9	1.1	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-12.7GHz	45	50	dBc
	@21.8-46.0GHz	45	50	dBc

环境要求

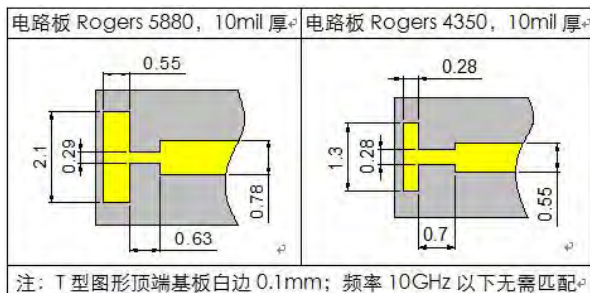
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

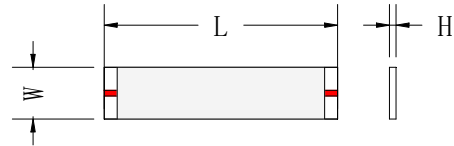
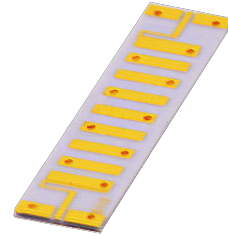


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm / °C),载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

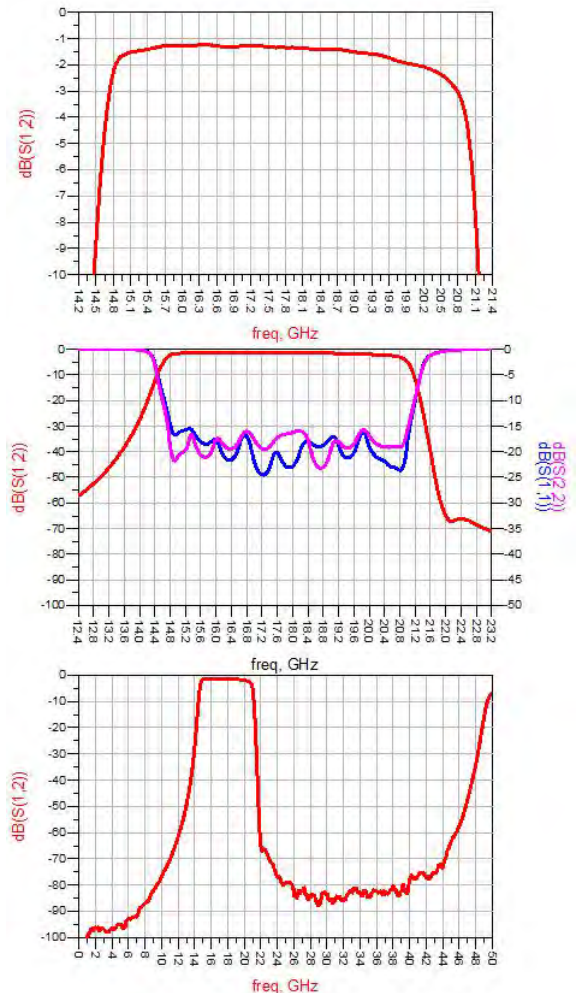


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

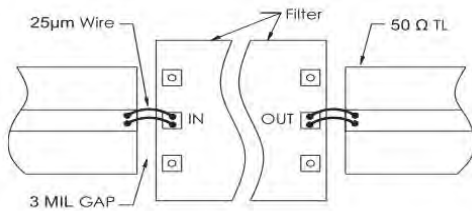
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		17.7		GHz
工作频率	14.9		20.5	GHz
中心损耗		1.6	2.0	dB
带内波动		1.1	1.5	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-12.7GHz	60	65	dBc
	@22.0-42.0GHz	60	65	dBc

环境要求

最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

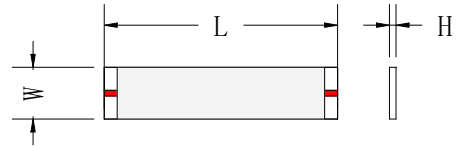
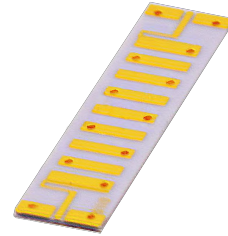


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

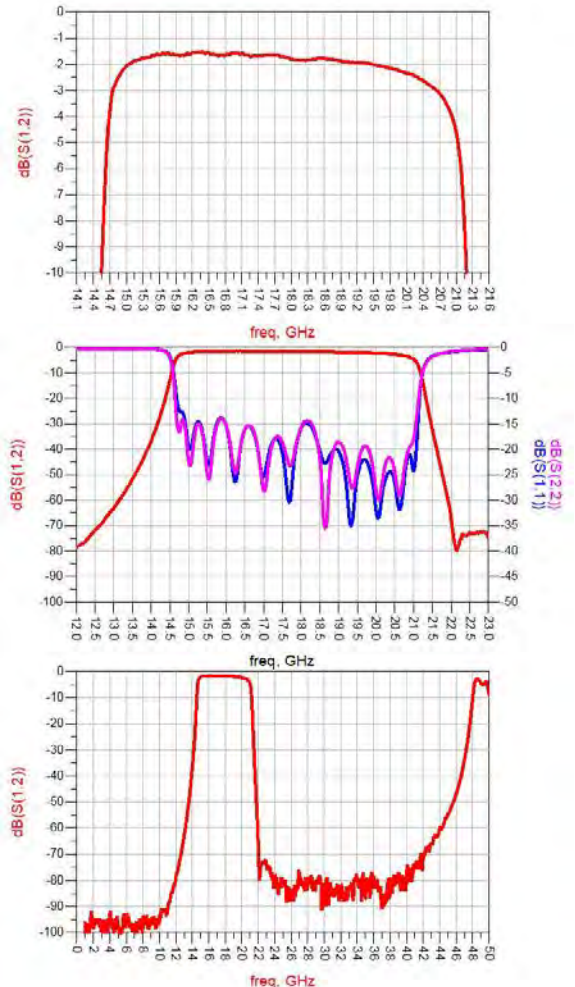
电路板Rogers5880, h:0.254mm	电路板Rogers5880, h:0.127mm

外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.5	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



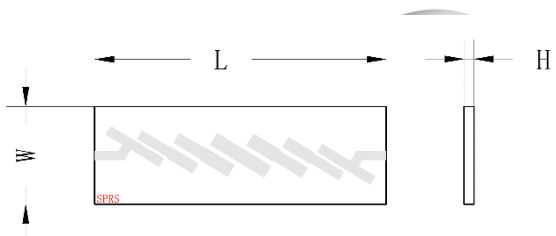
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

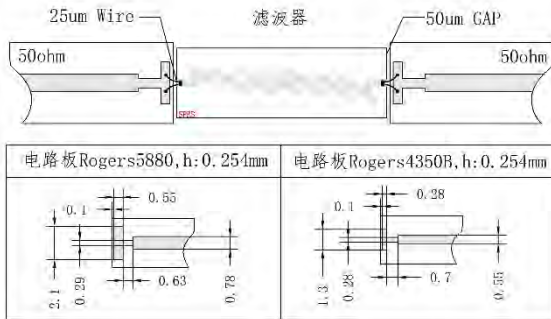
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		15.0		GHz
工作频率		/		GHz
中心损耗		6.5	7.0	dB
带内波动		/		dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-14.4GHz	38	43		dBc
带外抑制@15.6-24.0GHz	38	43		dBc
承受功率			20	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 6.0, W: 4.0, H: 0.254, 端口居中



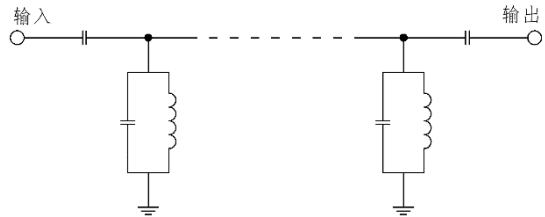
推荐装配图:



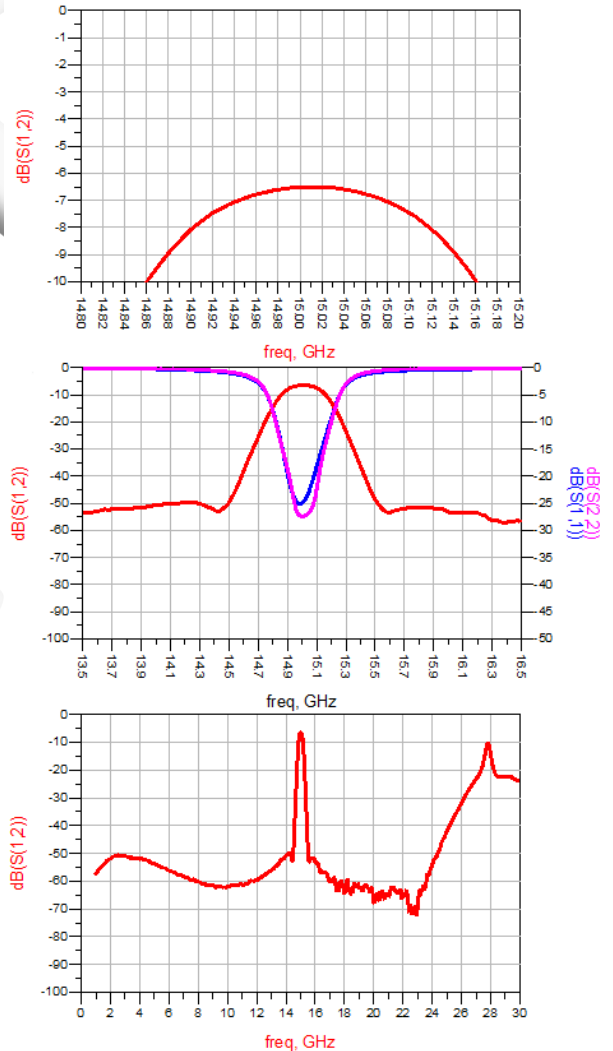
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块

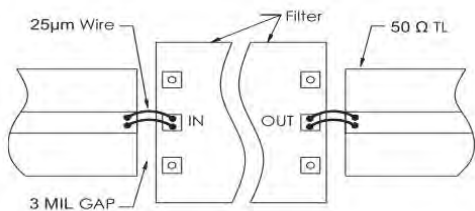
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		16.0		GHz
工作频率	15.0		17.0	GHz
中心损耗		2.4	2.9	dB
带内波动		0.9	1.2	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-14.0GHz	60	65	dBc
	@18.0-38.0GHz	52	57	dBc

环境要求

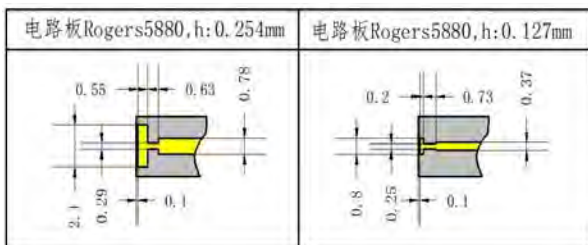
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

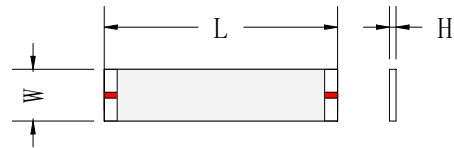
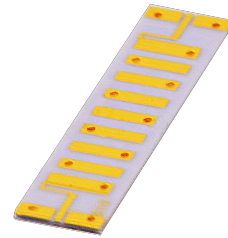


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁**0.1mm**,表面距上盖**1.75mm**,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^{\circ}\text{C}$ ),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配,T型尺寸如下:

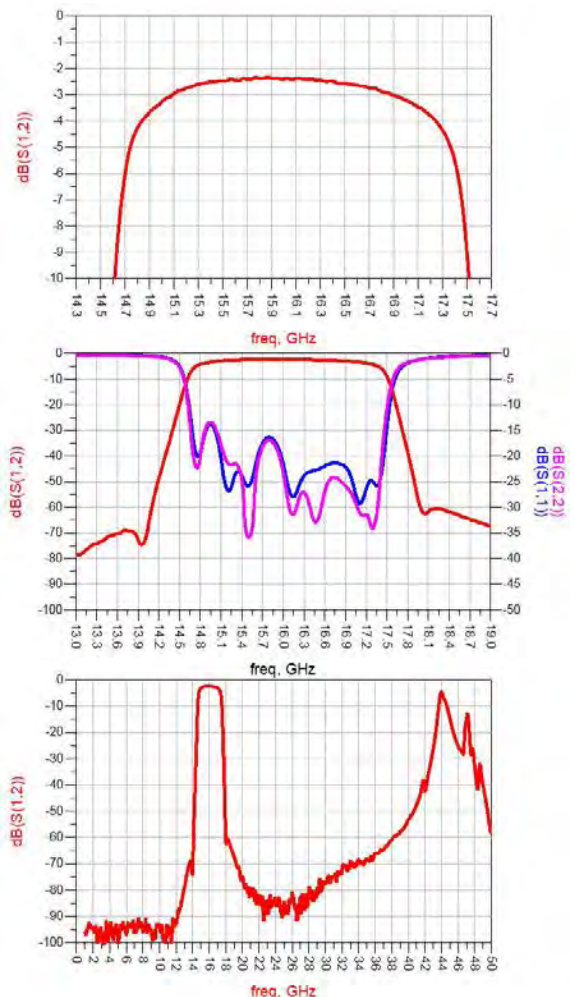


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.5	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

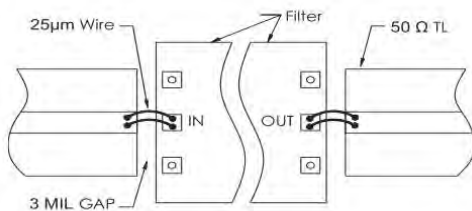
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		16.0		GHz
工作频率	15.0		17.0	GHz
中心损耗		1.6	2.1	dB
带内波动		0.5	0.8	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-13.4GHz	50	55	dBc
	@18.6-39.0GHz	50	55	dBc

环境要求

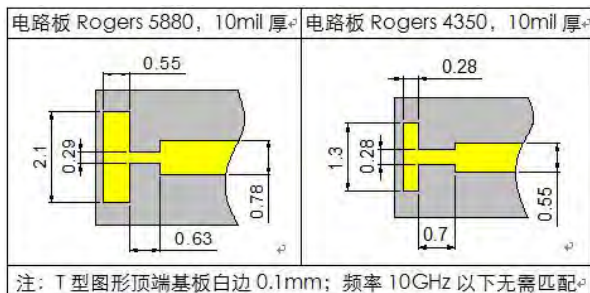
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

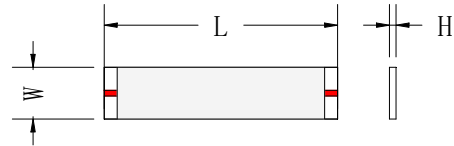
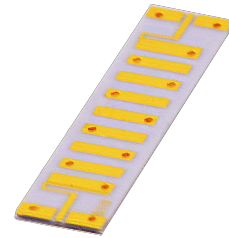


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

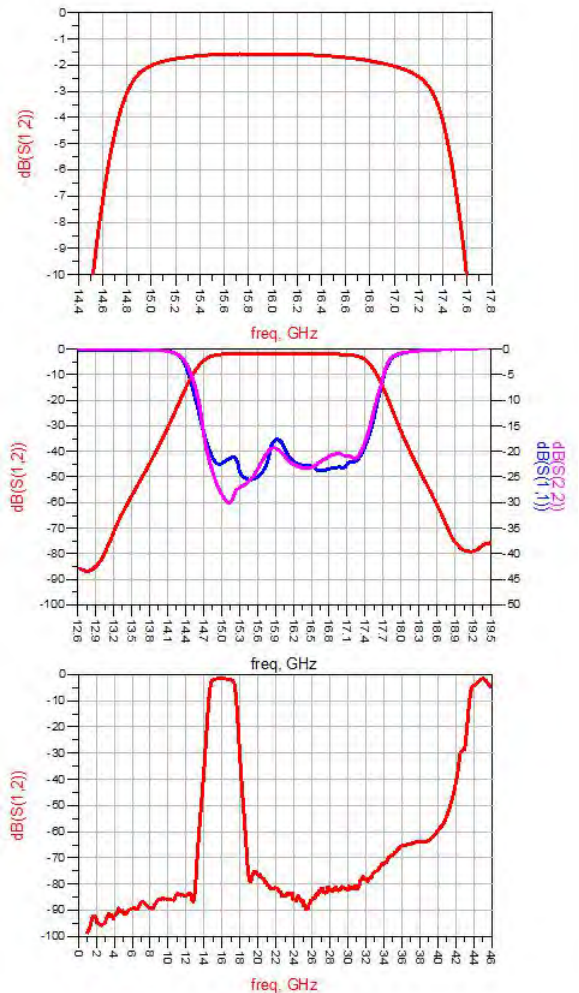


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



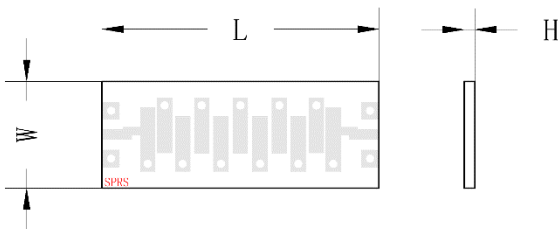
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

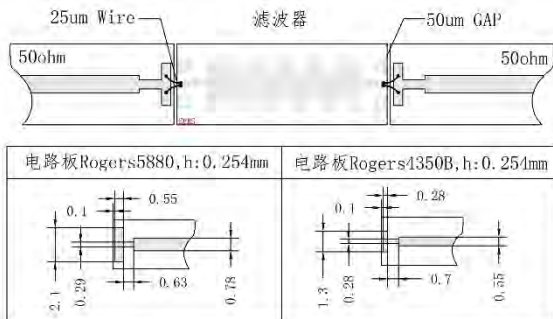
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		15.8		GHz
工作频率	15.2		16.4	GHz
中心损耗		3.0	3.5	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-14.2GHz	50	55		dBc
带外抑制@17.8-32.0GHz	70	75		dBc
承受功率			27	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 10.0, W: 3.0, H: 0.254, 端口居中



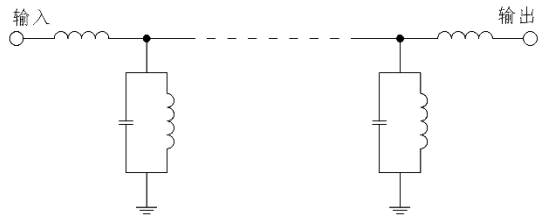
推荐装配图:



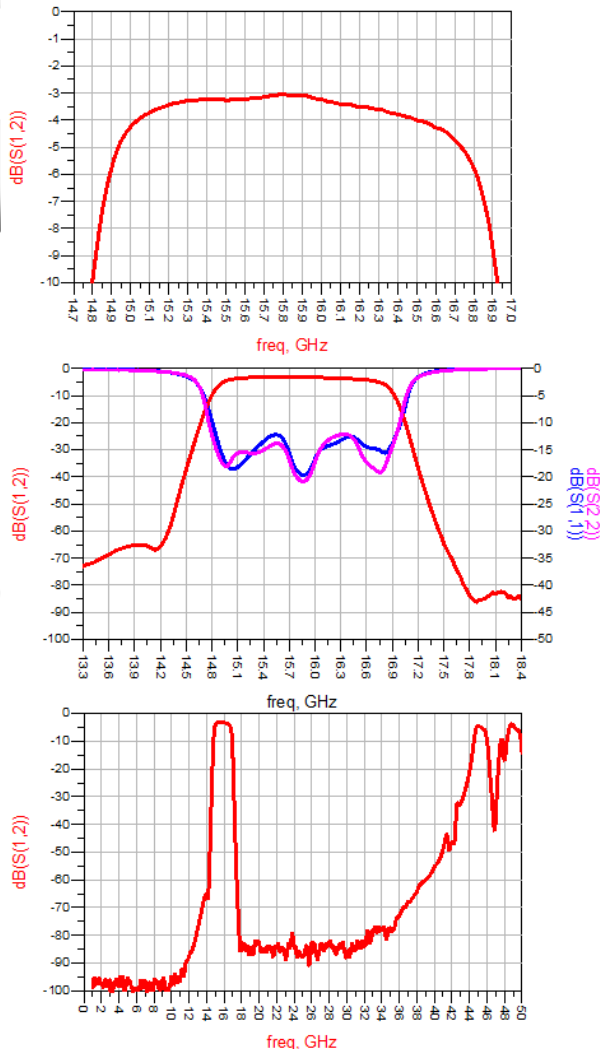
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

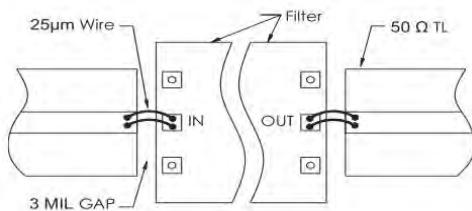
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		16.5		GHz
工作频率	15.2		17.8	GHz
中心损耗		1.5	2.0	dB
带内波动		0.6	0.8	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-13.9GHz	40	45	dBc
	@19.1-38.0GHz	40	45	dBc

### 环境要求

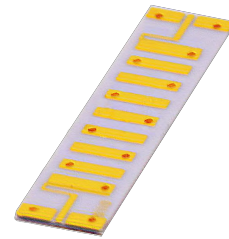
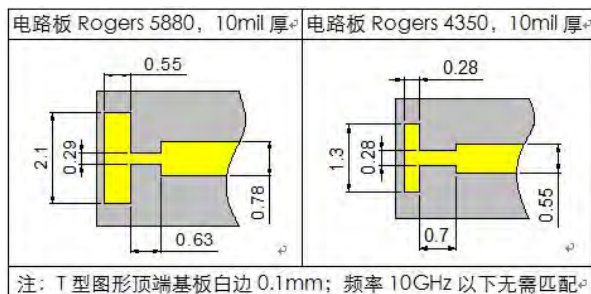
最大输入功率	30	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

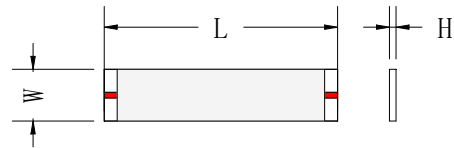


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm；
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配，T型尺寸如下：

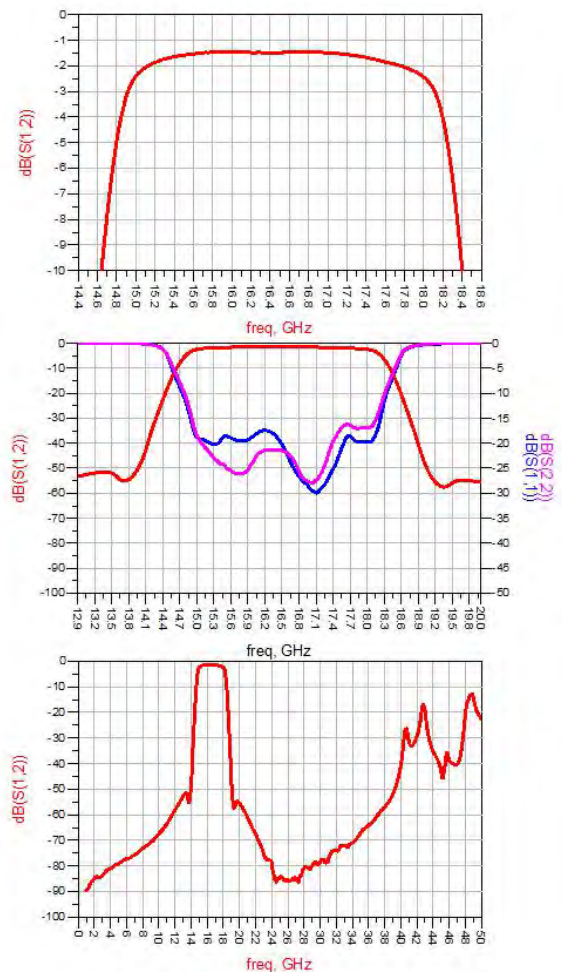


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.5	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块

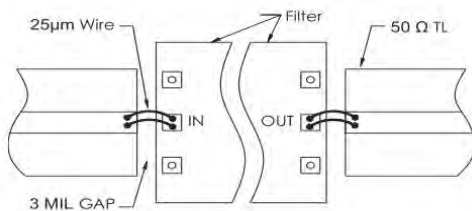
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		16.5		GHz
工作频率	15.3		17.7	GHz
中心损耗		2.4	2.8	dB
带内波动		0.9	1.2	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-13.8GHz	60	65	dBc
	@19.0-39.0GHz	60	65	dBc

环境要求

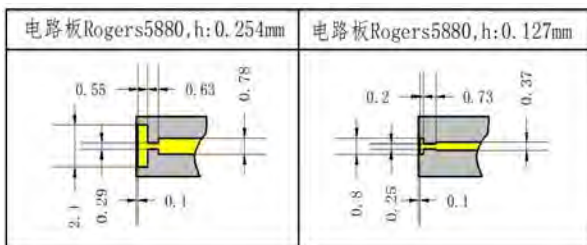
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

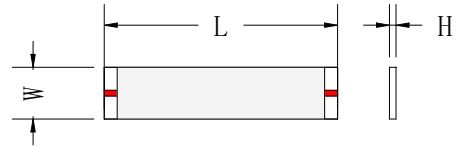
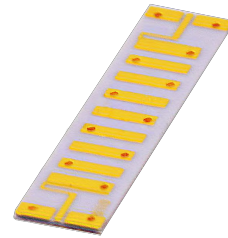


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁**0.1mm**,表面距上盖**1.75mm**,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^{\circ}\text{C}$ ),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配,T型尺寸如下:

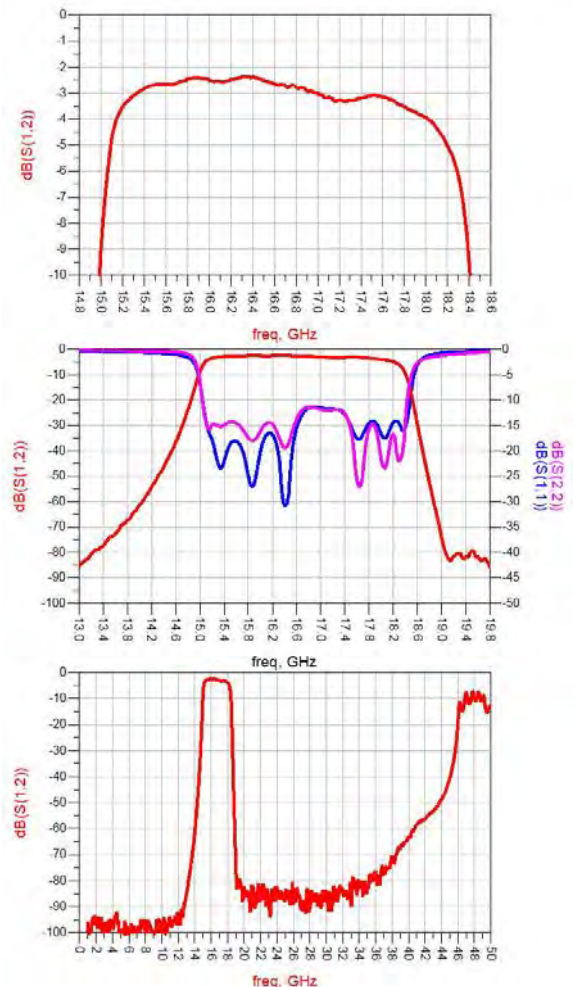


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.5	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

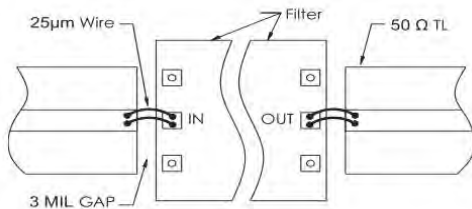
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		17		GHz
工作频率	15.4		18.6	GHz
中心损耗		1.5	2.0	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	10	12		
带外抑制	@9.0-12.5GHz	40	45	dBc
	@20.2-20.8GHz	40	45	dBc
	@DC-9.0GHz	60	63	dBc
	@20.8-38GHz	60	63	dBc

环境要求

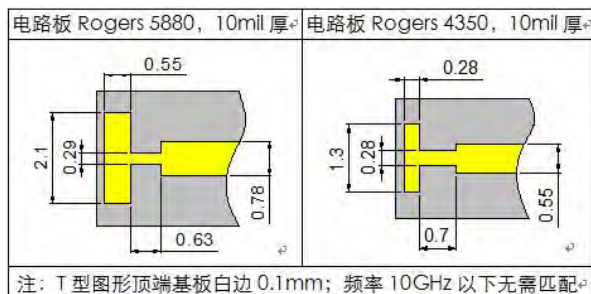
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

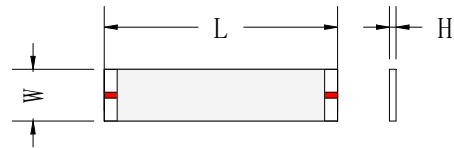
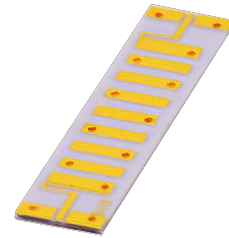


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

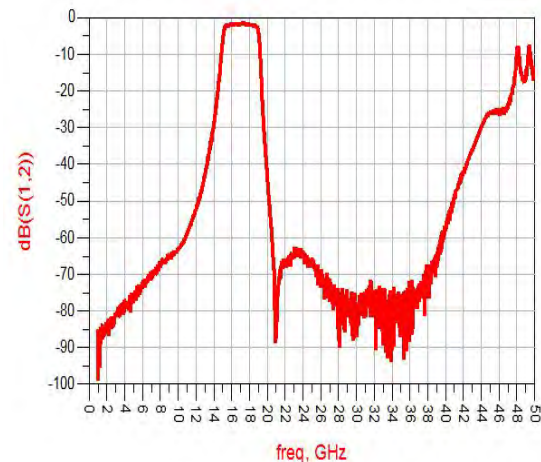
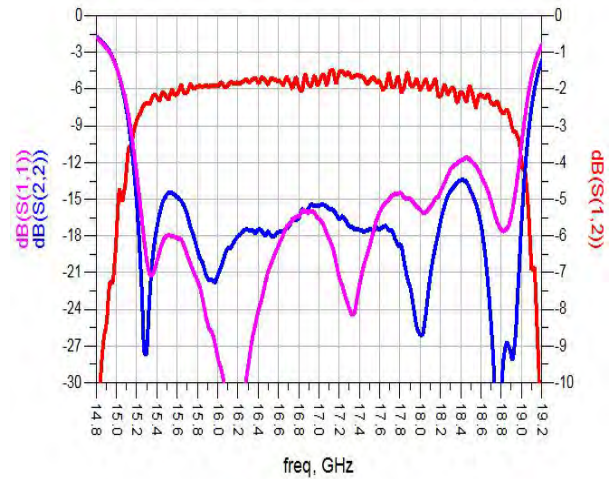


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

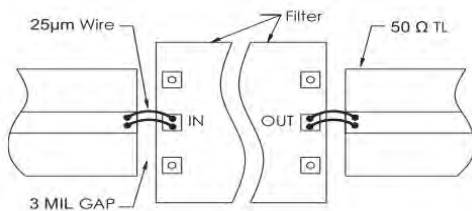
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		16.2		GHz
工作频率	15.5		16.9	GHz
中心损耗		1.7	2.2	dB
带内波动		0.5	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-14.1GHz	50	55	dBc
	@18.2-40GHz	50	55	dBc

环境要求

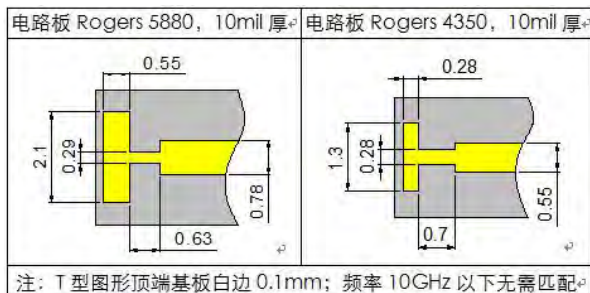
最大输入功率	30	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

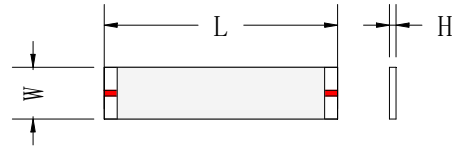
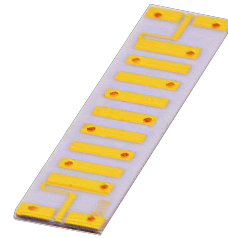


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

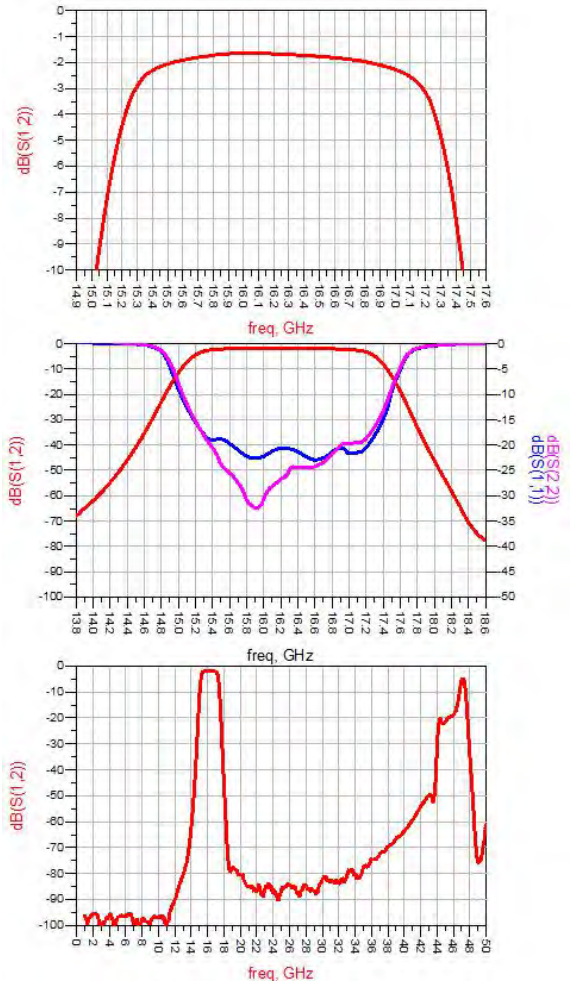


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



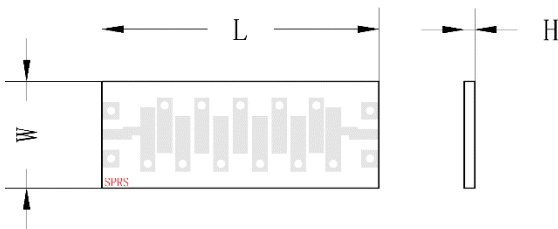
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

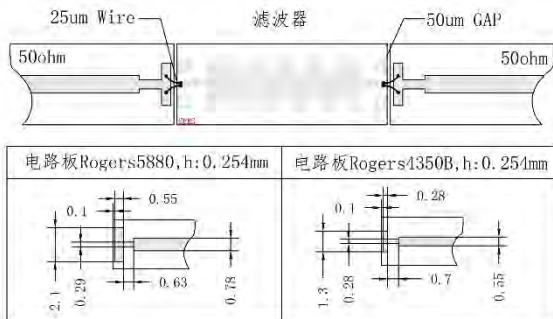
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		16.5		GHz
工作频率	15.5		17.5	GHz
中心损耗		2.0	2.5	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-13.3GHz	70	75		dBc
带外抑制@19.2-37.0GHz	70	75		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 8.5, W: 2.5, H: 0.254, 端口居中



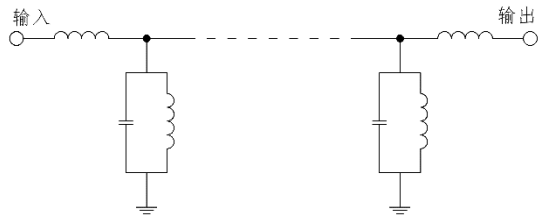
推荐装配图:



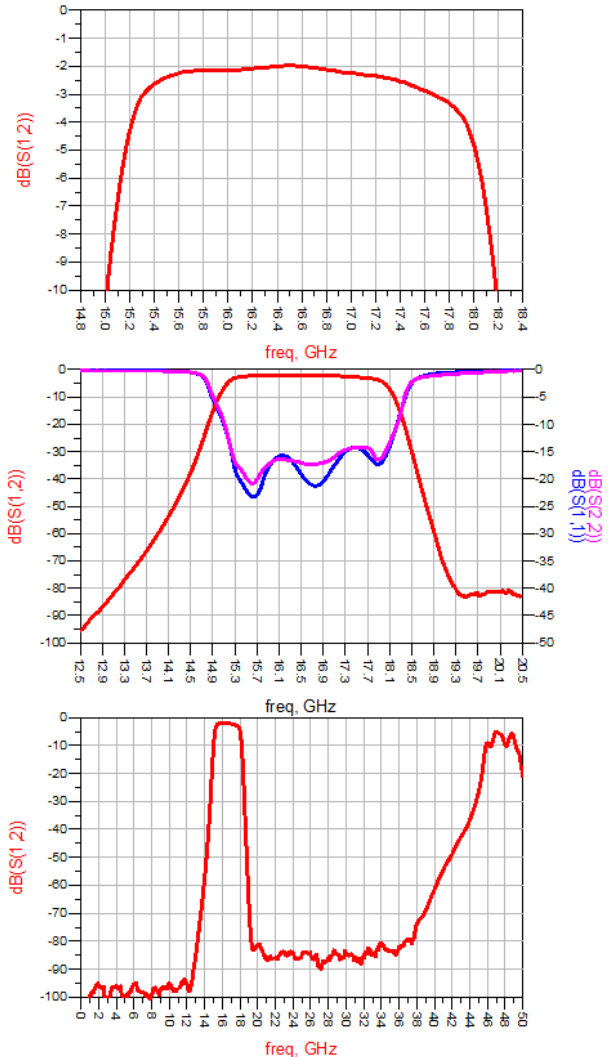
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

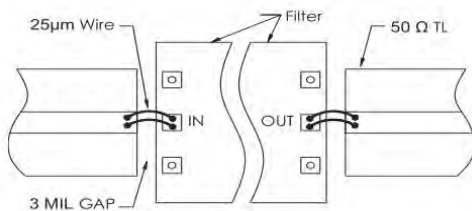
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		18.6		GHz
工作频率	15.6		21.6	GHz
中心损耗		1.3	1.7	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-13.2GHz	40	45	dBc
	@23.2-44.0GHz	40	45	dBc

环境要求

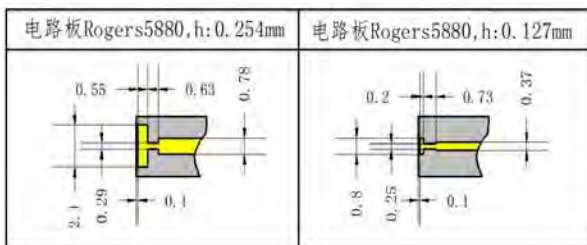
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

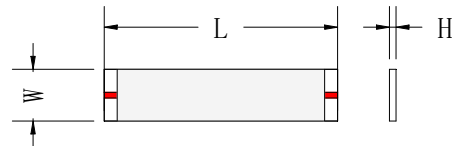
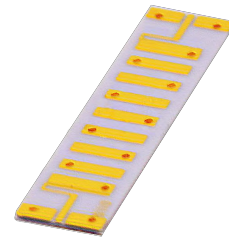


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

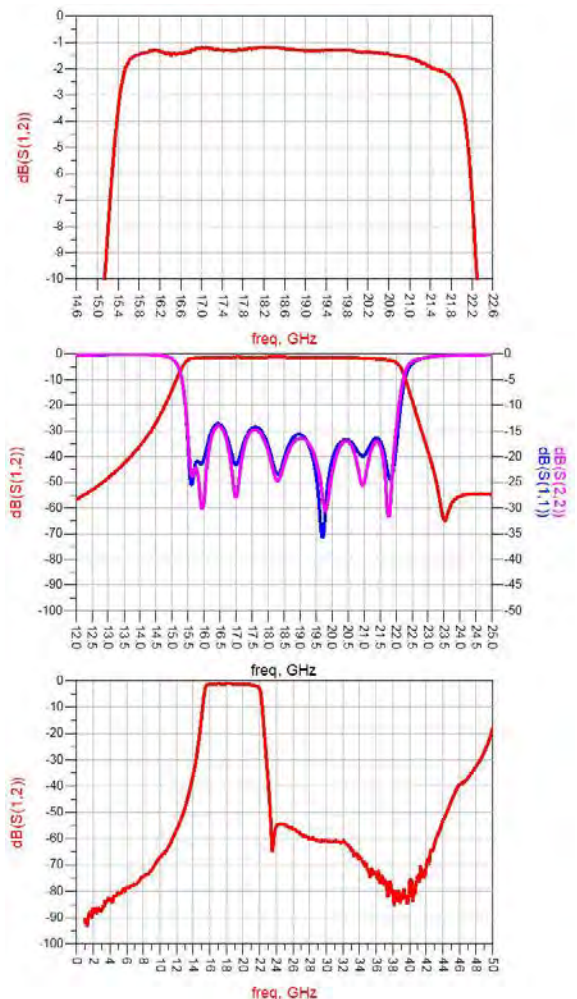


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



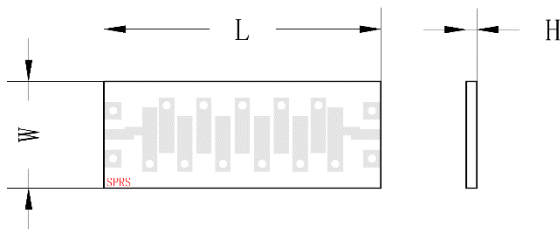
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

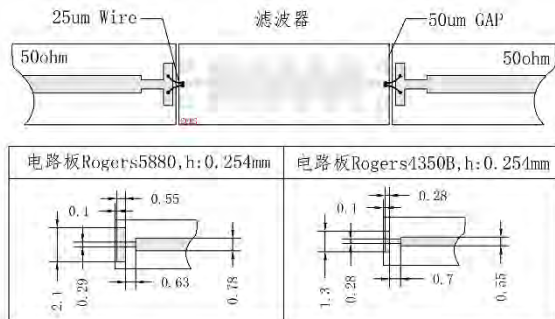
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		18.7		GHz
工作频率	15.7		21.7	GHz
中心损耗		1.2	1.7	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-12.5GHz	40	45		dBc
带外抑制@23.5-43.0GHz	40	45		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.0, W: 2.5, H: 0.254, 端口居中



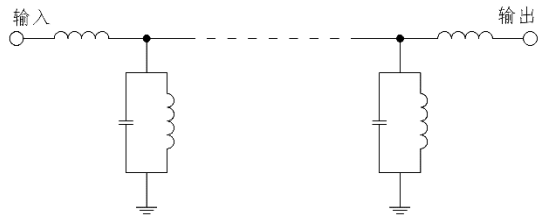
推荐装配图:



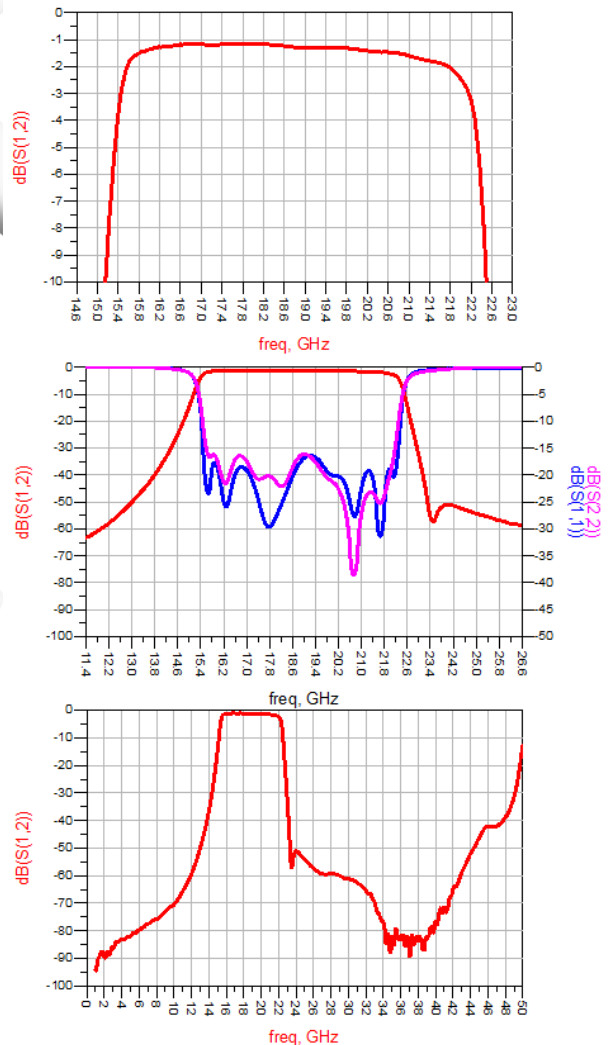
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

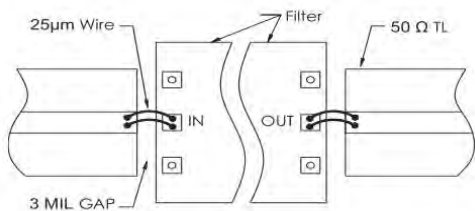
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		16.85		GHz
工作频率	15.8		17.9	GHz
中心损耗		1.9	2.4	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@13.5-14.5GHz	40	45	dBc
	@18.8-19.2GHz	40	45	dBc
	@DC-13.5GHz	60	65	dBc
	@19.2-37GHz	60	65	dBc

环境要求

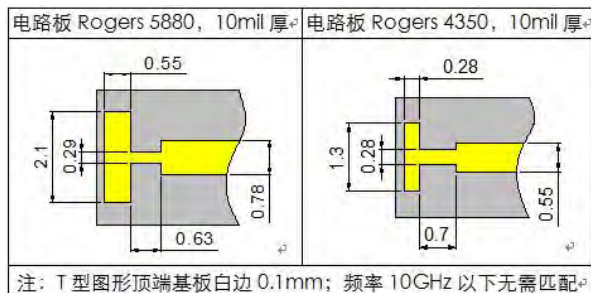
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^\circ\text{C}\sim+85^\circ\text{C}$	
储存温度	$-55^\circ\text{C}\sim+125^\circ\text{C}$	

推荐装配图

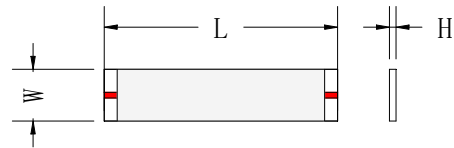
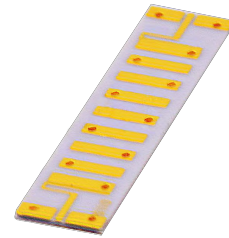


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

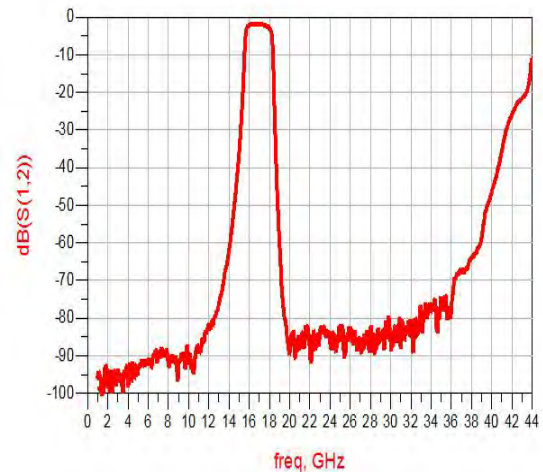
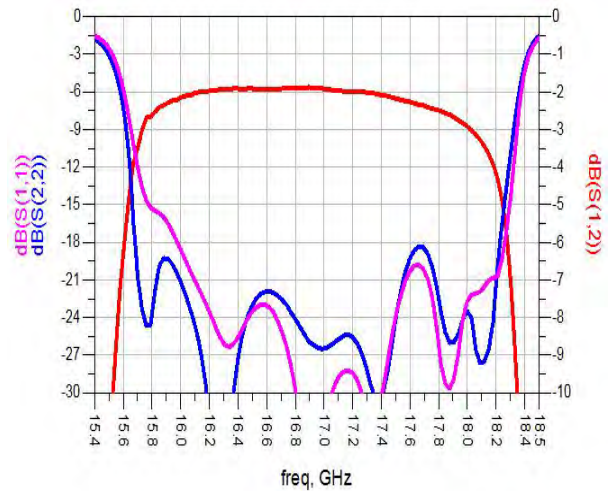


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	10.0	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

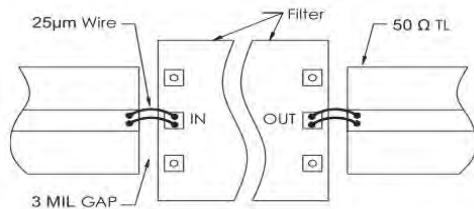
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		16.95		GHz
工作频率	15.9		18.0	GHz
中心损耗		2.0	2.5	dB
带内波动		0.7	0.8	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-14.1GHz	55	60	dBc
	@19.7-38GHz	55	60	dBc

环境要求

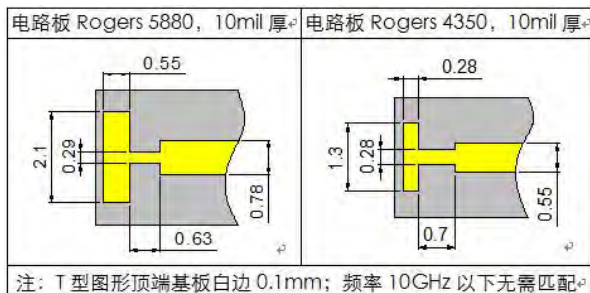
最大输入功率	30	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

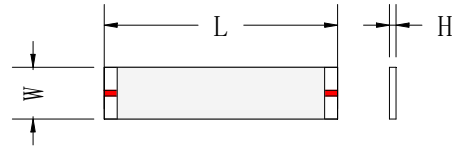
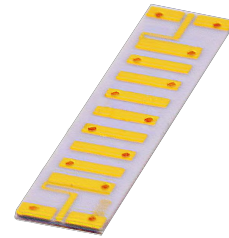


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

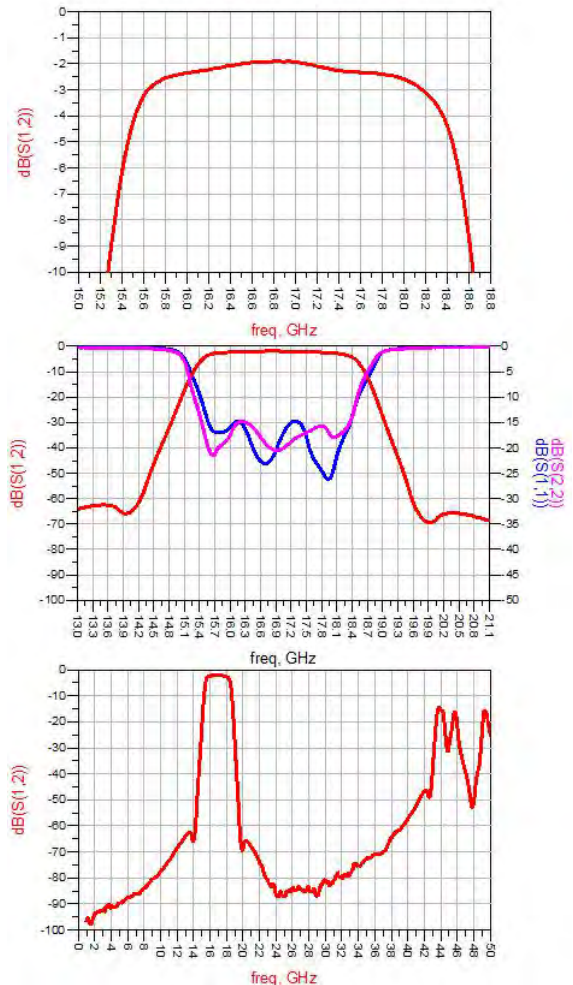


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

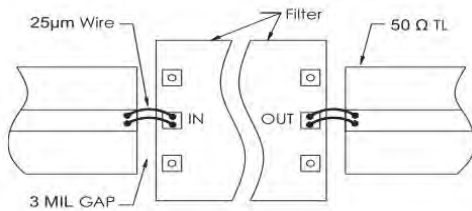
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		17.05		GHz
工作频率	15.9		18.2	GHz
中心损耗		1.5	2.0	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-14.8GHz	45	50	dBc
	@19.6-39.0GHz	47	52	dBc

环境要求

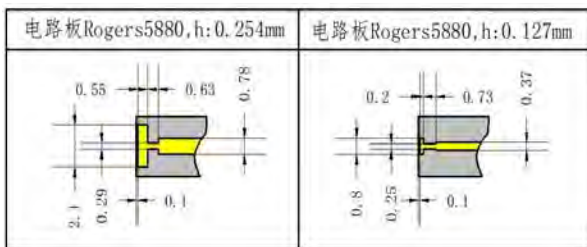
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

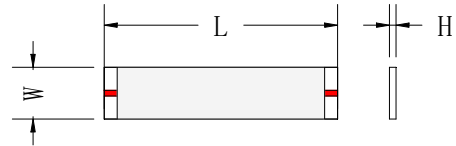
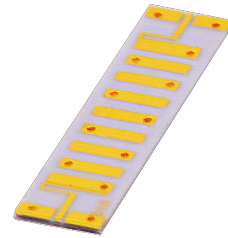


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

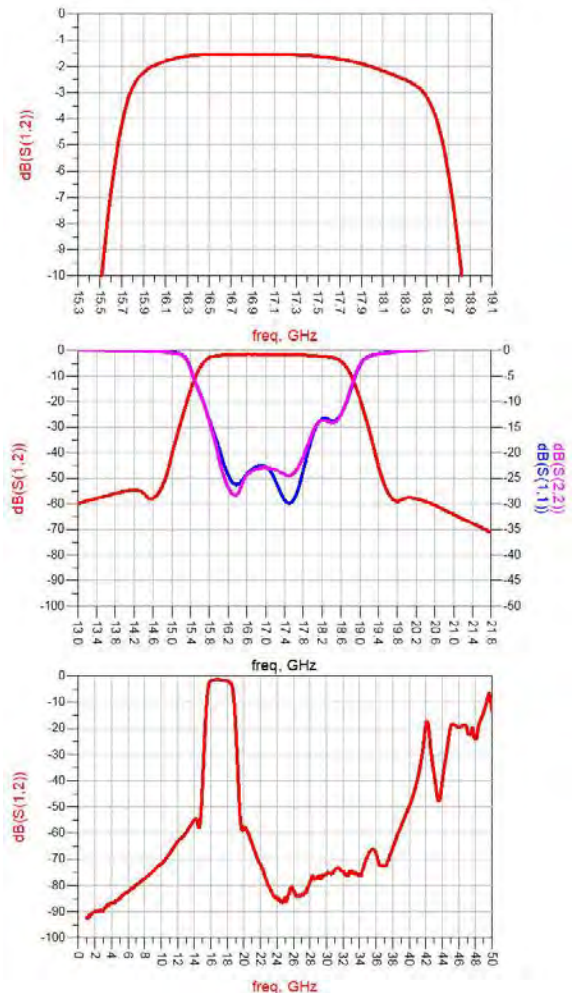


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



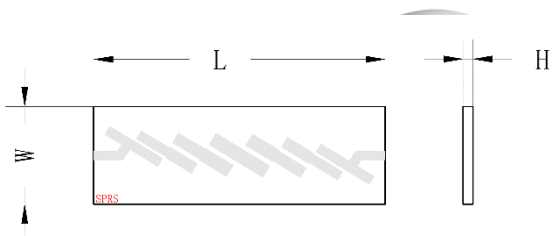
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

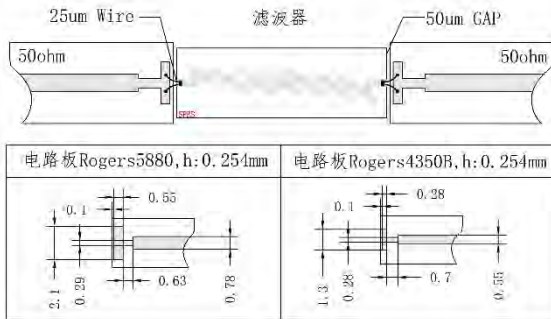
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		16.0		GHz
工作频率		/		GHz
中心损耗		6.6	7.1	dB
带内波动		/		dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-15.4GHz	38	43		dBc
带外抑制@16.6-25.0GHz	38	43		dBc
承受功率			20	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 6.0, W: 4.0, H: 0.254, 端口居中



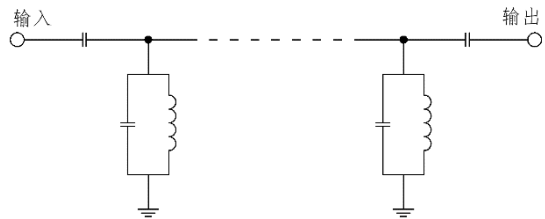
推荐装配图:



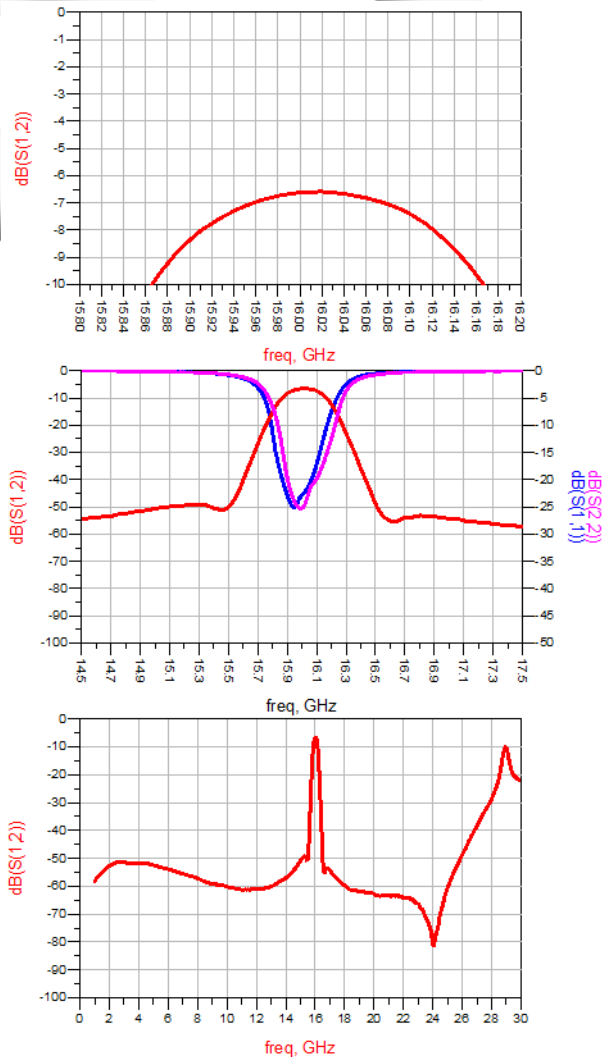
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



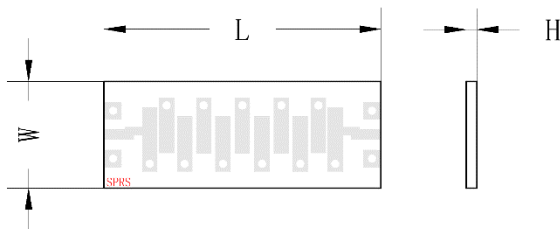
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

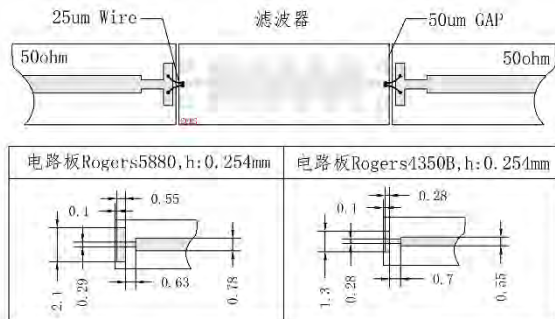
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		19.2		GHz
工作频率	16.0		22.4	GHz
中心损耗		0.9	1.4	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-12.5GHz	45	50		dBc
带外抑制@24.2-48.0GHz	45	50		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 8.0, W: 2.5, H: 0.254, 端口居中



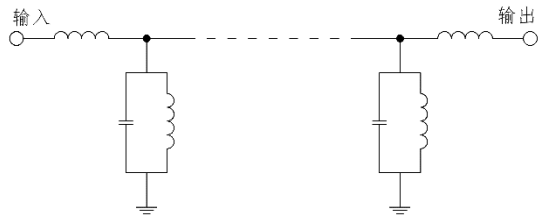
推荐装配图:



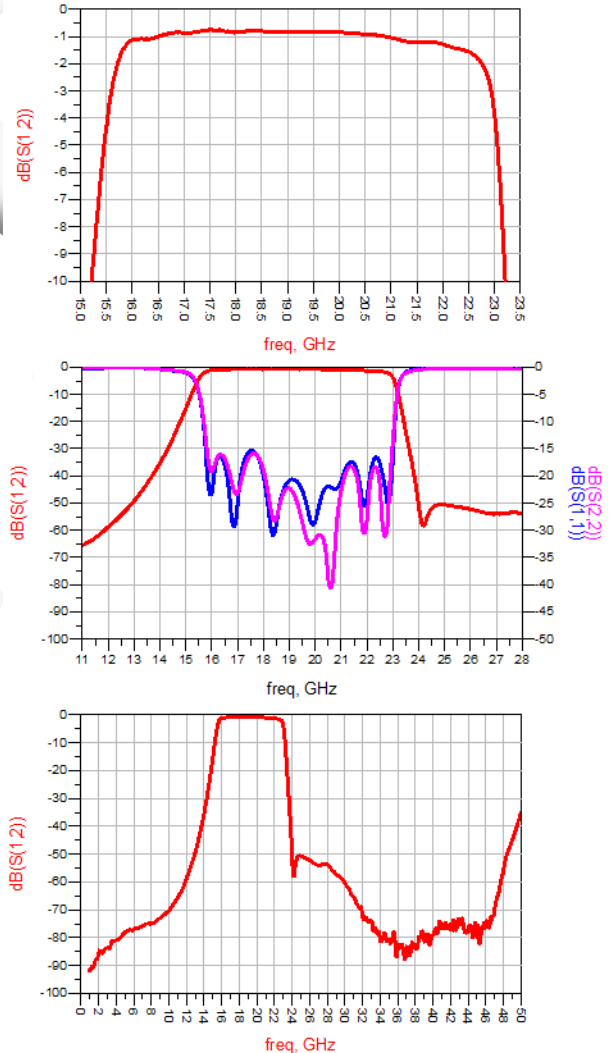
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

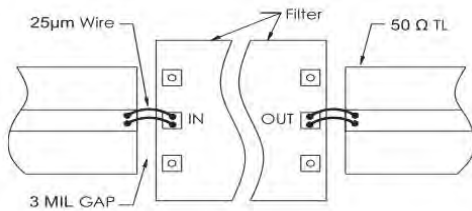
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		17.0		GHz
工作频率	16.1		17.9	GHz
中心损耗		2.7	3.2	dB
带内波动		0.9	1.4	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-15.1GHz	45	50	dBc
	@19.0-41.0GHz	45	50	dBc

环境要求

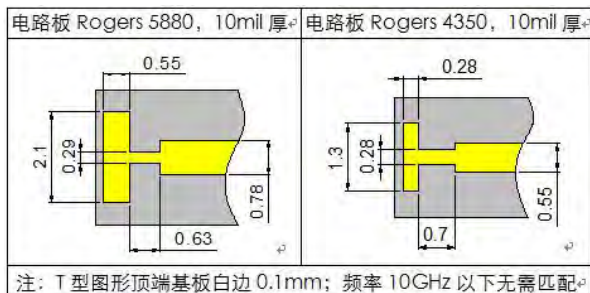
最大输入功率	30	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

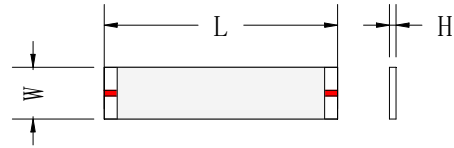
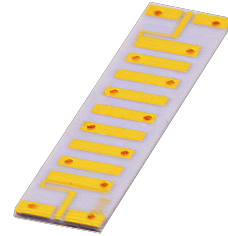


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

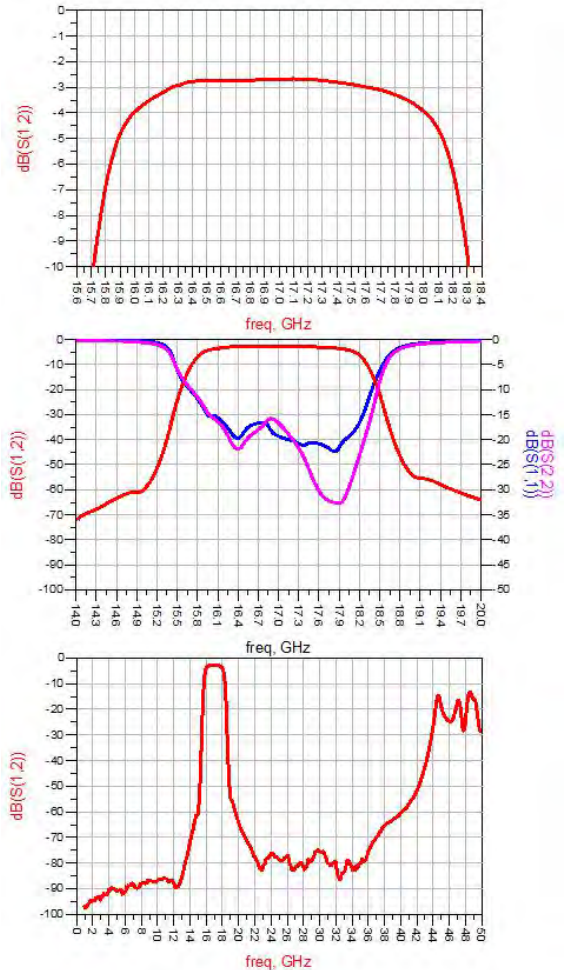


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.5	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

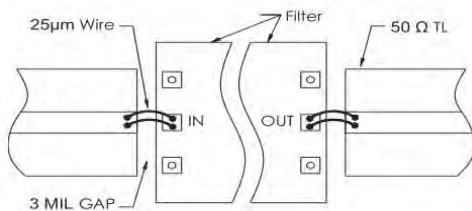
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		16.85		GHz
工作频率	16.2		17.5	GHz
中心损耗		2.5	3.0	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	15	18		
带外抑制	@1.35-14.6GHz	40	45	dBc
	@18.4-18.8GHz	40	45	dBc
	@DC-13.5GHz	60	65	dBc
	@18.8-34GHz	60	65	dBc

### 环境要求

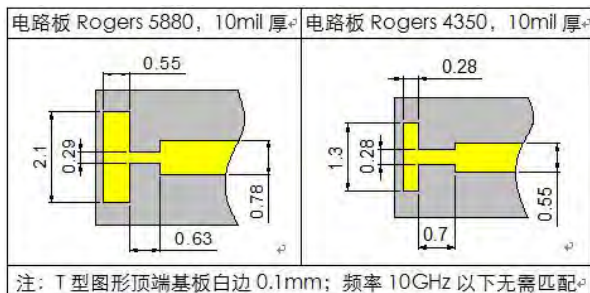
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

### 推荐装配图

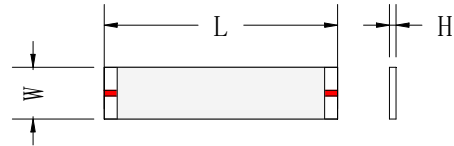
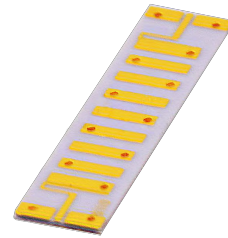


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

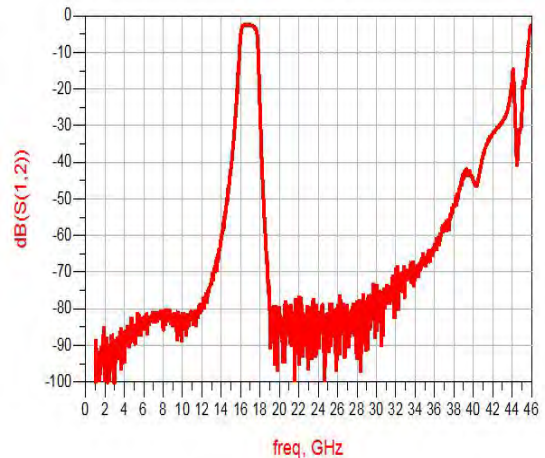
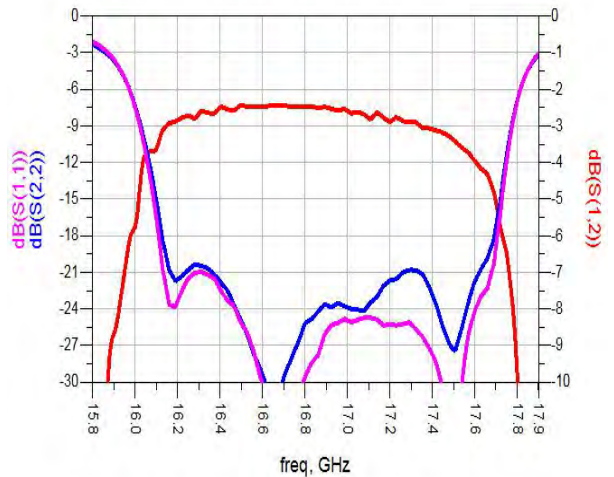


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	3.0	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



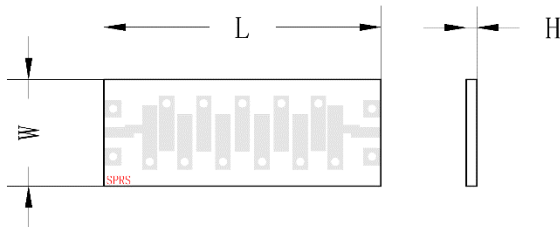
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

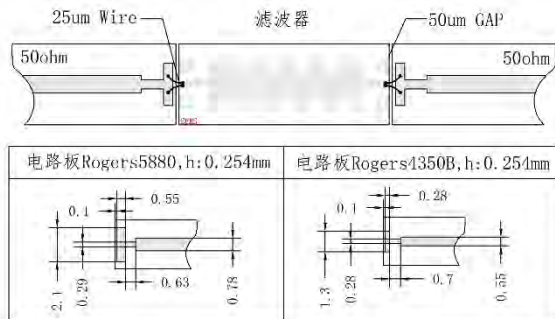
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		17.7		GHz
工作频率	16.3		19.1	GHz
中心损耗		1.9	2.4	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-14.7GHz	40	45		dBc
带外抑制@20.5-39.0GHz	40	45		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.0, W: 3.0, H: 0.254, 端口居中



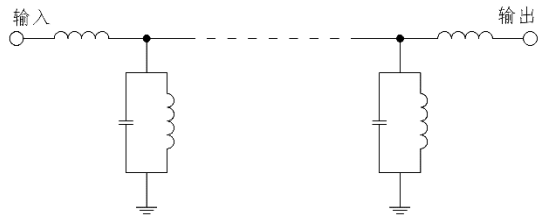
推荐装配图:



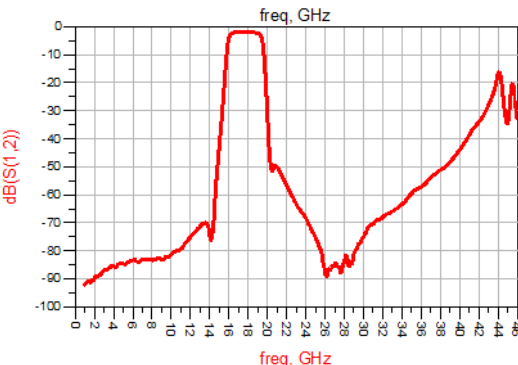
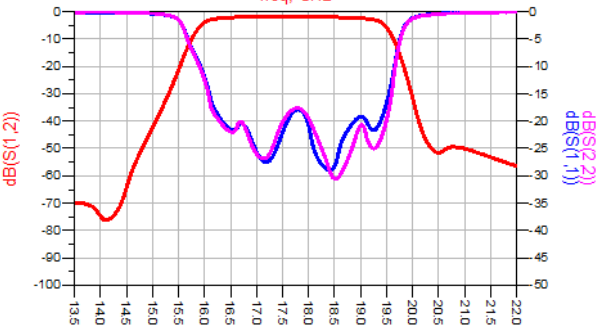
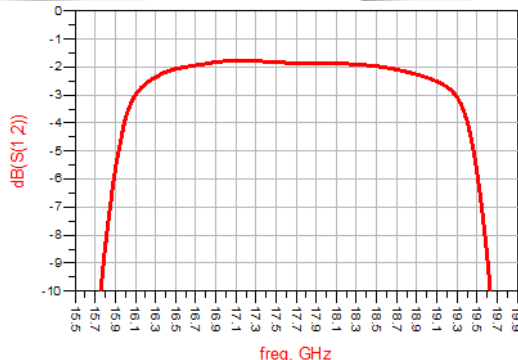
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁0.1mm，表面距上盖2.75mm，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

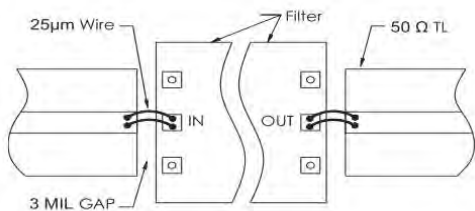
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		21.9		GHz
工作频率	16.7		27.1	GHz
中心损耗		0.9	1.4	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	10	12		
带外抑制	@DC-14.2GHz	40	45	dBc
	@29.9-50GHz	40	45	dBc

环境要求

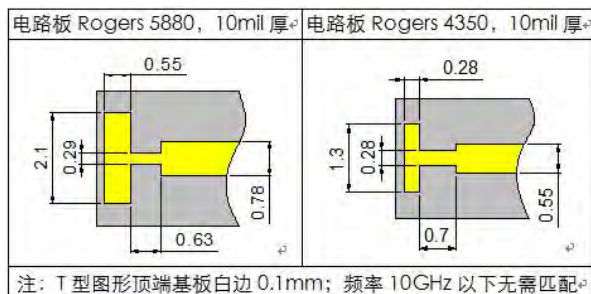
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

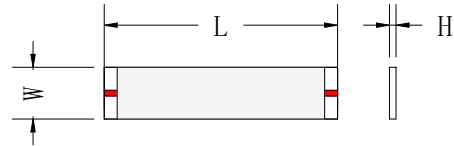
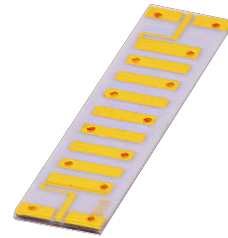


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

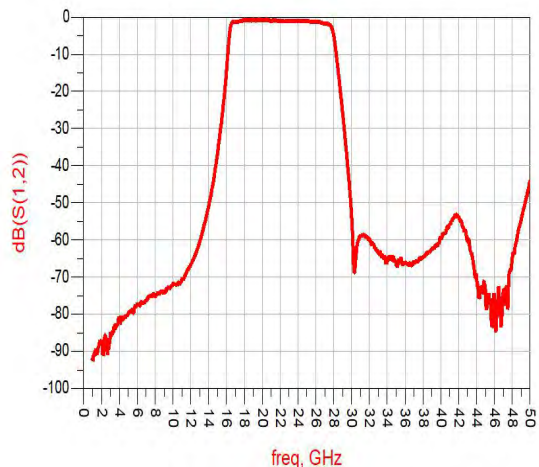
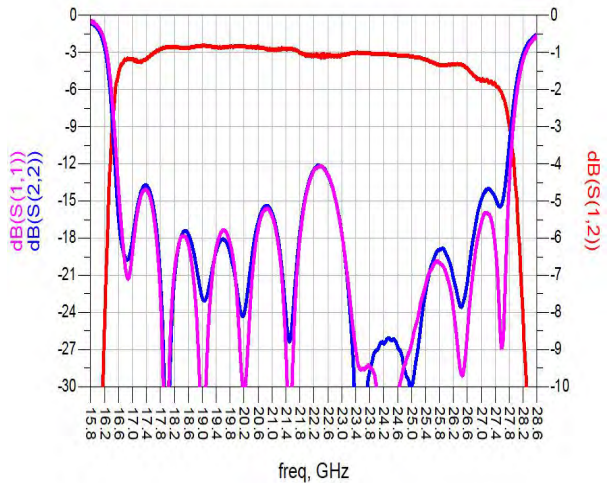


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块

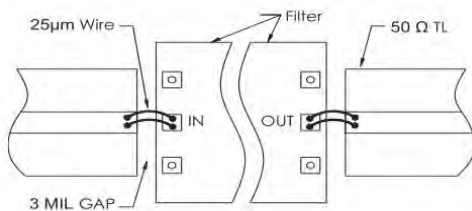
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		18.35		GHz
工作频率	16.9		19.8	GHz
中心损耗		1.5	2.0	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@DC-14.7GHz	40	45	dBc
	@21.4-41GHz	40	45	dBc

环境要求

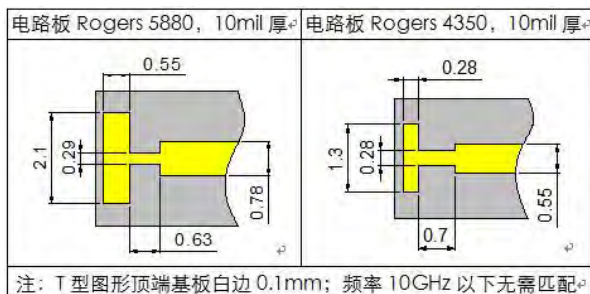
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

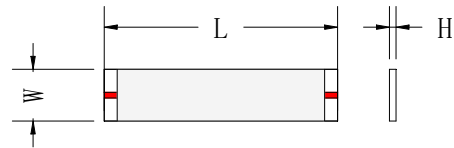
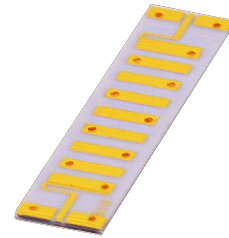


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁**0.1mm**,表面距上盖**1.75mm**,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配,T型尺寸如下:

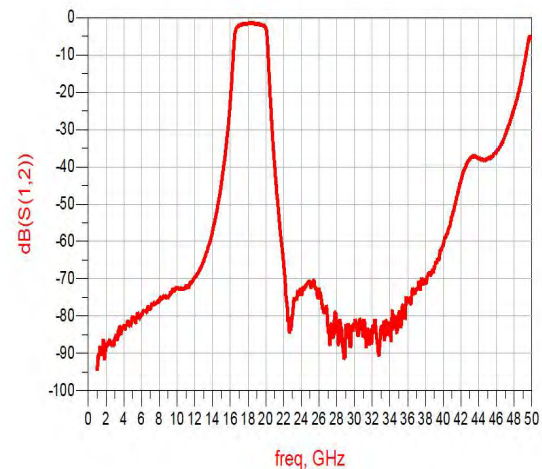
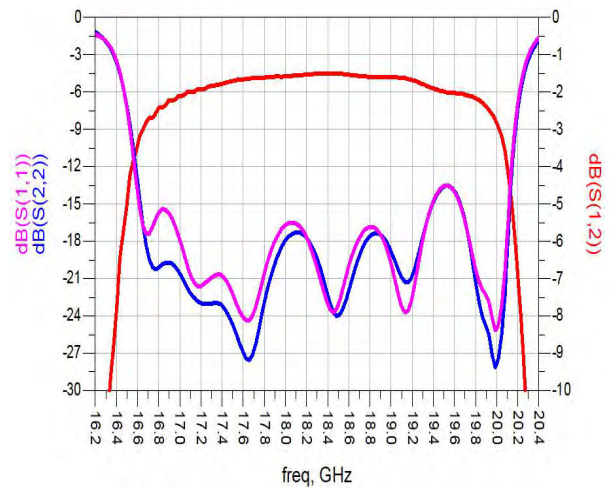


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



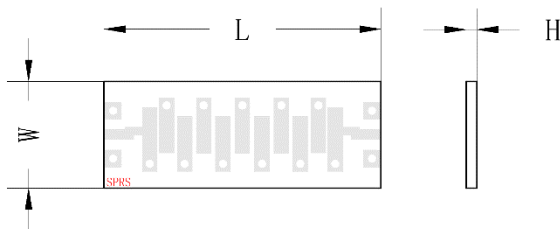
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

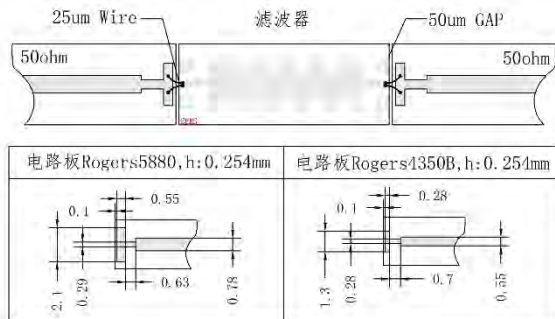
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		18.5		GHz
工作频率	16.9		20.1	GHz
中心损耗		1.6	2.1	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-15.2GHz	45	50		dBc
带外抑制@21.7-40.0GHz	45	50		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 8.0, W: 3.0, H: 0.254, 端口居中



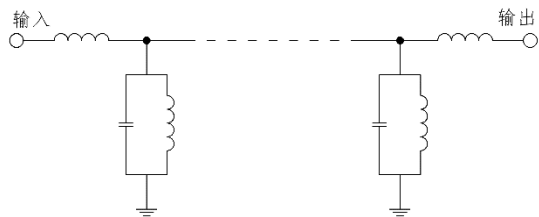
推荐装配图:



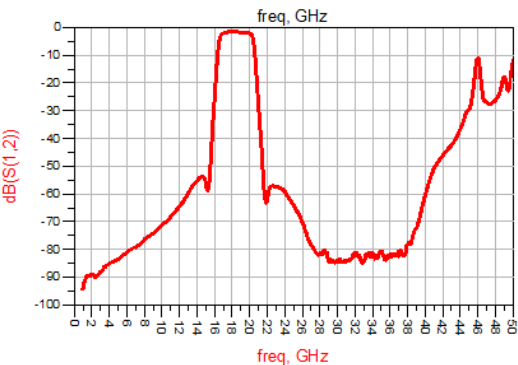
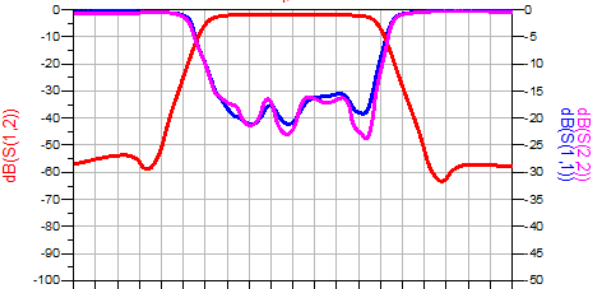
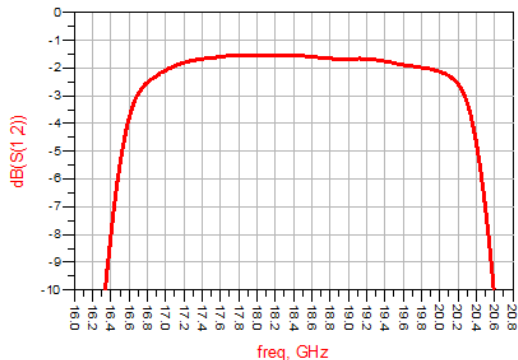
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁0.1mm，表面距上盖2.75mm，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

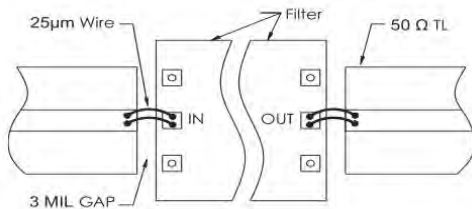
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		19.7		GHz
工作频率	16.9		22.5	GHz
中心损耗		1.4	1.9	dB
带内波动		1.1	1.2	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-13.3GHz	55	60	dBc
	@24.5-42.0GHz	55	60	dBc

环境要求

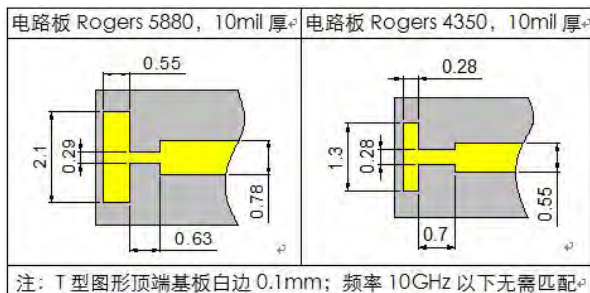
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

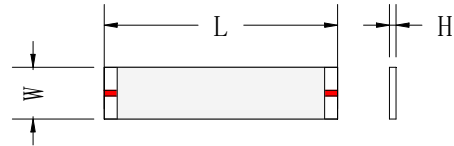
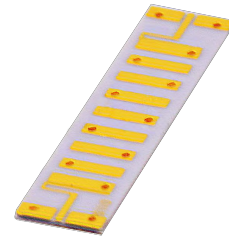


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

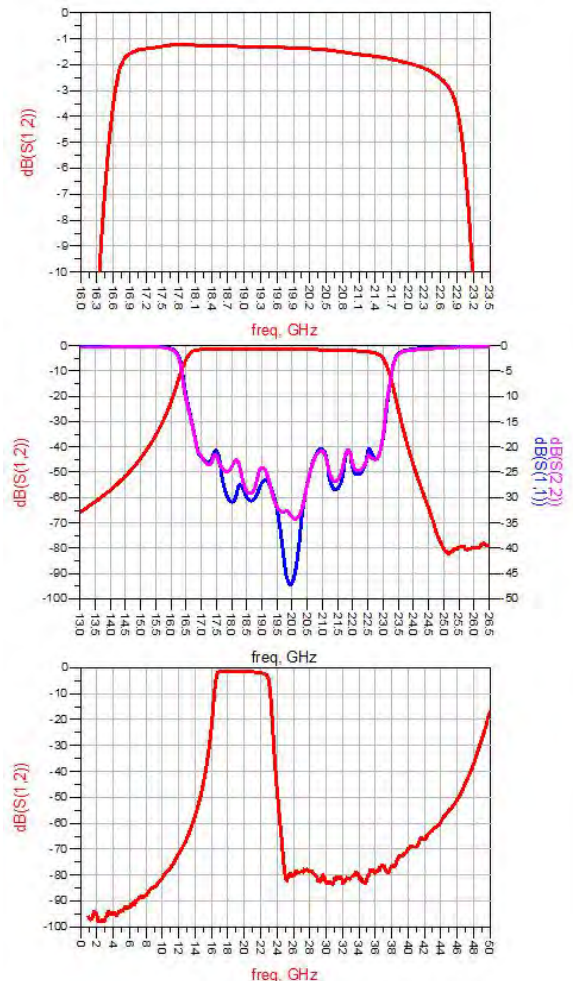


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



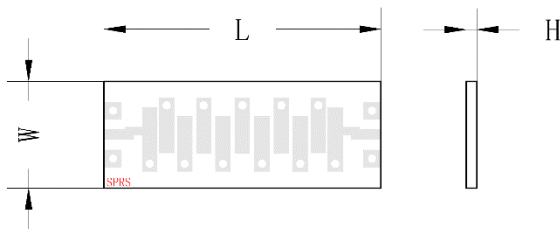
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

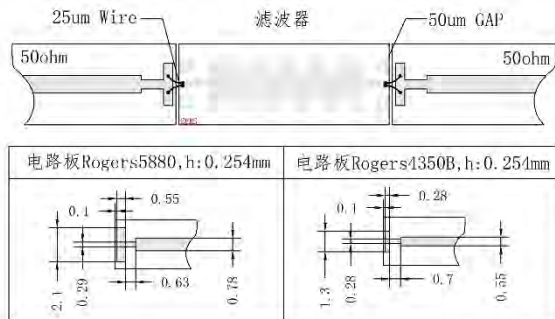
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		20.1		GHz
工作频率	17.0		23.2	GHz
中心损耗		1.6	2.1	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-14.6GHz	45	50		dBc
带外抑制@25.9-44.5GHz	45	50		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.5, W: 2.5, H: 0.254, 端口居中



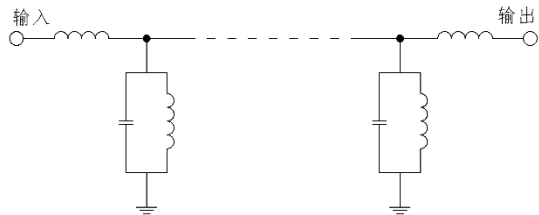
推荐装配图:



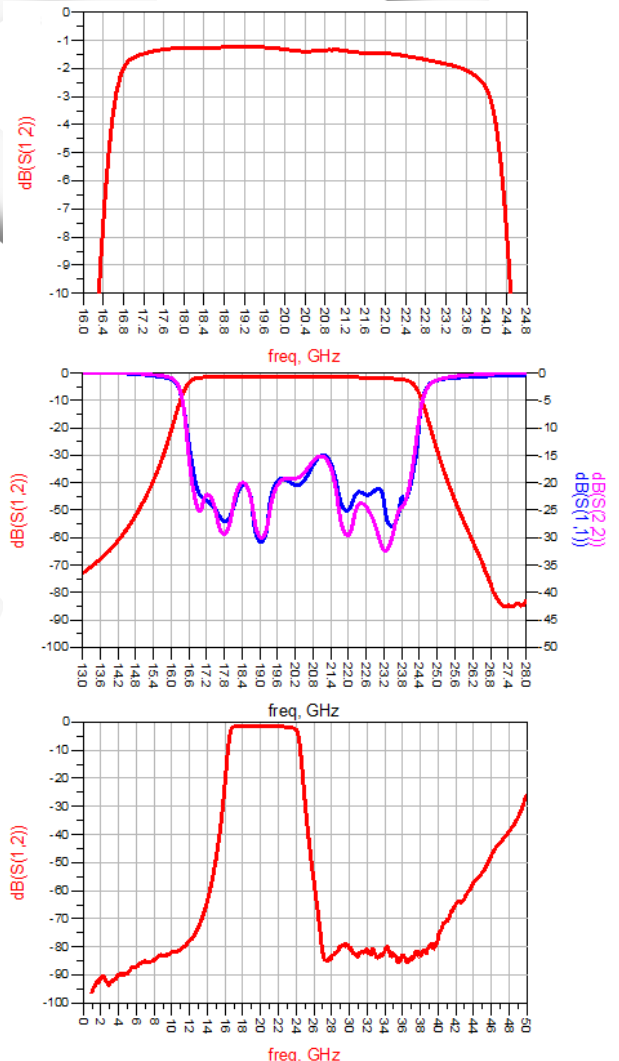
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**1.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块

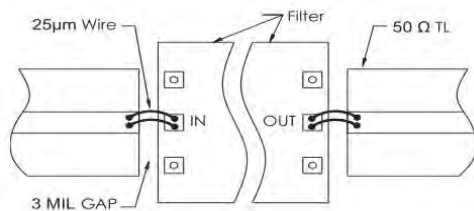
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		21.8		GHz
工作频率	17.0		26.6	GHz
中心损耗		1.0	1.5	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	10	12.5		
带外抑制	@DC-14.0GHz	40	45	dBc
	@28.8-48GHz	40	42	dBc

环境要求

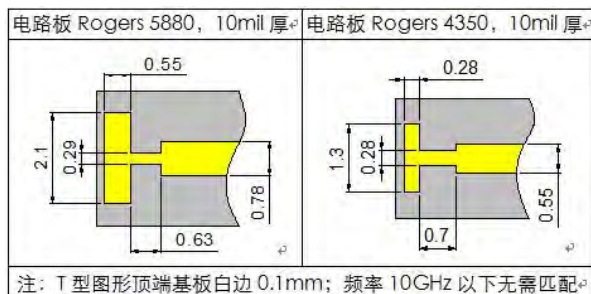
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

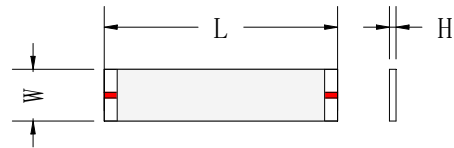
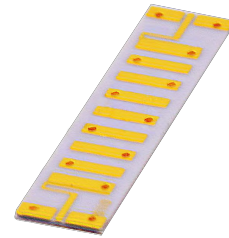


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁**0.1mm**,表面距上盖**1.75mm**,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配,T型尺寸如下:

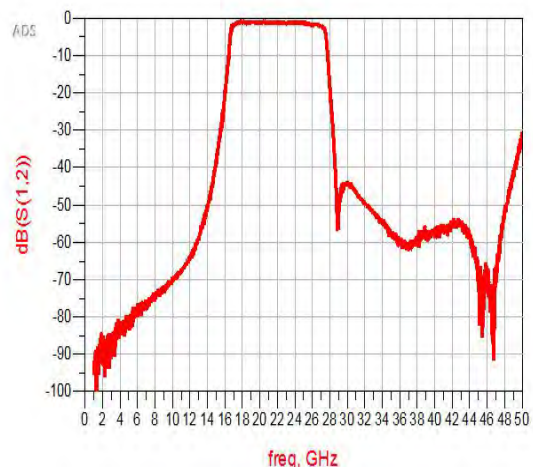
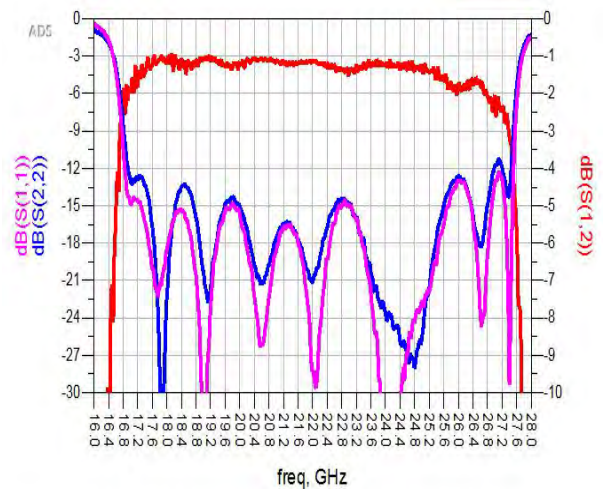


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

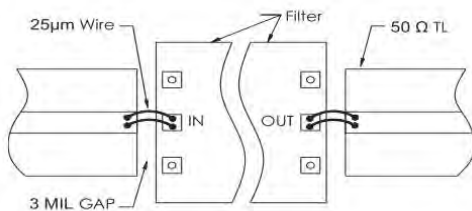
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		19.5		GHz
工作频率	17.1		21.9	GHz
中心损耗		1.2	1.7	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	14		
带外抑制	@14.5-15.6GHz	40	45	dBc
	@23.5-24GHz	40	45	dBc
	@DC-14.5GHz	60	65	dBc
	@24-46GHz	60	65	dBc

环境要求

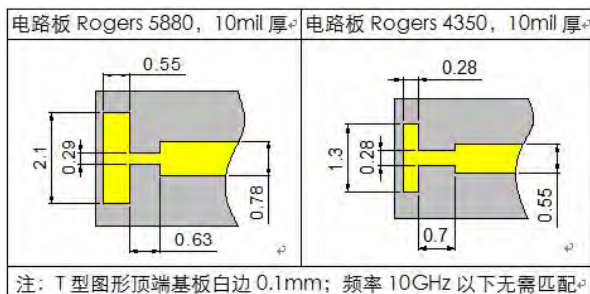
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

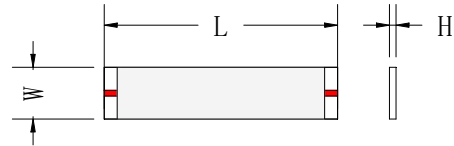
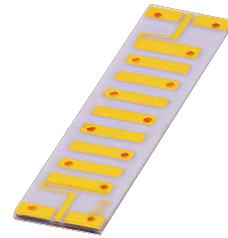


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖1.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

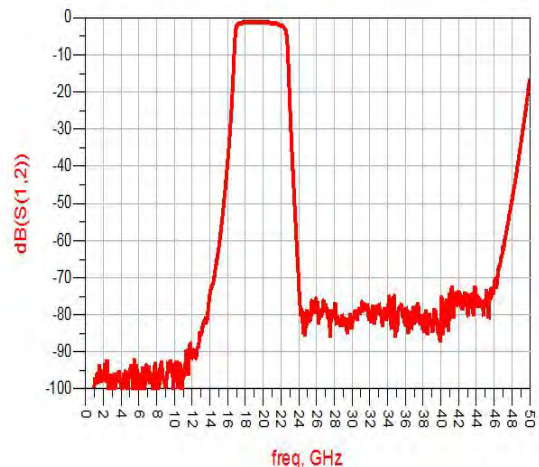
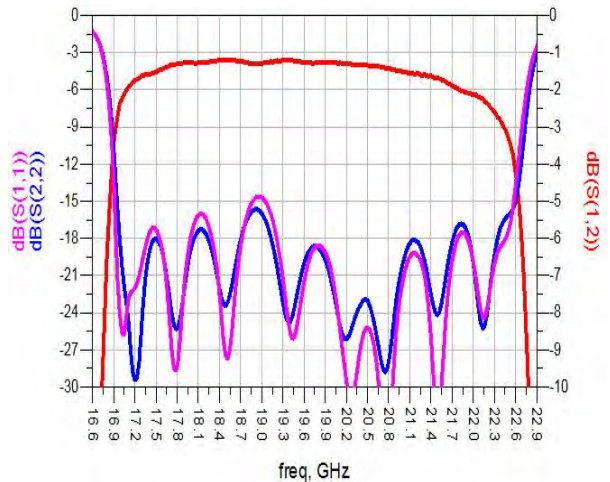


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

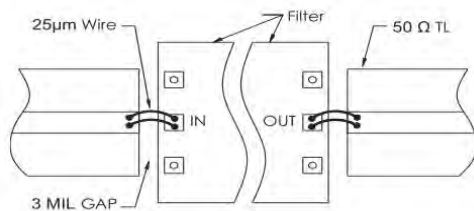
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		19.9		GHz
工作频率	17.2		22.6	GHz
中心损耗		1.4	1.9	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	10	13		
带外抑制	@14.5-15.7GHz	40	45	dBc
	@24.1-24.55GHz	40	45	dBc
	@DC-14.5GHz	60	65	dBc
	@24.55-47GHz	60	65	dBc

### 环境要求

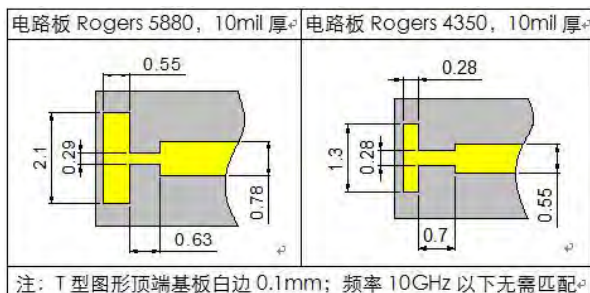
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

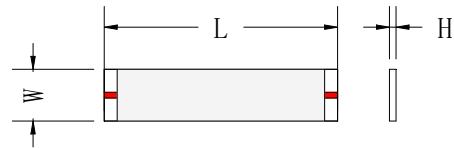
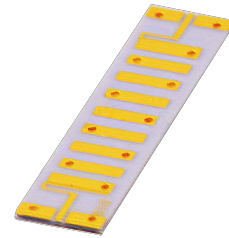


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

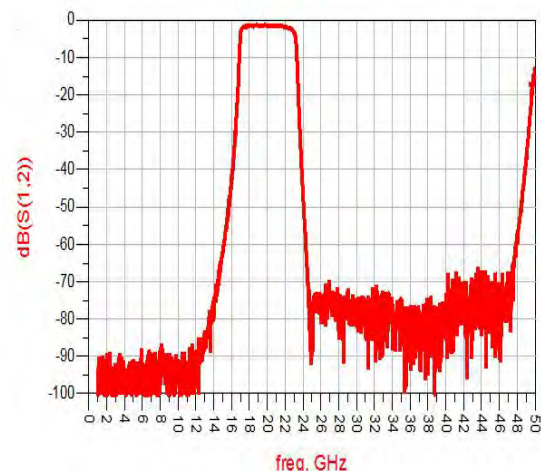
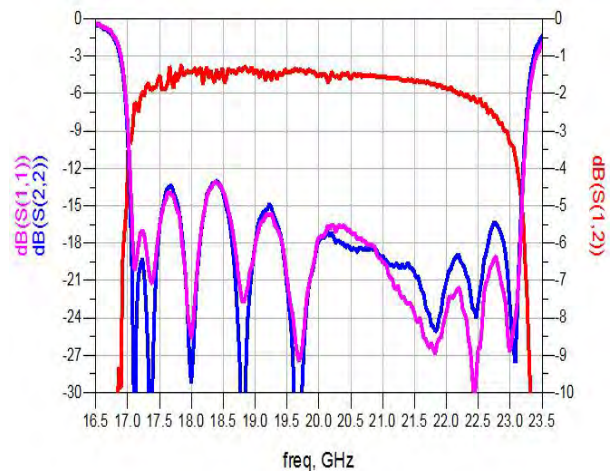


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	2.5	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

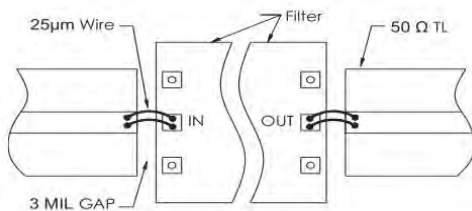
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		21.1		GHz
工作频率	17.2		25.0	GHz
中心损耗		2.1	2.6	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	10	12		
带外抑制	@DC-8.0GHz	70	75	dBc
	@8.0-14.3GHz	40	45	dBc
	@28.5-48GHz	40	45	dBc

### 环境要求

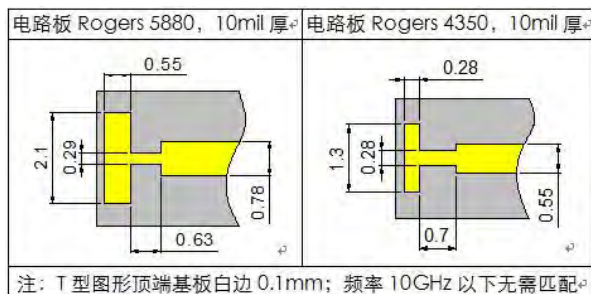
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

### 推荐装配图

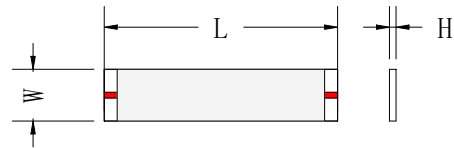
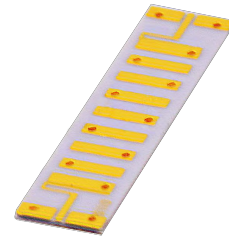


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

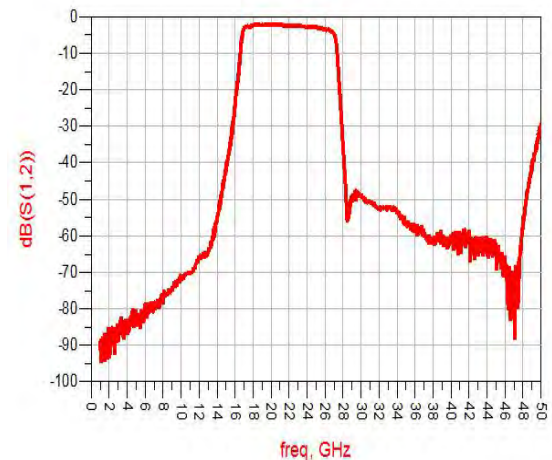
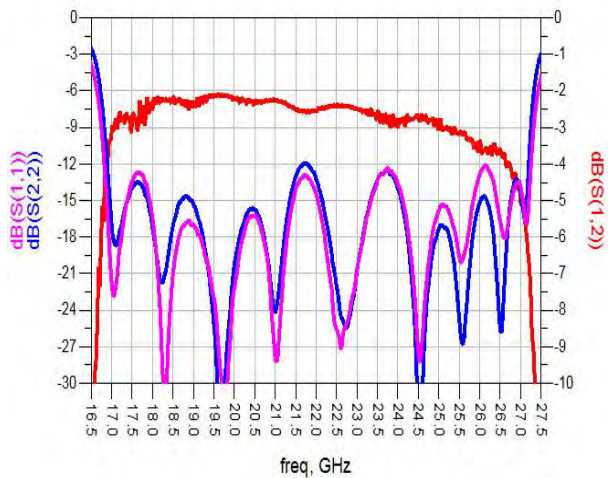


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	2.5	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

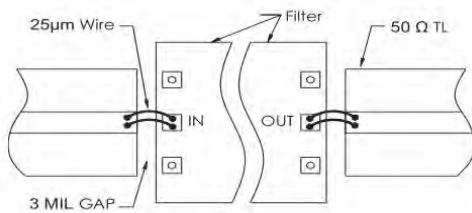
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		18.1		GHz
工作频率	17.3		18.9	GHz
中心损耗		1.0	1.5	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	14		
带外抑制	@DC-14.4GHz	40	45	dBc
	@21.3-28GHz	40	45	dBc

环境要求

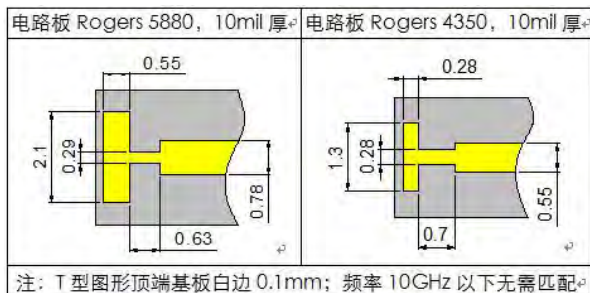
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

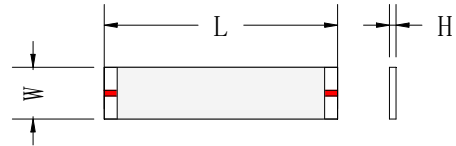


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

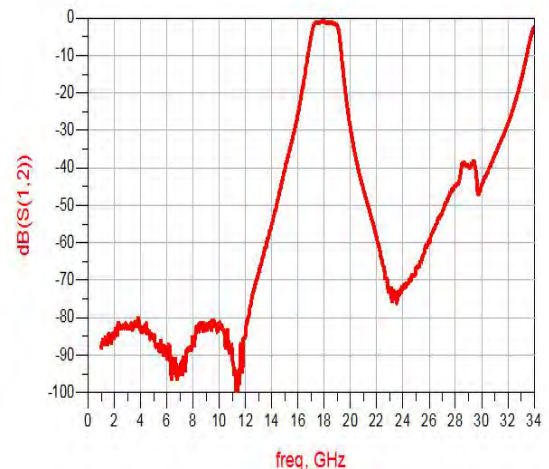
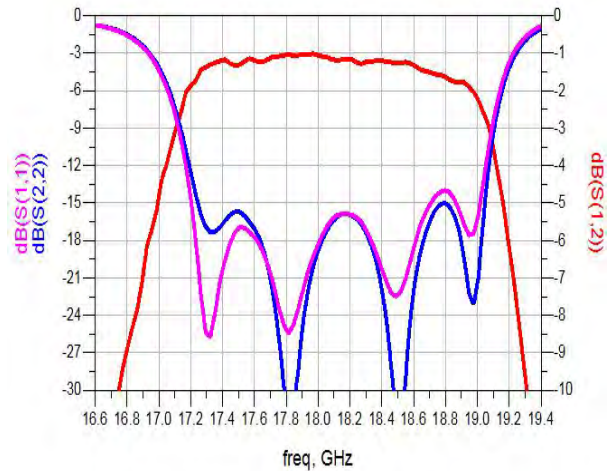


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

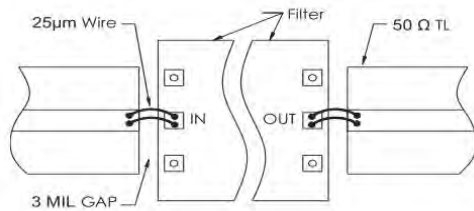
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		22.0		GHz
工作频率	17.3		26.7	GHz
中心损耗		0.9	1.4	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-14.0GHz	40	45	dBc
	@28.9-49.0GHz	40	45	dBc

环境要求

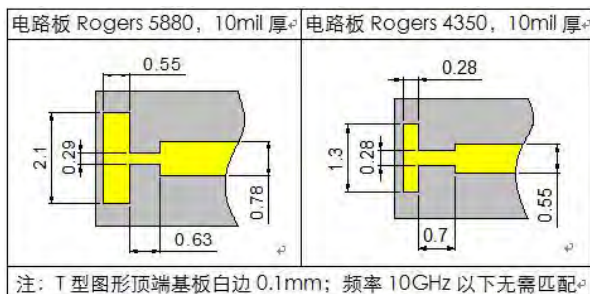
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

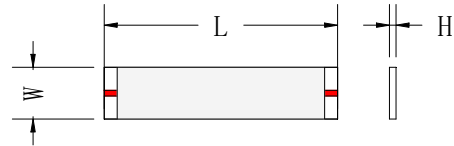
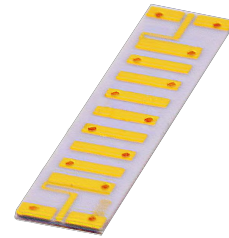


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

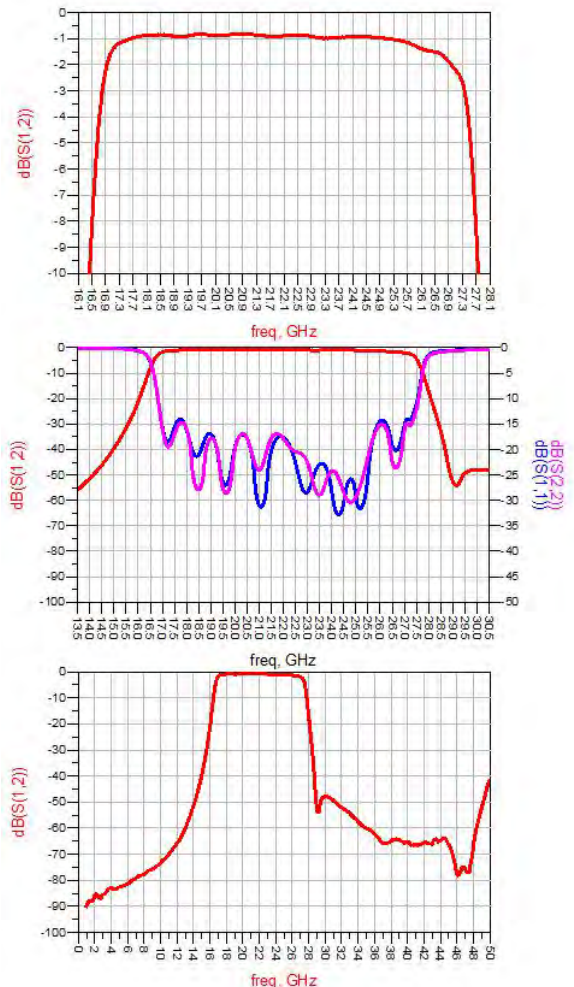


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.5	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

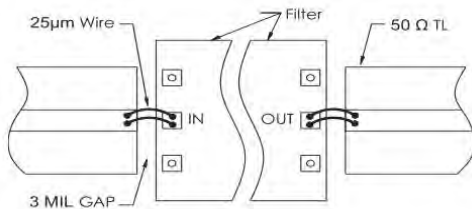
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		19.5		GHz
工作频率	17.4		21.6	GHz
中心损耗		1.2	1.7	dB
带内波动		0.6	0.8	dB
回波损耗		12	13	dB
带外抑制	@DC-15.8GHz	40	45	dBc
	@23.6-43.0GHz	40	45	dBc

环境要求

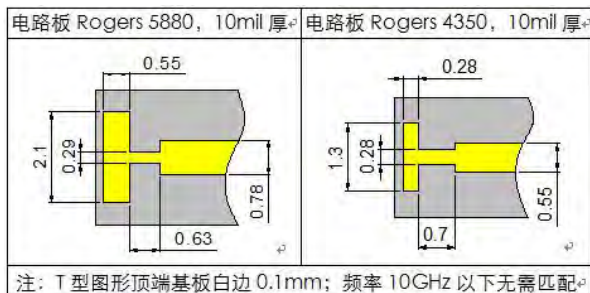
最大输入功率	30	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

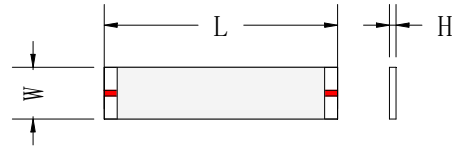
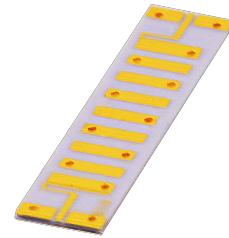


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

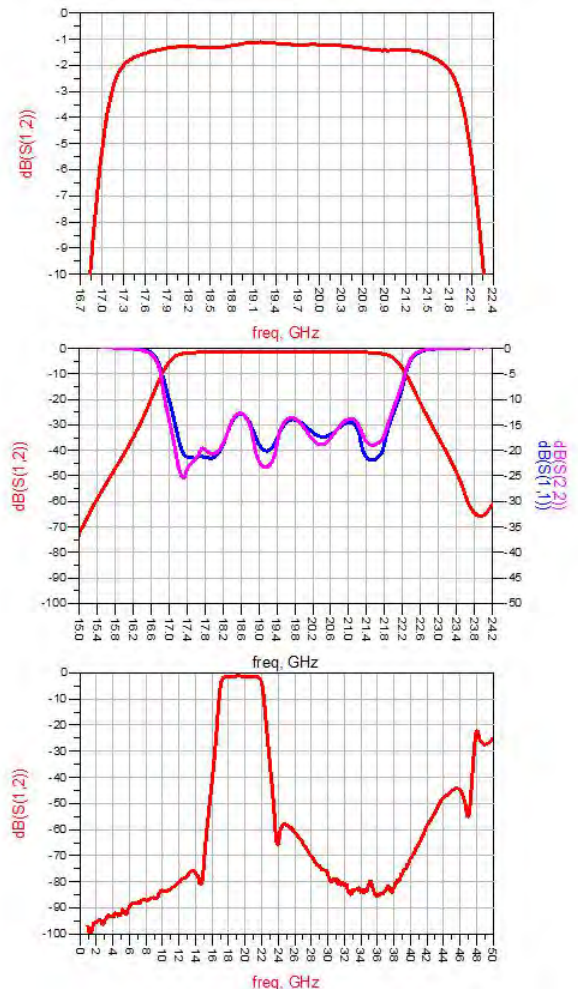


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



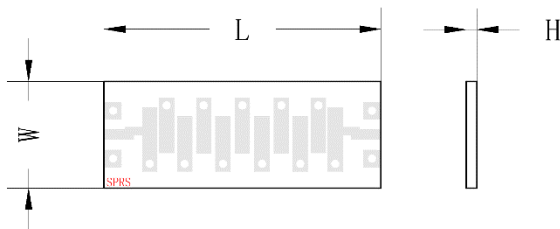
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

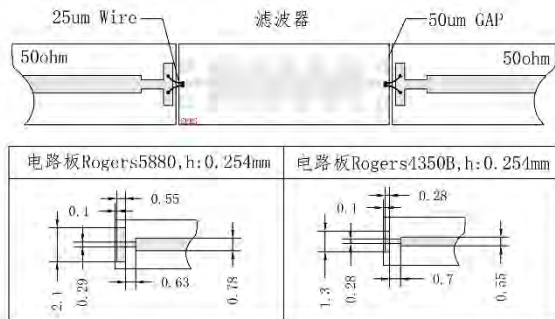
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		22.1		GHz
工作频率	17.4		26.8	GHz
中心损耗		1.0	1.5	dB
带内波动		0.9	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-13.0GHz	60	65		dBc
带外抑制@30.5-50.0GHz	60	65		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^{\circ}\text{C}$

外形图: L: 7.0, W: 2.0, H: 0.254, 端口居中



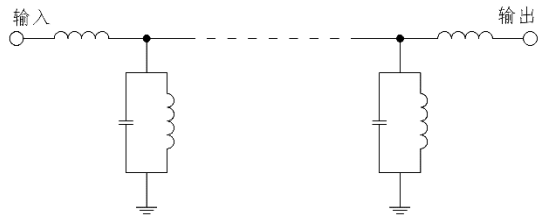
推荐装配图:



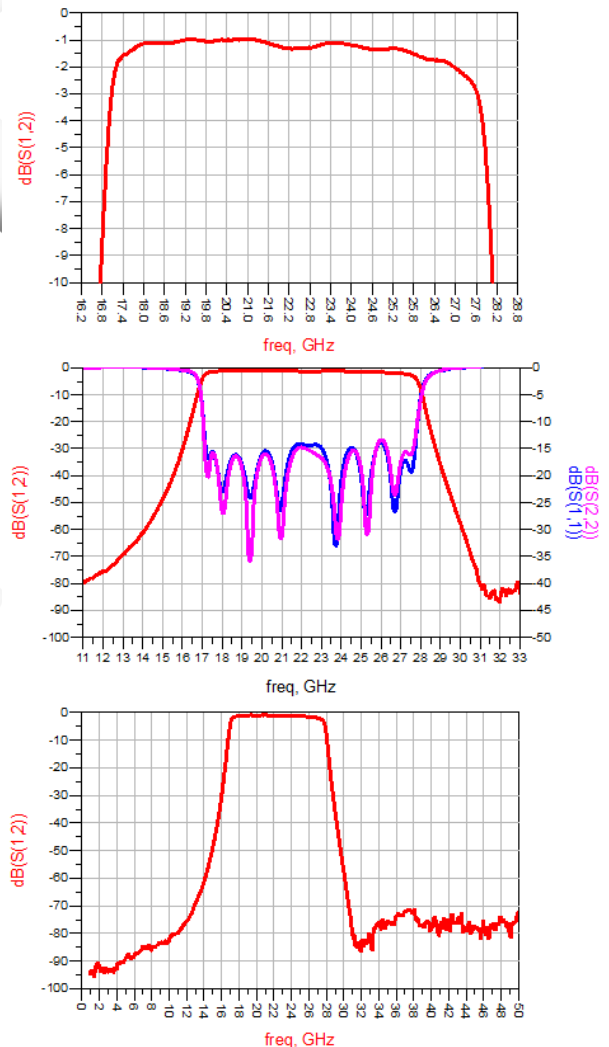
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**1.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^{\circ}\text{C}$ )载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

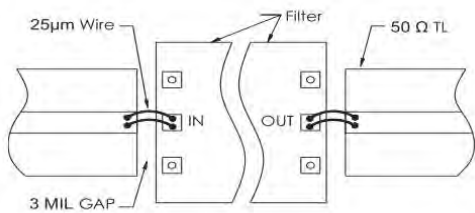
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		20.65		GHz
工作频率	17.5		23.8	GHz
中心损耗		1.6	2.0	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	14		
带外抑制	@DC-10GHz	65	70	dBc
	@10-14.3GHz	40	45	dBc
	@26.2-28GHz	40	45	dBc
	@28-44GHz	50	55	dBc

环境要求

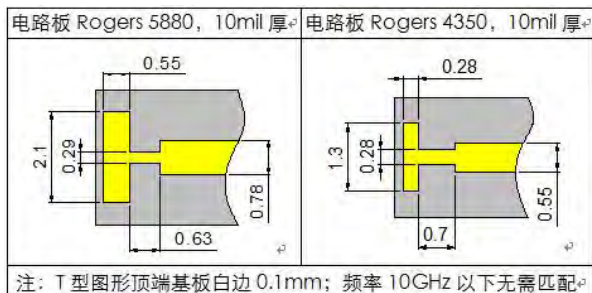
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

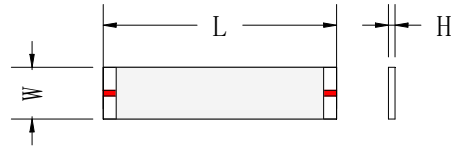
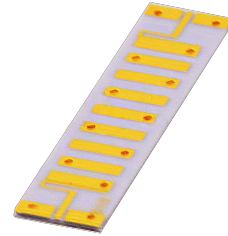


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖1.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

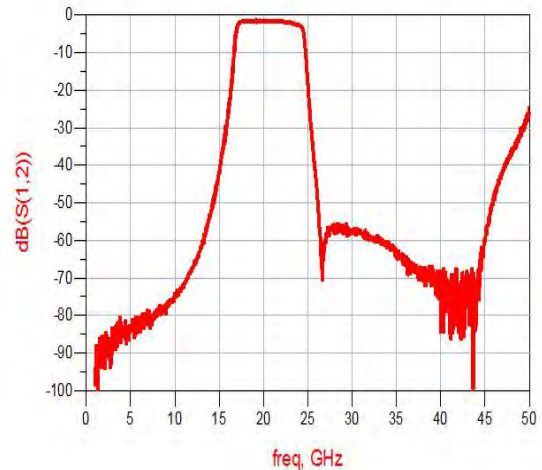
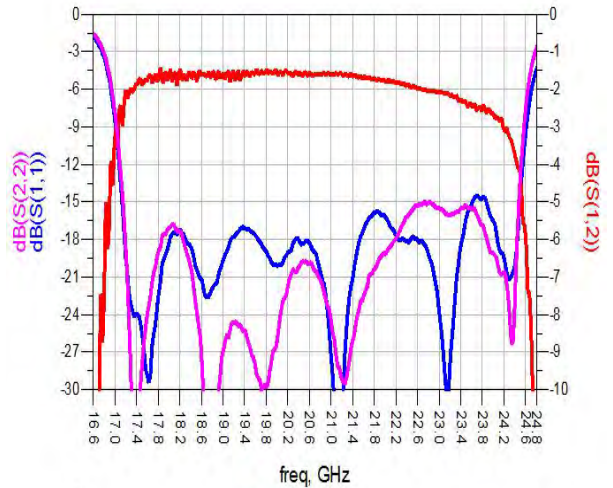


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	2.2	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

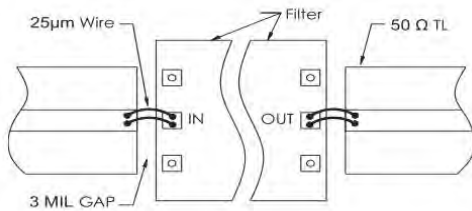
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		22.0		GHz
工作频率	17.6		26.4	GHz
中心损耗		0.6	1.1	dB
带内波动		0.9	1.2	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-15.1GHz	30	35	dBc
	@28.0-48.0GHz	35	40	dBc

环境要求

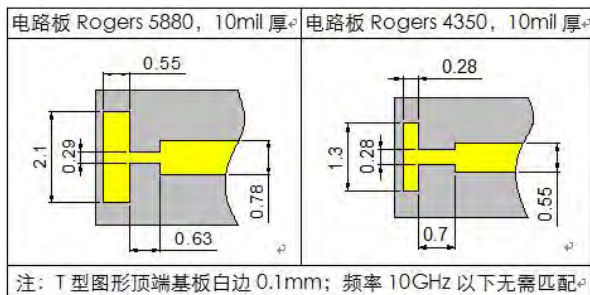
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

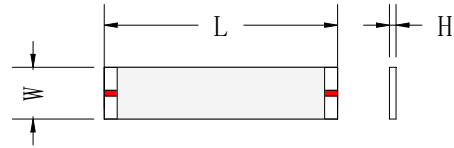
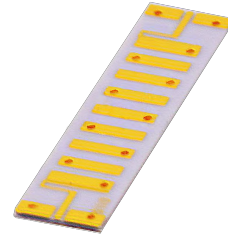


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

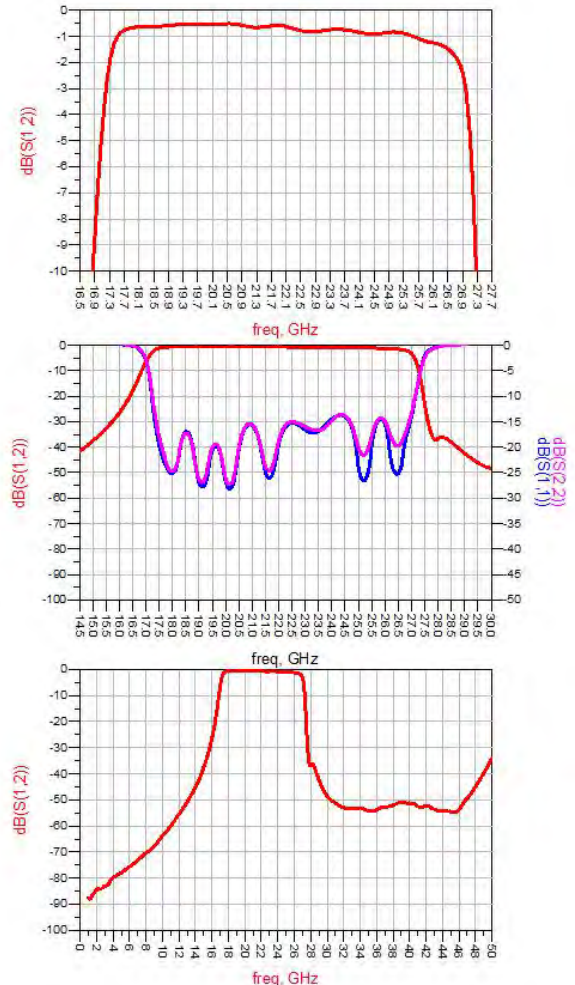


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

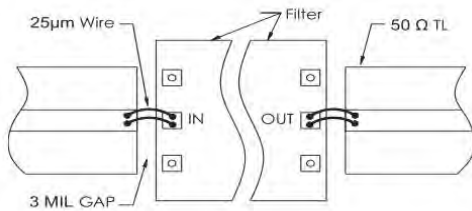
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		17.95		GHz
工作频率	17.8		18.1	GHz
中心损耗		2.6	3.1	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-16.5GHz	50	55	dBc
	@19.4-31.0GHz	50	55	dBc

环境要求

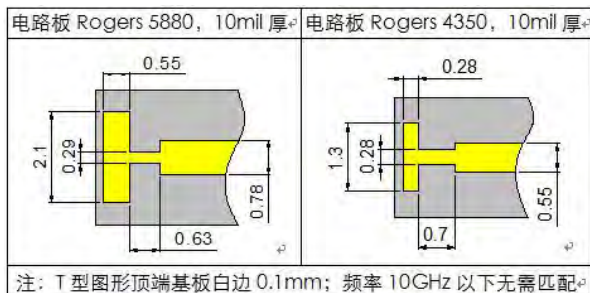
最大输入功率	30	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

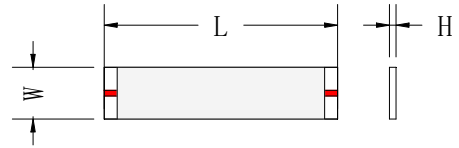


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

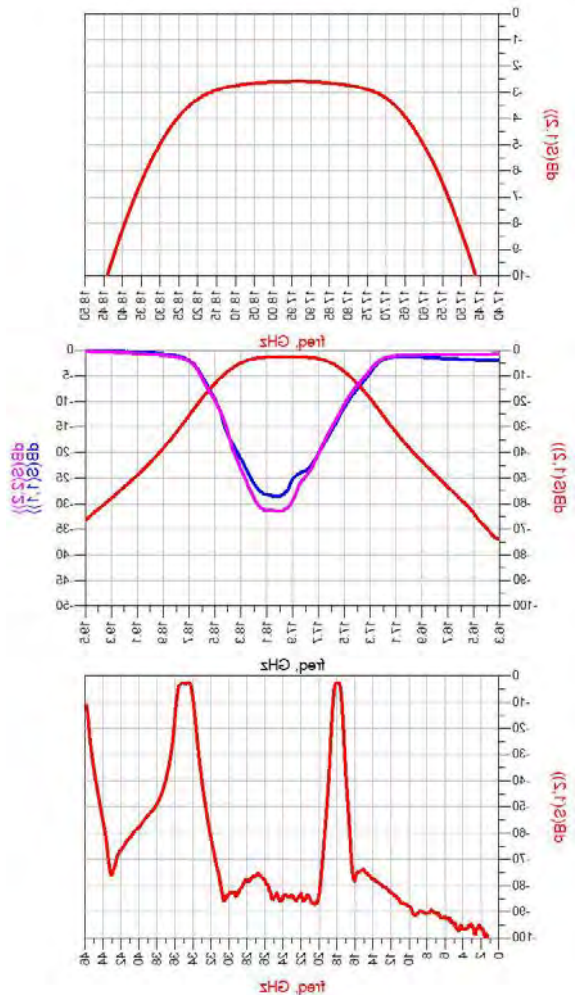


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	10.0	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

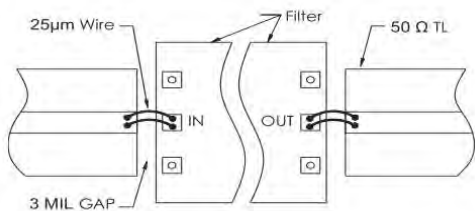
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		19.05		GHz
工作频率	17.9		20.2	GHz
中心损耗		1.7	2.2	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	14	18		
带外抑制	@16.2-16.7GHz	40	45	dBc
	@21.7-22.6GHz	40	45	dBc
	@DC-16.2GHz	60	65	dBc
	@22.6-32GHz	60	65	dBc

环境要求

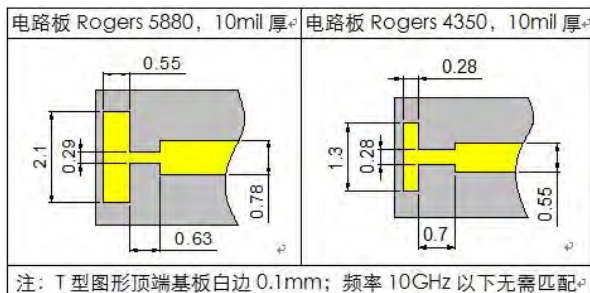
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

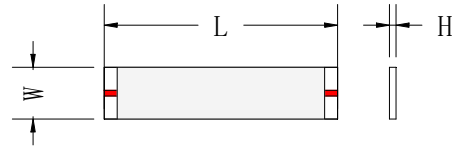


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

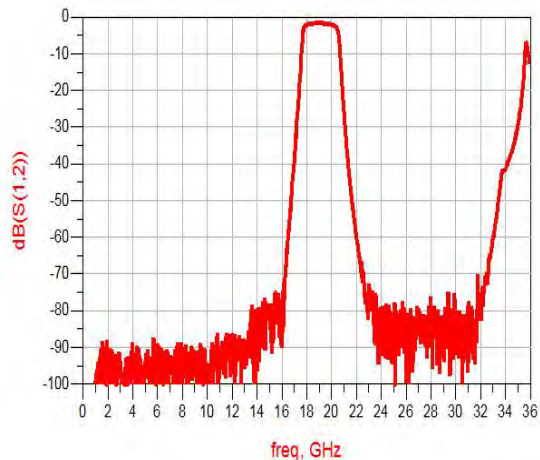
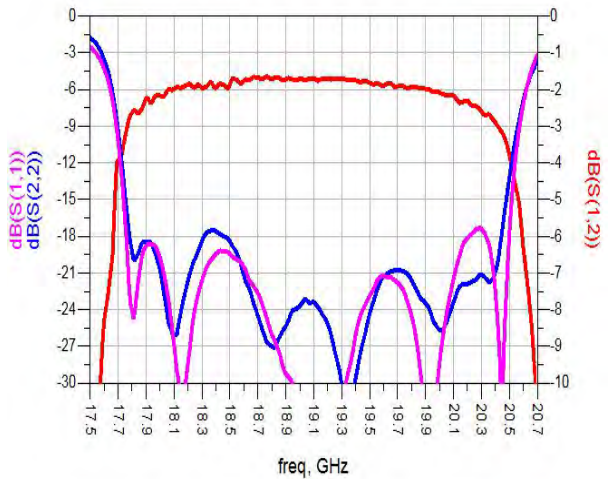


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	12.0	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



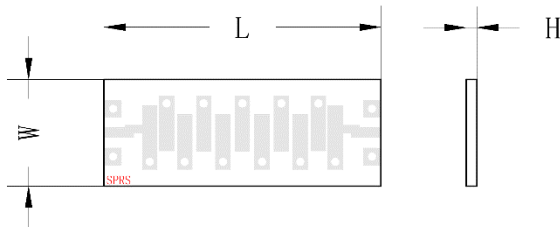
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

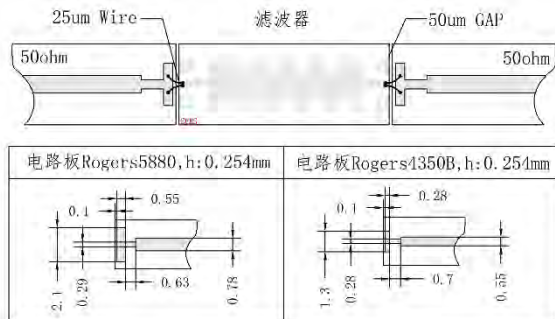
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		19.2		GHz
工作频率	17.9		20.5	GHz
中心损耗		2.8	3.3	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-15.6GHz	65	70		dBc
带外抑制@22.3-41.0GHz	65	70		dBc
承受功率			27	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 8.5, W: 2.5, H: 0.254, 端口居中



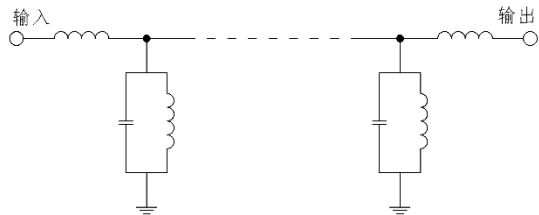
推荐装配图:



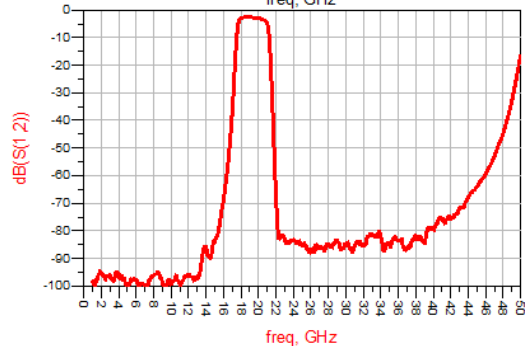
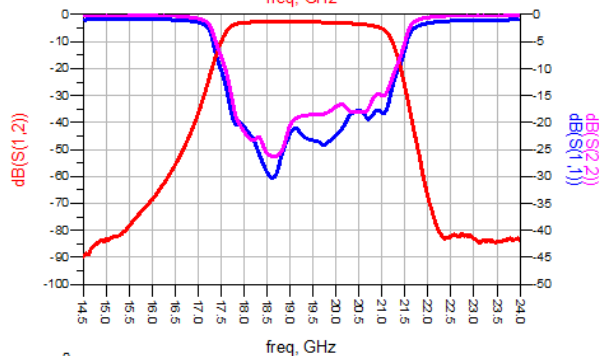
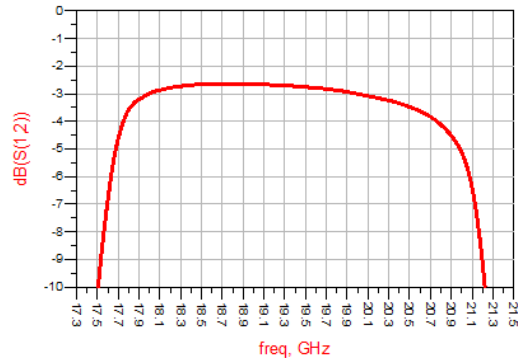
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**1.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

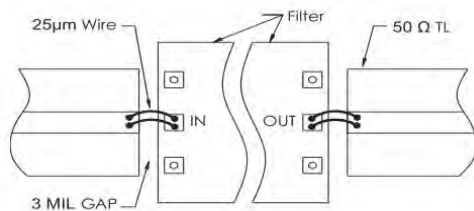
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		20.4		GHz
工作频率	17.9		22.9	GHz
中心损耗		1.2	1.7	dB
带内波动		0.7	0.9	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-15.5GHz	55	60	dBc
	@25.8-42.5GHz	55	60	dBc

### 环境要求

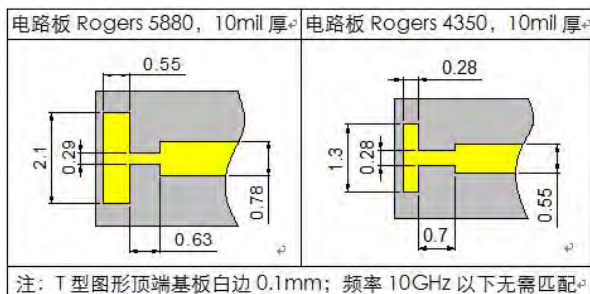
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

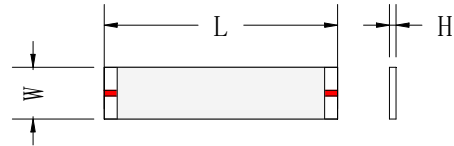
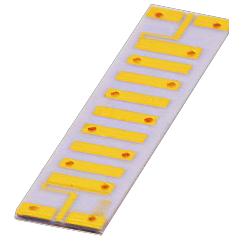


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**1.75mm**，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm；
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配，T型尺寸如下：

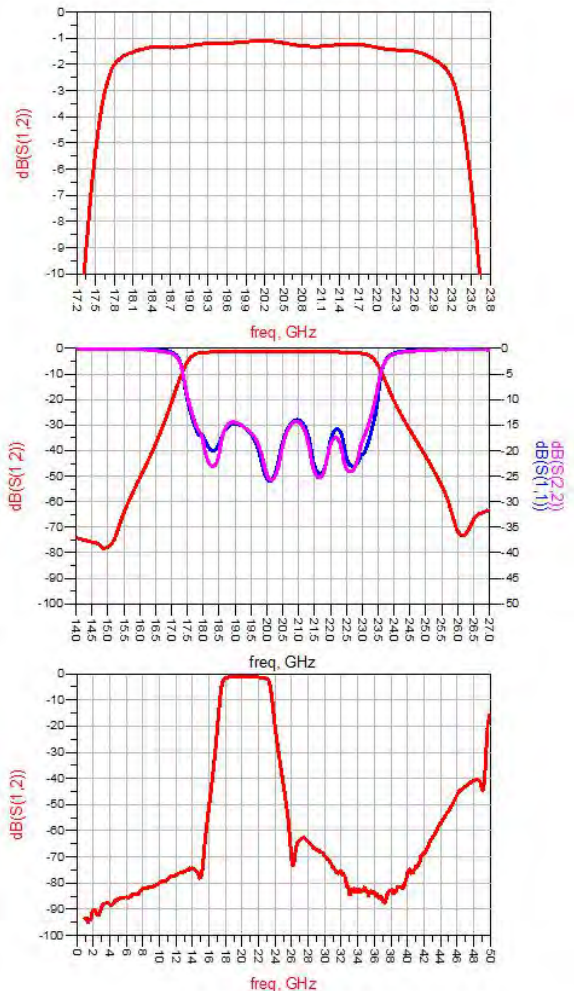


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	2.5	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

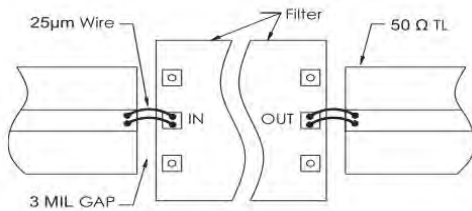
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		19.0		GHz
工作频率	18.0		20.0	GHz
中心损耗		2.3	2.8	dB
带内波动		1.0	1.2	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-17GHz	40	45	dBc
	@21.1-41.5GHz	40	45	dBc

环境要求

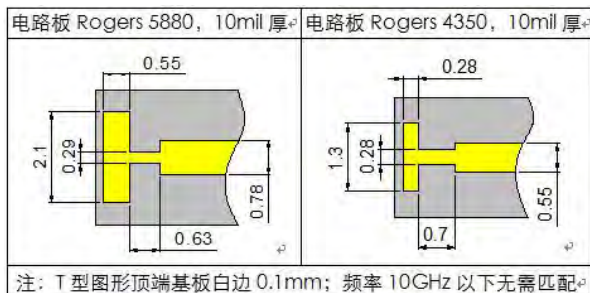
最大输入功率	30	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

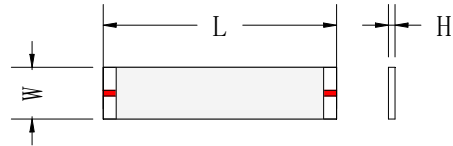
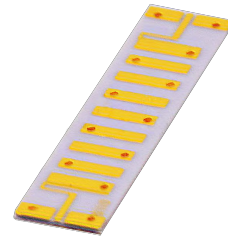


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm / °C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

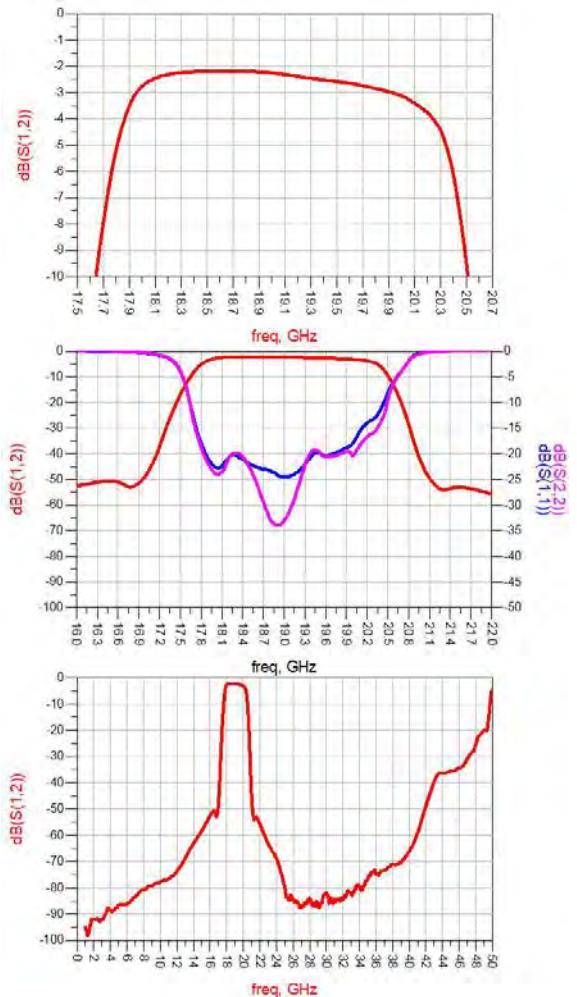


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.5	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

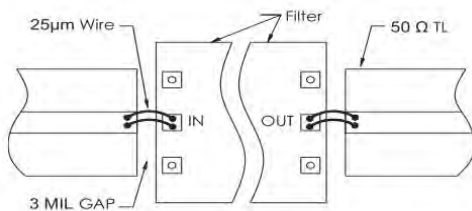
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		19.65		GHz
工作频率	18		21.3	GHz
中心损耗		1.9	2.4	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	10	12		
带外抑制	@DC-16.5GHz	43	46	dBc
	@23-42GHz	45	50	dBc

环境要求

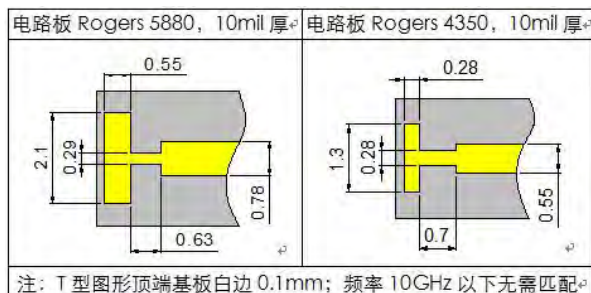
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

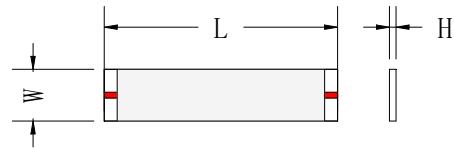
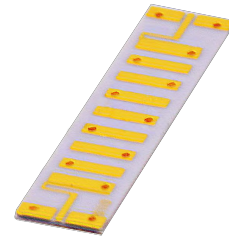


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

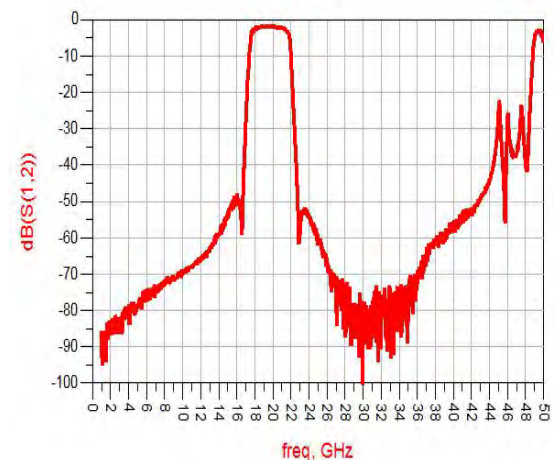
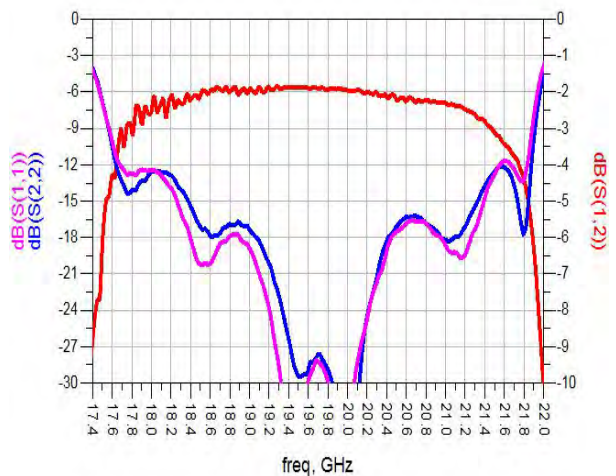


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.5	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

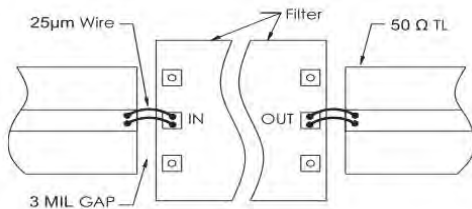
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		22.1		GHz
工作频率	18.1		26.1	GHz
中心损耗		0.8	1.3	dB
带内波动		0.6	0.7	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-14.5GHz	39	44	dBc
	@28.5-48.0GHz	39	44	dBc

环境要求

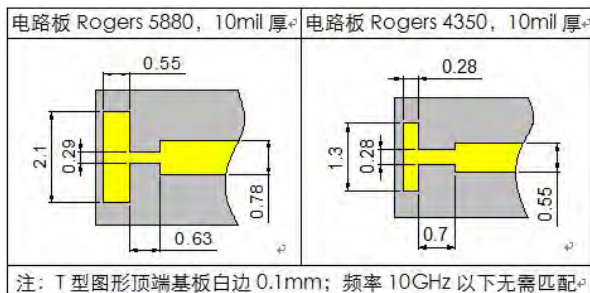
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

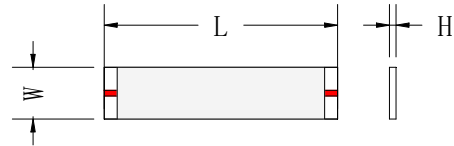
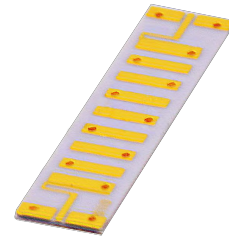


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

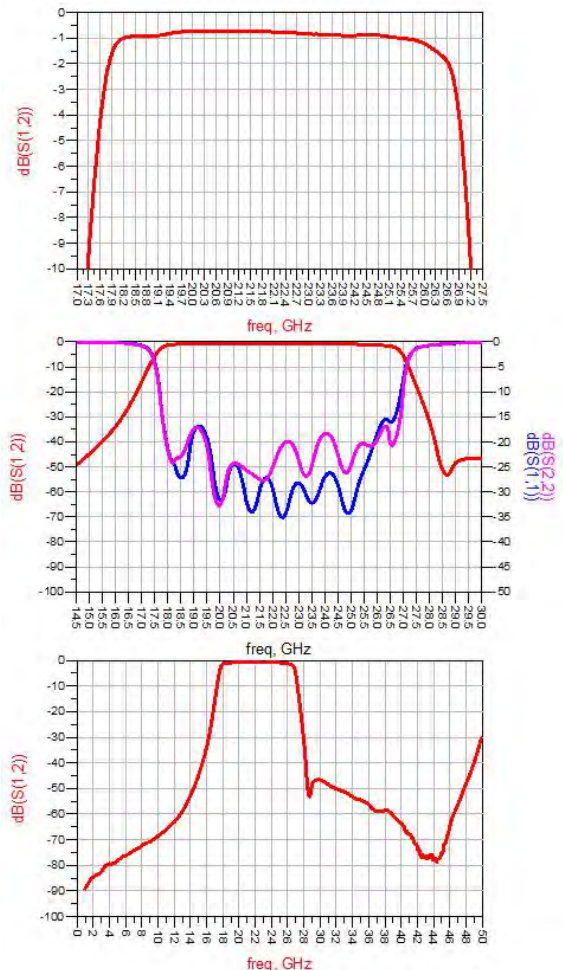


外形图



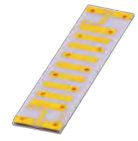
外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

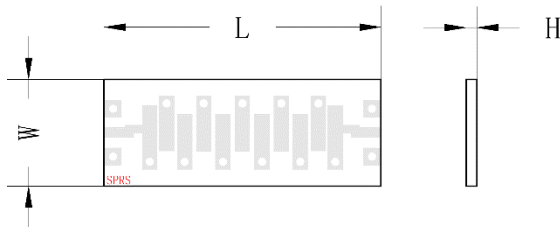
- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块



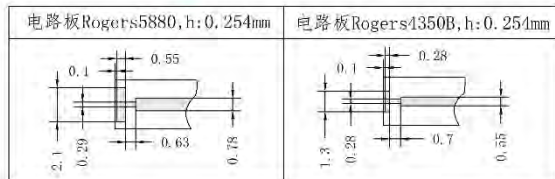
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		19.8		GHz
工作频率	18.3		21.3	GHz
中心损耗		1.8	2.3	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-16.6GHz	40	45		dBc
带外抑制@22.7-39.0GHz	40	45		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.0, W: 3.0, H: 0.254, 端口居中



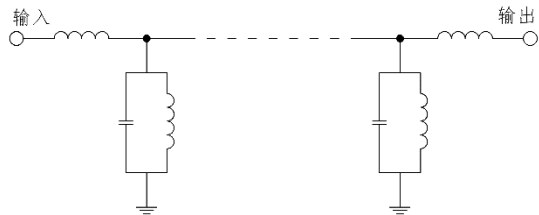
推荐装配图:



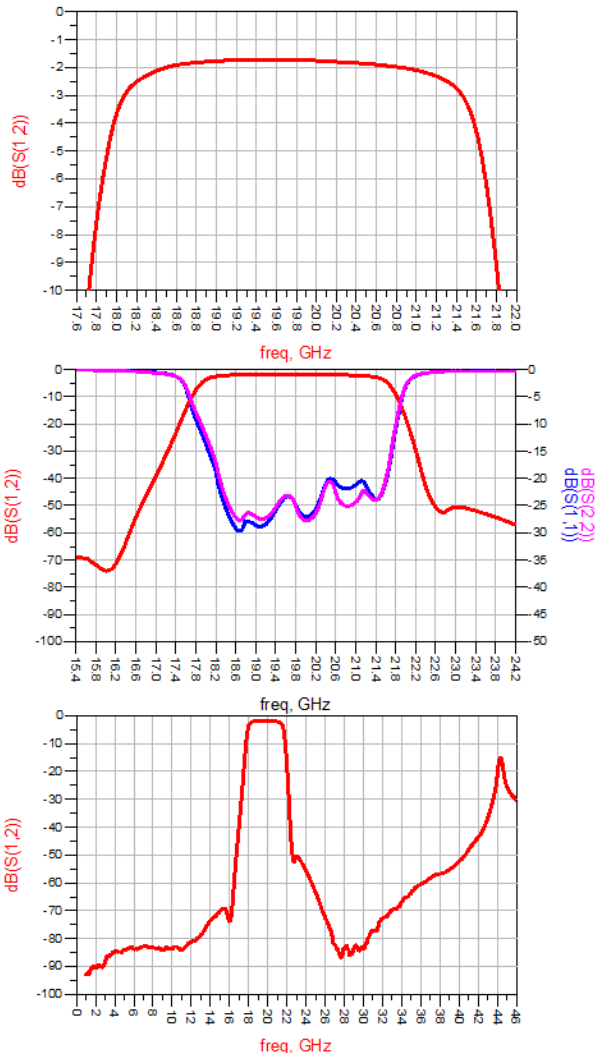
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁0.1mm，表面距上盖2.75mm，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

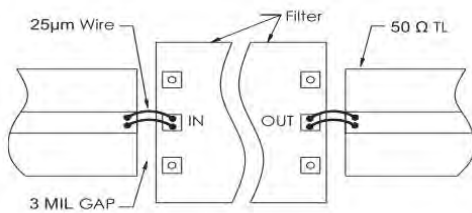
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		18.67		GHz
工作频率	18.56		18.8	GHz
中心损耗		3.0	3.5	dB
带内波动		0.5	1.2	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-17.5GHz	45	50	dBc
	@20.1-43GHz	45	50	dBc

### 环境要求

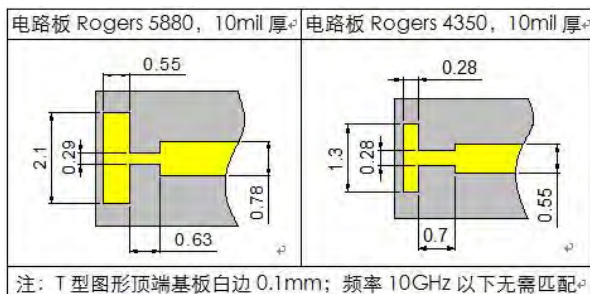
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

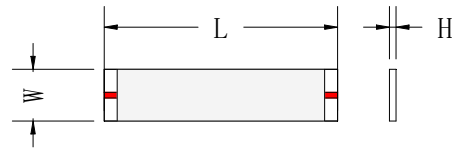
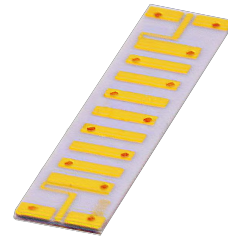


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

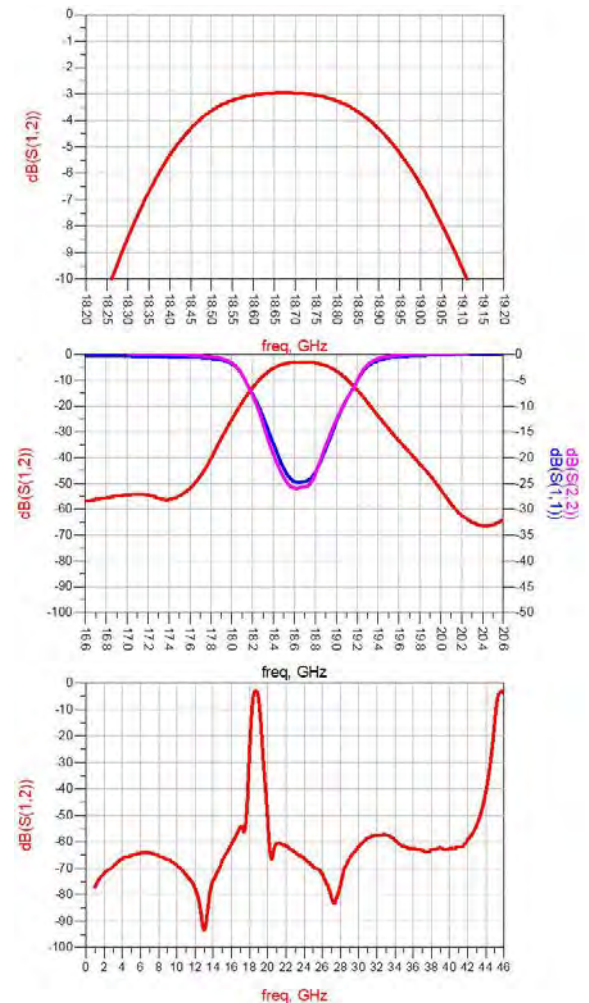


### 外形图



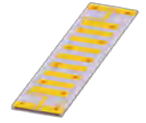
外形尺寸	L	W	H	单位
	4.5	2.5	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

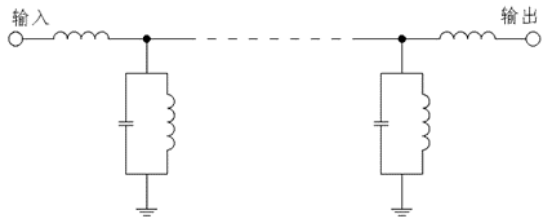
- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块



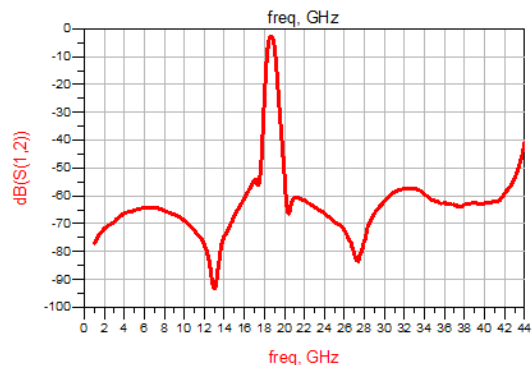
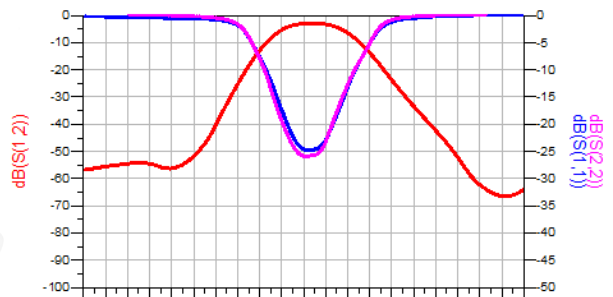
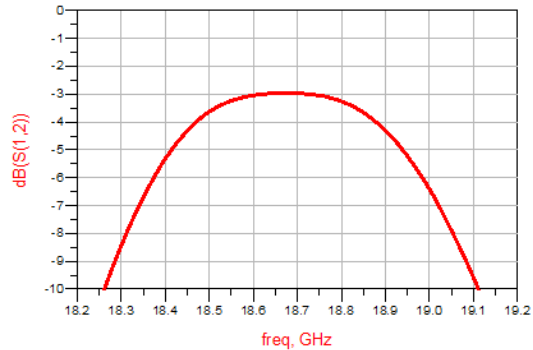
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		18.65		GHz
工作频率	18.6		18.7	GHz
中心损耗		3.0	3.5	dB
带内波动		0.5	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-17.5GHz	45	50		dBc
带外抑制@20.2-43.0GHz	45	50		dBc
承受功率			25	dBm
工作温度	-55		+85	°C
储存温度	-55		+125	°C

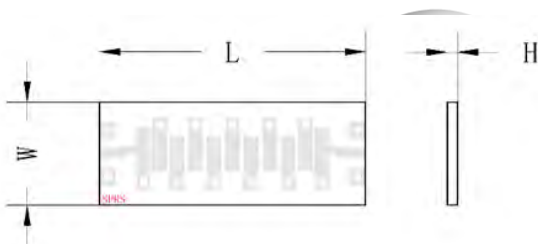
原理图



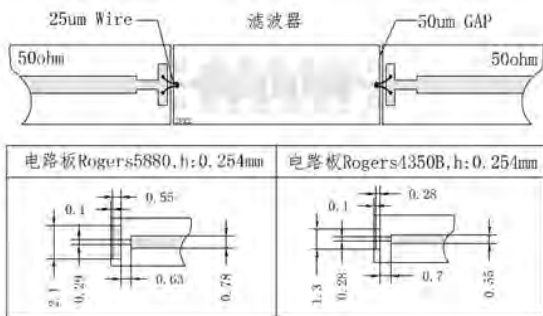
典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



外形图: L: 4.5, W: 2.5, H: 0.254, 端口居中



推荐装配图:



注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖1.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

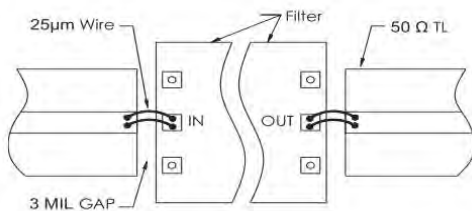
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		20.6		GHz
工作频率	18.6		22.6	GHz
中心损耗		0.9	1.4	dB
带内波动		0.7	0.9	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-15.8GHz	35	40	dBc
	@24.1-46.0GHz	35	40	dBc

环境要求

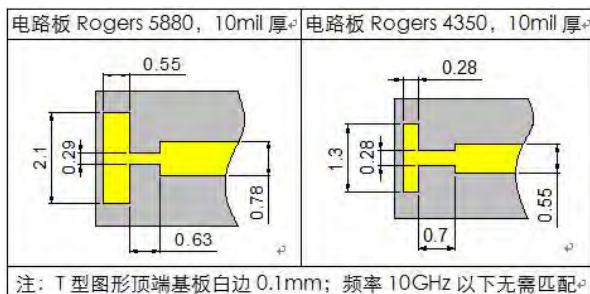
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

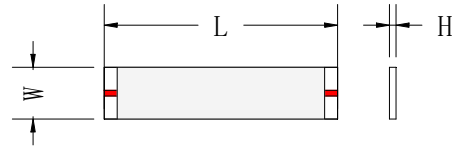
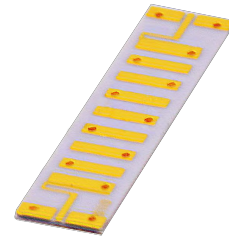


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

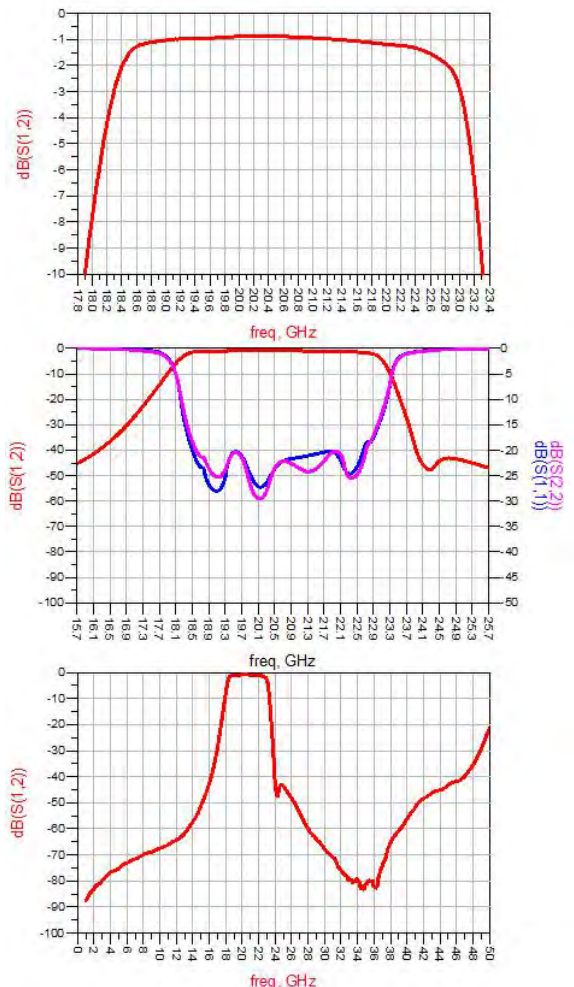


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	5.5	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

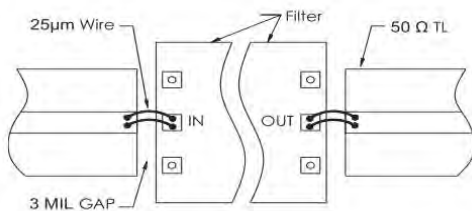
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		24.9		GHz
工作频率	19.2		30.6	GHz
中心损耗		0.8	1.3	dB
带内波动		0.6	0.7	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-15.9GHz	55	60	dBc
	@34.1-50.0GHz	55	60	dBc

环境要求

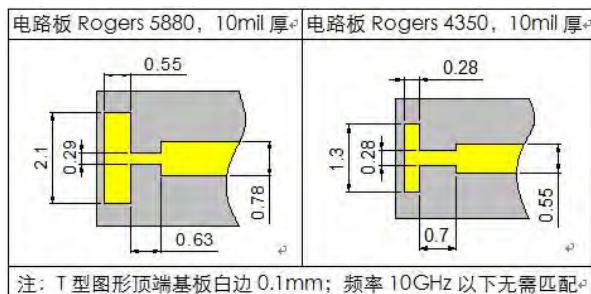
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

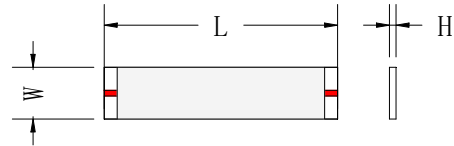
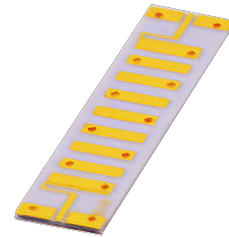


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

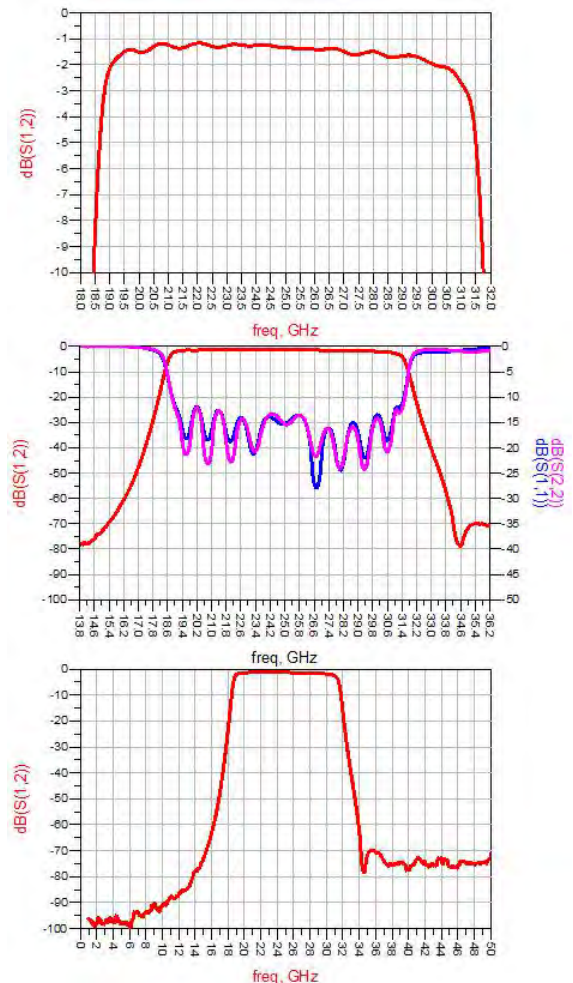


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	2.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



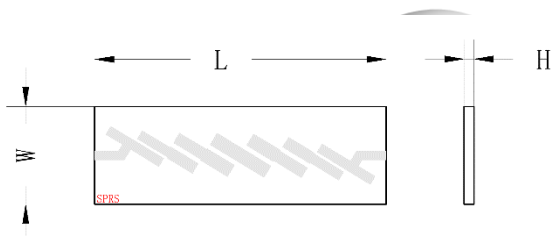
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

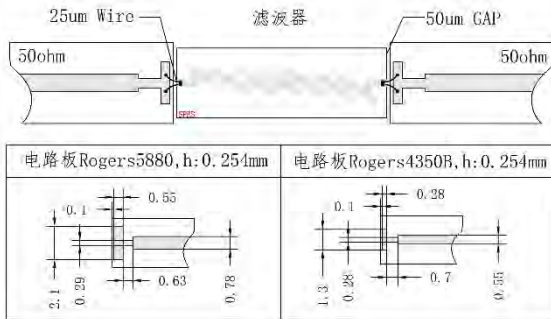
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		19.3		GHz
工作频率		/		GHz
中心损耗		7.6	8.1	dB
带内波动		/		dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-18.7GHz	36	41		dBc
带外抑制@20.2-29.0GHz	43	48		dBc
承受功率			20	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 6.0, W: 3.5, H: 0.254, 端口居中



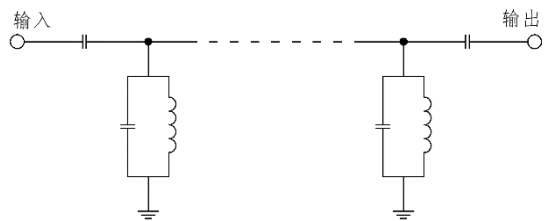
推荐装配图:



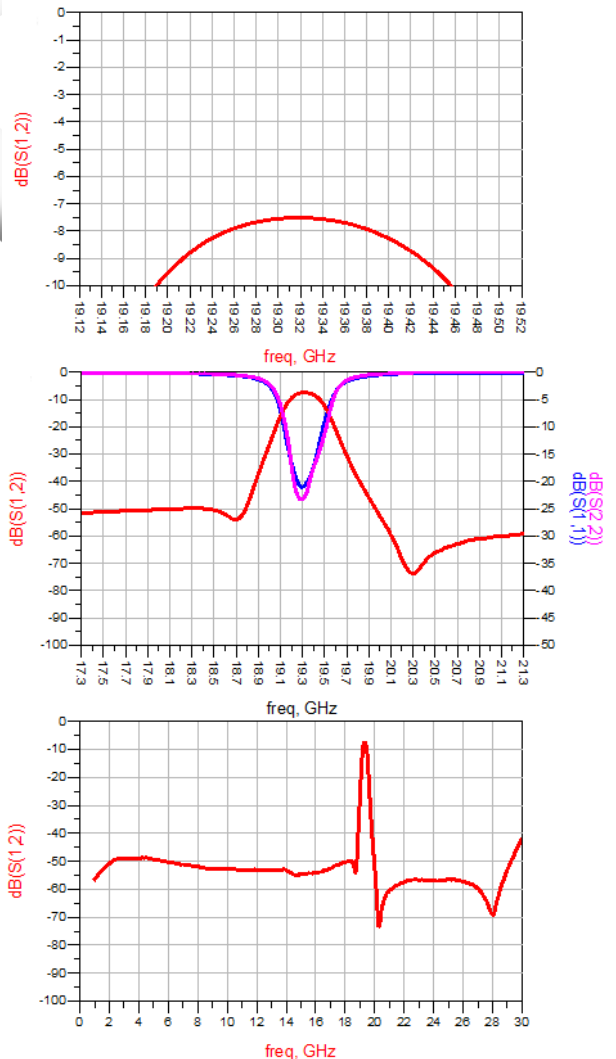
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

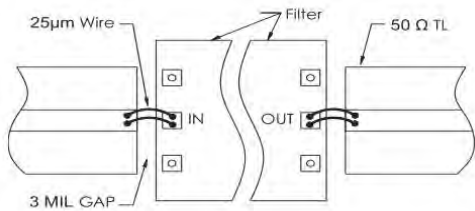
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		20.3		GHz
工作频率	19.3		21.3	GHz
中心损耗		2.2	2.7	dB
带内波动		0.9	1.2	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-18.2GHz	45	50	dBc
	@22.4-45.0GHz	45	50	dBc

环境要求

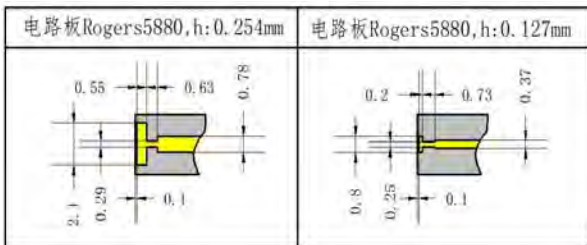
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

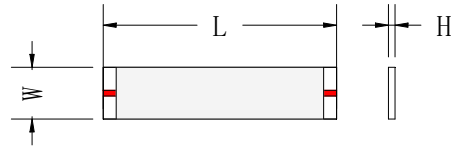
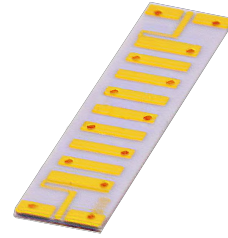


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

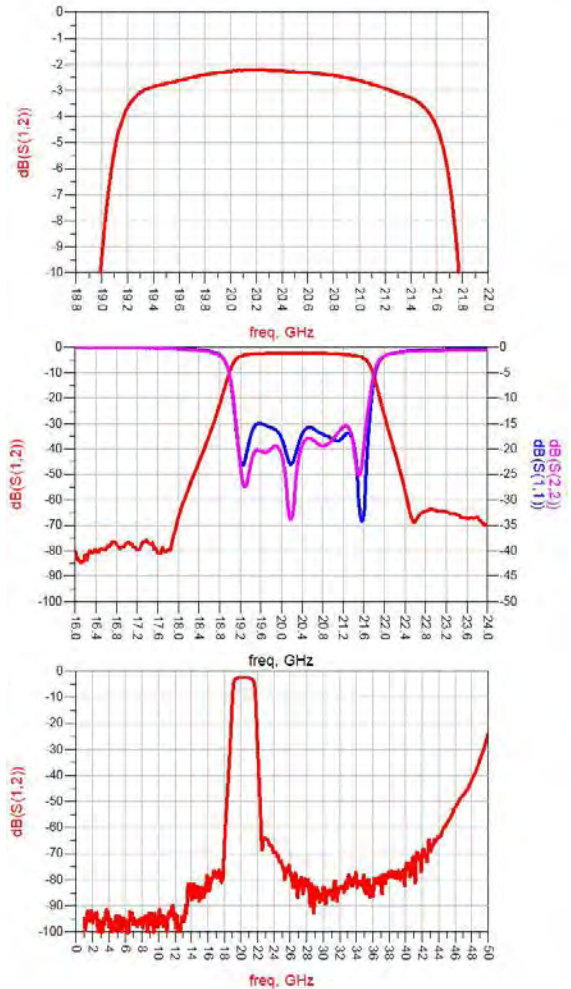


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

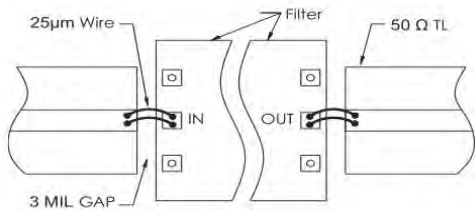
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		22.3		GHz
工作频率	19.6		25.0	GHz
中心损耗		1.9	2.3	dB
带内波动		1.1	1.5	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-16.8GHz	60	65	dBc
	@27.2-46.0GHz	60	65	dBc

环境要求

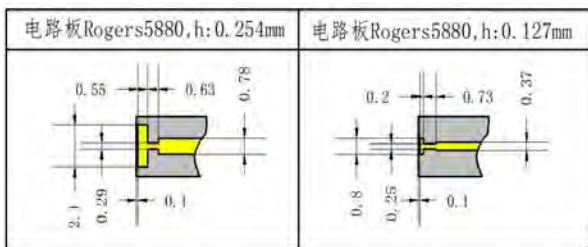
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

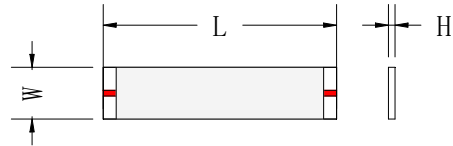
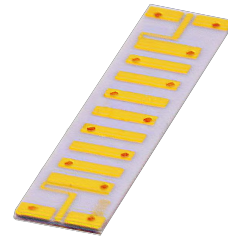


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

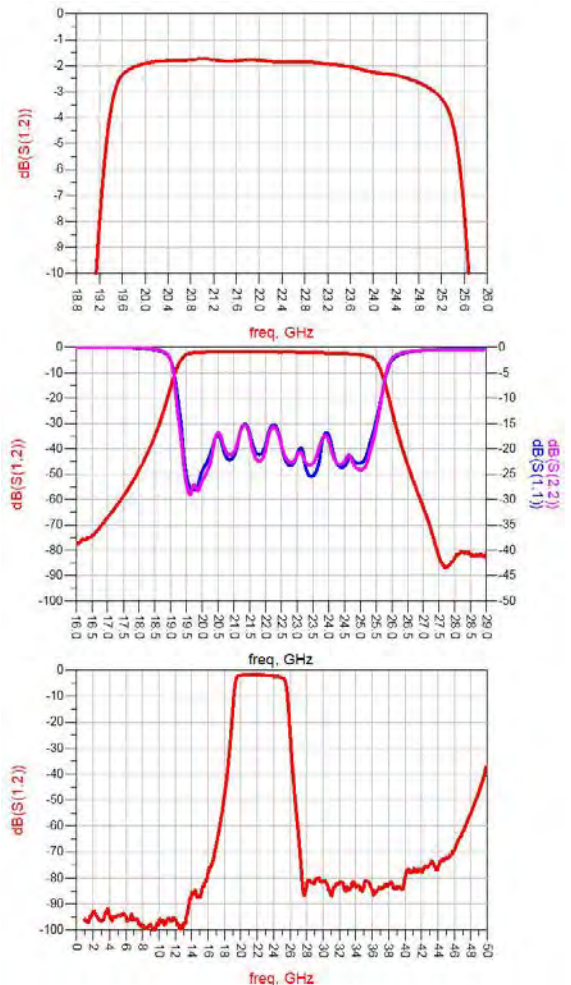


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.2	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

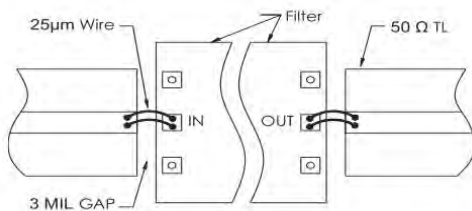
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		19.95		GHz
工作频率	19.8		20.1	GHz
中心损耗		2.5	3.0	dB
带内波动		0.5	1.0	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-18.4GHz	50	55	dBc
	@21.4-33.0GHz	50	55	dBc

### 环境要求

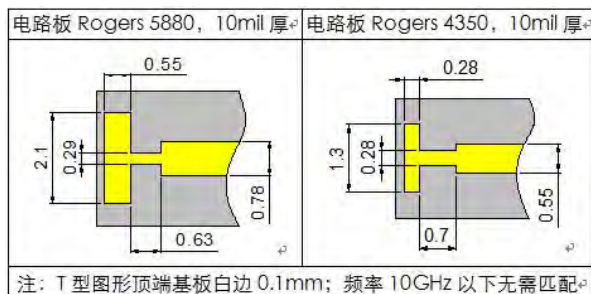
最大输入功率	30	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

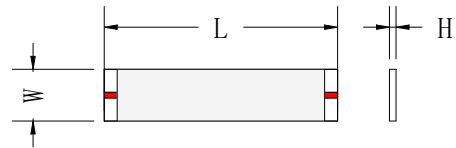


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

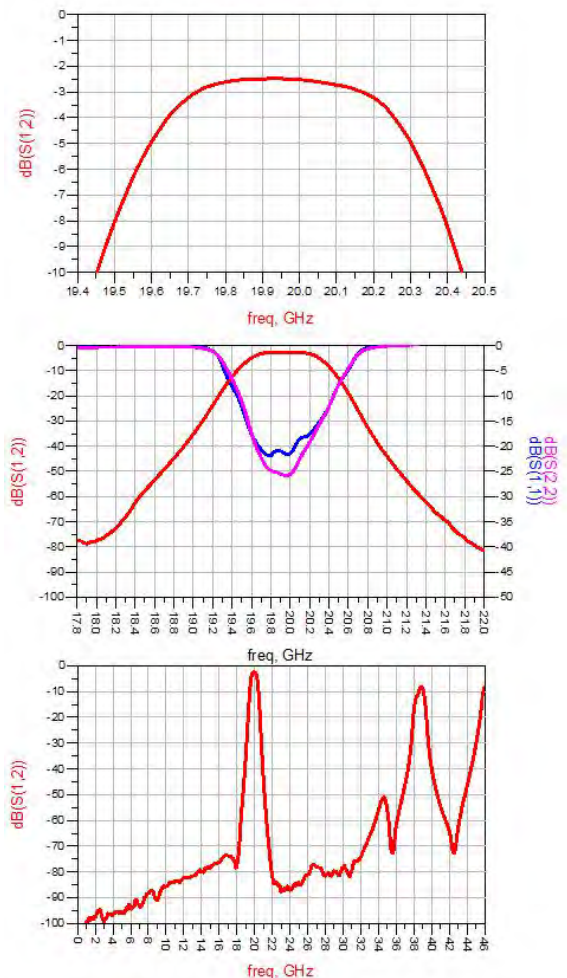


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	10.0	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块

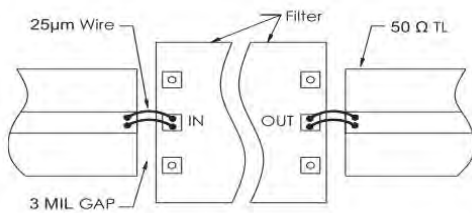
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		23.0		GHz
工作频率	19.9		26.1	GHz
中心损耗		1.3	1.6	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-16.0GHz	60	65	dBc
	@29.0-43.0GHz	60	65	dBc

环境要求

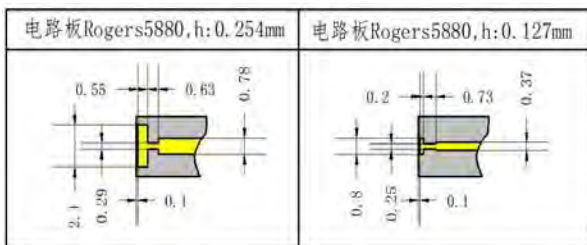
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

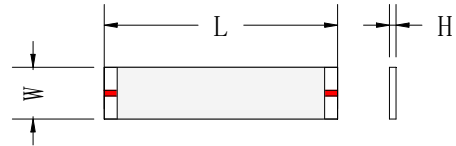
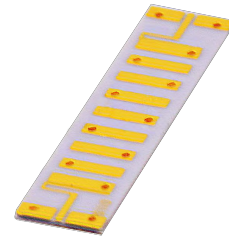


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁**0.1mm**,表面距上盖**1.75mm**,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配,T型尺寸如下:

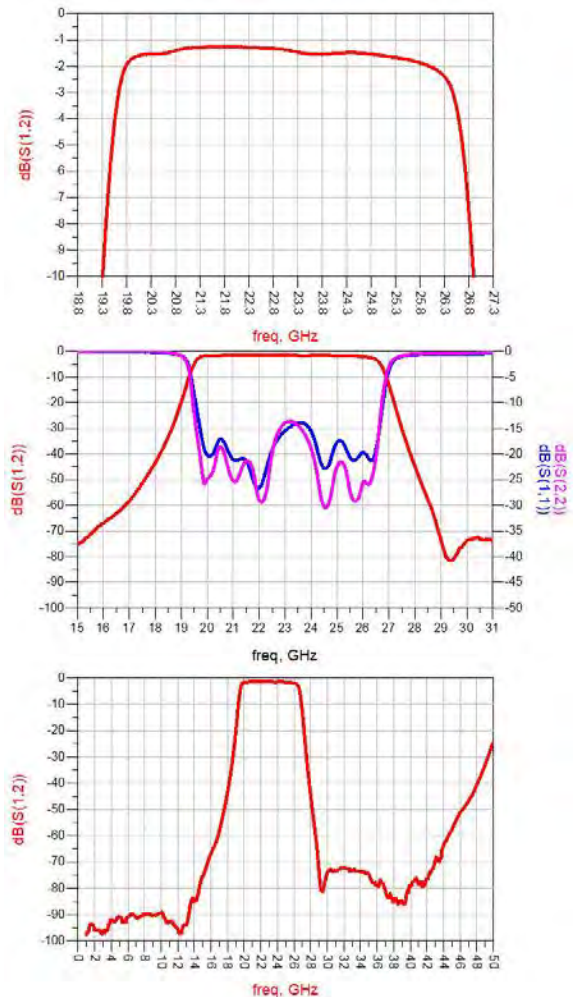


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.5	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

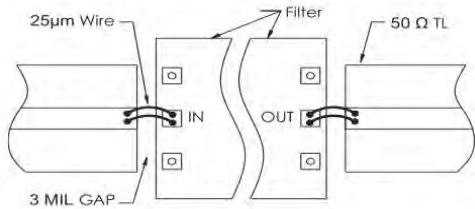
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		20.7		GHz
工作频率	20.0		21.4	GHz
中心损耗		1.7	2.2	dB
带内波动		0.8	1.2	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-18.6GHz	45	50	dBc
	@22.7-38GHz	45	50	dBc

环境要求

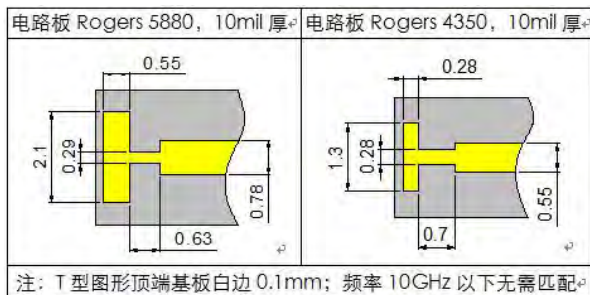
最大输入功率	30	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

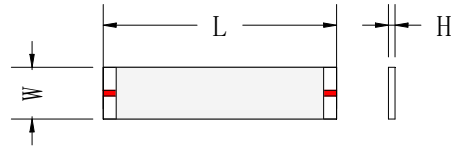
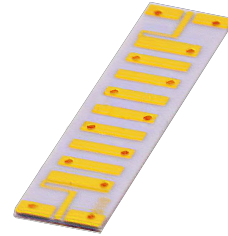


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

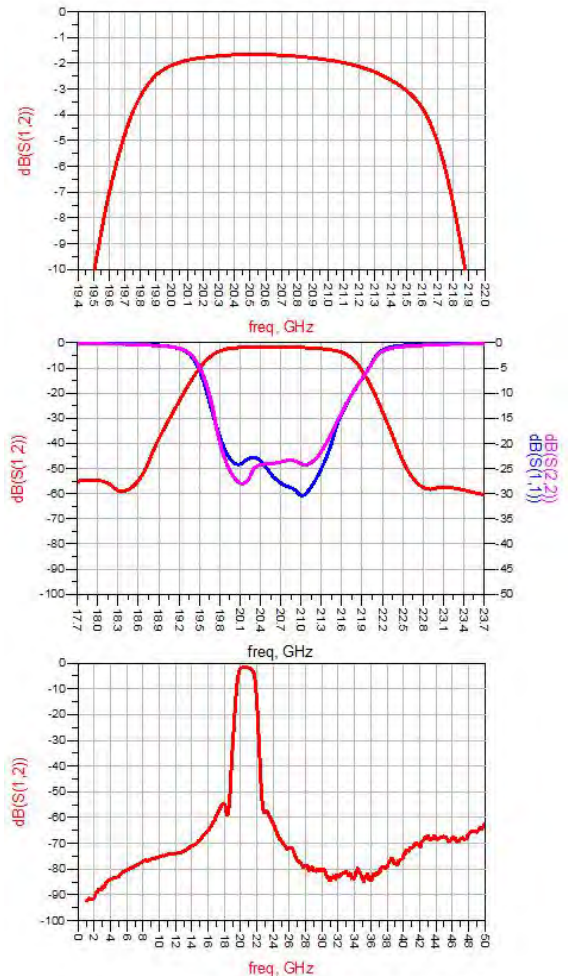


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	2.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

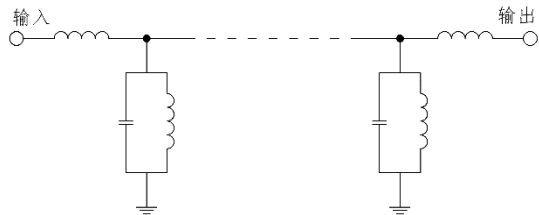
- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块



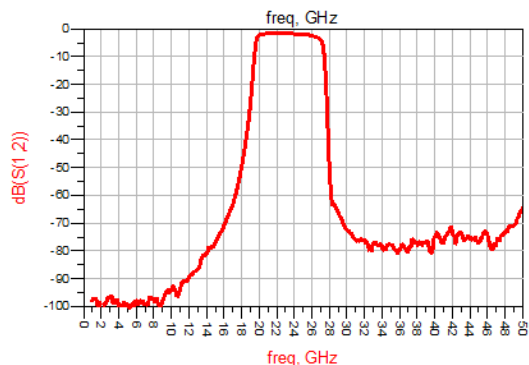
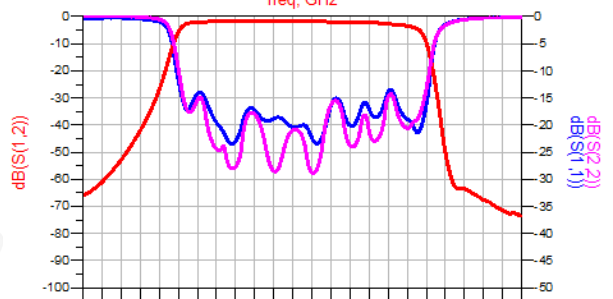
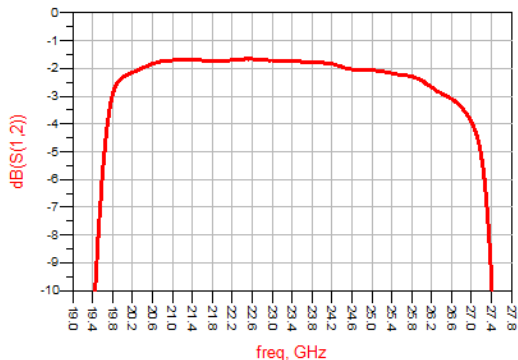
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		23.0		GHz
工作频率	20.0		26.0	GHz
中心损耗		1.8	2.3	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-16.9GHz	55	60		dBc
带外抑制@28.4-50.0GHz	55	60		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

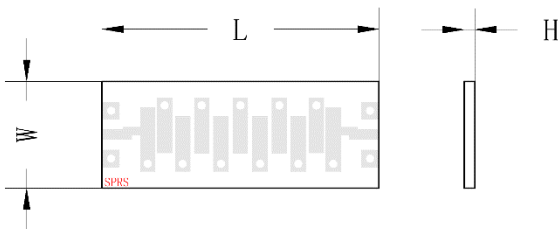
### 原理图



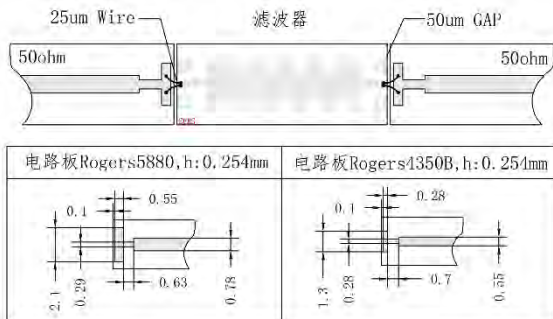
### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



外形图: L: 8.0, W: 2.5, H: 0.254, 端口居中



### 推荐装配图:



### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁0.1mm，表面距上盖2.75mm，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

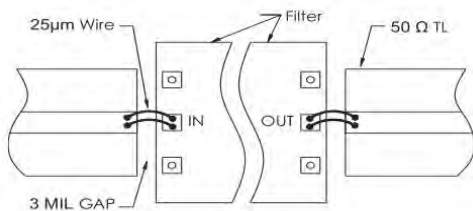
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		24.9		GHz
工作频率	20.0		29.8	GHz
中心损耗		1.5	2.0	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	14		
带外抑制	@16.4-17.5GHz	40	45	dBc
	@32.8-33.7GHz	40	45	dBc
	@DC-16.4GHz	55	60	dBc
	@33.7-48GHz	55	60	dBc

### 环境要求

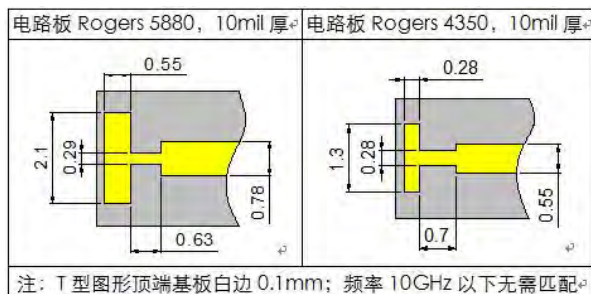
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

### 推荐装配图

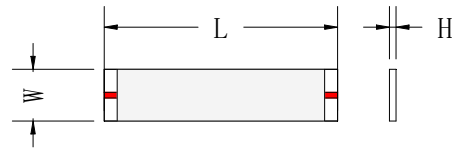
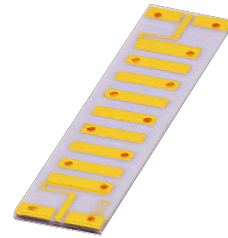


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

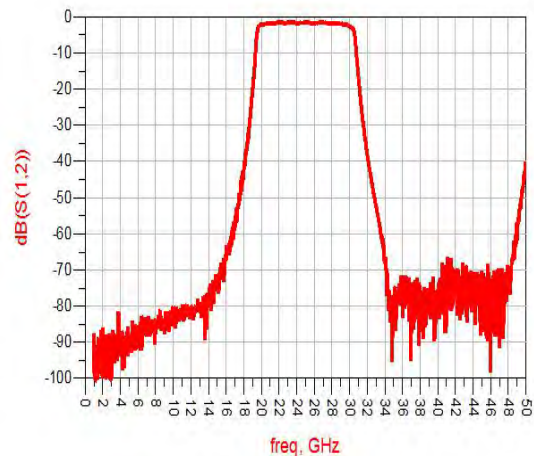
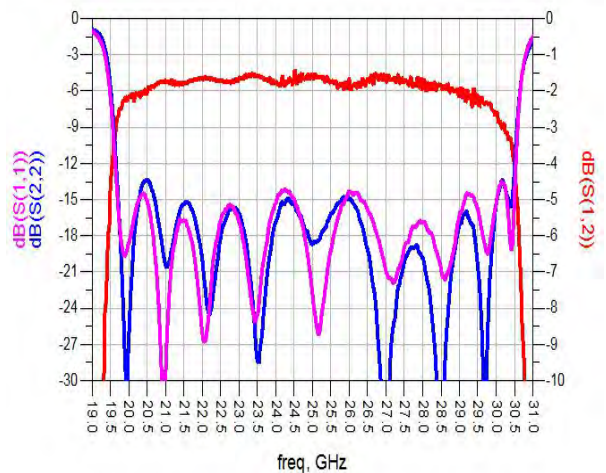


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	2.5	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

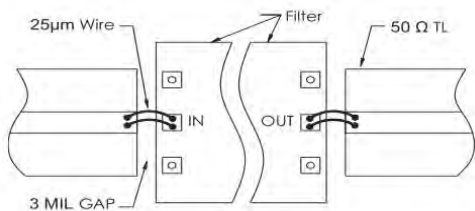
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		21.1		GHz
工作频率	20.1		22.1	GHz
中心损耗		1.8	2.3	dB
带内波动		0.9	1.2	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-19GHz	35	40	dBc
	@23.1-42.0GHz	35	40	dBc

环境要求

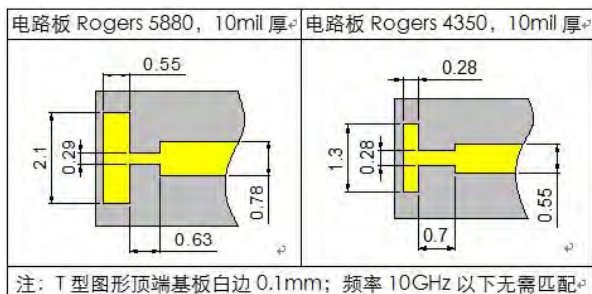
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

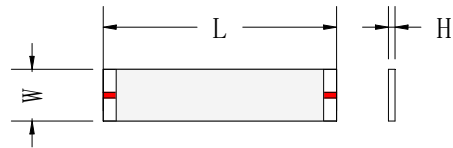
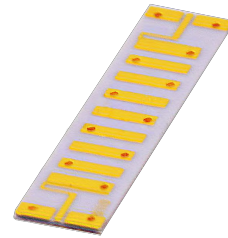


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

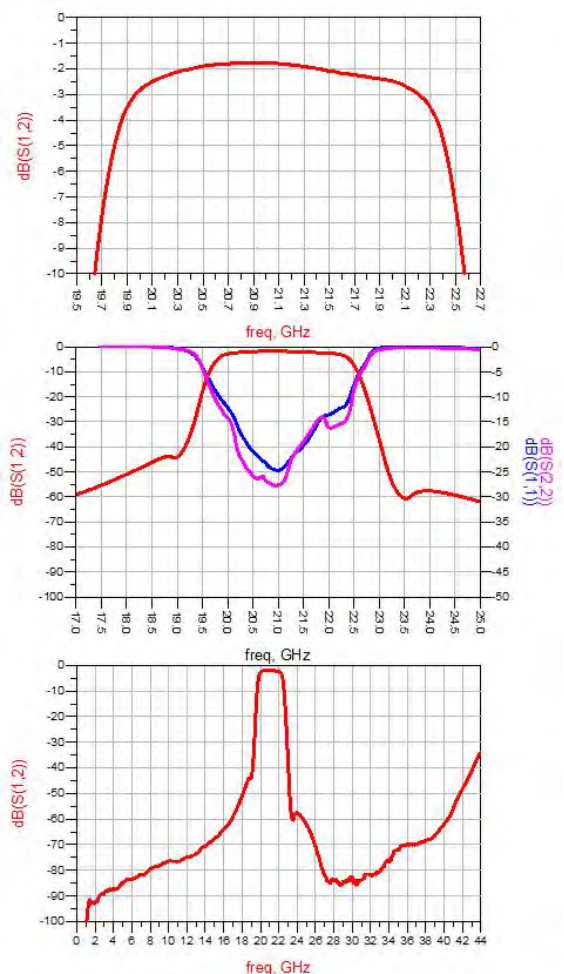


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.5	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

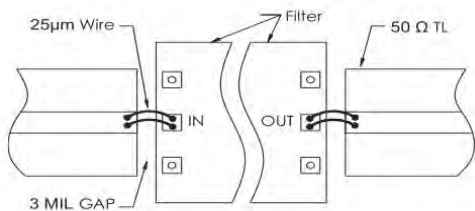
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		21.7		GHz
工作频率	20.2		23.2	GHz
中心损耗		1.3	1.8	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-18.7GHz	45	50	dBc
	@24.8-45GHz	45	50	dBc

环境要求

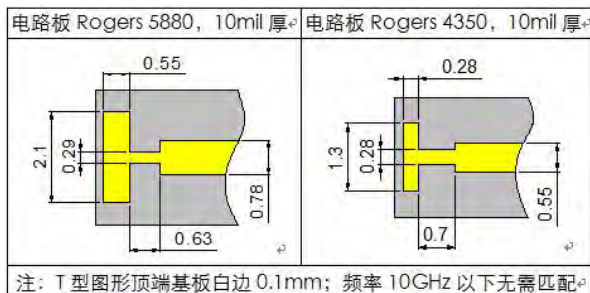
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

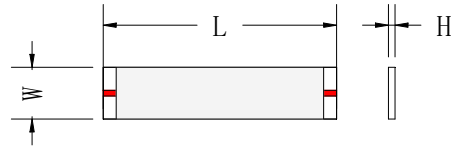
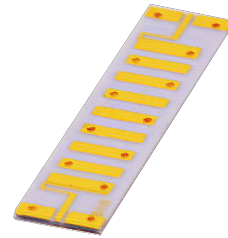


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

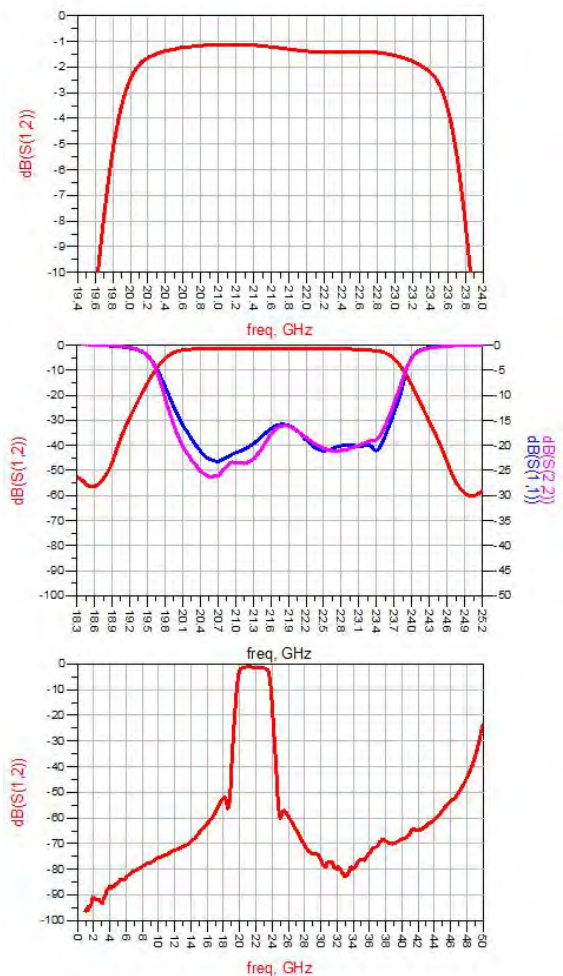


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

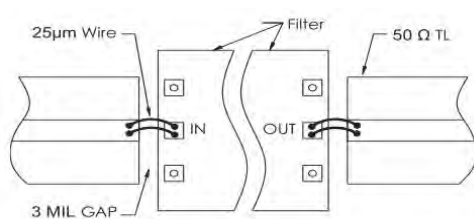
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		22.1		GHz
工作频率	20.2		24.0	GHz
中心损耗		2.0	2.5	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	14		
带外抑制	@DC-17.4GHz	40	45	dBc
	@27.2-37GHz	40	45	dBc

### 环境要求

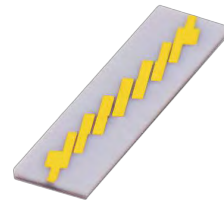
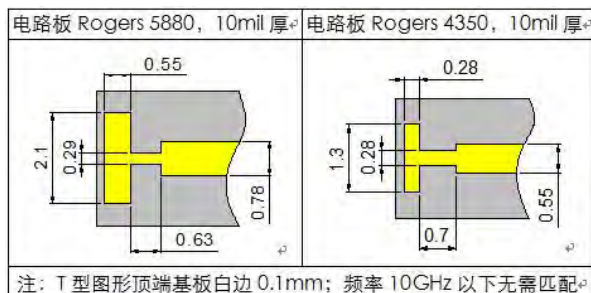
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

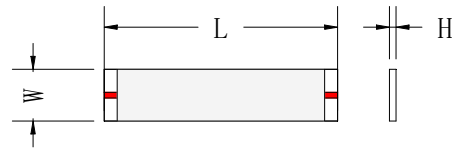


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

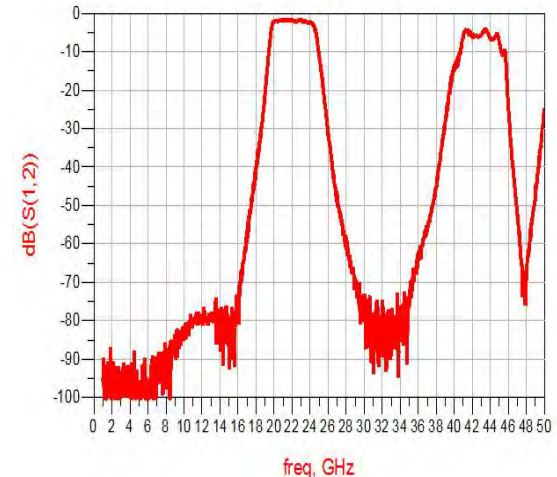
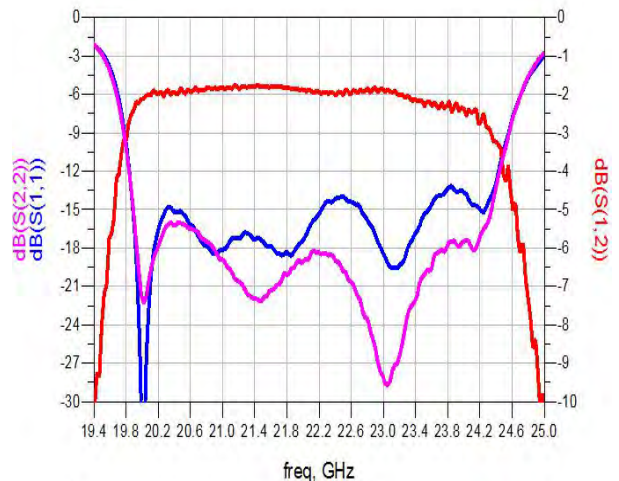


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	9.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

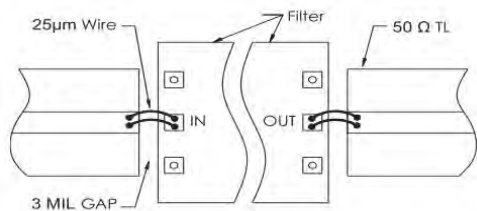
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		22.95		GHz
工作频率	20.4		25.5	GHz
中心损耗		1.3	1.8	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@16.6-18.6GHz	40	45	dBc
	@27.2-27.4GHz	40	45	dBc
	@DC-16.6GHz	60	65	dBc
	@27.7-46GHz	60	65	dBc

环境要求

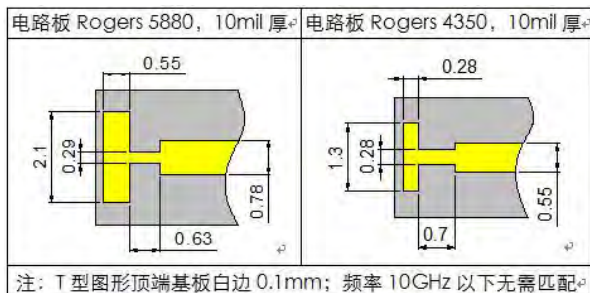
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

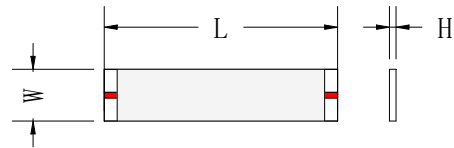
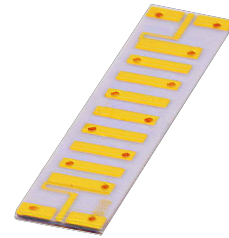


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖1.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

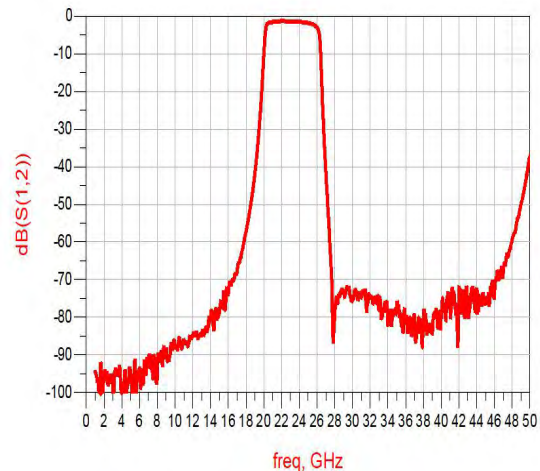
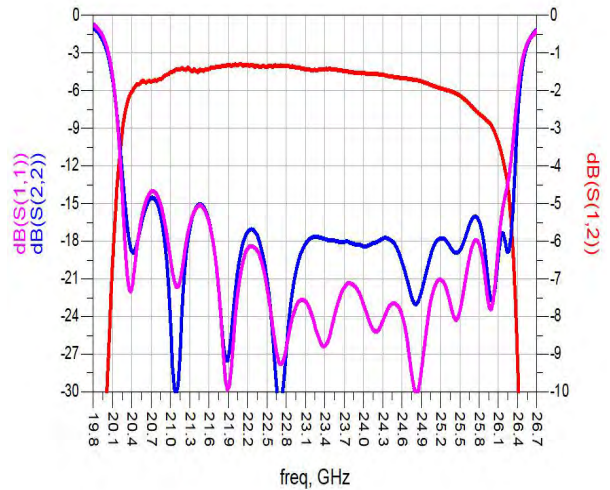


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

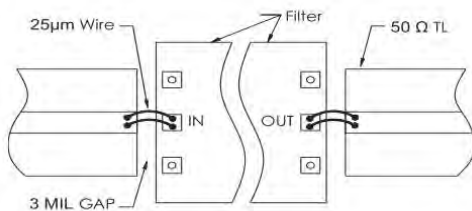
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		21.0		GHz
工作频率	20.7		21.3	GHz
中心损耗		2.2	2.7	dB
带内波动		0.5	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-18.8GHz	40	45	dBc
	@23.0-29GHz	40	45	dBc

### 环境要求

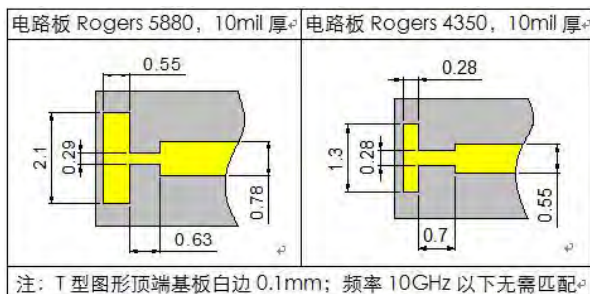
最大输入功率	30	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

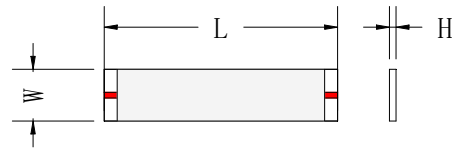


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

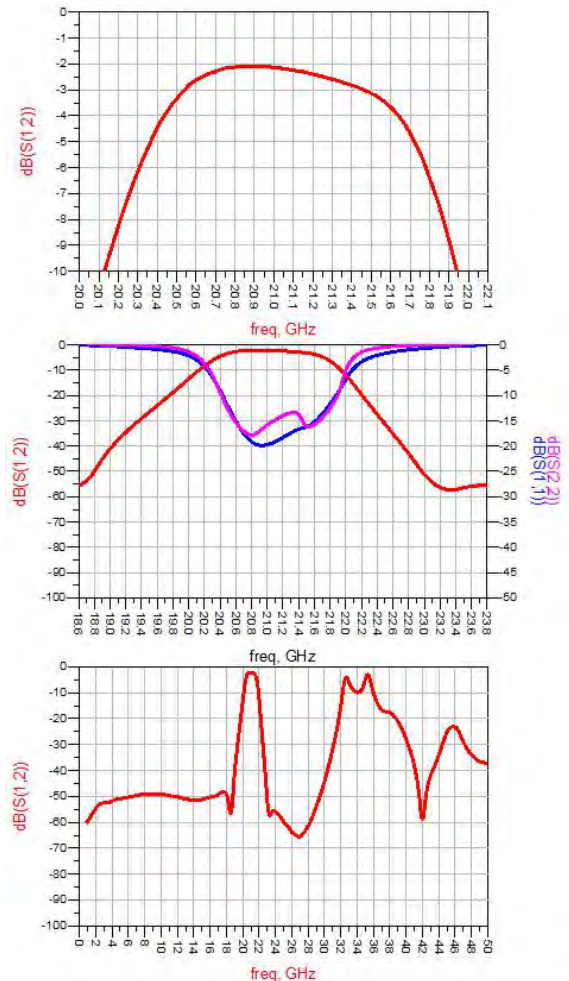


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	2.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

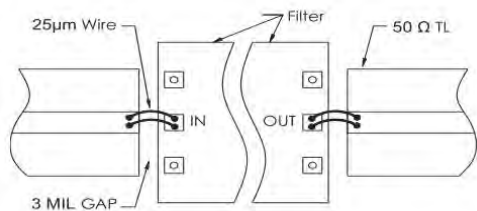
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		23.5		GHz
工作频率	20.7		26.3	GHz
中心损耗		1.4	1.9	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	10	13		
带外抑制	@17.7-19.0GHz	40	45	dBc
	@28.1-28.5GHz	40	45	dBc
	@DC-17.7GHz	60	65	dBc
	@28.5-50GHz	60	65	dBc

环境要求

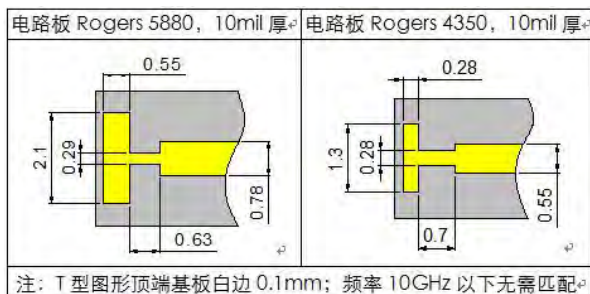
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

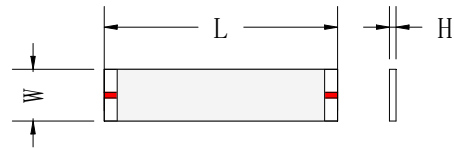
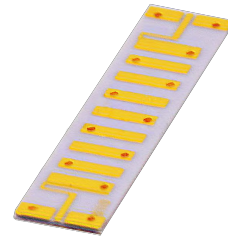


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

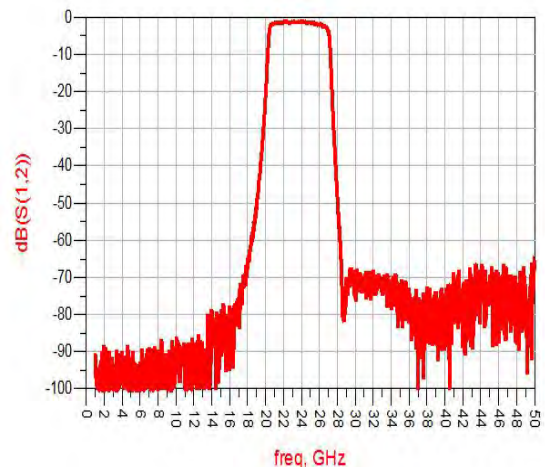
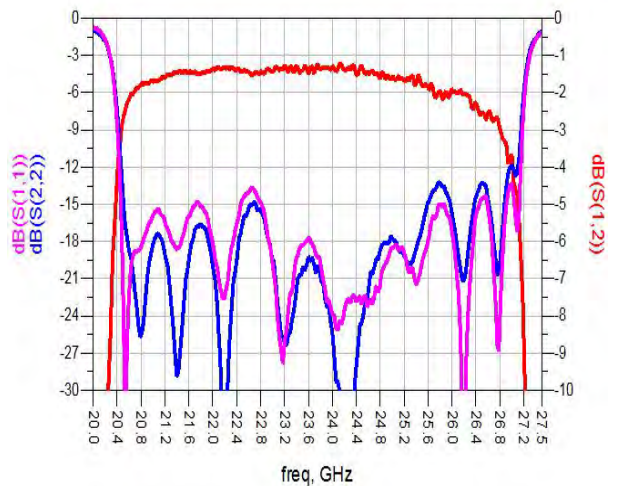


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

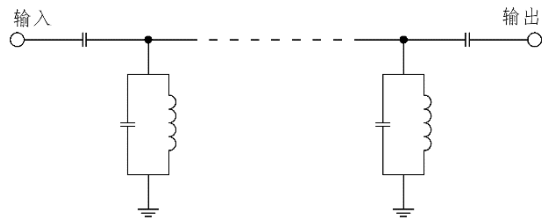
- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块



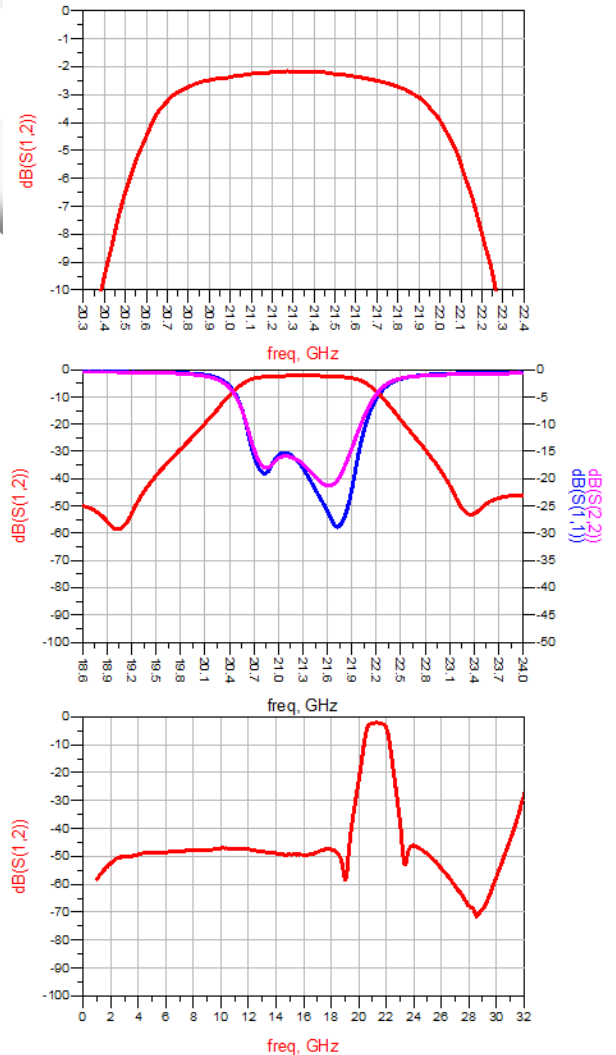
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		21.3		GHz
工作频率	20.8		21.8	GHz
中心损耗		2.2	2.7	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-19.2GHz	40	45		dBc
带外抑制@23.2-30.0GHz	40	45		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	°C
储存温度	-55		+125	°C

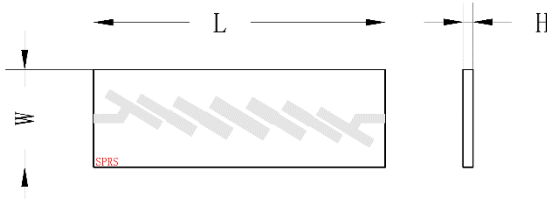
原理图



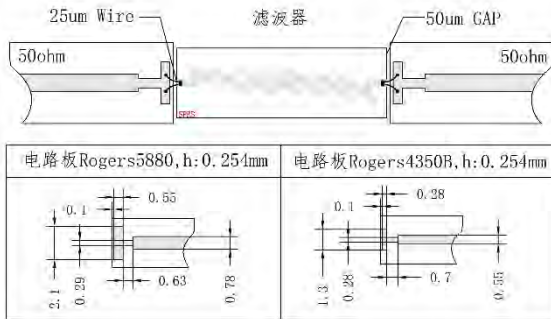
典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



外形图: L: 6.5, W: 2.0, H: 0.254, 端口居中



推荐装配图:



注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖1.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 ≥ 0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

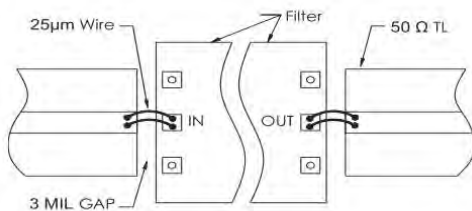
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		21.45		GHz
工作频率	20.9		22.0	GHz
中心损耗		2.2	2.7	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-19.9GHz	45	50	dBc
	@23.3-35.0GHz	45	50	dBc

### 环境要求

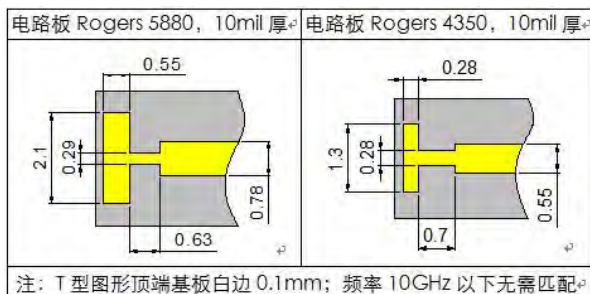
最大输入功率	30	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

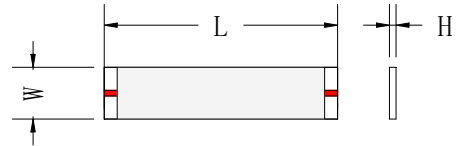


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**1.75mm**，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm / °C),载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配，T型尺寸如下：

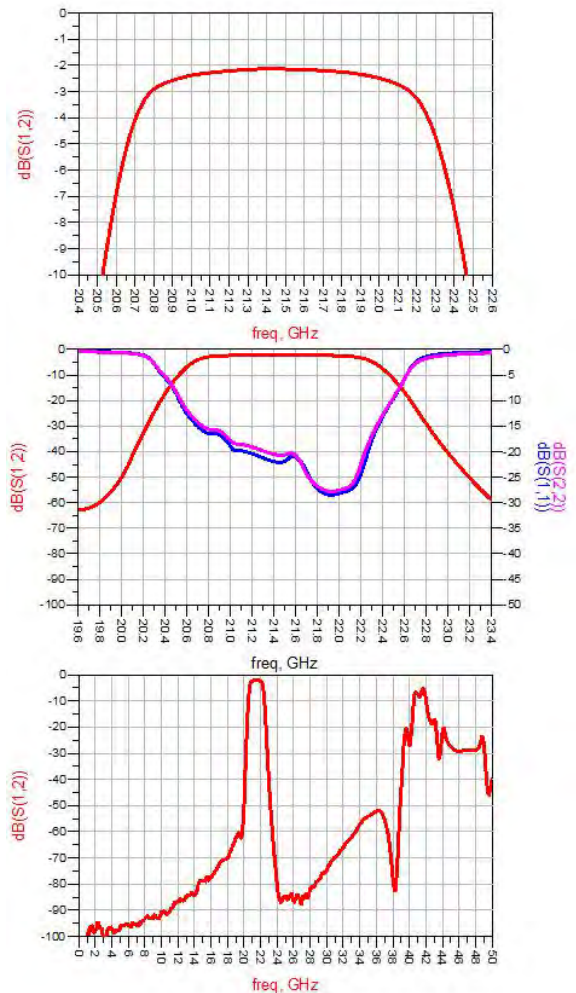


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	11.0	3.0	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



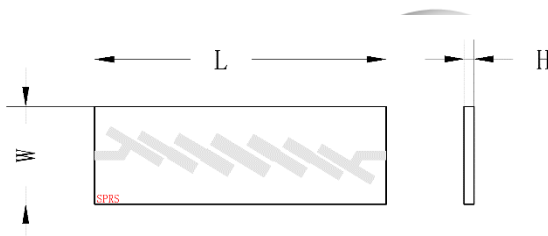
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

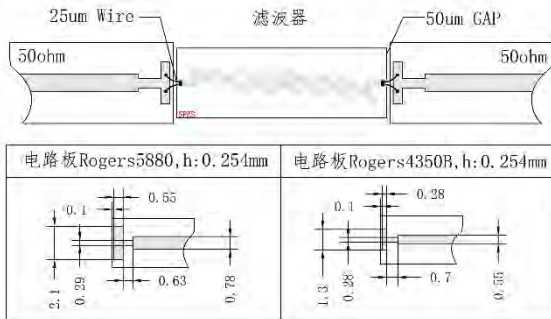
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		21.8		GHz
工作频率	21.2		22.4	GHz
中心损耗		2.4	2.9	dB
带内波动		0.5	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-19.8GHz	55	60		dBc
带外抑制@24.1-31.0GHz	55	60		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 6.5, W: 3.0, H: 0.254, 端口居中



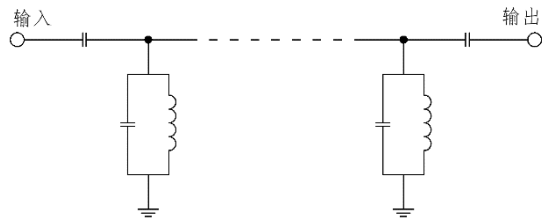
推荐装配图:



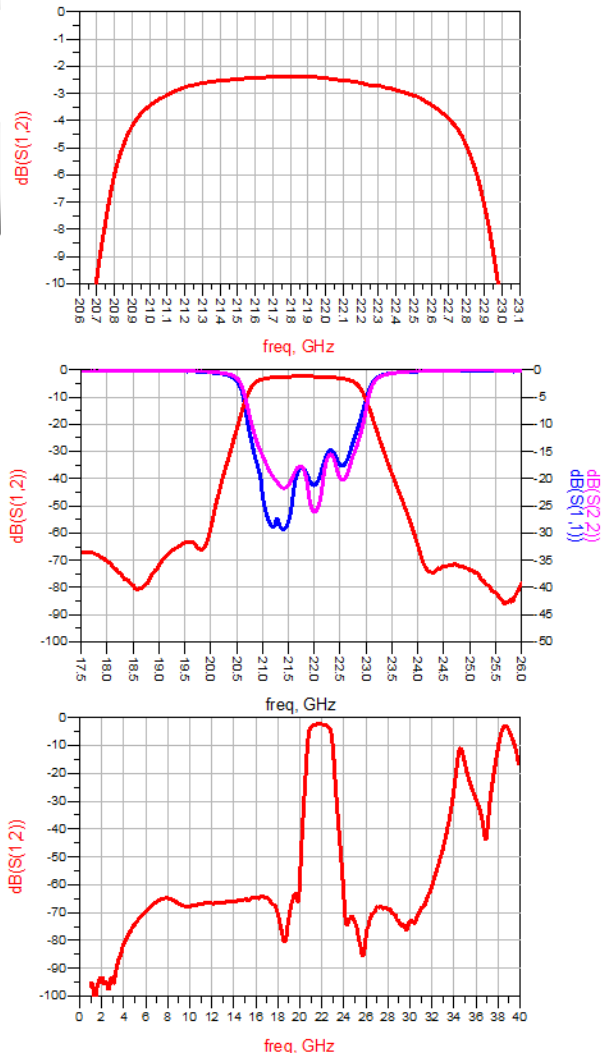
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖1.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

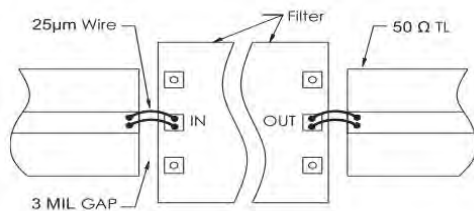
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		21.95		GHz
工作频率	21.5		22.4	GHz
中心损耗		2.8	3.3	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-20.65GHz	40	45	dBc
	@23.35-32.0GHz	40	45	dBc

环境要求

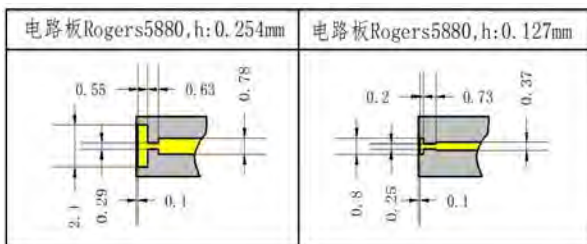
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

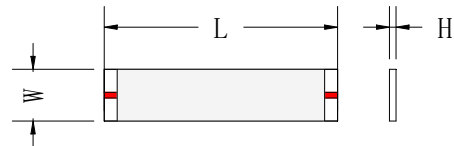


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

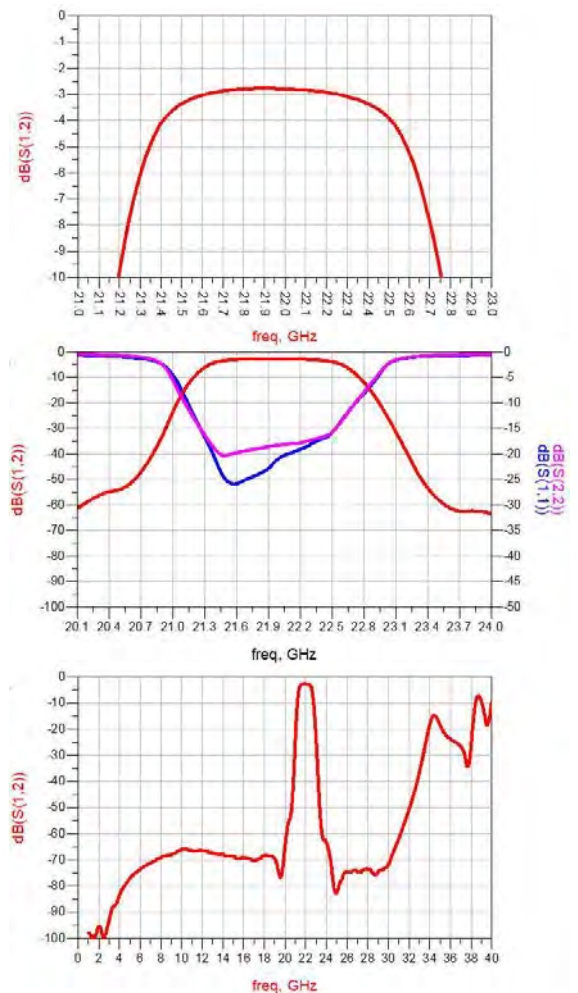


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

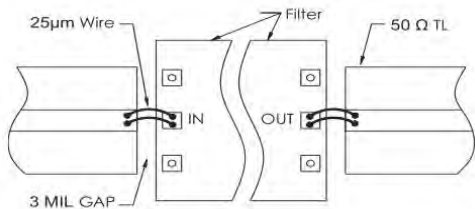
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		22.4		GHz
工作频率	21.6		23.2	GHz
中心损耗		2.3	2.8	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-20.7GHz	40	45	dBc
	@24.4-34.0GHz	40	45	dBc

环境要求

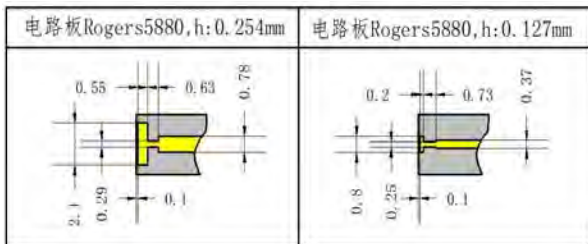
最大输入功率	30	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

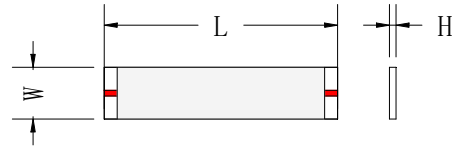


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

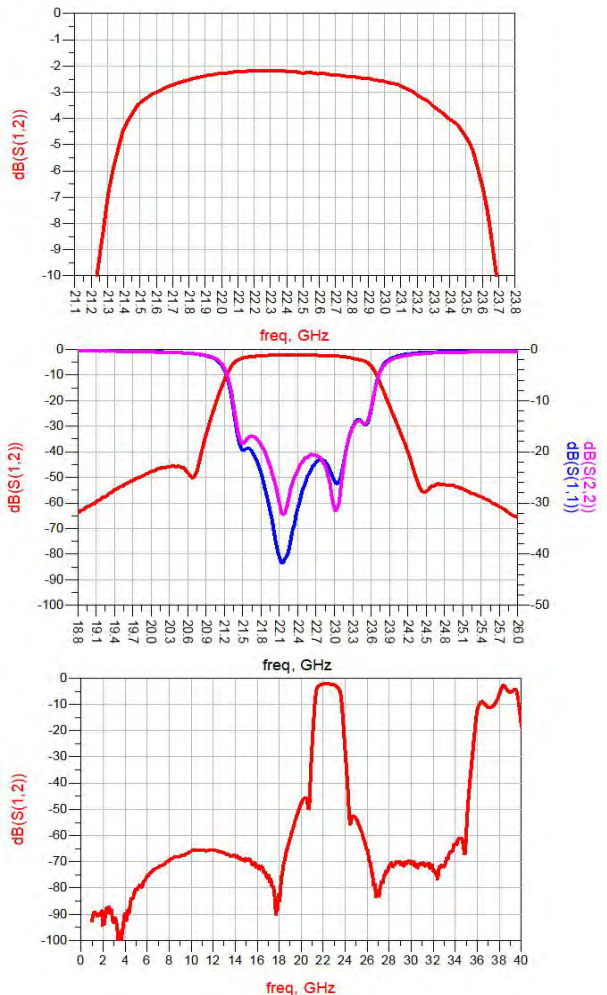


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



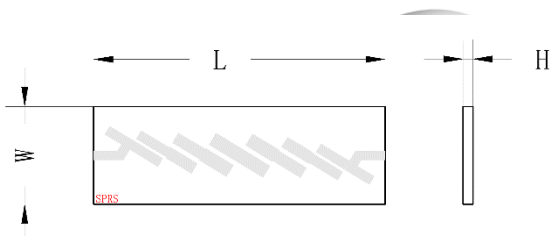
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

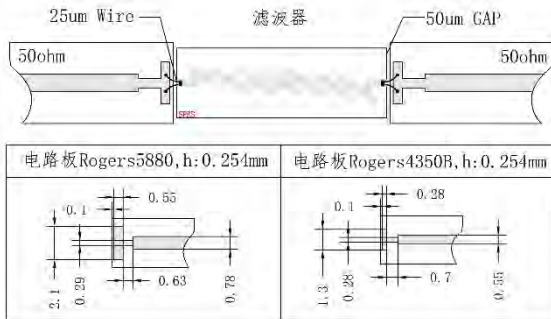
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		23.7		GHz
工作频率	21.6		25.8	GHz
中心损耗		0.8	1.3	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-18.1GHz	55	60		dBc
带外抑制@30.1-38.5GHz	50	55		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 8.0, W: 2.5, H: 0.254, 端口居中



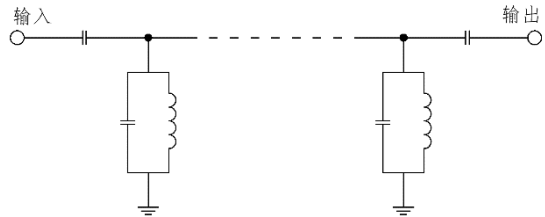
推荐装配图:



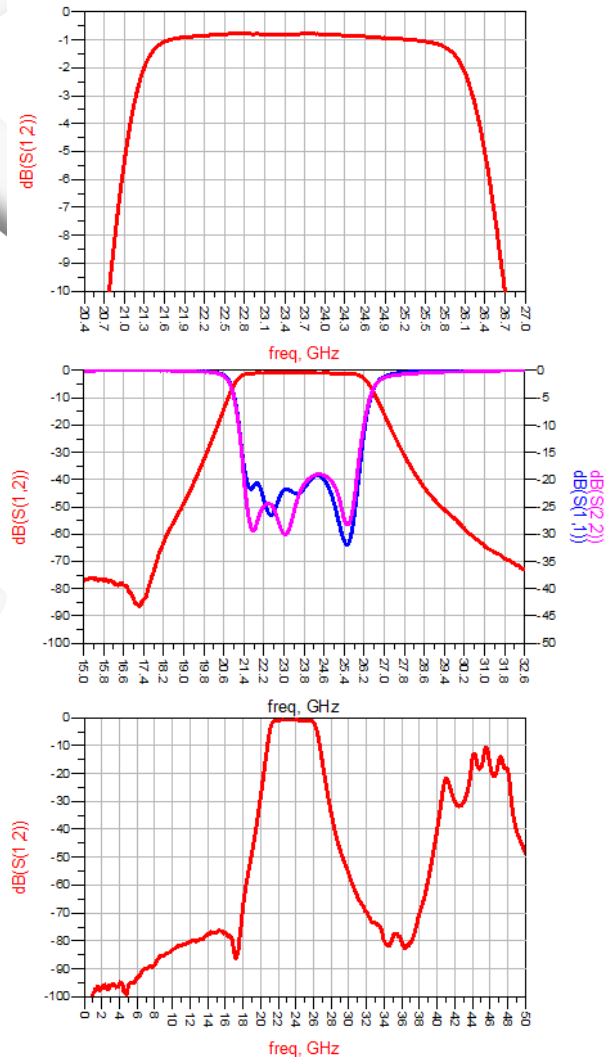
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

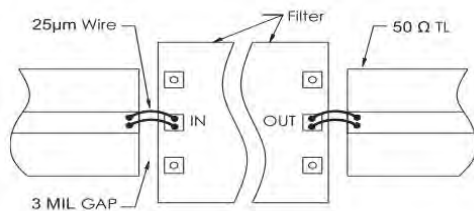
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		22.7		GHz
工作频率	21.7		23.7	GHz
中心损耗		2.0	2.5	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	14		
带外抑制	@19.3-20.2GHz	40	45	dBc
	@25.1-25.6GHz	40	45	dBc
	@DC-19.3GHz	60	63	dBc
	@25.6-50GHz	60	65	dBc

### 环境要求

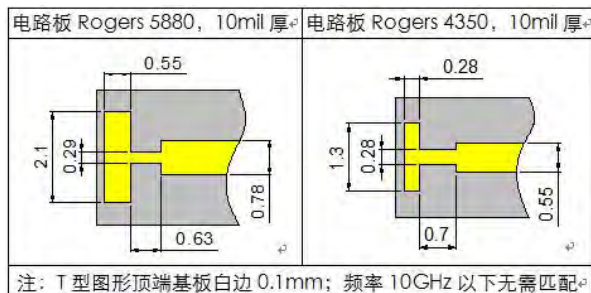
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

### 推荐装配图

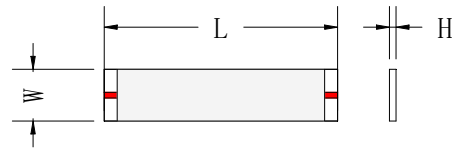
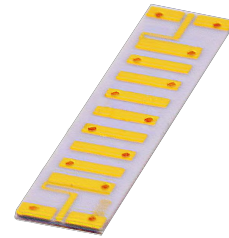


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

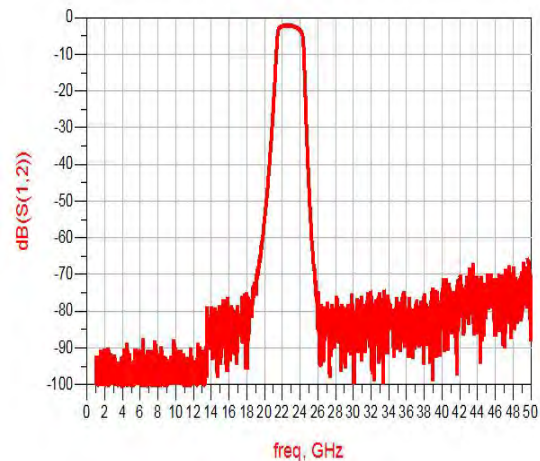
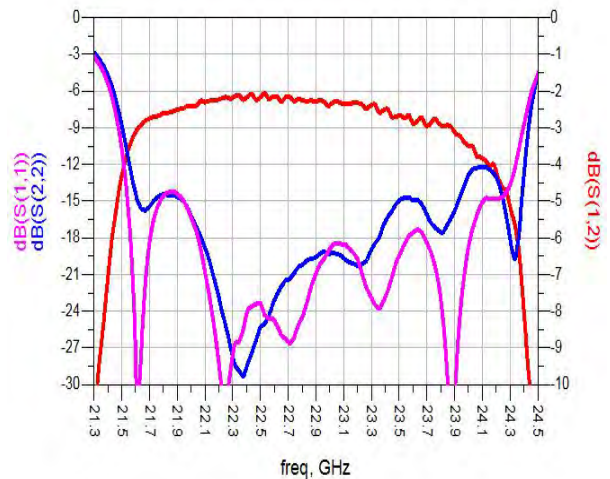


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	2.0	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



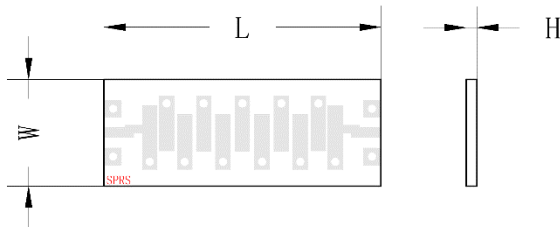
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

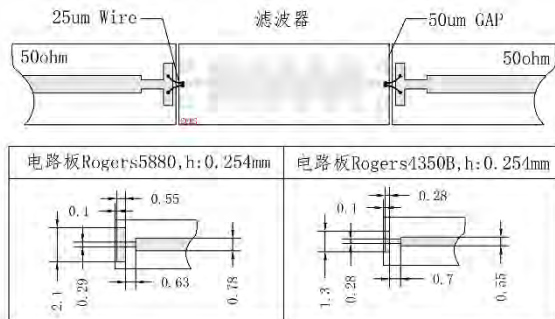
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		24.3		GHz
工作频率	21.8		26.8	GHz
中心损耗		1.4	1.9	dB
带内波动		0.9	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-18.6GHz	43	48		dBc
带外抑制@28.7-48.0GHz	40	45		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^{\circ}\text{C}$

外形图: L: 7.0, W: 2.5, H: 0.254, 端口居中



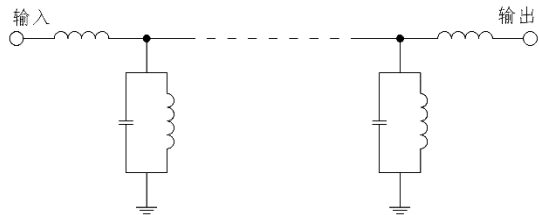
推荐装配图:



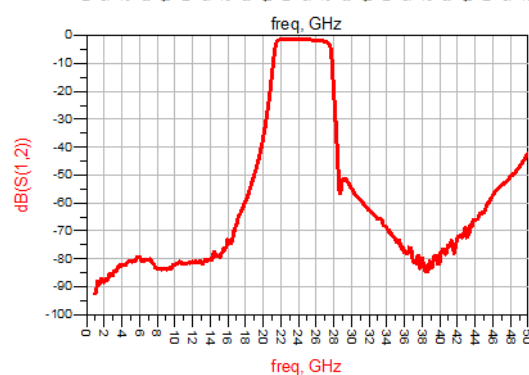
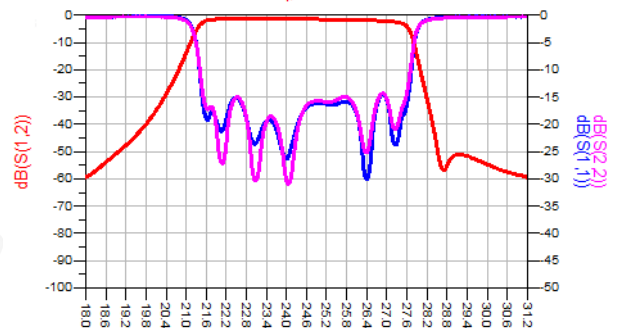
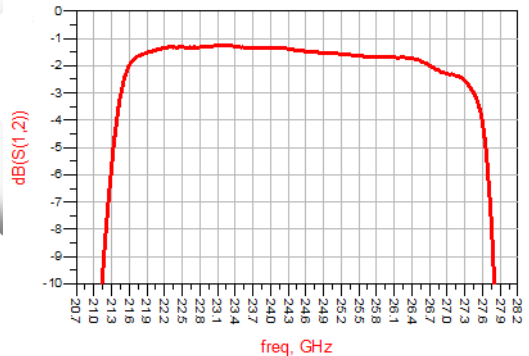
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^{\circ}\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

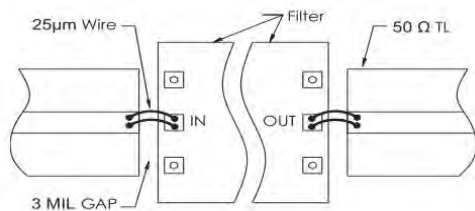
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		25.0		GHz
工作频率	21.8		28.2	GHz
中心损耗		0.5	1.0	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-19.0GHz	43	48	dBc
	@32.5-42GHz	43	48	dBc

### 环境要求

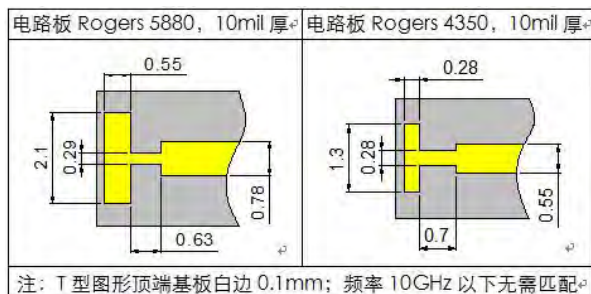
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

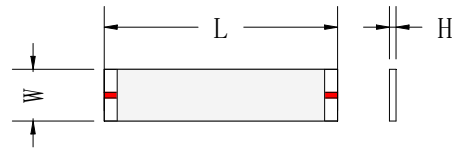


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

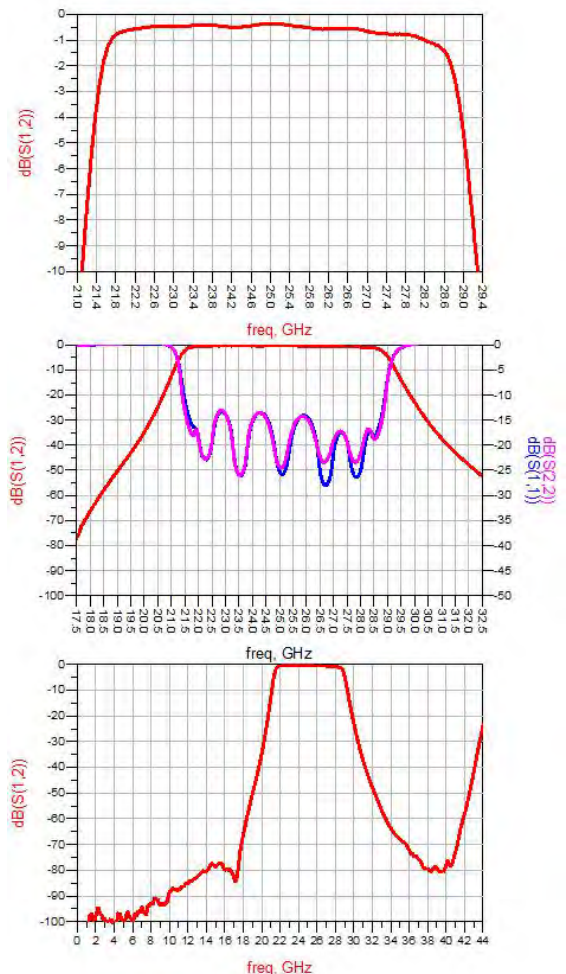


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	9.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

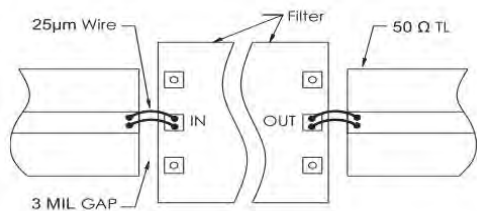
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		23.5		GHz
工作频率	22		25	GHz
中心损耗		2.0	2.5	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	10	12		
带外抑制	@DC-20.7GHz	45	50	dBc
	@27.2-45GHz	45	50	dBc

环境要求

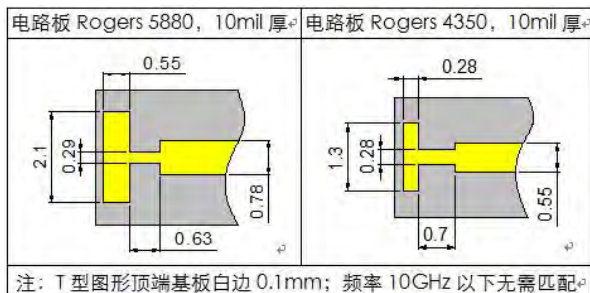
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

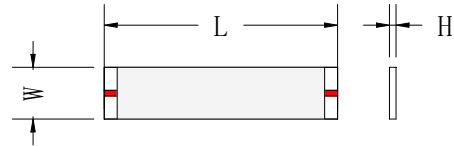
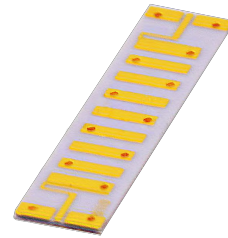


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

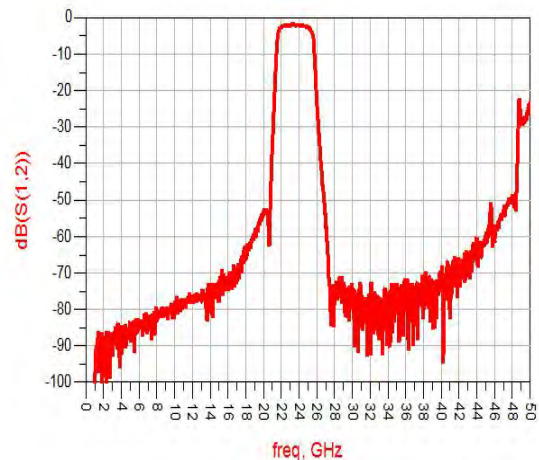
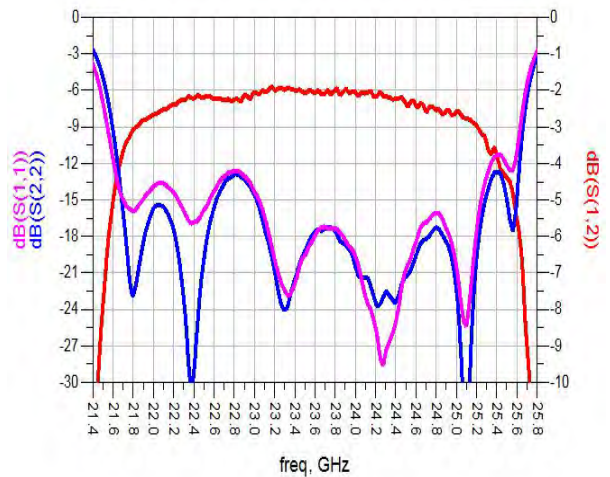


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.5	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

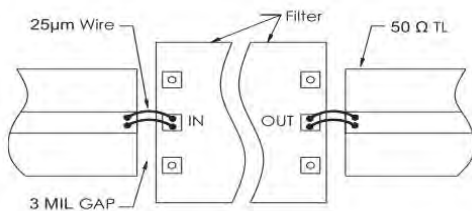
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		22.8		GHz
工作频率	22.1		23.5	GHz
中心损耗		2.0	2.5	dB
带内波动		0.5	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-20.9GHz	39	44	dBc
	@24.8-41GHz	39	44	dBc

环境要求

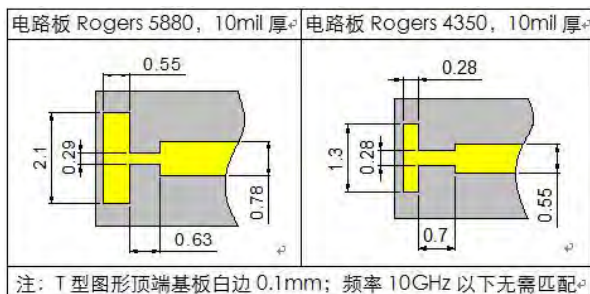
最大输入功率	30	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

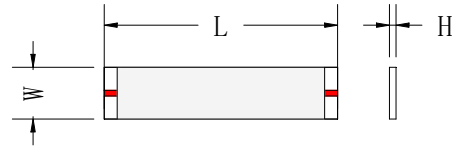
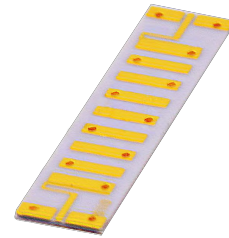


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

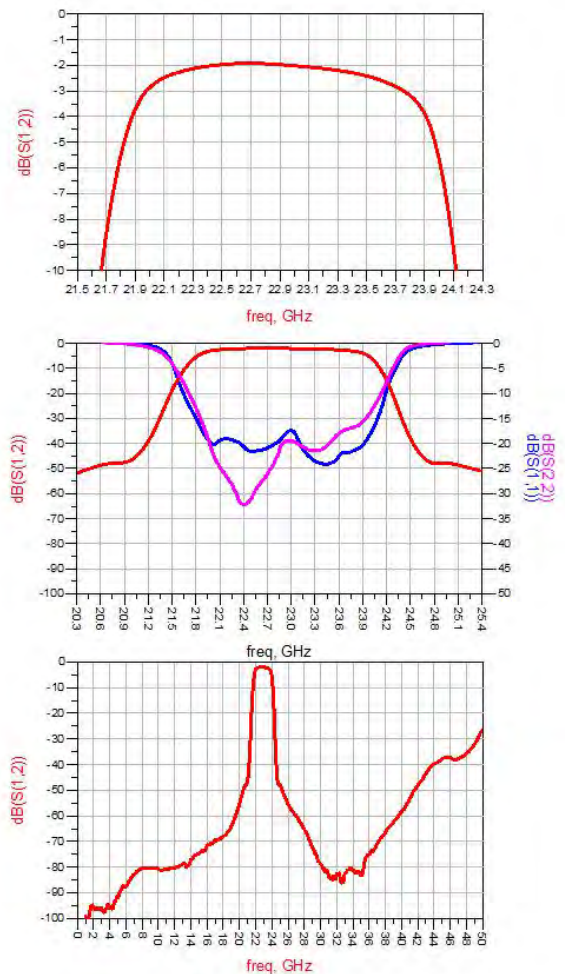


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

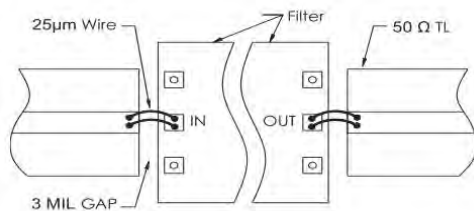
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		22.5		GHz
工作频率	22.2		22.8	GHz
中心损耗		3.6	4.2	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@21.6GHz	30	35	dBc
	@23.5-31.0GHz	40	45	dBc
	@DC-21.0GHz	45	50	dBc

### 环境要求

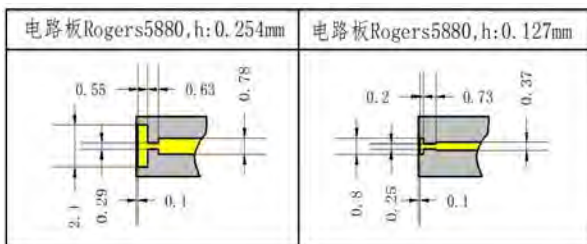
最大输入功率	30	dBm
工作温度	$-55^\circ\text{C}\sim+85^\circ\text{C}$	
储存温度	$-55^\circ\text{C}\sim+125^\circ\text{C}$	

### 推荐装配图

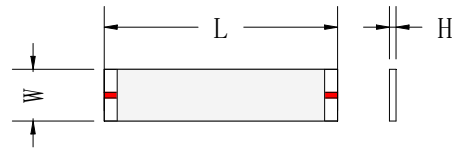


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**1.75mm**，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3. 芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm / °C),载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ；
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配，T型尺寸如下：

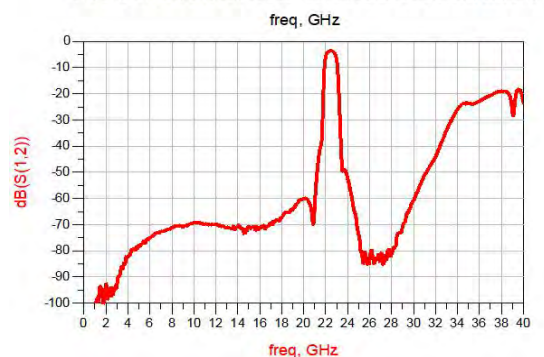
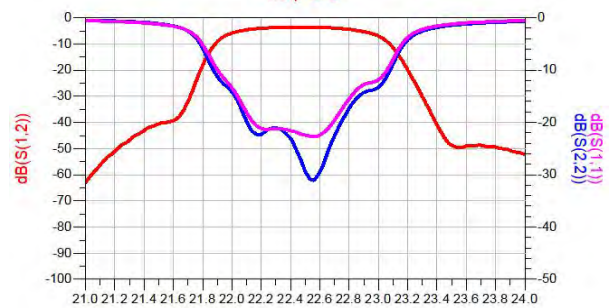


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	3.0	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块

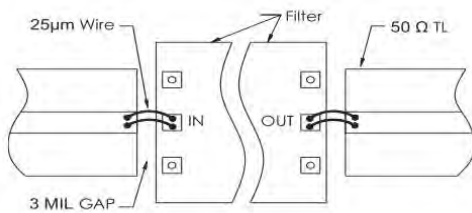
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		24.9		GHz
工作频率	22.2		27.6	GHz
中心损耗		1.6	2.0	dB
带内波动		1.1	1.5	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-19.3GHz	60	65	dBc
	@29.8-45.0GHz	60	65	dBc

环境要求

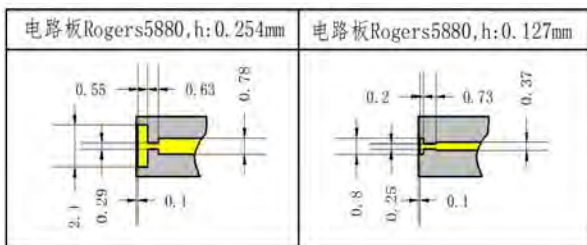
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

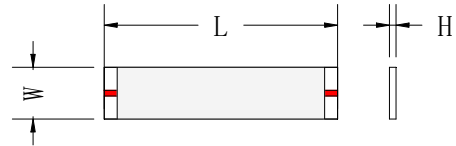
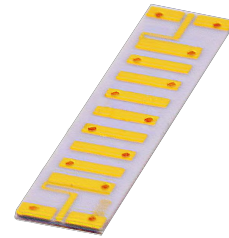


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁**0.1mm**,表面距上盖**1.75mm**,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配,T型尺寸如下:

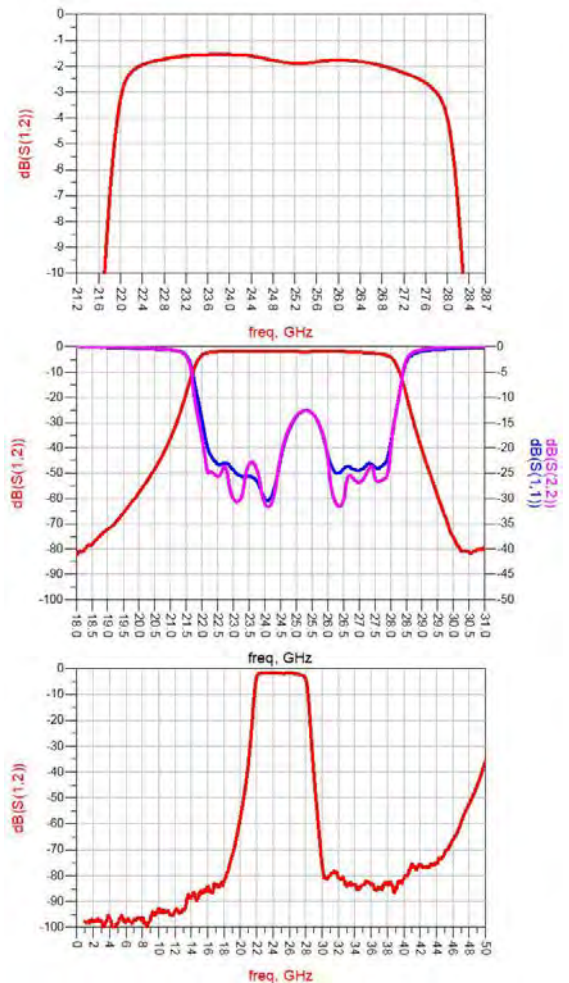


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.4	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

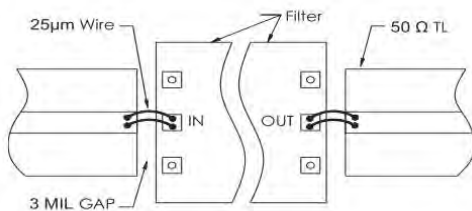
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		22.75		GHz
工作频率	22.5		23.0	GHz
中心损耗		3.7	4.2	dB
带内波动		0.5	0.7	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-21.0GHz	45	50	dBc
	@24.0-49GHz	45	50	dBc

环境要求

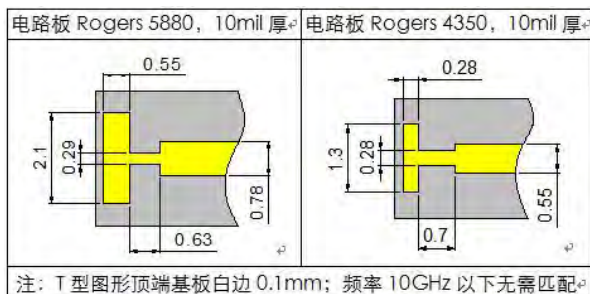
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

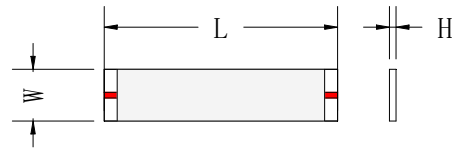
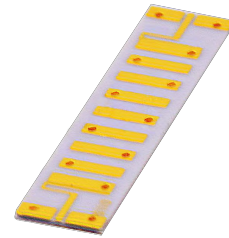


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

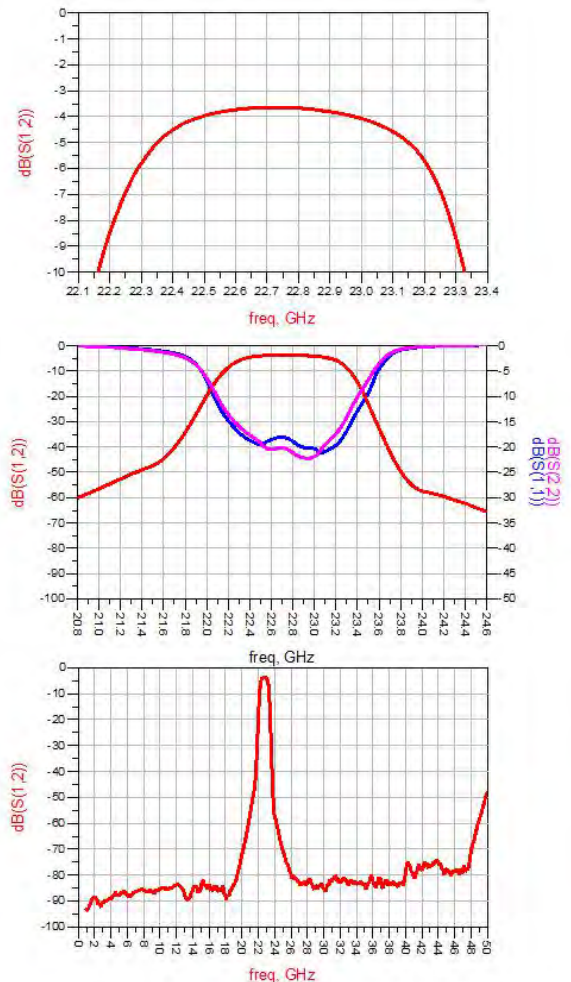


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

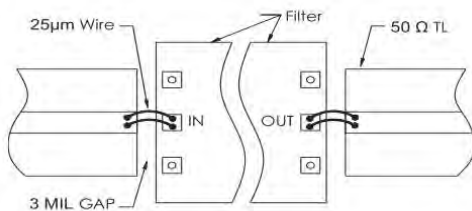
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		27.5		GHz
工作频率	23.2		31.8	GHz
中心损耗		1.3	1.8	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@DC-20.4GHz	40	45	dBc
	@35.6-50GHz	40	45	dBc

### 环境要求

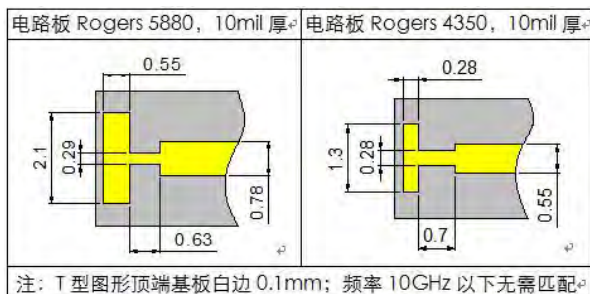
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

### 推荐装配图

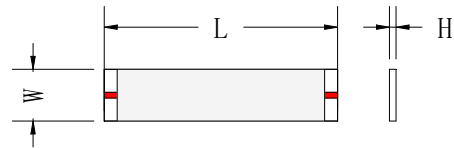
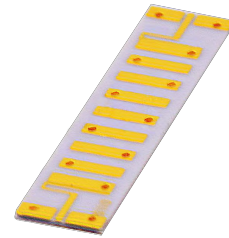


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

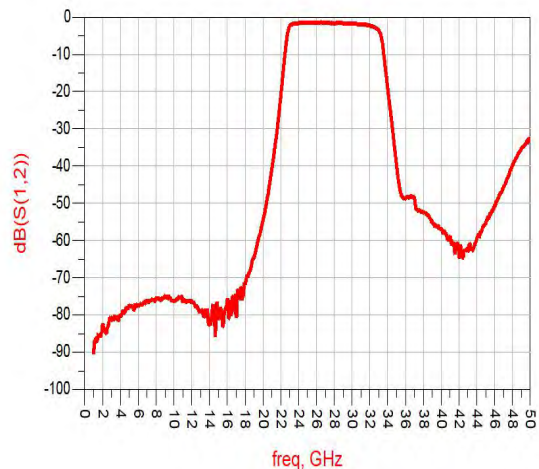
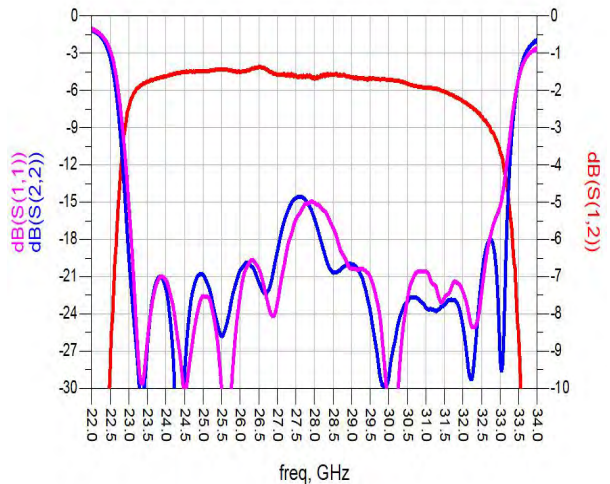


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	9.0	2.8	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

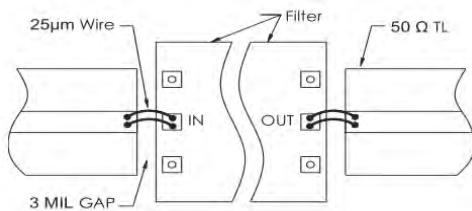
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		28		GHz
工作频率	23.4		32.6	GHz
中心损耗		1.0	1.5	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	14	16		
带外抑制	@DC-19.2GHz	40	45	dBc
	@35.1-47GHz	40	45	dBc

### 环境要求

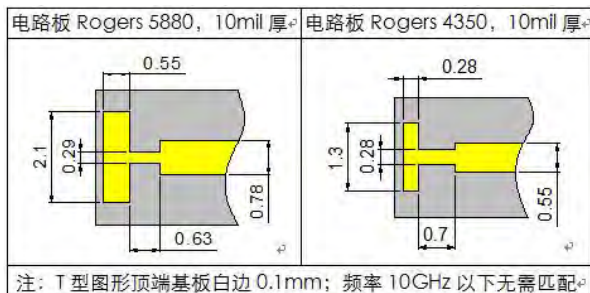
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

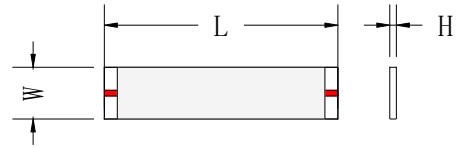
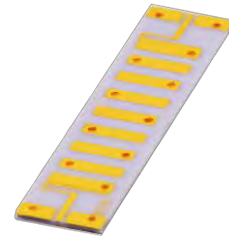


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**1.75mm**，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm；
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配，T型尺寸如下：

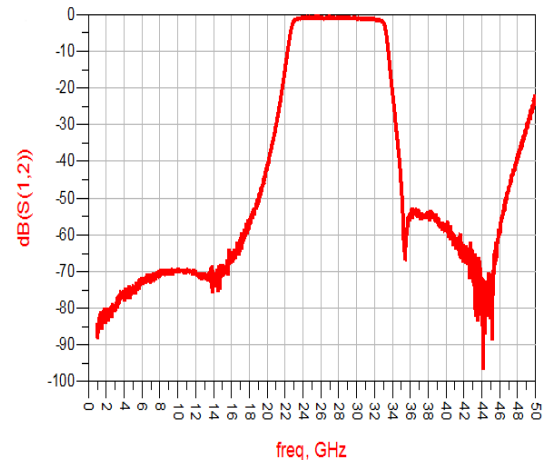
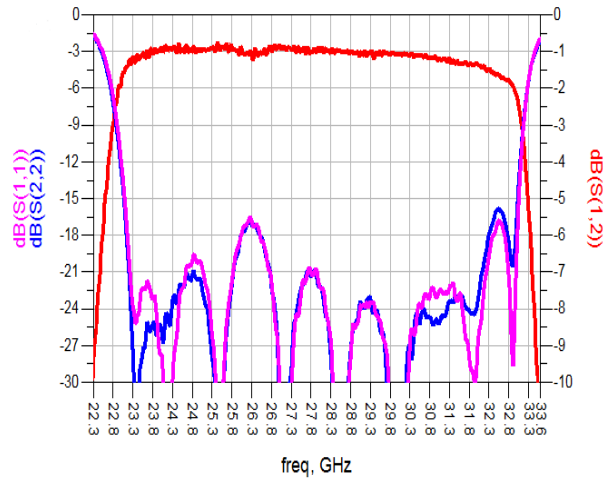


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.0	2.5	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

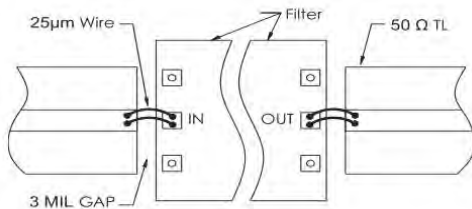
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		24.0		GHz
工作频率	23.5		24.5	GHz
中心损耗		2.4	2.9	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-22.2GHz	55	60	dBc
	@25.9-31.0GHz	55	60	dBc

### 环境要求

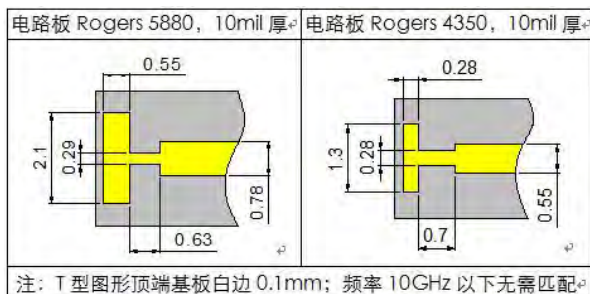
最大输入功率	30	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

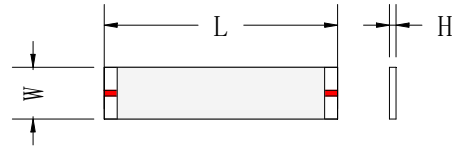


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

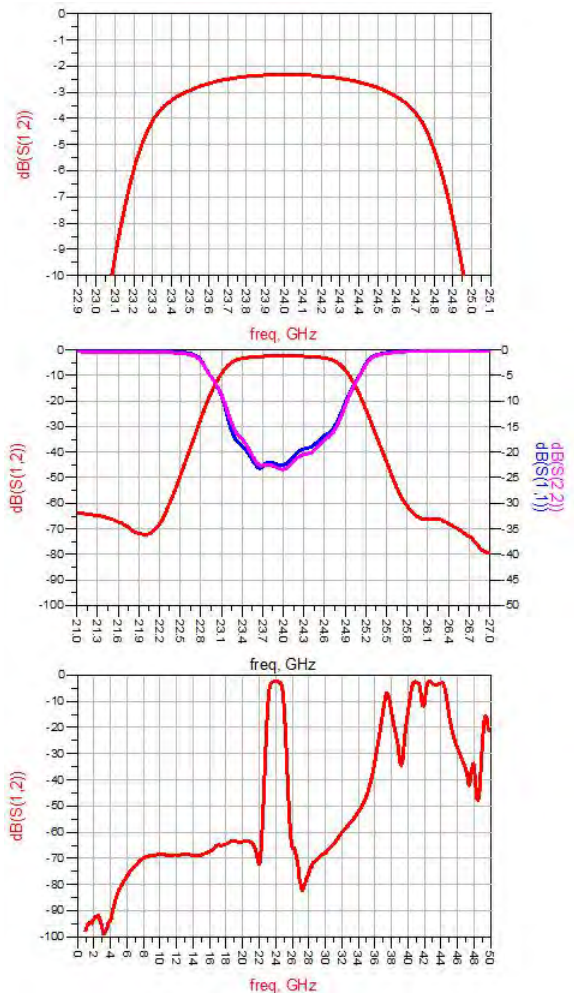


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.0	3.0	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块

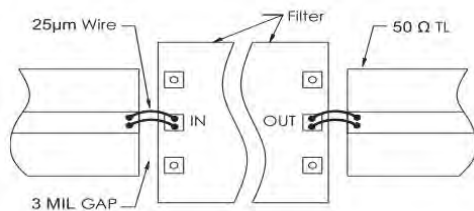
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		28.1		GHz
工作频率	23.5		32.7	GHz
中心损耗		1.4	1.8	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-19.2GHz	53	58	dBc
	@35.2-50.0GHz	53	58	dBc

环境要求

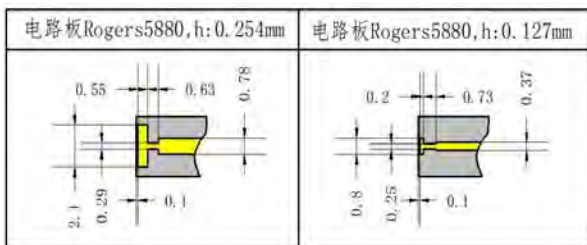
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

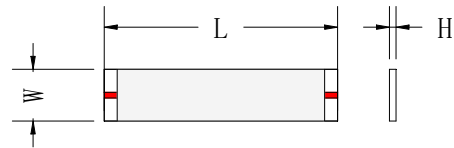
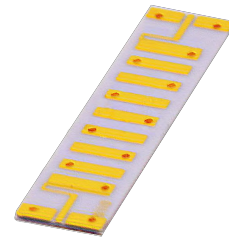


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁**0.1mm**,表面距上盖**1.75mm**,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配,T型尺寸如下:

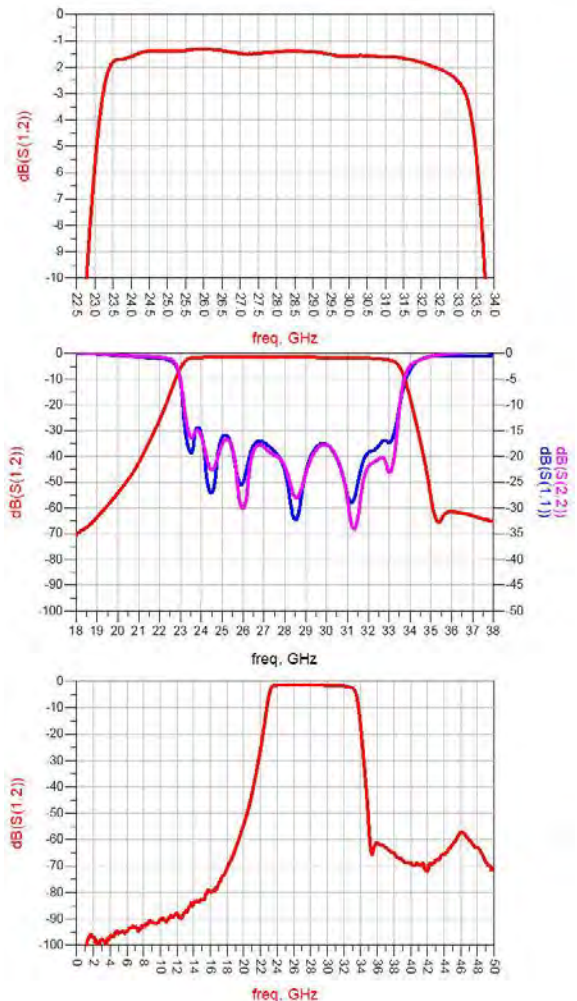


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	2.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

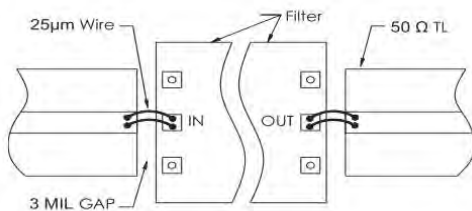
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		24.4		GHz
工作频率	23.8		25.0	GHz
中心损耗		2.6	3.1	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@DC-22.8GHz	40	45	dBc
	@26.0-40.0GHz	40	45	dBc

环境要求

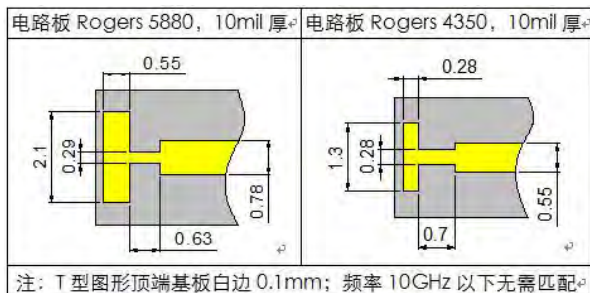
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

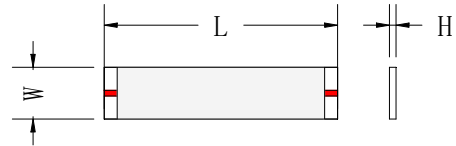


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

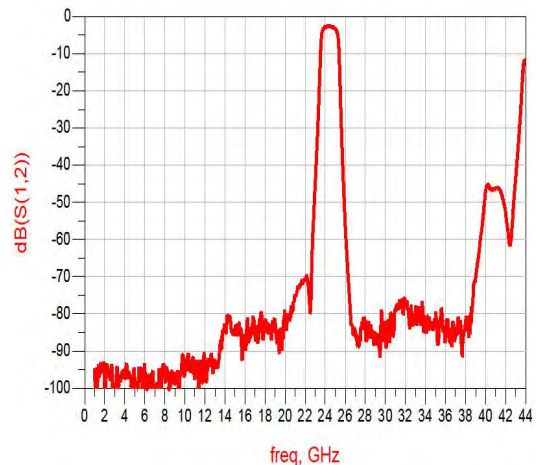
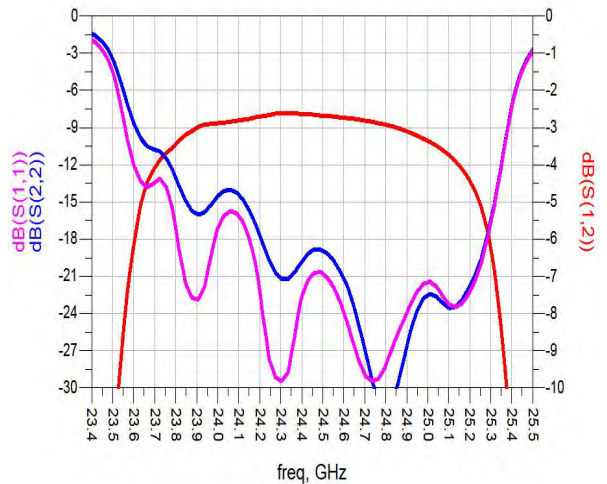


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	10.0	3.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

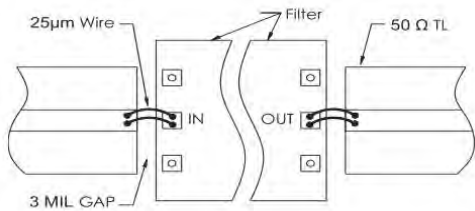
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		26.1		GHz
工作频率	24.0		28.2	GHz
中心损耗		1.0	1.5	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@DC-21.6GHz	40	45	dBc
	@31.6-43.5GHz	40	45	dBc

环境要求

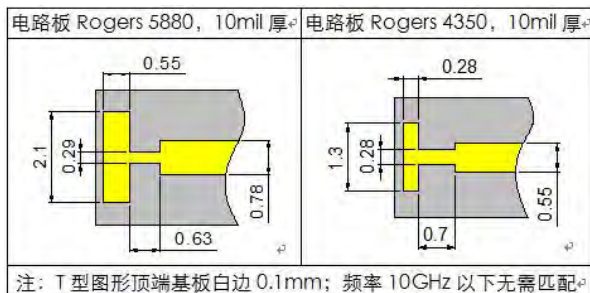
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

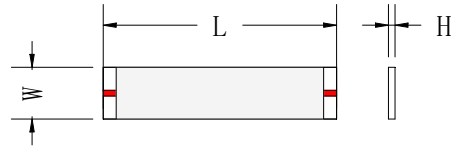


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

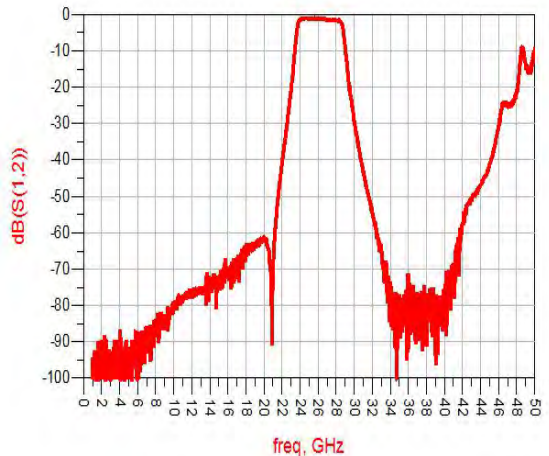
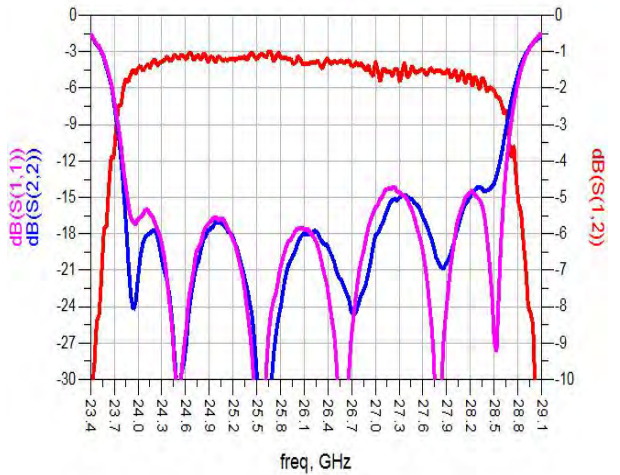


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



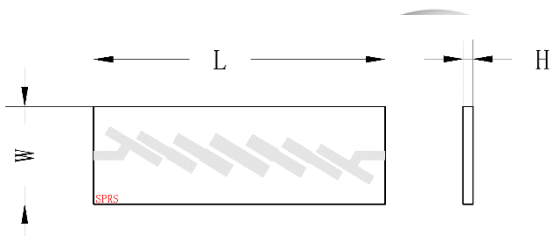
### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

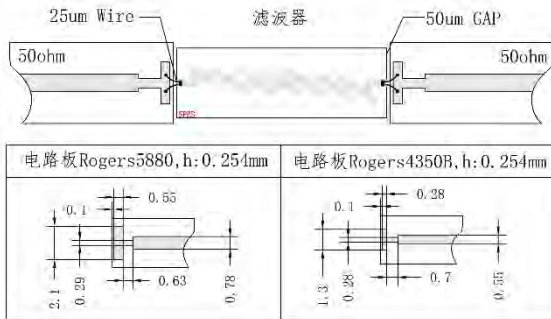
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		26.2		GHz
工作频率	24.0		28.4	GHz
中心损耗		1.4	1.9	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-21.0GHz	55	60		dBc
带外抑制@33.4-41.0GHz	55	60		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 8.0, W: 2.5, H: 0.254, 端口居中



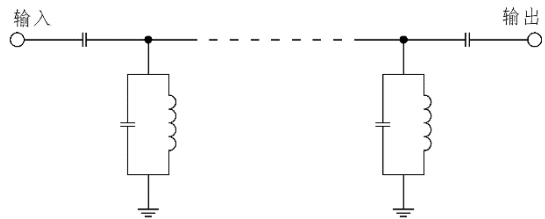
### 推荐装配图:



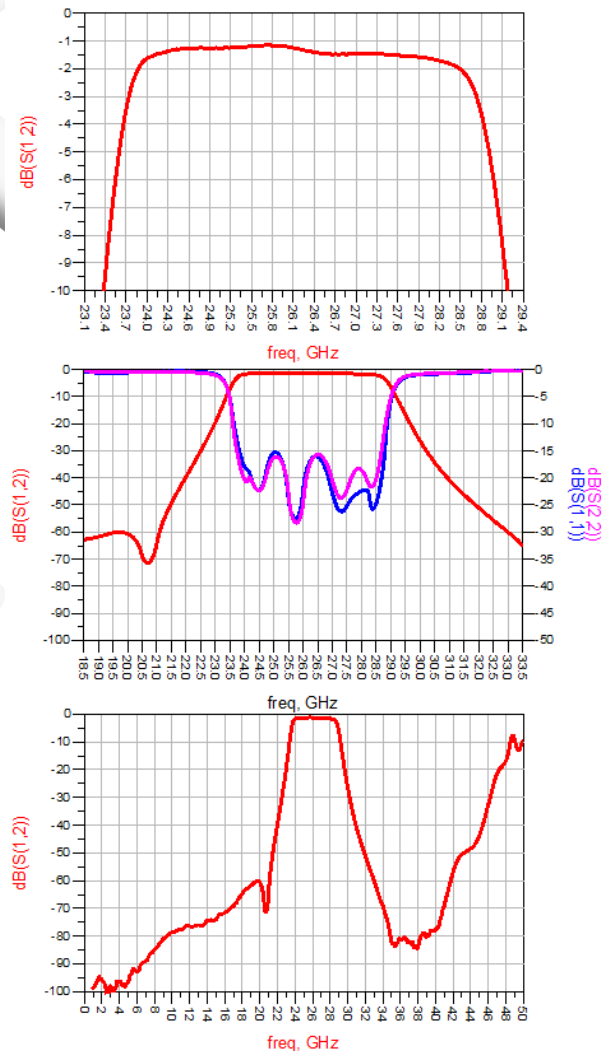
### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

### 原理图



### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

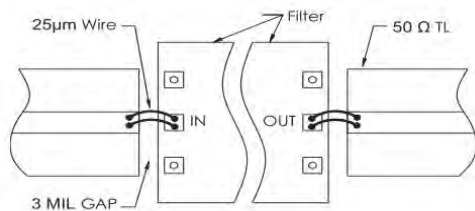
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		26.7		GHz
工作频率	24.2		29.2	GHz
中心损耗		1.8	2.3	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@20-22GHz	40	45	dBc
	@31.1-31.7GHz	40	45	dBc
	@DC-20GHz	60	65	dBc
	@31.7-46GHz	60	65	dBc

### 环境要求

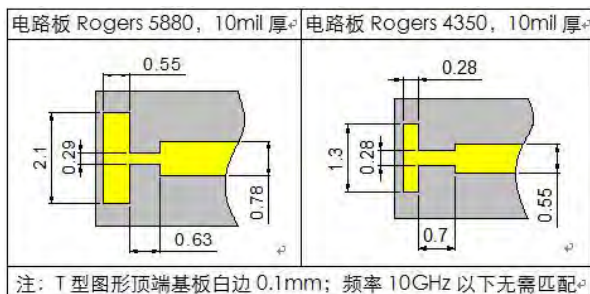
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^\circ\text{C}\sim+85^\circ\text{C}$	
储存温度	$-55^\circ\text{C}\sim+125^\circ\text{C}$	

### 推荐装配图

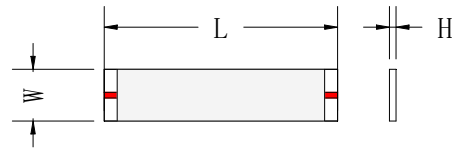
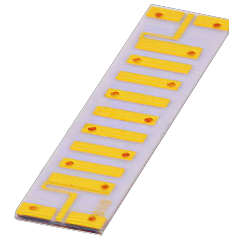


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

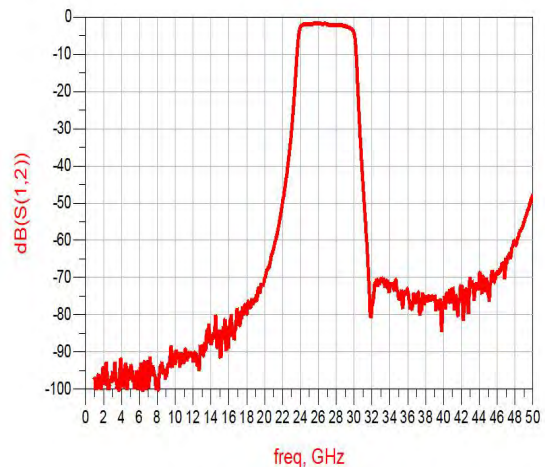
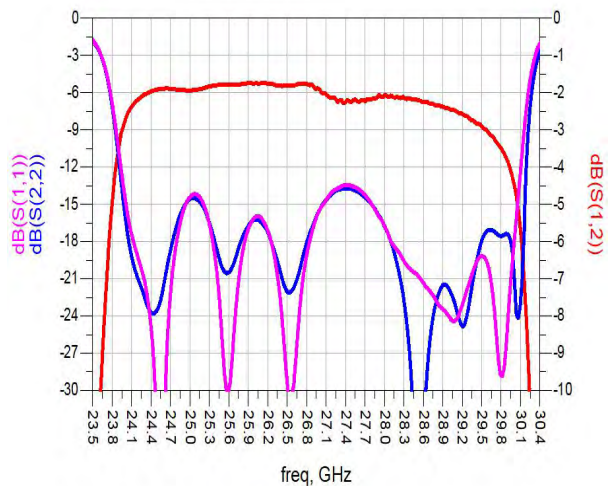


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	2.5	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

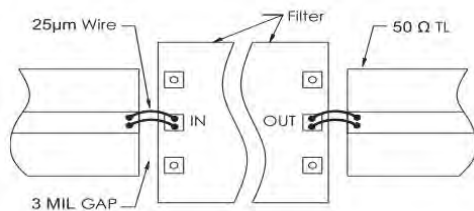
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		28.8		GHz
工作频率	24.6		33.0	GHz
中心损耗		1.9	2.4	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	10	12		
带外抑制	@DC-18GHz	60	65	dBc
	@18-20.5GHz	40	45	dBc
	@36.6-48GHz	40	45	dBc

### 环境要求

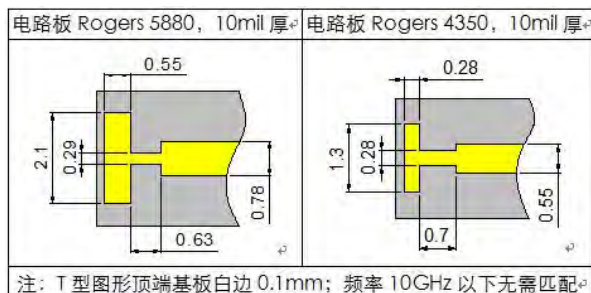
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

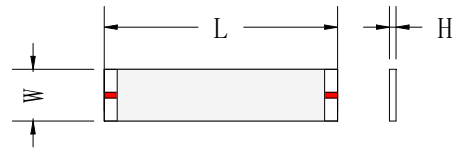


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

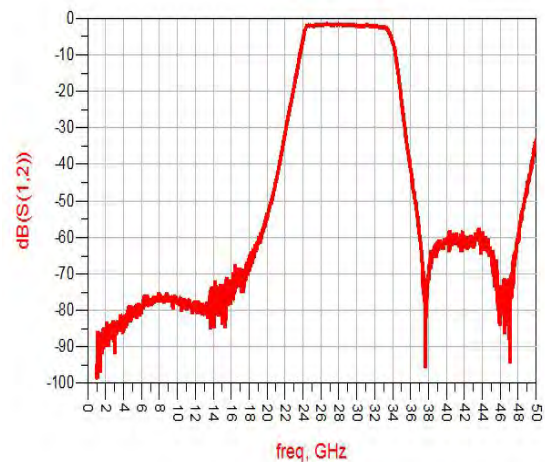
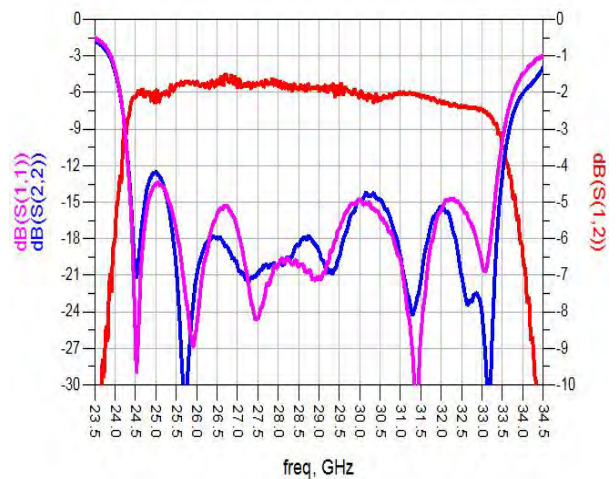


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块

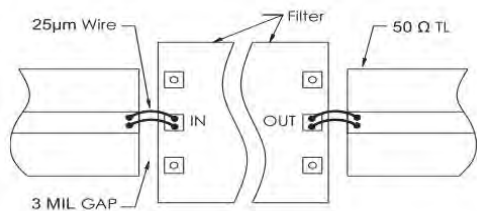
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		27.6		GHz
工作频率	24.8		30.4	GHz
中心损耗		1.5	2.0	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@21.9-23.0GHz	40	45	dBc
	@32.4-32.8GHz	40	45	dBc
	@DC-21.9GHz	60	65	dBc
	@32.8-45GHz	60	65	dBc

环境要求

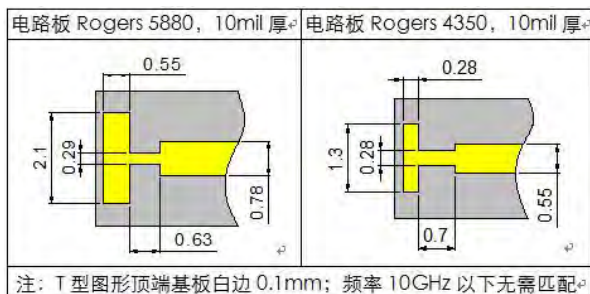
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

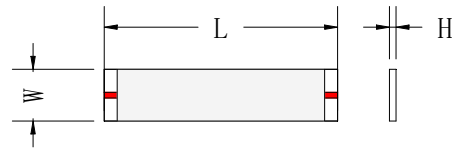
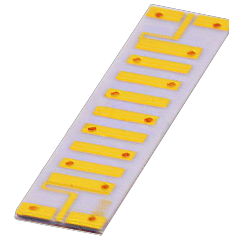


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁**0.1mm**,表面距上盖**1.75mm**,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配,T型尺寸如下:

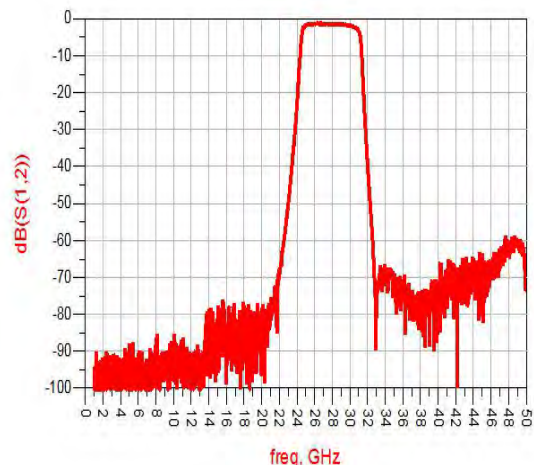
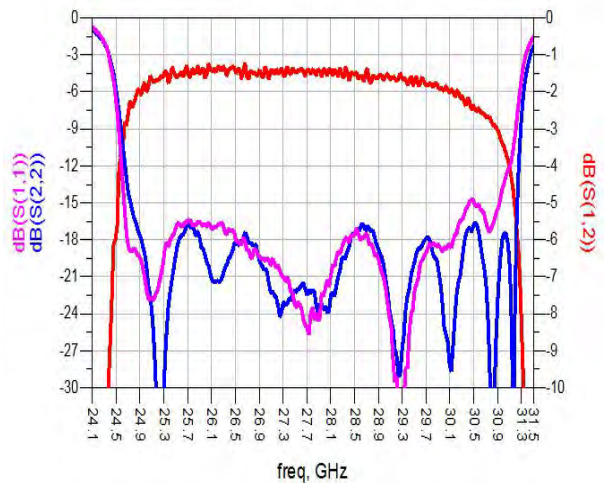


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

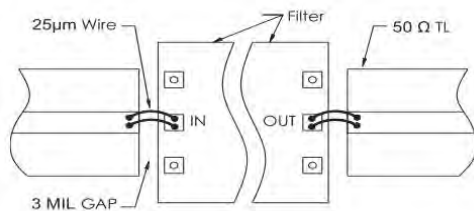
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		26.25		GHz
工作频率	25.0		27.5	GHz
中心损耗		1.7	2.2	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	11	13		
带外抑制	@21.2-23.8GHz	40	45	dBc
	@29.3-30.2GHz	40	45	dBc
	@DC-21.2GHz	60	65	dBc
	@30.2-45GHz	60	65	dBc

环境要求

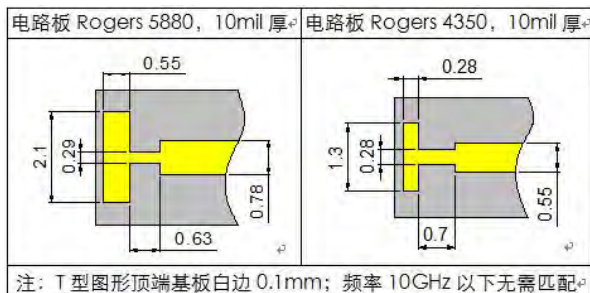
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

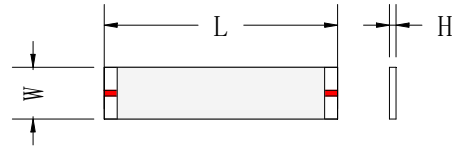


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

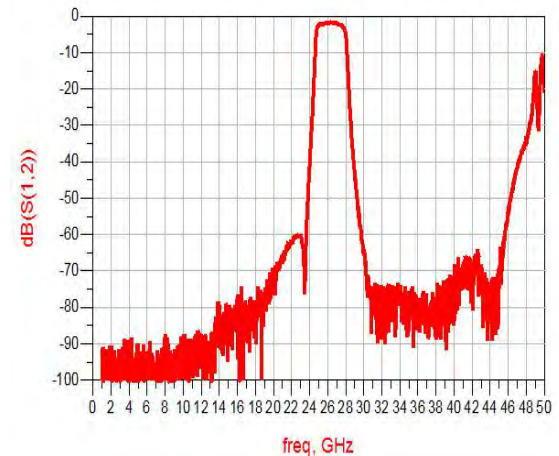
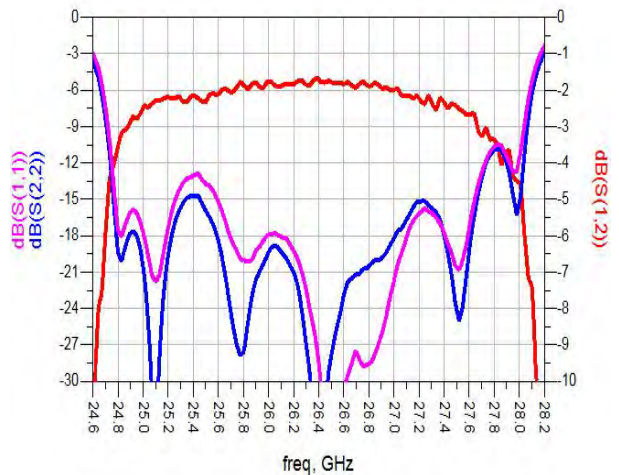


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	10.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块

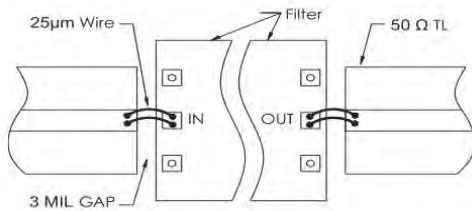
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		27.5		GHz
工作频率	25.0		30.0	GHz
中心损耗		1.9	2.3	dB
带内波动		1.1	1.5	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-21.0GHz	60	65	dBc
	@32.6-50.0GHz	60	65	dBc

环境要求

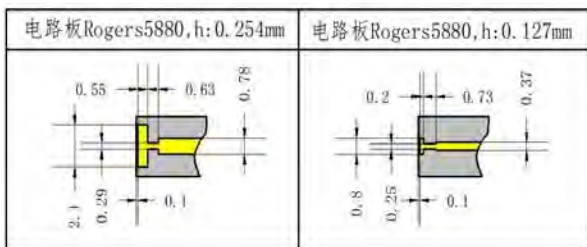
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

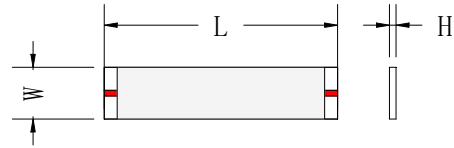
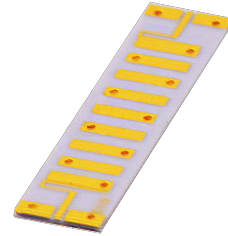


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁**0.1mm**,表面距上盖**1.75mm**,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配,T型尺寸如下:

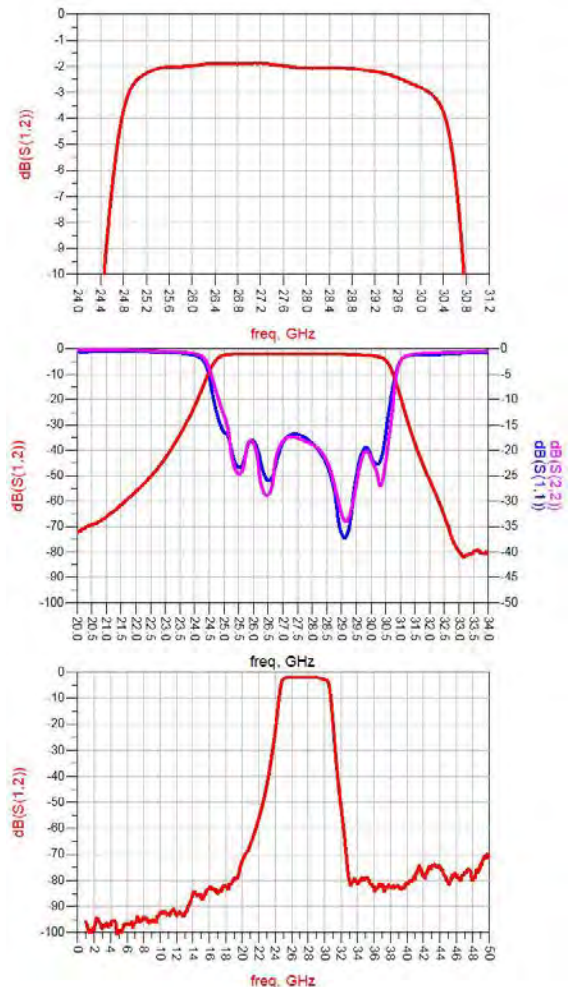


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.2	2.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

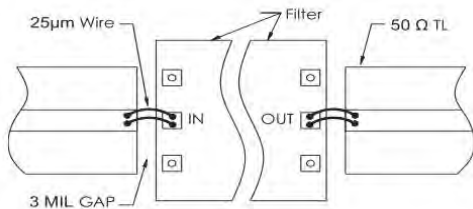
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		28.85		GHz
工作频率	25.1		32.6	GHz
中心损耗		1.0	1.5	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@DC-22.8GHz	40	45	dBc
	@37.2-47GHz	40	45	dBc

### 环境要求

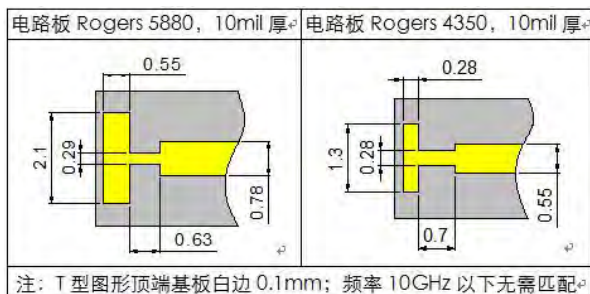
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

### 推荐装配图

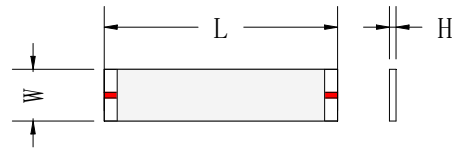


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**1.75mm**，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配，T型尺寸如下：

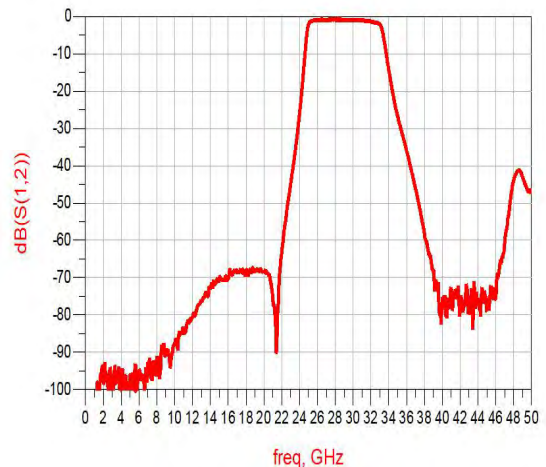
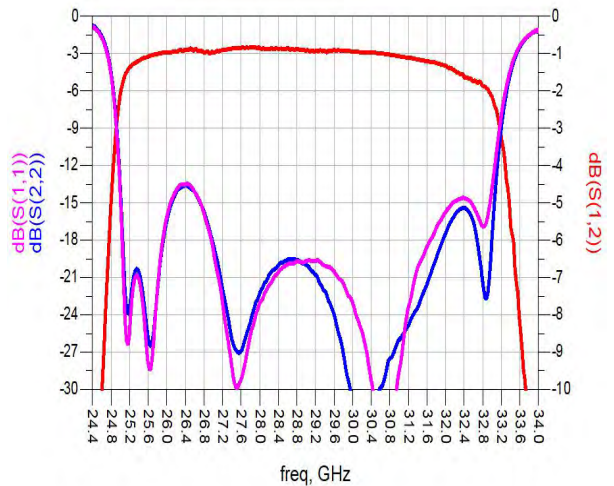


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	2.5	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

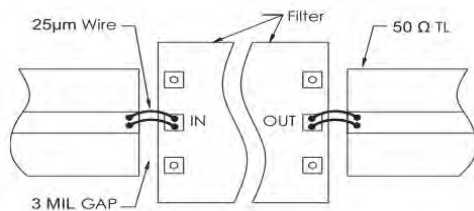
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		29.3		GHz
工作频率	25.1		33.5	GHz
中心损耗		1.0	1.5	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	11	13		
带外抑制	@DC-21.9GHz	40	45	dBc
	@38.7-48GHz	40	45	dBc

### 环境要求

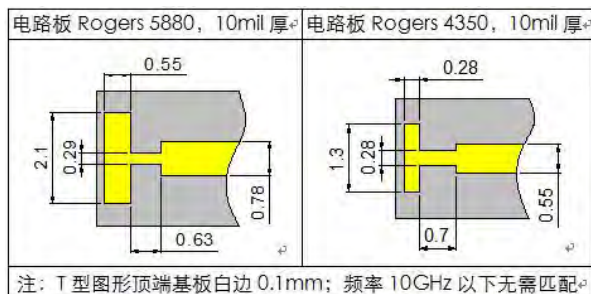
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

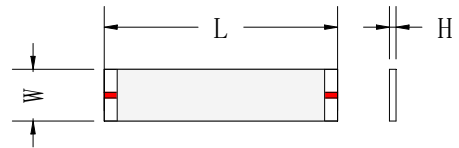


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

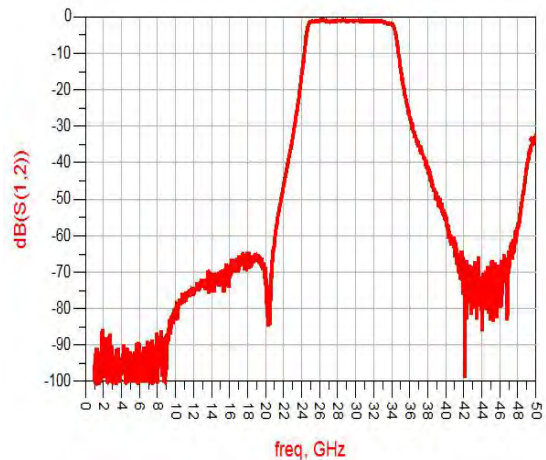
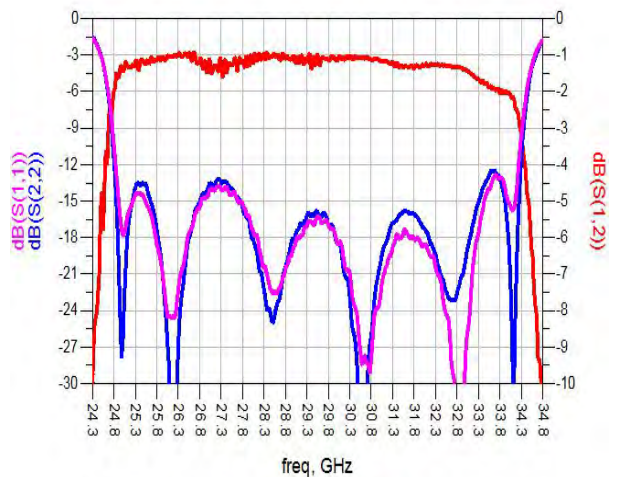


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



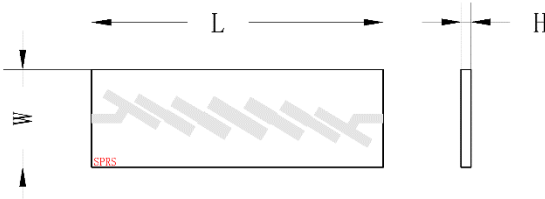
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

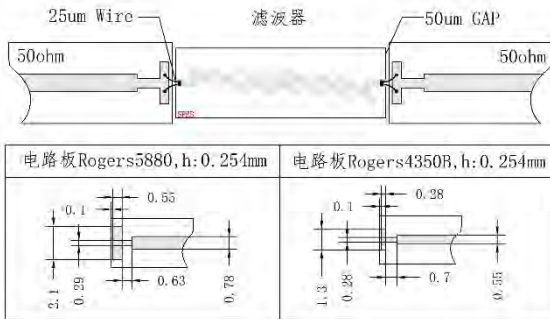
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		25.6		GHz
工作频率	25.2		26.0	GHz
中心损耗		2.6	3.1	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-24.0GHz	40	45		dBc
带外抑制@27.2-45.0GHz	40	45		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 10.0, W: 3.0, H: 0.254, 端口居中



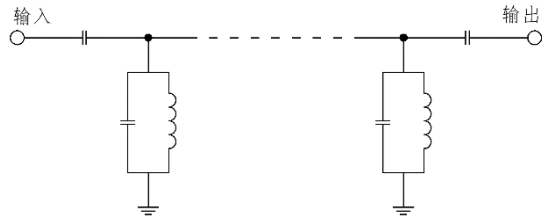
推荐装配图:



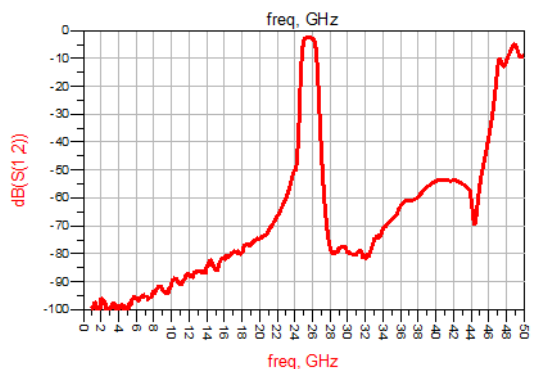
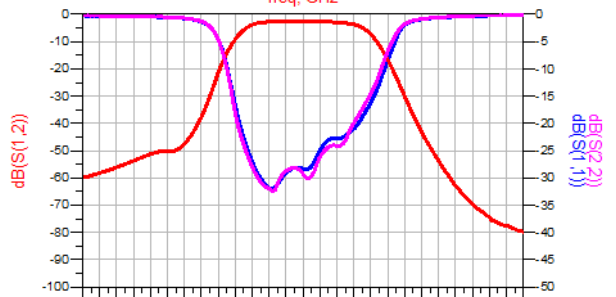
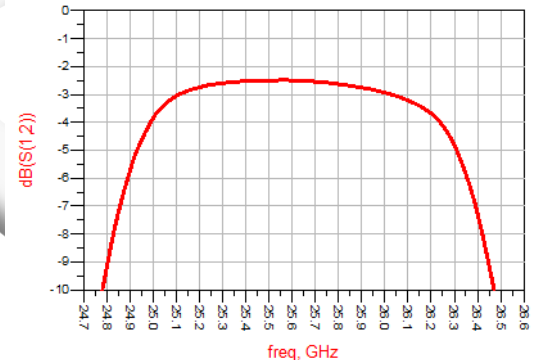
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

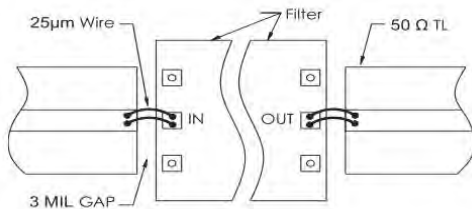
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		28.8		GHz
工作频率	25.3		32.3	GHz
中心损耗		1.4	1.7	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-19.5GHz	60	65	dBc
	@35.5-50.0GHz	60	65	dBc

环境要求

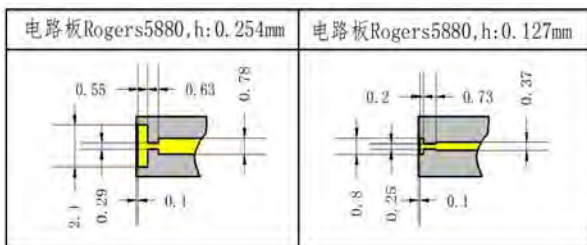
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

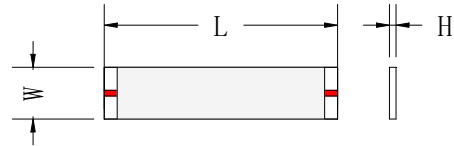
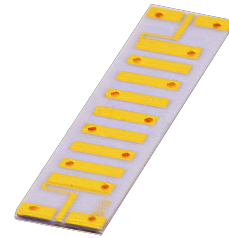


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

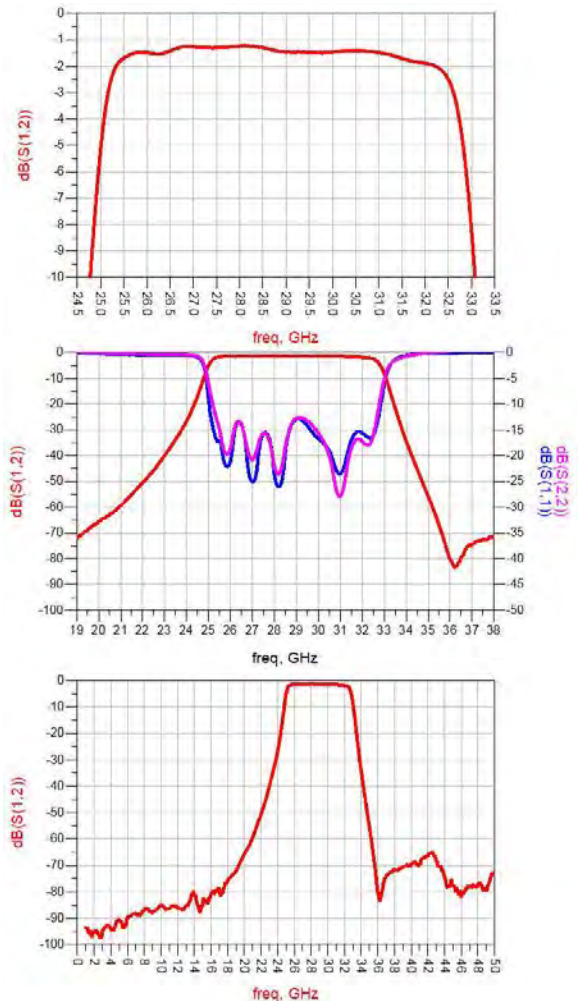


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	2.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

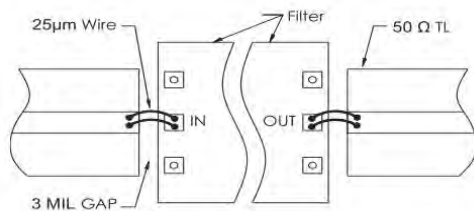
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		33.0		GHz
工作频率	26.0		40.0	GHz
中心损耗		1.0	1.5	dB
带内波动		1.6	1.7	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-22.5GHz	45	50	dBc
	@45.8-46.5GHz	45	50	dBc

环境要求

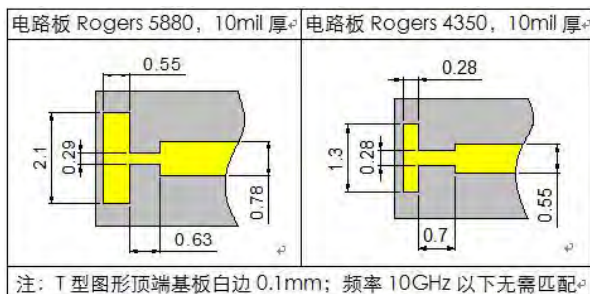
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

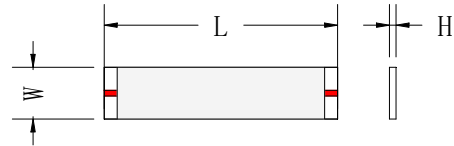


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

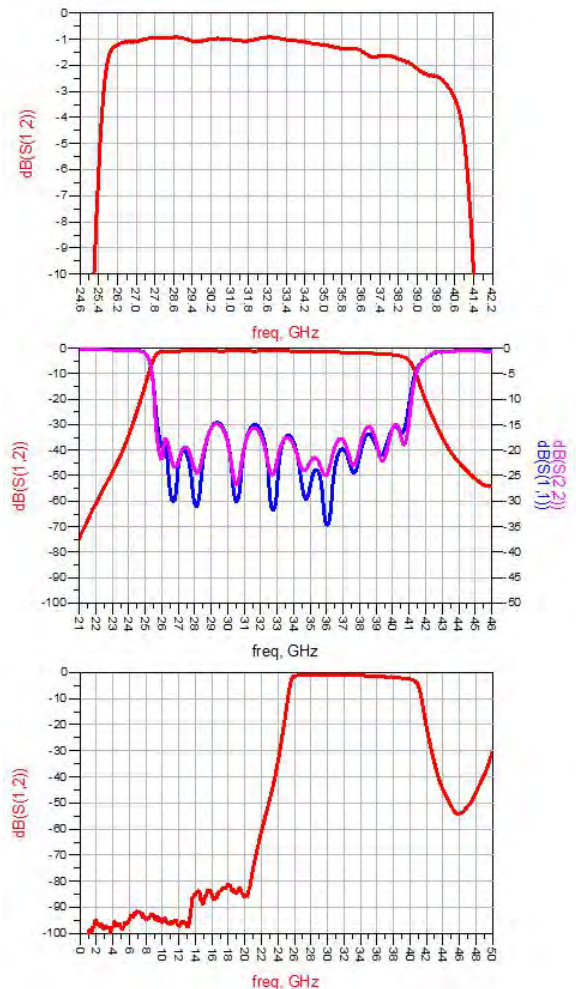


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	10.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



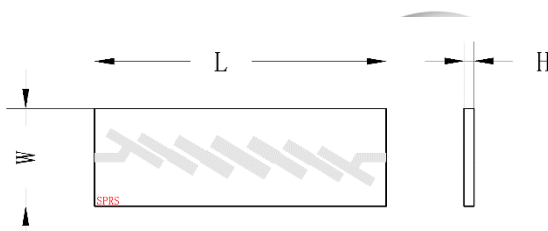
### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

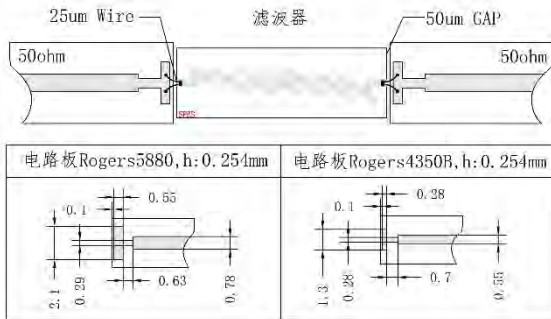
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		26.65		GHz
工作频率	26.2		27.1	GHz
中心损耗		2.8	3.3	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-25.2GHz	40	45		dBc
带外抑制@28.2-44.5GHz	40	45		dBc
承受功率			27	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 10.0, W: 3.0, H: 0.254, 端口居中



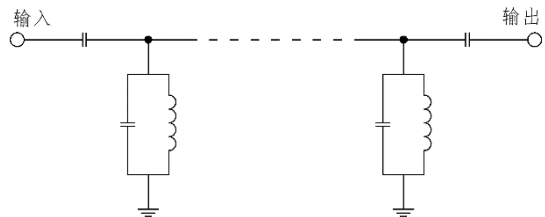
### 推荐装配图:



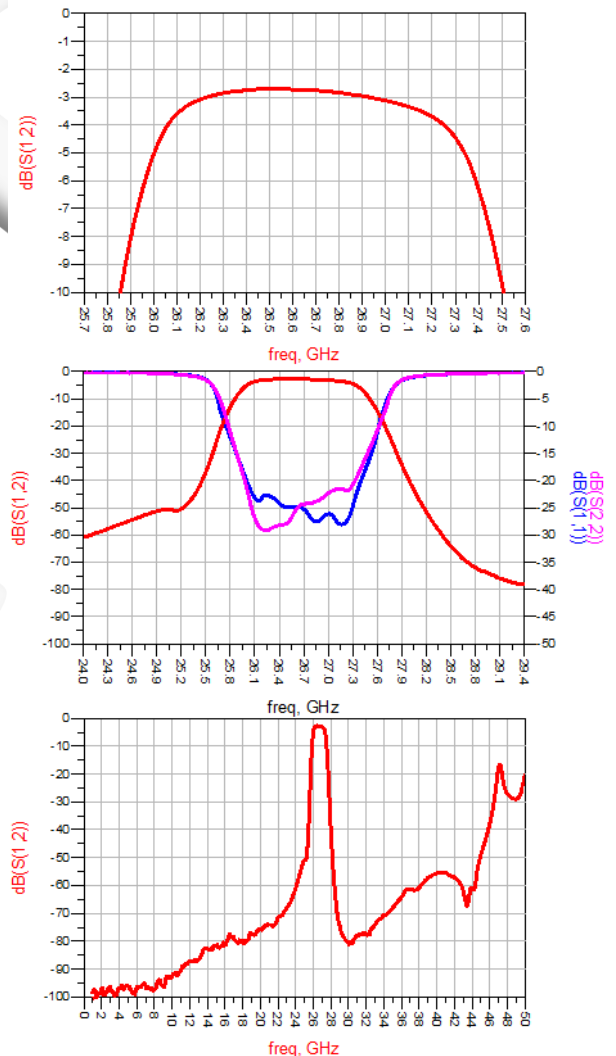
### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

### 原理图



### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



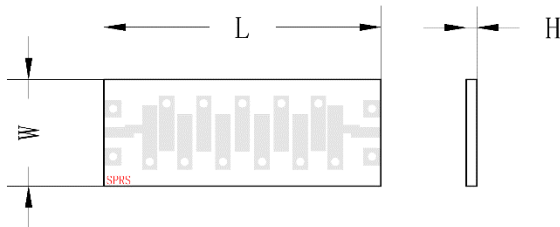
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

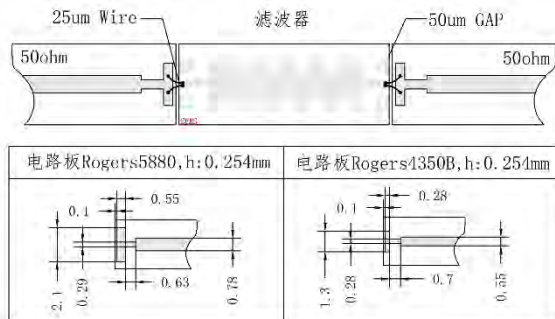
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		31.2		GHz
工作频率	26.3		36.1	GHz
中心损耗		0.8	1.3	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-19.8GHz	50	55		dBc
带外抑制@41.2-50.0GHz	50	55		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.0, W: 2.0, H: 0.254, 端口居中



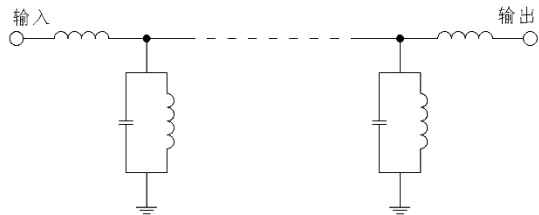
推荐装配图:



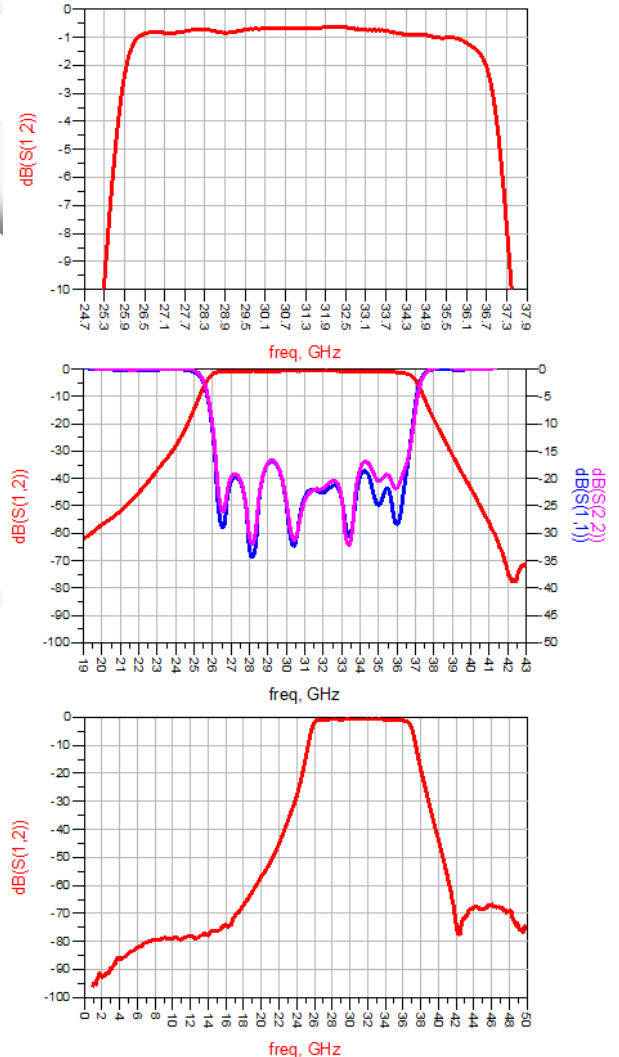
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

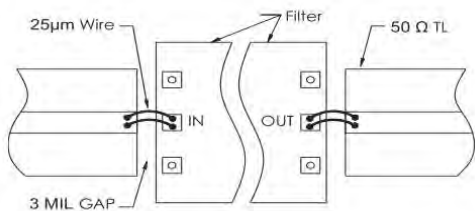
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		32.1		GHz
工作频率	26.5		37.7	GHz
中心损耗		0.5	1.0	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-24.3GHz	43	48	dBc
	@41.8-49GHz	43	48	dBc

### 环境要求

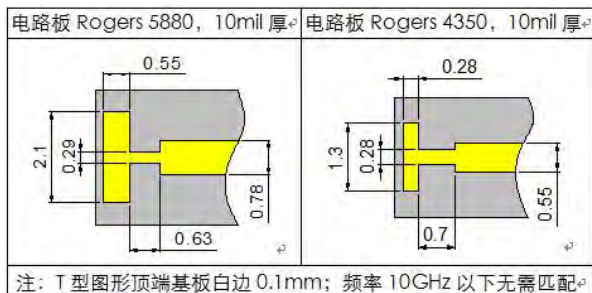
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

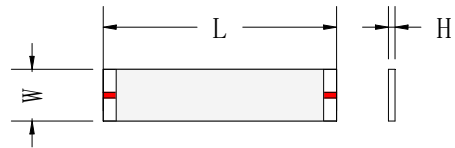


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

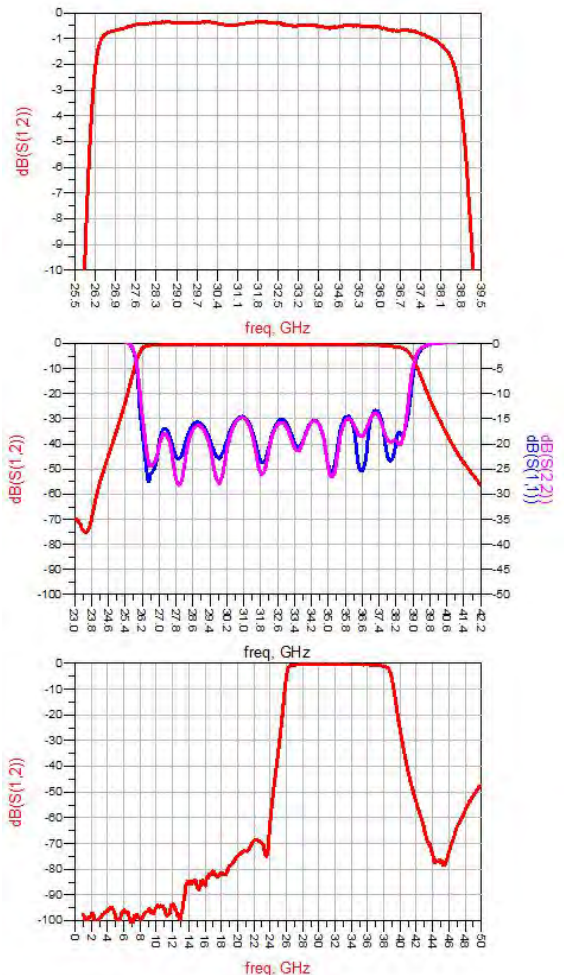


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	10.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

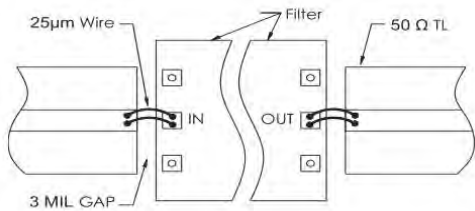
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		28.6		GHz
工作频率	26.6		30.6	GHz
中心损耗		1.0	1.5	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-24.8GHz	45	50	dBc
	@33.6-47GHz	45	50	dBc

### 环境要求

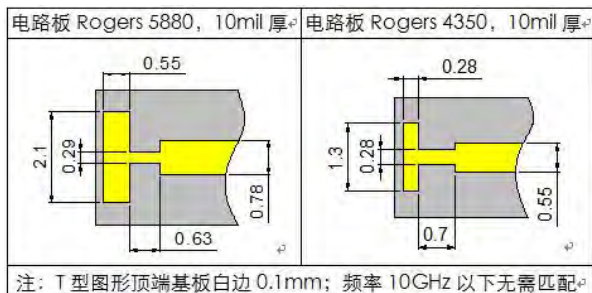
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

### 推荐装配图

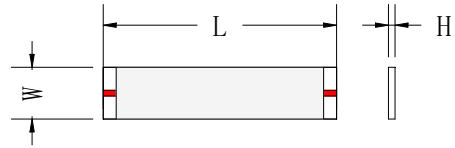


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

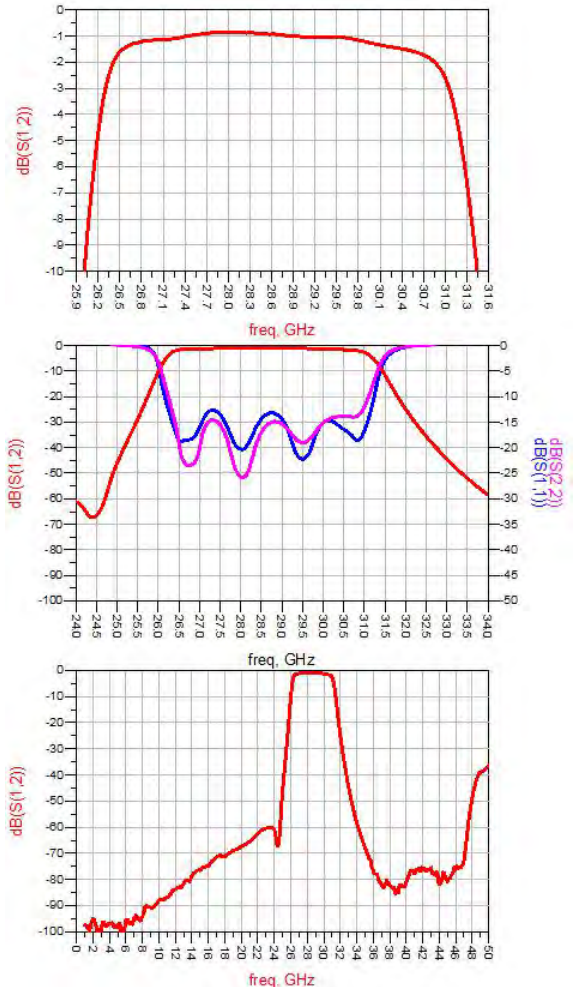


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	2.5	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

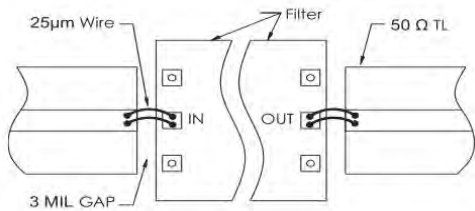
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		28.9		GHz
工作频率	26.6		31.2	GHz
中心损耗		1.1	1.6	dB
带内波动		0.6	0.8	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-24.6GHz	45	50	dBc
	@34.6-49GHz	45	50	dBc

### 环境要求

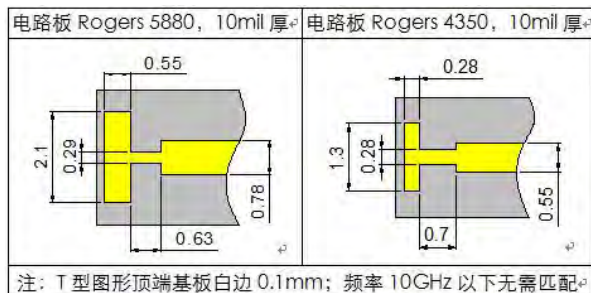
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

### 推荐装配图

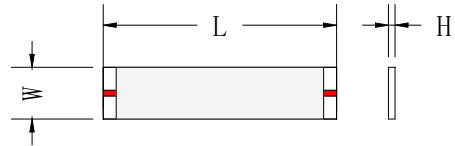


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

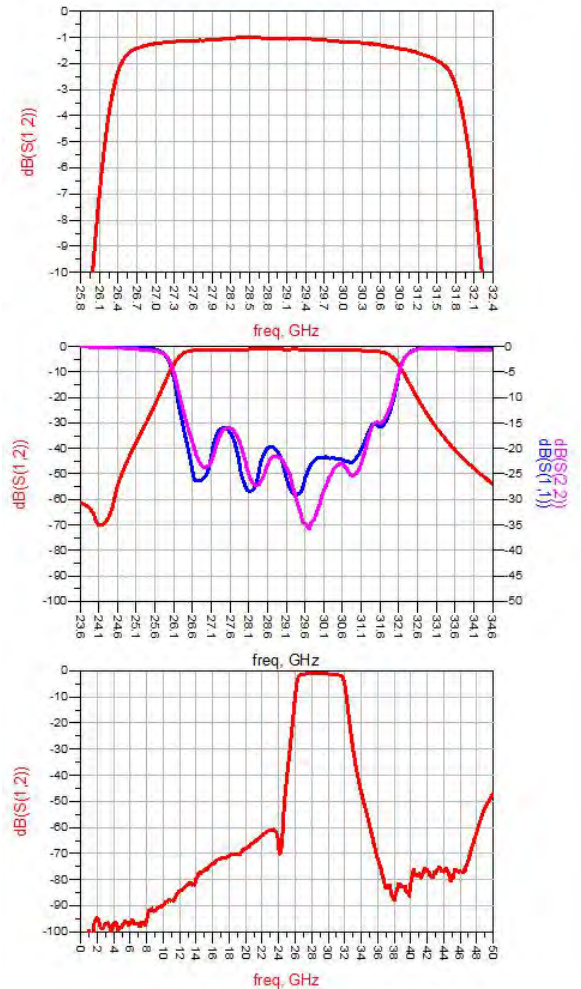


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

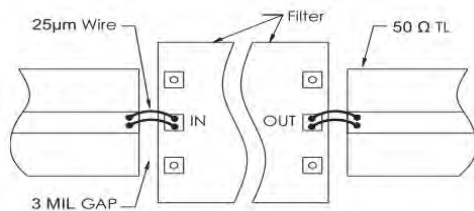
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		31.15		GHz
工作频率	27.0		35.3	GHz
中心损耗		0.6	1.1	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗		12	15	
带外抑制	@DC-23.7GHz	40	45	dBc
	@39.3-50.0GHz	40	45	dBc

环境要求

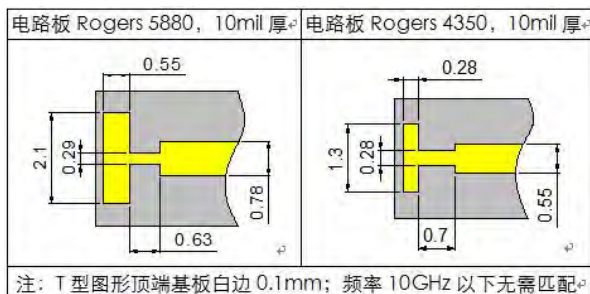
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

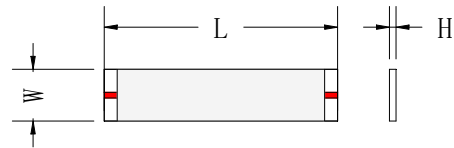


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖1.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

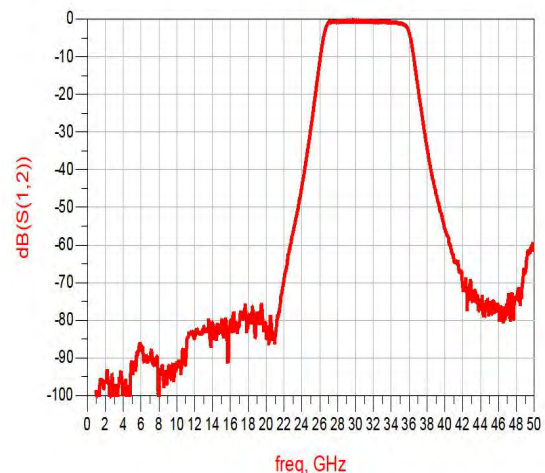
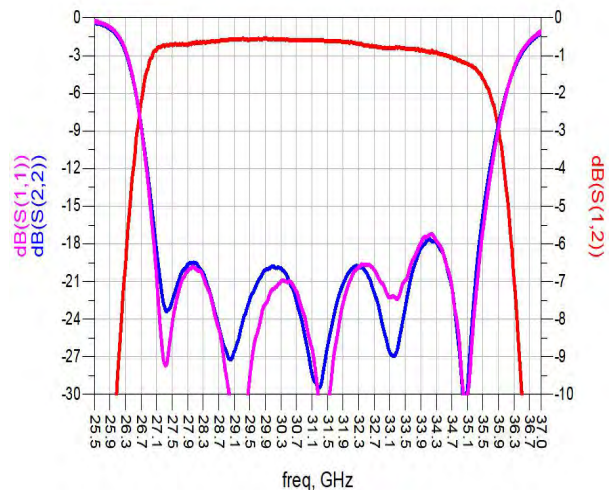


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	2.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



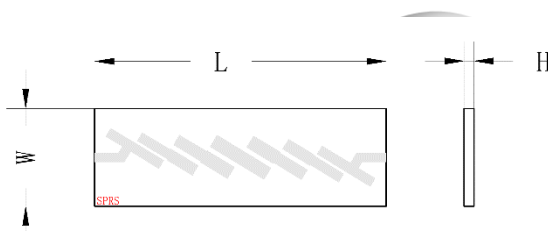
### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

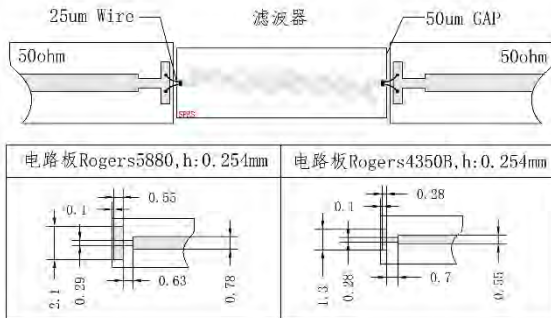
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		33.5		GHz
工作频率	27.0		40.0	GHz
中心损耗		0.6	1.1	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-23.0GHz	45	50		dBc
带外抑制@45.5-48.5GHz	45	50		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 8.0, W: 2.5, H: 0.254, 端口居中



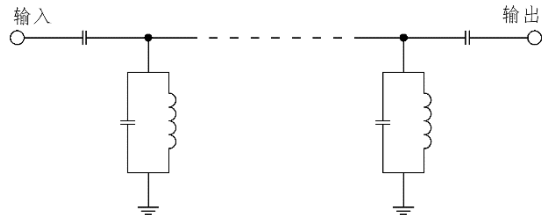
### 推荐装配图:



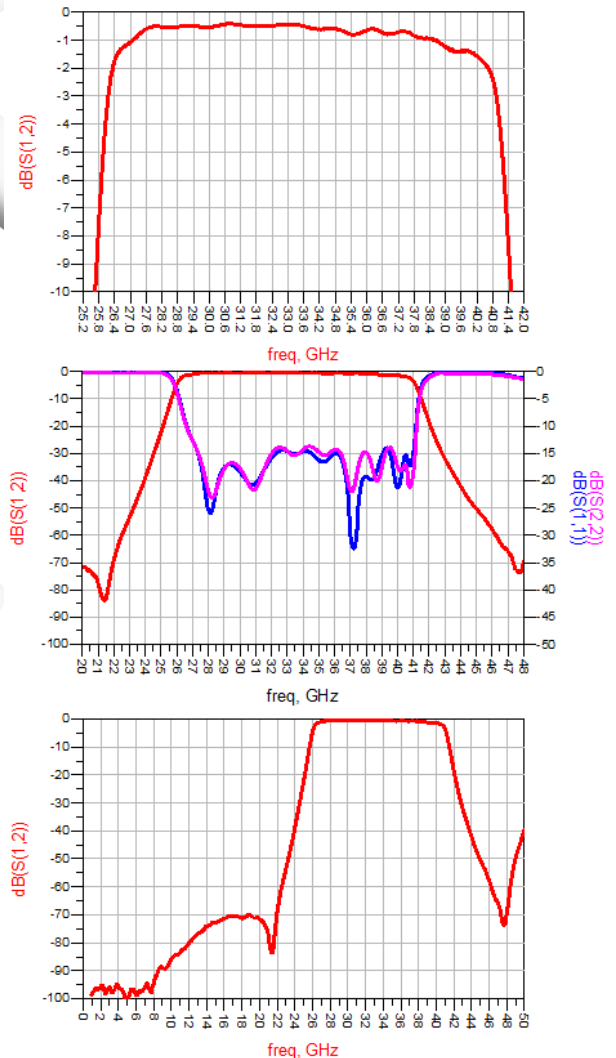
### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**1.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

### 原理图



### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



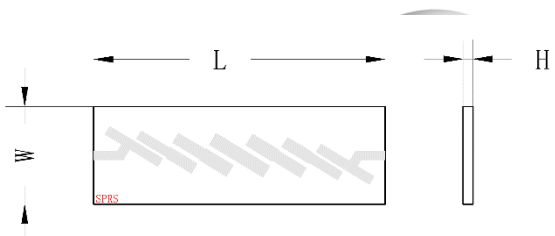
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

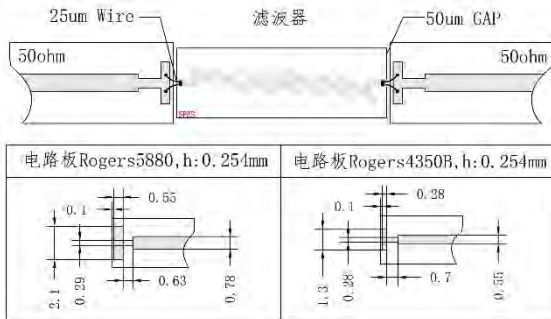
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		27.8		GHz
工作频率	27.5		28.1	GHz
中心损耗		3.5	4.0	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-26.4GHz	40	45		dBc
带外抑制@29.4-42.0GHz	45	50		dBc
承受功率			27	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 10.0, W: 3.0, H: 0.254, 端口居中



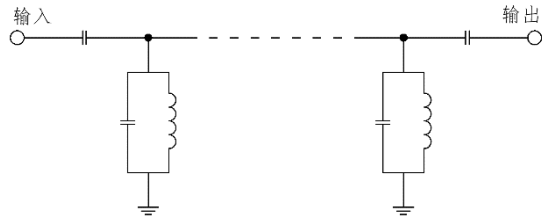
推荐装配图:



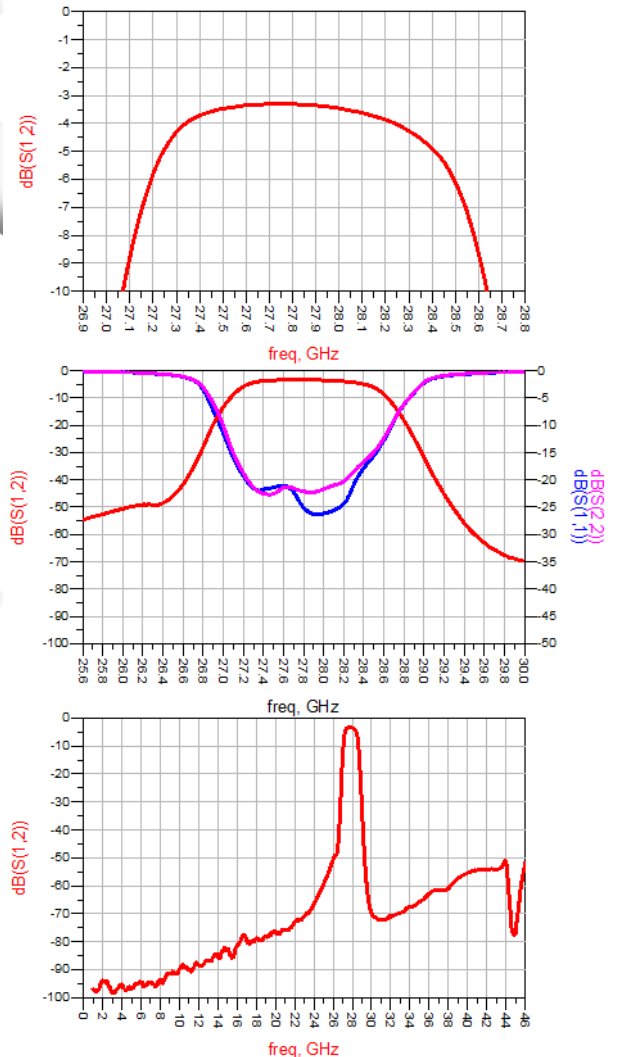
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



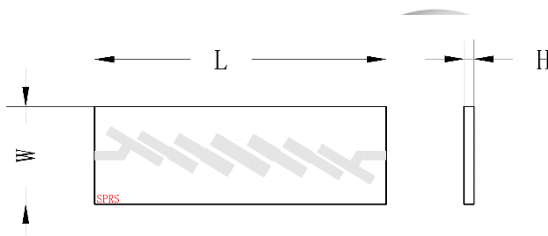
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

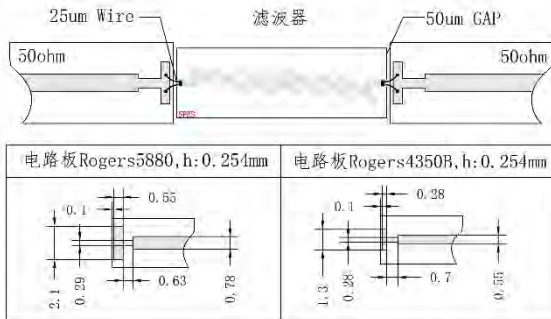
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		29.9		GHz
工作频率	27.5		32.3	GHz
中心损耗		1.2	1.7	dB
带内波动		0.9	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-23.0GHz	41	46		dBc
带外抑制@39.0-43.0GHz	60	65		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 6.5, W: 2.5, H: 0.254, 端口居中



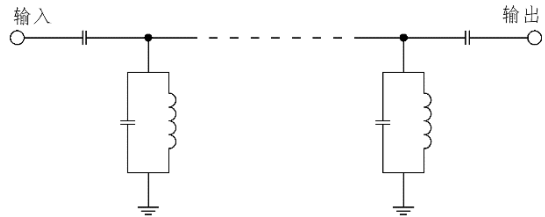
推荐装配图:



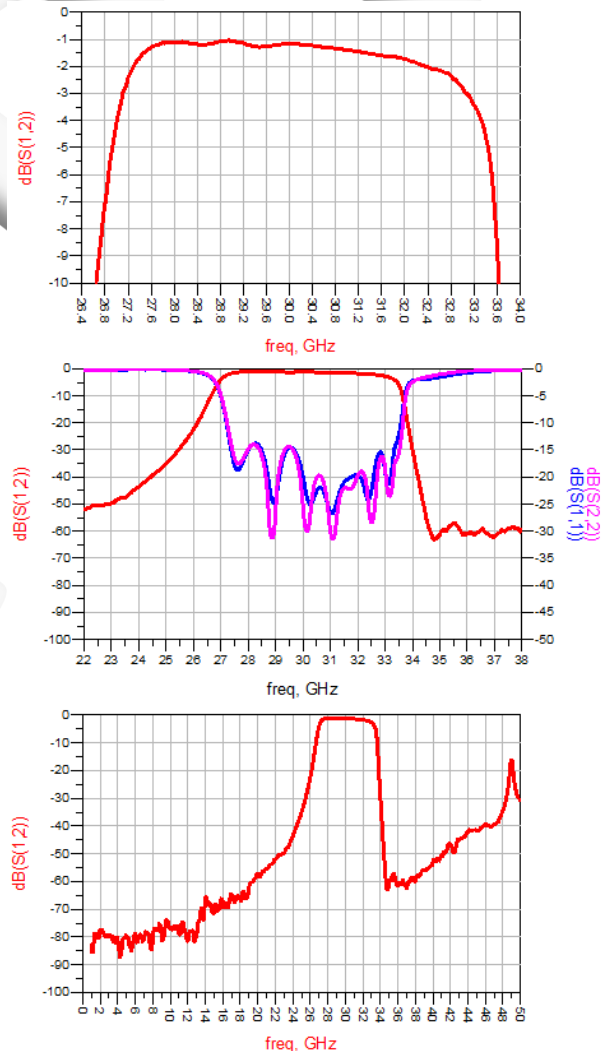
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

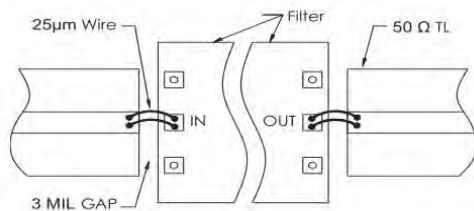
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		33.9		GHz
工作频率	27.5		40.3	GHz
中心损耗		1.0	1.5	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	14		
带外抑制	@DC-22GHz	60	65	dBc
	@22-23.4GHz	40	47	dBc
	@45.8-50GHz	40	47	dBc

### 环境要求

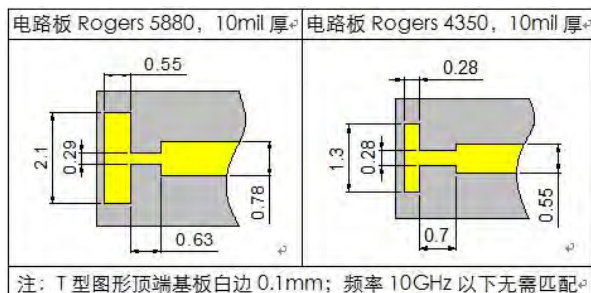
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

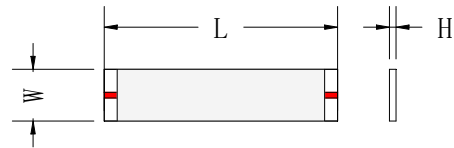


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

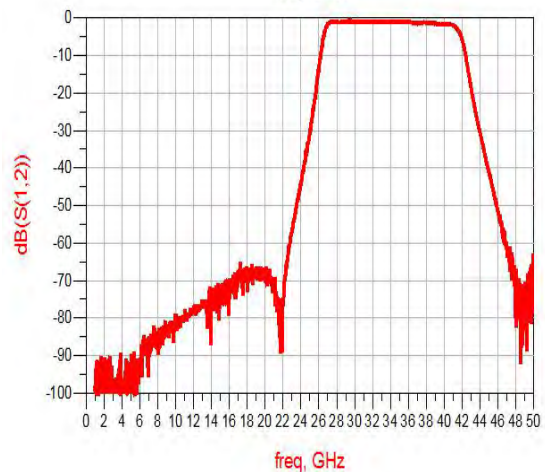
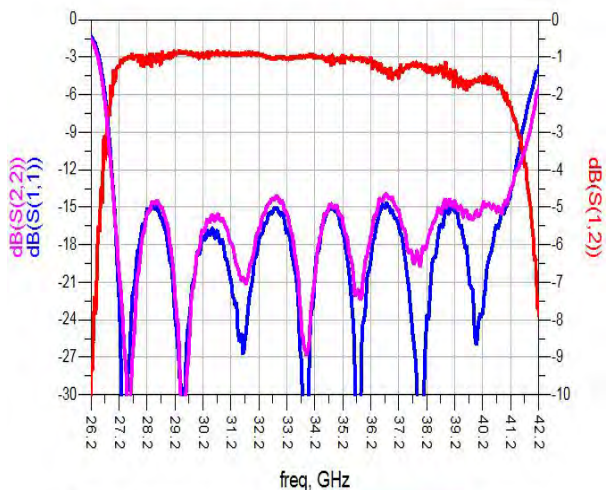


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块

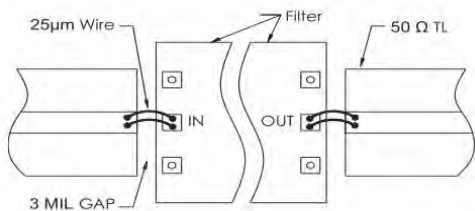
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		31.6		GHz
工作频率	27.7		35.5	GHz
中心损耗		1.2	1.7	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@DC-24.8GHz	40	45	dBc
	@39.6-50.0GHz	40	45	dBc

环境要求

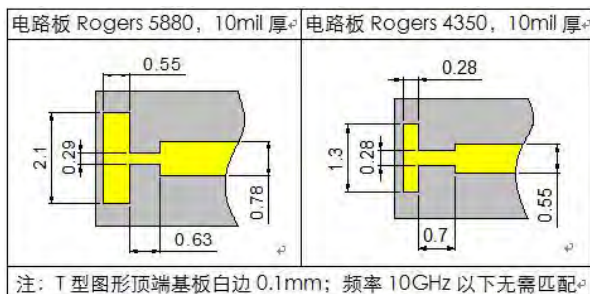
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

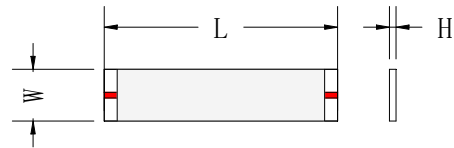


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁**0.1mm**,表面距上盖**1.75mm**,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配,T型尺寸如下:

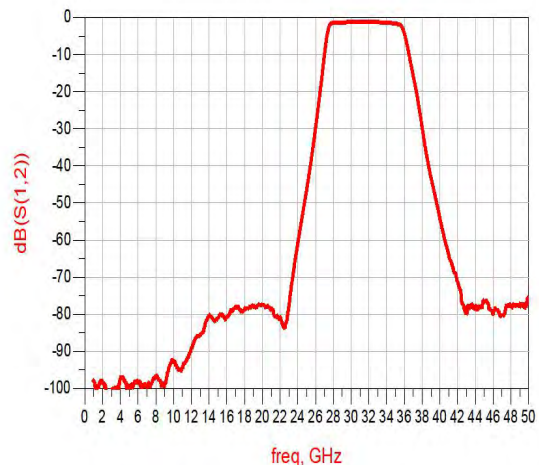
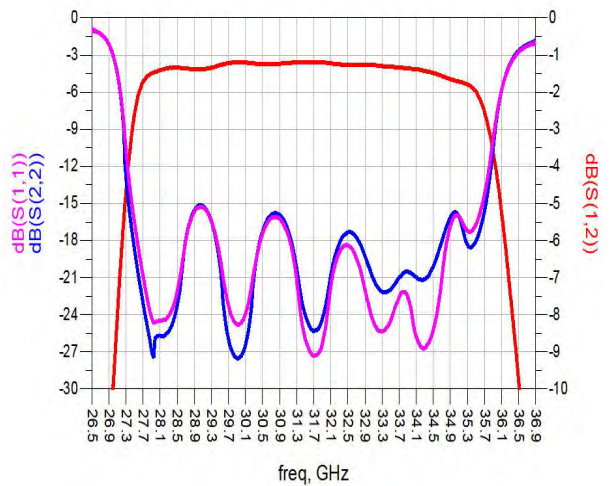


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.5	2.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

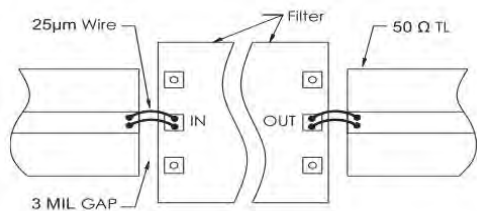
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		30.3		GHz
工作频率	27.8		32.8	GHz
中心损耗		1.6	2.1	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@DC-25.3GHz	40	45	dBc
	@35.9-49GHz	40	45	dBc

### 环境要求

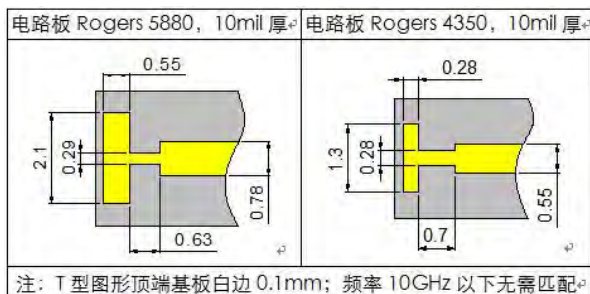
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

### 推荐装配图

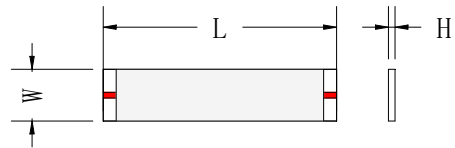


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.25mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

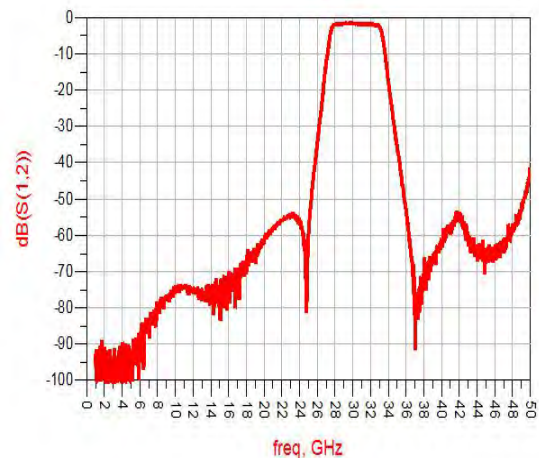
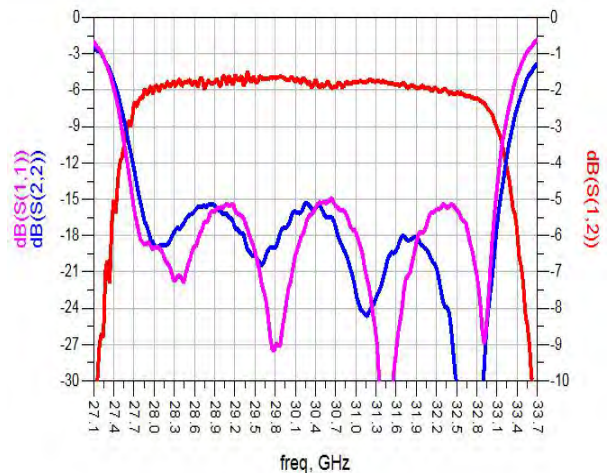


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.5	2.5	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

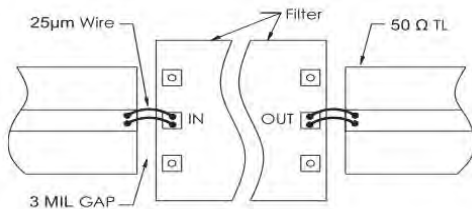
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		31.1		GHz
工作频率	27.8		34.4	GHz
中心损耗		1.0	1.5	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@DC-25.2GHz	40	45	dBc
	@37.6-50GHz	40	45	dBc

环境要求

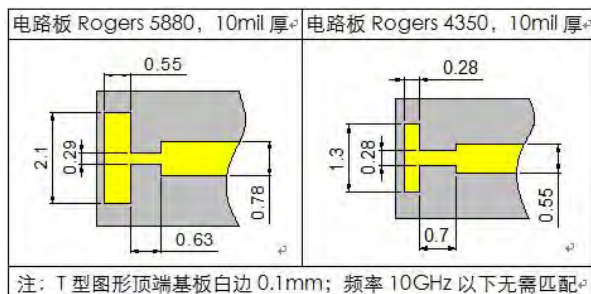
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

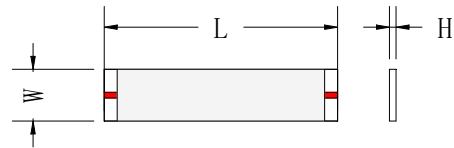


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

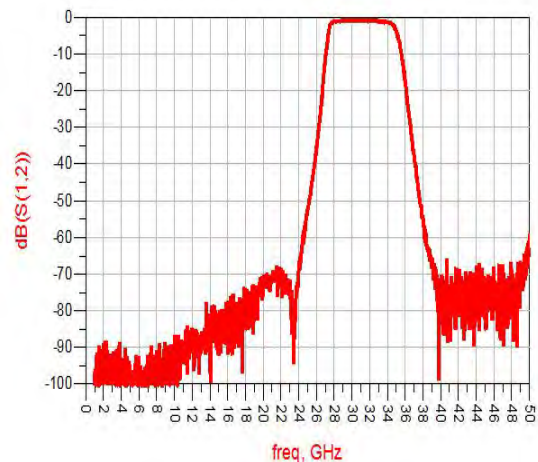
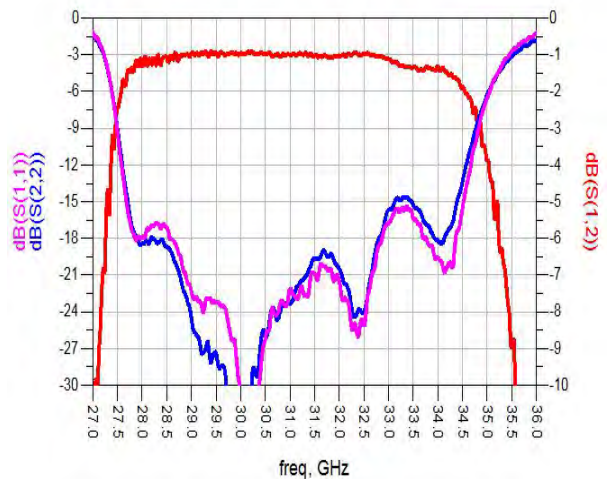


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	2.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



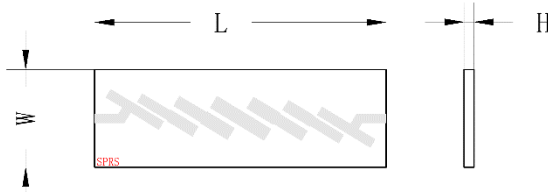
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

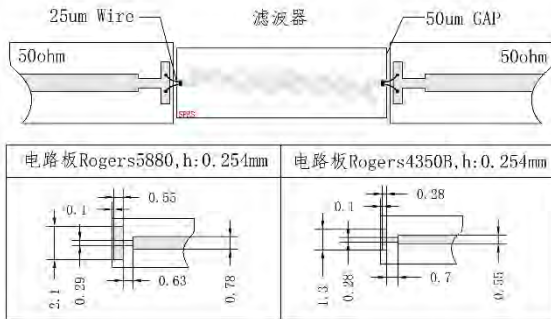
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		28.8		GHz
工作频率	28.0		29.6	GHz
中心损耗		2.4	2.9	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-25.2GHz	43	48		dBc
带外抑制@31.5-40.0GHz	43	48		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 8.0, W: 2.5, H: 0.254, 端口居中



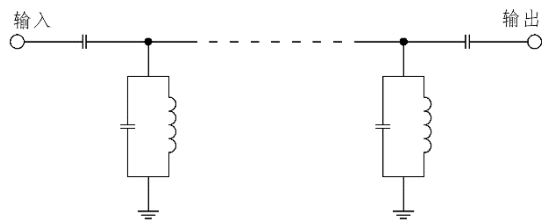
推荐装配图:



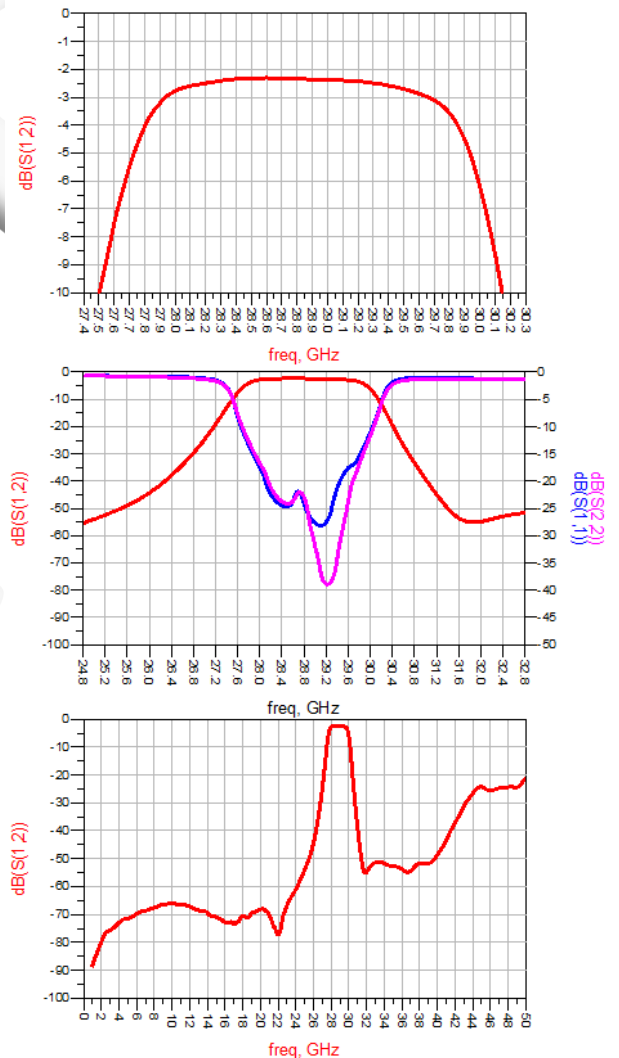
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



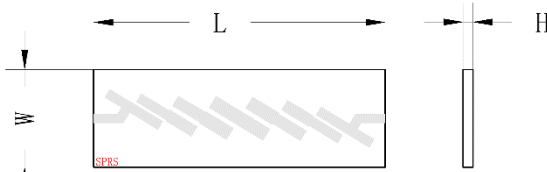
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

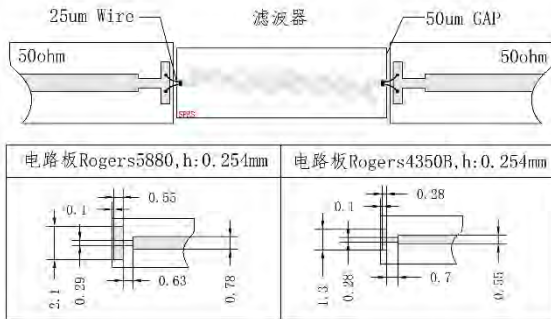
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		30.25		GHz
工作频率	28.1		32.4	GHz
中心损耗		1.2	1.7	dB
带内波动		0.9	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-23.0GHz	45	50		dBc
带外抑制@35.0-50.0GHz	45	50		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 6.5, W: 2.0, H: 0.254, 端口居中



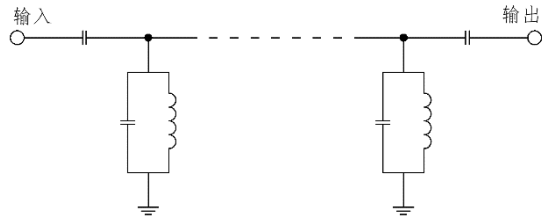
推荐装配图:



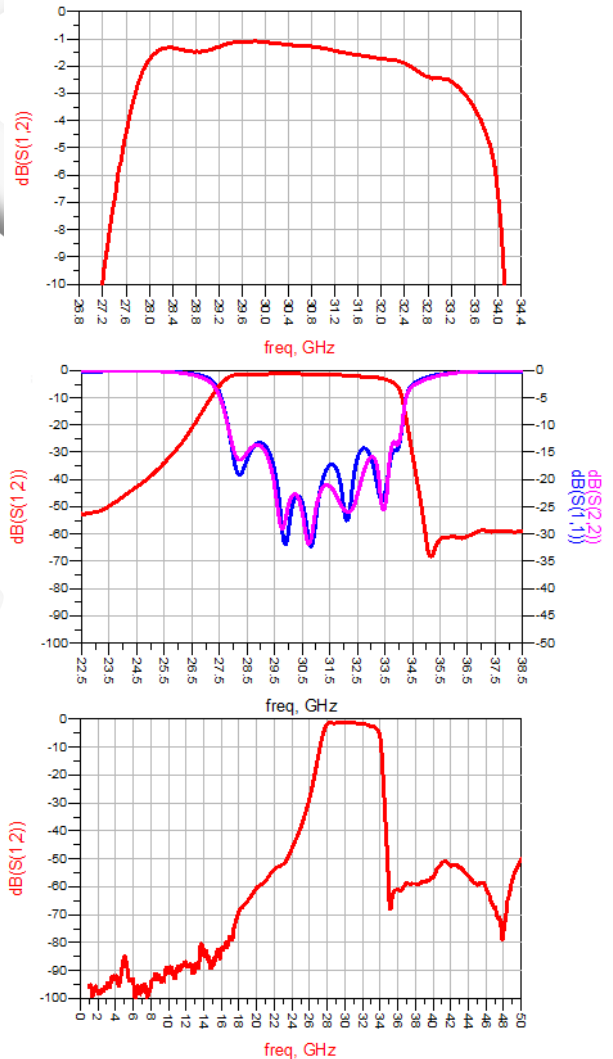
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

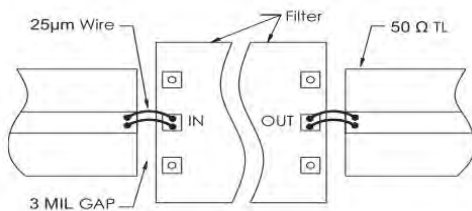
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		30.65		GHz
工作频率	28.3		33.0	GHz
中心损耗		1.7	2.2	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-26.2GHz	40	45	dBc
	@35.0-49.0GHz	40	45	dBc

环境要求

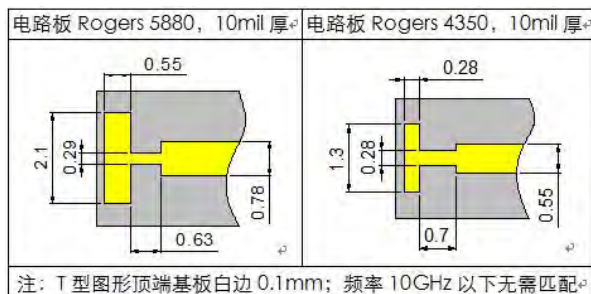
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

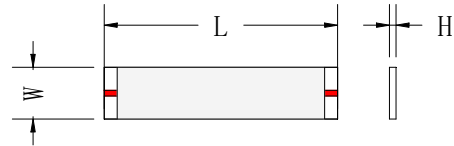
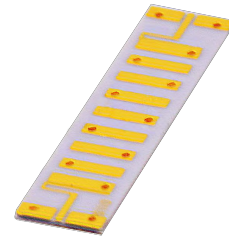


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

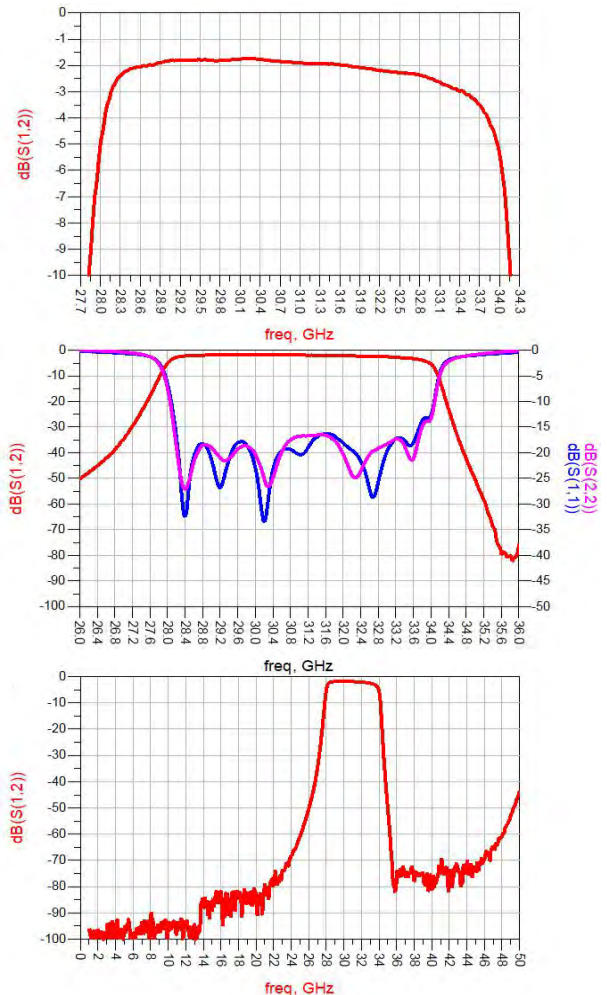


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.5	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



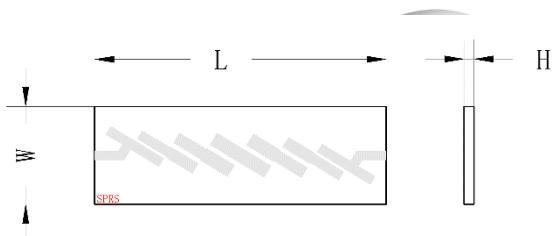
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

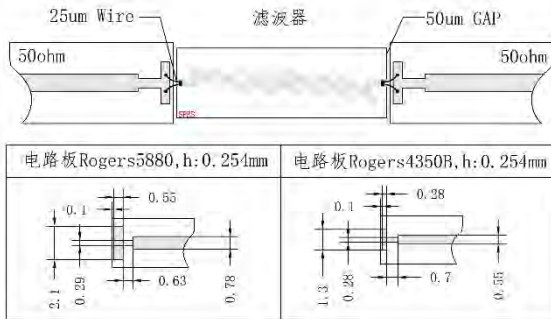
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		29.8		GHz
工作频率	28.8		30.8	GHz
中心损耗		1.5	2.0	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-25.4GHz	55	60		dBc
带外抑制@34.1-48.0GHz	55	60		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 6.5, W: 2.0, H: 0.254, 端口居中



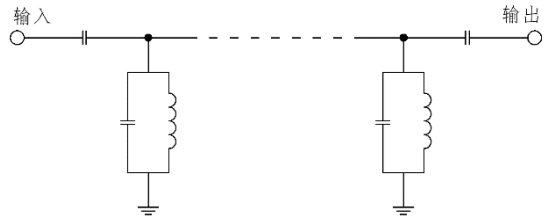
推荐装配图:



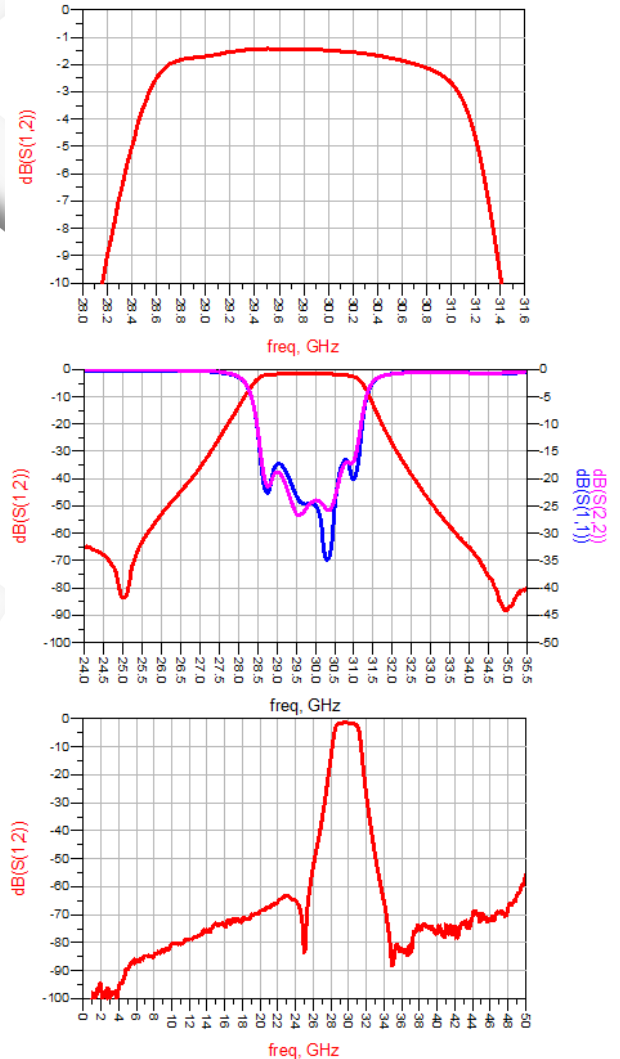
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁0.1mm，表面距上盖1.75mm，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

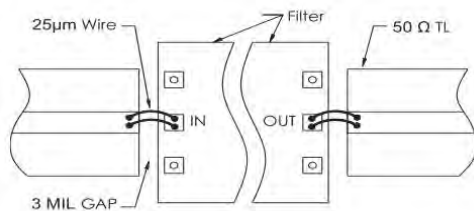
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		30.1		GHz
工作频率	28.8		31.4	GHz
中心损耗		1.6	2.1	dB
带内波动		0.7	0.8	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-26.7GHz	50	55	dBc
	@33.3-41.0GHz	50	55	dBc

### 环境要求

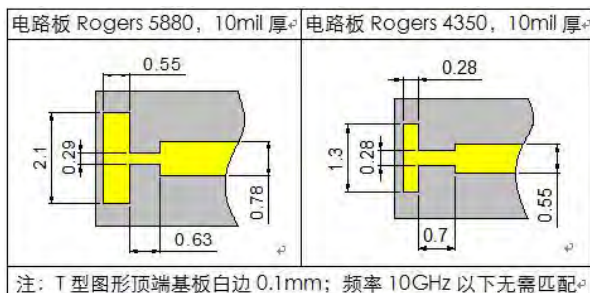
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

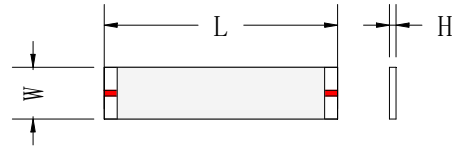


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

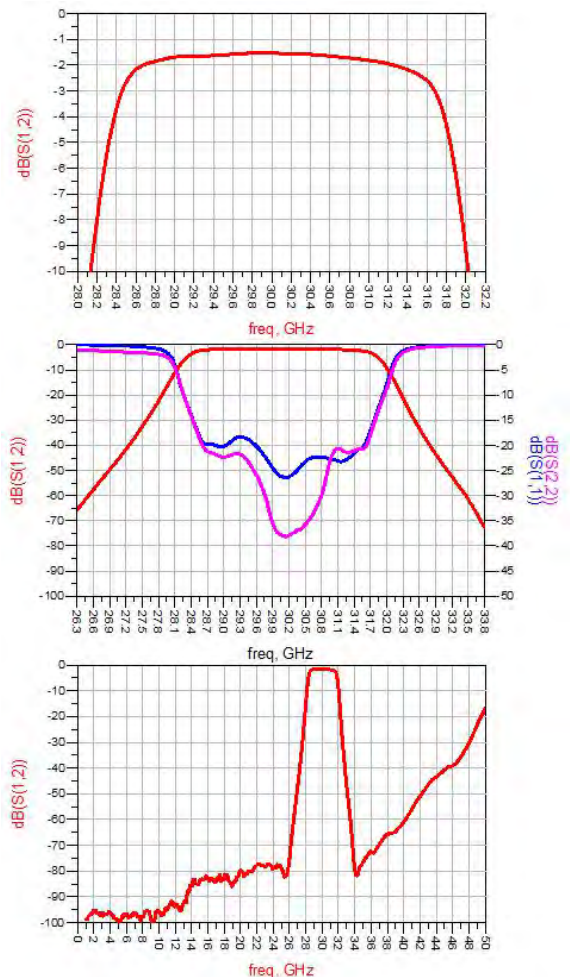


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	2.5	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块

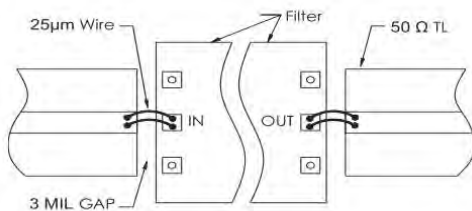
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		31.7		GHz
工作频率	29.0		34.4	GHz
中心损耗		1.6	2.1	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	10	13.5		
带外抑制	@26.0-27.1GHz	40	45	dBc
	@36.3-36.7GHz	40	45	dBc
	@DC-26.0GHz	55	60	dBc
	@36.7-48.5GHz	55	60	dBc

环境要求

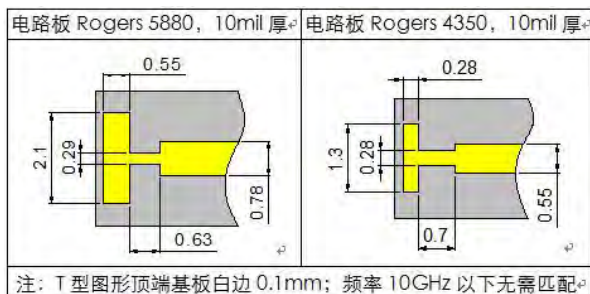
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

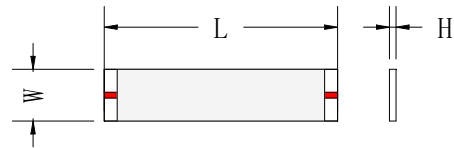
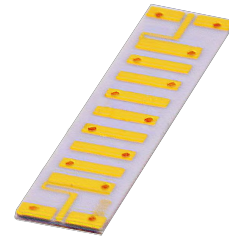


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁**0.1mm**,表面距上盖**1.75mm**,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配,T型尺寸如下:

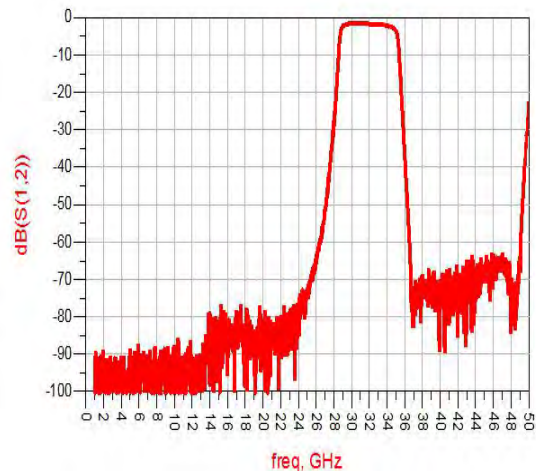
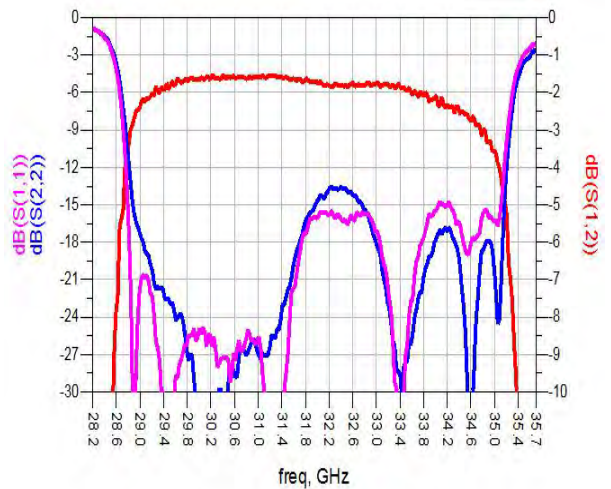


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.5	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



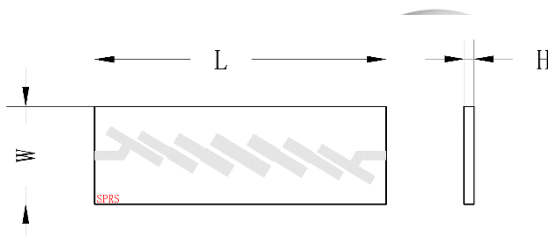
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

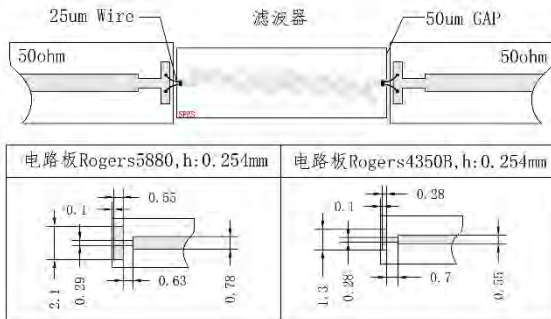
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		34.3		GHz
工作频率	29.4		39.2	GHz
中心损耗		1.0	1.5	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-24.0GHz	53	58		dBc
带外抑制@45.5-50.0GHz	53	58		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 6.5, W: 2.0, H: 0.254, 端口居中



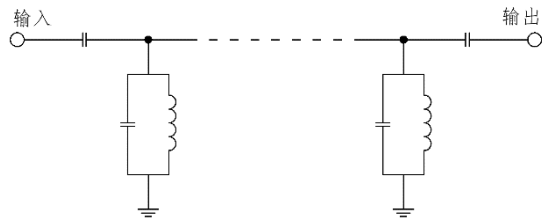
推荐装配图:



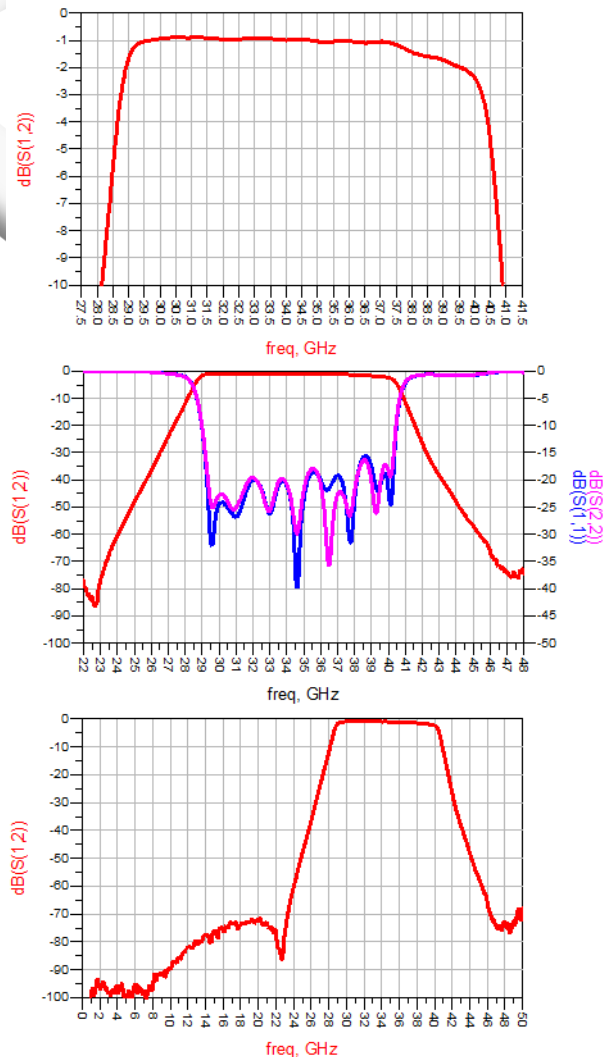
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



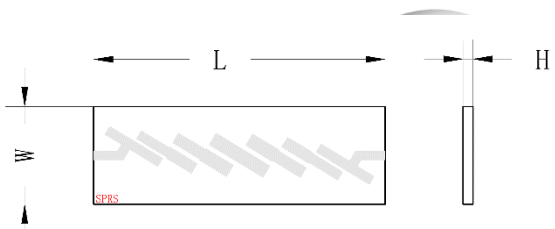
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

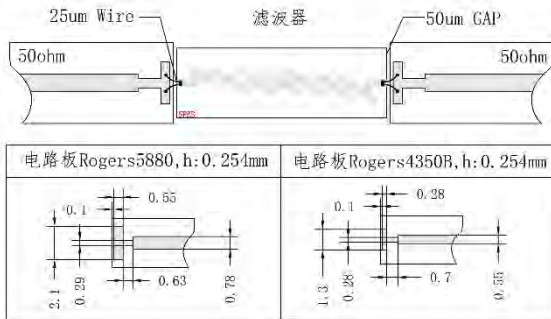
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		30.65		GHz
工作频率	29.5		31.8	GHz
中心损耗		1.7	2.2	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-26.5GHz	57	62		dBc
带外抑制@34.5-46.0GHz	57	62		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^{\circ}\text{C}$

外形图: L: 6.5, W: 2.0, H: 0.254, 端口居中



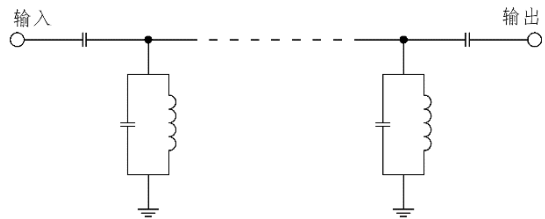
推荐装配图:



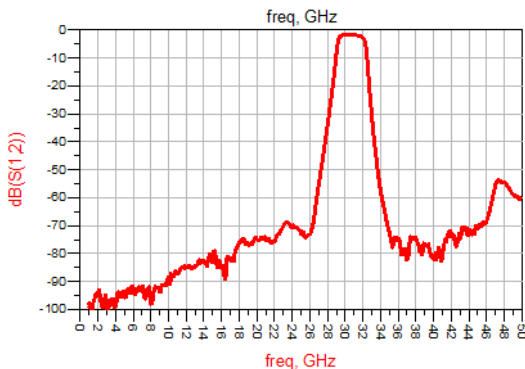
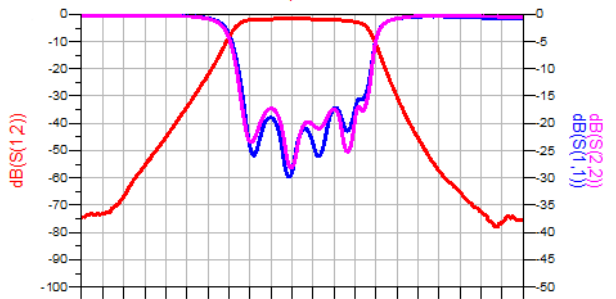
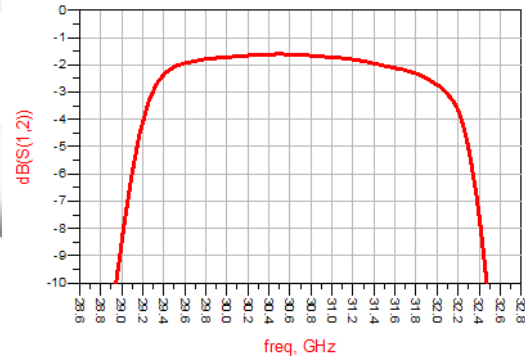
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖1.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^{\circ}\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

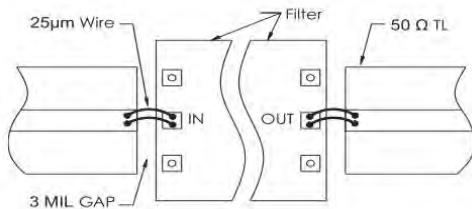
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		32.5		GHz
工作频率	29.8		35.2	GHz
中心损耗		1.2	1.7	dB
带内波动		0.9	1.1	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-27.9GHz	45	50	dBc
	@37.5-45.0GHz	45	50	dBc

环境要求

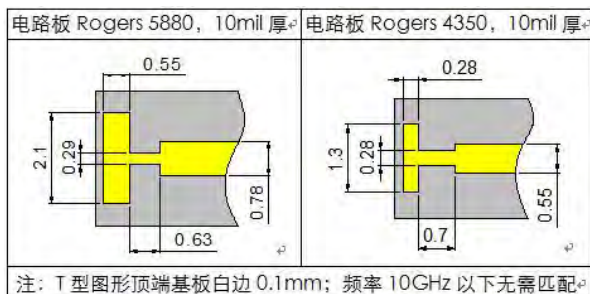
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

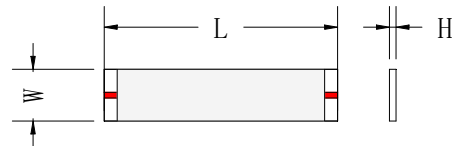


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

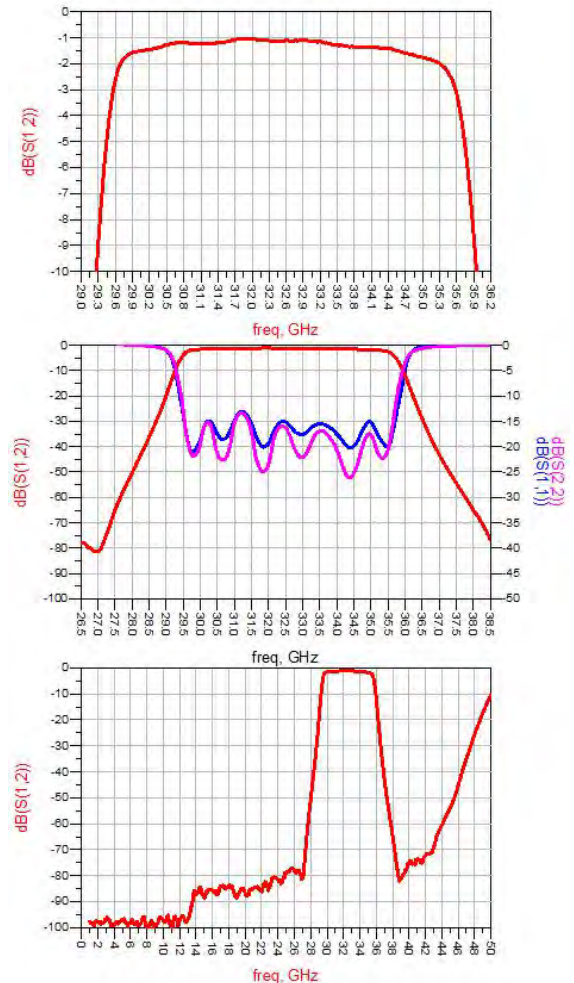


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	9.5	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

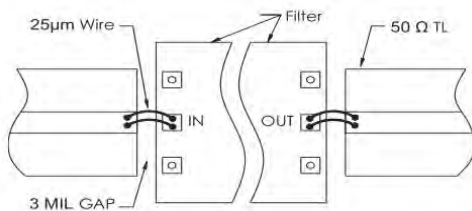
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		30.4		GHz
工作频率	29.9		30.9	GHz
中心损耗		3.5	4.0	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-28.1GHz	45	50	dBc
	@32.2-50.0GHz	45	50	dBc

### 环境要求

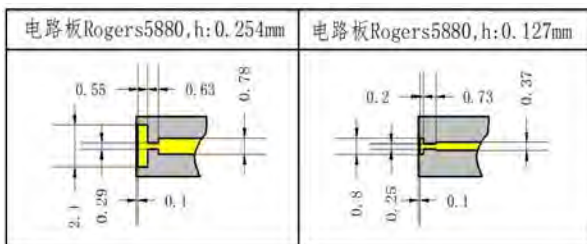
最大输入功率	30	dBm
工作温度	$-55^\circ\text{C}\sim+85^\circ\text{C}$	
储存温度	$-55^\circ\text{C}\sim+125^\circ\text{C}$	

### 推荐装配图

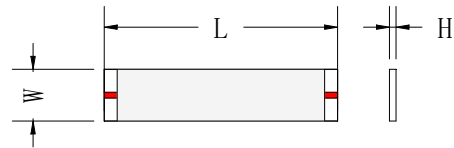


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

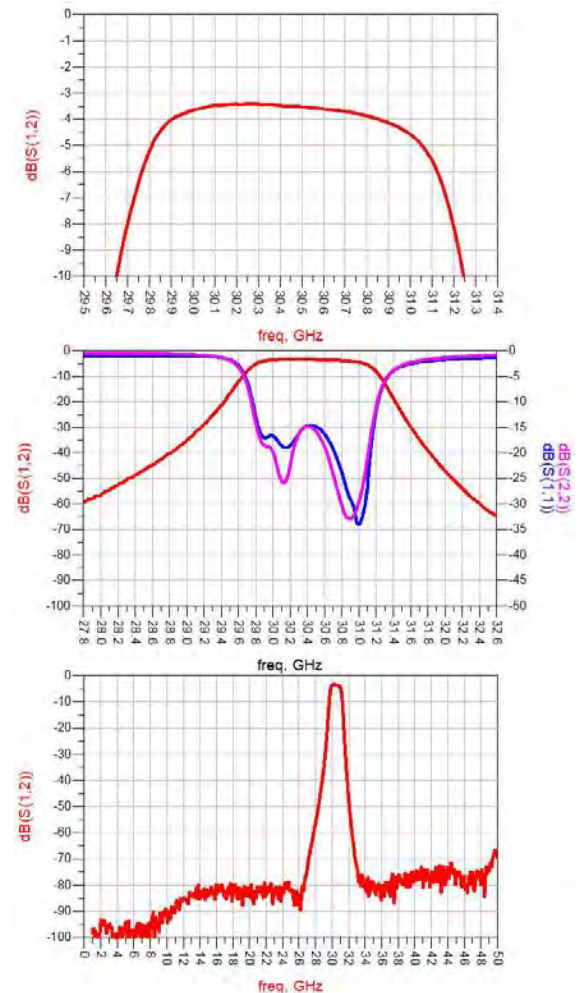


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	2.0	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

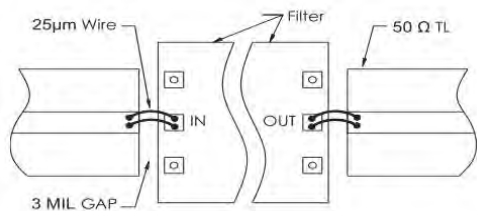
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		30.55		GHz
工作频率	29.9		31.2	GHz
中心损耗		3.3	3.8	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	14	17		
带外抑制	@DC-28.9GHz	40	45	dBc
	@32.5-47GHz	40	45	dBc

### 环境要求

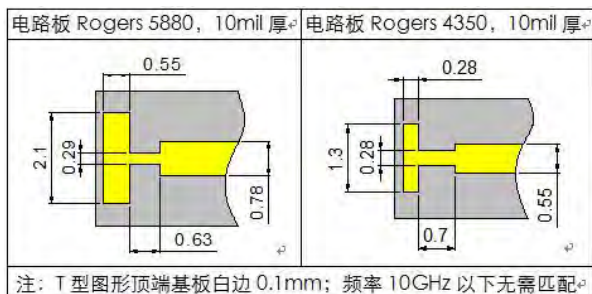
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

### 推荐装配图

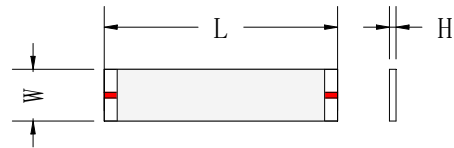


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

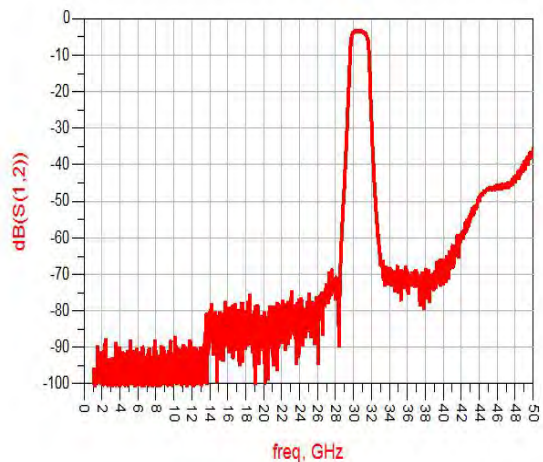
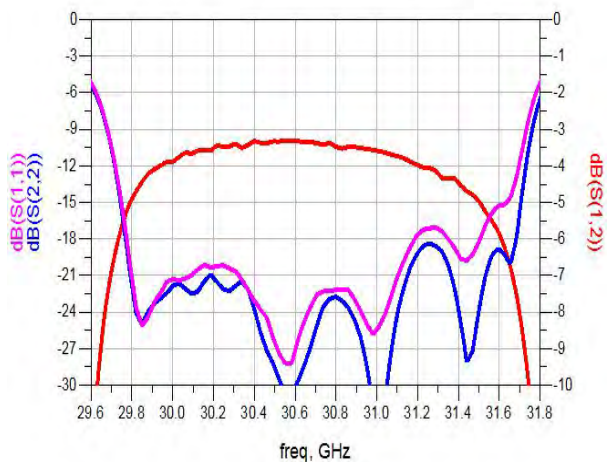


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	10.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

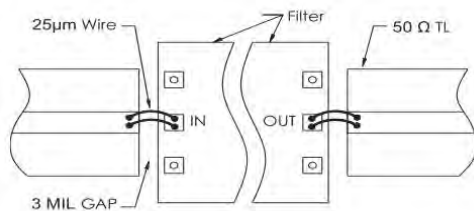
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		32.1		GHz
工作频率	30.2		34.0	GHz
中心损耗		0.9	1.4	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-28.3GHz	45	50	dBc
	@36.9-45GHz	45	50	dBc

环境要求

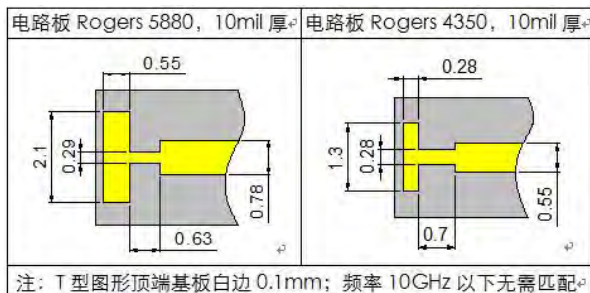
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

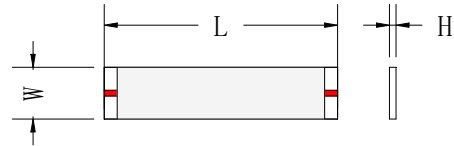


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

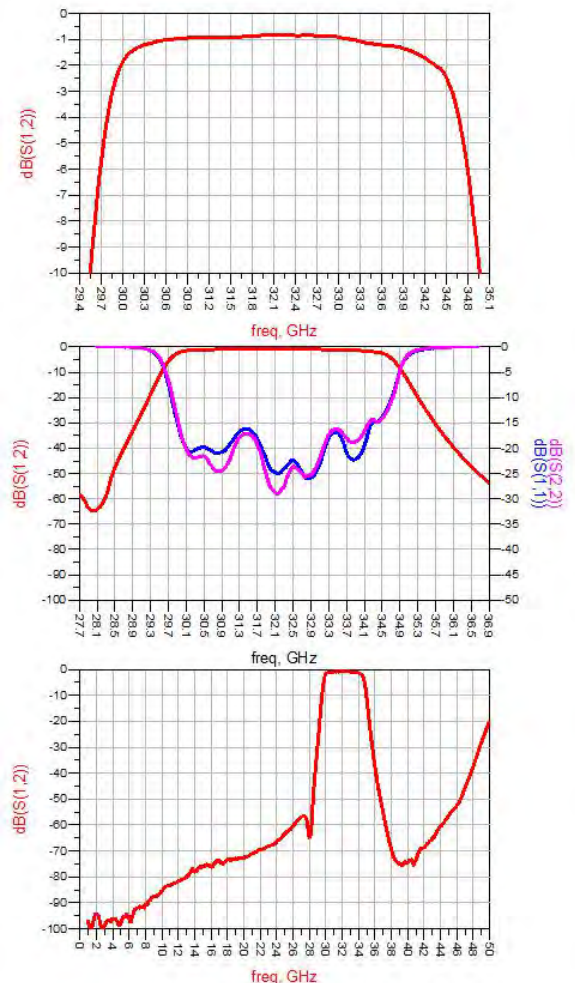


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



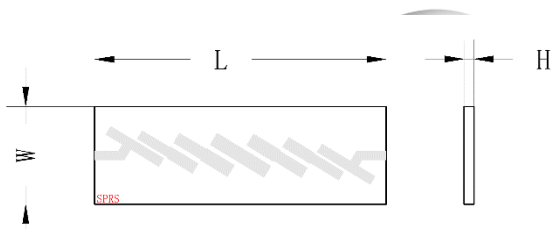
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

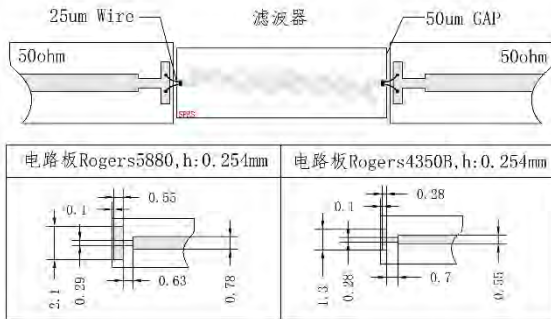
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		33.3		GHz
工作频率	30.7		35.9	GHz
中心损耗		1.7	2.2	dB
带内波动		0.9	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-28.6GHz	60	65		dBc
带外抑制@39.0-43.0GHz	60	65		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^{\circ}\text{C}$

外形图: L: 9.5, W: 2.5, H: 0.254, 端口居中



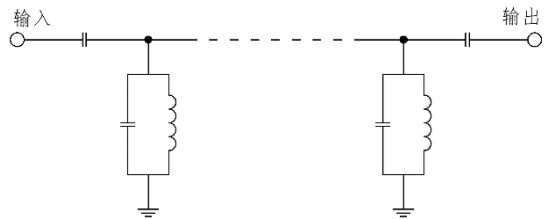
推荐装配图:



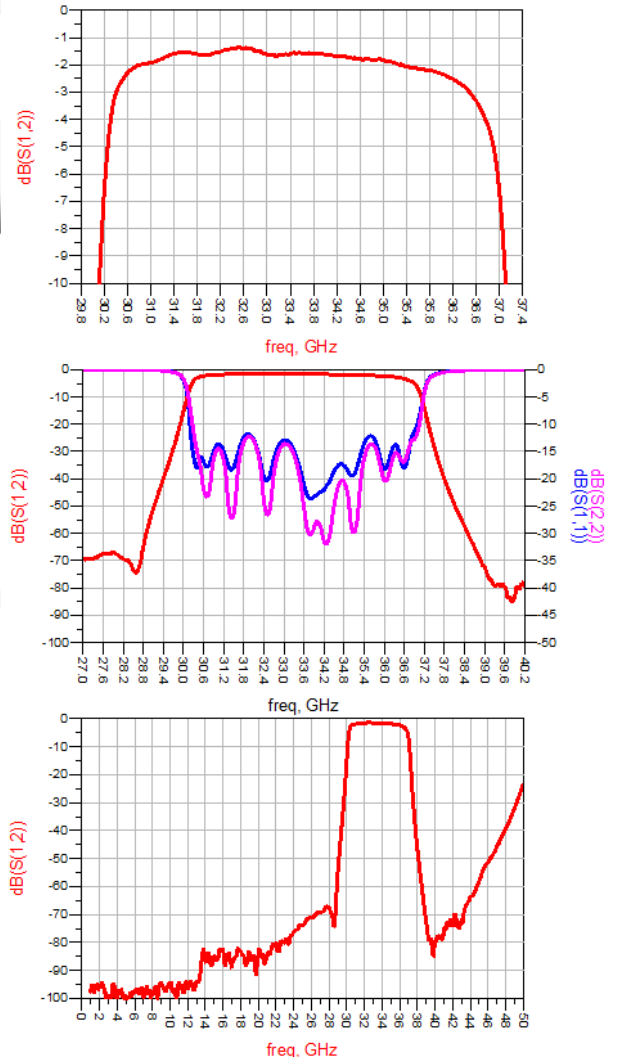
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^{\circ}\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



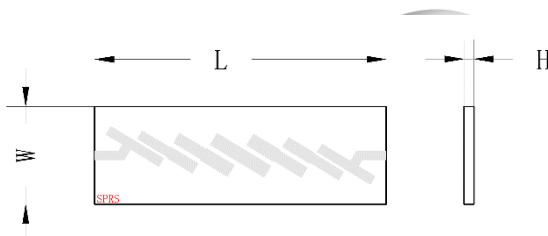
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

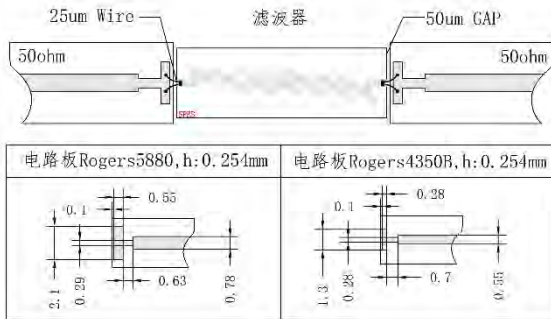
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		35.6		GHz
工作频率	30.8		40.4	GHz
中心损耗		1.3	1.8	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-26.8GHz	45	50		dBc
带外抑制@45.3-50.0GHz	45	50		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.5, W: 2.0, H: 0.254, 端口居中



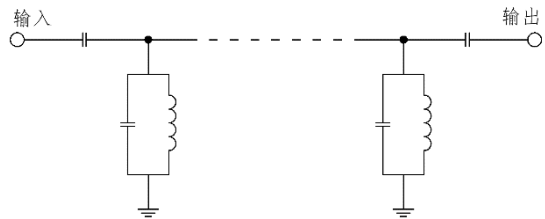
推荐装配图:



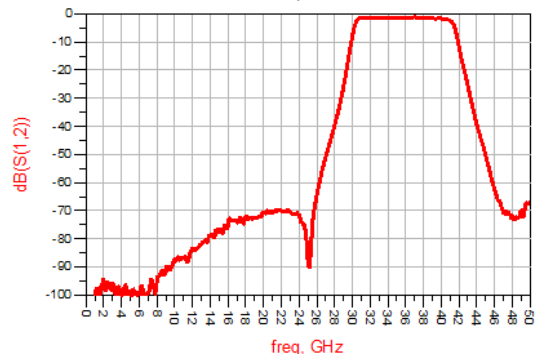
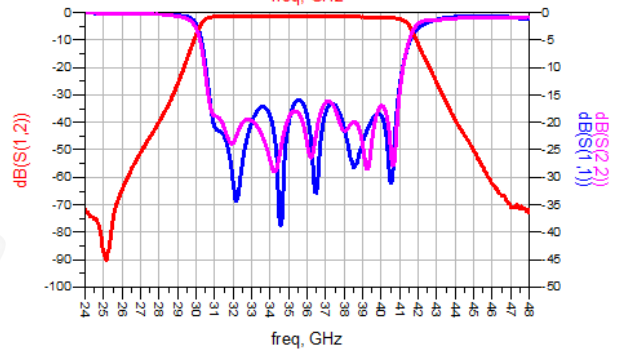
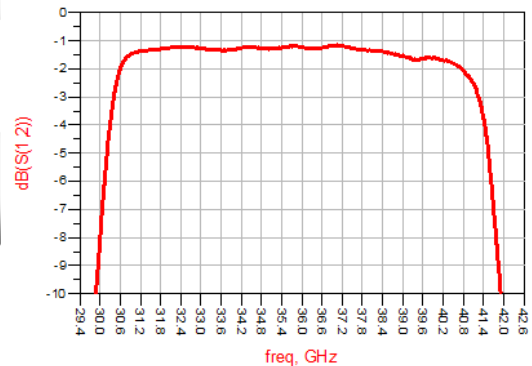
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖1.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

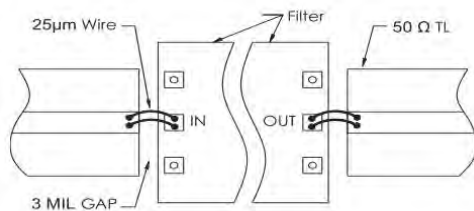
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		33.9		GHz
工作频率	31.1		36.7	GHz
中心损耗		0.9	1.4	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	14		
带外抑制	@DC-29.2GHz	50	52	dBc
	@39.9-50GHz	50	56	dBc

### 环境要求

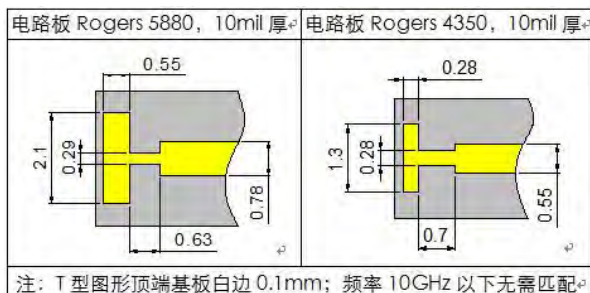
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^\circ\text{C}\sim+85^\circ\text{C}$	
储存温度	$-55^\circ\text{C}\sim+125^\circ\text{C}$	

### 推荐装配图

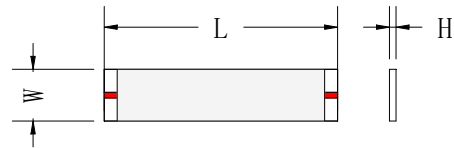


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

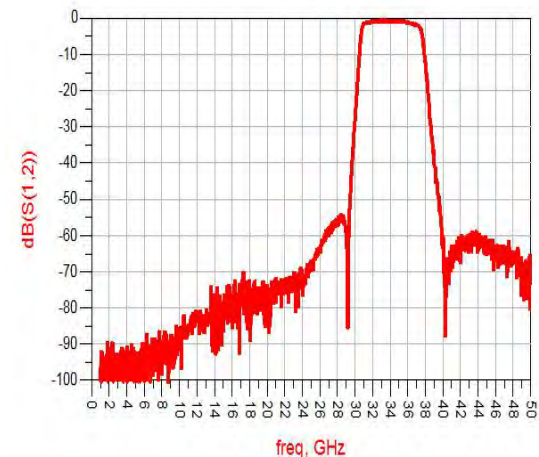
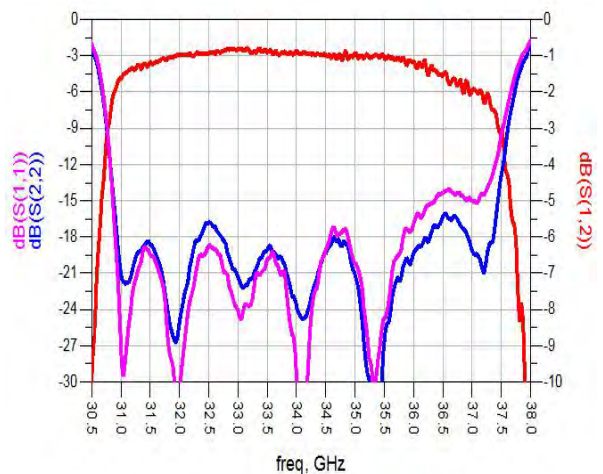


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	9.0	2.5	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



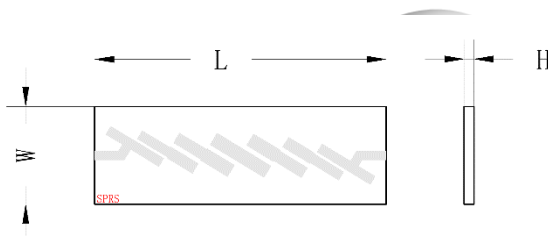
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

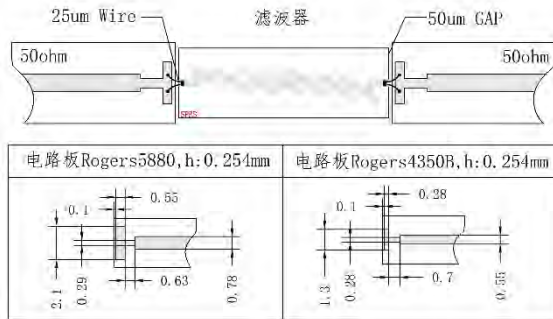
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		35.1		GHz
工作频率	31.4		38.8	GHz
中心损耗		0.7	1.2	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-27.2GHz	55	60		dBc
带外抑制@43.4-50.0GHz	55	60		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 8.0, W: 1.9, H: 0.254, 端口居中



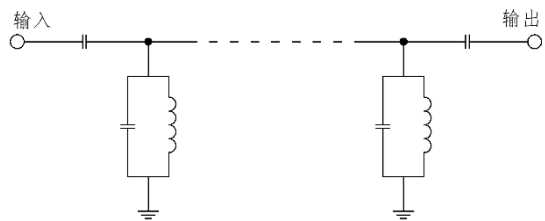
推荐装配图:



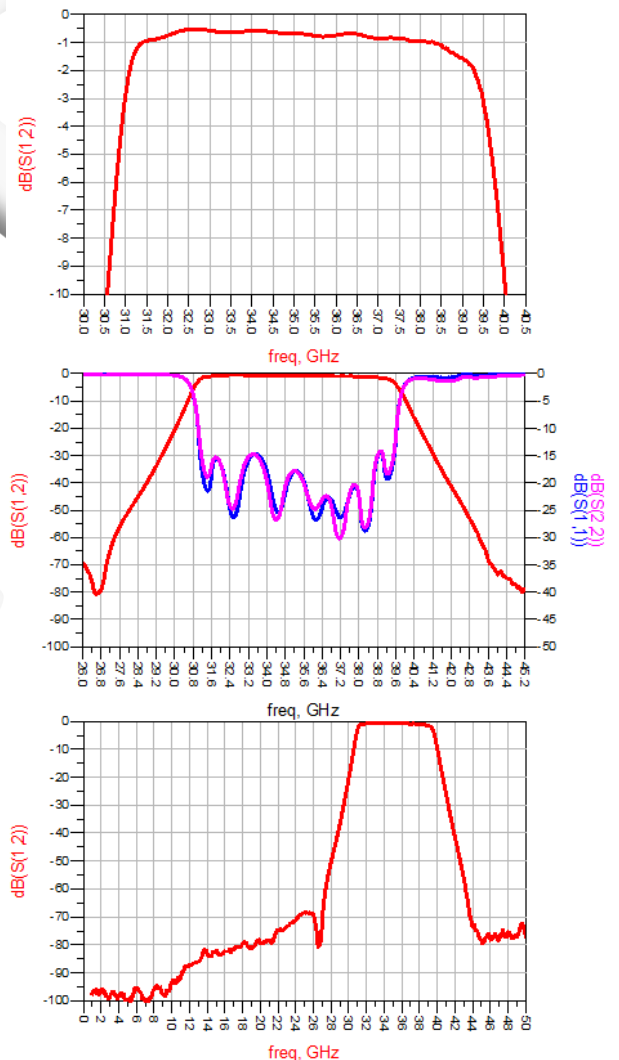
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖1.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

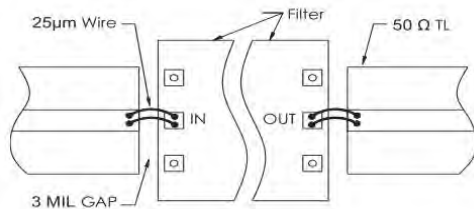
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		36.1		GHz
工作频率	31.7		40.5	GHz
中心损耗		1.3	1.7	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-29.0GHz	55	60	dBc
	@44.5-50.0GHz	55	60	dBc

环境要求

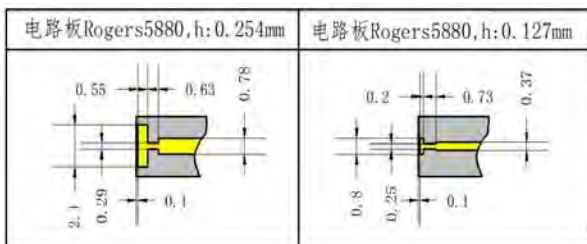
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

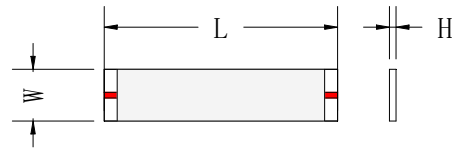


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

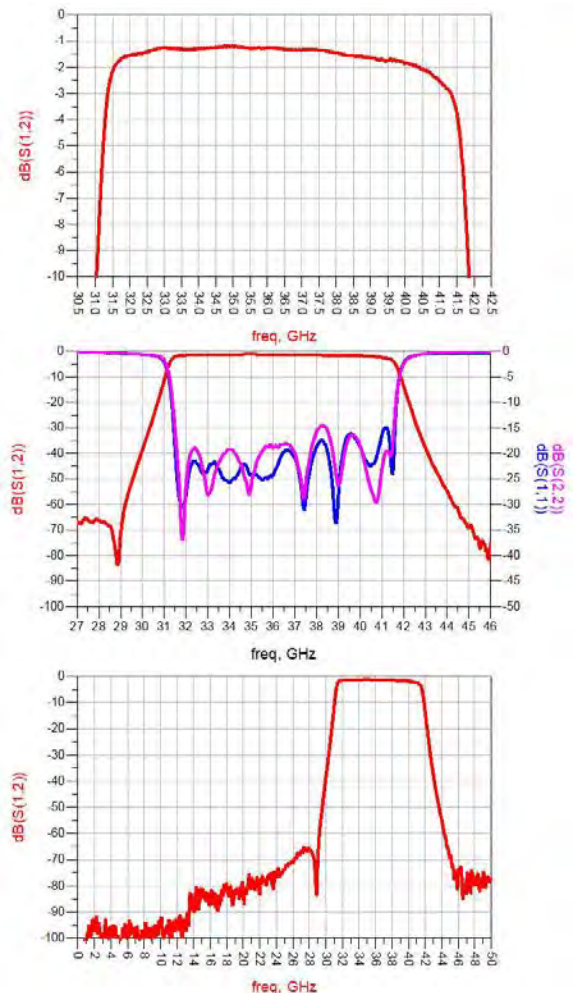


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.5	2.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



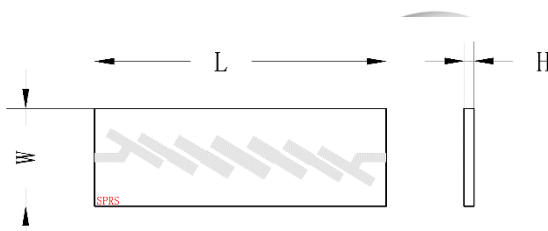
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

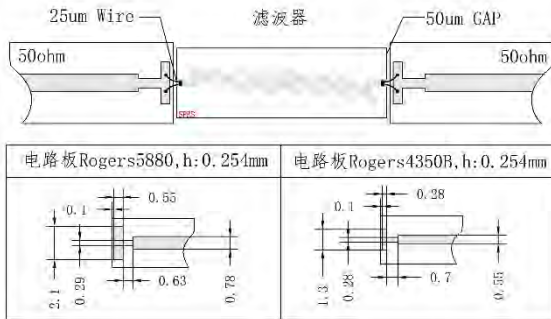
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		36.1		GHz
工作频率	31.8		40.4	GHz
中心损耗		0.7	1.2	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-28.6GHz	55	60		dBc
带外抑制@44.5-50.0GHz	55	60		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^{\circ}\text{C}$

外形图: L: 7.5, W: 2.0, H: 0.254, 端口居中



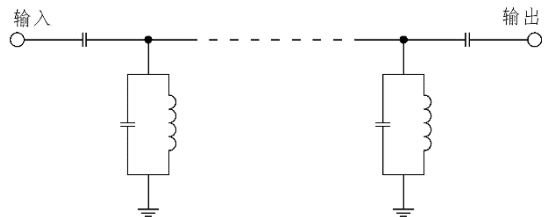
推荐装配图:



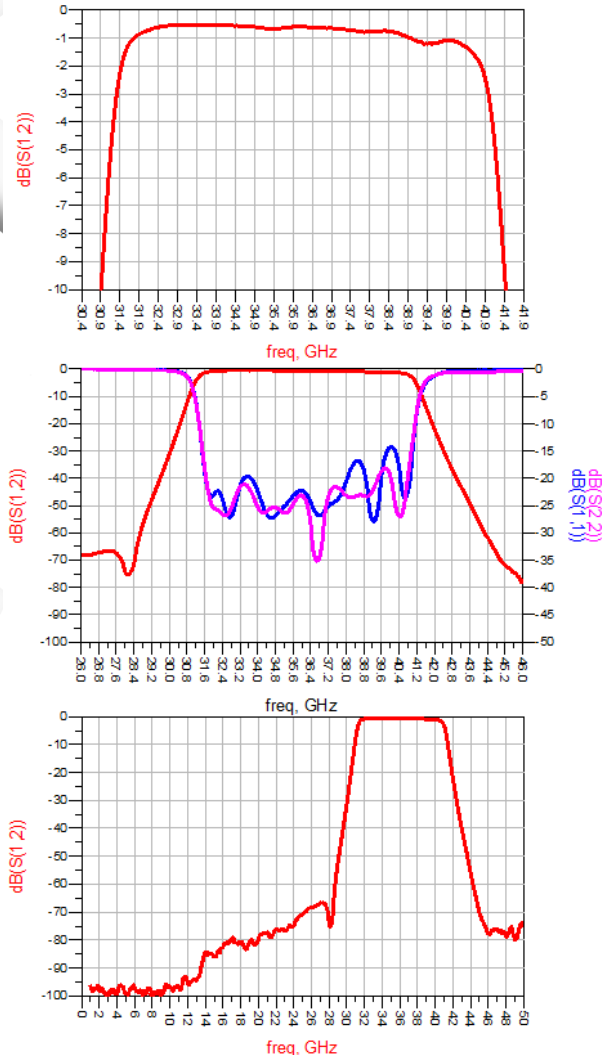
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖1.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^{\circ}\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

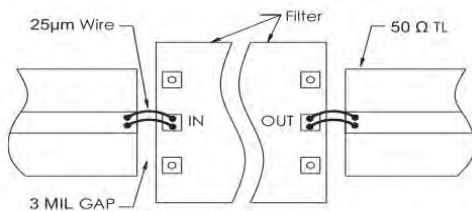
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		32.9		GHz
工作频率	31.9		33.9	GHz
中心损耗		1.0	1.5	dB
带内波动		0.6	0.7	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-28.9GHz	40	45	dBc
	@35.7-42.0GHz	40	45	dBc

### 环境要求

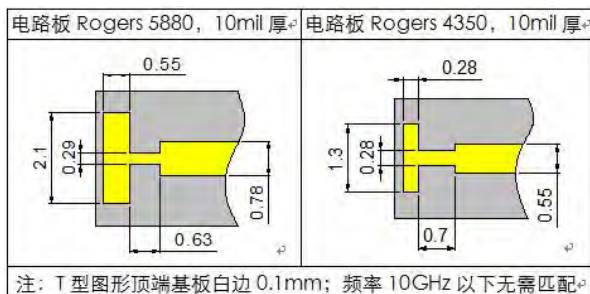
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

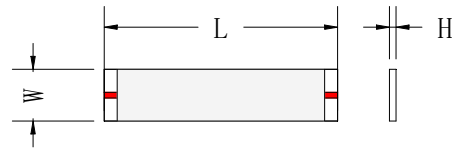


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

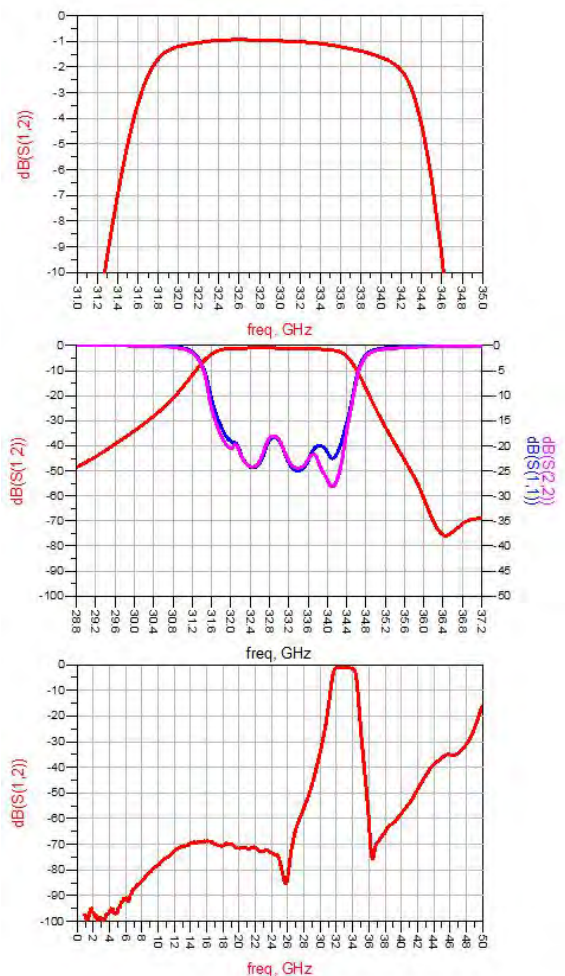


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	2.5	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

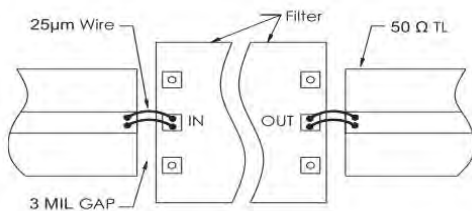
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		34.3		GHz
工作频率	31.9		36.7	GHz
中心损耗		1.6	2.1	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@DC-29.2GHz	40	45	dBc
	@39.4-46GHz	40	45	dBc

环境要求

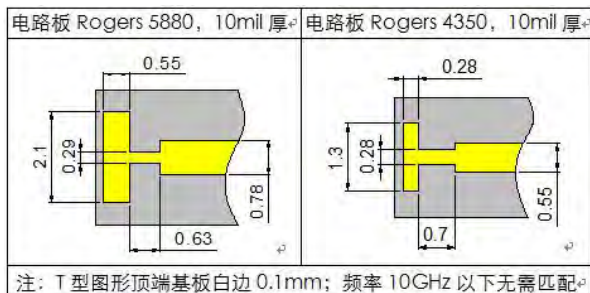
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

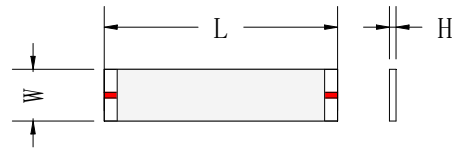


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.25mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

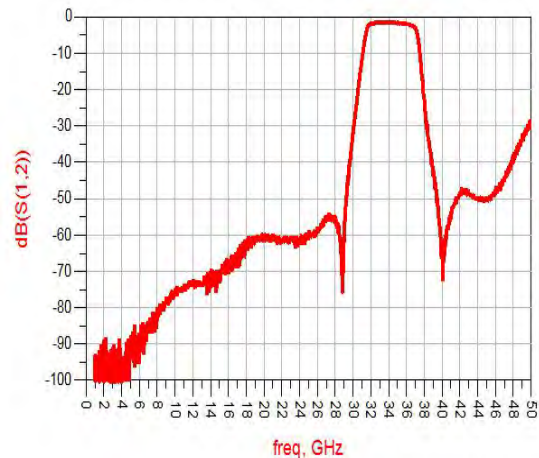
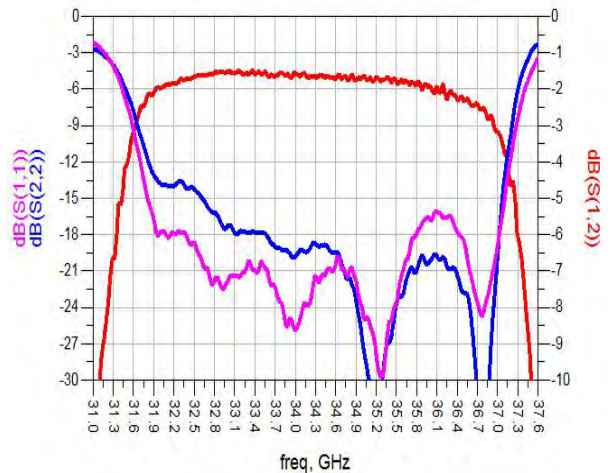


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



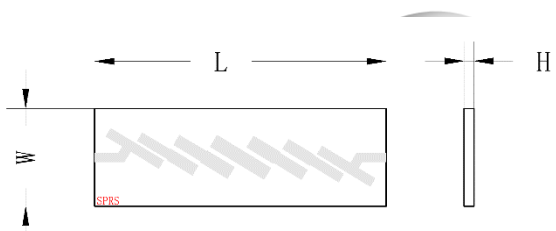
### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

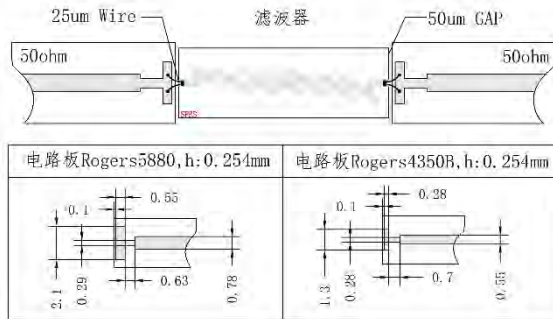
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		34.0		GHz
工作频率	32.0		36.0	GHz
中心损耗		1.3	1.8	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-30.2GHz	55	60		dBc
带外抑制@38.7-48.0GHz	55	60		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 9.0, W: 2.5, H: 0.254, 端口居中



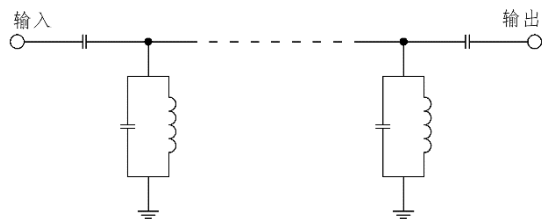
### 推荐装配图:



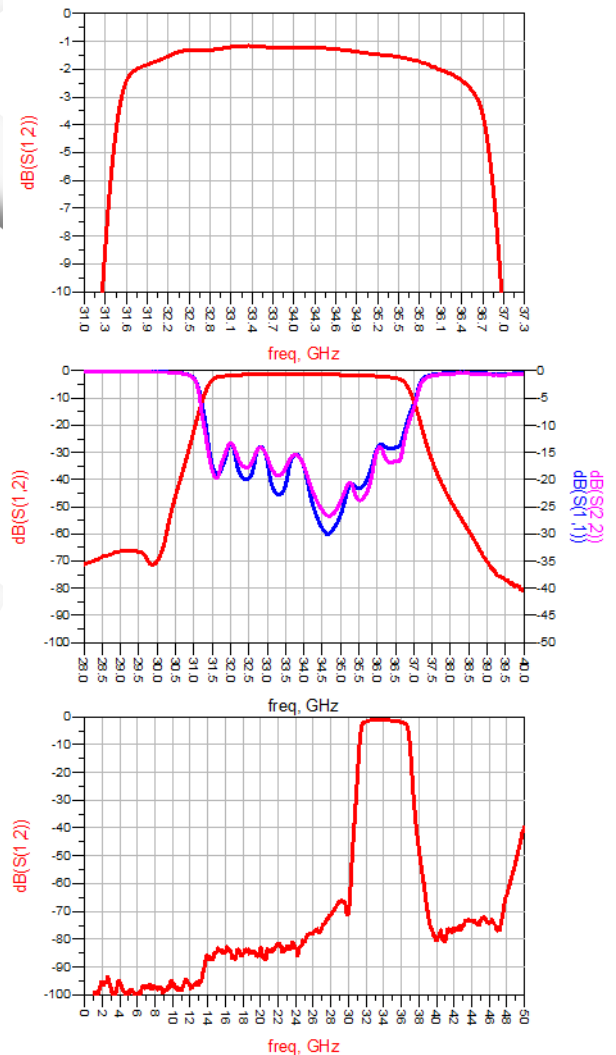
### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**1.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

### 原理图



### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

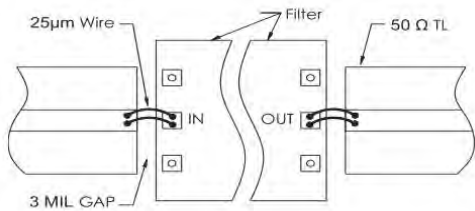
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		36.1		GHz
工作频率	32.0		40.2	GHz
中心损耗		1.1	1.4	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-29.6GHz	48	53	dBc
	@43.5-48.0GHz	40	45	dBc

环境要求

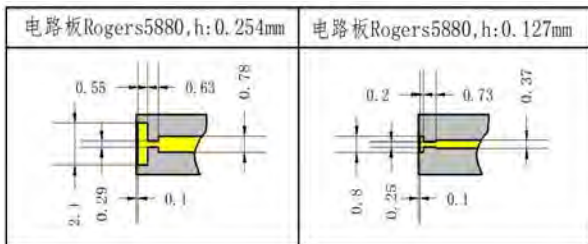
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

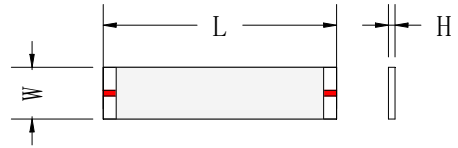


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

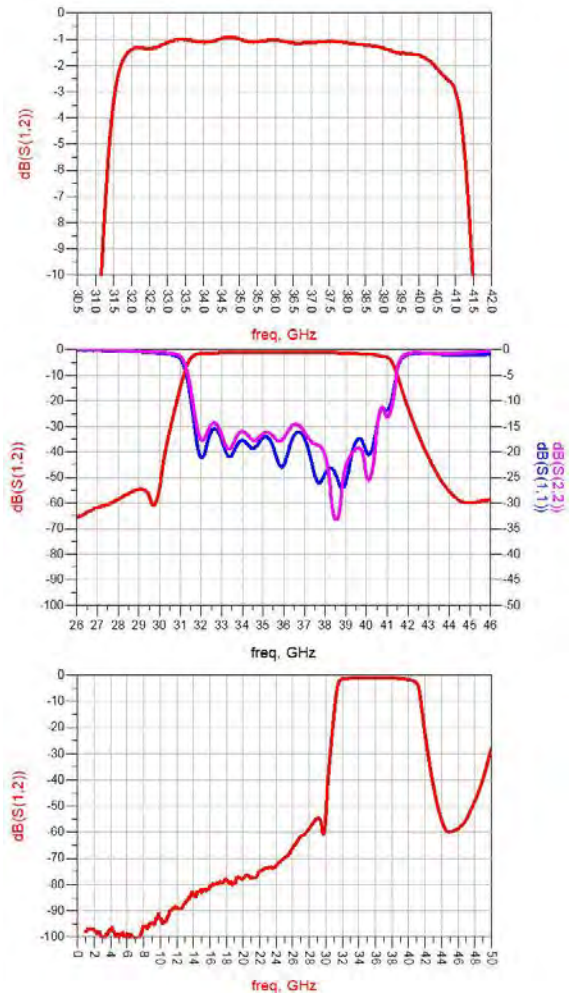


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	9.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

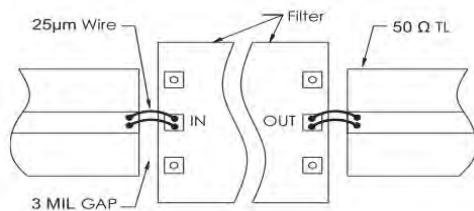
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		36.25		GHz
工作频率	32		40.5	GHz
中心损耗		2.4	2.9	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	10	11		
带外抑制	@DC-15GHz	55	60	dBc
	@15-28.2GHz	45	50	dBc
	@44-50GHz	20	25	dBc

环境要求

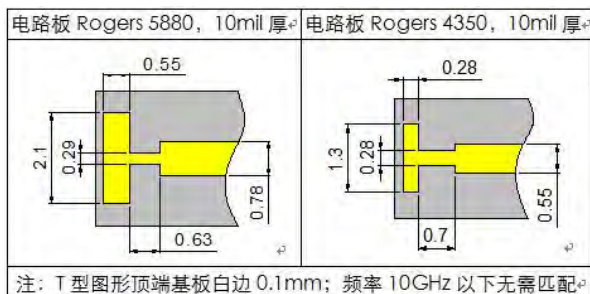
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

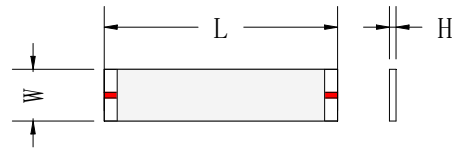


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

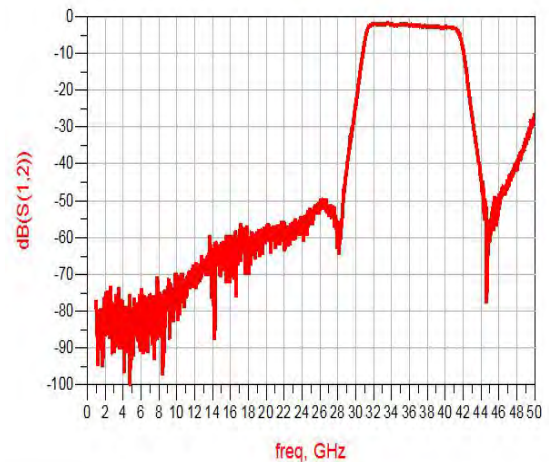
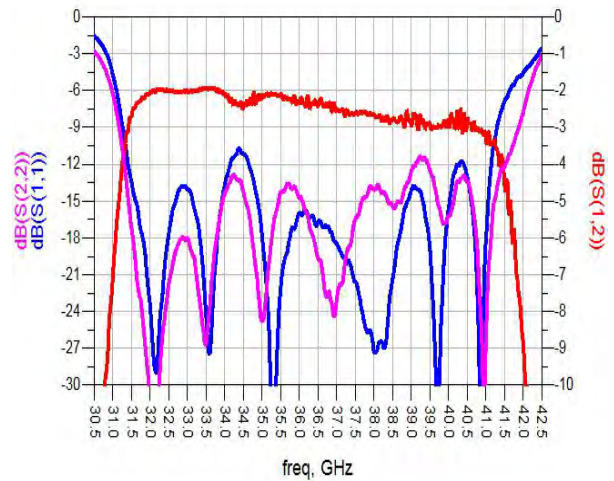


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

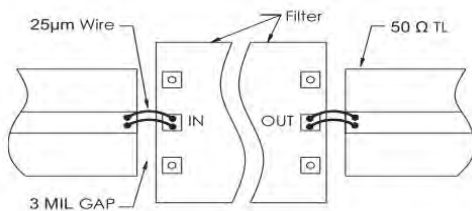
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		36.5		GHz
工作频率	32.0		41.0	GHz
中心损耗		0.8	1.3	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-26.8GHz	40	45	dBc
	@46.5-50.0GHz	40	45	dBc

### 环境要求

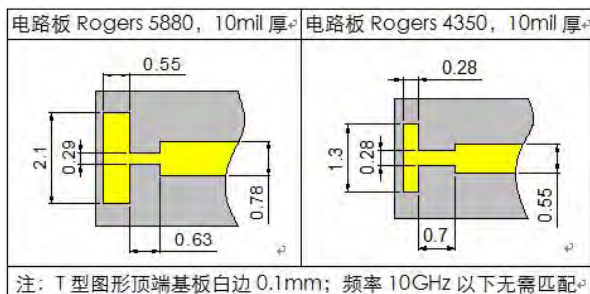
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

### 推荐装配图

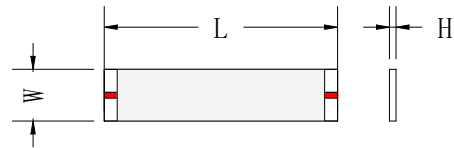


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

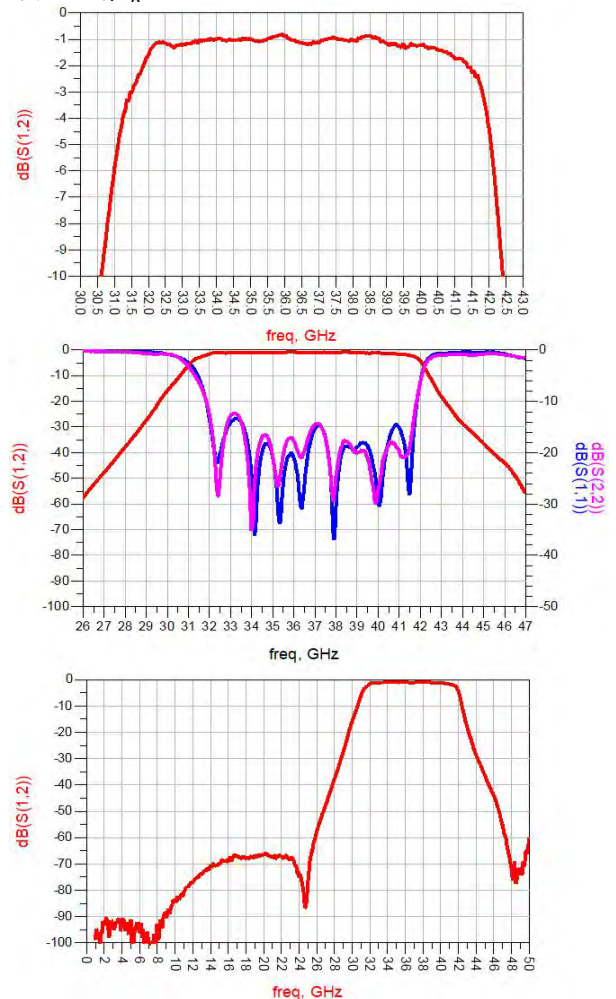


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	1.9	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



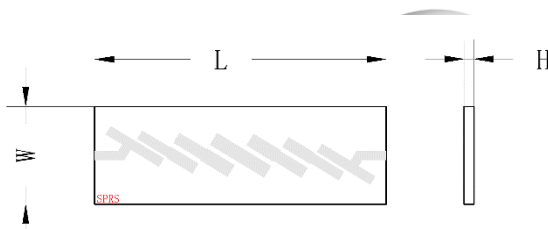
### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

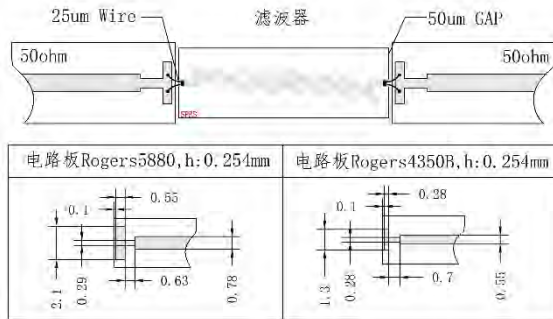
技术要求,  $T_A = 25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		37.6		GHz
工作频率	32.0		43.2	GHz
中心损耗		0.9	1.4	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-26.5GHz	45	50		dBc
带外抑制@49.1-50.0GHz	45	50		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.5, W: 2.0, H: 0.254, 端口居中



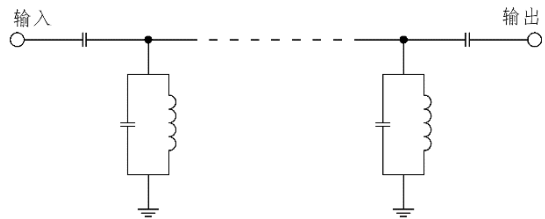
### 推荐装配图:



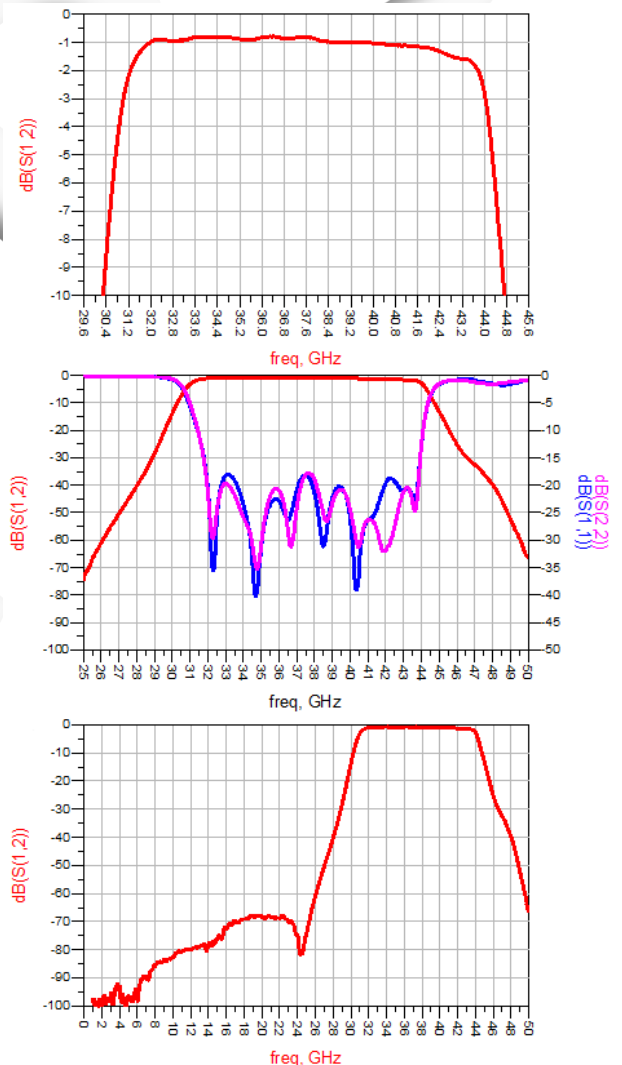
### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME845E)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

### 原理图



### 典型曲线, $T_A = 25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块

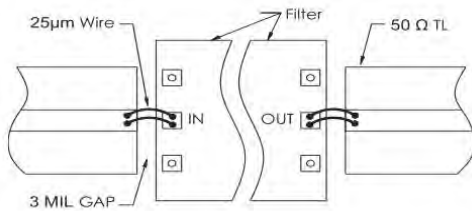
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		35.5		GHz
工作频率	32.3		37.7	GHz
中心损耗		1.4	1.8	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-30.2GHz	40	45	dBc
	@39.8-47.0GHz	40	45	dBc

环境要求

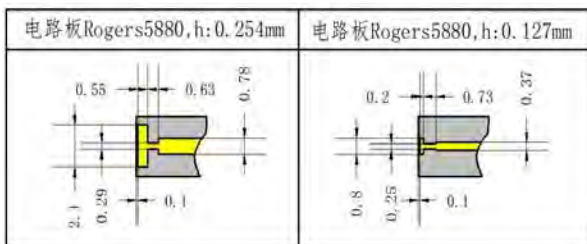
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

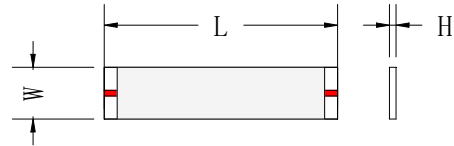


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁**0.1mm**,表面距上盖**1.75mm**,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配,T型尺寸如下:

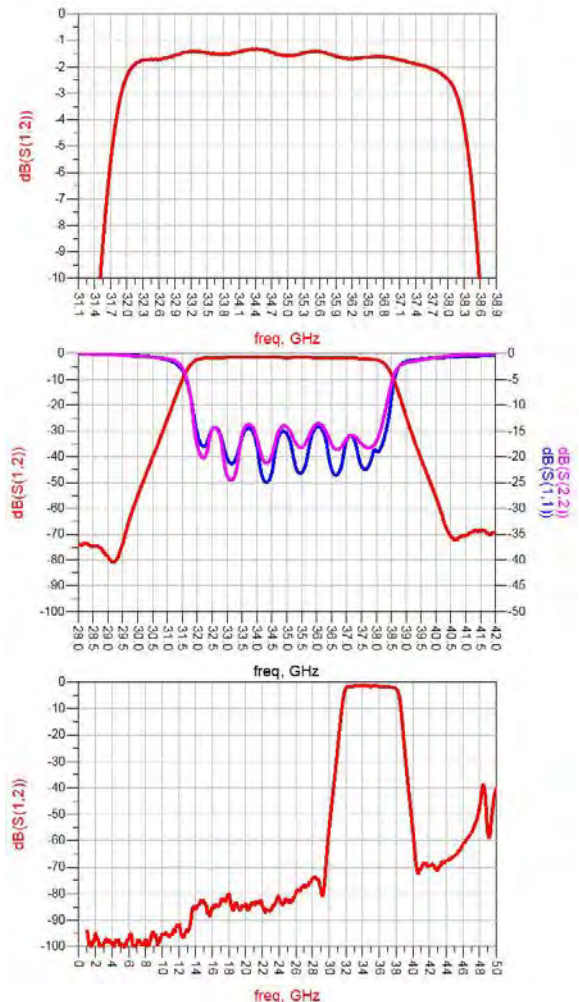


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.5	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

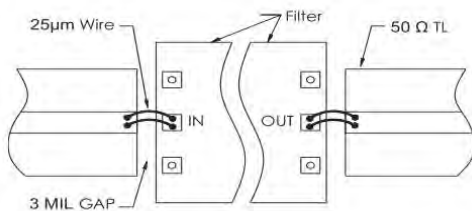
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		34.7		GHz
工作频率	32.4		37	GHz
中心损耗		1.3	1.8	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	15	18		
带外抑制	@DC-28.8GHz	70	75	dBc
	@28.8-30.5GHz	40	45	dBc
	@39.3-45GHz	40	45	dBc

环境要求

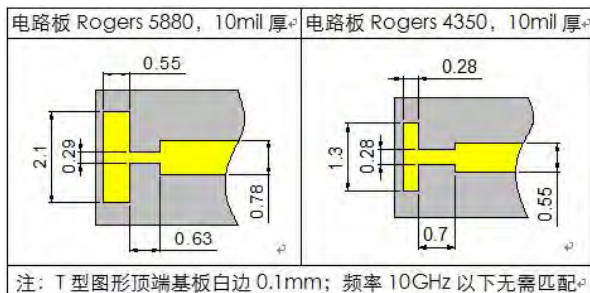
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

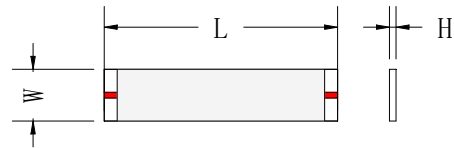


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.25mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

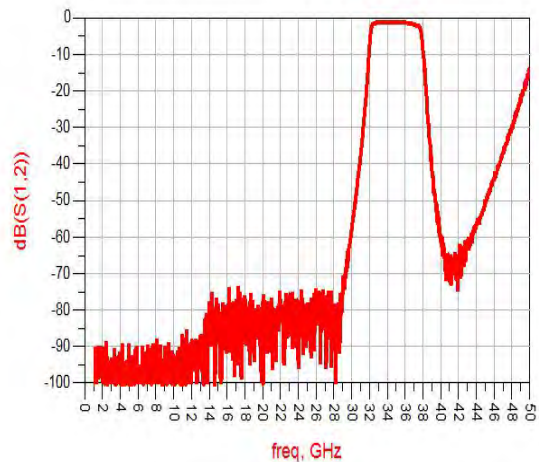
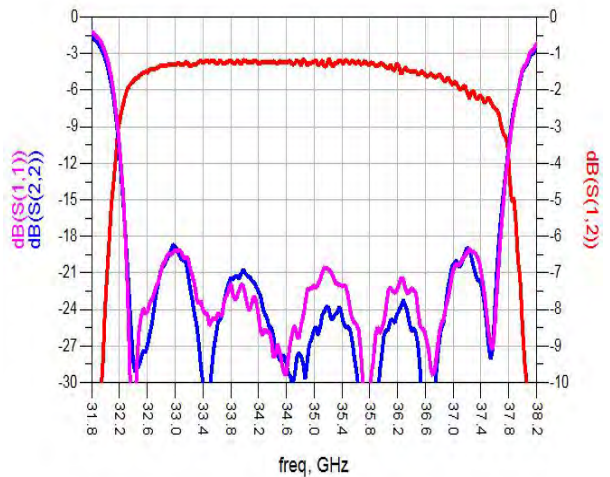


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.5	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



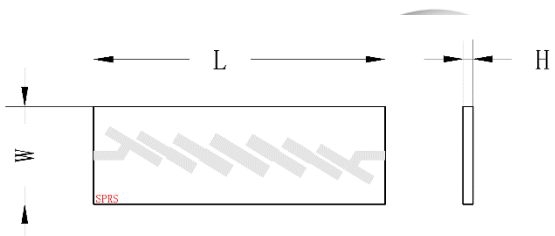
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

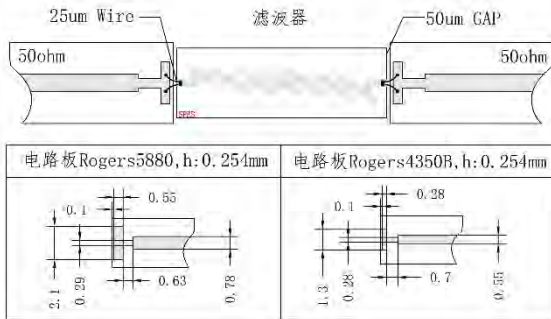
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		34.4		GHz
工作频率	32.8		36.0	GHz
中心损耗		2.2	2.7	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-30.6GHz	67	72		dBc
带外抑制@38.4-45.0GHz	55	60		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^{\circ}\text{C}$

外形图: L: 9.5, W: 2.5, H: 0.254, 端口居中



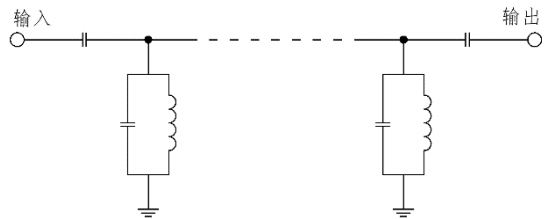
推荐装配图:



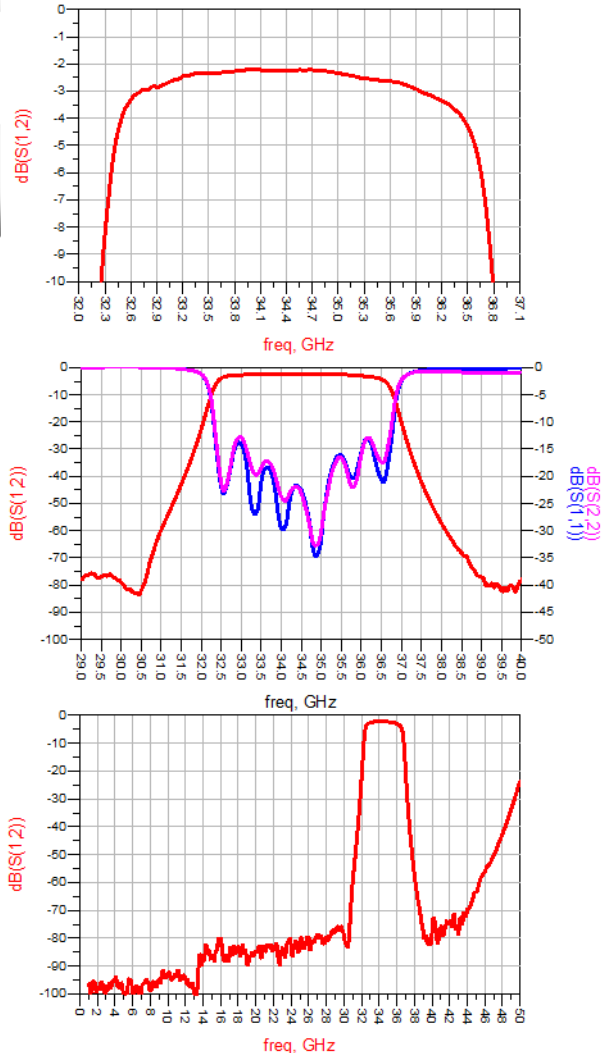
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖1.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^{\circ}\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

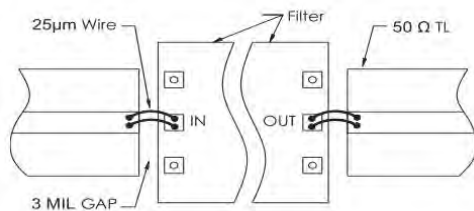
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		35.0		GHz
工作频率	33.0		37.0	GHz
中心损耗		1.7	2.2	dB
带内波动		1.3	1.6	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-31.0GHz	63	68	dBc
	@39.4-44.0GHz	63	68	dBc

### 环境要求

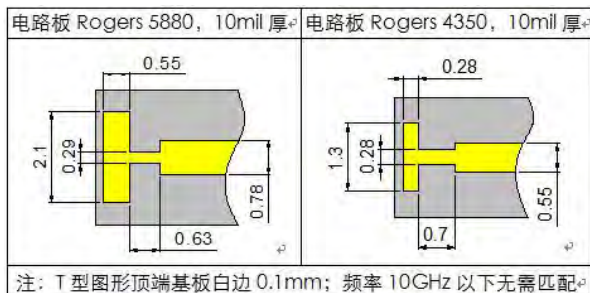
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

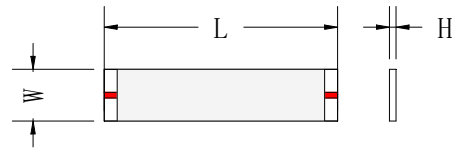


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

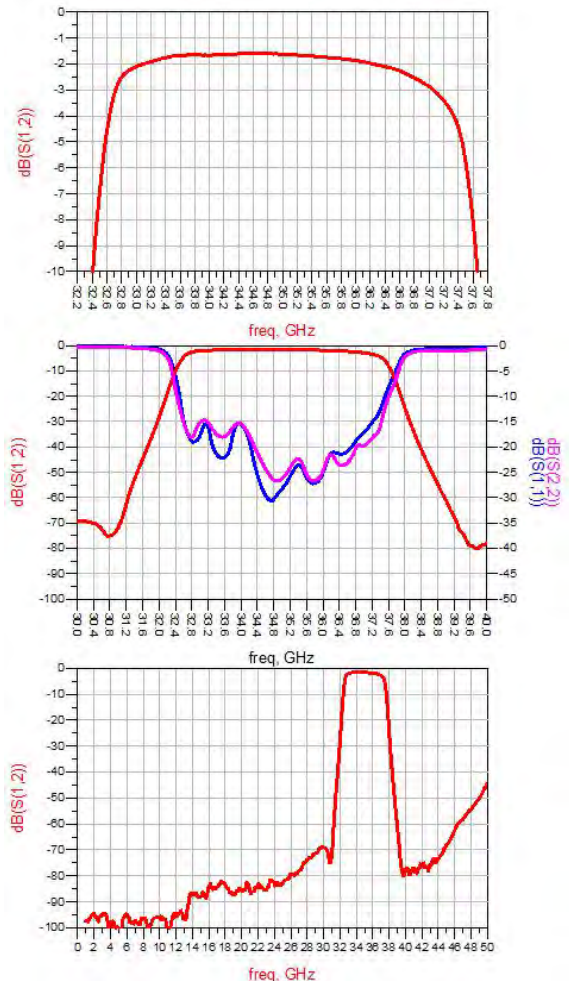


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	9.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



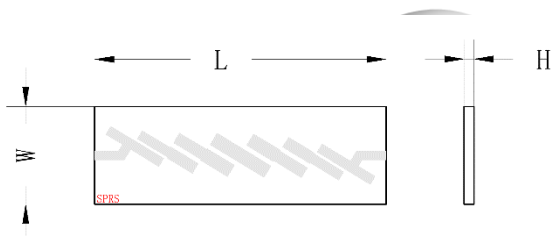
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块

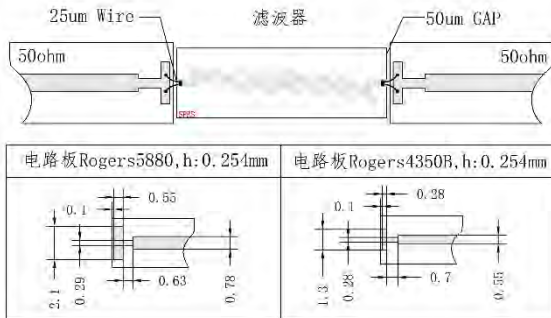
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		35.3		GHz
工作频率	32.8		37.8	GHz
中心损耗		1.4	1.9	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-28.5GHz	50	55		dBc
带外抑制@41.5-50.0GHz	65	70		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.0, W: 2.0, H: 0.254, 端口居中



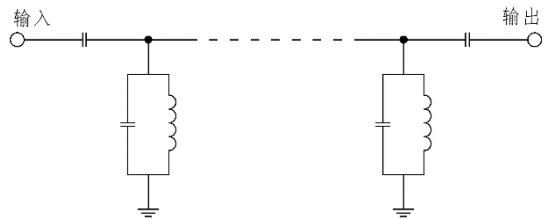
推荐装配图:



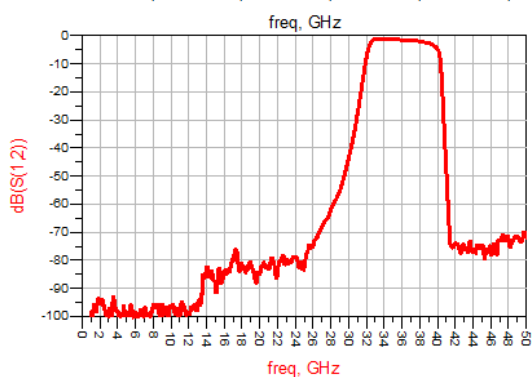
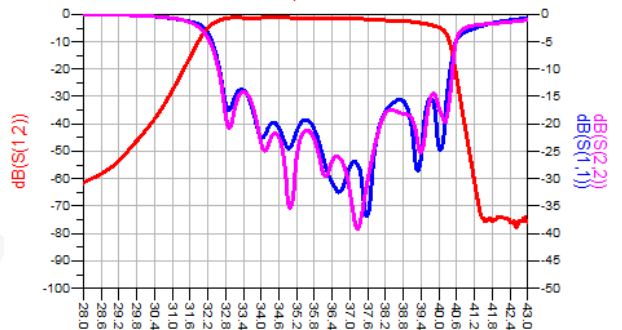
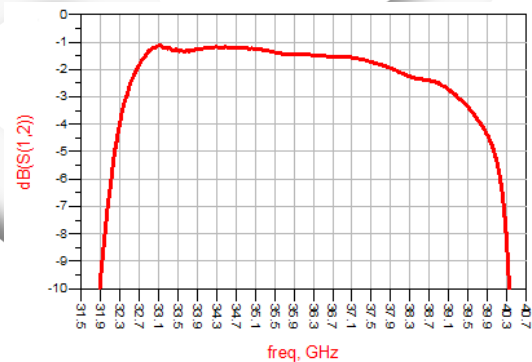
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖1.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

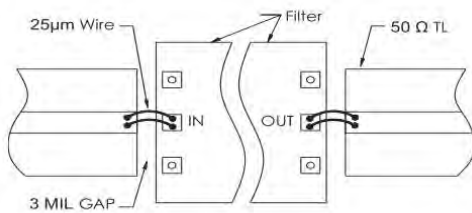
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		36.1		GHz
工作频率	33.0		39.2	GHz
中心损耗		1.6	2.1	dB
带内波动		1.0	1.1	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-29.0GHz	50	55	dBc
	@41.5-50.0GHz	50	55	dBc

环境要求

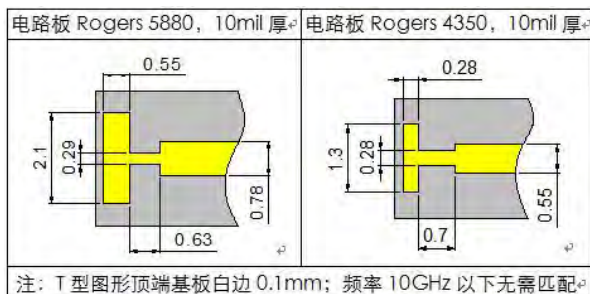
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

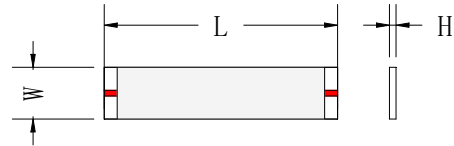
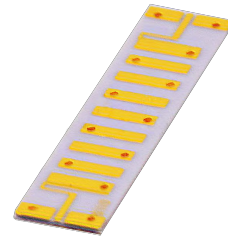


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

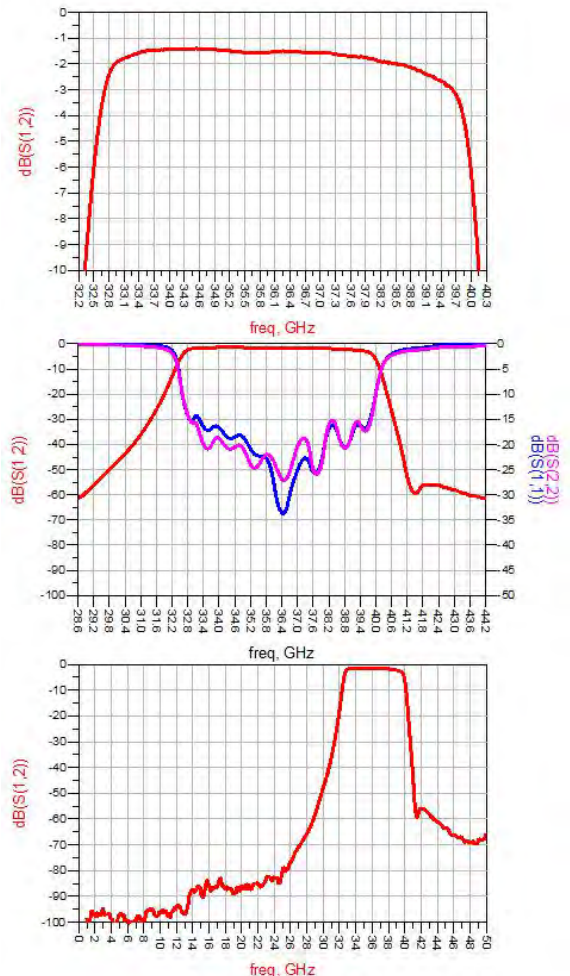


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	2.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

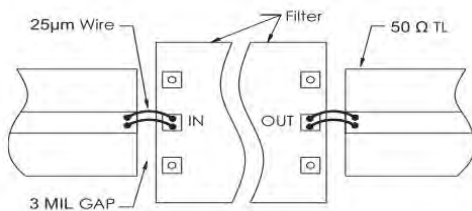
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		37.4		GHz
工作频率	33.0		41.8	GHz
中心损耗		1.5	2.0	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@DC-29.5GHz	40	45	dBc
	@45.5-50.0GHz	40	45	dBc

环境要求

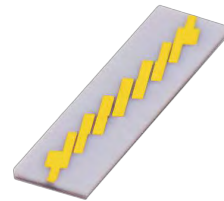
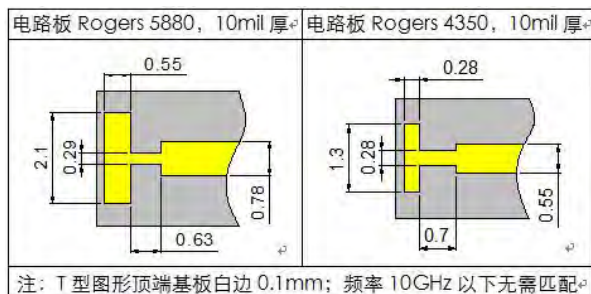
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

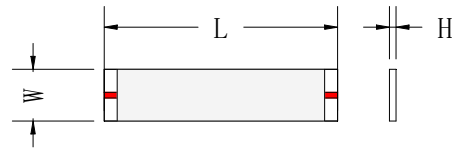


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

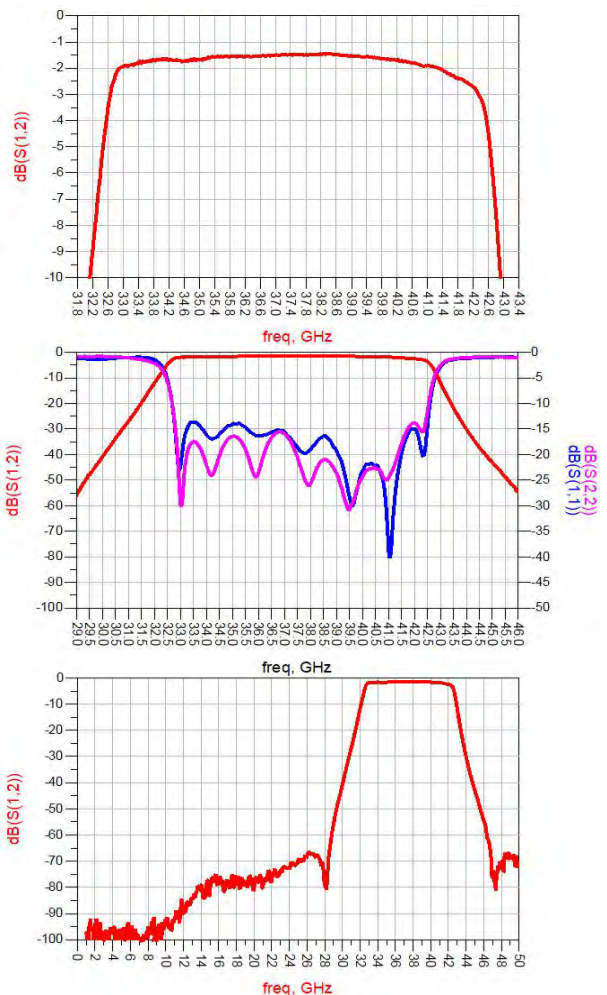


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	1.8	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

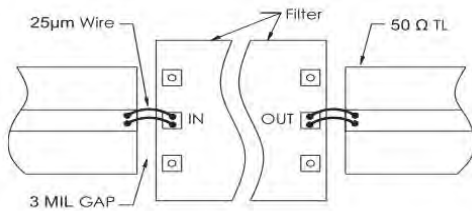
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		35.5		GHz
工作频率	33.3		37.7	GHz
中心损耗		1.4	1.8	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-31.6GHz	40	45	dBc
	@39.8-49.0GHz	40	45	dBc

环境要求

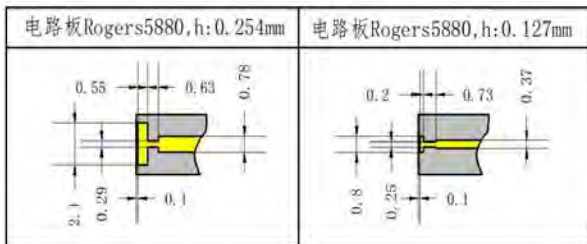
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

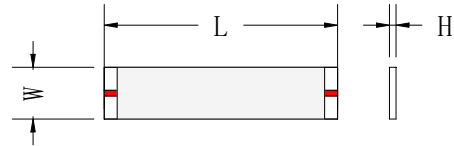


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

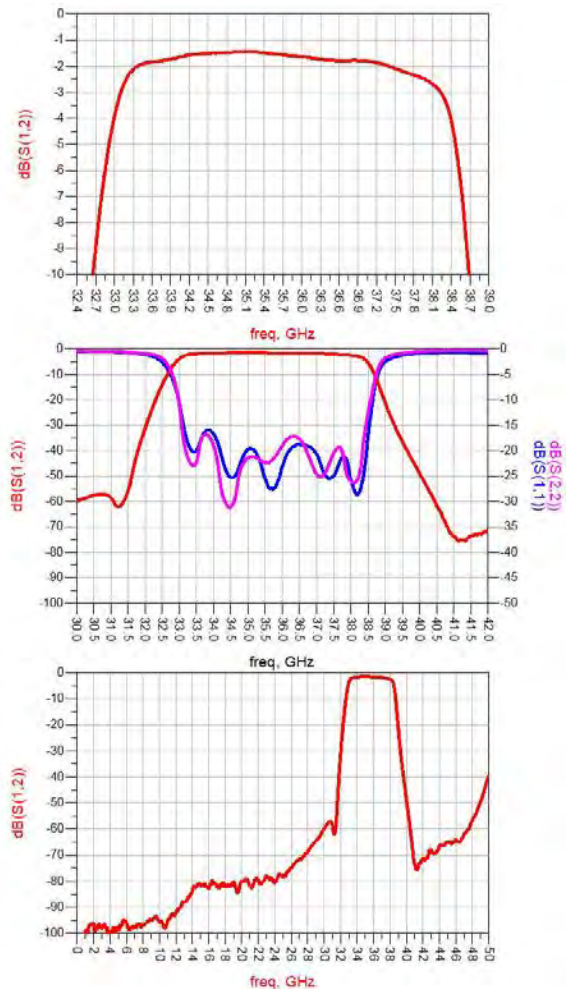


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.5	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

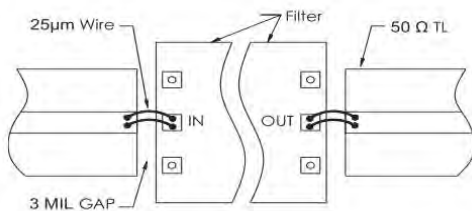
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		35.95		GHz
工作频率	33.5		38.4	GHz
中心损耗		1.4	1.9	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@DC-32.0GHz	40	45	dBc
	@40.3-50.0GHz	40	45	dBc

### 环境要求

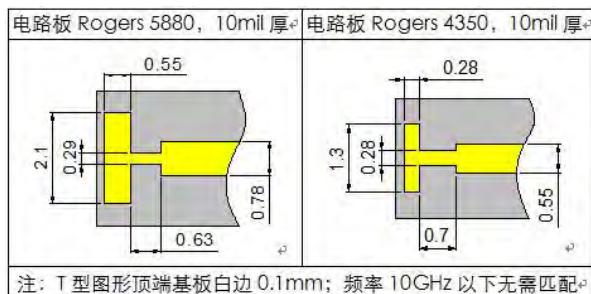
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

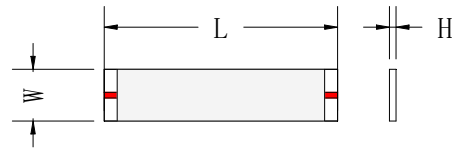


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖1.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

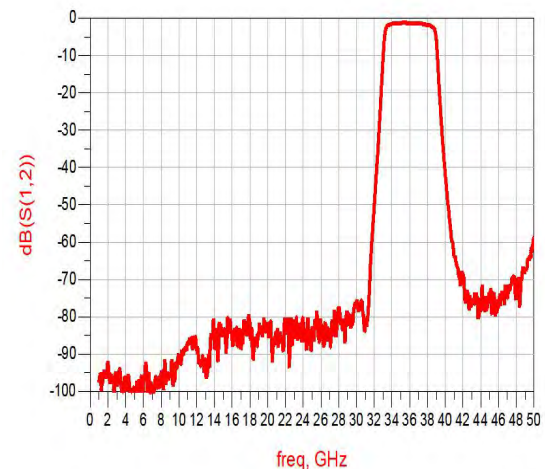
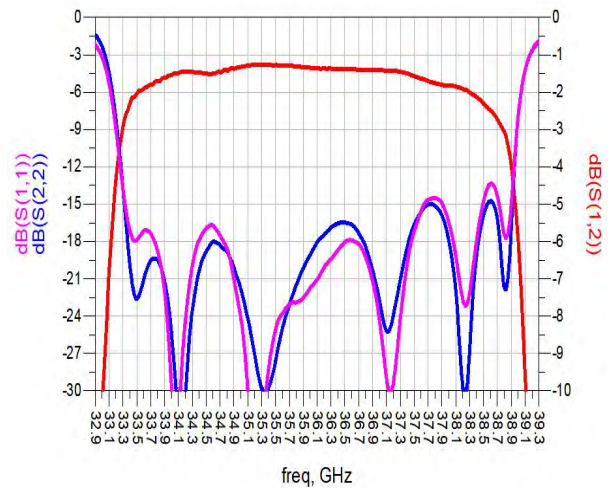


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	9.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

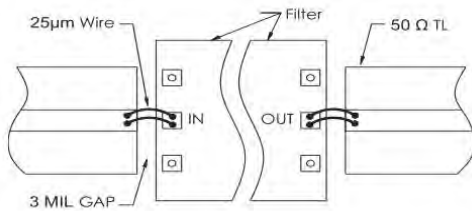
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		36.9		GHz
工作频率	33.6		40.2	GHz
中心损耗		1.5	1.8	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-31.0GHz	40	45	dBc
	@44.0-46.0GHz	35	40	dBc

环境要求

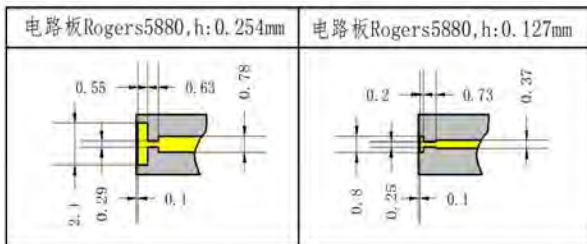
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

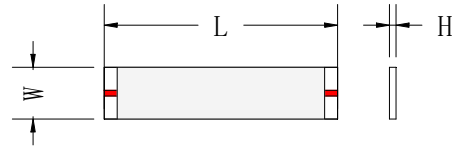


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

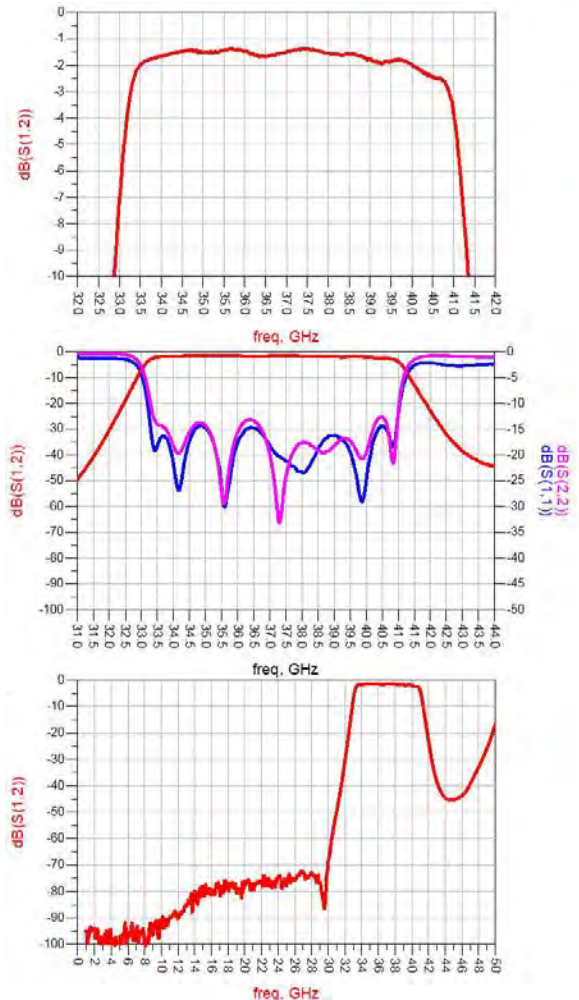


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	2.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

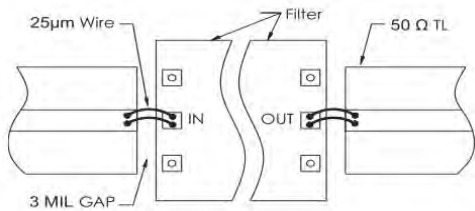
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		34.65		GHz
工作频率	33.7		35.6	GHz
中心损耗		2.0	2.5	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-32.5GHz	45	50	dBc
	@37.0-50GHz	45	50	dBc

环境要求

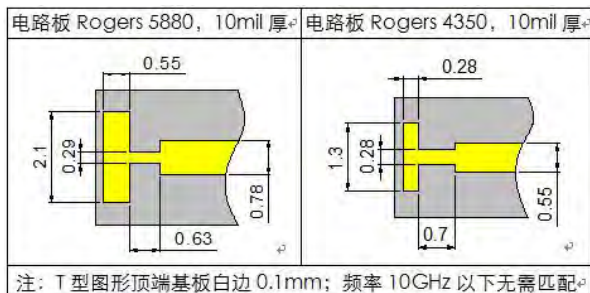
最大输入功率	30	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

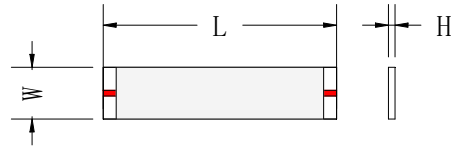


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

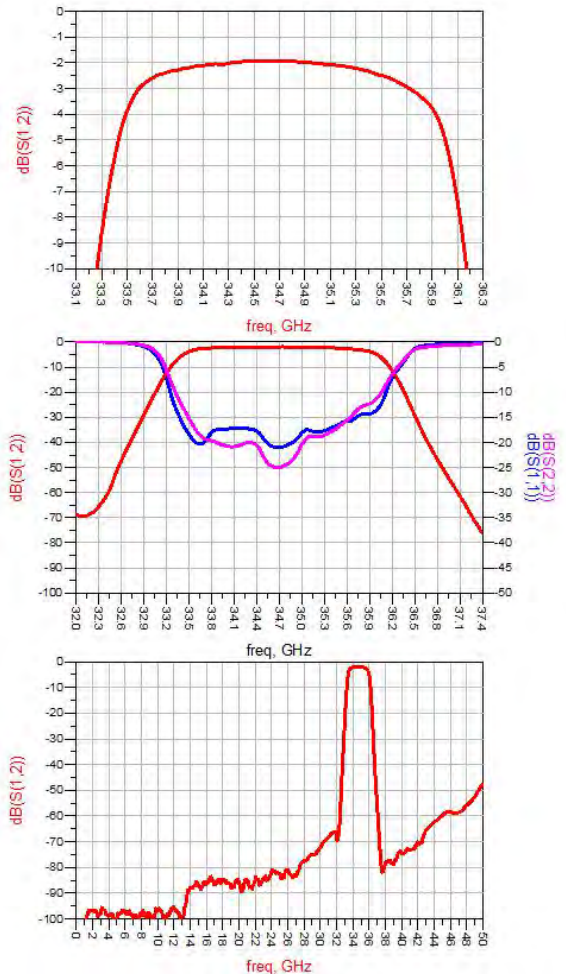


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	9.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



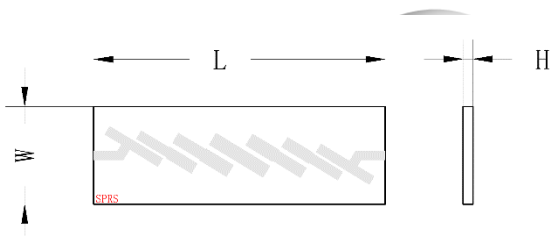
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

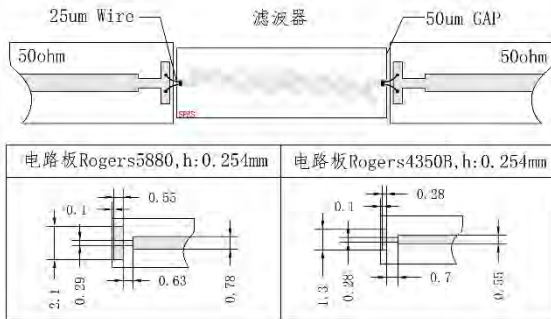
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		35.0		GHz
工作频率	34.1		35.9	GHz
中心损耗		2.7	3.2	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-31.8GHz	50	55		dBc
带外抑制@40.3-45.0GHz	50	55		dBc
承受功率			27	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.5, W: 2.5, H: 0.254, 端口居中



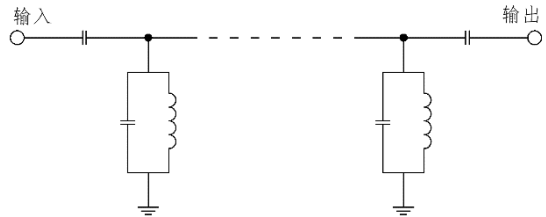
推荐装配图:



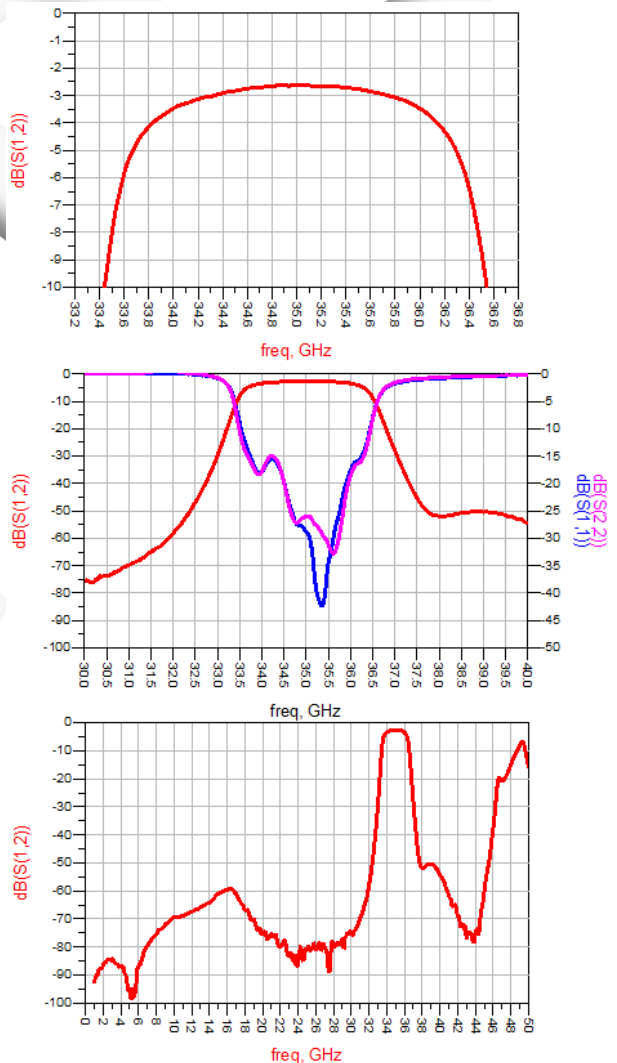
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



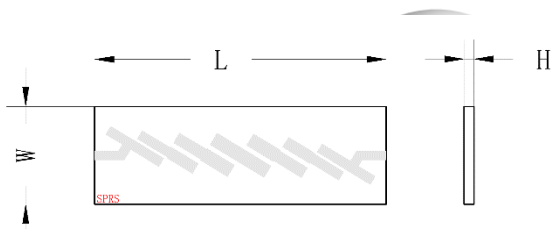
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

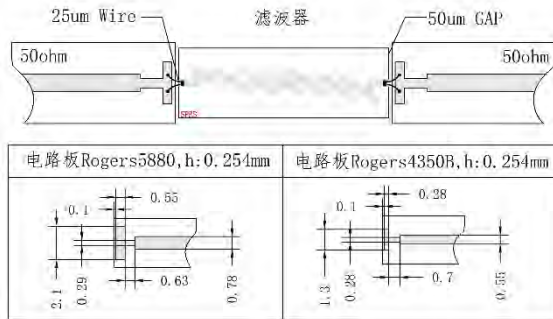
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		36.35		GHz
工作频率	34.7		38.0	GHz
中心损耗		1.9	2.4	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-32.5GHz	60	65		dBc
带外抑制@40.3-47.0GHz	55	60		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 9.0, W: 2.5, H: 0.254, 端口居中



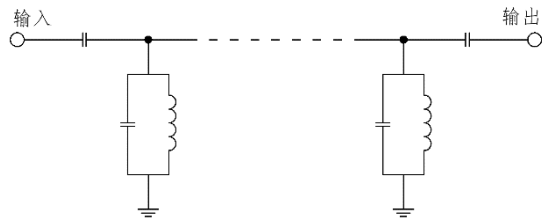
推荐装配图:



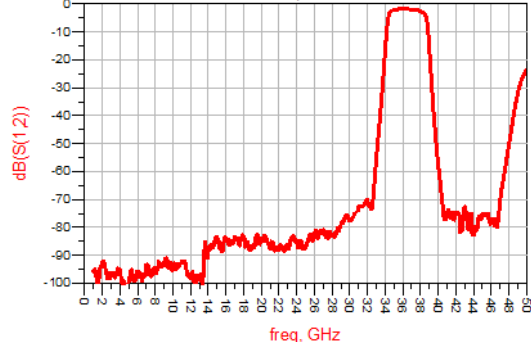
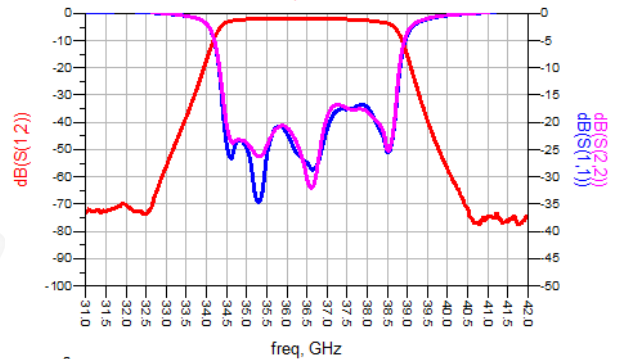
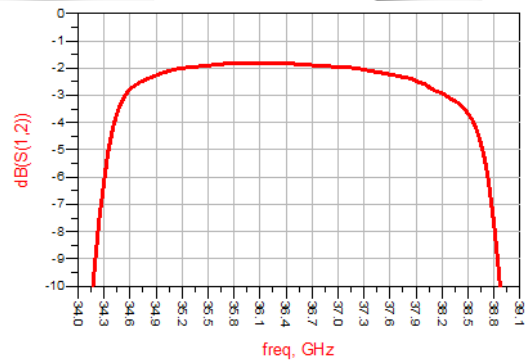
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

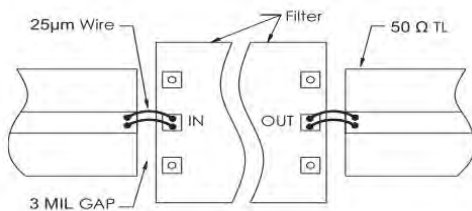
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		37.3		GHz
工作频率	34.8		39.8	GHz
中心损耗		1.3	1.8	dB
带内波动		1.5	1.8	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-33.4GHz	45	50	dBc
	@41.8-48GHz	45	50	dBc

环境要求

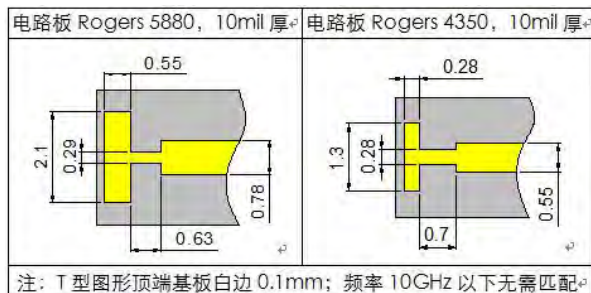
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

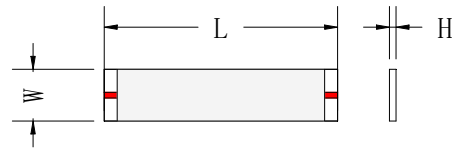


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

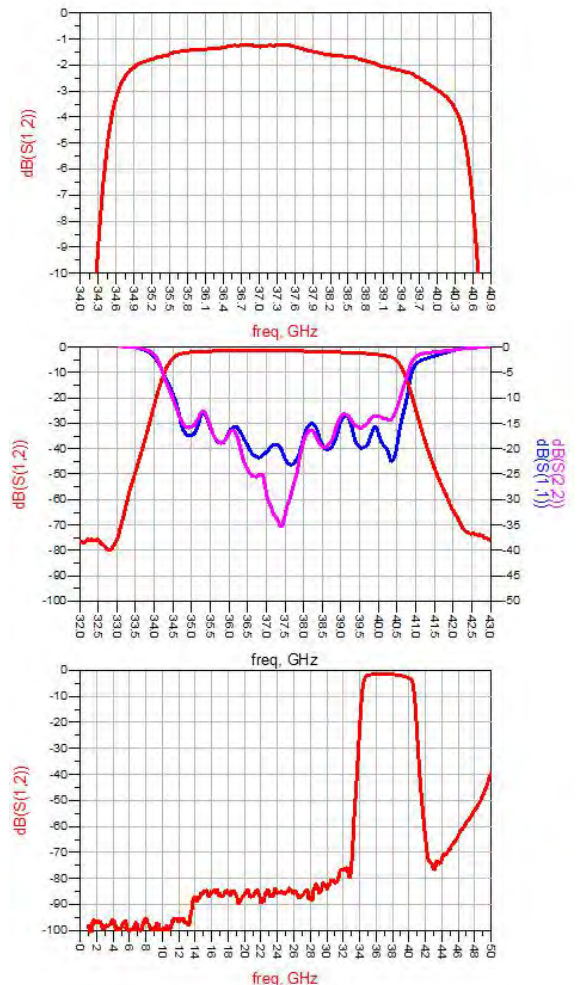


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	9.5	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



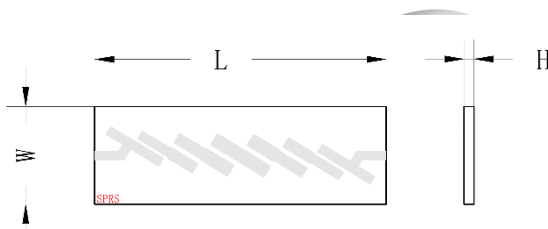
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块

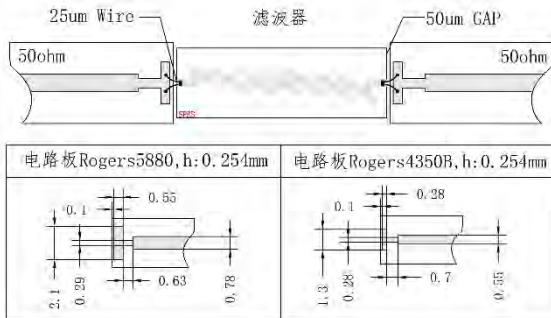
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		37.4		GHz
工作频率	34.9		40.1	GHz
中心损耗		1.4	1.9	dB
带内波动		0.9	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-32.3GHz	60	65		dBc
带外抑制@43.1-49.0GHz	40	45		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^{\circ}\text{C}$

外形图: L: 9.0, W: 2.5, H: 0.254, 端口居中



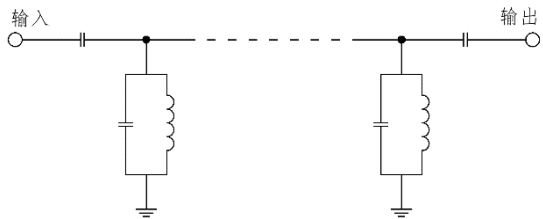
推荐装配图:



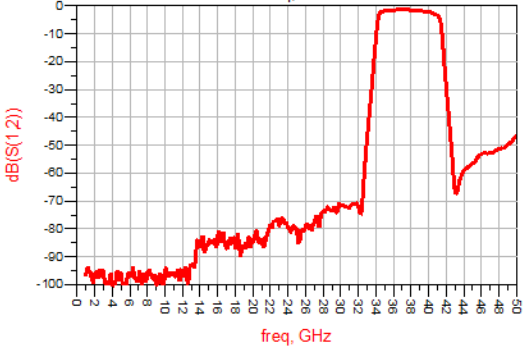
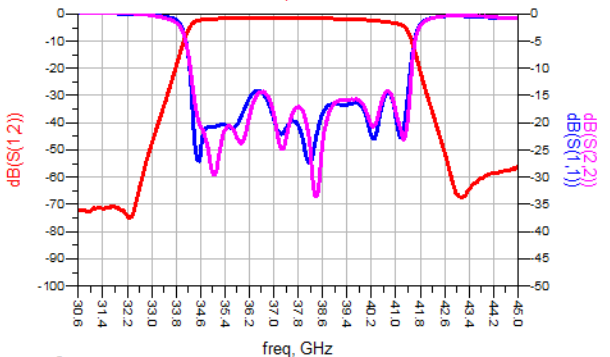
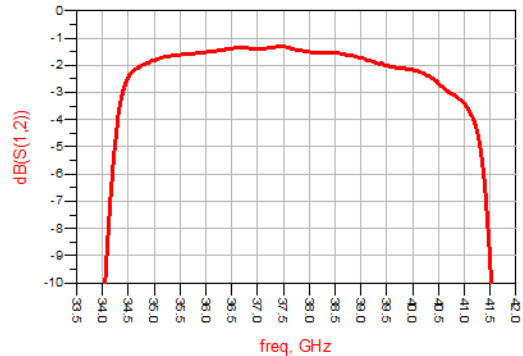
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖1.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^{\circ}\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



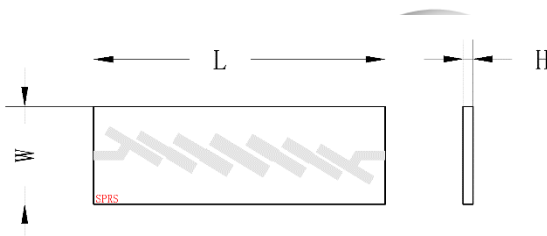
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

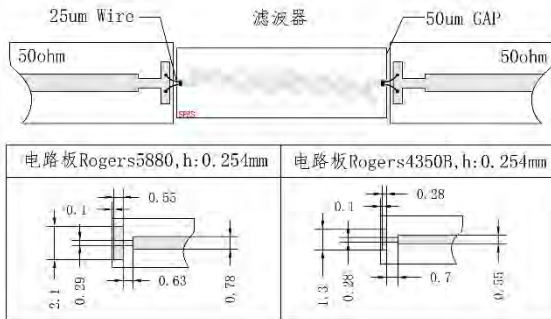
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		38.1		GHz
工作频率	35.2		41.0	GHz
中心损耗		0.9	1.4	dB
带内波动		0.9	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-33.5GHz	45	50		dBc
带外抑制@43.2-49.0GHz	45	50		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 9.0, W: 2.5, H: 0.254, 端口居中



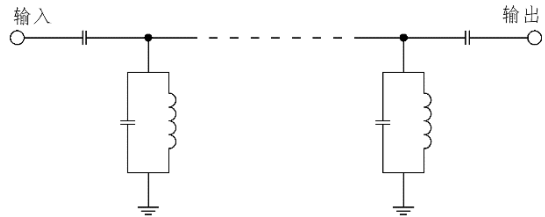
推荐装配图:



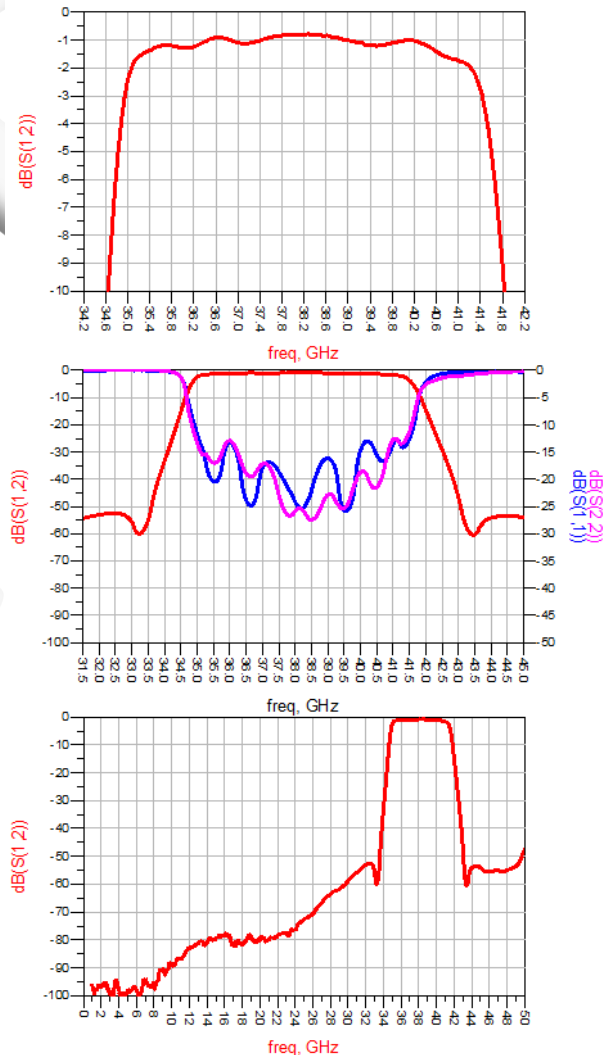
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



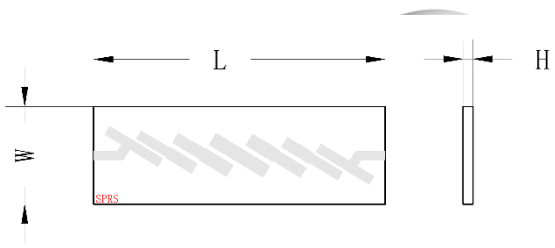
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

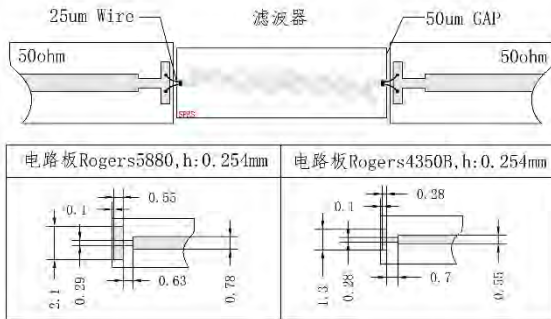
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		37.05		GHz
工作频率	35.3		38.8	GHz
中心损耗		2.0	2.5	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-33.8GHz	35	40		dBc
带外抑制@40.7-41.5GHz	35	40		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 6.5, W: 2.0, H: 0.254, 端口居中



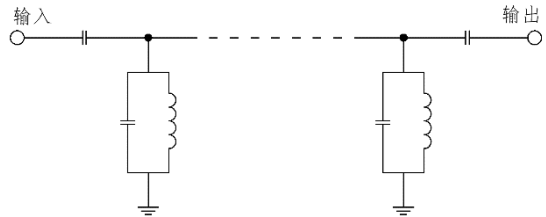
推荐装配图:



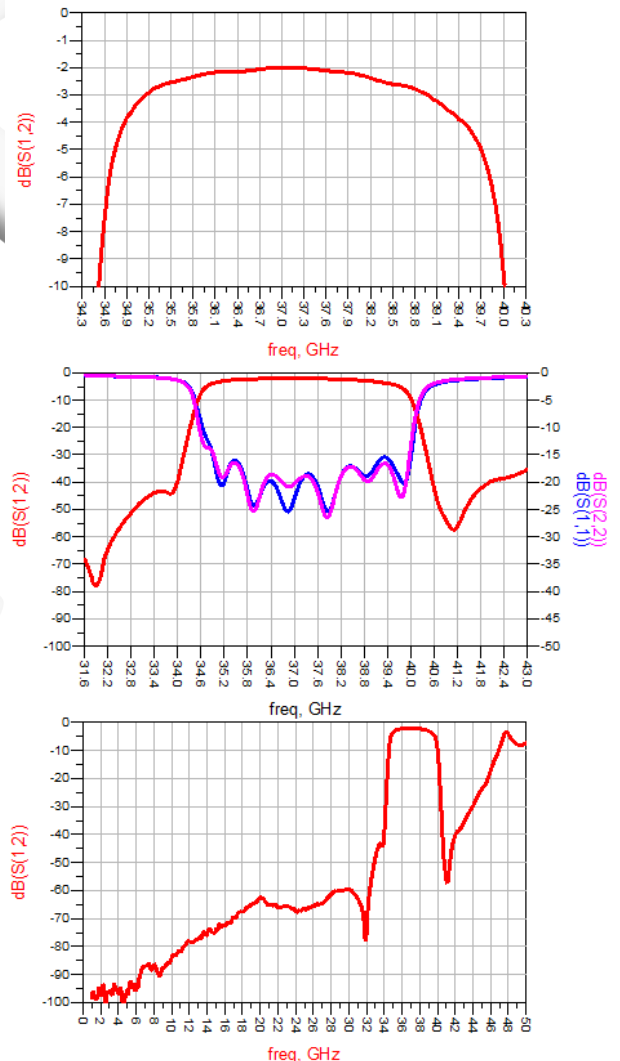
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

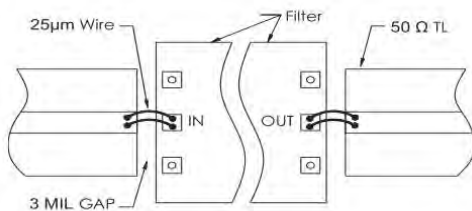
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		38		GHz
工作频率	35.6		40.4	GHz
中心损耗		1.4	1.9	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	13	15		
带外抑制	@DC-30.5GHz	70	75	dBc
	@30.5-33.2GHz	40	45	dBc
	@42.2-45GHz	40	45	dBc

### 环境要求

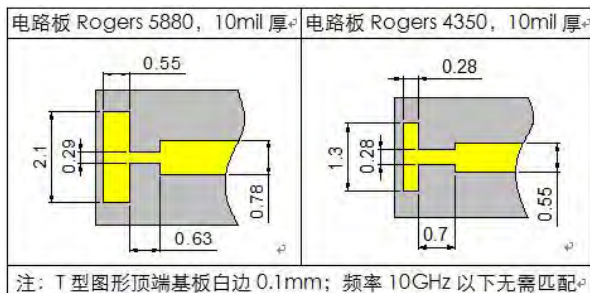
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^\circ\text{C}\sim+85^\circ\text{C}$	
储存温度	$-55^\circ\text{C}\sim+125^\circ\text{C}$	

### 推荐装配图

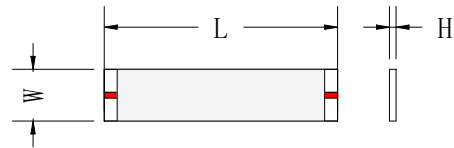


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.25mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

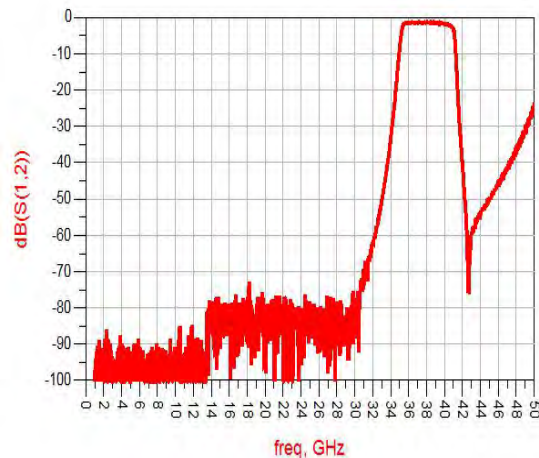
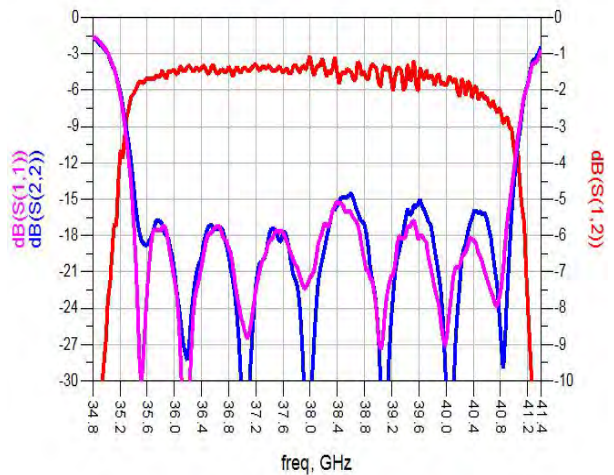


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.5	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

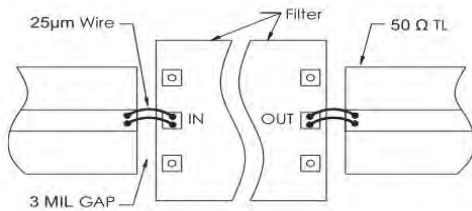
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		38.1		GHz
工作频率	35.8		40.4	GHz
中心损耗		1.8	2.2	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-31.0GHz	40	45	dBc
	@44.0-46.0GHz	40	45	dBc

环境要求

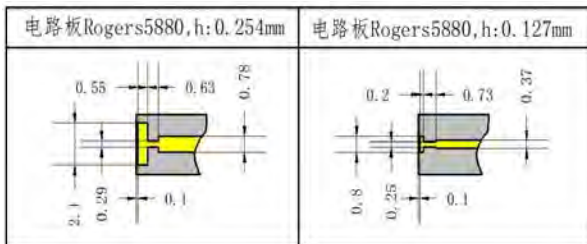
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

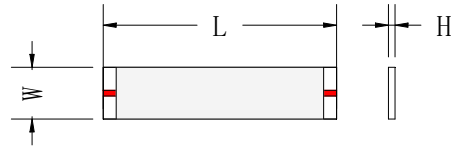


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

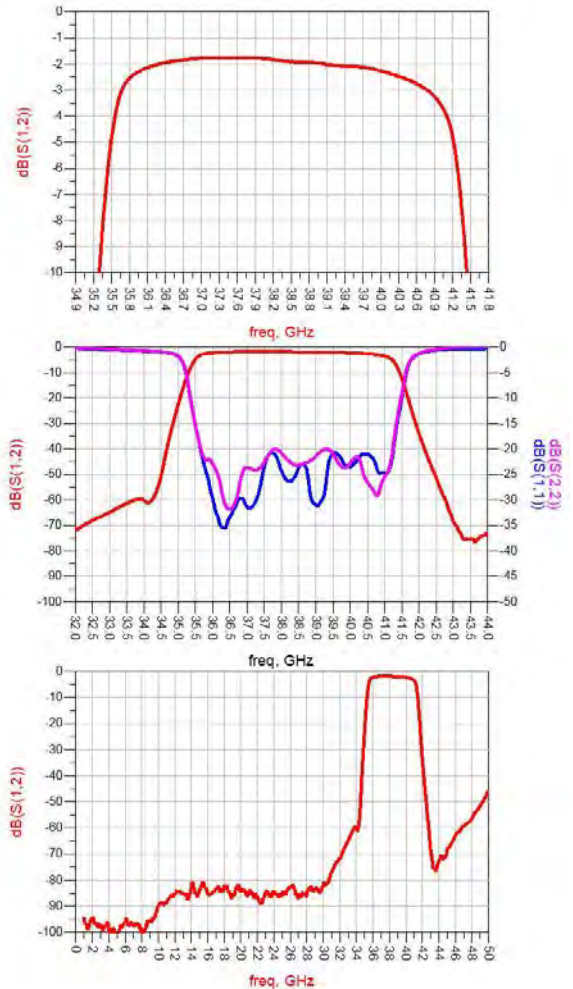


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	9.2	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



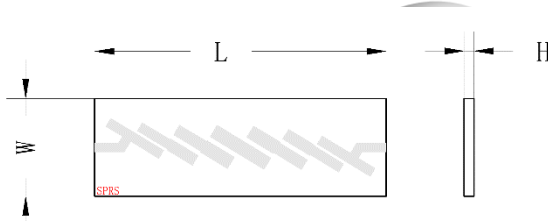
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

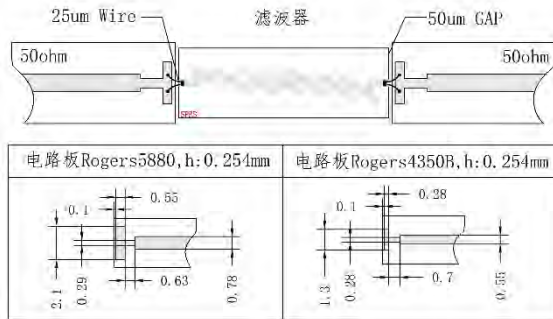
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		39.35		GHz
工作频率	35.8		42.9	GHz
中心损耗		1.7	2.1	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-34.1GHz	45	50		dBc
带外抑制@46.0-48.0GHz	40	45		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^{\circ}\text{C}$

外形图: L: 8.5, W: 2.5, H: 0.254, 端口居中



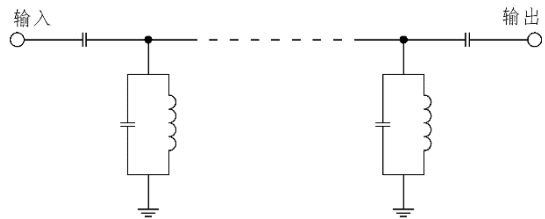
推荐装配图:



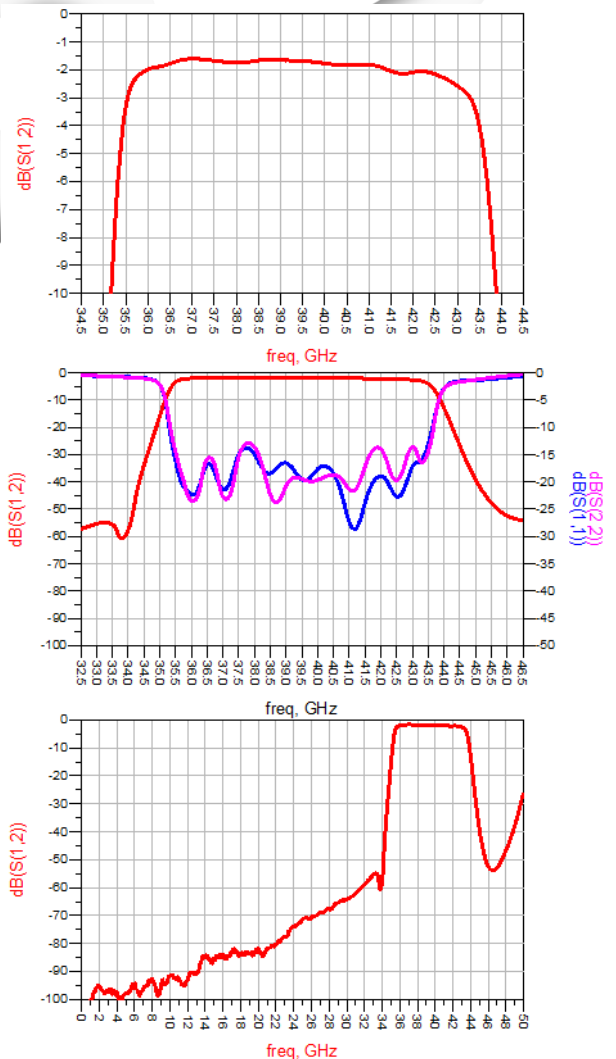
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖1.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^{\circ}\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

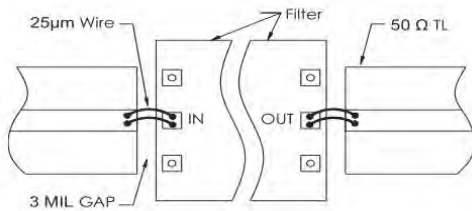
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		38.3		GHz
工作频率	36.6		40.0	GHz
中心损耗		1.8	2.2	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-35.0GHz	40	45	dBc
	@42.5-47.0GHz	40	45	dBc

环境要求

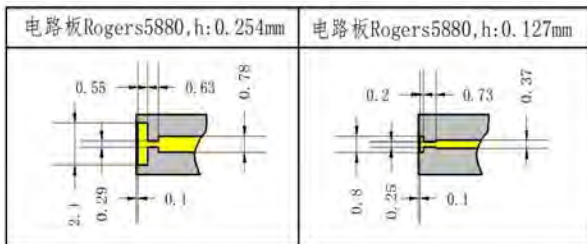
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

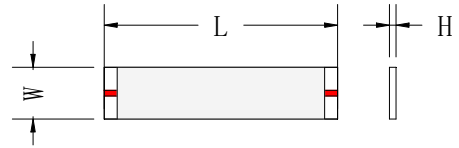


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

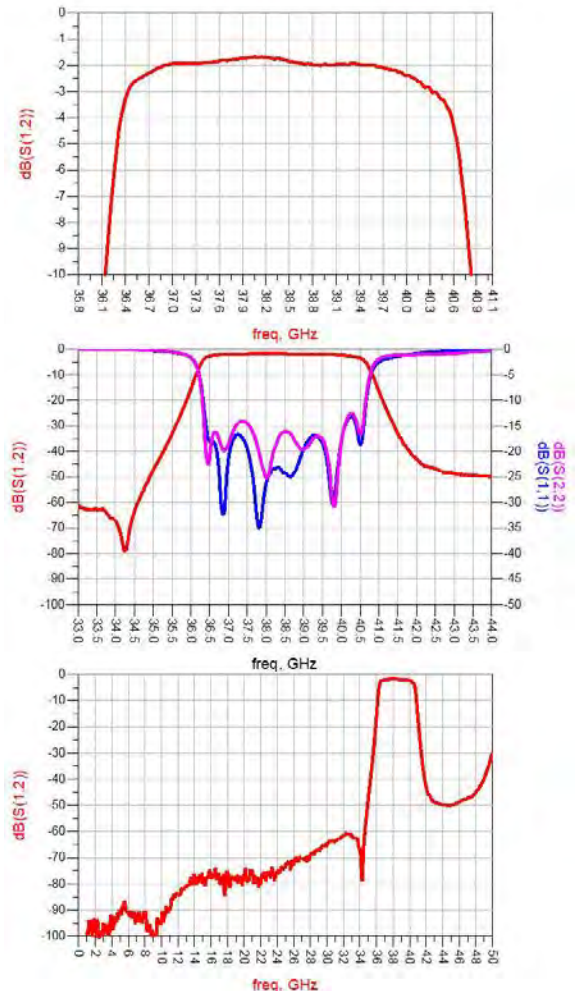


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

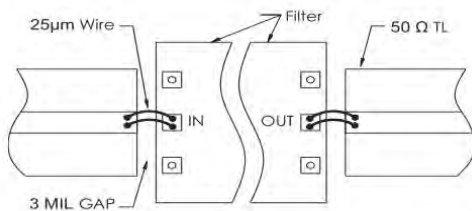
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		41.1		GHz
工作频率	37.2		45.0	GHz
中心损耗		1.5	2.0	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	10	12		
带外抑制	@DC-34.3GHz	40	45	dBc
	@48.3-50GHz	40	45	dBc

### 环境要求

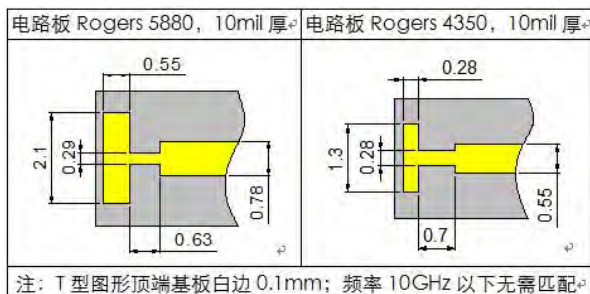
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

### 推荐装配图

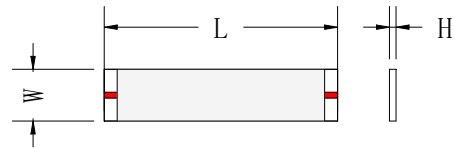


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

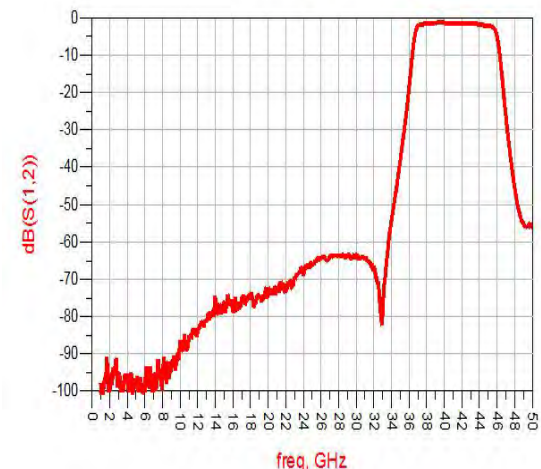
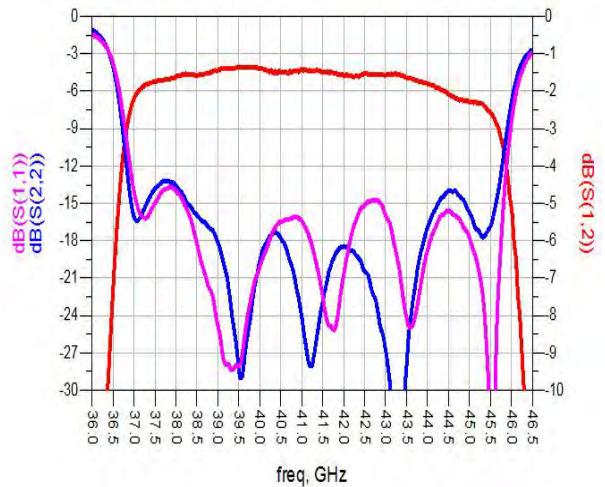


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	1.8	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

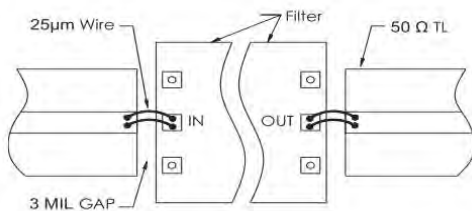
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		39.1		GHz
工作频率	38.1		40.1	GHz
中心损耗		2.0	2.5	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-37.1GHz	20	25	dBc
	@42.0-44.0GHz	10	15	dBc

### 环境要求

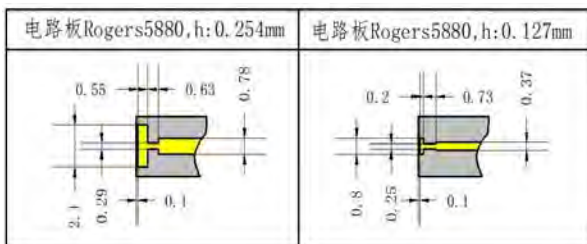
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

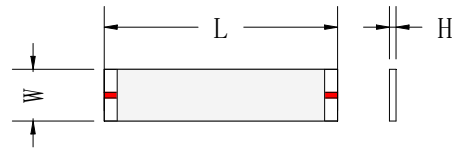


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

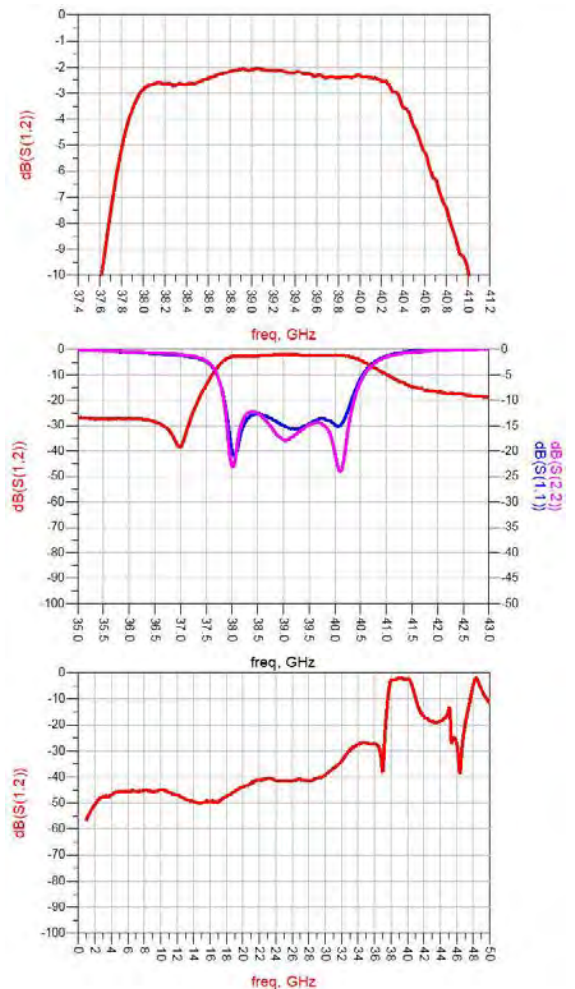


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.0	3.0	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



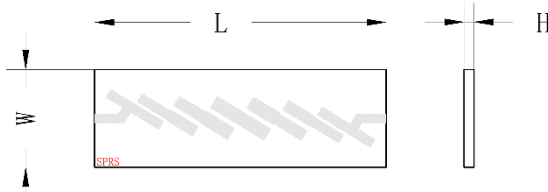
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

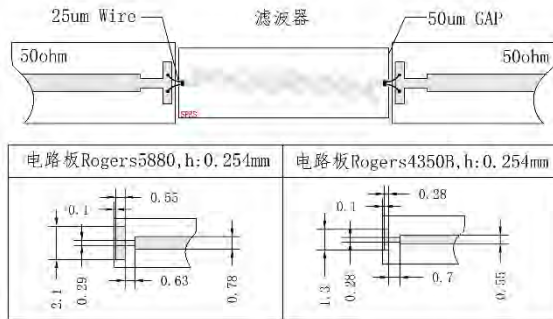
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		42.2		GHz
工作频率	38.4		46.0	GHz
中心损耗		1.5	2.0	dB
带内波动		1.1	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-35.2GHz	41	46		dBc
带外抑制@50.0GHz	41	46		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^{\circ}\text{C}$

外形图: L: 6.0, W: 1.8, H: 0.254, 端口居中



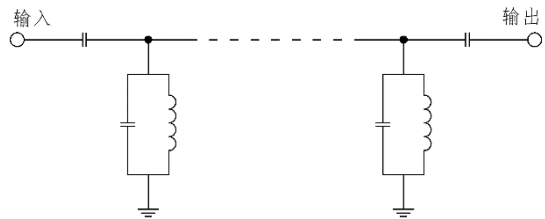
推荐装配图:



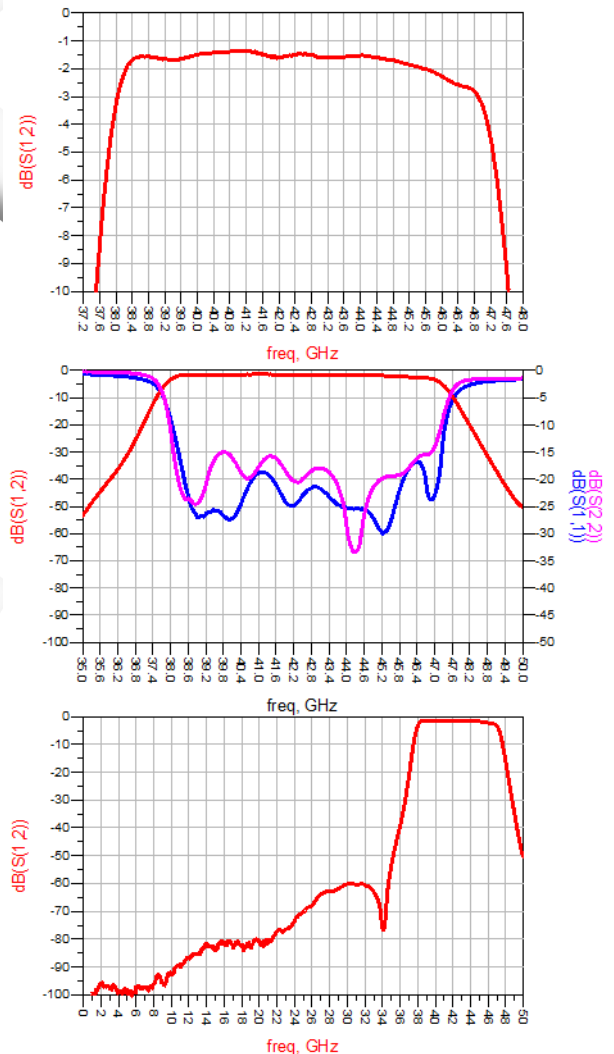
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^{\circ}\text{C}$ ), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

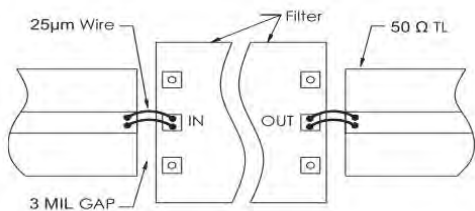
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		44.25		GHz
工作频率	38.5		50	GHz
中心损耗		1.8	2.3	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	10	11		
带外抑制	@DC-20GHz	55	58	dBc
	@20-34.5GHz	40	45	dBc

环境要求

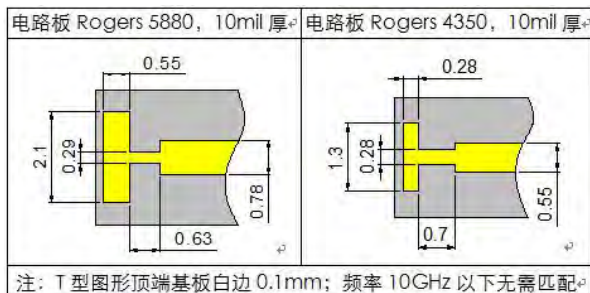
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

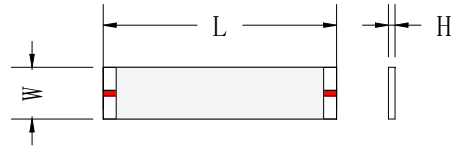


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

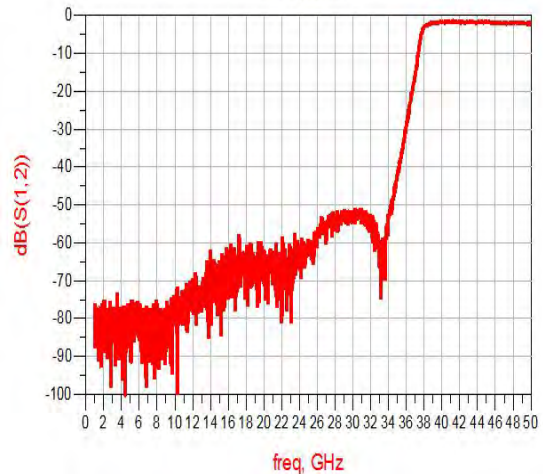
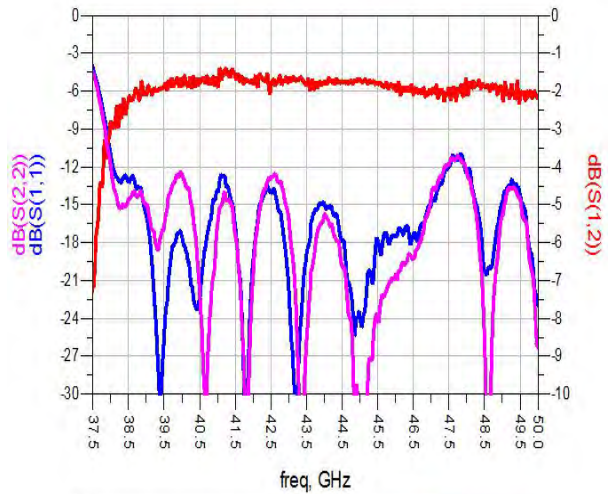


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	5.5	1.8	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

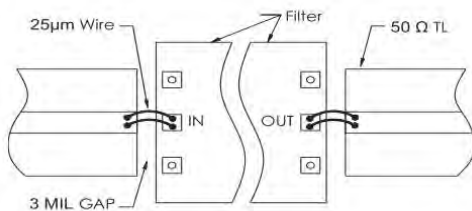
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		44.5		GHz
工作频率	39.0		50.0	GHz
中心损耗		0.8	1.3	dB
带内波动		0.5	1.0	dB
回波损耗	10	12		
带外抑制	@DC-34.0GHz	40	45	dBc

环境要求

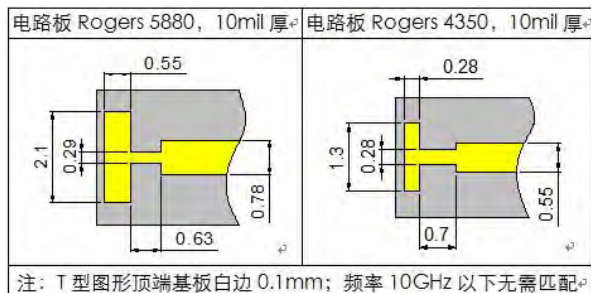
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

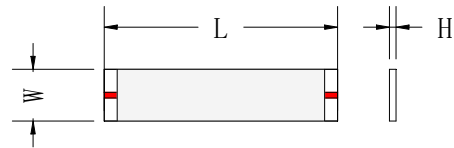


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

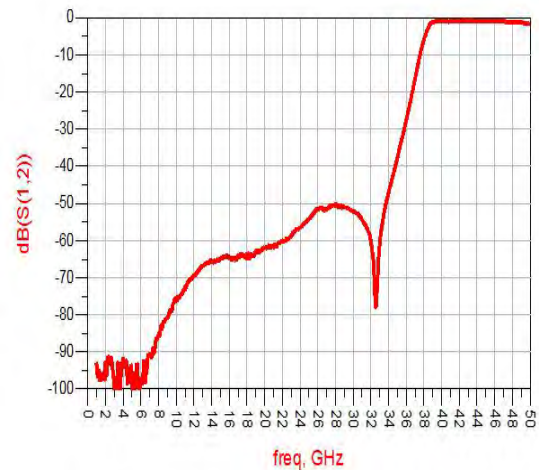
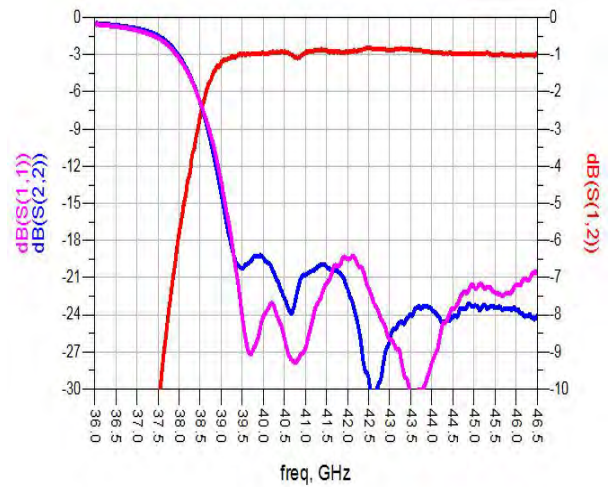


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	5.0	1.8	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



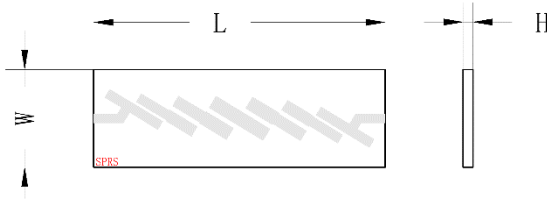
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

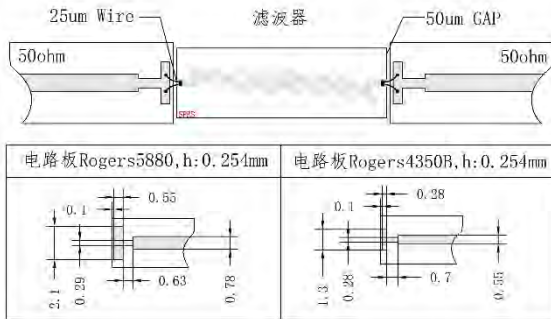
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		42.0		GHz
工作频率	39.8		44.2	GHz
中心损耗		1.5	2.0	dB
带内波动		0.9	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-35.6GHz	41	46		dBc
带外抑制@46.5-50.0GHz	41	46		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^{\circ}\text{C}$

外形图: L: 6.0, W: 2.0, H: 0.254, 端口居中



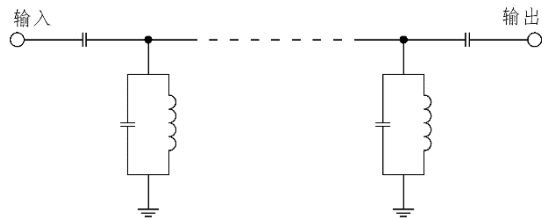
推荐装配图:



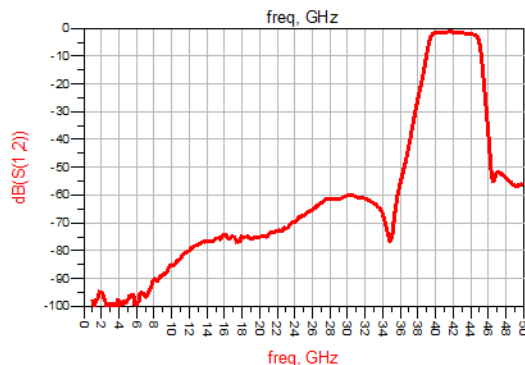
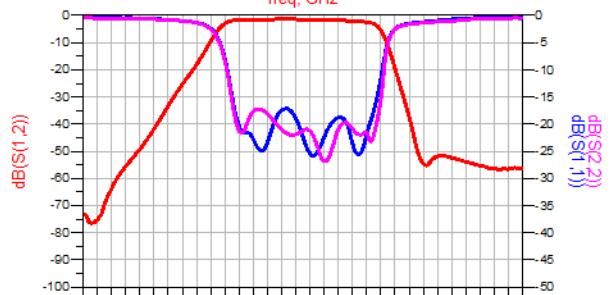
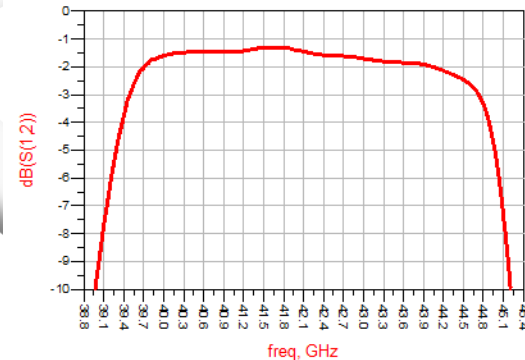
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^{\circ}\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

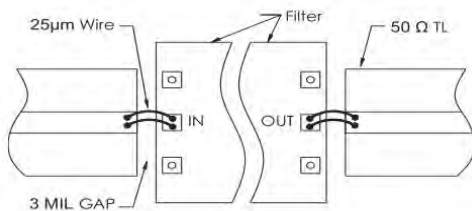
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		45.3		GHz
工作频率	40.6		50.0	GHz
中心损耗		1.4	1.7	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗		12	15	dB
带外抑制	@DC-37.5GHz	55	60	dBc

### 环境要求

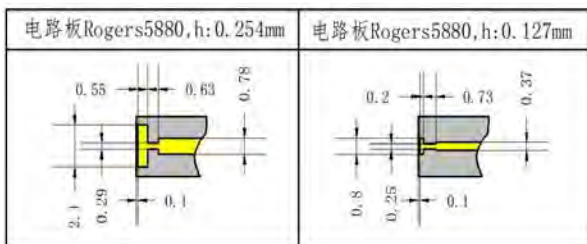
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

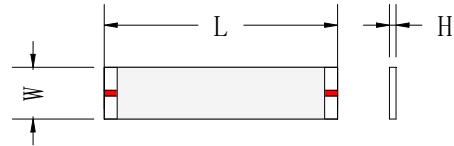


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**1.75mm**，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3. 芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm / °C),载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ；
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配，T型尺寸如下：

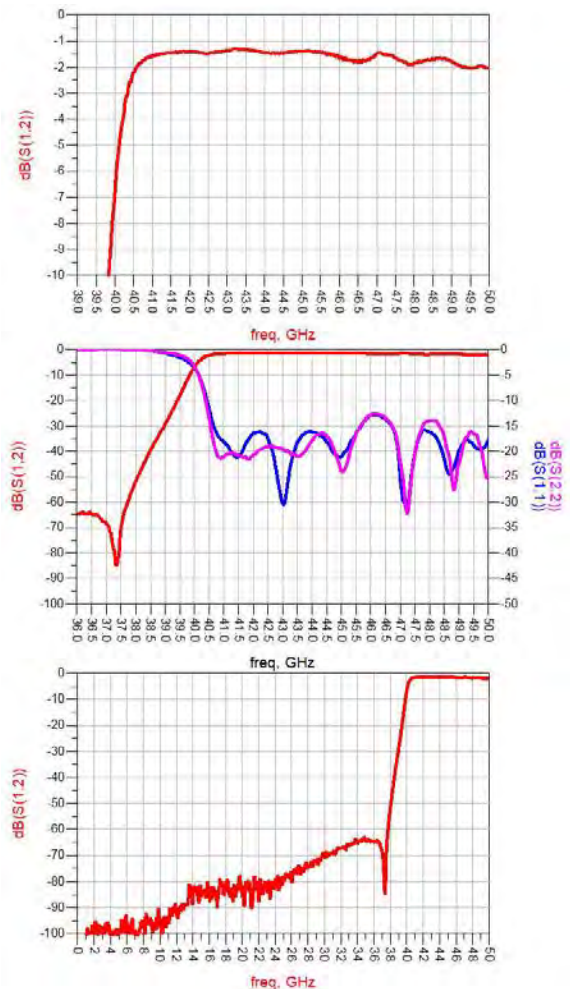


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	2.0	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

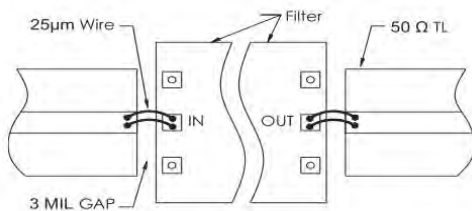
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		44.8		GHz
工作频率	43.4		46.2	GHz
中心损耗		2.6	3.1	dB
带内波动		1.2	1.5	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-40.0GHz	65	70	dBc
	@48.7-50.0GHz	65	70	dBc

### 环境要求

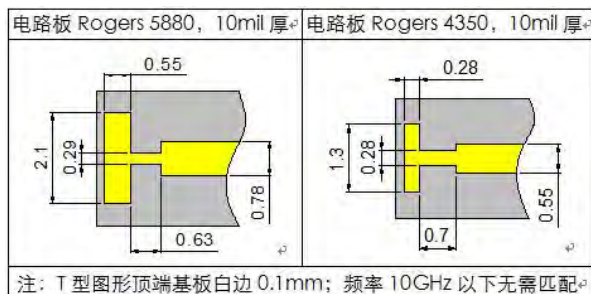
最大输入功率	30	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

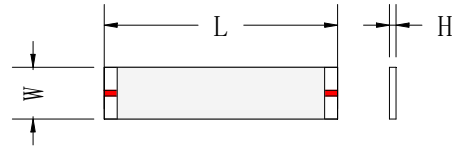


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

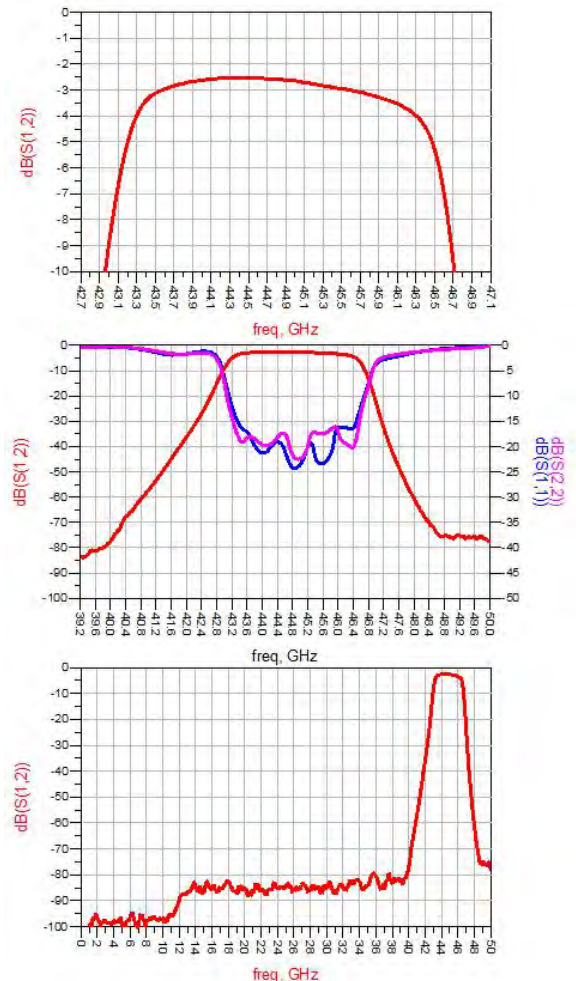


### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	2.0	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



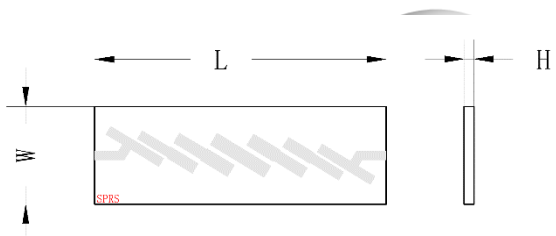
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块

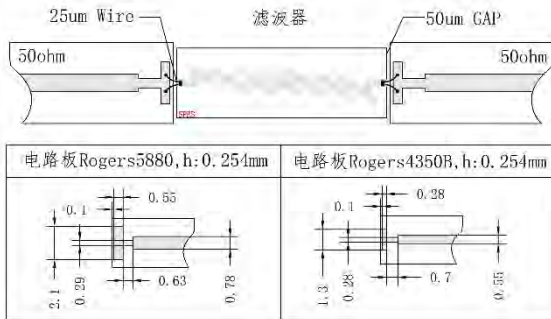
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		47.5		GHz
工作频率	45.0		50.0	GHz
中心损耗		2.1	2.6	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-39.0GHz	45	50		dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 6.0, W: 1.8, H: 0.254, 端口居中



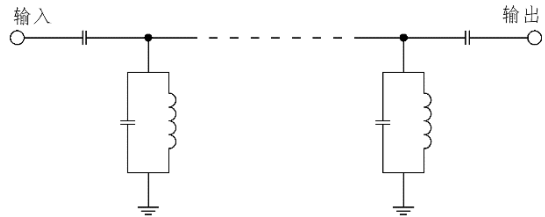
推荐装配图:



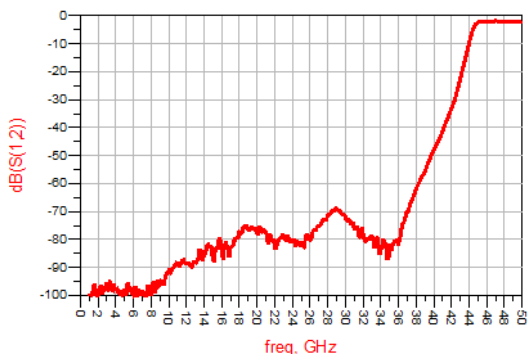
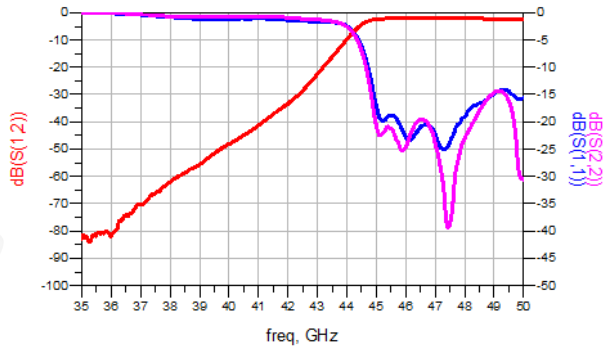
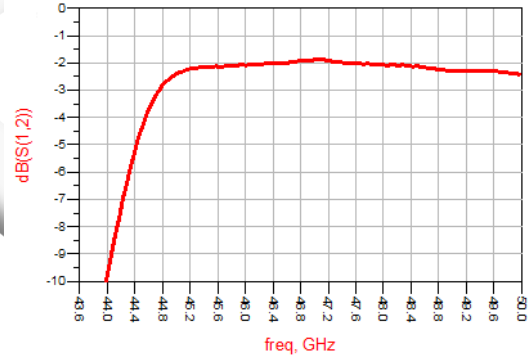
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁**0.1mm**,表面距上盖**1.75mm**,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



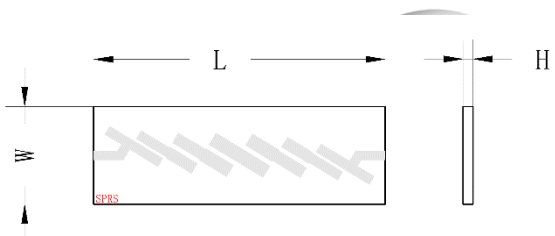
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

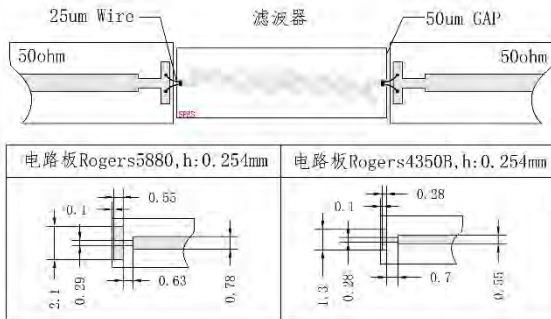
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		47.7		GHz
工作频率	45.4		50.0	GHz
中心损耗		1.5	2.0	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-41.1GHz	55	60		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.0, W: 2.0, H: 0.254, 端口居中



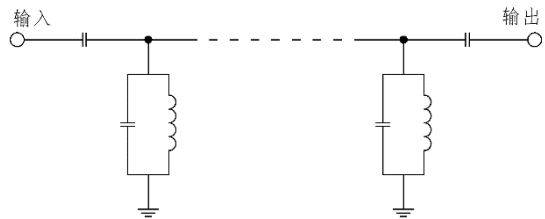
推荐装配图:



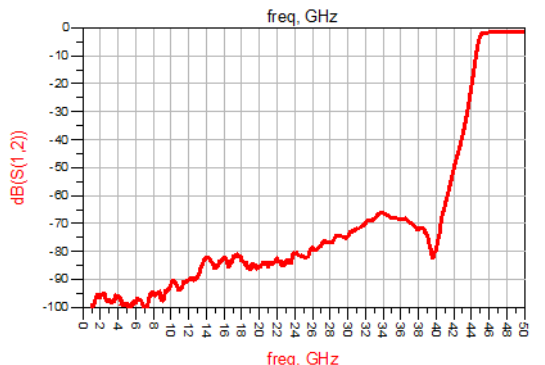
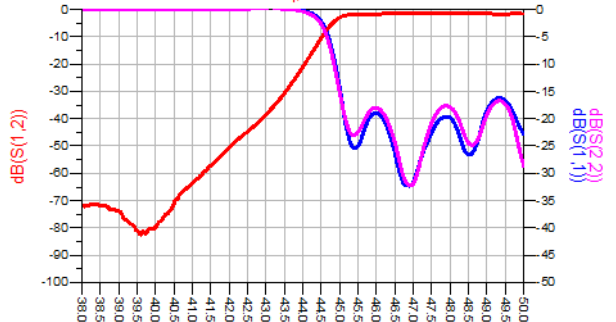
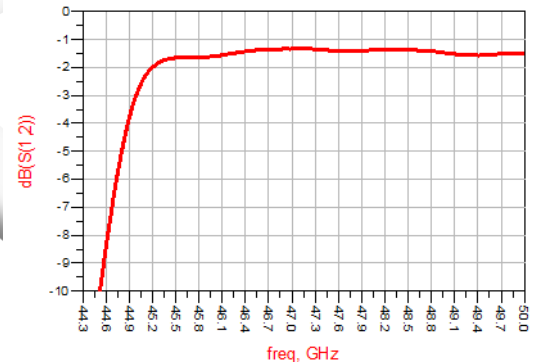
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖1.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

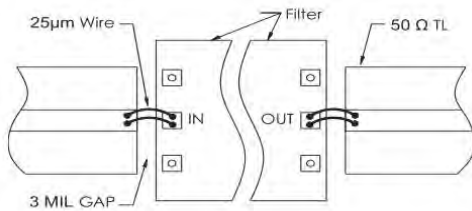
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2.7		6.5	GHz
插入损耗		1.2	1.5	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-1.7GHz	38	43	dBc

环境要求

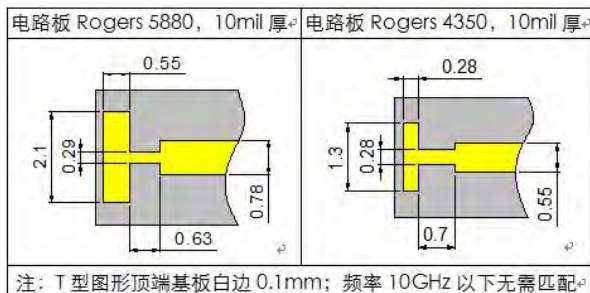
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

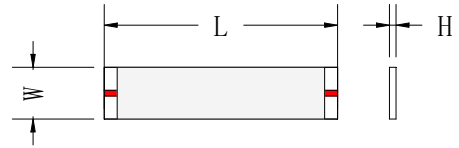
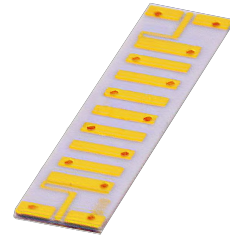


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

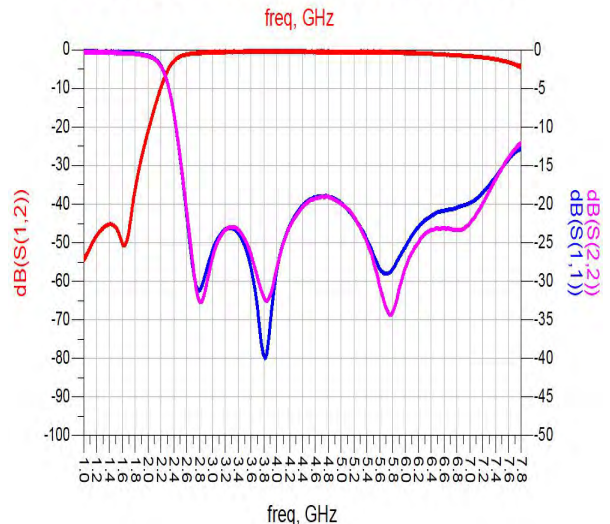
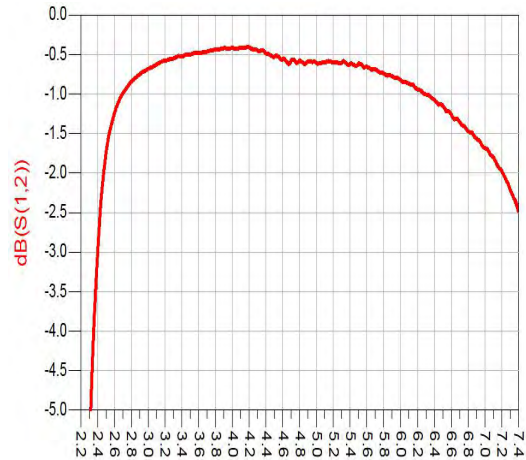


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	5.5	5.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

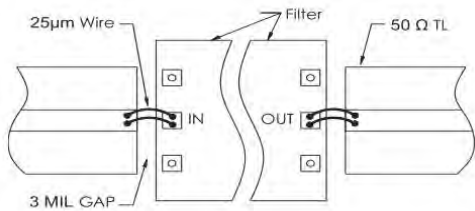
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	6.0		13.0	GHz
插入损耗		1.8	2.3	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-5.0GHz	43	48	dBc

环境要求

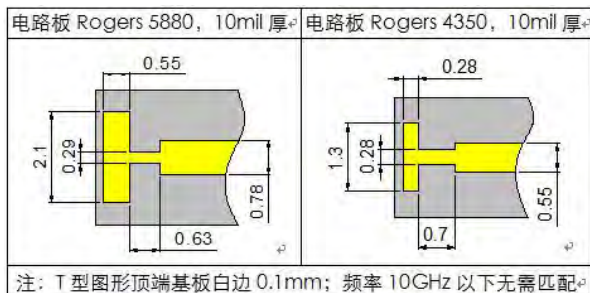
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

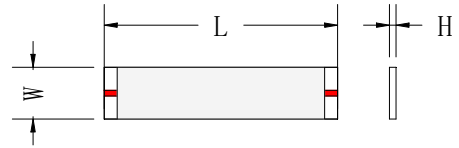
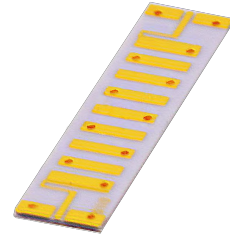


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

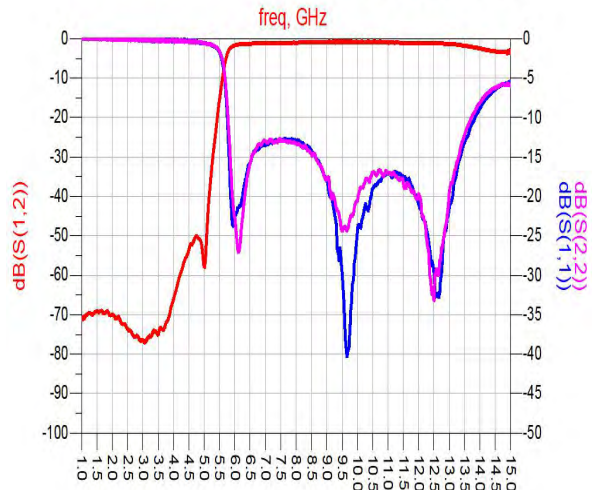
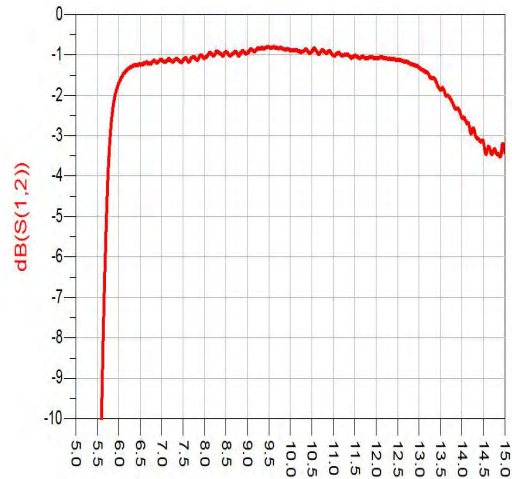


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	2.8	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

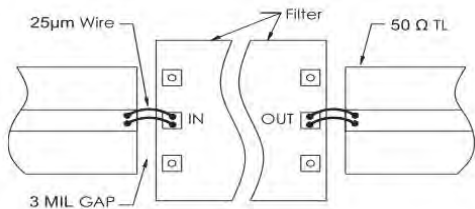
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	6.0		14.0	GHz
插入损耗		1.2	1.5	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-4.0GHz	38	43	dBc

环境要求

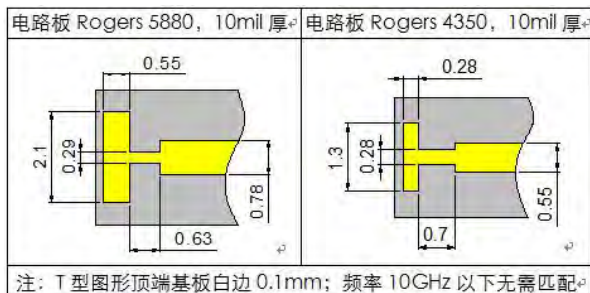
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

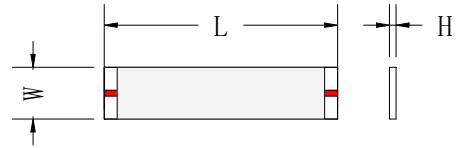
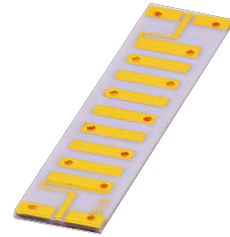


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

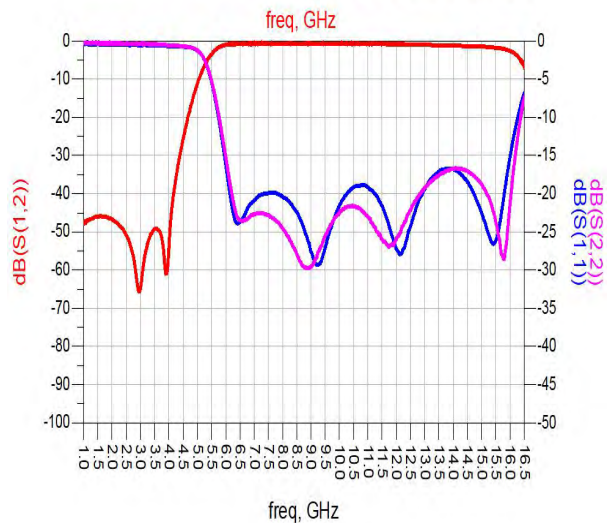
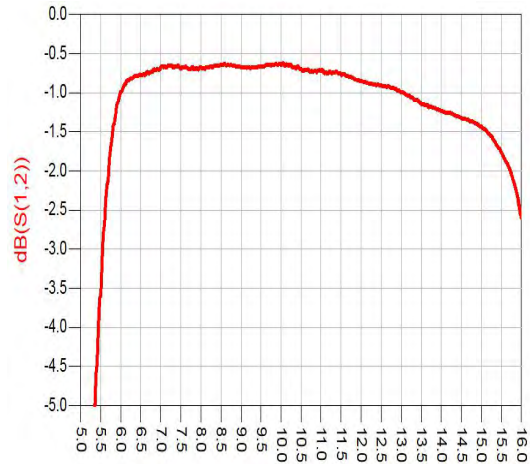


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	4.5	3.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



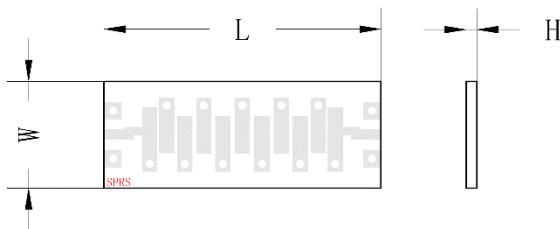
### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

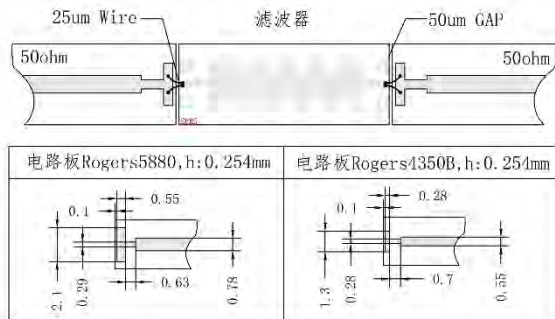
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		13.0		GHz
工作频率	6.4		19.6	GHz
中心损耗		0.7	1.2	dB
截止频率损耗		1.5	2.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-4.7GHz	52	57		dBc
承受功率			20	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 8.5, W: 5.0, H: 0.254, 端口居中



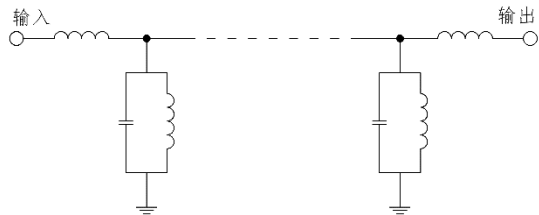
推荐装配图:



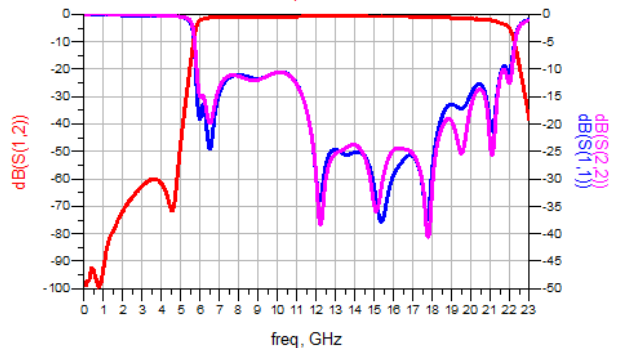
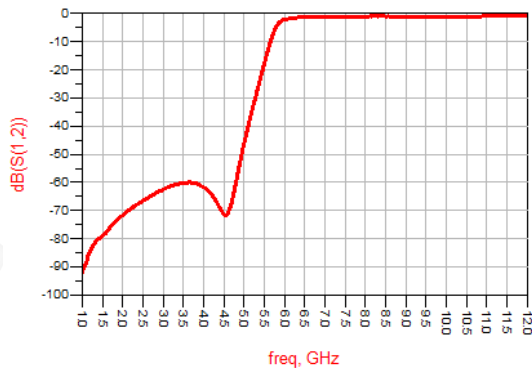
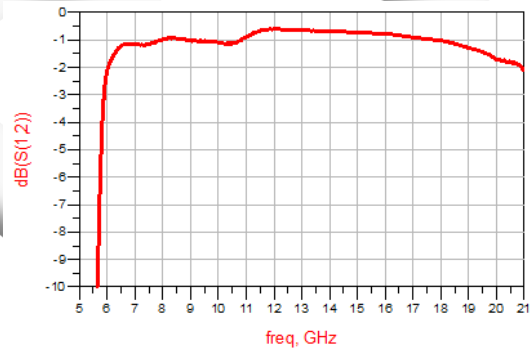
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

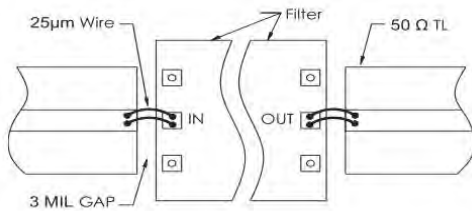
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	7.0		17.5	GHz
插入损耗		1.0	1.3	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@3.5-4.7GHz	43	48	dBc
	@DC-3.5GHz	47	52	dBc

环境要求

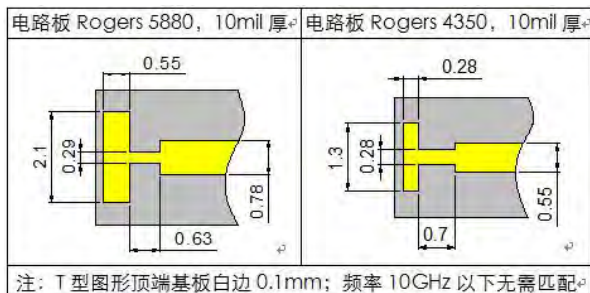
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

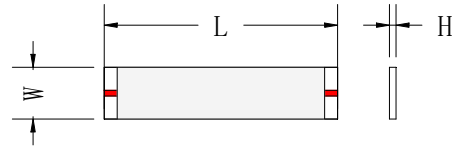
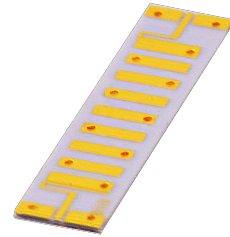


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

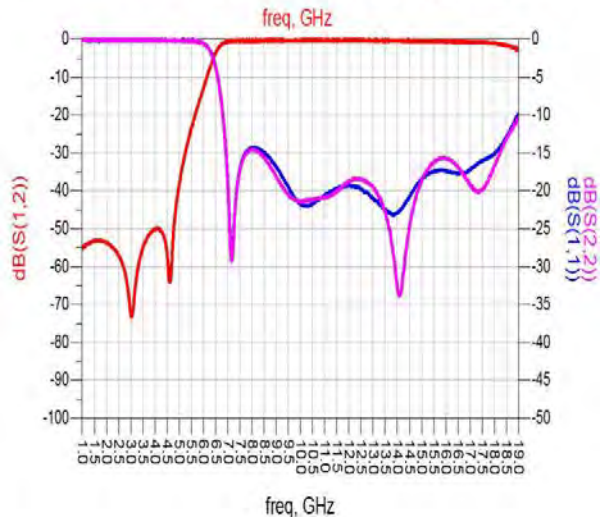
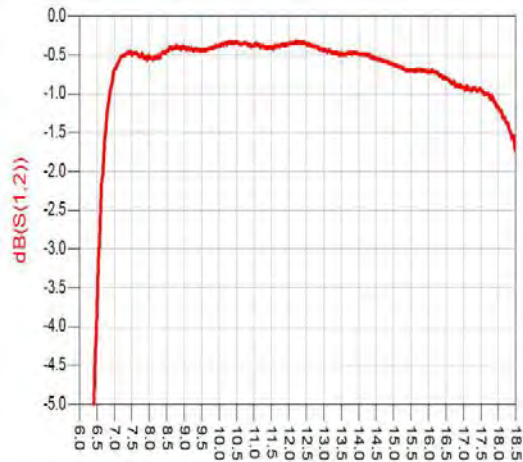


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	4.5	3.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

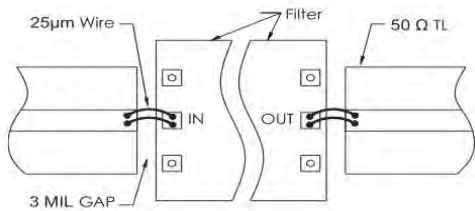
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	8.0		20.0	GHz
插入损耗		1.0	1.2	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-5.6GHz	43	46	dBc

环境要求

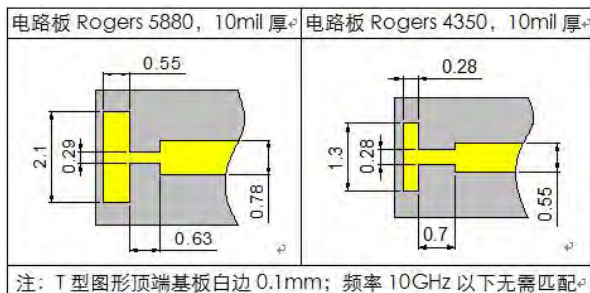
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

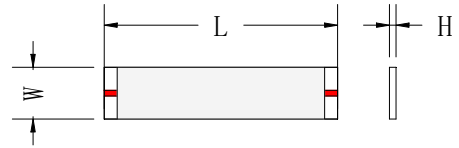
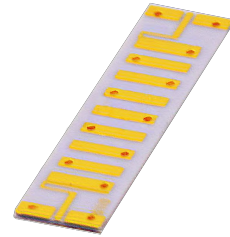


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

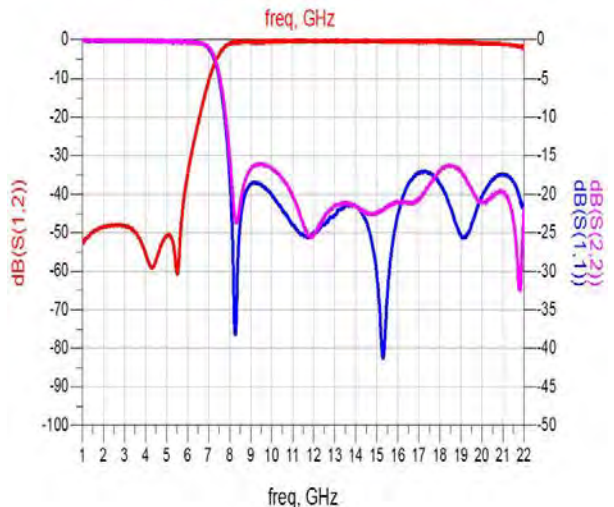
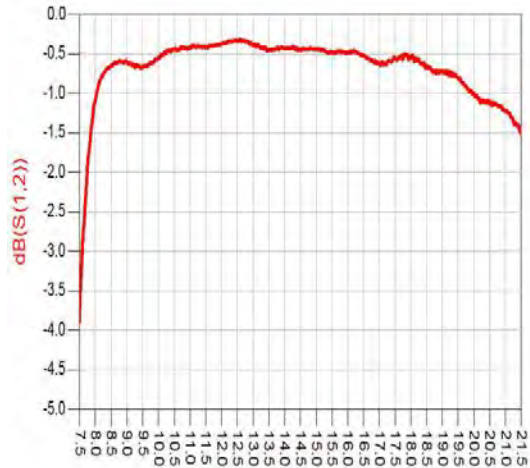


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	4.5	3.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

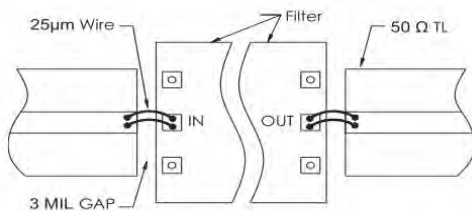
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	9.2		22.0	GHz
中心损耗		1.0	1.2	dB
带内波动		0.6	0.8	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-6.7GHz	42	45	dBc

环境要求

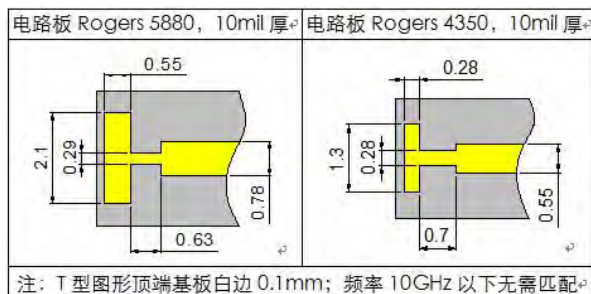
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

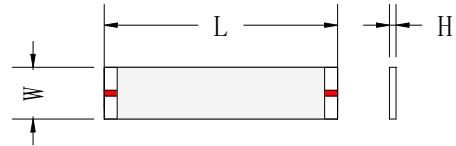
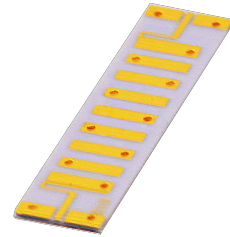


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁0.1mm，表面距上盖2.75mm，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm；
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配，T型尺寸如下：

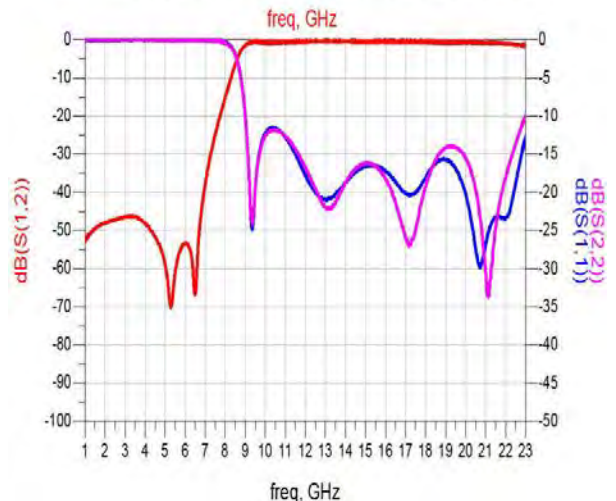


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	3.2	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块

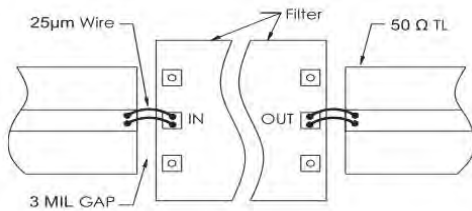
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	10.0		23.0	GHz
插入损耗		1.2	1.5	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@5.8-7.7GHz	30	35	dBc
	@DC-75.8GHz	35	40	dBc

环境要求

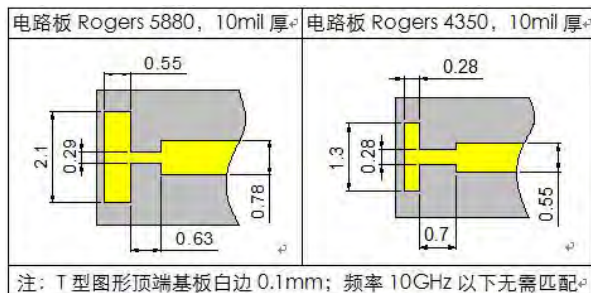
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

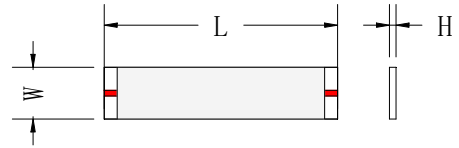
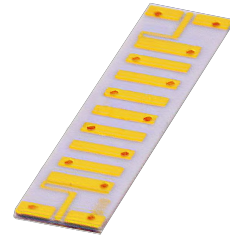


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁**0.1mm**,表面距上盖**2.75mm**,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配,T型尺寸如下:

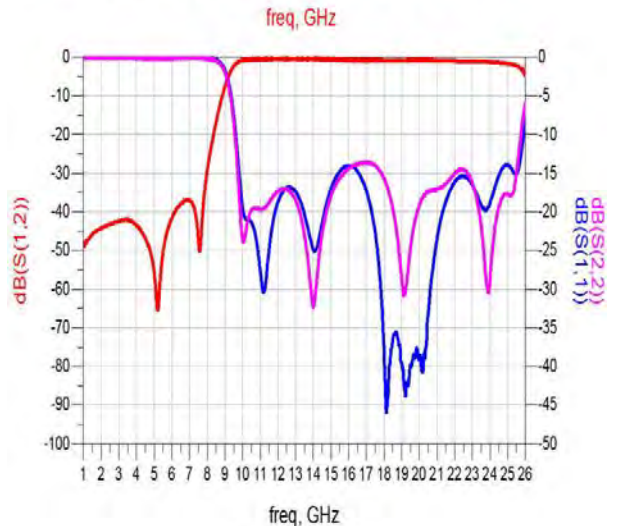
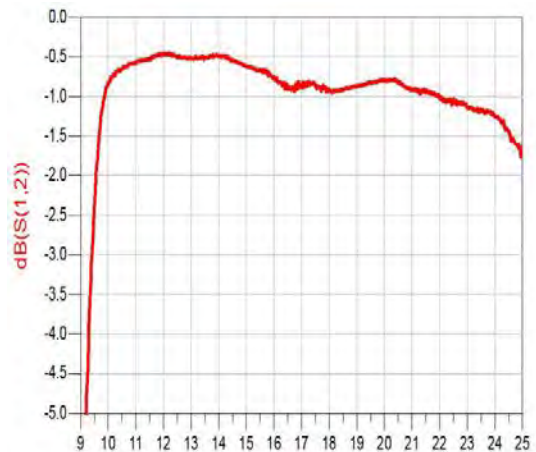


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	3.2	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



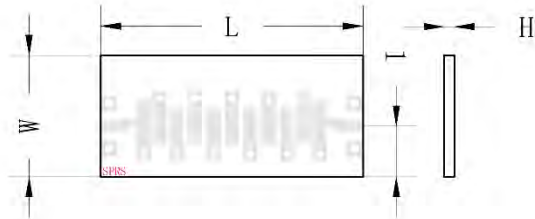
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

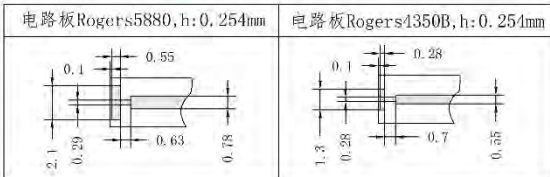
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	11.0	17.5	24.0	GHz
插入损耗		1.5	2.0	dB
带内波动		1.0	1.2	dB
回波损耗	12	14		dB
带外抑制@DC-9.5GHz	25	28		dBc
承受功率			20	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 5.0, W: 2.5, H: 0.254



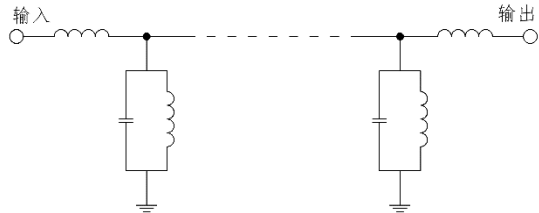
推荐装配图:



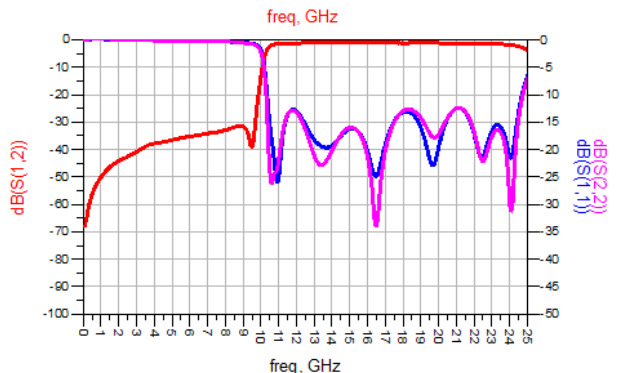
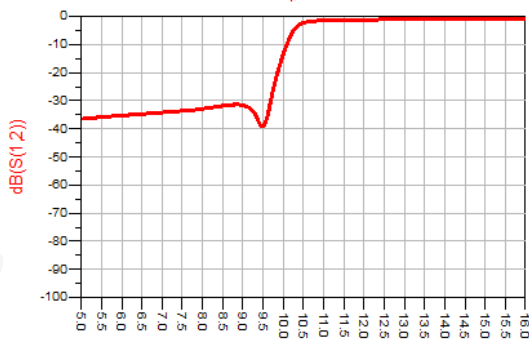
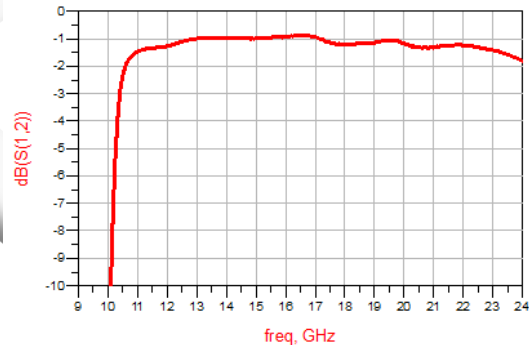
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块

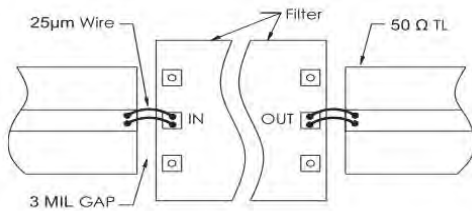
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	11.0		27.0	GHz
插入损耗		1.0	1.3	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@6.5-8.5GHz	30	35	dBc
	@DC-6.5GHz	37	42	dBc

环境要求

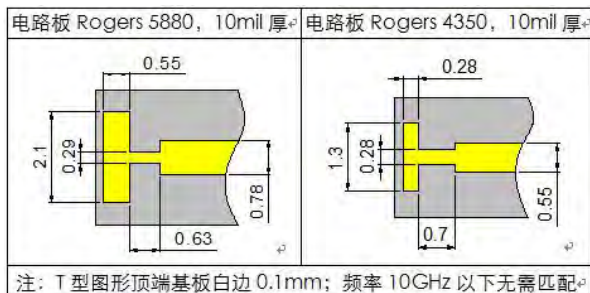
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

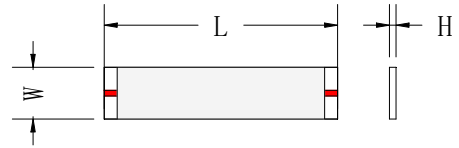
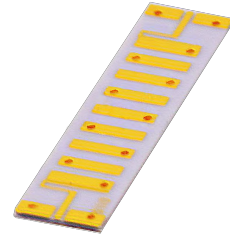


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配,T型尺寸如下:

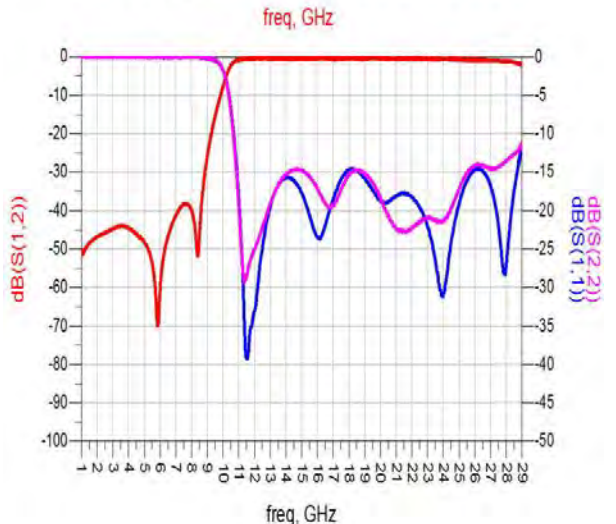


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	3.2	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

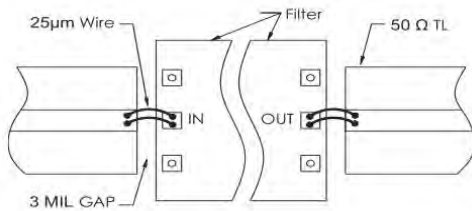
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	12.0		28.0	GHz
插入损耗		1.2	1.5	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@6.8-9.3GHz	28	33	dBc
	@DC-6.8GHz	36	41	dBc

环境要求

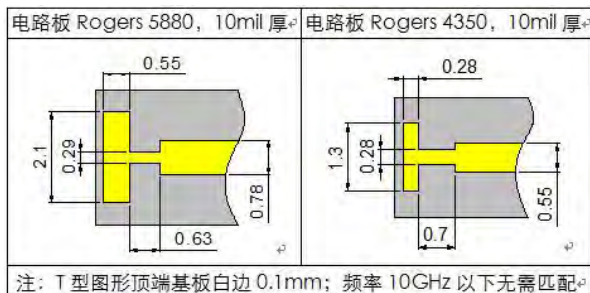
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

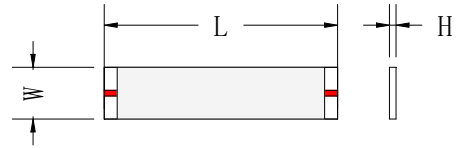
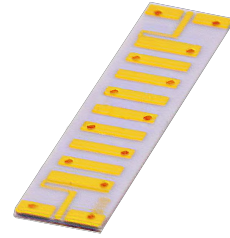


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁0.1mm，表面距上盖2.75mm，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配，T型尺寸如下:

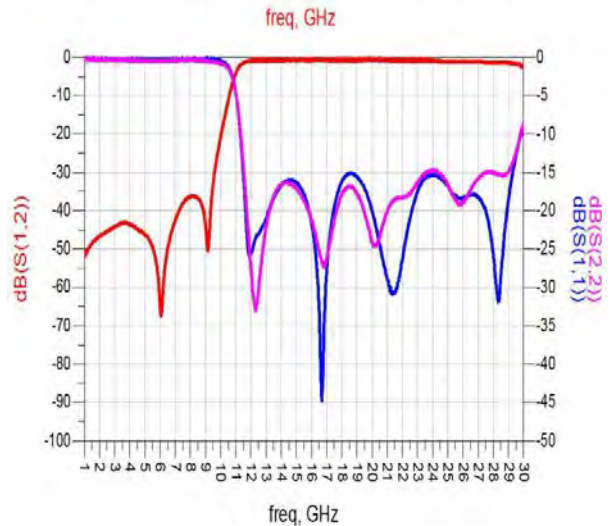


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	3.2	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

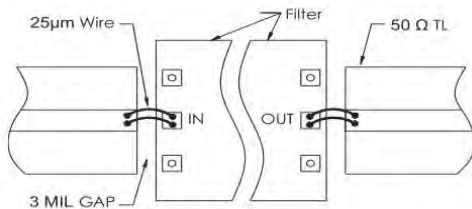
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	13.0		28.0	GHz
插入损耗		0.8	1.0	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@7.8-10.3GHz	27	32	dBc
	@DC-7.8GHz	34	39	dBc

环境要求

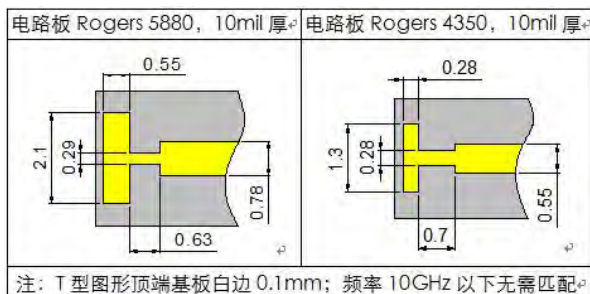
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

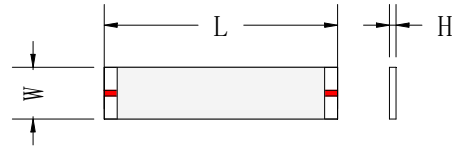
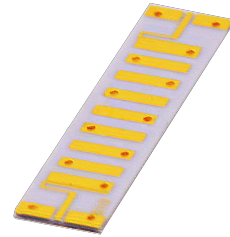


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁0.1mm，表面距上盖2.75mm，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配，T型尺寸如下:

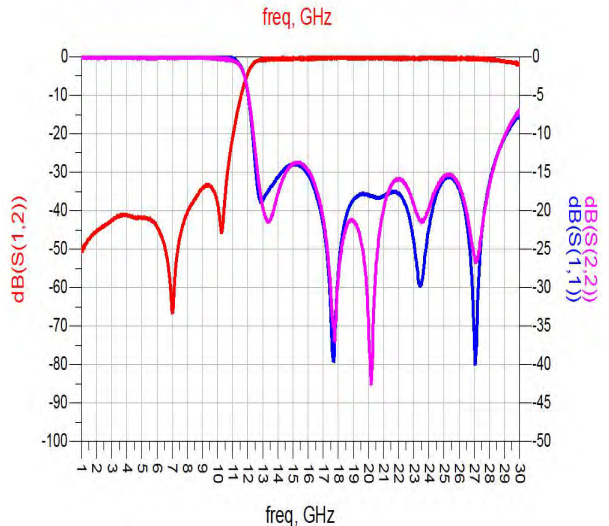


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	3.0	2.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

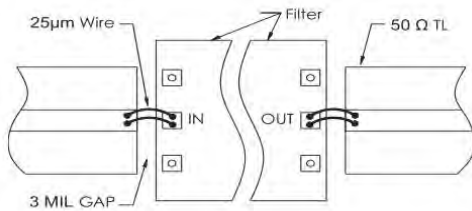
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	14.0		30.0	GHz
插入损耗		1.0	1.3	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@8.5-11.0GHz	27	32	dBc
	@DC-8.5GHz	33	37	dBc

环境要求

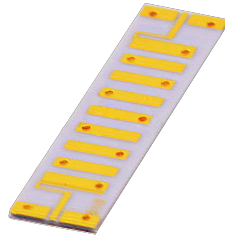
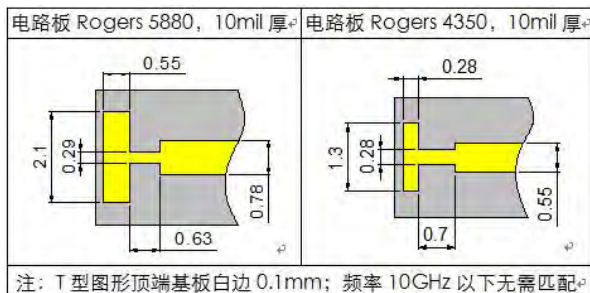
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

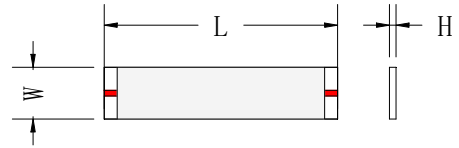


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁0.1mm，表面距上盖2.75mm，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配，T型尺寸如下:

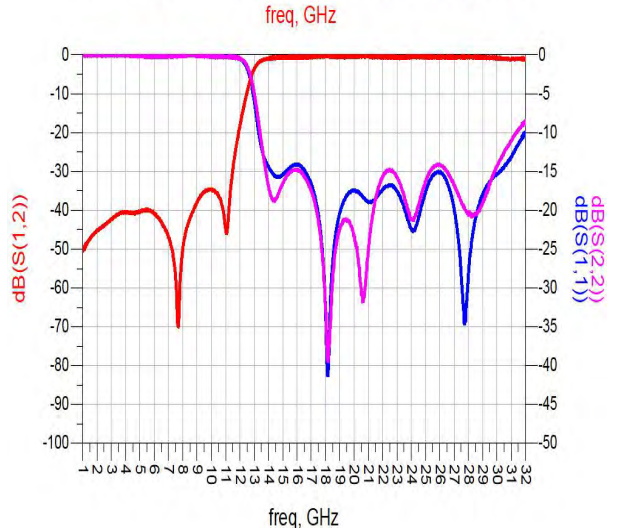
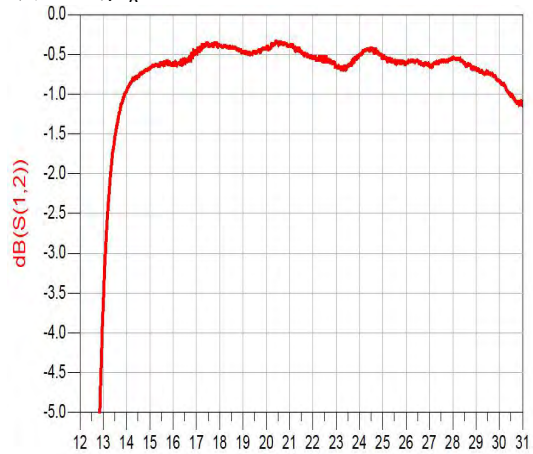


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	3.0	2.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

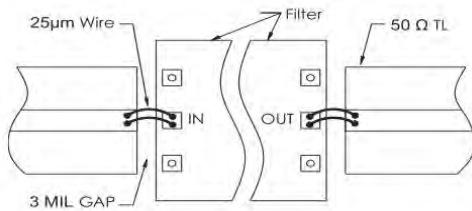
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	15.0		32.0	GHz
插入损耗		0.8	1.0	dB
带内波动		0.6	0.8	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@8.5-11.9GHz	27	32	dBc
	@DC-8.5GHz	32	37	dBc

环境要求

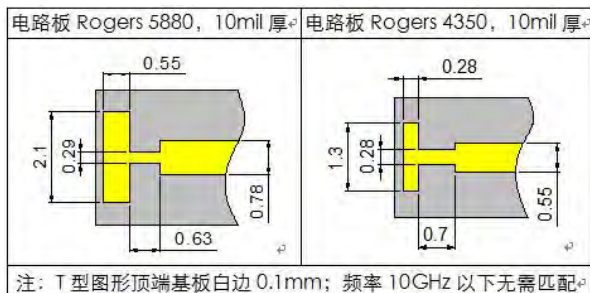
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

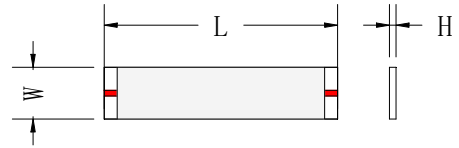
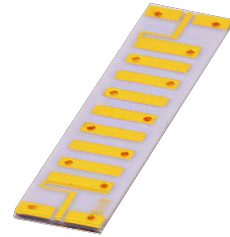


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

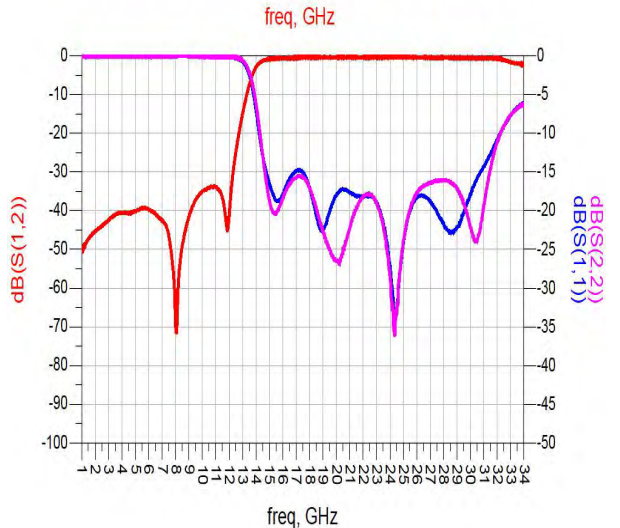


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	3.0	2.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块

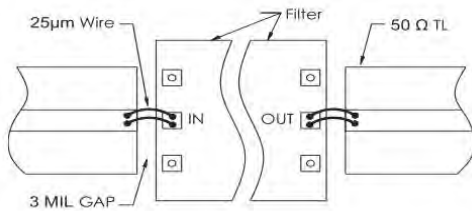
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	16.0		38.0	GHz
插入损耗		0.8	1.0	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@9.5-12.5GHz	27	32	dBc
	@DC-9.5GHz	30	35	dBc

环境要求

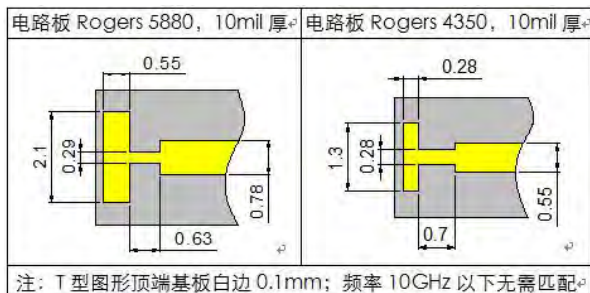
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

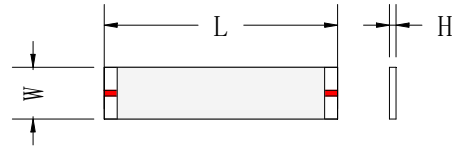
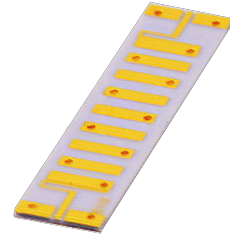


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁**0.1mm**,表面距上盖**2.75mm**,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配,T型尺寸如下:

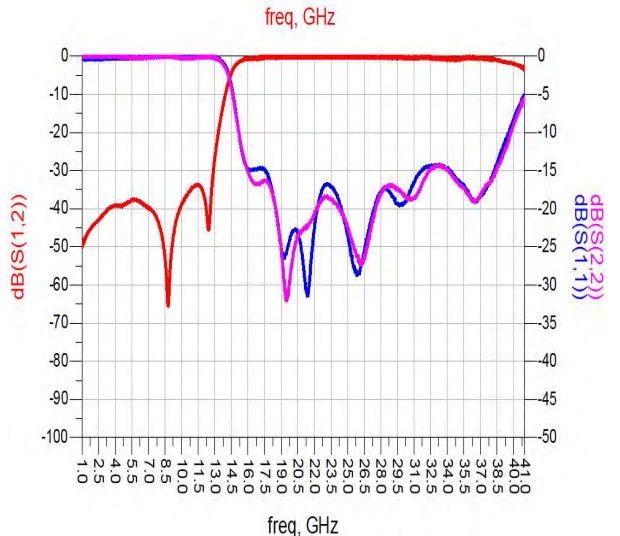
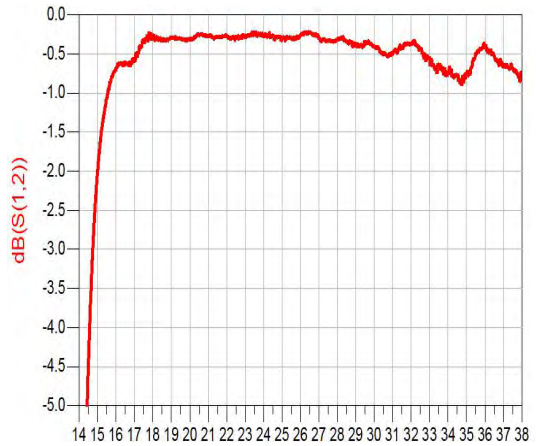


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	3.0	2.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

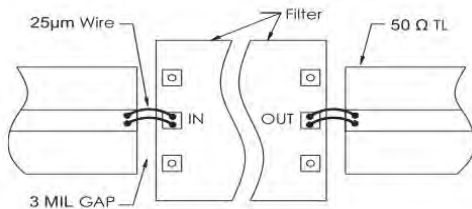
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	16.5		40.0	GHz
插入损耗		1.0	1.3	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-12.0GHz	28	33	dBc

环境要求

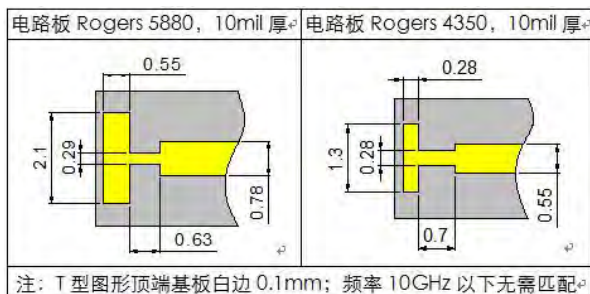
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

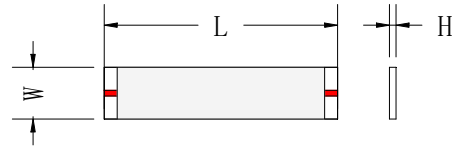
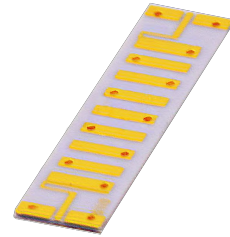


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm；
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配，T型尺寸如下：

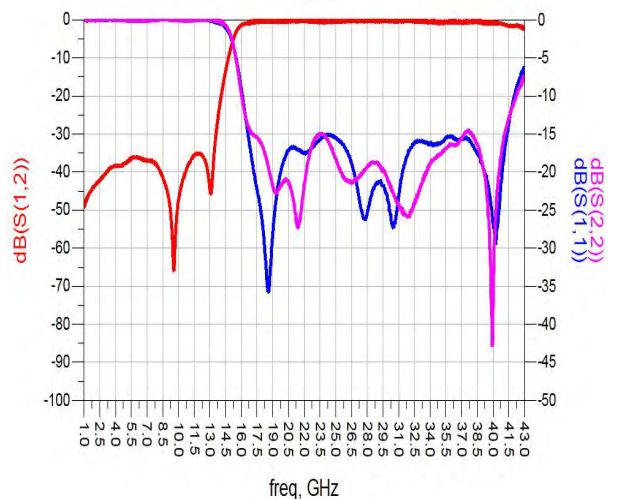
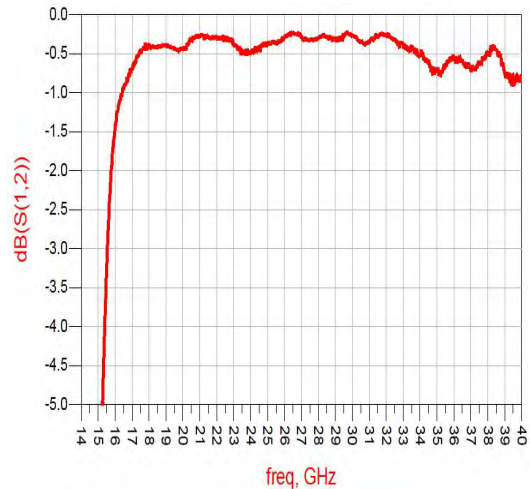


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	3.0	2.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

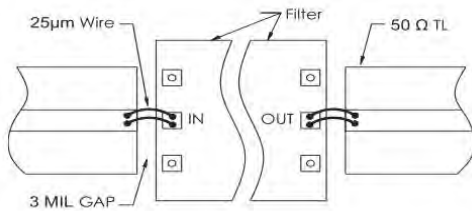
### 技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	17.0		37.0	GHz
插入损耗		0.8	1.2	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@9.5-13.4GHz	23	28	dBc
	@DC-9.5GHz	30	35	dBc

### 环境要求

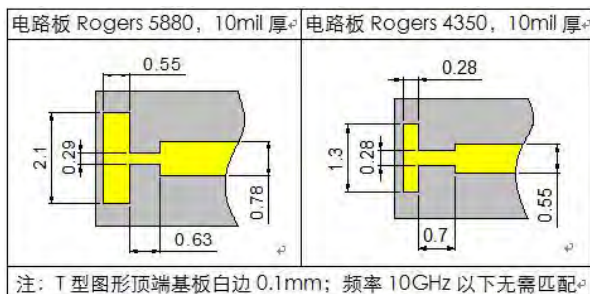
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

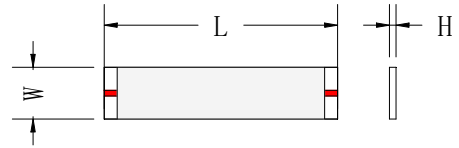
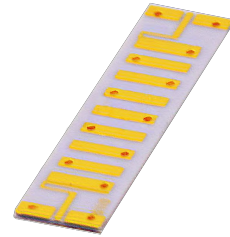


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

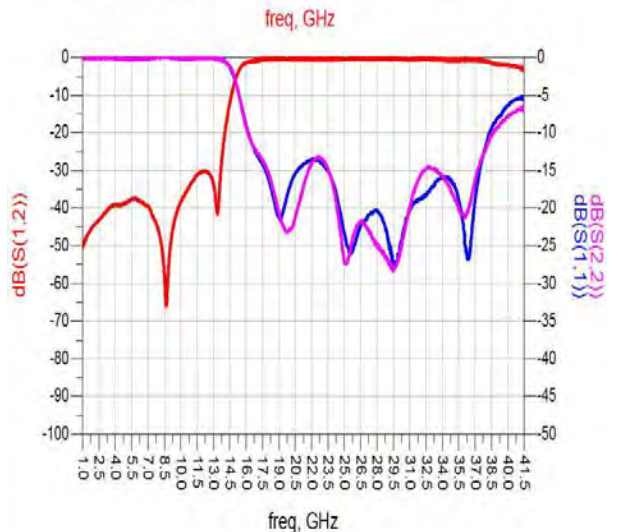


### 外形图



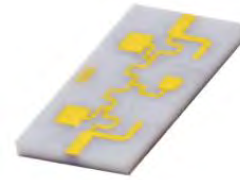
外形尺寸	L	W	H	单位
	3.0	2.0	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

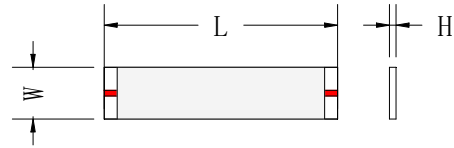
- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块



技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		2.2		GHz
工作频率	DC		4.4	GHz
中心损耗		0.3	0.5	dB
截止频率损耗		1.4	2.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@5.8-10.0GHz	45	50	dBc

外形图

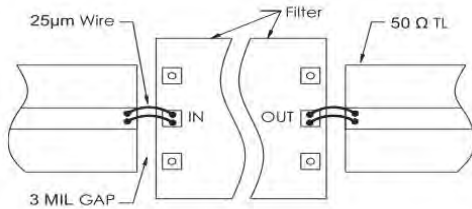


外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	5.0	0.254	mm

环境要求

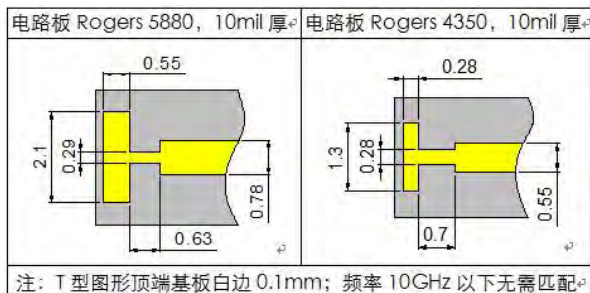
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

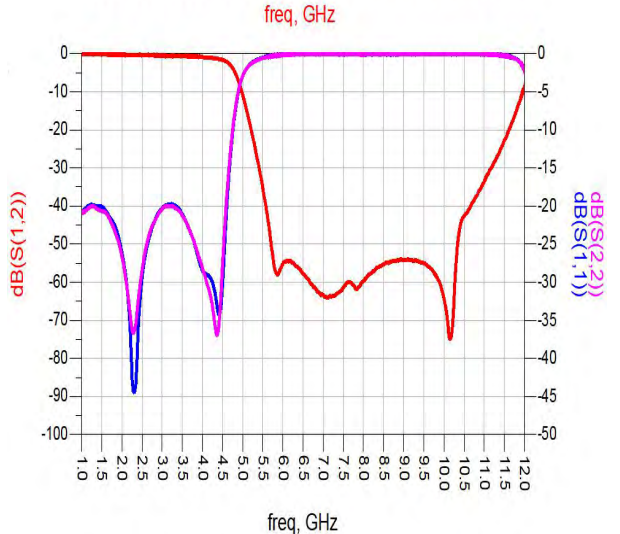
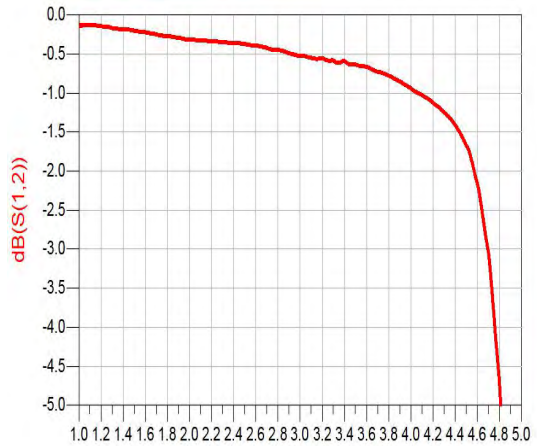


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁**0.1mm**,表面距上盖**2.75mm**,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配,T型尺寸如下:

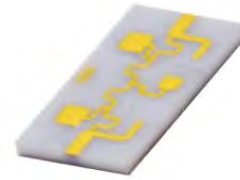


典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

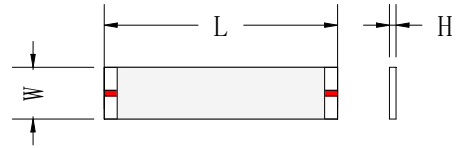
- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块



技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		2.5		GHz
工作频率	DC		5.0	GHz
中心损耗		0.5	0.7	dB
截止频率损耗		1.2	1.7	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@6.5-12.0GHz	35	40	dBc

外形图

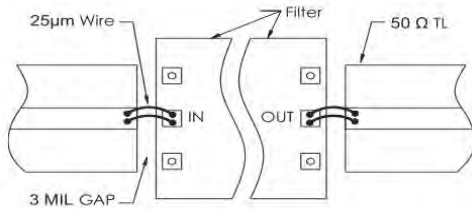


外形尺寸	L	W	H	单位
	6.0	3.0	0.254	mm

环境要求

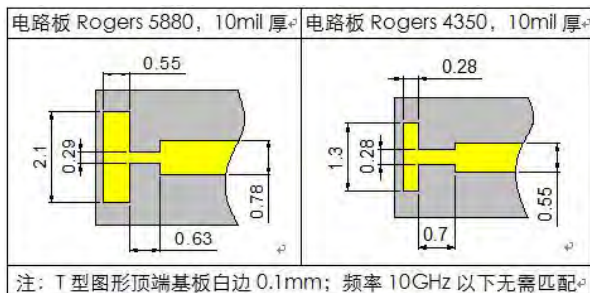
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

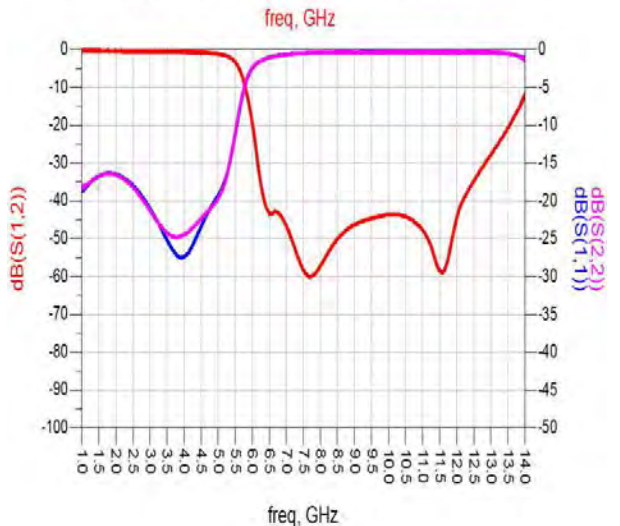
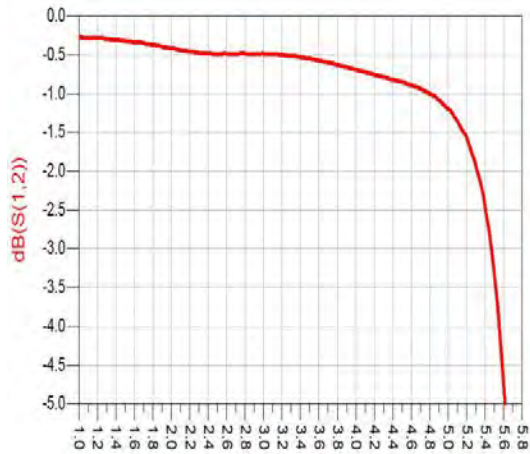


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

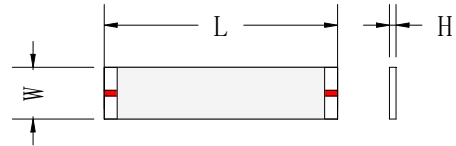
- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块



技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		3.0		GHz
工作频率	DC		6.0	GHz
中心损耗		0.3	0.5	dB
截止频率损耗		1.6	2.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@7.1-13.5GHz	35	40	dBc

外形图

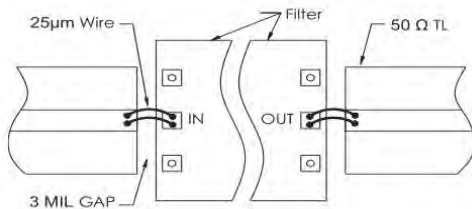


外形尺寸	L	W	H	单位
	6.0	3.0	0.254	mm

环境要求

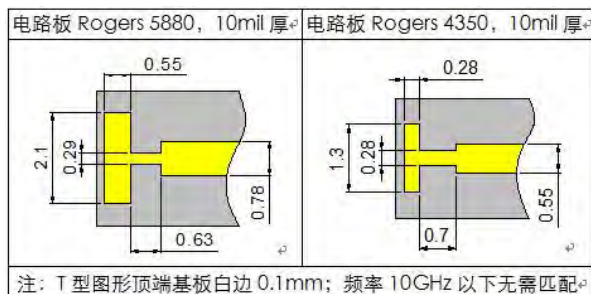
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

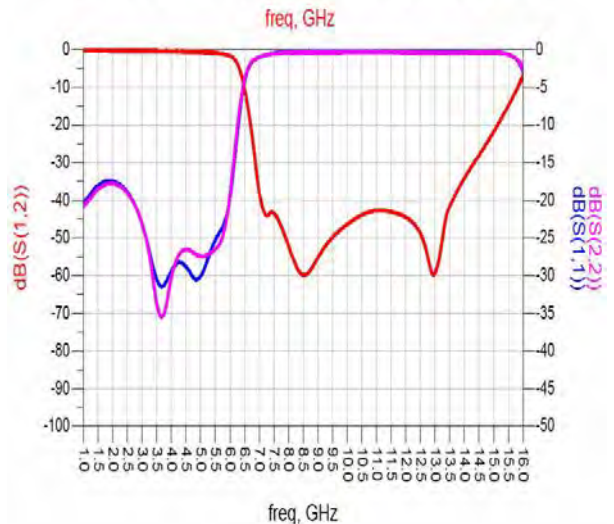
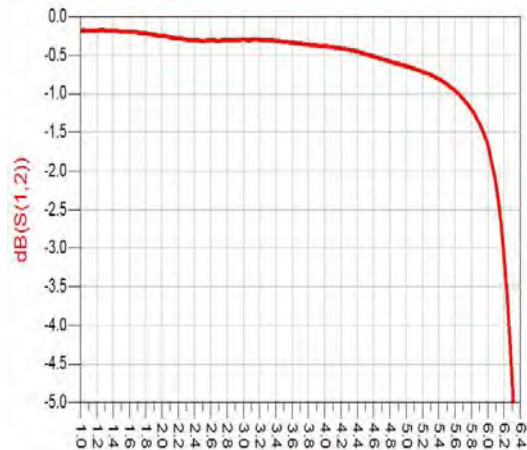


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

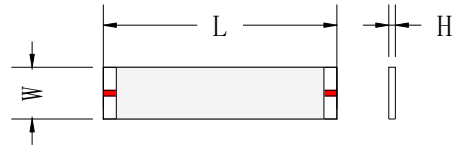
- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块



技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		3.5		GHz
工作频率	DC		7.0	GHz
中心损耗		0.5	0.7	dB
截止频率损耗		1.6	2.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@8.2-14.5GHz	32	36	dBc

外形图

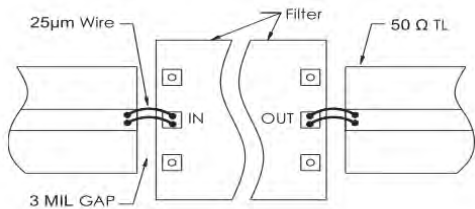


外形尺寸	L	W	H	单位
	6.0	3.0	0.254	mm

环境要求

最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

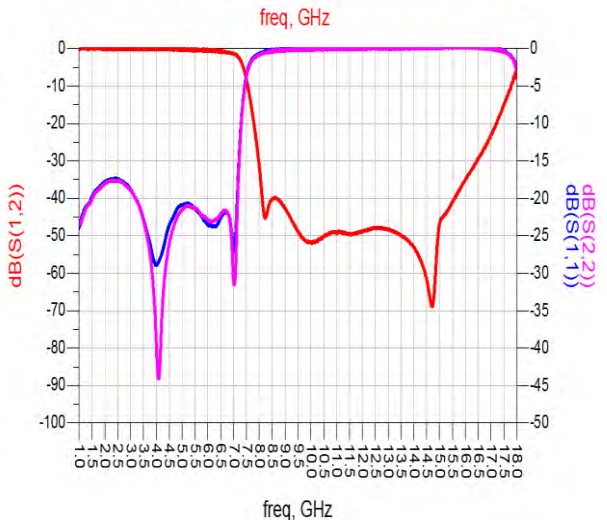
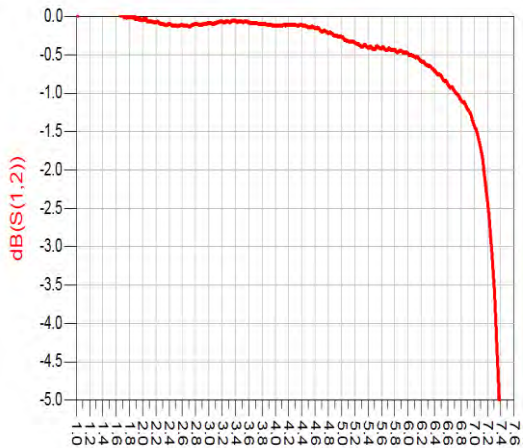


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
3. 芯片应安装在可伐（推荐）或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm；
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配，T型尺寸如下：

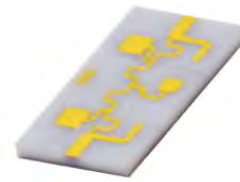
电路板 Rogers 5880, 10mil 厚	电路板 Rogers 4350, 10mil 厚
注: T型图形顶端基板白边 0.1mm; 频率 10GHz 以下无需匹配	

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

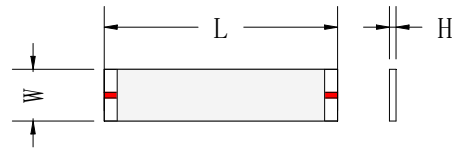
- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块



技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		4.0		GHz
工作频率	DC		8.0	GHz
中心损耗		0.5	0.7	dB
截止频率损耗		1.6	2.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@9.5-11.5GHz	30	35	dBc
	@11.5-18.0GHz	40	45	dBc

外形图

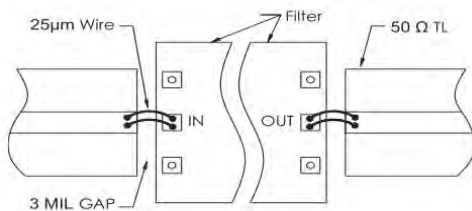


外形尺寸	L	W	H	单位
	5.0	2.5	0.254	mm

环境要求

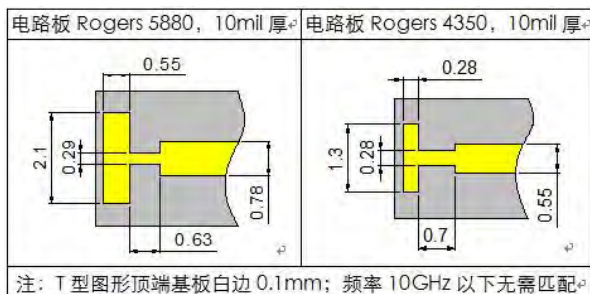
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

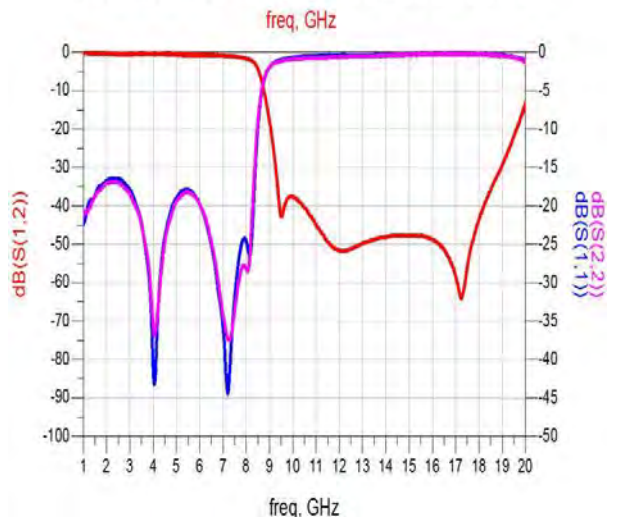


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁**0.1mm**,表面距上盖**2.75mm**,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配,T型尺寸如下:

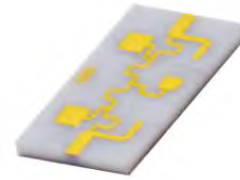


典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

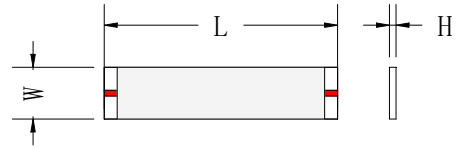
- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块



技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		4.0		GHz
工作频率	DC		8.0	GHz
中心损耗		0.7	0.9	dB
截止频率损耗		1.7	2.2	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@11.2-42.0GHz	35	40	dBc

外形图

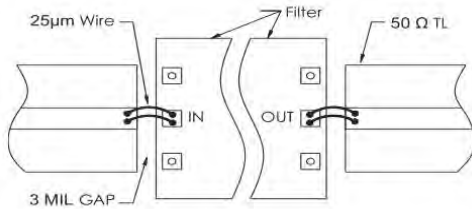


外形尺寸	L	W	H	单位
	9.0	3.0	0.254	mm

环境要求

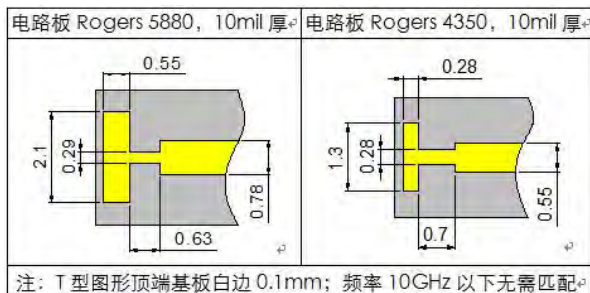
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

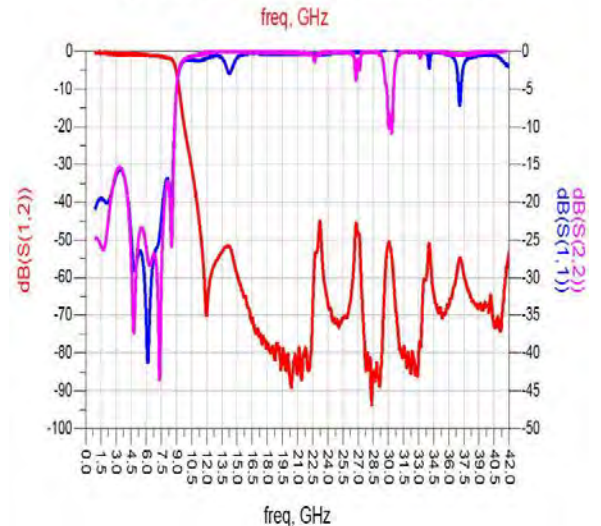
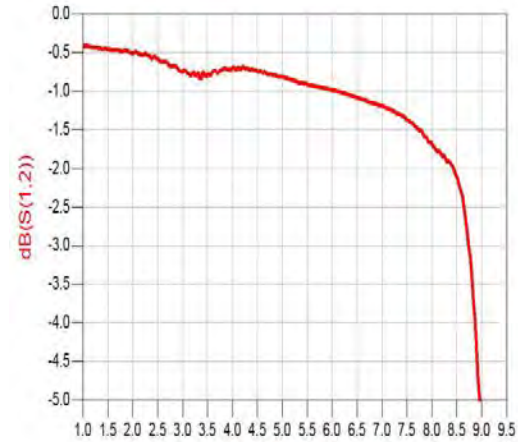


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配，T型尺寸如下:

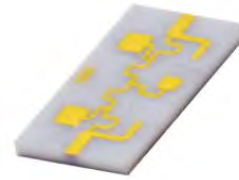


典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

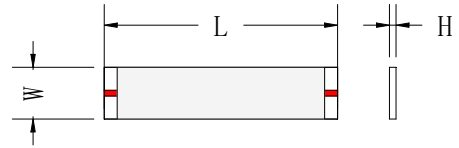
- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块



技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		4.3		GHz
工作频率	DC		8.6	GHz
中心损耗		0.5	0.7	dB
截止频率损耗		1.5	2.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@10.2-12.0GHz	31	36	dBc
	@12.0-18.5GHz	40	45	dBc

外形图

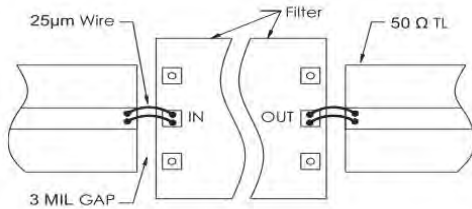


外形尺寸	L	W	H	单位
	5.0	2.5	0.254	mm

环境要求

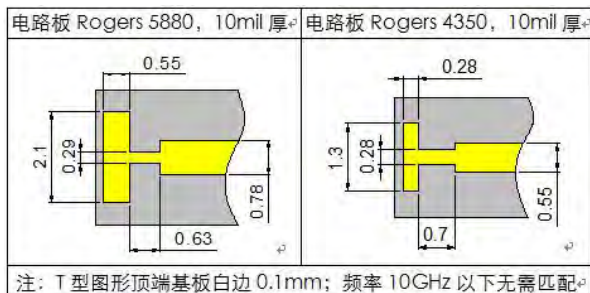
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

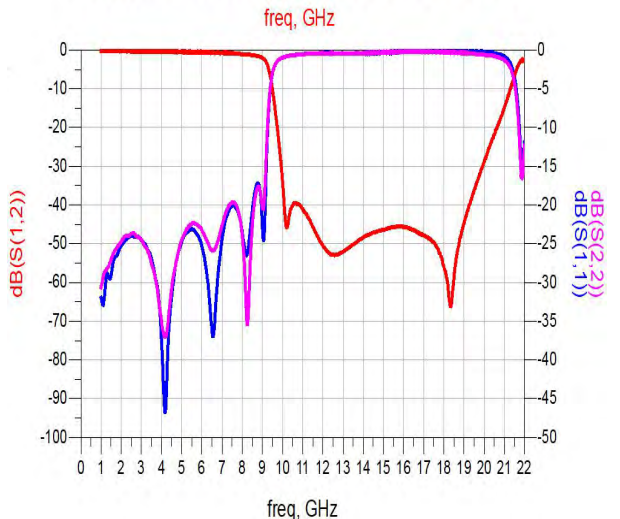


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:



典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

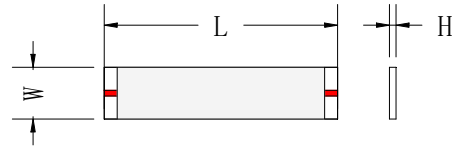
- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块



技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		4.9		GHz
工作频率	DC		9.8	GHz
中心损耗		0.4	0.6	dB
截止频率损耗		1.7	2.1	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@11.2-13.0GHz	30	35	dBc
	@13.0-21.0GHz	38	43	dBc

外形图

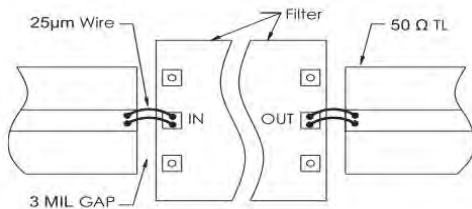


外形尺寸	L	W	H	单位
	5.0	2.5	0.254	mm

环境要求

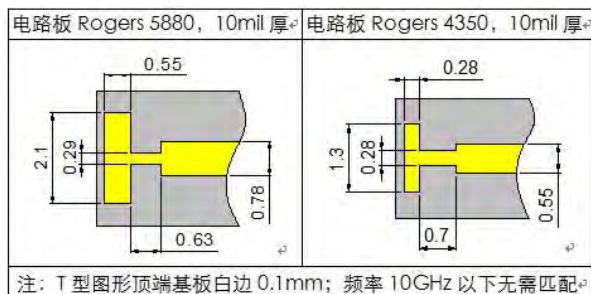
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

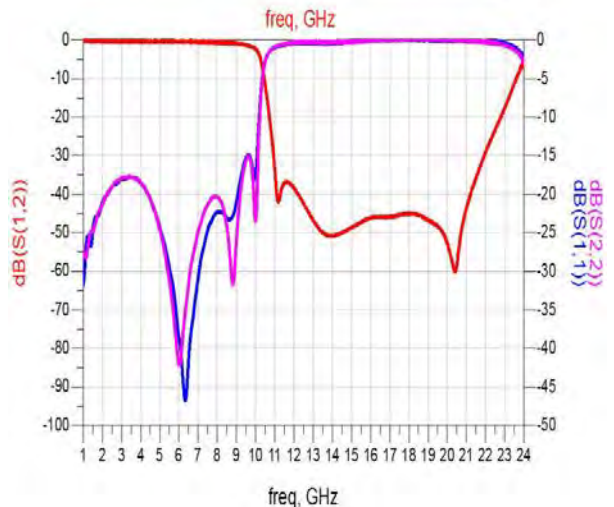
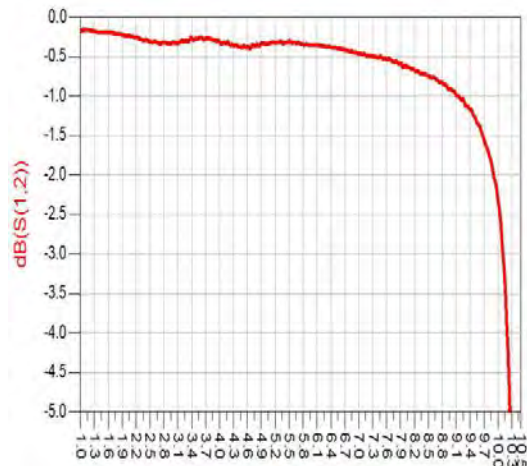


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁**0.1mm**,表面距上盖**2.75mm**,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配,T型尺寸如下:



典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

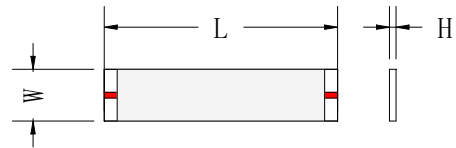
- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块



技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		5.5		GHz
工作频率	DC		11.0	GHz
中心损耗		0.4	0.6	dB
截止频率损耗		1.3	1.6	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@12.4-14.5GHz	30	32	dBc
	@14.5-21.5GHz	40	43	dBc

外形图

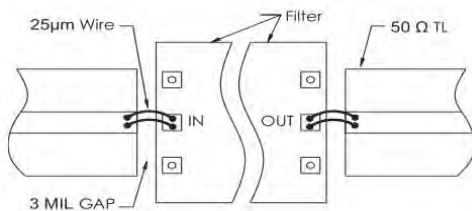


外形尺寸	L	W	H	单位
	5.0	2.5	0.254	mm

环境要求

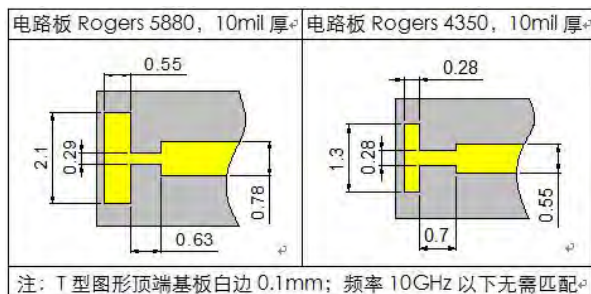
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

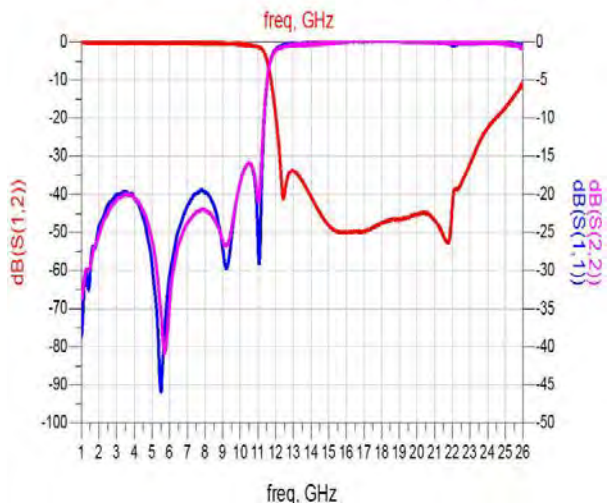
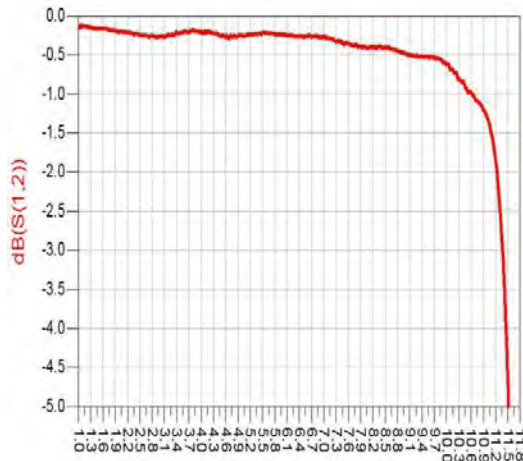


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

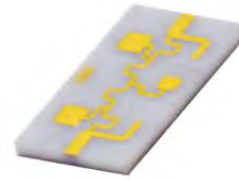


典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

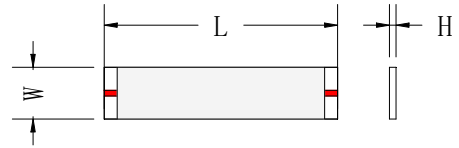
- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块



技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		5.7		GHz
工作频率	DC		11.4	GHz
中心损耗		0.4	0.6	dB
截止频率损耗		1.6	2.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@13.8-15.0GHz	40	45	dBc
	@15.0-25.0GHz	50	55	dBc

外形图

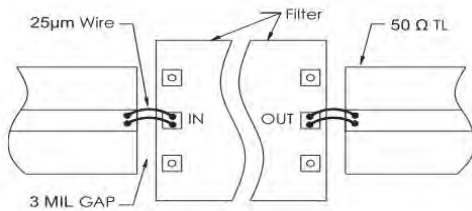


外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	2.6	0.254	mm

环境要求

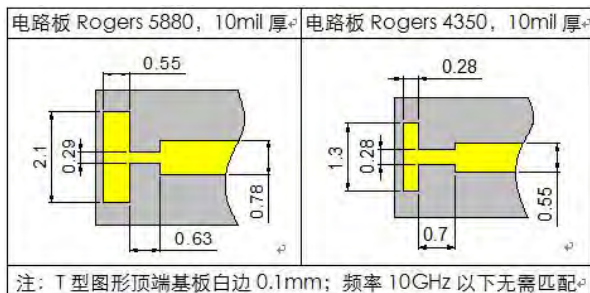
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

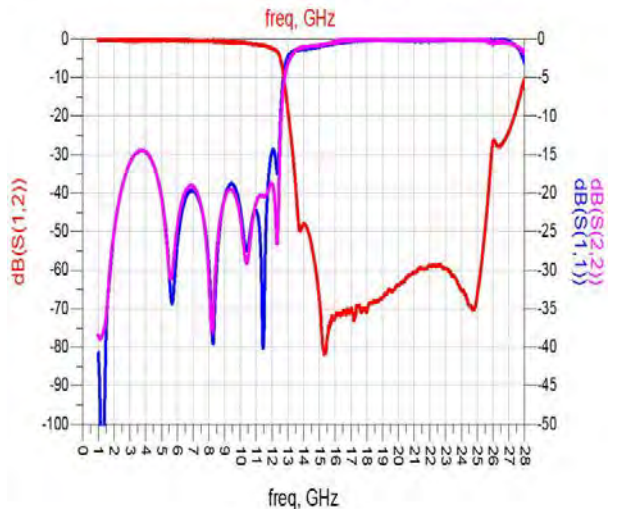
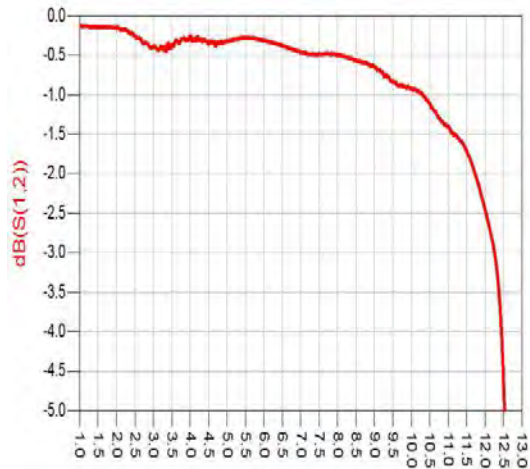


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖0.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

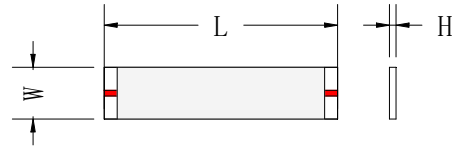
- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块



技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		6.0		GHz
工作频率	DC		12.0	GHz
中心损耗		0.4	0.6	dB
截止频率损耗		1.5	2.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@13.6-16.0GHz	20	25	dBc
	@16.0-22.0GHz	30	35	dBc

外形图

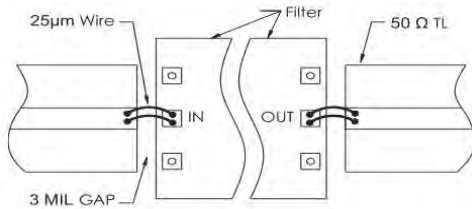


外形尺寸	L	W	H	单位
	4.0	2.0	0.254	mm

环境要求

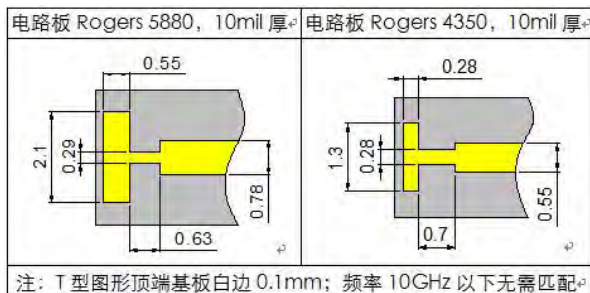
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

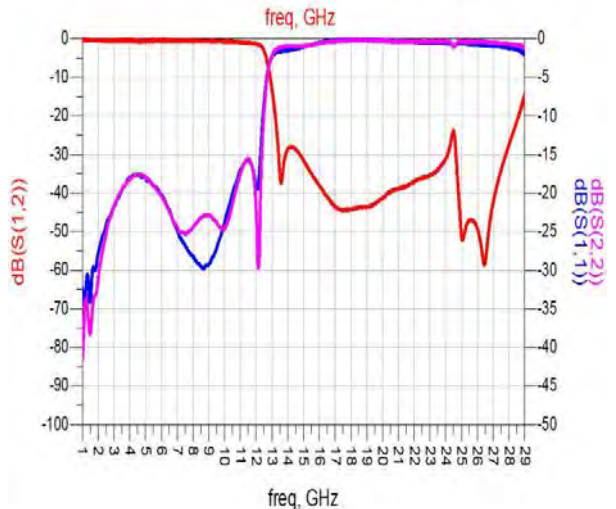
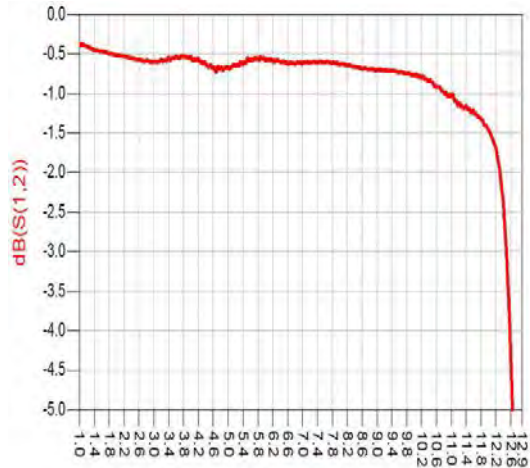


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

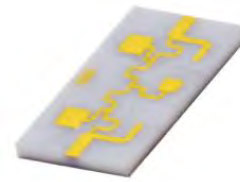


典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



### 产品特点

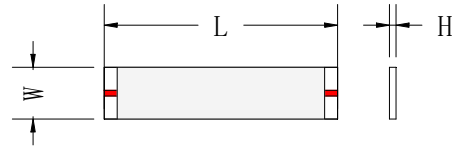
- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块



### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		6.5		GHz
工作频率	DC		13.0	GHz
中心损耗		0.5	0.7	dB
截止频率损耗		1.3	1.8	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@15.2-27.5GHz	28	33	dBc

### 外形图

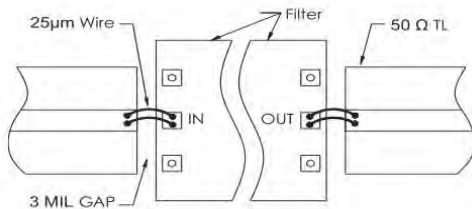


外形尺寸	L	W	H	单位
	4.0	2.0	0.254	mm

### 环境要求

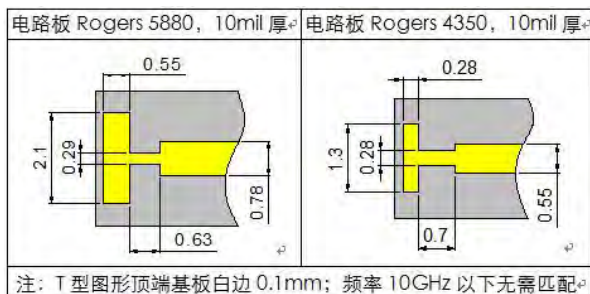
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

### 推荐装配图

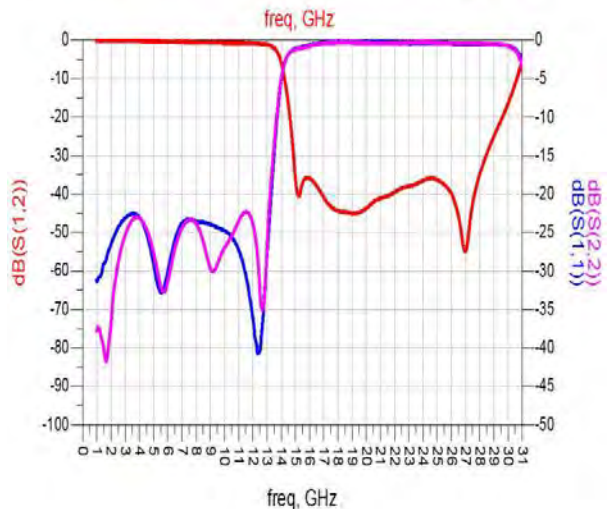
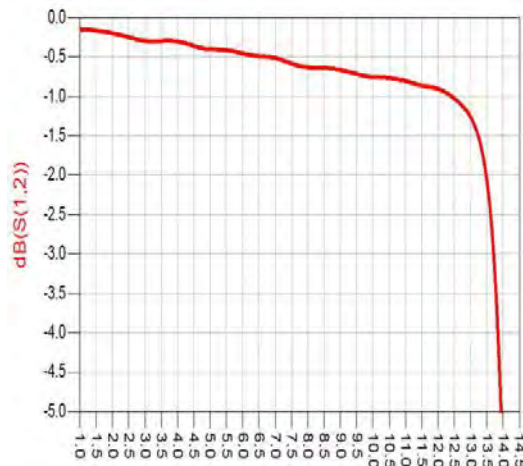


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3. 芯片应安装在可伐（推荐）或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm；
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配，T型尺寸如下：

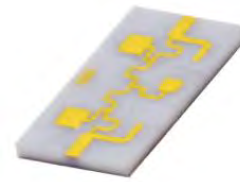


### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

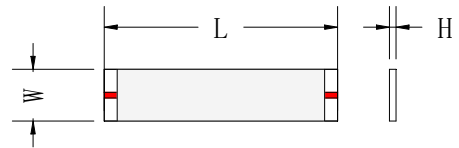
- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块



技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		6.9		GHz
工作频率	DC		13.8	GHz
中心损耗		0.4	0.6	dB
截止频率损耗		1.5	2.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@15.8-17.5GHz	25	30	dBc
	@17.5-26.5GHz	35	35	dBc

外形图

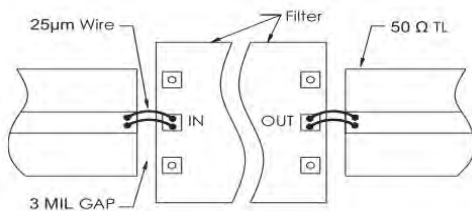


外形尺寸	L	W	H	单位
	4.0	2.0	0.254	mm

环境要求

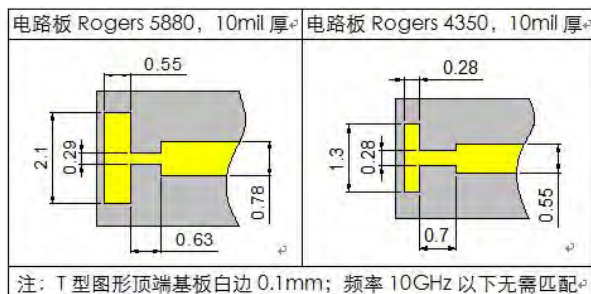
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

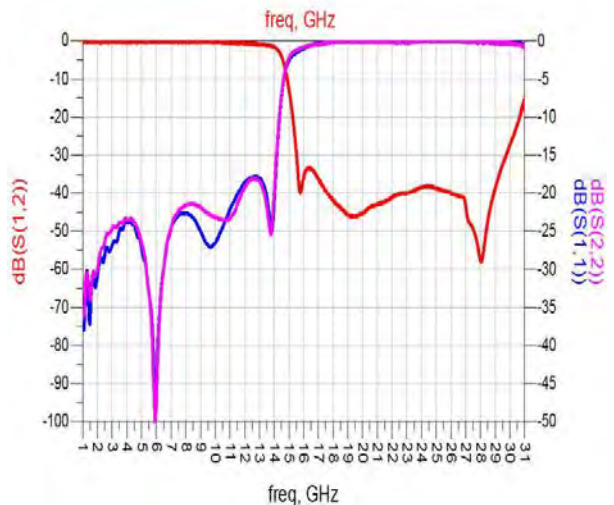


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁**0.1mm**,表面距上盖**2.75mm**,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配,T型尺寸如下:



典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

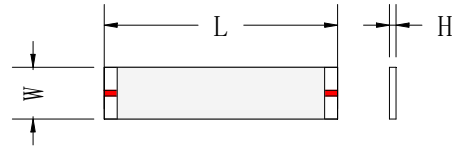
- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块



技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		7.3		GHz
工作频率	DC		14.6	GHz
中心损耗		0.5	0.7	dB
截止频率损耗		1.5	2.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@16.8-30.0GHz	30	35	dBc

外形图

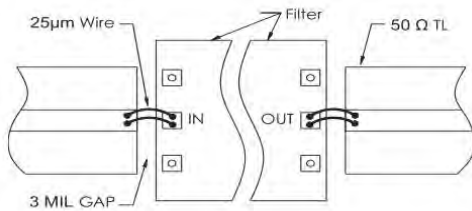


外形尺寸	L	W	H	单位
	4.0	2.0	0.254	mm

环境要求

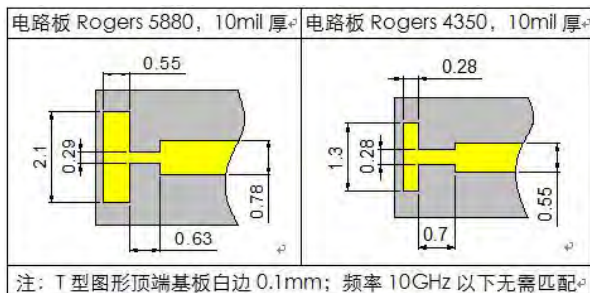
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

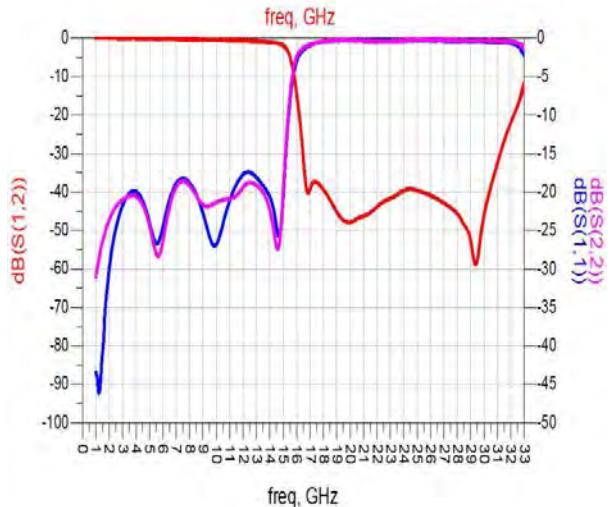


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

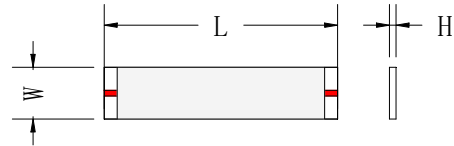
- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块



技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		7.9		GHz
工作频率	DC		15.8	GHz
中心损耗		0.4	0.6	dB
截止频率损耗		1.5	2.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@18.0-20.0GHz	28	33	dBc
	@20.0-32.0GHz	33	38	dBc

外形图

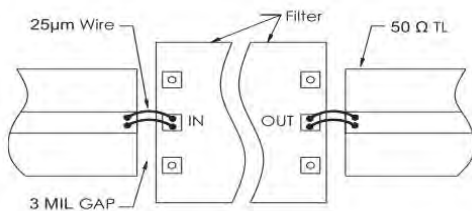


外形尺寸	L	W	H	单位
	4.0	2.0	0.254	mm

环境要求

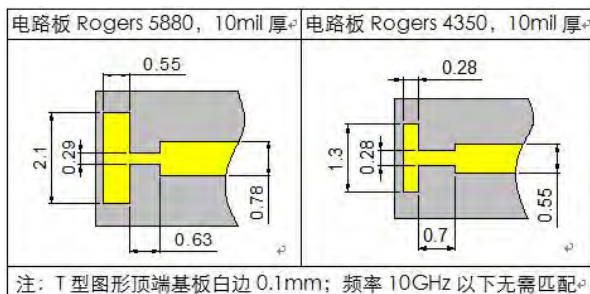
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

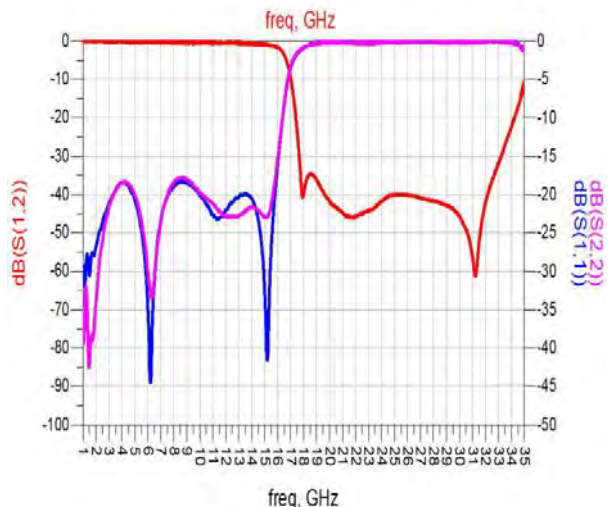


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁**0.1mm**,表面距上盖**2.75mm**,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配,T型尺寸如下:



典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

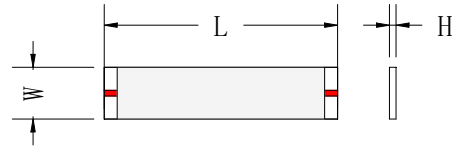
- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块



技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		8.5		GHz
工作频率	DC		17.0	GHz
中心损耗		0.4	0.6	dB
截止频率损耗		1.5	2.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@19.5-23.0GHz	28	33	dBc
	@23.0-34.0GHz	33	38	dBc

外形图

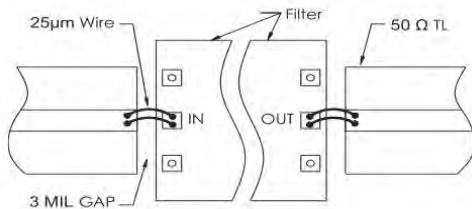


外形尺寸	L	W	H	单位
	4.0	2.0	0.254	mm

环境要求

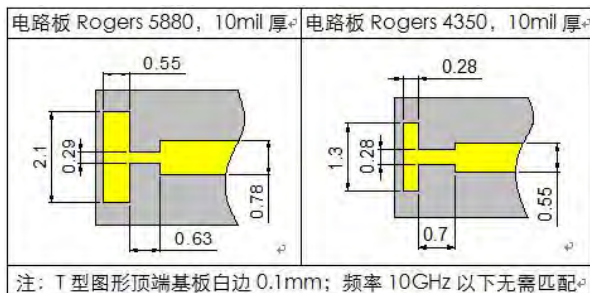
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

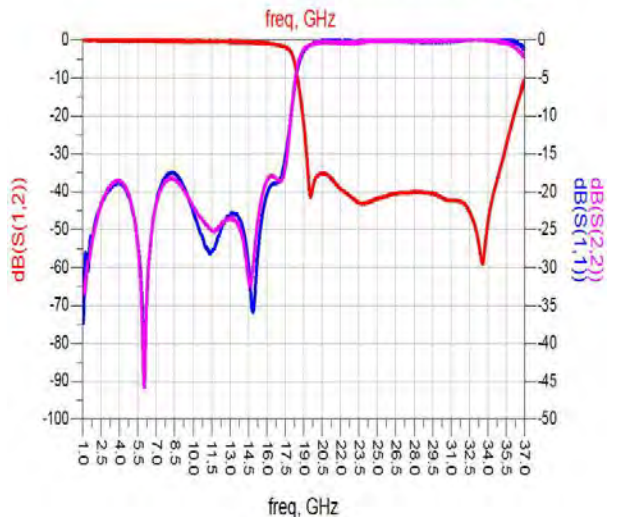


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

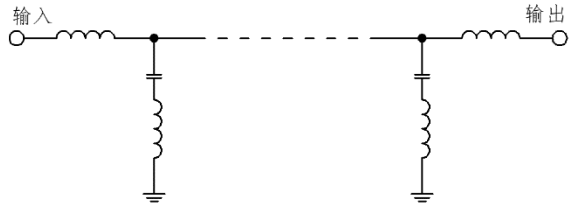
- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块



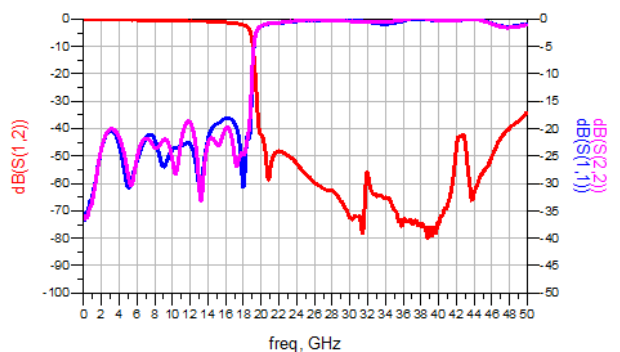
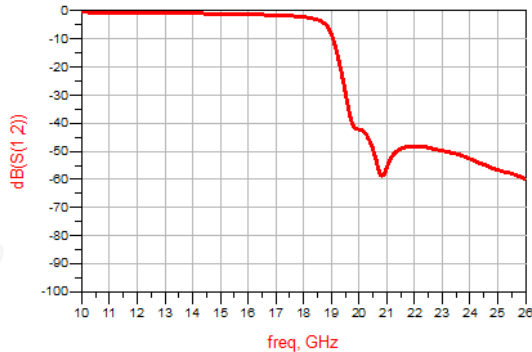
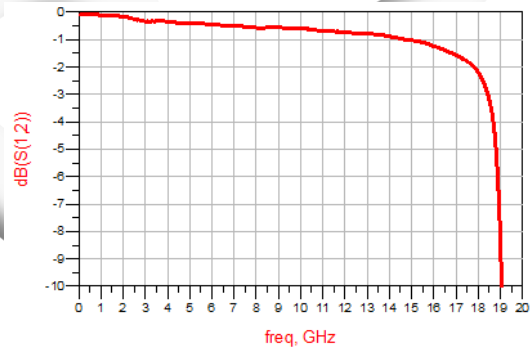
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		8.75		GHz
工作频率	DC		17.5	GHz
中心损耗		0.6	0.9	dB
截止频率损耗		1.9	2.4	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@20.0-47.0GHz	35	40		dBc
承受功率			25	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

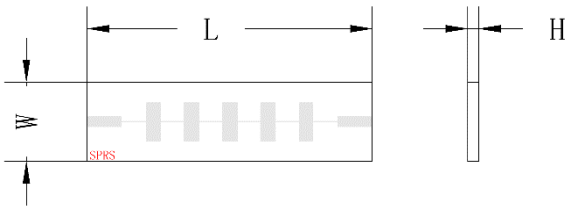
原理图



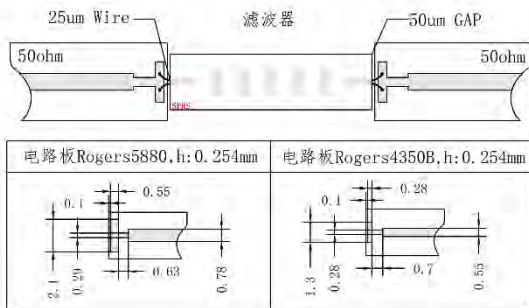
典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



外形图: L: 7.0, W: 3.0, H: 0.254, 端口居中



推荐装配图:



注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块



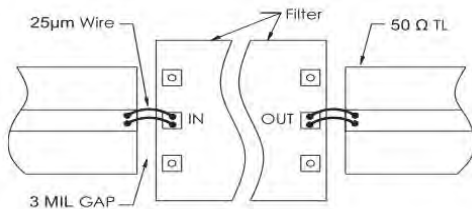
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		8.8		GHz
工作频率	DC		17.6	GHz
中心损耗		0.4	0.6	dB
截止频率损耗		1.5	2.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@20.0-35.5GHz	30	35	dBc

环境要求

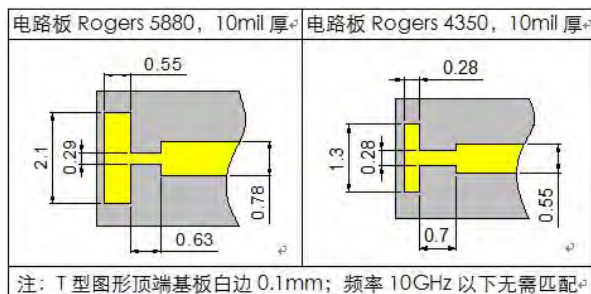
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

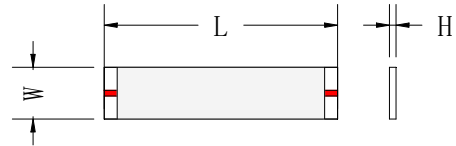


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

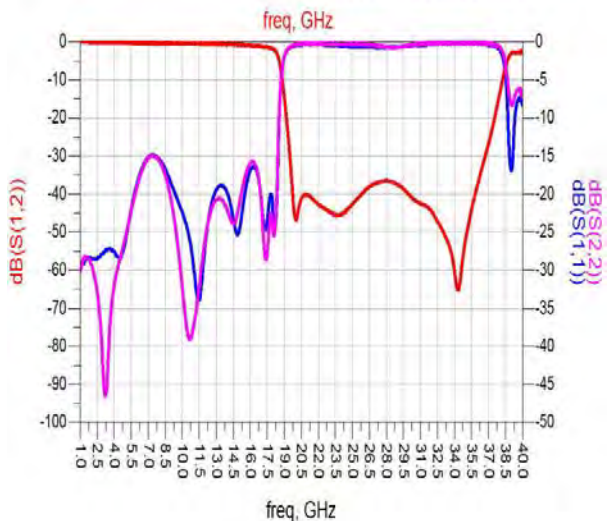
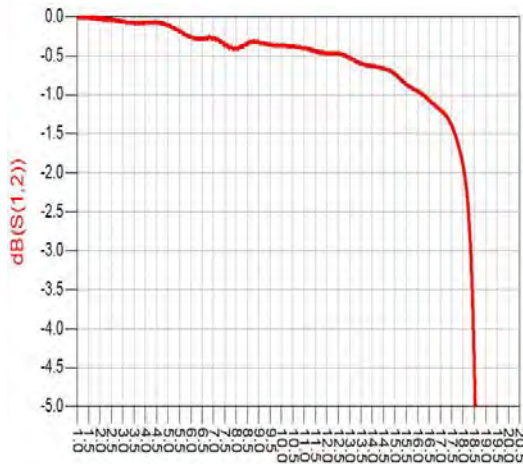


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	4.0	2.0	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

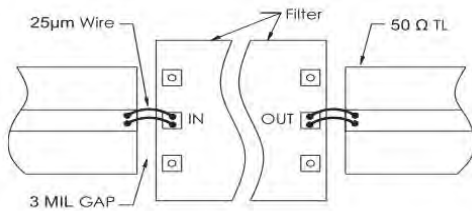
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		8.9		GHz
工作频率	DC		17.8	GHz
中心损耗		0.3	0.5	dB
截止频率损耗		1.5	2.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@22.2-40.0GHz	55	60	dBc

环境要求

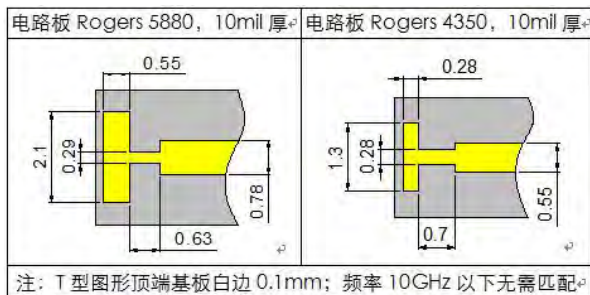
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图



注意事项:

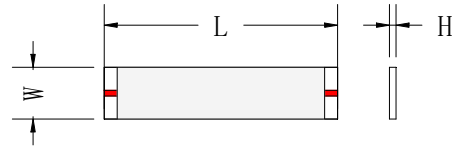
1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:



注: T型图形顶端基板白边0.1mm; 频率10GHz以下无需匹配

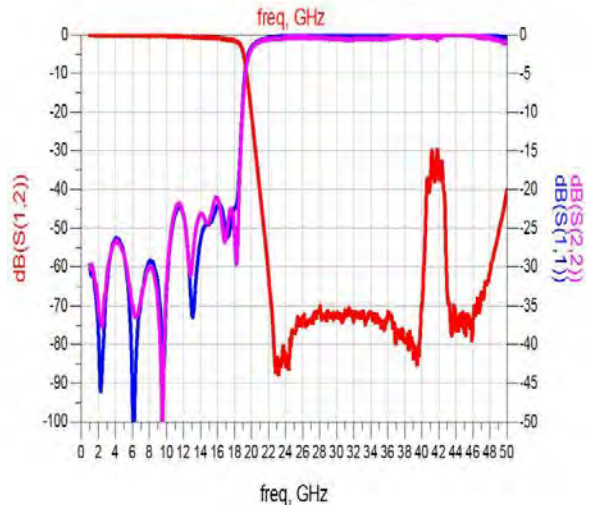
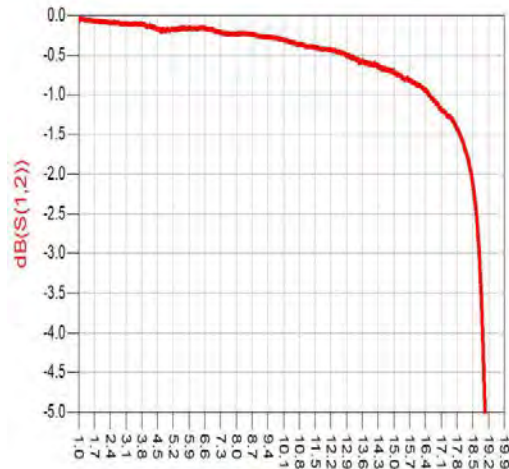


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.5	2.5	0.254	mm

典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

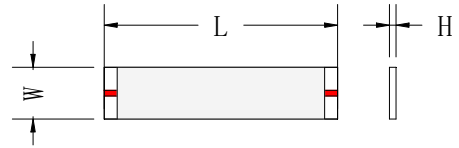
- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块



技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		9.0		GHz
工作频率	DC		18.0	GHz
中心损耗		0.5	0.8	dB
截止频率损耗		1.6	2.2	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@21.0-26.0GHz	35	40	dBc
	@26.0-39.0GHz	50	55	dBc

外形图

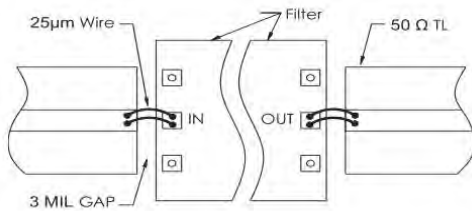


外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	2.0	0.254	mm

环境要求

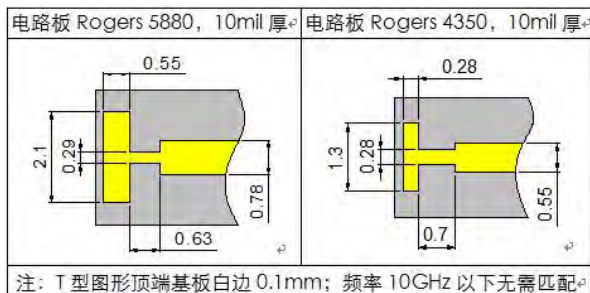
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

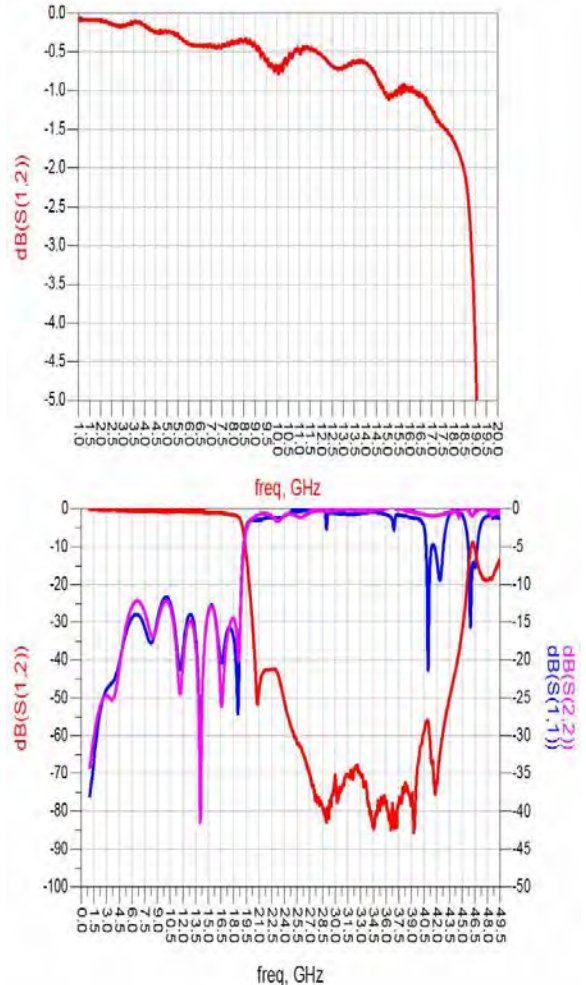


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:



典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

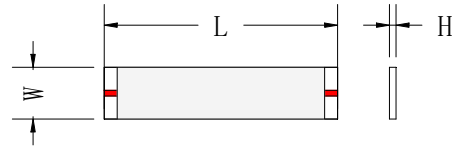
- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块



技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		9.5		GHz
工作频率	DC		19.0	GHz
中心损耗		0.4	0.6	dB
截止频率损耗		1.5	2.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@22.0-27.5GHz	26	31	dBc
	@27.5-36.0GHz	36	41	dBc

外形图

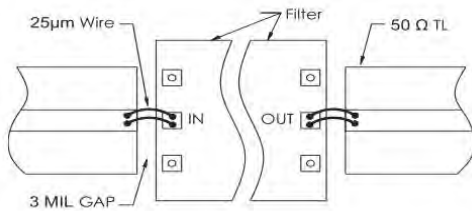


外形尺寸	L	W	H	单位
	4.0	2.0	0.254	mm

环境要求

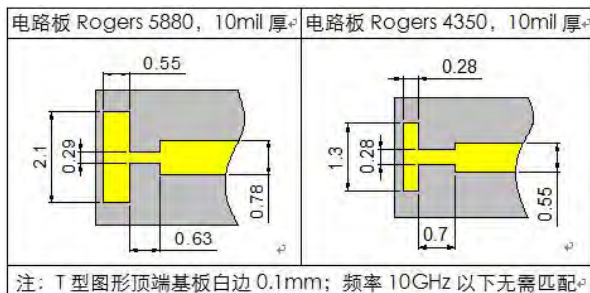
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

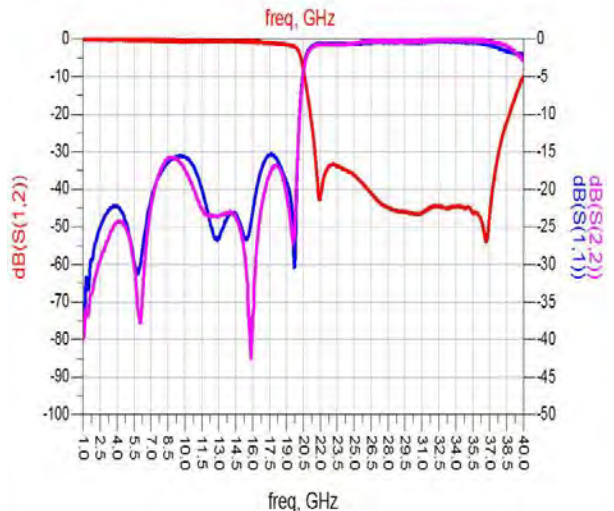


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm / °C), 载体厚度 ≥ 0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:



典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

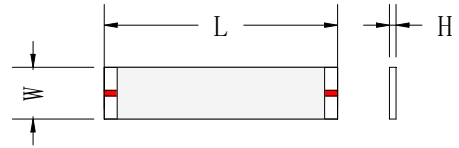
- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块



技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		10.0		GHz
工作频率	DC		20.0	GHz
中心损耗		0.4	0.6	dB
截止频率损耗		1.2	1.8	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@22.8-27.0GHz	26	31	dBc
	@27.0-38.0GHz	30	35	dBc

外形图

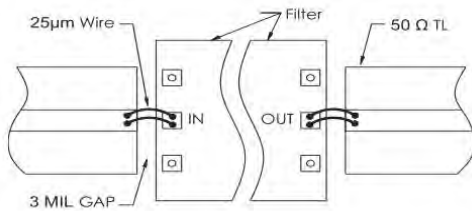


外形尺寸	L	W	H	单位
	4.0	2.0	0.254	mm

环境要求

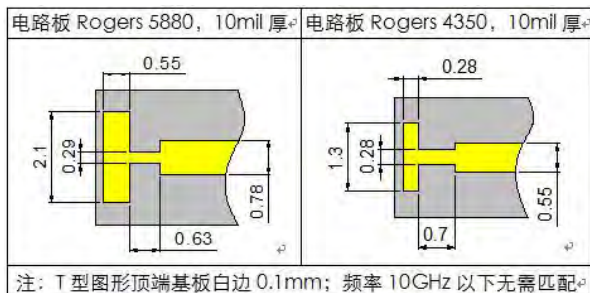
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

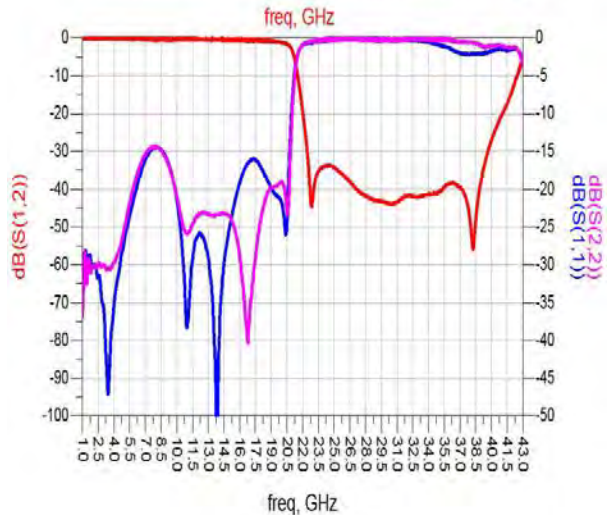
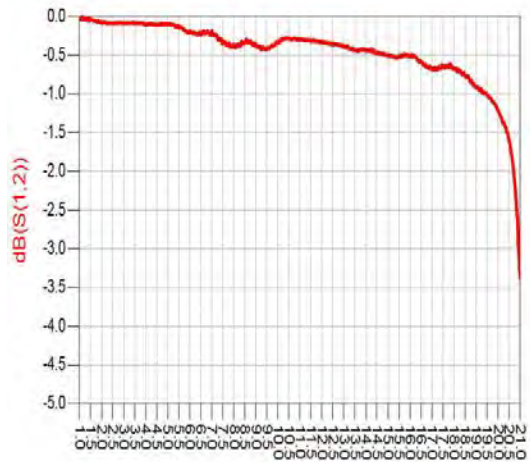


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配,T型尺寸如下:



典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



产品特点

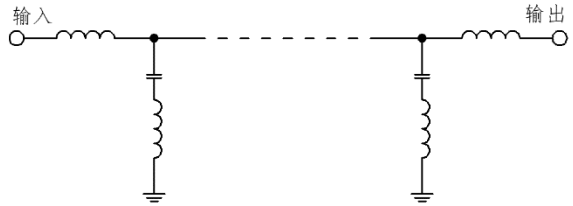
- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块



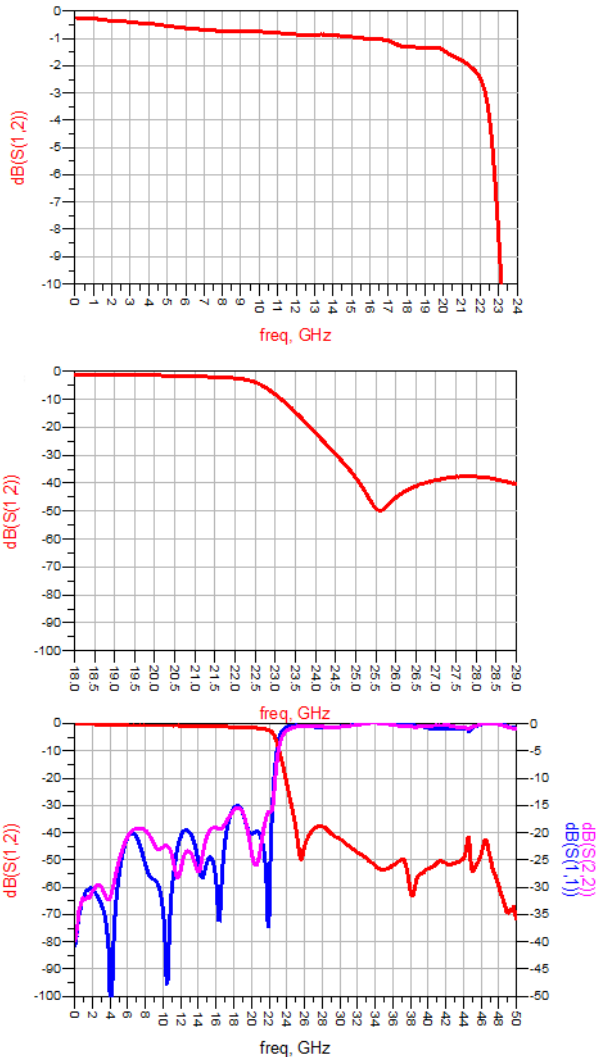
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		12.0		GHz
工作频率	DC		21.4	GHz
中心损耗		0.8	1.1	dB
截止频率损耗		2.0	2.4	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@25.3-50.0GHz	32	35		dBc
承受功率			25	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

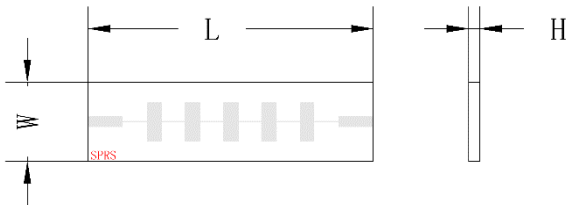
原理图



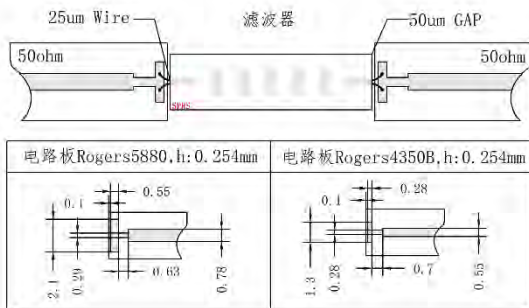
典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



外形图: L: 4.5, W: 2.0, H: 0.254, 端口居中



推荐装配图:



注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

产品特点

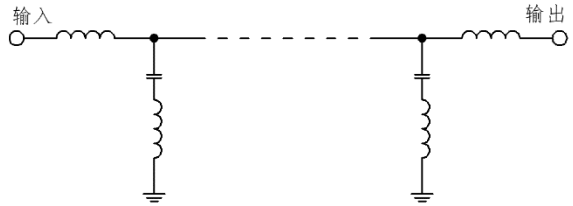
- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块



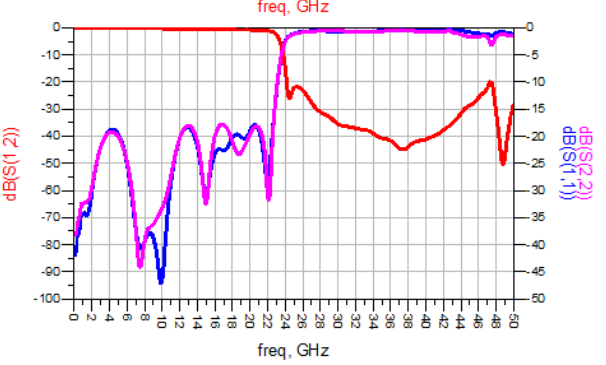
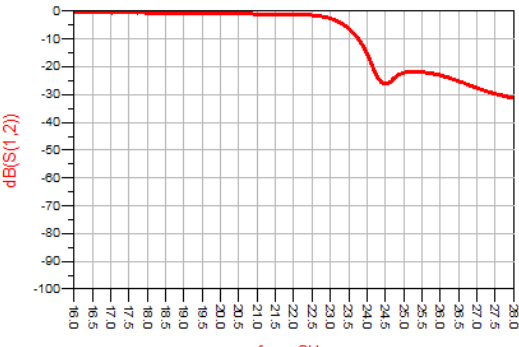
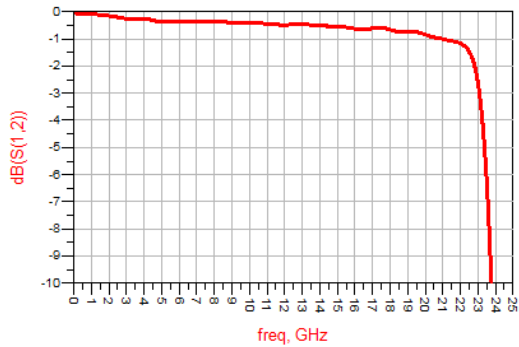
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		11.0		GHz
工作频率	DC		22.0	GHz
中心损耗		0.5	0.8	dB
截止频率损耗		1.2	1.8	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@24.5-46.0GHz	16	20		dBc
承受功率			25	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

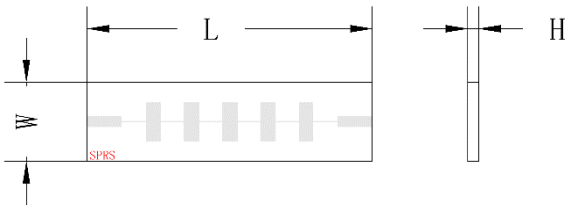
原理图



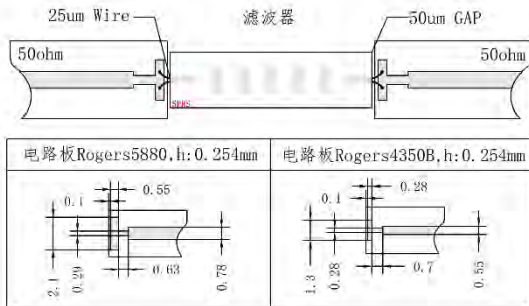
典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



外形图: L: 3.0, W: 2.0, H: 0.254, 端口居中



推荐装配图:



注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

产品特点

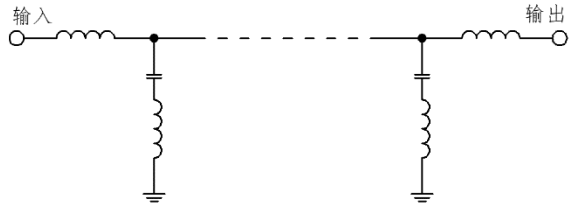
- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块



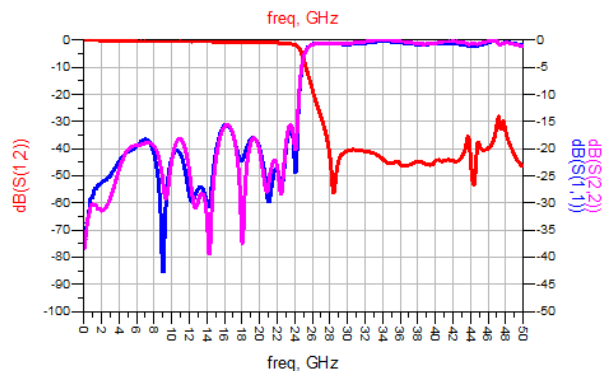
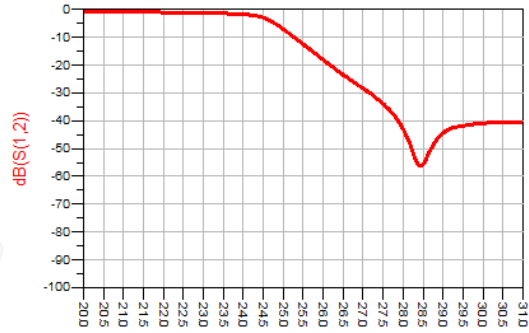
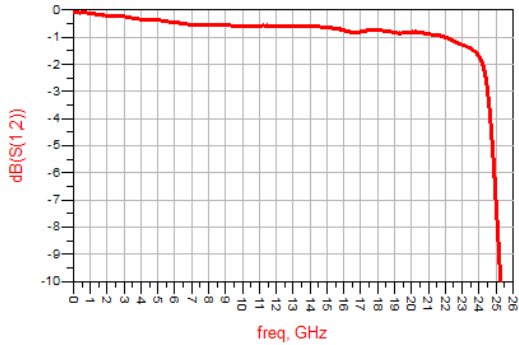
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		12.0		GHz
工作频率	DC		24.0	GHz
中心损耗		0.5	0.8	dB
截止频率损耗		1.8	2.2	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@28.0-43.0GHz	37	40		dBc
承受功率			25	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

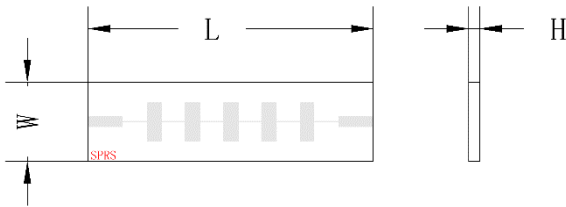
原理图



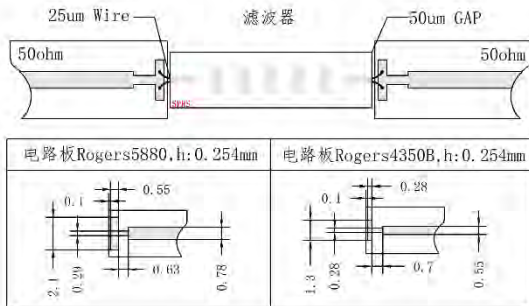
典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



外形图: L: 4.5, W: 2.0, H: 0.254, 端口居中



推荐装配图:



注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖1.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

产品特点

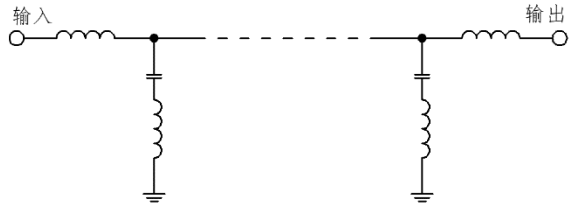
- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块



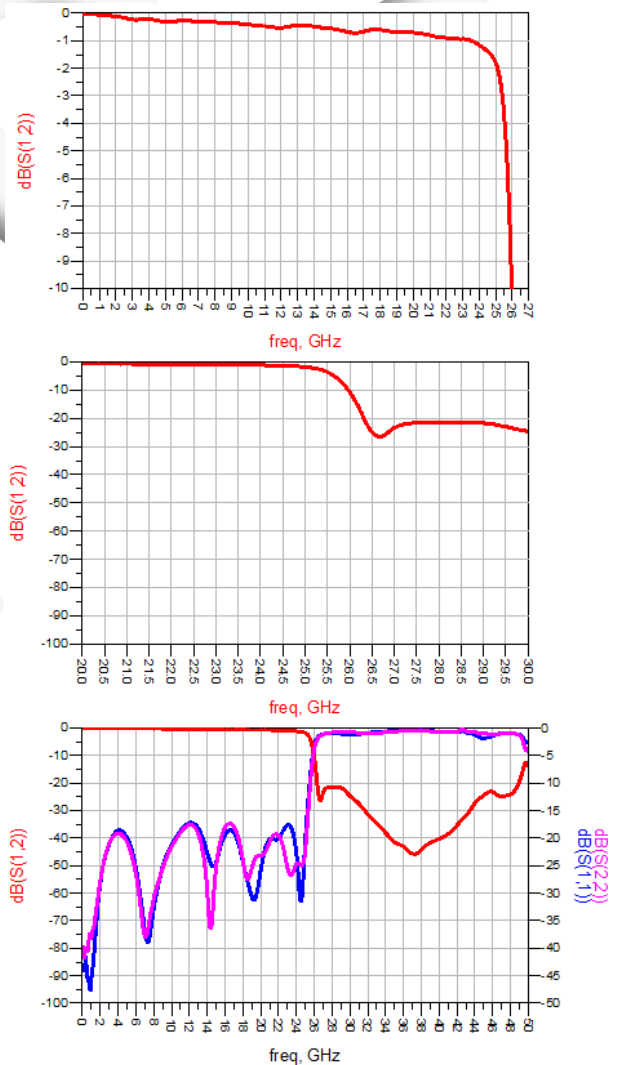
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		12.5		GHz
工作频率	DC		24.5	GHz
中心损耗		0.6	0.9	dB
截止频率损耗		1.4	1.9	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@26.5-48.0GHz	17	20		dBc
承受功率			25	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

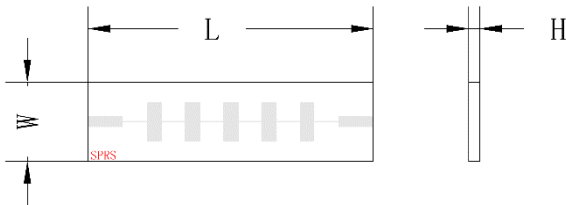
原理图



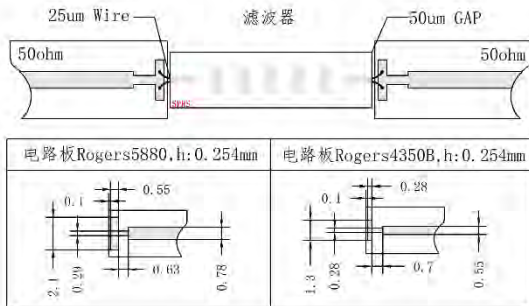
典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



外形图: L: 3.0, W: 2.0, H: 0.254, 端口居中



推荐装配图:



注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖1.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

产品特点

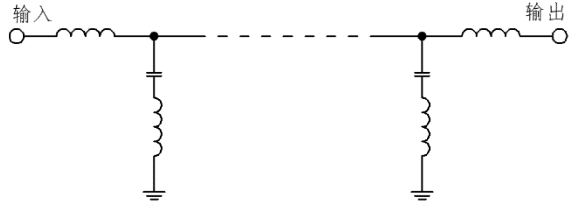
- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块



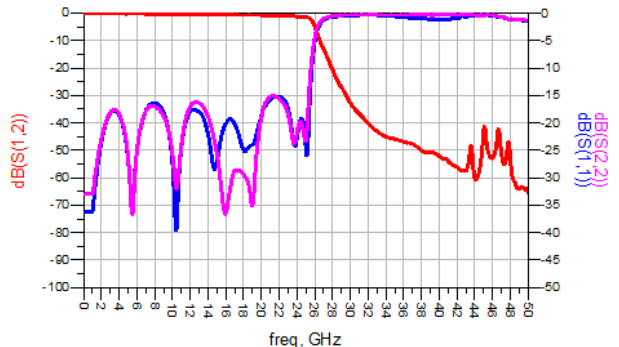
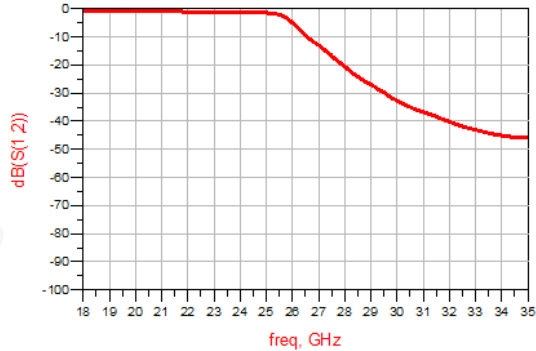
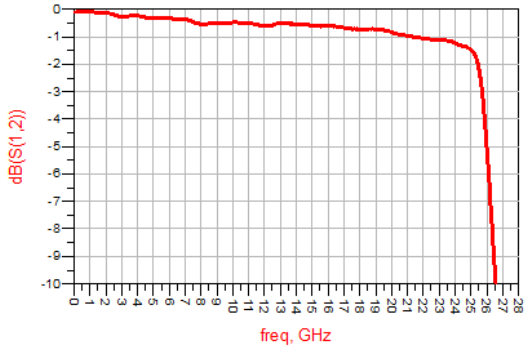
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		12.4		GHz
工作频率	DC		24.8	GHz
中心损耗		0.6	0.9	dB
截止频率损耗		1.4	1.8	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@32.0-50.0GHz	33	37		dBc
承受功率			25	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

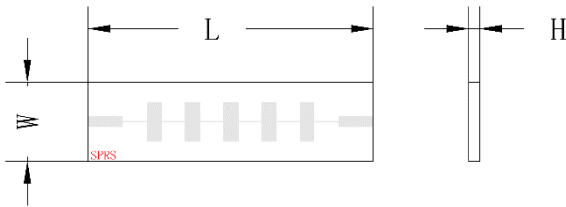
原理图



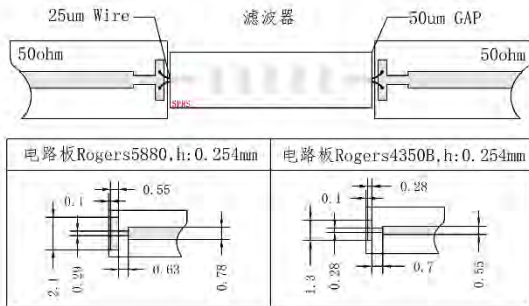
典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



外形图: L: 6.5, W: 1.8, H: 0.254, 端口居中



推荐装配图:



注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖1.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

产品特点

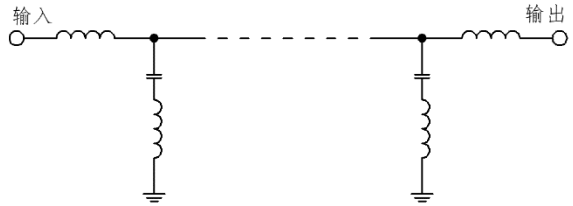
- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块



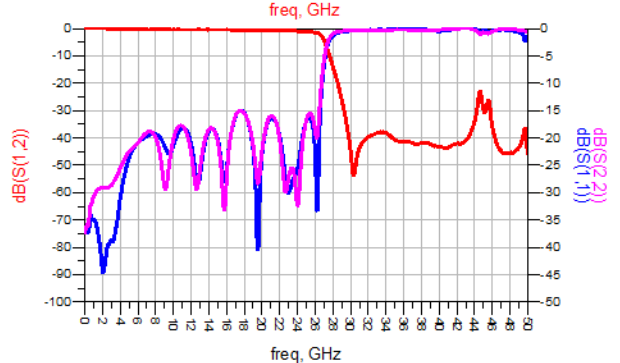
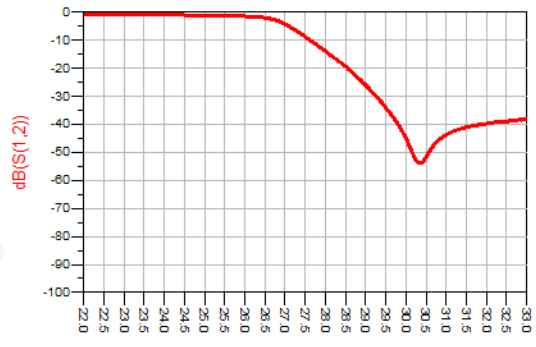
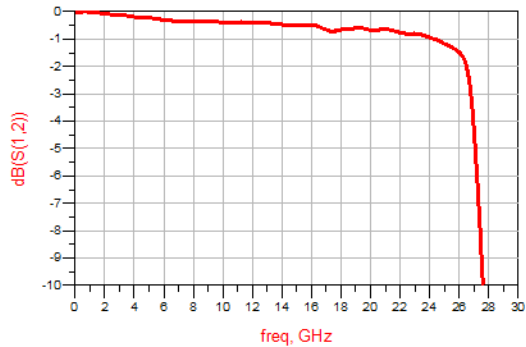
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		13.00		GHz
工作频率	DC		26.0	GHz
中心损耗		0.5	0.8	dB
截止频率损耗		1.5	2.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@30.2-43.0GHz	32	35		dBc
承受功率			25	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

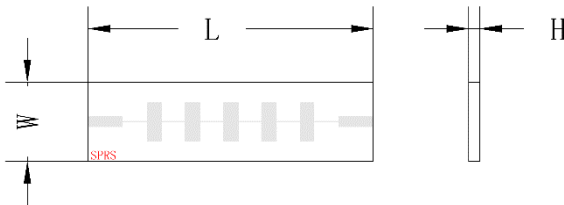
原理图



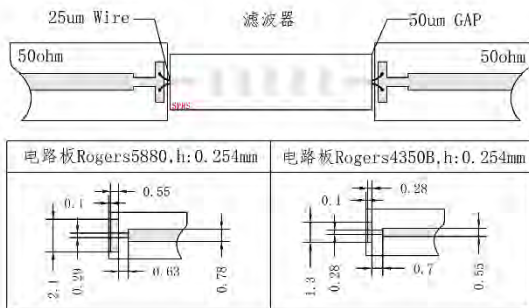
典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



外形图: L: 4.0, W: 2.0, H: 0.254, 端口居中



推荐装配图:



注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁**0.1mm**,表面距上盖**1.75mm**,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

产品特点

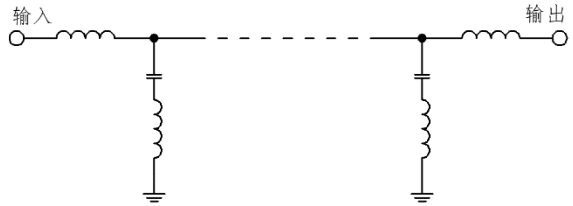
- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块



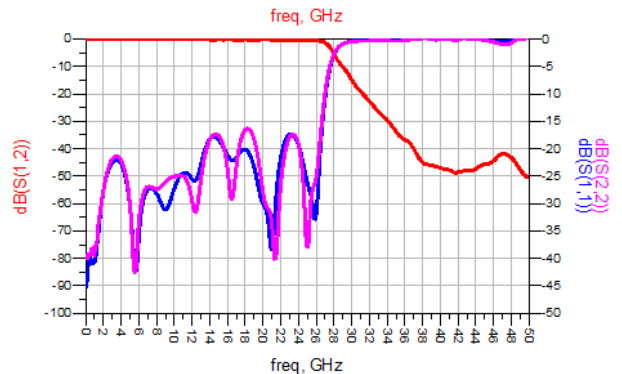
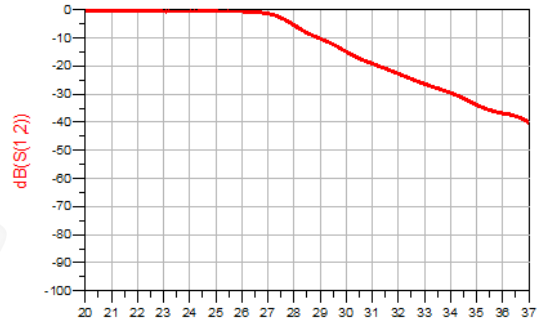
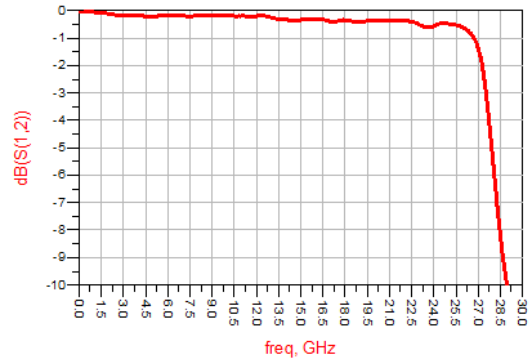
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		13.0		GHz
工作频率	DC		26.0	GHz
中心损耗		0.4	0.7	dB
截止频率损耗		1.8	2.2	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@35.0-50.0GHz	27	30		dBc
承受功率			25	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

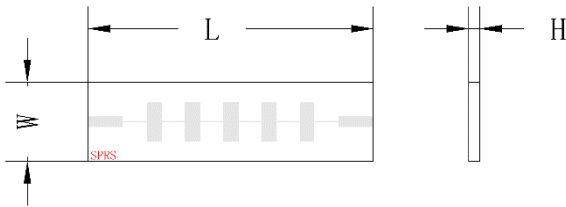
原理图



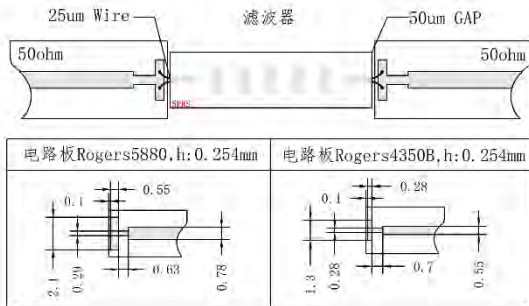
典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



外形图: L: 5.0, W: 2.0, H: 0.254, 端口居中



推荐装配图:



注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

产品特点

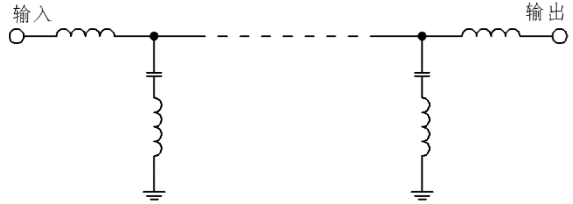
- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块



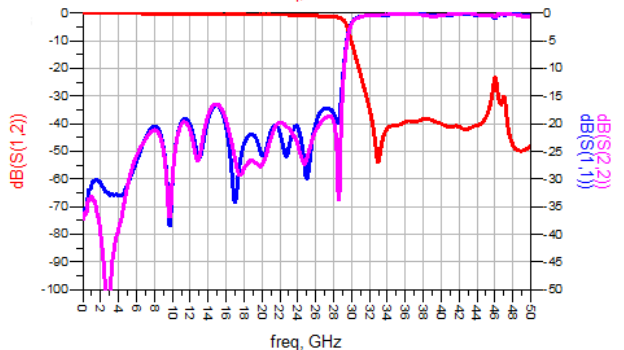
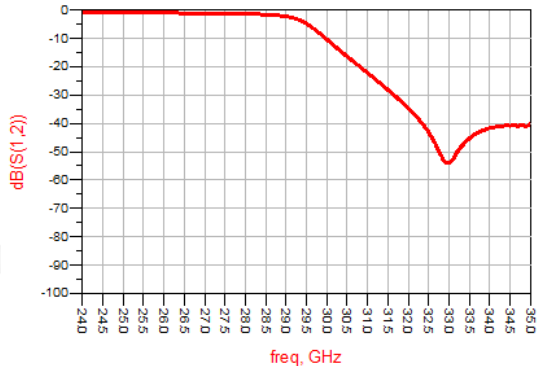
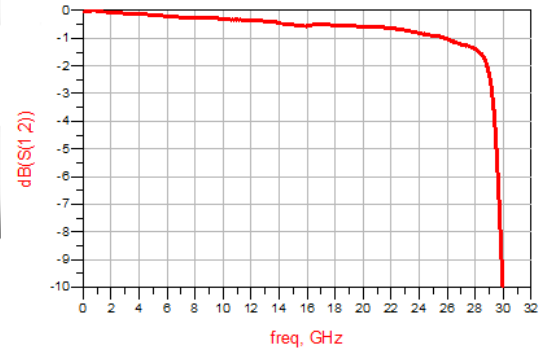
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		14.00		GHz
工作频率	DC		28.0	GHz
中心损耗		0.5	0.8	dB
截止频率损耗		1.6	2.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@32.5-44.0GHz	32	35		dBc
承受功率			25	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

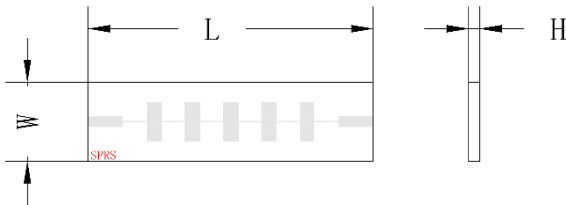
原理图



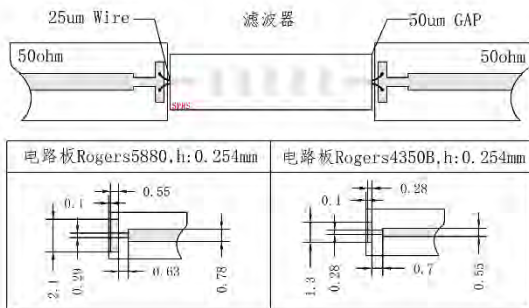
典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



外形图: L: 4.0, W: 2.0, H: 0.254, 端口居中



推荐装配图:



注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖1.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

产品特点

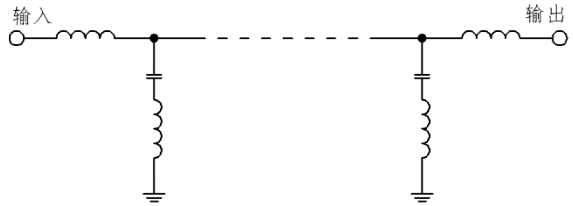
- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块



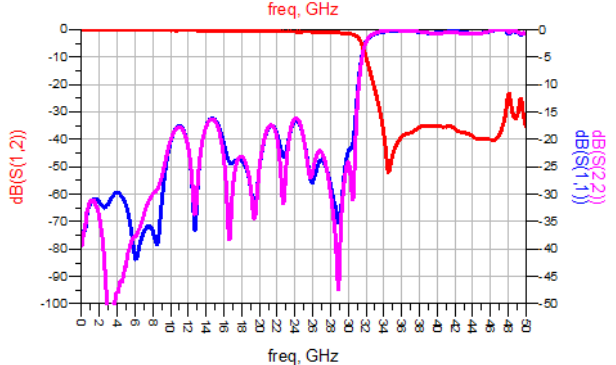
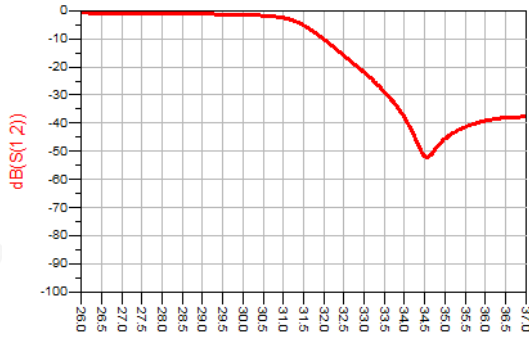
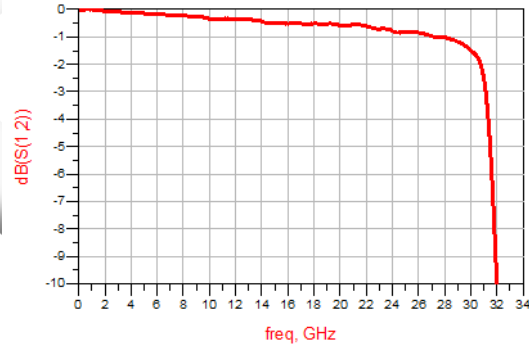
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		15.00		GHz
工作频率	DC		30.0	GHz
中心损耗		0.5	0.8	dB
截止频率损耗		1.6	2.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@34.5-47.0GHz	29	32		dBc
承受功率			25	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

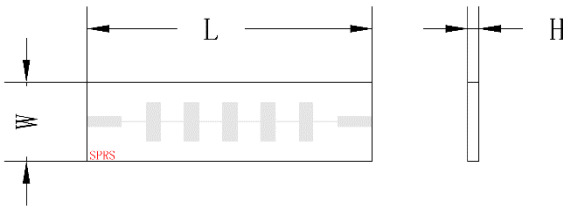
原理图



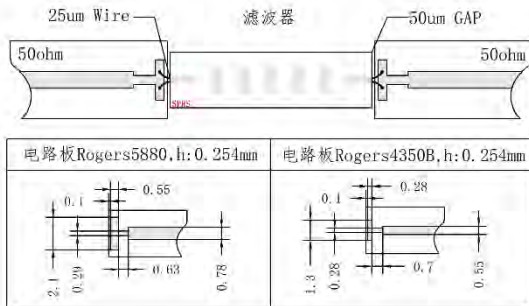
典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



外形图: L: 4.0, W: 2.0, H: 0.254, 端口居中



推荐装配图:



注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁0.1mm，表面距上盖1.75mm，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

产品特点

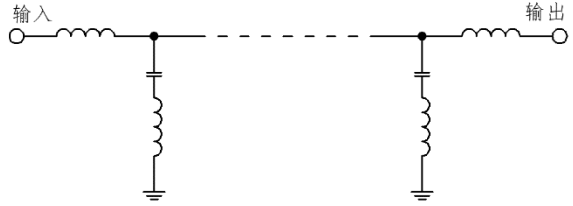
- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块



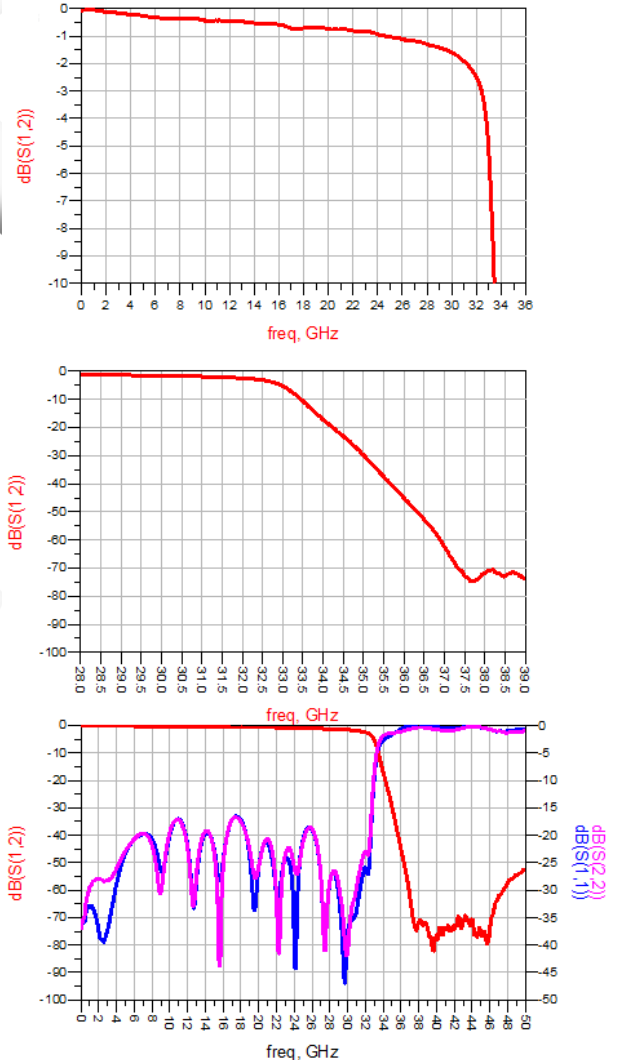
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		15.75		GHz
工作频率	DC		31.5	GHz
中心损耗		0.6	0.9	dB
截止频率损耗		2.3	2.8	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@36.8-50.0GHz	45	50		dBc
承受功率			25	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

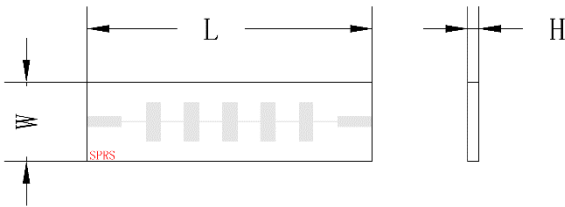
原理图



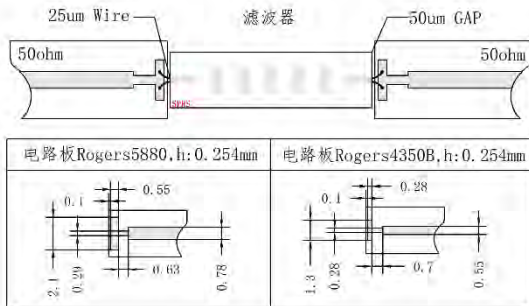
典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



外形图: L: 5.5, W: 2.0, H: 0.254, 端口居中



推荐装配图:



注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

产品特点

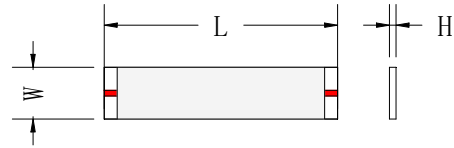
- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块



技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		16.0		GHz
工作频率	DC		32.0	GHz
中心损耗		0.7	0.9	dB
截止频率损耗		1.7	2.2	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@39.0-50.0GHz	35	40	dBc

外形图

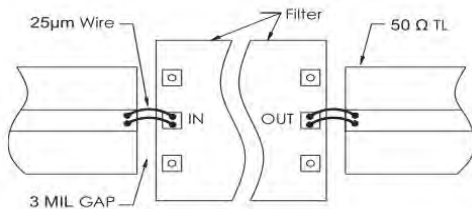


外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	1.8	0.254	mm

环境要求

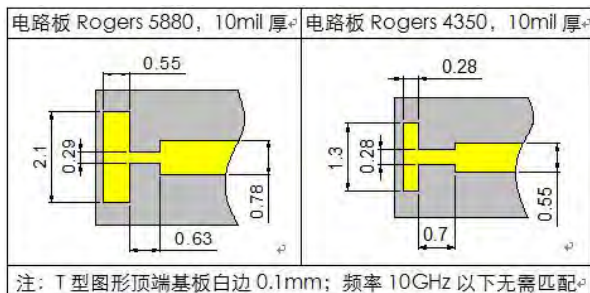
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图

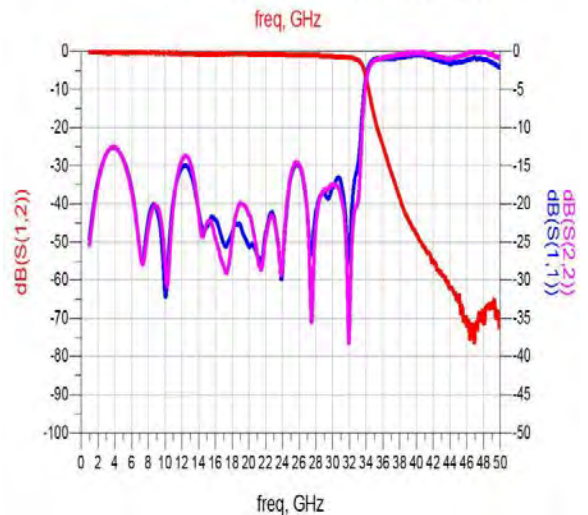


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配,T型尺寸如下:



典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



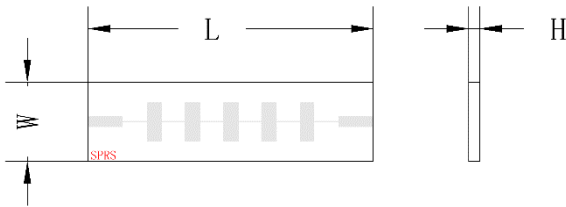
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

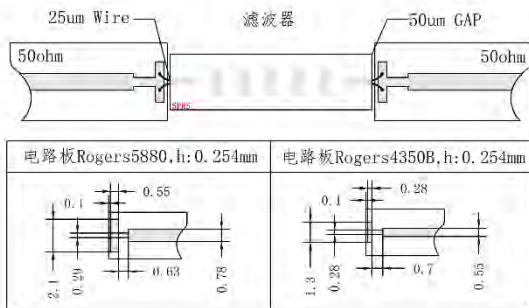
技术要求,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		17.0		GHz
工作频率	DC		34.0	GHz
中心损耗		0.5	0.8	dB
截止频率损耗		1.8	2.3	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@38.0-48.0GHz	23	28		dBc
承受功率			25	dBm
工作温度	-55		+85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^{\circ}\text{C}$

外形图: L: 3.5, W: 2.0, H: 0.254, 端口居中



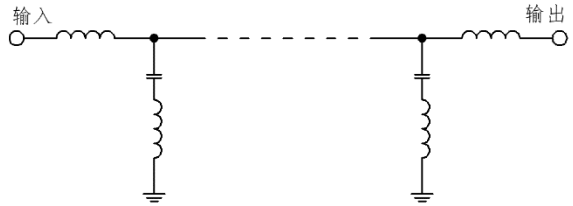
推荐装配图:



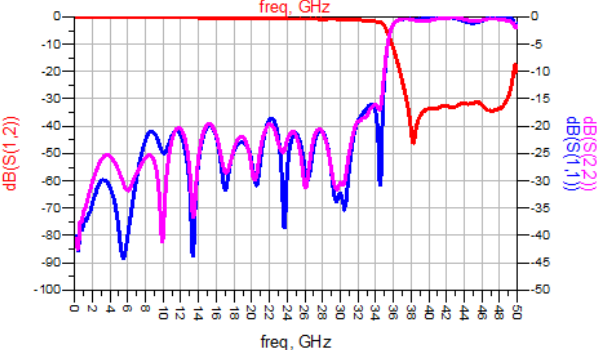
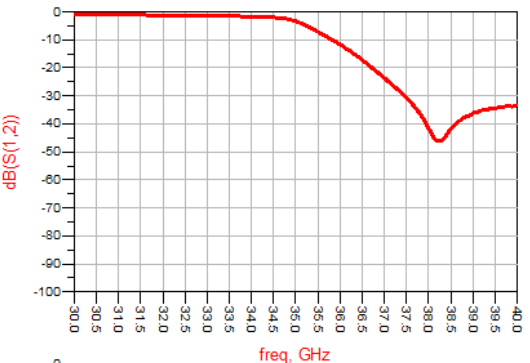
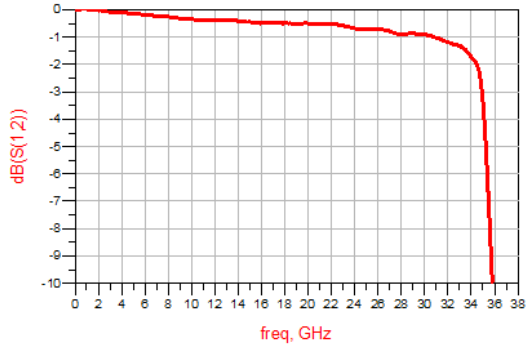
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^{\circ}\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$



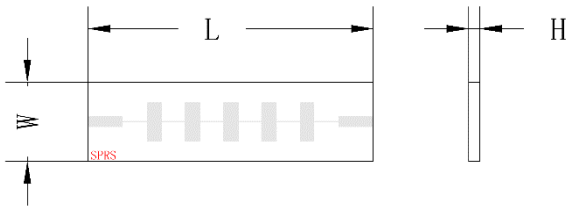
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块

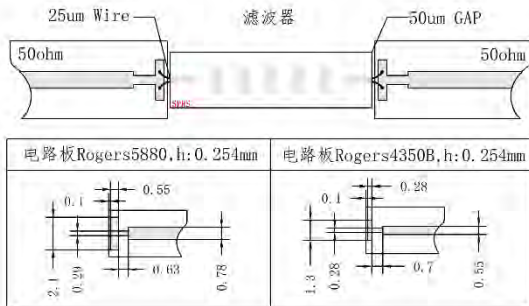
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		18.0		GHz
工作频率	DC		36.0	GHz
中心损耗		0.5	0.8	dB
截止频率损耗		1.8	2.3	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@39.5-50.0GHz	23	28		dBc
承受功率			25	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 3.5, W: 2.0, H: 0.254, 端口居中



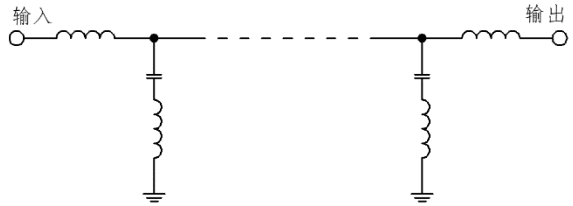
推荐装配图:



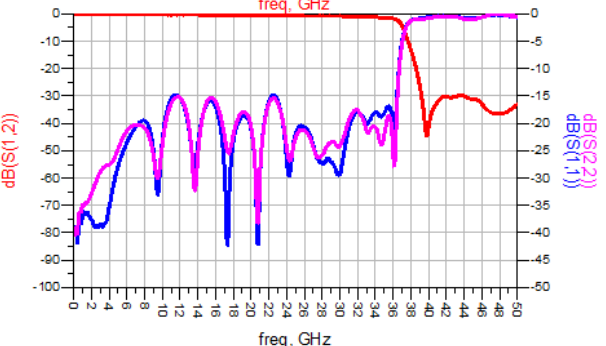
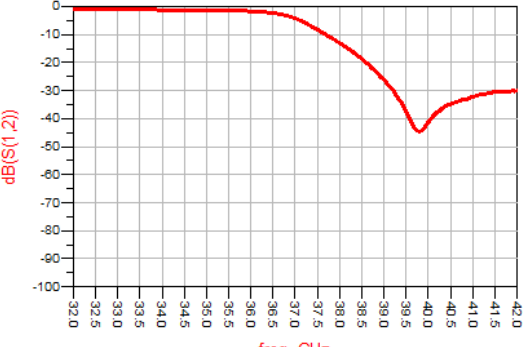
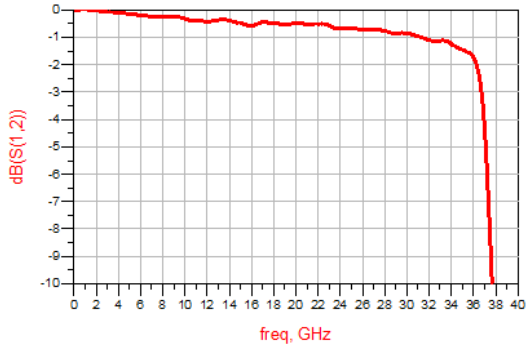
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖1.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



产品特点

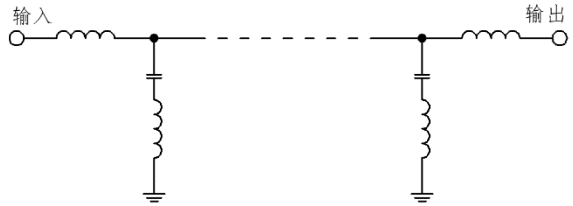
- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块



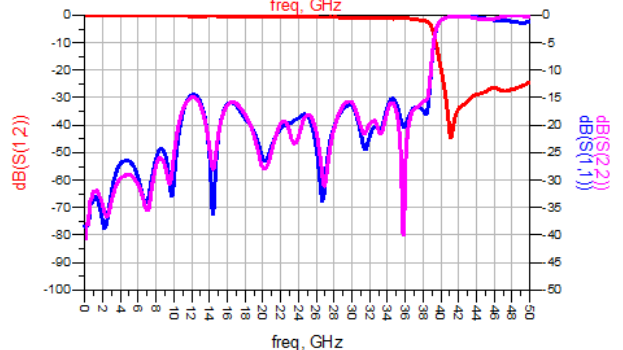
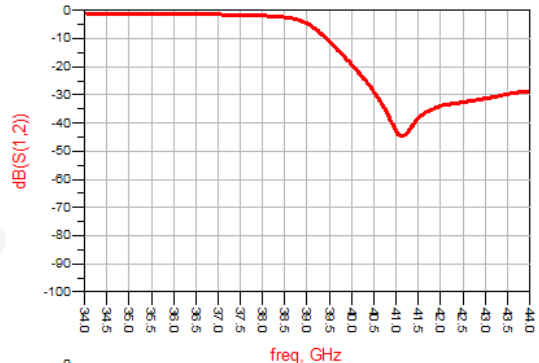
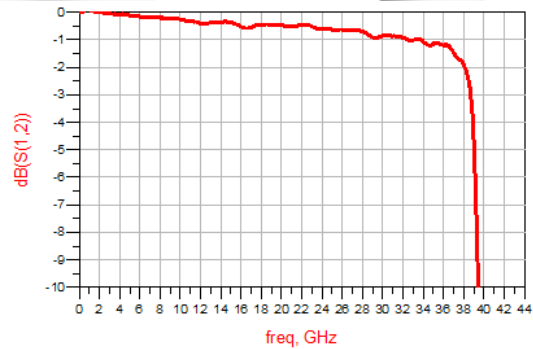
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		18.9		GHz
工作频率	DC		37.8	GHz
中心损耗		0.5	0.8	dB
截止频率损耗		1.9	2.4	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@42.6-50.0GHz	20	22		dBc
承受功率			25	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

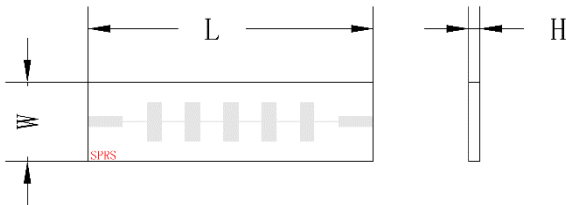
原理图



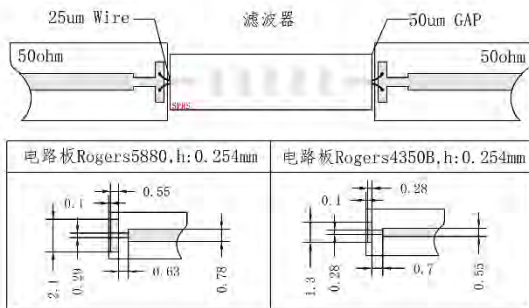
典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



外形图: L: 3.5, W: 2.0, H: 0.254, 端口居中



推荐装配图:



注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖1.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钎铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

产品特点

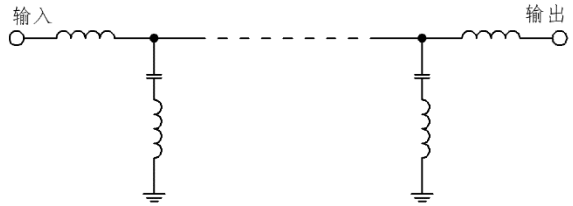
- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块



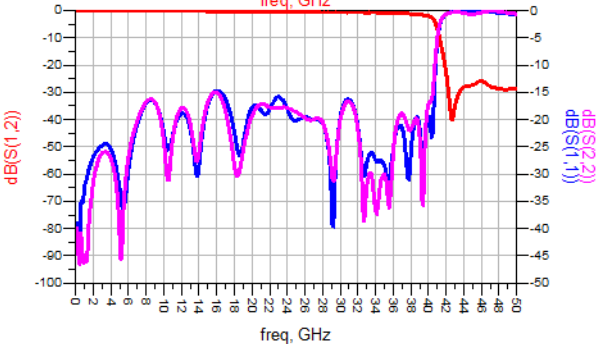
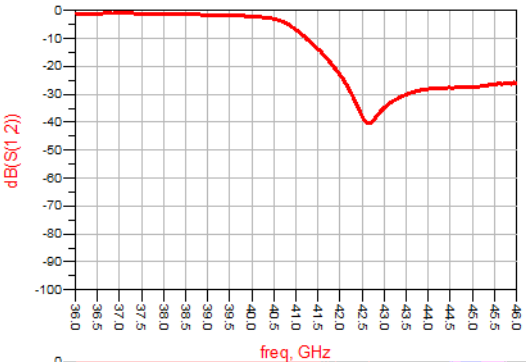
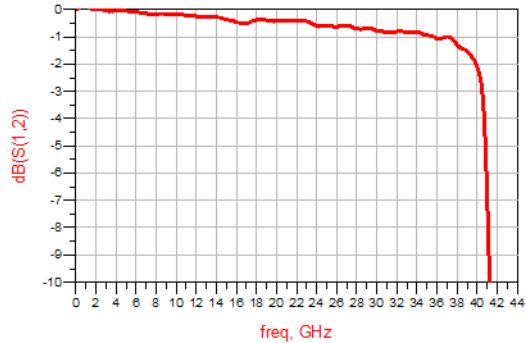
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		19.8		GHz
工作频率	DC		39.6	GHz
中心损耗		0.5	0.8	dB
截止频率损耗		2.0	2.5	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@42.6-50.0GHz	20	23		dBc
承受功率			25	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

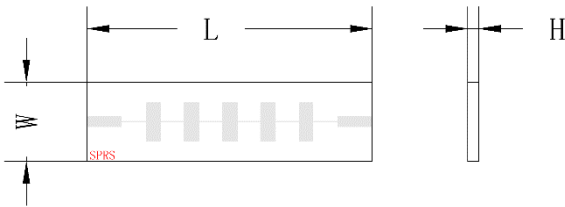
原理图



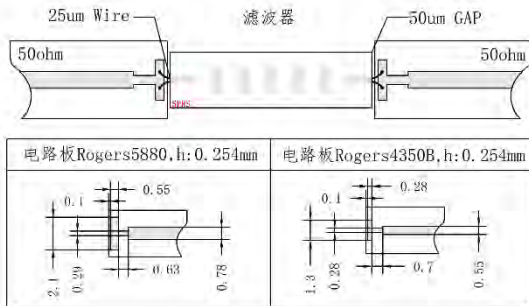
典型曲线,  $T_A=25^\circ\text{C}$



外形图: L: 3.0, W: 2.0, H: 0.254, 端口居中



推荐装配图:



注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁**0.1mm**,表面距上盖**1.75mm**,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ ),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配;